

TOSHIBA



■スーパーミニトランジスタシリーズ

FET

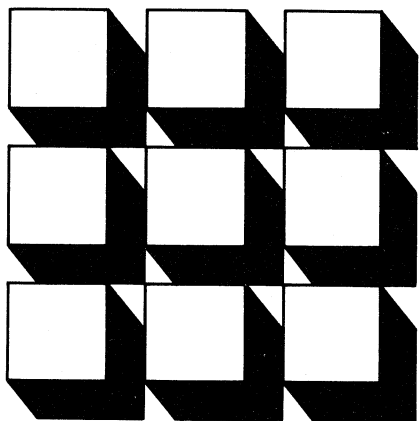
品名	用途	最大定格 (Ta=25°C)			品名表示	I _{DSS} (mA)	TO-92 相当品
		V _{GSD} V _{CDS} (V)	I _C (mA)	P _D (mW)			
2SK 208	低周波増幅	-50	10	100	J R	0.3~0.75	2SK30ATM
					J O	0.6~1.4	
2SK 209	低周波低雑音増幅	-50	10	150	X O	0.6~1.4	2SK117
					X Y	1.2~3.0	
					X L	6.0~14	
					Y Y	3.0~7.0	
2SK 210	FM高周波増幅	-18	10	100	Y G	6.0~14	2SK192A
					Y L	12~24	
					K O	1.0~3.0	
2SK 211	FM高周波増幅	-18	10	100	K Y	2.5~6.0	2SK161
					K G	5.0~10	
					T O	1.5~3.5	
2SK 302	VHFバンド増幅	V _{DSX} 20	I _D 30	150	T Y	3~7	2SK241
					T G	6~14	
					T O	1.5~3.5	
					T Y	3~7	

トランジスタ

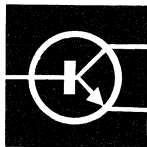
品名	用途	最大定格 (Ta=25°C)			品名表示	h _{FE}	コンプライメン タリペア	TO-92 相当品
		V _{CEO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)				
2SA1162	低周波低雑音増幅	-50	-150	150	S O	70~140	2SC2712	2SA1015
					S Y	120~240		
					S G	200~400		
2SC2712	低周波低雑音増幅	50	150	150	L O	70~140	2SA1162	2SC1815
					L Y	120~240		
					L G	200~400		
					L L	350~700		
2SA1163	低周波低雑音増幅	-120	-100	150	C G	200~400	2SC2713	2SA 970
					C L	350~700		
2SC2713	低周波低雑音増幅	120	100	150	D G	200~700	2SA1163	2SC2240
					D L	350~700		
					Z O	70~140		
2SA1182	低周波増幅	-30	-500	150	Z Y	120~240	2SC2859	2SA562TM
					W O	70~140		
2SC2859	低周波増幅	30	500	150	W Y	120~240	2SA1182	2SC1959
					O O	70~140		
2SA1255	高電圧スイッチング用 高電圧増幅用	-200	-50	150	O Y	120~240	2SC3138	—
					N O	70~140		
2SC3138	高電圧スイッチング用 高電圧増幅用	200	50	150	N Y	120~240	2SA1255	—
					A	最小5000		
2SC2532 (ターリントン トランジスタ)	低周波増幅用 LEDドライブ用	40	300	150				2SC982TM
2SC2714	高周波増幅	30	20	100	Q R	40~80	—	2SC1923
					Q O	70~140		
					Q Y	100~200		
					R R	40~80		
2SC2715	高周波増幅	30	50	150	R O	70~140	—	2SC380TM
					R Y	120~240		
2SC2716	高周波増幅	30	100	150	F R	40~80	—	2SC941TM
					F O	70~140		
					F Y	120~240		
2SC2996	FM/AM 高周波増幅用	30	50	150	G R	40~80	—	—
					G O	70~140		
					G Y	120~240		

東芝ハイブリッドIC用トランジスタ

東芝



最新 トランジスタ
規格表



☆規格表ご利用の際のお願い

本規格表の仕様はメーカー発表の資料に基づき作成しておりますが、メーカーによって予告なく規格・外形等を変更する場合がありますので、量産品等、大量に素子を使用して製品を生産する必要がある際には、事前に該当メーカーにお問合わせの上、仕様をご確認ください。

規格表の 使い方

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)										外 形	備 考		
				V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CE} (V)	直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{FE}	h_{ie}	h_{ie}^* (Ω)	h_{re}			h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe}
1	2	3	4	5					6		7		8				9		10		11	12

- 1** TYPE NUMBER
- 2** ORIGINAL MANUFACTURER
- 3** USES
- 4** MATERIAL AND STRUCTURE
- 5** MAXIMUM RATINGS
- 6** I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CE} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})
- 7** STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8** STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CE} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- * INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
- 9** f_{β} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T .
- 10** C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11** OUTLINE
- 12** REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO

トランジスタ規格表 使い方の手引

トランジスタは上手に使えば非常に長い寿命を持つものですが、定格をオーバーしたり、少し無理な使い方をする、真空管とは比べものにならないほど弱いものです。そこでトランジスタを使う前に、できれば買う前にそのトランジスタの特性や規格を良く調べて、最も適した使い方をするのが大切です。

ここでお目にかかる規格一覧表は電子機械工業会 (EIAJ) に登録されている全てのトランジスタを集めています。この中には電電公社やNHKの専用品種、あるいはメーカーが通信・工業用として作った、ラジオ用でない品種も含まれていますが、私達アマチュアの場合には、ジャンク屋のゴミの中から特殊なものを探し出すことも

充分考えられますので、全品種をとりあげることにはしたわけです。

トランジスタ・メーカーで試作的に作ったものは例外ですが、一般に販売するトランジスタは全てEIAJに登録されたものでなければなりません。これです。これで私達が入手し得る国産のトランジスタ全部ということです。

本規格表では資料は原則としてEIAJに登録されたものを用い、これを入手できるかぎりのメーカーの最新のカatalogと比較して補ってあります。したがって、EIAJ登録とメーカーのカatalogとがくい違ったときは、メーカーのカatalogを優先してあります。この規格一覧表で使用した記号、略号は次の通りです。

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)				電 気 的 特 性 (Ta=25°C)										外 形	備 考	
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値 (μA) V _{CE} (V)	直流又はパルス h _{FE} V _{CE} (V) I _C (mA)	バイアス V _{CE} (V) I _E (mA)	h _{FE} h _{FE} *	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μS)	f _{β0} f _{β0} * (Mc)	C _{ob} C _{ob} (pF)			r _{ob} r _{ob} (real)* (Ω)
1	2	3	4	5				6		7				8		9	10		11	12

- 1 EIAJに登録されたトランジスタ型名です。
- 2 その型名と規格をEIAJに登録した会社名です。
- 3 EIAJに登録された時の用途を示しました。したがってこれ以外の用途に使えないというわけではありません。
- 4 トランジスタの材料と、構造名を書きました。いずれもEIAJに登録された時のものです。
- 5 トランジスタの最大定格です。
- 6 I_{CEO}の最大値と、その測定条件であるV_{CE}の値です。
- 7 直流h_{FE}またはパルスh_{FE}の標準値と、その測定条件であるV_{CE}、I_Cの値です。
- 8 hパラメータの標準値とその測定条件であるバイアスV_{CE}、I_Eの

- 9 高周波特性のf_{β0}です。*印をつけた場合はf_Tの値を示します。
 - 10 高周波特性のC_{ob}とr_{ob}です。r_{ob}の欄で*印をつけた場合はh_{ie}(real)の値を示しました。
 - 11 この規格表のあとの方にまとめた外形図の番号です。
 - 12 必要に応じて、そのトランジスタについての特別な注釈を加えました。
- 《各項目のくわしい説明は次頁以下の各■番号のところを参照ください》

トランジスタを活用するための規格表の見方

1 型名

トランジスタはJISのトランジスタ型名付与法 (JIS-C-7012) にもとづいて決められた型名と、規格をEIAJに登録することになっています。EIAJというのは電子機械工業会で、昔はCESという略称を使っていたのでCES型名、あるいはCES名称などという呼び名で知られていました。今ではEIAJ型名 正しくはJIS型名とされています。この名前つけ方は次のようになっています。

2 S **文字** **数字** **文字**

(例) 2 S A 244 A

最初の2 Sは有効電極数が3の半導体素子を表わします。

ダイオードでは1 S、有効電極数が4のトランジスタ (4極トランジスタのような) では3 Sを用います。

2 Sにつづく文字はトランジスタとしてはA, B, C, Dのいずれかを使います。その使いわけは次のとおりです。

A……………PNP型の高周波用

B……………PNP型の低周波用

C……………NPN型の高周波用

D……………NPN型の低周波用

高周波と低周波の区別はあまり明確では

なく、登録するメーカーの指定用途によっているので、 f_t が200Mcくらいの低周波用があったり、逆に50Mcぐらいの高周波用があることもあります。2 Sに続く文字は他の構造の素子にはまた別の文字を使うことになっており、本規格表では関係ありませんが一応紹介しておく、次のようなものが今までに決まっています。

F……………SCR

H……………単接合トランジスタ

J……………PチャンネルFET

K……………NチャンネルFET

M……………トライアック

次にこのA, B, C, Dの文字につづく数字は、登録順につける番号で11から始めることになっています。

最後の文字は改良品種を示すもので、最初はつけません。改良品種ができるごとにA, B, C, D, E, F, G, H, J, Kまでつけられます。

改良品種は前の品種に置きかえて使えることが必要ですが、逆のおきかえ、つまり改良品種の代わりに前の品種が使えないことはあり得るわけです。

以上の原則にしたがってトランジスタ型名をながめて見ると、たとえば2SA244AというのはPNP高周波用トランジスタで、244番目の品種 (11番から始めるので、正

確には234番目に登録された品種) である2SA244の改良品種というわけです。

この改良を示す文字については、上記のA~Kのほか、各社で独自にきめた文字たとえば⑧, ⑨, (1)などを使うことがあり、この場合には各社のカタログを調べてみる必要があります。メーカーによってはEIAJに登録して、EIAJ型名がきまっていながらそれを使わないで、各社型名でカタログを作ったり、現品表示をしたりしている場合もあります。

2 社名

そのトランジスタの型名と規格をEIAJに登録した会社名を書きました。これをオリジナルの登録会社といいます。

EIAJに登録が完了すると、その型名と規格は業界共有のものとなされ、オリジナルの登録会社以外の会社がその型名のトランジスタを生産してもよいことになっています。本規格表では次のような略称を使いました。

富士通	富士通株式会社 (神戸工業株式会社として 登録されたものも含む)
富士電機	富士電機製造株式会社
日立	株式会社日立製作所

松下	松下電子工業株式会社
三菱	三菱電機株式会社
日電	日本電気株式会社
沖	沖電気工業株式会社
サンケン	サンケン電気株式会社
三洋	東京三洋電機株式会社
新電元	新電元工業株式会社
ソニー	ソニー株式会社
東芝	東京芝浦電気株式会社
ゼネラル	株式会社ゼネラル
東光	東光株式会社
芝電	芝電気株式会社
新日無	新日本無線株式会社
モトローラ	日本モトローラ株式会社
ローム	ローム株式会社

3 用途

EIAJに登録された用途です。したがって、使い方によっては、これ以外にでも使えることはもちろんです。本規格表では次のような記号を使ってあります。

AF	低周波増幅
Conv	周波数変換
Ch	チョップ
Diff	差動増幅
IF	中間周波増幅
LN	低雑音増幅

Mix	周波数混合
Osc	発振
PA	電力増幅
RF	高周波増幅
SW	スイッチング

4 構造

トランジスタの材料がゲルマニウムであるかシリコンであるかをまず書き、次に主として接合の作り方やパッシベーションに着目した構造を示しました。これらはいずれもEIAJに登録されたものです。

トランジスタを使う立場からみると、接合の作り方の構造など、どうでもよいように思えますが、トランジスタの各種の特性やそのバイアス依存性などはこの構造によって、あるていど推定できる似た傾向をもっているため、それぞれの特長をつかんでおくとう便利です。本規格表では次のような記号を使ってあります。

Ge	ゲルマニウム
Si	シリコン
A	合金接合 (アロイ)
AD	合金拡散 (アロイ・ディフュージョン)
D	ドリフト
DB	ベース拡散
DJ	拡散接合

E	エピタキシャル
E _b	エピタキシャル・ベース
EMe	エピタキシャル・メサ
EP	エピタキシャル・プレーナ
G	成長接合 (グロン)
GD	成長拡散 (グロン・ディフューズド)
MA	マイクロ合金接合 (マイクロ・アロイ)
MD	マイクロ・ドリフト
Me	メサ
P	プレーナ
T	三重拡散
TMe	三重拡散メサ
TP	三重拡散プレーナ
Pa	パッシベーション

5 最大定格

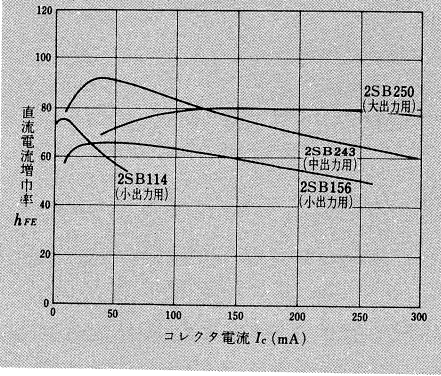
これ以上の条件で使うとトランジスタがこわれる危険があるという限界で、メーカーの示す警告とみていただきたいと思えます。ただしトランジスタによって丈夫なものもあり、弱いものもあるので、この限界を越えても、直ちに全部こわれるわけではありません。また程度によってはすぐにはこわれず、寿命が短くなるということも考えられます。本規格表では次のような記号を使ってあります。

- V_{CBO} コレクタ-ベース間電圧
- V_{EBO} エミッター-ベース間電圧
- I_C コレクタ電流
- P_C コレクタ損失
(周囲温度 T_a , ケース温度 T_C の二通りの規定方法があり, 通常 $T_a=25^\circ\text{C}$)
- T_j 接合部温度
(ジャンクション温度ともいう)

一般に V_{CBO} , V_{EBO} 等の耐圧は, PN接合のブレイクダウン電圧の制限から決められるので, これら電圧の最大定格は厳密に守らないと危険です。

電流の最大定格である I_C は, 普通はこわれる限界というよりは図1のように大電流のところで h_{FE} が低下して歪が増し, 増幅素子として満足に動作しなくなる限界で決

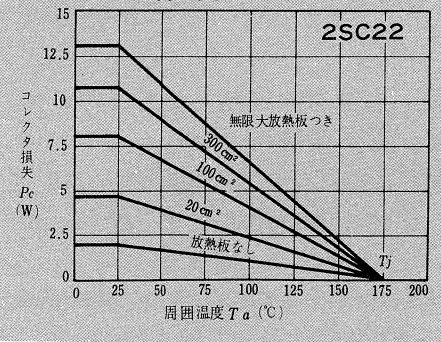
〈図1〉 h_{FE} の電流による変化の一例



めていますから, 少しぐらいこれを越えてもこわれないことが多いようです。ただ大きな電流のところではコレクタでの電圧降下 $V_{CE(sat)}$ が急激に増加して, コレクタ消費電力が増すことに注意しなければなりません。また非常に大きな電流のところでは二次ブレイクダウンの現象を起こして急激に耐圧が数Vに低下してしまうこともあるので, あまり極端なアマチュア規格は避けなければなりません。

コレクタ損失は真空管のプレート損失にあたるもので, コレクタで許容できる電力損失です。コレクタで電力を消費すると熱となり, 内部の温度を上昇させますから, 接合部(内部のトランジスタ動作をしている部分)での温度の限界 T_j との間に図2のような関係があります。つまり 25°C 以上の

〈図2〉 放熱板と $T_a - P_C$ カーブの傾斜の変化

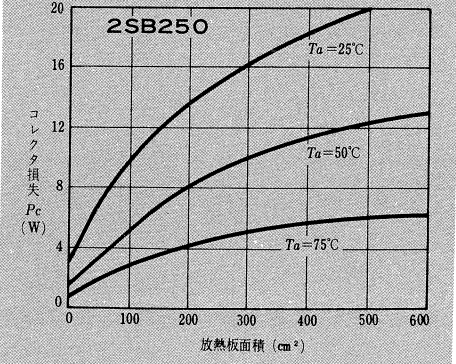


温度では, 25°C の P_C と T_j とからこの図を書いて, 許容し得る P_C を割り引きして考えなければなりません。そして T_j (接合部温度の最大定格) のところでは, 許容できる P_C はちょうど零となります。

P_C の規定には上述のように周囲温度 (T_a) 25°C の時の値とケース温度 (T_C) 25°C の時の値と二通りの規定方法があり, 一般にパワー・トランジスタではケース温度を基準にしています。

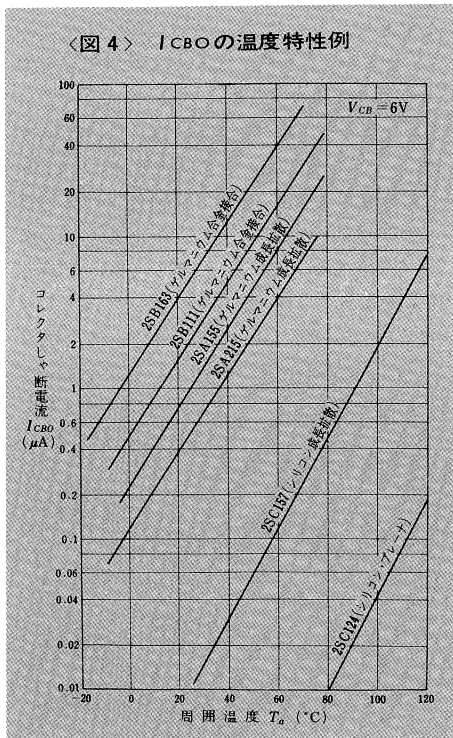
ケース温度 25°C というのは, 周囲温度が 25°C の時に無限に大きい放熱板をつけるかまたは猛烈な風を送って強制空冷にしたときの理想的な値であり, 実用上考えられるような適当な大きさの放熱板では, 許容し得る P_C はこれよりも小さい値になってしまうことに注意しなければなりません。図2

〈図3〉 放熱板面積と許容コレクタ損失



および図3はこの例です。

本規格表では通常 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ の場合を書いてあり、メーカー側が $T_c=25^{\circ}\text{C}$ またはその他の条件で規定した場合には P_c 欄にその条件を小さく書き添えました。



6 コレクタしや断電流 I_{CBO}

コレクタ・ベース間に逆方向電圧をかけた時の漏洩電流で、小さいものほど良いとされています(図4), シリコン・トランジスタなどである程度小さい値になると実用上は全く影響しなくなります。温度によってはほぼ 10°C 上昇するごとに2倍になり、非常に大きく変わるので、 25°C の時の値を示すことにしています。ふつうは規格の最大値を書きますが、実際は中心値はゲルマニウムの小信号用小型トランジスタで $0.5\sim 5\mu\text{A}$ ぐらい、パワー・トランジスタで $100\mu\text{A}\sim 5\text{mA}$ です。これがシリコン・トランジスタになると小型のもので $0.0001\sim 0.001\mu\text{A}$ 、パワー・トランジスタで $10\mu\text{A}\sim 1\text{mA}$ 程度となっています。

本規格表では、この欄は左側に I_{CBO} の最大値を書き、右側の欄には、その I_{CBO} を測定した条件であるコレクタ電圧 V_{CB} を書きました。

7 直流電流増幅率またはパルス電流増幅率 h_{FE}

直流で測ったエミッタ接地電流増幅率、つまりコレクタ電流 I_C をベース電流 I_B で割った I_C/I_B をいいます。

スイッチング用あるいはパワー用トラン

ジスタ等では、大電流で使うため小信号パラメータでは設計できないからです。さらに大きな電圧、電流で測るものになると、そのバイアスによる電力で発熱してしまうので、非常に短い時間だけ電流を流してパルス的に測ることも行なわれます。これをパルス h_{FE} といいます。これらはいずれもバイアス、特に電流によって大きく変わるので h_{FE} の大小を論ずる時には必ず測定条件も考えなければいけません。

図1のように小電流で使うものは少ない電流で早く立上り、大電流のところでは低下してしまうのに対し、大電流用のものは立上りは遅いかわりに大電流のところまで h_{FE} が低下しないようにリニアリティを良くするよう設計されています。

本規格表では、この欄は一番左側に h_{FE} の標準値を書き、右側の2つにはその h_{FE} を測定した条件であるコレクタ電圧 V_{CE} とコレクタ電流 I_C を書きました。

メーカーのカタログが標準値で規定せず50~240のように範囲で規定してあるものについては、その範囲で書いてあります。

8 h パラメータ

h パラメータには電流増幅率 h_f 、入力インピーダンス h_i 、電圧帰還率 h_r 、出力アドミタンス h_o の4つがありますが、それぞれに

ベース接地では**b**、エミッタ接地では**e**の添字をつけて区別しています。

- h_{fe} 電流増幅率 (エミッタ接地)
- h_{fb} 電流増幅率 (ベース接地)
- h_{ie} 入力インピーダンス (エミッタ接地)
- h_{ib} 入力インピーダンス (ベース接地)
- h_{re} 電圧帰還率 (エミッタ接地)
- h_{rb} 電圧帰還率 (ベース接地)
- h_{oe} 出力アドミタンス (エミッタ接地)
- h_{ob} 出力アドミタンス (ベース接地)

これらベース接地とエミッタ接地のパラメータは次式で換算することができます。

$$\begin{aligned}
 h_{ie} &= \frac{h_{ib}}{1 + h_{fb}} & h_{ib} &= \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}} \\
 h_{fe} &= \frac{-h_{fb}}{1 + h_{fb}} & h_{fb} &= \frac{-h_{fe}}{1 + h_{fe}} \\
 h_{re} &= \frac{h_{ib} \times h_{ob}}{1 + h_{fb}} - h_{rb} & h_{rb} &= \frac{h_{ie} \times h_{oe}}{1 + h_{fe}} - h_{re} \\
 h_{oe} &= \frac{h_{ob}}{1 + h_{fb}} & h_{ob} &= \frac{h_{oe}}{1 + h_{fe}}
 \end{aligned}$$

これらはいずれもバイアスにより大幅に変化するものです。図5、図6は代表的な合金接合型トランジスタの**h**パラメータのバイアスによる変化です。

本規格表ではこの欄はまず測定条件であるコレクタ電圧 V_{CB} 、エミッタ電流 I_E を書き、次に h_{re} 、 h_{ie} 、 h_{re} 、 h_{oe} の順に並べました。通常エミッタ接地での標準値ですが、*印をつけた場合はベース接地の値を示します。**h**パラメータは一般に270%とか **kc** のように低周波の値を示しますが、エミッタ接地電流増幅率 h_{re} だけは高周波での値も示すメーカーがあります。この場合、高周波 h_{re} は単位なしの値 (倍率) の時と、**dB** の時とあるので注意が必要です。

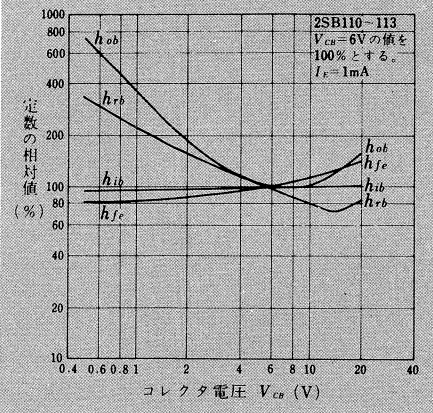
なお、この欄は**h**パラメータが規定されないで空欄となっている時などには、動作例、例えば電力利得が $PG = 25\text{dB}$ ($f = 1\text{Mc}$)

とか、スイッチング時間が $t_{on} < 80\text{ns}$ 、 $t_{off} < 200\text{ns}$ 、 $t_{stg} < 400\text{ns}$ などのように**h**パラメータではないものを記入した場合があります。

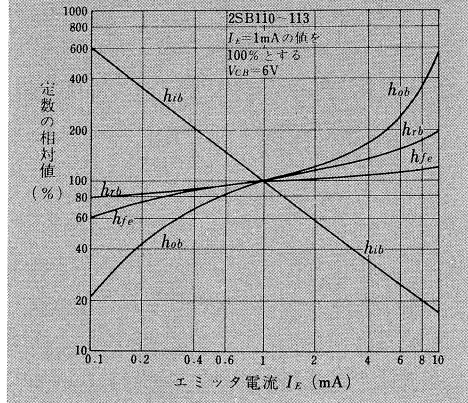
これには次のようなものがあります。

- NF 雑音指数
 - PGまたは G_P 増幅電力利得
 - CGまたは G_C 変換電力利得
 - P_o 出力電力
 - t_d 遅延時間
 - t_r 上昇時間
 - t_s 蓄積時間
 - t_f 下降時間
 - t_{on} ターンオン時間
 - t_{off} ターンオフ時間
 - t_{stg} 蓄積時間
- } 動作例
} スイッチング時間

〈図5〉 **h**パラメータの電流特性例



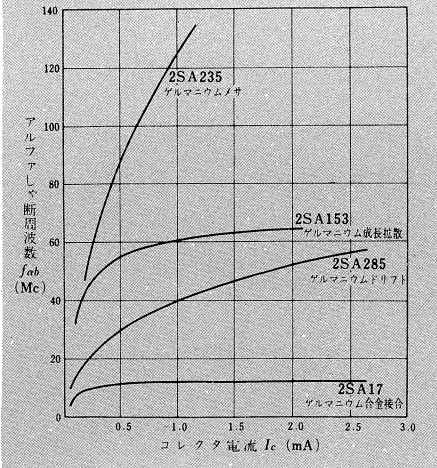
〈図6〉 **h**パラメータの電圧特性例



9 シャ断周波数と利得帯域幅積

シャ断周波数にはベース接地の f_{ab} (図7)とエミッタ接地の f_{ae} とあって、いずれも電流増幅率が低周波の値より3dB低下する周波数です。ふつうは f_{ab} ですが、パワー・トランジスタ等でまれに f_{ae} で表示したものがああります。また、最近のベース内部にドリフト電界のあるトランジスタ(高周波用のほとんどはそうなっている)では位相回転が大きいため f_{ab} で高周波特性を決めるのは不適当で、これに代わって利得帯域幅積 f_T が良く使われます。 f_T はまた f_i と書かれる

〈図7〉 f_{ab} の電流特性例



こともあり、エミッタ接地の電流増幅率が1(=0dB)となる周波数です。

高い周波数での h_{fe} は周波数に対してオクターブあたり6dBで低下しますから、

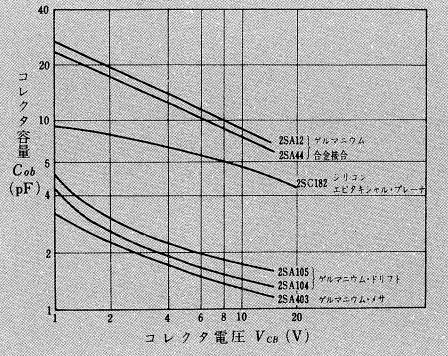
$$f_T = \text{高周波 } h_{fe} \times \text{測定周波数}$$

で計算することもできます。 f_T を利得帯域幅積と呼ぶのはこのためです。 f_{ab} 、 f_{ae} 、 f_T の間には次のような関係があり、この中の m の値は合金接合型、マイクロ合金型で約0.21、その他の高周波トランジスタでは0.5~0.7の値となります。

$$f_{ae} = \frac{f_T}{h_{fe}} = \frac{f_{ab} \cdot (1 + h_{fe})}{(1 - h_{fe} \cdot m)}$$

これらはトランジスタの高周波特性を示す一つの目安になるので高い方がよいにはちがひありませんが、必ずしもこの周波数まで使えるという意味ではありません。 C_{ob}

〈図8〉 構造によるコレクタ容量の傾向の例



(正しくは C_c)と r_{bb} との総合で高周波特性の良し悪しが決まるので、 $C_c \cdot r_{bb}$ が小さければ f_T が低いのを補うことができるからです。

本規格表では f_{ab} の場合にはそのまま値を記入し、 f_T の場合には値に*印をつけました。またごくまれにある f_{ae} の時には $\frac{f_{ae}}{10kc}$ のように書いてあります。

10 コレクタ容量 C_{ob} 、およびベース広がり抵抗 r_{bb}

ベース広がり抵抗 r_{bb} とコレクタ容量 C_{ob} は、 f_T と共にトランジスタの高周波特性を決める大切なパラメータです。電力利得が0dBになる周波数すなわち最高発振可能周波数 f_{max} は

$$f_{max} = \sqrt{\frac{f_T}{8\pi \cdot C_{ob} \cdot r_{bb}}}$$

で示されますから、 C_{ob} と r_{bb} は小さいほど良いわけです。コレクタ容量 C_{ob} はコレクタ電圧の高い場合には小さくなり、この傾向は図8のようになります。

このコレクタ容量は正しくはコレクターベース間の容量で、 C_c の記号で表わしますが、一般にはこれを外部から測った値として C_{ob} をコレクタ容量としています。 C_{ob} に

はトランジスタ動作をしていない部分の寄生素子の容量とか、ケースの浮遊容量も含んでいるので、最近のように C_c の小さい超高周波トランジスタでは上の式を C_{ob} で計算したのでは実際と合わない場合が多くなります。こんな時には是非とも C_c と $r_{bb'}$ または $C_c \cdot r_{bb'}$ 積の値が必要となります。

EIAJ登録では、高周波用トランジスタを登録する際には $r_{bb'}$ の代わりに $h_{ie}(\text{real})$,つまりエミッタ接地高周波入力インピーダンスの実数分を書いてもよいようになっているので、本規格表では $h_{ie}(\text{real})$ の時には $r_{bb'}$ 欄の値に*印をつけました。また、 $C_c \cdot r_{bb'}$ の時には $r_{bb'}$ の欄に $\frac{C_c \cdot r_{bb'}}{10\text{pS}}$ のように書いてあります。

11 トランジスタの外形

トランジスタの外形は良く似ているようでも、それぞれのメーカーのカタログをよく調べてみると少しずつちがっています。これは同じRCAの技術を導入した日立、東芝、三洋等でもちがっているのは一つにはインチの寸法をミリに直した時の端数の切上げ、切捨てとか、あるいはそれぞれのメーカーでの家庭の事情で少しずつちがったと思われる。したがって技術導入の系統

のちがう松下(フィリップス系)ではなおさらです。

これらのわずかなちがいを全部ちがった外形としてとり扱うと、この規格一覧表の半分以上のページを外形図でとられてしまいます。かといって筆者の判断で似ているものを統一した外形図面にしてしまうと、メーカーからお叱りをうけることになってしまいます。

電子機械工業会(EIAJ)では、日本国内で2社以上が使っている外形と、日本国内で使っているのは1社ですが、米国のJEDEC, または世界の標準であるIECに標準外形として決められているものを優先的にとり上げて、EIAJの標準外形を決めています。このEIAJ標準外形に合致するものをまとめれば、大部分のものがこれに吸収でき、それ以外の1メーカー独自のものをそれぞれの外形図で示すことにしました。このためEIAJ標準外形となっているものでは寸法の決め方がEIAJの規定通りなので、最小値と最大値が \sim で示されることが多く、1メーカー独自のものではもっと簡単に……MINとか……MAXといったように最小値または最大値のどちらか片方しか規定しない場合が大部分です。この場合にも根本思想としては、素子本体の幅、直径、高さなどは最大値(……MAX)

で、リード線の長さは最小値(……MIN)で規定します。パワー・トランジスタのリードのような固い足の長さや、穴の寸法、位置などは、EIAJ標準外形では、最小値 \sim 最大値として許容範囲が示されますが1メーカー独自のものは一般に標準寸法と許容偏差が、例えば 4.2 ± 0.2 のように示されます。

EIAJ標準外形ではケースとベースを分けて標準化しており、このそれぞれの組み合わせをある程度自由にしてあります。その組み合わせは図中にケースはTC番号で、ベースはTB番号でEIAJの外形標準番号を記入しておきました。ここで、注意を要するのは、やわらかいリード線の場合のA, B, Cの区分で、同じTB番号であって、リードの長さだけが異なるものを区別しています。例えばTB-1A, TB-1B, TB-1Cのようにです。このA, B, Cによってリードの寸法 l, l_1, l_2 がそれぞれ異なるので、例えば規格表から外形図の番号を12Aと引いた時、12の図の中にAに相当する外形寸法は照合文字 l, l_1, l_2 が表のAに相当する数字を使うこととなります。EIAJ標準外形では、 l, l_1, l_2 は実際のどの部分の長さを示すかわかりにくいようですが、この考え方は次のとおりです。

l ……本体の根元から測ったリードの

全長

ℓ_1 ……本体の根元からこの長さの範囲は、リード線径の規定がないかまたは最大値のみの規定

ℓ_2 ……本体の根元から、この長さの範囲は ℓ_1 の範囲を除き、リード線径が最小値～最大値の規定寸法内にあること

このリードの長さだけが異なるものの扱いは、EIAJ標準外形でないものにも一部A、B……として照合文字 ℓ や、同じ外形で電極接続の違いを別表に記入する方式をとったものがあります。

図面の書き方はすべて第三角法で、できるだけ、JISの製図法によっています。

電極接続はすべて図中にリード番号を入れて示しましたが、エミッタ、ベース、コレクタのどれかの電極がケースに内部で接続されている場合には、1メーカー独自の外形図では、コレクタ(ケース)のように示しましたが、EIAJ標準外形図の場合には示されませんので、特にご注意ください。

12 備考

この欄にはいろいろの事を書きました。これらには、次のようなものがあります。

(1) 現在のEIAJ名称が決まる前の旧型名、

または試作名。

例 ST28B, OC170, HJ17など。

(2) 特性規格に表現されにくい特別な特性

例 フォワードAGC, 双方向性

(3) 特殊な組み合わせ複合素子

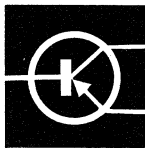
例 2素子複合, ツェナ・ダイオード
組みこみ, など

(4) コンプリメンタリ(相補対称)の品種を

例えば 2SC828
とコンプリ のように書いて

あります。

(5) 規格一覧表左欄外の★印は、その品種がメーカーによって保守または廃品種に指定されていることを表わしています。



規格一覽表

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考			
				V _{CE} (V)	V _{BE0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE}	h _{ie} *	h _{ie} * h _{ib} * (Ω)	h _{re} * h _{rs} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} * h _{ob} * (μU)			f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{FB} h _{ie(res)} * (Ω)
									(μA)	V _{CEB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CEB} (V)	I _E (mA)										
★ 2SA 12	日立	IF	Ge. A	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12			-6	1	60	PG = 31 dB (f = 455 kc)	8	10	70	12A	2N218 HJ22D			
★ " 13	"	"	"	-12	-0.5	-15	80	85	-10	-12			-6	1	55	PG = 31 dB (f = 455 kc)	8	10	70	12A	2N410 HJ 56			
★ " 14	"	"	"	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12			-6	1	50			4	10	90	12A	2S 148 HJ 62		
★ " 15	"	Conv	"	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12			-6	1	60	CG = 35 dB (f = 1.5 Mc)	12	10	70	12A	2N219 HJ23D			
★ " 16	"	"	"	-12	-0.5	-15	80	85	-10	-12			-6	1	60	CG = 35 dB (f = 1.5 Mc)	12	10	70	12A	2N412			
★ " 17	"	Mix	"	-12	-0.5	-15	50	85	-6	-12			-6	1		CG = 20 dB (f = 12 Mc)	19	9.5	110	12A	2S 146 HJ 60			
★ " 18	"	RF	"	-21	-0.5	-15	80	85	-7	-23			-6	1				19	9.5	110	12A	2S 148 HJ 62		
★ " 19	日電	IF	Ge. GD	-12	-0.5	-2	15	55	-10	-9			-6	1	20	PG = 36 dB (f = 455 kc)	50	1.5		19A				
★ " 20	"	"	"	-12	-0.5	-2	15	55	-10	-9			-6	1	30	PG = 39 dB (f = 455 kc)	55	1.5		19A				
★ " 21	"	"	"	-12	-0.5	-2	15	55	-10	-9			-6	1	50	PG = 42 dB (f = 455 kc)	55	1.5		19A				
★ " 22	富士通	RF. IF	Ge. A	-20		-20	100	70	-5	-20			-6	1	-0.98*	30*	6*	0.4*	12	12	120	76	2S125	
★ " 23	"	"	"	-20		-15	100	70	-5	-20			-6	1	-0.98*	30*	6*	0.4*	8	12	120	76	2S126	
★ " 24	"	RF	Ge. D	-30		-10	60	70	-5	-6			-6	1	-0.975*	27*	1*	0.2*	100	3.5	150	61		
★ " 25	"	"	"	-25		-15	50	70	-5	-6			-6	1	-0.975*	27*	1*	0.2*	100	3.5	100	61		
★ " 26	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. A	-20	-15	-50	200	85	-12	-16			-6	1	60	30*	12	0.8	6	15	100	84A	ST20B ST20C	
★ " 27	東芝	Conv	Ge. D	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18			-6	1					50	2	40	13A	2S60	
★ " 28	"	RF	"	-18	-0.5	-5	55	75	-8	-12			-6	1	75	h _{FE} = 8-44 (f = 1.5 Mc)			2	40	13A	2S92		
★ " 29	"	IF	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18			-6	1				35	2	35	13A	2S93		
★ " 30	富士通	Conv	Ge. A	-12	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-6	1	75	PG = 30 dB (f = 1.5 Mc)	10	10	85	12A	2NJ8A 2S30			
★ " 31	"	IF	"	-12	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-6	1	50	PG = 37 dB (f = 455 kc)	5	10	75	12A	2NJ5A 2S31			
★ " 32	"	RF. IF	"	-20	-10	-50	100	70	-5	-20			-6	1	-0.985*	29*		0.4*	10	12	150	78		
★ " 33	"	"	"	-20	-10	-25	100	70	-5	-20			-6	1	-0.985*	29*		0.4*	6	12	150	78		
★ " 35	"	Conv	"	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12			-6	1	75	2570	4.23	32.7	10	10	85	12A	2S35	
★ " 36	"	IF	"	-16	-0.5	-15	80	85	-6	-12			-6	1	50	1520	3.16	24.6	5	10	75	12A	2S36	
★ " 37	東芝	Conv	"	-18	-12	-5	25	75	-10	-18			-6	1	-0.985*	CG = 32 dB (f = 1 Mc)	7	10.5	80	5				
★ " 38	"	IF	"	-18	-12	-5	25	75	-10	-18			-6	1	-0.985*	h _{re} = 18 (f = 455 kc)	10	10.5	80	5				
★ " 39	"	"	"	-18	-12	-5	25	75	-10	-18			-6	1	-0.98*	h _{re} = 9 (f = 455 kc)	5.5	10.5	80	5				
★ " 40	富士通	SW	"	-25	-12	-50	80	85	-6	-12			-6	1	65	r _r = 0.3 μS t _r = 0.4 μS	5	10	< 75	12A				
★ " 41	日立	RF	"	-35	-20	-40	250 (放熱設計)	70	-6	-12			-6	1	45				6	10	95	64	2S191 HJ 41	
★ " 42	"	"	"	-45	-20	-40	250 (放熱設計)	70	-6	-12			-6	1	45				6	10	95	64	2S192 HJ 42	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)								電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											備考
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αβ} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (est)* (Ω)		
									I _{CB0}	V _{CB0}	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)								h _{fb} *	
★ 2SA 43	富士通	RF	Ge. D	-35	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-9	1	60	PG = 24 dB (f = 10.7Mc)	40	2.3	40	13A	2S 43		
★ "	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. A	-15	-10	-10	80	75	-10	-10			-6	1	100	CG = 28 dB (f = 1 Mc)	15	10.5	110	20	OC 44		
★ "	東芝	IF	"	-18	-12	-5	60	75	-12	-18			-6	1		h _{fe} = 5 (f = 455kc)		11	80	12A	2S 45		
★ "	富士通	RF. IF	"	-12	-0.5	-25	100	70	-10	-12			-6	1	-0.985 [*]	29 [*]		0.4 [*]	10	12	150	78	
★ "	"	"	"	-12	-0.5	-25	100	70	-10	-12			-6	1	-0.985 [*]	29 [*]		0.4 [*]	6	12	150	78	
★ "	東芝	RF	"	-18	-12	-5	60	75	-12	-18			-6	1		h _{fe} = 14 (f = 1.5Mc)		11	80	12A	2S 48		
★ "	"	IF	"	-18	-12	-5	60	75	-10	-18			-6	1	30~200	h _{fe} = 11~40 (f = 455kc)		10.5	90	12A	2S 49		
★ "	50	SW	"	-18	-12	-24	60	75	-3	-12	100	-1	-24	-6	1			14	10	<150	12A	2S 50	
★ "	51	RF	"	-18	-12	-5	60	75	-10	-18			-6	1	-0.985 [*]	PG = 36 dB (f = 1 Mc)	14	10.5	90	12A	2S 51		
★ "	52	Conv	"	-18	-12	-5	60	75	-10	-18			-6	1	25~180	h _{fe} = 8~22 (f = 455kHz)		10.5	80	12A	2S 52		
★ "	53	IF	"	-18	-12	-5	60	75	-10	-18			-6	1	20~140	h _{fe} = 5~17 (f = 455kc)		10.5	90	12A	2S 53		
★ "	54	日電 RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	-20	-0.2	-5	75	85	-5	-12			-6	2	10	PG = 12 dB (f = 200Mc)	400 [*]	1.5	40	59			
★ "	55	松下	Ge. A	-15	-10	-10	80	75	-10	-10			-6	1	50		6	10.5	75	20	OC 45		
★ "	56	日電	Ge. Me	-15	-3.5	-50	150	100	-5	-5	40	-0.3	-10	-3	10	t _d = 22nS, t _r = 65nS t _s = 28nS, t _f = 45nS	300 [*]	5		49C			
★ "	57	東芝	Ge. D	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18			-6	1	20~350	PG = 16 dB (f = 50 Mc)	85	2	45	13A	2S 57		
★ "	58	RF. Conv	"	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18			-6	1	20~350	PG = 24 dB (f = 20 Mc)	75	2	45	13A	2S 58		
★ "	59	Conv	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18			-6	1	70	CG = 23 dB (f = 18 Mc)	65	2	40	13A	2S 59		
★ "	60	"	"	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18			-6	1	40~350	CG = 26 dB (f = 12 Mc)	55	2	40	13A	2S60A		
★ "	61	松下 RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6			-6	1	80		70	2	50	12A			
★ "	64	富士通	Ge. A	-16	-9	-40	80	85	-6	-12			-6	1	65	t _r = 0.2 μS, t _f = 1.5 μS t _s = 0.35 μS	15	10	< 85	12A	2S 64		
★ "	65	東芝	"	-18	-12	-200	150	75	-7	-12	80	-0.5	-100	-6	1	t _r = 0.1 μS, t _f = 0.1 μS t _s = 0.14 μS	6	<16	<140	12A			
★ "	66	"	"	-18	-12	-200	150	75	-7	-12	80	-0.5	-100	-6	1	t _r = 0.085 μS, t _f = 0.085 μS t _s = 0.14 μS	10	<16	<140	12A			
★ "	67	"	"	-18	-12	-200	150	75	-7	-12	80	-0.5	-100	-6	1	t _r = 0.06 μS, t _f = 0.06 μS t _s = 0.14 μS	14	<16	<140	12A			
★ "	68	松下 RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. AD	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6			-6	1	80	$\frac{g_{ie}}{3 \text{ m}\Omega}$ $\frac{y_{fe}}{20 \text{ m}\Omega}$ $\frac{g_{oe}}{90 \mu\text{U}}$	70	C _{oe} = 5 pF		72A			
★ "	69	"	"	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6			-6	1	80	$\frac{g_{ie}}{3 \text{ m}\Omega}$ $\frac{y_{fe}}{27 \text{ m}\Omega}$ $\frac{g_{oe}}{90 \mu\text{U}}$	70	C _{oe} = 5 pF		72A	OC169		
★ "	70	"	"	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6			-6	1	80	$\frac{g_{ie}}{2.5 \text{ m}\Omega}$ $\frac{y_{fe}}{32 \text{ m}\Omega}$ $\frac{g_{oe}}{60 \mu\text{U}}$	70	2	50	72A	OC170		
★ "	71	"	"	-20	-0.5	-10	100	75	-13	-6			-6	1	80	$\frac{g_{ie}}{23 \text{ m}\Omega}$ $\frac{y_{fe}}{14 \text{ m}\Omega}$ $\frac{g_{oe}}{350 \mu\text{U}}$	100	2	50	72A	OC171		
★ "	72	東芝	Ge. D	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18			-6	1	50	h _{fe} = 19 (f = 1.5Mc)	40	2	40	13A			
★ "	73	Conv	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18			-6	1	50	h _{fe} = 15 (f = 1.5Mc)	35	2	40	13A			
★ "	74	RF	"	-50	-0.5	-50	120	75	-8	-12			-9	1	70	2000	0.3	15	70	2.2	30	13A	

2SA

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考			
				V _{CE0}	V _{EB0}	I _C	P _C	T _J	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie} *	h _{re} *	h _{oe} *	f _{αB}			C _{ob}	r _{bb}	r _{bb}
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fs} *	(Ω)	(×10 ⁻⁴)	(μΩ)	(Mc)			(pF)	(Ω)	(Ω)
2SA 75	東芝	RF	Ge. D	-20	-0.5	-50	120	75	-8	-12				-9	1	70	2000	0.3	15	30	2.2	30	13A	
" 76	"	"	"	-18	-0.5	-5	55	75	-15	-18				-6	1	20~350	PG = 13 dB (f = 100Mc)		130	1.7	40	13A		
" 77	"	Osc	"	-18	-0.5	-5	55	75	-15	-18				-6	1	20~350	V _{osc} = 100mV (f = 110.7Mc)		110	1.7	40	13A		
" 78	"	SW	"	-40	-2	-400	125	75	-8	-12	60	-1	-400		-6	1		t _r = 0.085μs, t _f = 0.25μs t _s = 0.085μs	40	< 6	< 120	13A		
" 79	"	"	Ge. A	-20	-12	-200	60	75	-7	-12	70	-0.5	-100		-6	1			> 4	< 15	< 140	12A		
" 80	日立	RF. Conv	Ge. D	-20	-0.5	-10	80	85	-20	-12				-9	1	80	PG = 16 dB (f = 12 Mc)		60	1.7	35	13A	2S140 HJ 70	
" 81	"	Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-20	-12				-9	1	80			40	1.7	41	13A	2S141 HJ 71	
" 82	"	Mix	"	-20	-0.5	-10	80	85	-8	-12				-9	1	6	CG = 24 dB (f = 12 Mc)		40	1.7	25	13A	2S142 HJ 72	
" 83	"	IF	"	-25	-0.5	-10	80	85	-8	-12				-9	1	60	PG = 39 dB (f = 455kc)		30	1.7	25	13A	2S143 HJ 73	
" 84	"	Conv	"	-25	-0.5	-10	80	85	-8	-12				-9	1	60	CG = 41 dB (f = 1.5Mc)		35	1.7	35	13A	2S144 HJ 74	
" 85	"	RF	"	-25	-1	-10	80	85	-8	-12				-9	1	60	PG = 31 dB (f = 1.5 Mc)		55	1.7	30	13A	2S145 HJ 75	
" 86	"	"	"	-45	-1	-50	225 (放熱板付)	85	-12	-12				-9	1	80			35	1.7	45	67	2S190 HJ 76	
" 87	"	"	"	-30	-0.5	-10	80	85	-12	-12				-12	1.5	100			100	1.9	40	13A		
" 88	"	Osc	"	-30	-0.5	-10	80	85	-12	-12				-12	1.5	80			100	1.9	60	13A		
" 89	"	Mix	"	-30	-0.5	-10	80	85	-12	-12				-12	1.5	80			90	2.3	60	13A		
" 90	"	RF	"	-30	-0.5	-20	200 (放熱板付)	85	-12	-12				-12	1.5	>20			>60	< 3	60	67		
" 92	東芝	Osc	"	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18				-6	1	40~350			50	1.9	40	13A	2S92A	
" 93	"	Mix	"	-18	-0.5	-5	55	75	-10	-18				-6	1	20~350	CG = 25 dB (f = 12 Mc)		45	1.9	30	13A	2S93A	
" 94	日立	Conv	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9				-3	1				45	5	65	13A		
" 95	富士通	RF	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12				-9	1				50	2.3	50	72B	2S 95	
" 96	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12				-9	1				45	2.3	50	72B	2S 96	
" 97	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12				-9	1				40	2.3	50	72B	2S 97	
" 98	"	Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12				-9	1				30	2.3	50	72B	2S 98	
" 99	"	Mix	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12				-9	1				20	2.3	50	72B	2S 99	
" 100	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	"	-40	-0.7	-10	60	75	-16	-10				-6	1	>80		1.5 *	20	1.7	100	12C		
" 101	"	"	"	-40	-0.7	-10	60	75	-16	-10				-6	1	>12		1.5 *	15	1.7	30	12C	MC101	
" 102	"	"	"	-40	-0.7	-10	60	75	-16	-10				-6	1	40		1.5 *	25	1.7	40	12C	MC102	
" 103	"	"	"	-40	-0.7	-10	60	75	-16	-10				-6	1	50		1.5 *	35	1.7	50	12C	MC103	
" 104	"	"	"	-40	-0.7	-10	60	75	-16	-10				-6	1	100		1.7 *	50	1.7	50	12C	MC104	
" 105	富士通	Conv	"	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6				-3	1	50	PG = 20 dB (f = 12 Mc)		75	3	50	13A		

型名	社名	用途	構造	電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)																外 形	備 考			
				最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)															
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CE0} 最大値 (μA)	V _{CEB} (V)	直流又は パルス I _C (mA)	h _{FE}	バイアス I _E (mA)	h _{fe}	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μS)	f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} h _{ie} (real) (Ω)		
★ 2SA106	富士通	Conv. Mix Osc	Ge. D	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6					-3	1	50	PG = 28 dB (f = 1.5Mc)	30	3	50	13A		
★ " 107	"	IF	"	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6					-3	1	40	PG = 40 dB (f = 455kc)	20	3	50	13A		
★ " 108	"	RF	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12					-9	1	70	PG = 17 dB (f = 20 Mc)	50	2.3	50	13A	2S108	
★ " 109	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12					-9	1	60	PG = 15 dB (f = 20 Mc)	45	2.3	50	13A	2S109	
★ " 110	"	Conv	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12					-9	1	60	PG = 20 dB (f = 12 Mc)	40	2.3	50	13A	2S110	
★ " 111	"	Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12					-9	1	40	Vosc = 0.4 V (f = 12 Mc)	30	2.3	50	13A	2S111	
★ " 112	"	Mix	"	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12					-9	1	45	PG = 15 dB (f = 12 Mc)	20	2.3	50	13A	2S112	
★ " 113	"	Conv. Mix	"	-34	-1	-10	80	85	-7	-12					-12	1	45	CG = 40 dB (f = 1 Mc)	20	2	50	13A		
★ " 114	"	IF	"	-34	-1	-10	80	85	-7	-12					-12	1	40	PG = 39 dB (f = 455kc)	20	2	50	13A		
★ " 115	"	RF	"	-34	-1	-10	80	85	-5	-12					-12	1	60	PG = 28 dB (f = 1.5Mc)	30	2	50	13A		
★ " 116	"	"	"	-30	-0.5	-10	80	85	-10	-12					-12	1.5	60	PG = 15 dB (f = 50 Mc)	120	2	50	13A		
★ " 117	"	Osc	"	-30	-0.5	-10	80	85	-10	-12					-12	1.5	40	Vosc = 0.25 V (f = 60.7Mc)	110	2	50	13A		
★ " 118	"	Mix	"	-30	-0.5	-10	80	85	-10	-12					-12	1.5	60	PG = 15 dB (f = 50 Mc)	100	2	50	13A		
★ " 121	ソニー	RF. Conv Mix. Osc	Ge. GD	-15		-2	15	65	-8	-15					-6	1	-0.96*	50 *	5 *	0.25 *	100	1.3	18	2S173 2T201
★ " 122	"	"	"	-15		-2	15	65	-8	-15					-6	1	-0.96*	50 *	5 *	0.25 *	100	1.3	18	2T201
★ " 123	"	"	"	-15		-2	15	65	-8	-15					-6	1	-0.96*	50 *	5 *	0.25 *	100	1.3	18	2T201
★ " 124	"	"	"	-15		-2	15	65	-8	-15					-6	1	-0.97*	50 *	5 *	0.25 *	120	1.3	18	2S138
★ " 125	"	"	"	-15		-2	15	65	-2	-15					-6	1	-0.98*	40 *	5 *	0.25 *	120	1.3	18	2S139
★ " 126	日電	SW	Ge. Me	-12	-1	-50	150	100	-5	-5	40	-0.5	-10	-3	10		t _d = 22nS, t _r = 65nS t _r = 28nS, t _f = 45nS	300 *			5	49C		
★ " 127	東芝	RF	Ge. D	-70	-0.5	-50	150	75	-50	-12					-6	1	-0.98*				25	15	40	13A
★ " 128	"	SW	"	-40	-2	-600	170	75	-50	-12	35	-1.5	-600	-6	1		t _r = 0.35μS, t _f = 1.1μS t _r = 0.8μS	>15	<25	<70	13A			
★ " 129	"	"	"	-40	-2	-600	170	75	-50	-12	70	-1.5	-600	-6	1		t _r = 0.35μS, t _f = 1.1μS t _r = 0.8μS	>15	<25	<70	13A			
★ " 130	日立	RF. Conv	Ge. Me	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9					-3	1	80	PG = 19 dB (f = 12 Mc)	65	4	55	13A		
★ " 131	"	Osc	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9					-3	1	50				45	4	60	13A
★ " 132	"	Mix	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9					-3	1	80	CG = 25 dB (f = 12 Mc)	50	4	70	13A		
★ " 133	"	IF	"	-9	-0.5	-10	80	85	-15	-9					-3	1	60	PG = 39 dB (f = 455kc)	40	4	110	13A		
★ " 134	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20					-6	1					140	3	100	72A
★ " 135	"	RF. Conv	"	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20					-6	1					150	3	80	72A
★ " 136	富士通	Conv	Ge. A	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6					-3	1	75	CG = 25 dB (f = 1.5Mc)	10	13	85	12A		
★ " 137	"	IF	"	-6	-0.5	-10	80	85	-10	-6					-3	1	50	PG = 28 dB (f = 455kc)	5	13	75	12A		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)							電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス			バイアス		h _{FE} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻³)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb} h _{ie(real)} * (Ω)
									(μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)									
★ 2SA138	富士通	SW	Ge. A	-20	-10	-25	80	85	-5	-20	70	-1	-10	-6	1				15	10	150	12A		
★ "	"	RF. IF	"	-20	-10	-50	80	85	-5	-20	70	-1	-50	-6	1	-0.985*	29*	0.4*	8	12	150	12A		
★ "	三菱	IF	"	-15	-1.5	-15	80	85	-5	-12				1	70*		PG = 33 dB (f = 455kc)	4	12	60	12A	TJ 41		
★ "	"	Conv	"	-15	-1.5	-15	80	85	-5	-12				1	70		CG = 28 dB (f = 1 Mc)	8	12	60	12A	TJ 42		
★ "	"	RF. Conv	"	-15	-1.5	-15	80	85	-5	-12				1	70*		PG = 15 dB (f = 1.5Mc)	15	12	60	12A	TJ 43		
★ "	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	"	-15	-10	-10	80	75	-10	-10				1	100		CG = 28 dB (f = 1 Mc)	15	10.5	110	12B	OC 44		
★ "	"	"	"	-15	-10	-10	80	75	-10	-10				1	50			6	10.5	75	12B	OC 45		
★ "	三菱	IF	Ge. D	-20	-0.5	-10	60	85	-15	-12				1	50		PG = 37 dB (f = 455kc)	20	2.5	40	13B	TJ 46		
★ "	"	Conv. Mix	"	-20	-0.5	-10	60	85	-15	-12				1	70			30	2.5	40	13B	TJ 47		
★ "	"	Conv	"	-20	-0.5	-10	60	85	-15	-12				1	70		CG = 36 dB (f = 1 Mc)	40	2.5	45	13B	TJ. 48		
★ "	"	RF	"	-20	-0.5	-10	60	85	-15	-12				1	70			50	2.5	50	13B	TJ 49		
★ "	日立	IF	Ge. A	-9	-0.5	-15	80	85	-5	-6				1				6	13.5	90	12A			
★ "	"	Conv	"	-9	-0.5	-15	80	85	-5	-6				1				10	13.5	110	12A			
★ "	日電	Mix	Ge. GD	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				1	60		CG = 28 dB (f = 12 Mc)	60	1.3		19A	2S153 ST27B		
★ "	"	IF	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				1	20		PG = 36 dB (f = 455kc)	50	1.5		19A	2S154 ST28A		
★ "	"	"	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				1	30		PG = 39 dB (f = 455kc)	55	1.5		19A	2S155 ST28B		
★ "	"	"	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				1	50		PG = 42 dB (f = 455kc)	55	1.5		19A	2S156 ST28C		
★ "	"	Osc	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				1	50		V _{osc} = 3 V (f = 18.455Mc)	65	1.5		19A	2S157 ST29		
★ "	"	Conv	Ge. GD	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				1	50		CG = 36 dB (f = 1.6 Mc)	55	1.5		19A	2S159 ST37E		
★ "	"	"	"	-15	-0.5	-4	20	65	-5	-9				1	60		CG = 39 dB (f = 1.6 Mc)	55	1.5		19A	2S160		
★ "	ソニー	RF	Ge. Me	-20		-15	50	85	-5	-15				2	-0.93*			400*	1.2	80	51			
★ "	"	"	"	-20		-15	50	85	-5	-15				2	-0.96*			400*	1.2	80	51			
★ "	"	"	"	-20		-15	50	85	-5	-15				2	-0.985*			400*	1.2	80	51			
★ "	"	Osc	"	-20		-15	50	85	-5	-15				2	-0.93*			400*	1.2	80	51			
★ "	"	"	"	-20		-15	50	85	-5	-15	24	-3	-1	-6	2	-0.96*	PG = 20 dB (f = 100Mc)	450*	1.7	80	51			
★ "	"	"	"	-20		-15	50	85	-5	-15				2	-0.985*			400*	1.2	80	51			
★ "	日電	RF	Ge. A	-20	-10	-50	125	75	-8	-20				1	70	28*	13*	0.8*	9	15	120	84A	2S167 ST20A	
★ "	"	"	"	-20	-10	-50	175	75	-8	-20				1	70	28*	13*	0.8*	9	15	120	91	2S168 ST20AR	
★ "	168A	"	"	-20	-10	-50	175	75	-8	-20				1	70	28*	13*	0.8*	9	15	120	91		
★ "	169	"	SW	-20	-10	-50	125	75	-8	-20	70	-1	-10	-6	1				15	11	250	84A	2S169 ST20E	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考				
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)	直流又はパルス h_{FP}		バイアス		h_{fe}	h_{ie} h_{iE}^* (Ω)	h_{re} h_{rE}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oE}^* (μU)	$f_{\alpha B}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} $h_{ic}(\text{real})^*$ (pF)			r_{bb} $h_{ic}(\text{real})^*$ (Ω)			
★ 2SA170	日電	SW	Ge. A	-20	-10	-50	175	75	-8	-20	70	-1	-10	-6	1						15	11	250	91	2S170 ST20ER
★ "	"	"	"	-20	-10	-50	125	75	-8	-20	60	-1	-10	-6	1						8	11	230	84A	2S171
★ "	"	"	"	-20	-10	-200	175	75	-8	-20	40	-0.35	-200	-6	1						8	11	230	91	2S172
★ "	"	"	"	-20	-10	-50	125	75	-8	-20	60	-1	-10	-6	1						4	13	200	84A	2S173
★ "	"	"	"	-20	-10	-50	175	75	-8	-20	60	-1	-10	-6	1						4	13	200	91	2S174
★ "	東芝	RF	Ge. D	-18	-0.5	-5	55	75	-15	-18				-6	1	20-350	PG = 16 dB ($f = 50\text{Mc}$)			85	2	40	13A	2S175	
★ "	"	"	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18				-6	1					85	2.5	45	13A	2S176	
★ "	"	"	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18				-6	1	$h_{fe} = 13$ (-1.5V, 1mA, $f = 1.5\text{Mc}$)					2	40	13A		
★ "	三洋	Conv	Ge. A	-15	-15	-10	50	75	-10	-15				-6	1	-0.986*	28*	4.7*	0.3*	10	12	100	12B		
★ "	"	IF	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-15				-6	1	-0.979*	29*	2.8*	0.4*	5	12	80	12B		
★ "	"	"	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-15				-6	1	-0.964*	29*	2.9*	0.5*	5	12	80	12B		
★ "	"	"	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-6				-6	1	-0.988*	28*	6*	0.5*	16	12	120	12B		
★ "	"	"	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-6				-6	1	-0.95*	29*	2.4*	0.5*	3	12	70	12B		
★ "	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc	"	-12	-0.5	-15	80	85	-10	-12				-6	1	70				10	10	150	12A		
★ "	"	IF	"	-12	-0.5	-15	80	85	-10	-12				-6	1	70				6	10	100	12A		
★ "	沖	Mix	Ge. D	-20	-0.5	-15	80	80	-20	-20				-6	1	60				40	2.6	60	13A		
★ "	"	"	"	-20	-0.5	-15	80	80	-20	-20				-6	1	25				20	2.6	50	13A		
★ "	"	Conv	"	-20	-0.5	-15	80	80	-20	-20				-6	1					13	3.2	40	13A		
★ "	"	"	Ge. A	-15	-12	-15	80	80	-12	-15				-6	1	50				13	10	100	12A		
★ "	"	IF	"	-15	-12	-15	80	80	-12	-15				-6	1	40				7	10	90	12A		
★ "	"	"	"	-15	-12	-15	80	80	-12	-15				-6	1	30				4	10	75	12A		
★ "	"	"	"	-15	-12	-15	80	80	-12	-15				-6	1	25				2.5	10	60	12A		
★ "	三洋	"	"	-15	-15	-10	50	75	-10	-15				-6	1		$h_{fe} = 2.5$ ($f = 455\text{kc}$)			12	55	12B			
★ "	"	"	"	-15	-5	-5	30	75	-25	-15				-6	1		$h_{fe} = 4$ - 50 ($f = 455\text{kc}$)			12	55	12B			
★ "	"	RF	"	-15	-5	-5	30	75	-10	-15				-6	1		$h_{fe} = 9$ ($f = 1.5\text{Mc}$)			11	95	12B			
★ "	"	"	"	-15	-5	-5	30	75	-10	-15				-6	1		$h_{fe} = 9$ ($f = 1.5\text{Mc}$)			11	95	12A			
★ "	"	IF. Conv	"	-15	-5	-15	100	75	-10	-15				-6	1	50	CG = 32 dB ($f = 1\text{Mc}$)			8	11	65	12B		
★ "	"	"	"	-15	-5	-15	100	75	-10	-15				-6	1	55	PG = 34 dB ($f = 455\text{kc}$)			12	11	70	12B		
★ "	"	IF	"	-15	-5	-15	100	75	-10	-15				-6	1	30	PG = 30.5 dB ($f = 455\text{kc}$)			5	11	55	12B		
★ "	日電	RF	"	-30	-20	-200	150	85	-6	-10	60	-1	-10	-6	1	65	28*	12*	0.9*	6	15	130	84A		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考			
				V_{CBO}	V_{EBO}	I_C	P_C	T_j	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe}	h_{ie}	h_{re}	h_{oe}	$f_{\beta T}$			C_{ob}	r_{bb}	
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	($^\circ\text{C}$)	(μA)	$V_{CB(V)}$	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$	h_{fb}^*	(Ω)	($\times 10^{-4}$)	(μD)	(Mc)			(pF)	(Ω)	
★ 2SA205	日電	RF. SW	Ge. A	-30	-20	-200	200	85	-6	-15	40	-1	-10	-6	1	45	28	9*	1.1*	5	15	110	84A	
★ "	"	"	"	-30	-20	-200	200	85	-6	-20	55	-1	-10	-6	1	60	28*	10*	0.8*	7	15	120	84A	
★ "	"	"	"	-30	-20	-200	200	85	-6	-15	65	-1	-10	-6	1	70	28	11*	0.8*	12	15	130	84A	
★ "	日立	SW	"	-20	-12	-400	120	85	-5	-12	>15	-0.3	-200	-6	1					>3	<25	<120	84A	
★ "	"	SW	"	-20	-12	-400	120	85	-5	-12	>30	-0.3	-200	-6	1					>5	<25	<150	84A	
★ "	"	"	"	-20	-12	-400	120	85	-5	-12	>45	-0.3	-200	-6	1					>10	<25	<200	84A	
★ "	"	"	"	-18	-10	-100	120	85	-10	-12	>30	-0.3	-100	-6	1					>4	<20	<150	84A	
★ "	"	"	"	-25	-12	-100	120	85	-5	-12	>30	-0.3	-100	-6	1					>4	<20	<150	84A	
★ "	日電	RF. Mix	Ge. GD	-15	-0.5	-2	15	65	-5	-9				-6	1	25	PG = 7 dB ($f = 100\text{Mc}$)			140	1		19A	
★ "	"	Conv. Osc	"	-15	-0.5	-2	15	65	-5	-9				-6	1	25	PG = 29.5 dB ($f = 10\text{Mc}$)			140	1		19A	
★ "	"	RF	"	-15	-0.5	-2	15	65	-5	-9				-6	1	40	PG = 24 dB ($f = 10\text{Mc}$)			120	1		19A	
★ "	"	"	"	-15	-0.5	-2	15	65	-5	-9				-6	1	40	PG = 27 dB ($f = 10\text{Mc}$)			120	1		19A	
★ "	三洋	RF. IF	Ge. D	-20	-0.5	-10	50	75	-12	-15				-6	1	90	CG = 30 dB ($f = 4.5\text{Mc}$)			55	3	65	13A	
★ "	"	RF	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15				-6	1	70	PG = 20 dB ($f = 10.7\text{Mc}$)			55	3.5	35	12B	
★ "	"	RF. Conv	"	-20	-0.5	-15	50	75	-15	-15				-6	1	150				60	3.5	35	12B	
★ "	"	"	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15				-6	1	80	CG = 23 dB ($f = 12\text{Mc}$)			55	3.5	35	12B	
★ "	"	"	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15				-6	1	90	CG = 13 dB ($f = 27\text{Mc}$)			60	3.5	35	12B	
★ "	"	Osc	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15				-6	1	120				65	3.5	30	12B	
★ "	"	RF	"	-20	-0.5	-10	50	75	-12	-15				-6	1	170	PG = 20 dB ($f = 25\text{Mc}$)			90	2.5	65	13A	
★ "	"	"	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15				-6	1	80				55	3.5	35	12B	
★ "	"	RF. Mix	"	-15	-0.5	-10	50	75	-12	-15				-6	1	70	PG = 20 dB ($f = 20\text{Mc}$)			95	3	70	13A	
★ "	"	RF	"	-20	-0.5	-10	50	75	-12	-15				-6	1					90	2	250	13A	
★ "	"	"	"	-80	-0.5	-50	170	75	-50	-40				-6	1	50				35	3	40	13A	
★ "	東芝	"	Ge. Me	-20	-0.2	-5	75	85	-10	-12				-6	2	-0.9*	PG = 9.5 dB ($f = 200\text{Mc}$)			400*	1	60	48C	
★ "	"	"	"	-20	-0.2	-5	75	85	-10	-12				-6	2	-0.9*	PG = 11.5 dB ($f = 200\text{Mc}$)			400*	1	50	48C	
★ "	日立	RF	Ge. A	-40	-12	-400	$\frac{3\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	70	-50	-40				-6	70	60	85	3.5	1	2.5	70	60	83	
★ "	"	"	"	-30	-12	-400	$\frac{3\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	70	-50	-30				-6	70	90	130	4.5	1	4	70	60	83	
★ "	"	IF	Ge. Me	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20				-6	1	70	PG = 38 dB ($f = 455\text{kc}$)			100	2.1	60*	13A	
★ "	"	"	"	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20				-6	1	70	PG = 38 dB ($f = 455\text{kc}$)			120	2.1	55*	13A	
★ "	"	RF. Conv	"	-20	-0.5	-10	80	85	-30	-20				-6	1	90	CG = 13 dB ($f = 100\text{Mc}$)			135	2.1	50*	13A	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考		
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA) V_{CB} (V)		直流又はパルス h_{FE} V_{CE} (V) I_C (mA)		バイアス V_{CB} (V) I_E (mA)		h_{fe}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	f_{β} f_T^* (Mc)			C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)
2SA236	東芝	IF	Ge. D	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-18			-6	1	-0.98*	$h_{fe} = 16$ ($f = 1.5\text{Mc}$)	35	1.7	35	13A			
" 237	"	"	"	-18	-0.5	-5	55	75	-12	-12			-6	1	-0.98*	$h_{fe} = 17$ ($f = 1.5\text{Mc}$)	35	2.5	35	13A			
* 238	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	-25		-30	200	85	-8	-15			-6	5	30	NF < 6 dB ($f = 70\text{Mc}$)	700	2.5	35	84C			
* 239	東芝	RF	"	-20	-0.2	-5	75	85	-10	-12			-6	1	-0.91*	PG = 14 dB ($f = 100\text{Mc}$)	200*	1.5	30	48C			
* 240	"	RF. Conv Mix. Osc	Ge. EMe	-20		-5	75	85	-10	-12			-6	1	20*	PG = 19dB ($f = 70\text{Mc}$)	200*	1	25	48C			
* 241	松下	"	Ge. AD	-20	-0.4	-5	50	75	-13	-10			-6	1	25		200*	1.5	70	72B			
* 242	"	"	"	-20	-0.4	-5	50	75	-13	-10			-6	1		g_{ie} 16 mU	g_{re} 15 mU	g_{oe} 300 μU	250*	1.5	70	72B	
* 243	"	"	"	-20	-0.4	-5	50	75	-13	-10			-6	1				300*	1.5	100	72B		
* 243A	"	"	"	-20		-5	80 (散熱抵抗付)	75	-13	-10			-6	1	25				300*	1.5	100	72B	
* 244	日電	RF. Conv. Mix Osc. PA	Ge. Me	-25	-0.5	-30	200	85	-8	-15			-6	5	30	PG = 12.5 dB ($f = 100\text{Mc}$)	600	3		84C			
* 244A	"	"	"	-25	-0.5	-30	200	85	-4	-15			-6	5	30	PG = 16 dB ($f = 70\text{Mc}$)	400*			84C			
* 245	"	"	"	-25	-0.5	-30	200	85	-8	-15			-6	5	30	PG = 14.5 dB ($f = 100\text{Mc}$)	700	2.5		84C			
* 246	日立	PA	"	-30	-0.5	-30	100	85	-30	-30			-6	5	70		160	3	70*	13A			
* 247	"	SW	"	-10	-1.2	-30	100	85	-5	-10	125	-3	-20	-3	20		200	4	65	13A			
* 248	東芝	"	Ge. D	-40	-2	-200	125	75	-8	-12	60	-1	-200	-6	1		$t_r = 30\text{nS}$, $t_f = 50\text{nS}$ $t_s = 200\text{nS}$	40		<120	13A		
* 249	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc	"	-40		-10	110	75	-16	-10			-6	1	60		50	1.7	50	12A			
* 250	"	"	"	-100	-0.7	-10	110	75	-16	-10			-6	1	100		50	1.7	50	12A			
* 251	富士通	SW	Ge. MA	-15	-15	-50	50	80	-5	-6	50	-1	-15	-6	1		50	2.5	150	60			
* 252	"	"	"	-15	-15	-50	50	80	-5	-6	150	-1	-15	-6	1		80	2.5	150	60			
* 253	"	RF	Ge. Me	-20		-30	200	85	-8	-15			-5	10	30		450	2.5	50	84C			
* 254	"	Conv	Ge. A	-12	-0.5	-10	55	85	-10	-12			-6	1	80	PG = 30 dB ($f = 1.5\text{Mc}$)	10	10	120	4			
* 255	"	IF	"	-12	-0.5	-10	55	85	-10	-12			-6	1	50	PG = 37 dB ($f = 455\text{ke}$)	5	10	100	4			
* 256	"	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. D	-20	-0.5	-10	55	85	-10	-12			-6	1	75	PG = 17 dB ($f = 20\text{Mc}$)	60	2.2	30	4			
* 257	"	"	"	-20	-0.5	-10	55	85	-10	-12			-6	1	60	PG = 20 dB ($f = 12\text{Mc}$)	50	2.2	50	4			
* 258	"	"	"	-20	-0.5	-10	55	85	-10	-12			-6	1	45	$V_{osc} = 0.4\text{V}$ ($f = 12\text{Mc}$)	40	2.2	70	4			
* 259	"	"	"	-20	-0.5	-10	55	85	-10	-12			-6	1	45	PG = 15 dB ($f = 12\text{Mc}$)	30	2.2	70	4			
* 260	三洋	RF	Ge. Me	-20	-0.4	-10	100	85	-15	-15			-6	2	12	CG = 17 dB ($f = 100\text{Mc}$)	300*	1.5	50	48C			
* 261	"	"	"	-20	-0.4	-10	100	85	-15	-15			-6	2	15	PG = 15 dB ($f = 100\text{Mc}$)	300*	1.5	60	48C			
* 262	"	"	"	-20	-0.4	-10	100	85	-15	-15			-6	2	15	CG = 12 dB ($f = 200\text{Mc}$)	450*	1.5	65	48C			
* 263	"	"	"	-20	-0.4	-5	60	85	-15	-15			-6	2	15	PG = 10 dB ($f = 200\text{Mc}$)	500*	1.5	65	48C			

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考		
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} *	h _{re} h _{rb} *	h _{oc} h _{ob} *	f _{αβ} f _T *			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(real)} *
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
★ 2SA297	ゼネラル	RF	Ge. A	-16		-15	80	85	-5	-12			-6	1	65			10	13	80	12B		
★ # 298	"	Conv. Mix Osc	Ge. D	-40		-10	80	85	-8	-12			-6	1	55			35	2.5	40	13B		
★ # 299	三洋	RF. IF	Ge. A	-15		-10	50	75	-11	-6			-6	1	60	PG = 31 dB (f = 455 kc)					12A		
★ # 300	"	"	"	-15		-10	50	75	-11	-6			-6	1	60	PG = 31 dB (f = 455 kc)					12B		
★ # 301	松下	SW	Ge. AD	-30	-0.5	-30	120	75	-6	-6	125	-1	-10									72B	
★ # 302	"	"	Ge. A	-20	-15	-100	83	75	-3	-5	20	-0.7	-100									20	
★ # 303	"	"	"	-20	-15	-100	83	75	-3	-5	50	-0.7	-100									20	
★ # 304	東芝	RF. IF. Conv Mix. Osc	"	-18	-12	-40	65	75	-4	-12			-6	1	70	PG = 38 dB (f = 455 kc)	4.5	11	80	84A			
★ # 305	"	"	"	-18	-12	-40	65	75	-4	-12			-6	1	70	PG = 36 dB (f = 1 Mc)	10	11	80	84A			
★ # 306	ゼネラル	"	Ge. D	-40		-10	80	85	-8	-12			-6	1	65			55	2.3	50	13B		
★ # 307	"	"	"	-40		-10	80	85	-8	-12			-6	1	70			75	2.2	50	13B		
★ # 308	松下	"	Ge. AD	-20	-0.3	-5	83	75	-13	-12	>20	-12	-1	-12	1	250		450*	0.5	35	72A		
★ # 309	"	"	"	-20	-0.3	-5	83	75	-13	-12	>20	-12	-1	-12	1	250		600*	0.5	20	72A		
★ # 310	"	"	"	-32	-0.3	-25	166	75	-13	-12	>20	-12	-1	-12	1	250		650*	0.7	60	72A		
★ # 311	東芝	SW	Ge. D	-40	-2	-400	150	75	-6	-12	65	-1	-400	-6	1		t _{re} = 0.34 μS, t _f = 0.15 μS t _{rs} = 0.18 μS	50	3	40	84A		
★ # 312	"	"	"	-40	-2	-400	150	75	-6	-12	40	-1	-200	-6	1		t _{re} = 0.4 μS, t _f = 0.14 μS t _{rs} = 0.18 μS	50	3	40	84A		
★ # 313	"	RF. IF. Conv Mix. Osc	"	-18	-0.5	-20	60	75	-6	-12			-6	1	60	h _{fe} = 15 (f = 1.5 Mc)	40	2	40	84A			
★ # 314	"	"	"	-18	-0.5	-20	60	75	-6	-12			-6	1	100	h _{fe} = 15 (f = 1.5 Mc)	40	2	40	84A			
★ # 315	"	"	"	-18	-0.5	-20	60	75	-6	-12			-6	1	110	h _{fe} = 22 (f = 1.5 Mc)	55	2	40	84A			
★ # 316	"	"	"	-18	-0.5	-20	60	75	-6	-12			-6	1	110	h _{fe} = 28 (f = 455 kc)	75	2	40	84A			
★ # 321	三洋	IF	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15			-6	1	70			30	2.5-4.5	30	12B		
★ # 322	"	"	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15			-6	1	70	CG = 36 dB (f = 1 Mc)	35	2-5	30	12B			
★ # 323	"	Conv	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15			-6	1	80			40	1.5-5.5	30	12B		
★ # 324	"	RF. IF	"	-20	-1.5	-15	70	75	-15	-15			-6	1	70			55	3.5	35	12B		
★ # 325	ゼネラル	SW	Ge. A	-20	-15	-80	80	85	-5	-12	60	-1	-80									12B	
★ # 326	"	"	"	-20	-15	-80	80	85	-5	-12	60	-1	-80									12B	
★ # 327	"	"	Ge. D	-40	-2	-80	80	85	-5	-12	30	-1	-80									13B	
★ # 328	三洋	IF	"	-20	-0.5	-10	50	75	-20	-9			-6	1	60				3			13B	
★ # 329	"	"	"	-20	-1.5	-10	50	75	-15	-12			-6	1	13-550			5-6	1.5-6.5	<90	12B		
★ # 330	"	RF. IF	"	-20	-1.5	-10	50	75	-15	-12			-6	1	13-550				1.5-6.5			12B	

★	型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)										外 形	備 考						
					V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バ イ ア ス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie}^* (Ω)	h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe}^* (μU)			$f_{\beta B}^*$ f_{T^*} (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{be}^{(real)^*}$ (Ω)			
										μA	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(mA)$	$V_{CB}(V)$	$I_E(mA)$										h_{fe}	h_{fb}^*	
★	2SA362	三菱	PA	Ge. DB	-30	-0.5	-30	100	85	-30	-30				-6	5	70				150*	3	70	13A			
★	" 363	"	SW	"	-10	-1.2	-30	100	85	-5	-10				-3	20	80								13A		
★	" 364	"	RF	"	-9	-0.5	-10	80	85	-30	-9				-3	1	60					45	6	100	13A		
★	" 365	"	Mix. Osc	"	-9	-0.5	-10	80	85	-30	-9				-3	1	60					50	6	70	13A		
★	" 366	"	RF. Conv	"	-9	-0.5	-10	80	85	-30	-9				-3	1	60					75	6	50	13A		
★	" 367	"	RF	Ge. D	-20	-0.5	-10	80	85	-15	-12				-9	1	70					30	2.5	40	12A		
★	" 368	"	Conv. Mix Osc	"	-20	-0.5	-10	80	85	-15	-12				-9	1	70					40	2.5	30	12A		
★	" 369	"	RF	"	-20	-0.5	-10	80	85	-15	-12				-9	1	80					50	2.5	30	12A		
★	" 370	"	"	"	-75	-1	-50	120	85	-12	-12				-9	1	70					40	2.5	40	64		
★	" 371	"	SW	Ge. A	-20	-12	-15	80	85	-6	-12	70	-1.5	-10									10.5*	10	110	12A	
★	" 372	東芝	"	Ge. EMe	-15	-2	-200	100	76	-10	-12	25	-1	-10	-3	5		$t_d + t_r = 6\text{nS}$, $t_f = 15\text{nS}$ $t_s = 30\text{nS}$				450*	2	120	49C		
★	" 373	日立	RF	"	-25	-0.5	-150	250	85	-15	-10				-10	5	40					400*	3.2	100	84A		
★	" 373A	"	"	"	-25	-0.5	-150	250	85	-15	-10				-10	5	40					400*	3.2	100	84A		
★	" 374	松下	RF. Conv. Mix Osc. PA	Ge. AD	-34	-0.5	-300	1.5W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	90	-12	-10				-2	150	100					300*	13	10	84A		
★	" 375	三菱	RF. Conv. Mix Osc. SW	Ge. D	-30	-1.5	-100	80	85	-6	-12	40	-1	-50	-9	1	80					40	2.5	30	12A		
★	" 376	ソニー	RF. Conv. Mix.	Ge. DB	-22		-10	60	85	-6	-10	48	-3	-1	-6	2	0.96*	$h_{fe} = 16\text{dB}$ ($f = 100\text{Mc}$)				0.4	70*	52			
★	" 377	松下	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	-20	-0.4	-5	50	75	-13	-10				-6	1	100					200*	1.5	60	50C		
★	" 378	"	"	"	-20	-0.4	-5	50	75	-13	-10				-6	1	100					250*	1.5	30	50C		
★	" 379	"	"	"	-20	-0.4	-5	50	75	-13	-10				-6	1	100					300*	1.5	30	50C		
★	" 380	ゼネラル	RF. Conv	Ge. D	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12				-6	1	70					60	2.2	40	12A		
★	" 381	"	Osc	"	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12				-6	1	50					35	2.5	40	12A		
★	" 382	"	Mix	"	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12				-6	1	55					30	2.2	40	12A		
★	" 383	"	RF	"	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12				-6	1	40					25	2.5	40	12A		
★	" 384	"	Conv	"	-25	-0.5	-10	80	85	-12	-12				-6	1	60					40	2.5	40	12A		
★	" 385	松下	RF	Ge. A	-16	-10	-10	80	75	-12	-10				-6	1	120					10	8	120	12A		
★	" 386	"	RF. Conv. Mix Osc	Ge. AD	-32	-0.5	-300	1.85W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	90	-12	-10				-2	100	80					350*	12	8	84B		
★	" 387	三洋	"	Ge. A	-10		-15	100	85	-50	-10				-6	1	30	$h_{fe} = 9$ ($f = 45\text{kc}$)				10	50	12B			
★	" 388	"	"	"																							
★	" 389	日立	RF	Ge. Me	-20	-0.3	-10	50	85	-30	-20				-10	2	30	$PG = 8.5\text{dB}$ ($f = 800\text{Mc}$)				600*	0.4	$C_c F_{\beta B}^*$ 10 pS	50C		
★	" 390	"	"	"	-20	-0.3	-10	50	85	-30	-20				-10	2	30	$PG = 9.5\text{dB}$ ($f = 800\text{Mc}$)				700*	0.4	$C_c F_{\beta B}^*$ 9.5pS	50C		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)						電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考			
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)	
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *
2SA391	沖	RF	Ge. A	-18	-12	-200	150	85	-6	-6			-5	1	70			7	10	150	84B			
" 392	"	"	"	-18	-12	-200	150	85	-6	-6			-5	1	100			11	9.5	175	84B			
" 393	"	"	"	-18	-12	-200	150	85	-6	-6			-5	1	150			16	9.2	200	84B			
" 393A	"	"	"	-30	-12	-200	150	85	-6	-6			-5	1	150			16	9.2	230	84B			
" 394	"	"	"	-18	-12	-200	150	85	-6	-6			-5	1	200			22	8.7	230	84B			
" 395	"	"	"	-18	-12	-200	150	85	-6	-6			-5	1	300			29	8.5	260	84B			
★ " 396	"	"	"	-15	-15	-200	200	85	-10	-12			-5	1	85			6	20	150	84B			
★ " 397	"	"	"	-23	-15	-200	200	85	-10	-12			-5	1	100			8	20	150	84B			
★ " 398	"	"	"	-30	-20	-200	200	85	-10	-12			-5	1	120			10	19	160	84B			
★ " 399	"	"	"	-30	-20	-200	200	85	-10	-12			-5	1	70			12	17	160	84B			
★ " 400	富士通	RF. Conv. Mix Osc	Ge. D	-20	-0.5	-10	80	85	-10	-12			-6	1	70			70	2.3	50	13A			
★ " 401	日立	RF	Ge. Me	-30	-0.5	-40	130	85	-30	-30			-6	5	70			30	3	70	13A			
★ " 402	東芝	"	Si. EP	-35		-100	250	175	-1	-15	200	-6	-2	-6	1			200*	6	30	49C			
★ " 403	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Ge. Me	-20	-0.2	-5	75	85	-10	-12			-6	2	10	PG = 16 dB (f = 70 Mc)		280*	1.5	40	19B			
★ " 404	"	"	"	-20	-0.2	-5	75	85	-10	-12			-6	2	10	PG = 12 dB (f = 200 Mc)		400*	1.5	40	59			
★ " 405	"	SW	"	-15	-3.5	-50	150	100	-3	-5	40	-0.5	-10	-3	10	t _d = 22 nS, t _r = 65 nS t _f = 28 nS, t _f = 45 nS		300*	5		49C			
★ " 406	"	"	Ge. A	-30	-20	-200	200	85	-7	-15	50	-1	-10	-6	1	60	28*	10*	0.8*	9	15	120	84A	
★ " 407	"	"	"	-30	-20	-200	200	85	-7	-12	60	-1	-10	-6	1	70	28*	11*	0.8*	14	15	130	84A	
★ " 408	富士通	"	Ge. MA	-15	-15	-50	50	80	-5	-6	100	-1	-15	-6	1			50	3		60			
★ " 409	"	"	"	-15	-15	-50	50	80	-5	-6	100	-1	-15	-6	1			80	3		60			
★ " 410	日電	"	Ge. EMe	-12	-1	-150	150	100	-5	-5	40	-0.3	-10	-3	10	t _d = 10 nS, t _r = 50 nS t _f = 15 nS, t _f = 40 nS		300	1.5		49C			
★ " 411	"	"	"	-15	-2.5	-150	150	100	-5	-5	40	-0.3	-10	-3	10	t _d = 10 nS, t _r = 40 nS t _f = 15 nS, t _f = 35 nS		300	1.5		49C			
★ " 412	日立	"	Ge. Me	-13	-1	-100	150	85	-3	-6	50	-0.5	-30	-3	10			40*	7		12A			
★ " 413	松下	"	Ge. AD	-20	-2.5	-30	100	75	-5	-5	90	-1	-30	-2	30			>300*	4		49C			
★ " 414	"	"	Ge. A	-30	-20	-200	150	85	-3	-5	40	-0.5	-100	-5	3			7*	9		84A			
★ " 415	"	"	"	-25	-20	-200	150	85	-3	-5	60	-0.5	-100	-5	3			10*	9		84A			
★ " 416	"	"	Ge. AD	-70	-1.5	-700	6W (T _c =25°C)	75	-1mA	-60	100	-10	-600	-10	300			120*	35		103			
★ " 417	日電	"	Ge. EMe	-15	-2.5	-200	150	100	-5	-10	70	-0.3	-10			t _d + t _r < 70 nS, t _r + t _f < 100 nS t _s < 50 nS					46C			
★ " 419	三洋	"	Ge. Me	-20		-5	50	85	-10	-12			-6	2	20	PG = 12 dB (f = 200 Mc)					48C			
★ " 420	"	"	"	-20		-5	50	85	-10	-12			-6	2	25	PG = 12 dB (f = 200 Mc)		550	2		48C			

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CEO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} (μA)	最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} (Ω)	h _{ie} (×10 ⁻⁴)	h _{re} (μU)			f _{αB} (Mc)	C _{ob} (pF)
										V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fb} *									
★ 2SA511	東芝	PA	Si.TP	-90	-5	-1A	800	150	-1	-30													
" 512	"	PA.SW	Si.E	-80	-5	-1.5A	800	175	-1	-30	30~150	-2	-200	-10	30								
★ " 513	"	"	"	-50	-5	-1A	800	150	-1	-30													
" 514																							
" 515																							
" 516	東芝	RF.PA	Si.DB	-80	-5	-1.5A	800	175	-0.5	-30	60	-2	-200	-5	200	60							
★ " 516A	"	"	"	-120	-5	-1.5A	800	175	-0.5	-30	60	-2	-200	-5	200	60							
★ " 517	"	RF	Ge.D	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18				-6	1	60							
★ " 518	"	RF.Conv.Mix Osc	"	-18	-0.5	-10	55	85	-12	-18				-6	1	60							
" 519																							
" 520																							
" 521																							
" 522	富士通	RF	Si.EP	-25	-5	-100	250	175	-0.1	-15	30~120	-1	-10	-10	10	50							
" 522A	"	"	"	-50	-5	-100	250	175	-0.1	-15	30~120	-1	-10	-10	10	50							
" 523	富士通	RF.PA	"	-40	-5	-300	650	175	-0.1	-10	30~120	-10	-10	-10	10	60							
" 523A	"	"	"	-60	-5	-300	650	175	-0.1	-10	30~120	-10	-10	-10	10	60							
" 524	"	"	"	-25	-3	-100	350	175	-0.1	-10				-10	10	50							
★ " 525	東芝	RF.Conv.Mix Osc	Ge.EMe	-20		-5	75	85	-10	-12				-6	1	20	PG = 21dB (f = 70Mc)						
★ " 526	ソニー	PA	Si.E	-50	-5	-1A	500	150	-5	-50	70	-2	-100	-6	1	50	h _{fe} = 5dB (f = 50Mc)				C _e r _{bb'} 100pS		
★ " 527	"	"	"	-50	-5	-2A	^{5 W} _(T=25°C)	150	-5	-50	50	-2	-200	-6	1	50	h _{fe} = 5dB (f = 50Mc)				C _e r _{bb'} 100pS		
★ " 528	"	"	"	-50	-5	-2A	^{5 W} _(T=25°C)	150	-5	-50	70	-2	-100	-6	1	50	h _{fe} = 5dB (f = 50Mc)				C _e r _{bb'} 100pS		
★ " 529	"	RF.PA	Si.EMe	-50	-5	-1A	^{5 W} _(T=25°C)	150	-5	-50	80	-2	-100	-10	50		h _{fe} = 5dB (f = 50MHz)				C _e r _{bb'} 100pS		
★ " 530	日立	SW	Si.E	-50	-5	-100	200	175	-1	-20	35~200	-1	-10	-10	20		f _{on} = 90nS, f _{off} = 160nS t _{stg} < 300nS						
★ " 531																							
★ " 532	三洋	RF.PA	Si.TP	-50	-5	-200	500	150	-10	-40	80	-6		-6	10								
" 533																							
" 534																							
" 535	三洋			-75	-4	-700	500	150			60	-6	-50										
" 536	"			-50	-4	-700	500	150			60	-6	-50										
★ " 537	日立	SW	Si.EP	-60	-5	-700	750	200	-1	-30	30~160	-4	-50	-10	20		f _{on} = 42nS, f _{off} = 280nS t _{stg} = 230nS						

2SC873
2SC874
とコンプリ

2SC708
とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE			バイアス		h _{fe}	h _{fe} *	h _{ie} h _{ie} *	h _{re} h _{re} *			h _{oe} h _{oe} *	f _{αB} f _T *	C _{ob} (pF)	τ _{MB} h _{ie(real)} *
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fe} *										
★ 2SA623	三菱	SW.PA	Si.EP	-35	-5	-1.5A	7 W (T _c =25°C)	150	-1	-25	100	-4	-500											132	2SC1033 とコンプリ
★ " 624	"	"	"	-50	-5	-1.5A	7 W (T _c =25°C)	150	-1	-25	100	-4	-500											132	2SC1034 とコンプリ
" 625	富士通	RF	"	-100	-6	-500	700	175	-1	-30	120	-2	-200	-10	10					100*	18	20	84B		
" 626	日電	PA	Si.EMe	-80	-5	-6A	60W (T _c =25°C)	150	-100	-70	60	-5	-2A	-10	200					10*	300	60*	102	2SD180 とコンプリ	
" 627	"	"	"	-100	-5	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-100	-80	60	-5	-2A	-10	200					10*	300	60*	102	2SD188 とコンプリ	
" 628	三菱	RF.AF.SW	Si.EP	-30	-5	-100	200	125	-0.1	-25	200	-6	-1	-6	1	6500	0.3	14	100*	3.5	C _e τ _{MB} 100pS		138B		
★ " 629	"	RF.AF.LN	"	-30	-5	-30	150	125	-0.1	-25	200	-6	-1	-6	1	6500	0.3	14	100*	3.5	C _e τ _{MB} 60pS		138B		
" 630																									
" 631																									
" 632																									
★ " 633	日電	PA	Si.E	-30	-5	-2A	10W (T _c =25°C)	150	-10	-30	80	-5	-1A	-5	150					60*	60	10*	167		
★ " 634	"	"	"	-40	-5	-3A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-30	100	-5	-1A	-5	100					55*	75		167	2SC1096 とコンプリ	
★ " 635	日電	PA.SW	"	-60	-5	-1A	10W (T _c =25°C)	150	-10	-40	80	-5	-500	-5	150					50*	60	10*	167		
★ " 636	"	"	"	-70	-5	-3A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-45	100	-5	-500	-5	100					45*	60		167	2SC1098 とコンプリ	
★ " 637	松下	RF.AF	Si.TP	-150	-5	-50	300	175	-1	-100	150	-3	-15	-10	3	67	540	0.4	7.7	150*	4	C _e τ _{MB} 150pS	49C		
" 638	日電	"	Si.E	-150	-5	-50	250	125	-1	-100	100	-6	-15	-10	10					130*	4.5		138		
" 639	"	"	"	-180	-5	-50	250	125	-1	-100	100	-6	-15	-10	10					130*	4.5		138		
" 640	"	RF.AF.LN	"	-50	-5	-50	250	125	-0.05	-50	450	-3	-0.5	-6	1	450	11k	15	50	100*	6.5	20*	138	2SC1222 とコンプリ	
" 641	"	RF.AF	"	-50	-5	-50	250	125	-0.05	-50	450	-3	-0.5	-6	1	450	11k	15	50	100*	6.5	20*	138	2SC923 とコンプリ	
★ " 642	"	PA	"	-30	-5	-300	250	125	-0.1	-15	120	-1	-50	-3	50					200*	15	12	138	2SD227 とコンプリ	
★ " 643	"	"	"	-40	-5	-500	500	125	-0.2	-25	120	-1	-100	-6	50					180*	24	10	44	2SD261 とコンプリ	
" 644																									
★ " 645	三菱	PA.SW	Si.EP	-70	-5	-800	7 W (T _c =25°C)	150	-10	-25	100	-4	-300											132	
★ " 646	"	"	"	-90	-5	-800	7 W (T _c =25°C)	150	-10	-25	100	-4	-300											132	
★ " 647	"	"	"	-110	-5	-800	7 W (T _c =25°C)	150	-10	-25	100	-4	-300											132	
★ " 648	日電	PA	Si.EMe	-120	-5	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-2mA	-80	50	-5	-3A	-10	200					10*	200	30*	102	2SD217 とコンプリ	
★ " 649	"	"	"	-150	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-2mA	-80	50	-5	-3A	-10	200					10*	200	30*	102	2SD218 とコンプリ	
★ " 650	"	"	"	-150	-5	-10A	100 W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	70	-5	-2A	-10	200					10*	500	20*	102		
★ " 651	"	"	"	-150	-5	-10A	100 W (T _c =25°C)	150	-1mA	-100	70	-5	-2A	-10	200					10*	500	20*	102		
★ " 652	"	"	"	-150	-6	-1A	15W (T _c =25°C)	150	-1mA	-60	80	-5	-200	-10	200					15*	100	30*	134		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CBO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oc} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)	
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fe} * (Ω)
★ 2SA653	日電	PA	Si.EMe	-150	-6	-1A	15W (T _c =25°C)	150	-1mA	-60	80	-5	-200	-10	200					15*	100	30*	134	
" 654																								
" 655																								
★ " 656	東芝	PA	Si.TMe	-130	-5	-7A	50W (T _c =25°C)	150	100	13	30~300	-5	-1A	-10	1A					5*	150		102	2SC519 とコンパリ
★ " 657	"	"	"	-100	-5	-7A	50W (T _c =25°C)	150	100	100	30~300	-5	-1A	-10	1A					5*	150		102	2SC520 とコンパリ
★ " 658	"	"	"	-70	-5	-7A	50W (T _c =25°C)	150	100	70	30~300	-5	-1A	-10	1A					5*	150		102	2SC521 とコンパリ
" 659	三洋	RF	Si.P	-50	-5	-200	400	125	-10	-40	100	-6	-50	-6	10					90*	7	C _c r _{bb} 50pS	138	
" 660																								
★ " 661	東芝	RF, AF, PA	Si.E	-70	-5	-200	600	150	-0.1	-20	40~400	-2	-50	-10	10					100*	9	10	131	2SC1166 とコンパリ
" 662																								
★ " 663	東芝	RF, AF, PA	Si.EP	-100	-5	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-1mA	-50	30~200	-5	-1A	-5	1A					6*	600	15	102	2SC793 とコンパリ
" 664																								
" 665																								
★ " 666	松下	RF, AF, LN	Si.EP	-25	-5	-50	150	125	-1	-10	250	-5	-2	-5	-2	200	5000	0.7	10	130*	2.8	C _c r _{bb} 160pS	138	
" 667																								
★ " 668	三菱	RF, SW	Si.EP	-100	-5	-100	150	125	-0.1	-25	100	-6	1	-6	1	t _{on} < 120nS, t _{off} < 290nS t _{str} < 100nS			100*	3.5	C _c r _{bb} 100pS	138B		
" 669	"	SW	"	-160	-5	-100	150	125	-0.1	-25	70	-6	1											138B
★ " 670	日立	PA, SW	Si.T	-50	-4	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-100	-20	35~200	-4	-1A	-4	500					32*	200		267	2SC1060 とコンパリ
★ " 671	"	"	"	-50	-4	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-100	-20	35~200	-4	-1A	-4	500					32*	200		268	2SC1061 とコンパリ
★ " 672	"	RF, LN	Si.EP	-50	-4	-200	200	125	-0.5	-18	110	-12	-2	-12	2					80*	16	12*	138	
" 673	"	RF, AF	Si.E	-35	-4	-500	400	125	-0.5	-20	60~320	-3	-10										138	2SC1213 とコンパリ
" 674																								
" 675	日電	SW	Si.E	-80	-5	-100	250	125	-1	-60	120	-3	-20	-6	10					170*	4.5		138	
" 676																								
" 677	ソニー	RF, SW	Si.E	-25	-5	-200	250	100	-0.5	-25	250	-3	-1	-6	2	h _{fe} = 3dB (f = 100MHz)			140*	6	C _c r _{bb} 60pS	38	2SC633A とコンパリ	
" 678	"	"	"	-50	-5	-200	320	120	-0.5	-25	250	-3	-1	-6	2	h _{fe} = 3dB (f = 100MHz)			140*	6	C _c r _{bb} 60pS	38	2SC634A とコンパリ	
★ " 679	東芝	PA	Si.EMe	-120		-12A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-50	40~140	-5	-2A	-5	2A					6*	900	20	102	2SC1079 とコンパリ
★ " 680	"	"	"	-80		-12A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-50	40~140	-5	-2A	-5	2A					6*	900	20	102	2SC1080 とコンパリ
★ " 681	"	RF, PA	Si.E	-100	-5	-1A	800	150	-1	-30	120	-2	-150	-2	150					50*	40	10	342	
" 682	"	"	"	-80	-5	-750	800	150	-0.1	-30	70~240	-2	-150	-2	150					100*	15	15	342	2SC1382 とコンパリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)													外 形	備 考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	T _{bb'} h _{bb'} (real)* (Ω)				
									(μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	h _{fb} *										V _{CE} (V)	I _C (mA)
2SA683	松下	PA	Si. EP	-30	-5	-1A	750	135	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50				200*	20	3.5*	165			
" 684	"	"	"	-60	-5	-1A	750	135	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50				200*	20	3.5*	165			
* 685	"	AF	Si. TP	-150	-5	-50	300	125	-1	-100	150	-3	-15	-10	3	67	540	0.4	77	100*	5	35	138		
" 686																									
" 687																									
" 688																									
" 689																									
" 690																									
" 691																									
" 692																									
" 693																									
" 694																									
" 695	三菱	RF. PA	Si. EP	-25	-4	-700	500	125	-1	-25	100	-1	-500	-6	10					150*	20	C _e T _{bb'} 100pS	138B	2SC1209 とコンプリ	
" 696	"	"	"	-45	-4	-300	500	125	-1	-25	100	-2	-150	-6	10					150*	10	C _e T _{bb'} 100pS	138B	2SC1210 とコンプリ	
" 697	"	"	"	-65	-4	-300	500	125	-1	-25	100	-2	-150	-6	10					150*	10	C _e T _{bb'} 100pS	138B	2SC1211 とコンプリ	
* 698	"	PA. SW	"	-130	-5	-800	$\frac{7W}{(T_c=25^\circ C)}$	150	-10	-25	100	-4	-300			t _{on} < 200nS, t _{off} < 800nS t _{stg} < 600nS								132	
" 699	松下	PA	"	-40	-5	-2A	$\frac{10W}{(T_c=25^\circ C)}$	150	-1	-20	120	-5	-1A	-5	500					150*	50	3.3*	161	2SC1226 とコンプリ	
* 700	日立	"	Si. E	-35		-1.5A	$\frac{8W}{(T_c=25^\circ C)}$	150	-10	-35	100	-2	-200	-4	500					11*	200	6*	268		
* 701	三洋	RF. LN	Si. EP	-30	-5	-50	200	125	-1	-25	200	-6	-1	-6	1		2200	0.5	7	80*	12	C _e T _{bb'} 100pS	138		
* 702	"	"	"	-50	-5	-50	200	125	-1	-45	200	-6	-1	-6	1		2200	0.5	7	80*	12	C _e T _{bb'} 100pS	138		
* 703	三菱	SW. PA	"	-25	-5	-1.5A	$\frac{7W}{(T_c=25^\circ C)}$	150	-1	-16	100	-4	-500			t _{on} < 0.2μS, t _{off} < 0.8μS t _{stg} < 0.6μS								132	2SC1243 とコンプリ
" 704	ソニー	RF. AF. LN SW	Si. EMe	-25	-5	-200	250	100	-0.5	-25	250	-3	-1	-6	1	6600	0.76	16.2	$h_{fe}=3dB$ (100MHz)	6	C _e T _{bb'} 60pS	38	2SC631A とコンプリ		
" 705	"	"	Si. E	-50	-5	-200	320	120	-0.5	-25	250	-3	-1	-6	1	$h_{fe}=3dB$ (f=100MHz)				140*	6	C _e T _{bb'} 60pS	38	2SC632A とコンプリ	
" 706	"	RF	Si. DB	-60	-6	-1A	950	120	-1	-50	150	-2	-100	-10	10					120*	10	C _e T _{bb'} 150pS	174		
* 707	日電	RF. PA	Si. E	-40	-5	-500	750	135	-0.2	-25	120	-1	-100	-3	50					180*	24	10	45	2SD336 とコンプリ	
" 708	"	RF. AF. SW	"	-80	-8	-700	800	150	-0.1	-60	150	-2	-50	-10	50					100*	25	25*	84B		
" 709	"	"	"	-60	-8	-200	300	150	-0.1	-40	160	-1	-10	-10	10					280*	7.5	70*	304		
" 710	"	RF. SW	"	-50	-5	-100	300	150	-0.1	-30	120	-1	-10	-10	10	t _{on} < 80nS, t _{off} < 180nS t _{stg} < 140nS				600*	2.5	34*	49C		
" 711	"	"	"	-50	-5	-100	300	150	-0.1	-30	120	-1	-10	-10	10	t _{on} < 70nS, t _{off} < 170nS t _{stg} < 130nS				1000*	2.5	34*	49C		
" 712	"	"	"	-150	-5	-500	750	175	-0.1	-100	110	-10	-50	-10	50					350*	5.5	11*	84B	2SC1217 とコンプリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)							電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}				バイアス				f _{ob} ft* (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} hie(real)* (Ω)				
									I _{CB0} (μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)							
★ 2SA713	日電	RF	Si, E F _{2N1, 1N}	-15	-10	-300	250	125	-0.1	-10	20,000	-5	-100	-10	10					180*	6	200*	138		
★ " 714	三洋	PA	Si, EMe	-150	-6	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-1mA	-30	60	-5	-1A	-5	1A					8*	500	20	102		
" 715	日立	RF, PA	Si, E	-35	-5	-2.5A	10W (T _c =25°C)	150	-20	-35	60~320	-2	-500	-2	200					160*	35		160	2SC1162 とコンパリ	
" 716																									
" 717	日電	RF, SW	Si, E	-60	-5	-1A	800	175	-0.1	-40	80	-10	-50	-10	50					280*	18	10*	123	2SC1072 とコンパリ	
" 718	"	"	"	-60	-8	-200	300	150	-0.1	-40	140	-1	-10	-10	10					250*	7	30*	49C		
" 719	松下	PA	Si, EP	-60	-5	-500	400	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50					200*	6	3.5*	138	2SC1317 とコンパリ	
" 720	"	"	"	-50	-5	-500	400	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50					200*	6	3.5*	138	2SC1318 とコンパリ	
" 721	"	RF, LN	"	-35	-5	-50	150	125	-0.1	-10	540	-5	-2	-5	2			3500	3	60	250*	5	100	138	2SC1327 とコンパリ
" 722	"	"	"	-55	-5	-50	150	125	-0.1	-10	540	-5	-2	-5	2			3500	3	60	250*	5	100	138	2SC1328 とコンパリ
★ " 723	日電	PA	Si, E	-40	-5	-500	250	125	-0.2	-25	120	-1	-100	-3	50					180*	24	10	138	2SD327 とコンパリ	
★ " 724	"	RF	"	-35	-5	-50	250	125	-0.1	-25	150	-10	-0.5	-1	10					300*	3.5	20*	138		
" 725	三菱	RF, AF, LN	Si, EP	-35	-5	-100	200	125	-0.1	-25	500	-6	-1	-6	1			15k	1.2	28	100*	3	C _c r _{bb'} 140 pS	138B	
" 726	"	"	"	-50	-5	-100	200	125	-0.1	-50	500	-6	-1	-6	1			15k	1.2	28	100*	3	C _c r _{bb'} 60 pS	138B	
" 727																									
★ " 728	三菱	RF, AF	Si, EP	-30	-5	-100	100	125	-0.1	-25	200	-6	-10	-6	1			6500	0.3	14	100*	3.5	C _c r _{bb'} 60 pS	175	
" 729																									
★ " 730	松下	PA	Si, EP	-30	-5	-500	600	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50					200*	6	3.5*	171	2SC1346 とコンパリ	
★ " 731	"	"	"	-60	-5	-500	600	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50					200*	6	3.5*	171	2SC1347 とコンパリ	
" 732	富士通	RF	"	-40	-4	-300	650	175	-0.1	-10	60	-10	-10	-10	10					200*	4.5	50*	84B		
" 733	日電	RF, AF	Si, E	-60	-5	-100	250	125	-0.1	-60	200	-6	-1	-6	1	205	5500	7.5	28	180*	4.5	12	138	2SC945 とコンパリ	
" 734																									
" 735																									
" 736																									
" 737																									
" 738	日立	PA	Si, E	-25	-5	-2.5A	8W (T _c =25°C)	150	-20	-25	60~320	-2	-500	-2	200					160*	35		160	2SC1368 とコンパリ	
" 739	東芝	SW	Si, TMe	-400	-5	-3A	50W (T _c =25°C)	150	-100	-300	20~300	-5	-500	-50								100		102	
★ " 740	"	RF, PA	"	-150	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-20	-100	75	-10	-500	-10	500					8*	100	25	268		
" 741	日立	SW	Si, E	-20	-4	-100	360	175	-0.2	-16	30~120	-0.5	-30	-10	10					t _{on} < 70nS, t _{off} < 120nS	350*			49C	
" 742	"	"	"	-55	-5	-500	700	175	-0.5	-20	80~200	-1.6	-100	-20	50					t _{on} < 40nS, t _{off} < 100nS	> 200*	< 8		123	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA) V _{CB} (V)		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{FE}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oc} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(REAL)} * (Ω)	
									I _C	V _{CB}	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CB(V)}	I _E (mA)										t _r < 350nS, t _f < 150nS t _{sig} < 200nS
2SA743	日立	RF. PA	Si. E	-50	-4	-1A	8 W (T _c =25°C)	150	-1mA	-50	120	-4	-50	-4	30				120*	30		160	2SC1212 とコンプリ	
" 744	サンケン	PA	Si.TMe	-80	-6	-8A	70W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	60	-4	-3A	-12	500				15*	220	10*	102	2SC1402 とコンプリ	
" 745	"	"	"	-100	-6	-8A	70W (T _c =25°C)	150	-1mA	-100	60	-4	-3A	-12	500				15*	220	10*	102	2SC1403 とコンプリ	
" 746	"	"	"	-80	-6	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	60	-4	-3A	-12	500				15*	255	10*	102	2SC1115 とコンプリ	
" 747	"	"	"	-120	-6	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-1mA	-120	60	-4	-3A	-12	500				15*	255	10*	102	2SC1116 とコンプリ	
" 748	松下	RF. PA	Si. EP	-70	-5	-2A	15W (T _c =25°C)	150	-1	-40	130	-5	-1A	-5	500				150*	50	3*	268	2SC1338 とコンプリ	
" 749	"	SW	"	-100	-5	-50	250	125	-0.1	-50	80	-1	-20	-10	10				>40*	3.5		138		
" 750	日電	RF. AF. LN	Si. E	-50	-5	-50	250	125	-0.05	-50	450	-3	-0.5	-6	1	450	11k	15	50	100*	8	20*	138	
" 751	松下	PA	Si. EP	-30	-5	-1A	1 W	135	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50				200*	20	3.5*	173	2SC1406 とコンプリ	
" 752	"	"	"	-60	-5	-1A	1 W	135	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50				200*	20	3.5*	173	2SC1407 とコンプリ	
" 753	日立	"	Si. T	-140	-5	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-1mA	-30	30~200	-5	-1A	-5	1 A				20*	220		102	2SC1343 とコンプリ	
" 754	"	"	"	-50	-4	-2A	20W	150	-100	-20	35~200	-4	-1A									267	2SC1418 とコンプリ	
" 755	"	"	"	-50	-4	-2A	20W (T _c =25°C)	150	-100	-20	35~200	-4	-1A	-4	500				50*			268	2SC1419 とコンプリ	
" 756	"	"	"	-100	-6	-6A	50W (T _c =25°C)	150	-1mA	-30	80	-5	-1A	-5	1 A				20*	240		102	2SC1030 とコンプリ	
" 757	"	"	"	-120	-6	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-1mA	-30	25~200	-5	-1A	-5	1 A				24*	250		102	2SC897 とコンプリ	
" 758	"	"	"	-130	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-1mA	-30	25~200	-5	-1A	-5	1 A				20*	250	10*	102	2SC898 とコンプリ	
" 759	日電	RF. PA	Si. E	-60	-5	-200	150	125	-0.1	-45	180	-1	-50	-10	10				200*	8.5	20	176		
" 760	"	"	"	-50	-5	-30	150	125	-0.1	-40	350	-3	-0.5	-3	1				100*	8	20*	176		
" 761	ソニー	"	Si. EP	-110	-5	-2A	6.3 W (T _c =25°C)	120	-10	-50	100	-2	-400	-2	200				80*	55	C _c r _{bb'} 98pS	181		
" 762	"	"	"	-110	-5	-2A	1.5 W	150	-10	-50	100	-2	-400	-2	200				80*	50	C _c r _{bb'} 95pS	84C		
" 763	新日無	RF. AF. LN	"	-30	-5	-50	200	125	-50nA	-20	250	-6	-1	-6	0.3	190	21k	3.4	6.2	120*	3	C _c r _{bb'} 55pS	138	2SC949 とコンプリ
" 764	サンケン	PA	Si. EMe	-60	-6	-6A	40W (T _c =25°C)	150	-1mA	-60	80	-4	-1A	-10	500				10*	90	8*	99	2SC1444 とコンプリ	
" 765	"	"	"	-80	-6	-6A	40W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	80	-4	-1A	-10	500				10*	90	8*	99	2SC1445 とコンプリ	
" 766	松下	"	Si. Me	-150	-5	-400	20W (T _c =80°C)	150	-30	-60	60	-5	-100	-10	100				15*	100	25	99	2SC1450 とコンプリ	
" 767	東芝	RF	Si. EP	-55	-5	-100	200	150	-0.1	-30	120	-1	-10	-10	1				150*	5	20	195		
" 768	サンケン	PA	Si. EMe	-60	-6	-4 A	30W (T _c =25°C)	150	-1mA	-60	60	-4	-1A	-10	200				10*	60	12*	298	2SC1826 とコンプリ	
" 769	"	"	"	-80	-6	-4 A	30W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	60	-4	-1A	-10	200				10*	60	12*	298	2SC1827 とコンプリ	
" 770	"	"	"	-60	-6	-6 A	40W (T _c =25°C)	150	-1mA	-60	80	-4	-1A	-12	500				10*	120	30	298	2SC1985 とコンプリ	
" 771	"	"	"	-80	-6	-6 A	40W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	80	-4	-1A	-12	500				10*	120	30	298	2SC1986 とコンプリ	
" 772	ソニー	RF. PA	Si. EP	-16	-6	-2A	750	120	-0.2	-16	350	-2	-100	-2	-10				80*	50	C _c r _{bb'} 600pS	259	2SC1474 とコンプリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)							電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考	
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{FE}	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *	f _β *	C _{ob}	r _{bb'} h _{ie} (real)*			
									(μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CEB} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *										h _{FE} *
2SA773	ソニー	RF. PA	Si. EP	-60	-6	-1A	750	120	-0.2	-25	250	-2	-100	-2	10					65*	25		259	2SC1475 とコンプリ
* # 774	松下	RF. LN	Si. EP	-35	-5	-50	150	175	-0.1	-10	540	-5	-2	-5	2					120*	5	100	243	
* # 775	日立	PA	Si. T	-100	-4	-700	12.5W (T _c =25°C)	150	-10		90	-4	-50	-4	30					30*	35	25	268	
* # 776	東芝	RF. LN	Si. EP	-55	-5	-50	200	150	-0.1	-30	300	-6	-2	-6	1	285	7300	1	21	180*	3	35	195	
# 777	松下	PA	"	-80	-5	-500	750	135	-0.1	-20	160	-10	150	-10	50					120*	20	2k*	165	2SC1509 とコンプリ
# 778	日立	SW	Si. T	-150	-5	-50	200	125	-1	-100	100	-3	-15	-3	15					50*	<4		138	
# 779	"	RF. PA. SW	Si. E	-35	-5	-1.5A	10W (T _c =25°C)	150	-20	-30	60-200	-2	-500	-2	200	t _{on} =130nS, t _{off} =550nS				110*	50		234	
# 780	"	PA. SW	"	-50	-4	-1A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-30	120	-4	-50	-4	50					120*	8		234	2SC1517 とコンプリ
# 781	"	SW. RF	"	-20	-4	-200	200	125	-0.2	-16	20-200	-0.5	-30	-1	30	t _{on} <70nS, t _{off} <120nS				550*	25		138	
# 782	ローム	RF. Conv. Mix Osc. PA. AF	"	-80	-5	-30	150	125	-1	-50	150	-6	-1	-6	1		7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _c r _{bb'} 160pS	235	
# 783	"	"	"	-50	-5	-30	150	125	-1	-30	150	-6	-1	-6	1		7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _c r _{bb'} 160pS	235	
# 784	"	"	"	-25	-5	-30	150	125	-1	-15	130	-6	-1	-6	1		7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _c r _{bb'} 160pS	235	
# 785	"	"	"	-80	-5	-50	150	125	-1	-50	150	-3	-10	-5	1		6.7k	0.8	10	180*	6.5	C _c r _{bb'} 150pS	235	
# 786	"	"	"	-50	-5	-50	150	125	-1	-30	150	-3	-10	-5	1		6.7k	0.8	10	180*	6.5	C _c r _{bb'} 150pS	235	
# 787	"	"	"	-20	-5	-50	150	125	-1	-15	150	-3	-10	-6	1		6.7k	0.8	10	180*	6.5	C _c r _{bb'} 150pS	235	
# 788	"	RF. Conv. Mix Osc. PA. AF. LN	"	-50	-5	-30	150	125	-1	-30	150	-3	-10	-6	1	NF=2dB (f=1kHz)	7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _c r _{bb'} 150pS	235	
# 789	"	"	"	-25	-5	-30	150	125	-1	-15	150	-3	-10	-6	1	NF=2dB (f=1kHz)	7.1k	0.4	6.7	200*	3	C _c r _{bb'} 160pS	235	
# 790	"	RF. Conv. Mix Osc. PA	"	-40	-6	-300	300	125	-1	-24	10,000	-5	-100	-5	10					200*	3	C _c r _{bb'} 100pS	235	
# 791	"	"	"	-25	-6	-300	300	125	-1	-15	10,000	-5	-100	-5	10					200*	3	C _c r _{bb'} 100pS	235	
# 792																								
# 793	富士通	RF	Si. EP	-80	-6	-600	800	175	-1	-30	120	-2	-200	-10	10					100*	18	20*	84B	
# 794	松下	PA	"	-100	-5	-500	1.2W	150	-1	-100	160	-10	-150	-10	50					120*	20	3.5k*	222	2SC1567 とコンプリ
* # 795	"	"	"	-150	-5	-250	10W (T _c =30°C)	150	-30	-60	120	-10	-100	-10	50					120*	15	15	236	2SC1565 とコンプリ
# 796	新日無	SW	"	-30	-10	-300	300	125	-1	-20	40,000	-6	-100			t _{on} <600nS, t _{off} <1.2μS t _{sig} <600nS							138	2SC1432 とコンプリ
# 797																								
# 798	三菱	Diff. LN	Si. EP	-50	-5	-100	200 unit	125	-0.1	-35	250~ 1200	-6	1	-6	1		ΔV _{BE} <10mV h _{FE} 小/h _{FE} 大=0.8-1.0			100*	3.0		274A	2素子複合
* # 799	富士通	SW	"	-60	-5	-1.5A	1W	200	-0.5	-50	54	-1	-500			t _{on} <45nS, t _{off} <110ns t _{sig} <80nS							84C	
# 800	日電	RF	Si. E	-20	-3	-30	250	200	-0.1	-15	60	-10	-10	-10	10		S ₂₁ e ² >5dB (10V, 10mA, 1GHz)			2500*	0.9		50C	
# 801	"	"	"	-20	-3	-50	300	200	-0.4	-10	90	-10	-15	-5	15		S ₂₁ e ² =10dB (10V, 20mA, 1GHz)			4000*	1.2		130	
# 802	ローム	SW	Si. TP	-130	-5	-30	150	125	-1	-80	56-270	-3	-5	-5	2					50*	8		235	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE}	h _{ie}	h _{ie} *	h _{ie} *	h _{ie} *			h _{ie} *	f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ip(real)} * (Ω)
									(μA)	V _{CB(V)}	I _C (mA)	V _{CE(V)}	I _E (mA)	h _{FB} *											
2SA803	ローム	RF. AF	Si.EP	-130	-5	-30	150	125	-1	-80	150	-6	-1	-5	10					200*	3	C _{e PBA} 160pS	235		
" 804	"	"	"	-130	-5	-50	150	125	-1	-80	120	-3	-10	-5	10					180*	6.5	C _{e PBA} 150pS	235		
" 805	"	SW	Si.TP	-180	-5	-30	150	125	-1	-120	56~270	-3	-5	-5	2					50*	8		235		
" 806	"	"	"	-210	-5	-30	150	125	-1	-150	56~270	-3	-5	-5	2					50*	8		235		
" 807	サンケン	PA	Si.EMe	-60	-6	-6A (T _c =25°C)	150	150	-1mA	-60	60	-4	-3A	-12	500					10*	90	8*	102	2SC1618 とコンプリ	
" 808	"	"	"	-80	-6	-6A (T _c =25°C)	150	150	-1mA	-80	60	-4	-3A	-12	500					10*	90	8*	102	2SC1619 とコンプリ	
" 809	富士通	RF	Si.EP	-150	-5	-50	700	175	-1	-140	150	-5	-10	-5	10	t _{on} <1μS t _{off} <10μS t ₁₀ <9.5μS			100*	3	70*	248			
" 810	"	"	"	-150	-5	-50	700	175	-1	-140	150	-5	-10	-5	10	t _{on} <1μS t _{off} <10μS t ₁₀ <9.5μS			100*	3	70*	248			
" 811	日電	RF. AF	Si.E	-50	-5	-30	150	125	-0.05	-40	400	-3	-0.5	-3	1		9200	2.7	33	100*	8	20*	176		
" 812	"	"	"	-60	-5	-100	150	125	-0.1	-60	200	-6	-1	-6	10		5500	7.5	28	180*	4.5	C _{e PBA} 35pS	176	2SC1623 とコンプリ	
" 813	"	RF. PA	"	-60	-5	-200	150	125	-0.1	-45	80	-1	-50	-10	10					200*	8.5	20	176		
" 814	東芝	PA	Si.Eb Me	-120	-5	-1A (T _c =25°C)	150	150	-1	-50	70~240	-5	-150	-5	150					30*	30		268	2SC1624 とコンプリ	
" 815	"	"	"	-100	-5	-1A (T _c =25°C)	150	150	-1	-50	70~240	-5	-150	-5	150					30*	30		268	2SC1625 とコンプリ	
" 816	"	"	Si. E	-80	-5	-750 (T _c =25°C)	150	150	-0.5	-30	70~240	-2	-150	-2	150					100*	20		268	2SC1626 とコンプリ	
" 817	"	"	"	-80	-5	-300	600	150	-0.1	-50	70~240	-2	-50	-10	10					100*	14		138	2SC1627 とコンプリ	
" 818	"	"	Si. T	-180	-5	-50	1 W	150	-1	-100	70~240	-5	-10	-10	10					120*	< 5		249	2SC1628 とコンプリ	
" 819																									
" 820	ローム	SW	Si.TP	-180	-5	-30	250	125	-1	-120	56~270	-3	-5	-5	2					50*	8		138		
" 821	"	"	"	-210	-5	-30	250	125	-1	-150	56~270	-3	-5	-5	2					50*	8		138		
" 822	"	RF. AF	Si.EP	-80	-5	-30	250	125	-1	-80	120	-6	-1	-5	10					200*	3	C _{e PBA} 160pS	138		
" 823	"	"	"	-50	-5	-30	250	125	-1	-30	180	-6	-1	-5	10					200*	3	C _{e PBA} 160pS	138		
" 824	"	"	"	-25	-5	-30	250	125	-1	-15	220	-6	-1	-5	10					200*	3	C _{e PBA} 160pS	138		
" 825	"	AF.RF.Osc.SW	"	-80	-5	-50	250	125	-1	-50	82~390	-3	-10	-5	10					180*	6.5		138		
" 826	"	"	"	-50	-5	-50	250	125	-1	-30	82~390	-3	-10	-5	10					180*	6.5		138		
" 827	"	RF. AF	"	-25	-5	-50	250	125	-1	-15	150	-3	-10	-5	10					180*	6.5	C _{e PBA} 150pS	138		
" 828	"	RF. LN	"	-50	-5	-30	250	125	-1	-30	180	-3	-10	-5	10	NF=2 dB (-5V, -0.1mA, f=1kHz)			180*	6.5	C _{e PBA} 150pS	138			
" 829	"	"	"	-25	-5	-30	250	125	-1	-15	220	-3	-10	-5	10	NF=2 dB (-5V, -0.1mA, f=1kHz)			180*	6.5	C _{e PBA} 150pS	138			
" 830	"	AF	"	-40	-6	-300	300	125	-1	-24	>1000	-5	-100	-5	10					200*	3		138	ターリントン	
" 831	"	"	"	-25	-6	-300	300	125	-1	-15	>1000	-5	-100	-5	10					200*	3		138	ターリントン	
" 832	"	SW	Si.TP	-130	-5	-30	250	125	-1	-80	56~270	-3	-5	-5	2					50*	8		138		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考		
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe} h_{fe}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μS)	f_{β} f_T^* (Mc)			C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ic}(\text{real})^*$ (Ω)
									(μA)	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$									
2SA893	日立	RF.AF	Si.E	-90	-5	-50	300	125	-0.5	-75	250~800	-12	-2	-12	2	$NF=2\text{dB}$ (1kHz, 6V, 50 μA)	120*	1.8		138	2SC1890 とコンプリ		
" 894	新日無	RF	Si.EP	-30	-6	-1A	600	125	-0.5	-20	200	-1	-100	-10	50		150*	25	$C_c r_{bb'}$ 100pS	138			
" 895	"	"	"	-30	-4	-30	200	125	-0.5	-20	100	-6	-1	-10	2		500*	1	$C_c r_{bb'}$ 8 pS	138			
" 896	ソニー	"	Si.E	-200	-5	-100	750	120	-0.2	-100	150	-5	-3	-10	10		70*	3	$C_c r_{bb'}$ 50pS	259	2SC1811 とコンプリ		
" 897	"	"	"	-60	-6	-2A	950	120	-0.2	-25	250	-2	-100	-2	10		55*	25	$C_c r_{bb'}$ 350pS	174B			
" 898	富士通	AF.RF	Si.EP	-150	-5	-50	1 W	175	-1	-140	150	-5	-50	-5	10		100*	3	70*	328			
" 899	"	"	"	-150	-5	-50	1 W	175	-1	-140	150	-5	-50	-5	10		100*	3	70*	328			
" 900	松下	PA	"	-20	-5	-1A	1.2W	150	-1	-10	200	-2	-500	-6	50		200*	40	3.5k*	222	2SC1568 とコンプリ		
* " 901	三菱	AF.RF	"	-40	-5	-100	200	125	-0.1	-35	250~1200	-6	-1	-6	1		100*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 50 pS	138B			
" 902																							
" 903																							
" 904	三菱	AF.RF	Si.EP	-90	-5	-50	200	125	-0.1	-50	250~1200	-6	-1	-6	1		150*	2.5		138B			
" 905	"	"	"	-120	-5	-50	800	135	-1	-100	150~800	-10	-10	-10	10		200*	3		242	2SC1915 とコンプリ		
" 906	"	LN	Si.E	-40	-5	-100	200	125	-0.1	-35	250~1200	-6	-1	-6	1	$V_{\lambda O} < 200\text{mV}$ ($-10\text{V}, -1\text{mA}, R_c = 100\text{k}\Omega, G_r = 80\text{dB}$)	100*	3.5	40	138B			
" 907	サンケン	PA	Si.EMe	-100	-6	-15A	150W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	150	-1 mA	-100	80	-4	-5 A	-12	500		10*	270	10*	102	2SC1584 とコンプリ		
" 908	"	"	"	-150	-6	-15A	150W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	150	-1 mA	-150	80	-4	-5 A	-12	500		10*	270	10*	102	2SC1585 とコンプリ		
" 909	"	"	"	-200	-6	-15A	150W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	150	-1 mA	-200	80	-4	-5 A	-12	500		10	270	10*	102	2SC1586 とコンプリ		
" 910																							
" 911	ソニー	RF	Si.E	-850	-12	-100	470	120	-1.5	-100	50	-5	-10	-10	10	$t_{\beta} = 650\text{nS}, t_{\alpha} = 500\text{nS}$ $t_r = 500\text{nS}, t_f = 850\text{nS}$	9*	8	$C_c r_{bb'}$ 70pS	181	2SC1762 とコンプリ		
* " 912	松下	PA	Si.EP	-150	-5	-50	750	135	-1	-100	200	-5	-10	-10	10		200*	3	6 k*	165			
" 913	"	RF	"	-150	-5	-1 A	15W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	150	-10	-150	150	-10	-150	-10	50		120*	30	3 k*	268			
" 914	"	"	"	-150	-5	-50	1 W	150	-1	-100	150	-5	-10	-10	10		200*	3	3.5k*	222			
" 915	日電	AF	Si.E	-120	-5	-50	1 W	150	-0.1	-120	200	-10	-10	-10	10		80*	2.5		278	2SC1940 とコンプリ		
" 916	"	"	"	-160	-5	-50	1 W	150	-0.1	-160	200	-10	-10	-10	10		80*	2.5		278	2SC1941 とコンプリ		
" 917	ソニー	RF	"	-120	-5	-100	750	120	-0.2	-100	150	-5	-3	-10	10		70*	3	$C_c r_{bb'}$ 50 pS	259	2SC1951 とコンプリ		
" 918	富士通	"	Si.EP	-40	-20	-300	300	150	-0.1	-10	60	-10	-10	-10	10		200*	4.5	50*	275			
" 919	ソニー	SW	Si.T	-850	-12	-100	950	120	-10	-650	50	-5	-10	-10	10	$t_{\alpha} < 1 \mu\text{S}, t_{\beta} < 1.5 \mu\text{S}$ $t_{\alpha} < 5.5 \mu\text{S}$	9*	8	$C_c r_{bb'}$ 70pS	174B			
" 920	"	RF	Si.E	-200	-8	-500	950	120	-0.2	-200	120	-2	-100	-10	100		40*	25	$C_c r_{bb'}$ 46pS	174			
" 921	松下	"	Si.EP	-120	-5	-20	150	125	-0.1	-50	600	-5	-2	-30	1		200*	3	70	138			
" 922	ソニー	"	Si.E	-80	-6	-1A	625	150	-0.1	-50	150	-2	-100	-10	10		120*	10	$C_c r_{bb'}$ 150pS	181			

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考						
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{fe} *	h _{ie} (Ω)	h _{ie} * (×10 ⁻⁴)			h _{oe} (μS)	f _{αβ} (Mc)	C _{ob} (pF)	T _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)		
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)												
2SA923	ソニー	RF	Si.E	-20*	-5	-200	625	150	-0.2	-100	150	-5	-3												181	2SC805A とコンパリ
" 924	日立	RF.AF	"	-30	-5	-100	500	150	-0.5	-24	100~320	-12	-2												138D	
" 925	ソニー	RF	Si.EPa	-30	-5	-30	250	120	-0.2	-30	200	-3	-1	-6	2				450*	3		C _c T _{bb'} 65pS		138	2SC1908 とコンパリ	
" 926																										
" 927	富士通	RF.AF	Si.EP	-60	-6	-250	500	150	-0.5	-40	140	-1	-10	-10	10				290*	5.5	70*			138		
" 928	ソニー	RF	Si.E	-20	-5	-1A	250	120	-0.2	-20	150	-2	-100								18	10*		138		
" 929	三洋	AF.LN	Si.EP	-55	-5	-50	200	125	-0.1	-30	160~960	-6	-1	-6	1	V _{CE} < 35mV (30V, 1mA, R _C = 56kΩ, A _v = 77dB)		80*	5				138			
" 930	"	"	"	-40	-5	-50	200	125	-0.1	-30	160~960	-6	-1	-6	1	V _{CE} < 35mV (30V, 1mA, R _C = 56kΩ, A _v = 77dB)		80*	5				138			
" 931	富士通	RF	"	-150	-5	-50	450	175	-1	-140	150	-5	-10					100*	5	70*			244			
" 932	"	"	"	-150	-5	-50	450	175	-1	-140	150	-5	-10					100*	5	70*			244			
" 933	ローム	AF.RF Osc.SW	"	-50	-5	-100	300	125	-0.5	-30	82~390	-6	-1	-12	2				140*	4				138	2SC2021 とコンパリ	
" 934	"	AF	"	-40	-5	-700	750	125	-0.5	-20	82~390	-3	-100	-5	50				150*	20				334	2SC2060 とコンパリ	
" 935	"	"	"	-80	-5	-700	750	125	-0.5	-50	82~390	-3	-100	-10	50				100*	14				334		
" 936	"	"	"	-40	-10	-300	300	125	-1	-30	>10000	-5	-10	-5	10				200*	4				138	ダーリントン	
" 937	"	AF.RF Osc.SW	"	-50	-5	-100	300	125	-0.5	-30	82~390	-6	-1	-12	2				140*	4				235	2SC1740 とコンパリ	
" 938	ソニー	RF.AF.SW	Si.PaMe	-50	-5	-500	500	120	-0.2	-50	150	-2	-100	-10	10	t _r < 100nS, t _f < 150nS t _{sig} < 400nS			h _{ie} = 10 (f _{ie} = 10MHz)	11	C _c T _{bb'} 120pS		138			
" 939	富士通	RF.AF	Si.EP	-250	-5	-50	1W	150	-1	-200	150	-5	-10	-5	10				100*	3	70*			328		
" 940	東芝	PA	Si.T	-150	-5	-1.5A	25W (T _c = 25°C)	150	-10	-120	75	-10	-500	-10	500				4*	55				268	2SC2073 とコンパリ	
" 941	"	LN	Si.E	-120	-5	-50	300	125	-0.1	-120	200~700	-6	-2	-6	1	NF = 1 dB (-6V, 0.1mA, 10Hz)		150*	2.8				138	2SC2088 とコンパリ		
" 942	"	"	"	-90	-5	-50	300	125	-0.1	-90	200~700	-6	-2	-6	1	NF < 6 dB (-6V, 0.1mA, 100Hz)		150*	2.8				138	2SC2089 とコンパリ		
" 943																										
" 944																										
" 945																										
" 946																										
" 947																										
" 948																										
" 949	東芝	AF.SW	Si.T	-150	-5	-50	800	150	-0.1	-150	70~240	-5	-10	-30	10				120*	4				241		
" 950	"	PA	Si.EP	-30	-5	-800	600	150	-0.1	-35	100~320	-1	-100	-5	10				120*	19				138	2SC2120 とコンパリ	
" 951	ソニー	"	Si.EPa	-140	-8	-500	950	120	-0.2	-100	150	-2	-100	-10	20				45*	30				174B		
" 952	日電	AF.PA	Si.E	-30	-5	-700	600	150	-0.1	-30	200	-1	-100	-6	10				160*	17				138	2SC2001 とコンパリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)	
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *
2SA953	日電	AF.PA	Si.E	-60	-5	-300	600	150	-0.1	-60	200	-1	-50	-6	10					100*	13		138	2SC2002 とコンプリ
" 954	"	"	"	-80	-5	-300	600	150	-0.1	-80	200	-1	-50	-6	10					100*	13		138	2SC2003 とコンプリ
" 955																								
" 956	日電	RF.AF.SW	Si.E	-60	-8	-100	150	125	-0.1	-40	160	-1	-10	-10	10	t _{on} = 100nS, t _{off} = 270nS t _{stg} = 200nS			280*	7.5		176		
" 957	サンケン	PA	Si.EMe	-150	-6	-2A	30W (T _c =25°C)	150	-100	-150	100	-10	-0.7A	-12	200					20*	35	35	298	
" 958	"	"	"	-200	-6	-2A	30W (T _c =25°C)	150	-100	-200	100	-10	-0.7A	-12	200					20*	35	35	298	
" 959	日電	SW	Si.E	-100	-7	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-100	30~200	-5	-5A			t _{on} < 1 μS, t _f < 0.3 μS t _{stg} < 1.5 μS						102		
" 960																								
" 961																								
" 962	東芝	PA	Si.E	-60	-5	-1.5A	1W	150	-1	-50	70~240	-2	-150	-10	100					100*	30		249	2SC2194 とコンプリ
" 963	松下	"	Si.EP	-50	-5	-1.5A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-20	120	-5	-1A	-5	500					150*	45	3.3k*	236	
* " 964	日電	"	Si.E	-200	-5	-200	10W (T _c =25°C)	150	-1	-180	180	-10	-10	-10	10					100*	3	16*	167C	
" 965	東芝	AF	"	-120	-5	-800	900	150	-0.1	-120	80~240	-5	-100	-5	100					120*	<40	40	241	2SC2235 とコンプリ
" 966	"	PA	"	-30	-5	-1.5A	900	150	-0.1	-30	100~320	-2	-500	-2	500					120*	<30		241	2SC2236 とコンプリ
" 967																								
" 968	東芝	PA	Si.E	-160	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-160	70~240	-5	-100	-10	100					100*	30		268	2SC2238 とコンプリ
" 969	"	"	"	-160	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-160	70~240	-5	-100	-10	100					100*	30		99	2SC2239 とコンプリ
" 970	"	AF.LN	"	-120	-5	-100	300	125	-0.1	-120	200~700	-6	-1	-6	1	NF < 6 dB (f=10Hz, 6V, 100μA) NF < 2 dB (f=1kHz)				100*	4		138	
" 971	サンケン	PA	Si.EMe	-150	-6	-15A	150W (T _c =25°C)	150	-100	-150	60	-4	-5A	-12	500					10*	270	18*	102	
* " 972	松下	AF	Si.EP	-30	-7	-100	250	135	-1	-10	250	-10	-2	-10	2					150*	5.5		138	
" 973	"	RF	"	-60	-5	-50	250	125	-0.1	-30	500	-5	-2	-10	1					70*	15	9.5k*	138	
" 974																								
" 975																								
" 976																								
* " 977	松下	PA	Si.EP	-180	-5	-50	1W	150	-1	-100	180	-5	-10	-10	10					80*	3.5	50	222	
" 978	三菱	AF.LN.RF	"	-40	-5	-100	200	125	-0.1	-35	150~1200	-6	-1	-6	10	V _{NO} < 300mV (10V, 1mA, R _G = 100kΩ, A _c = 80dB)				125*	13	13	138B	
" 979	"	LN.Diff	"	-100	-5	-50	200/unit	125	-0.1	-70	250~1200	-6	-1	-6	1	ΔV _{BE} < 10mV h _{FE1} /h _{FE2} = 0.8~1.0				150*	2.5		274A	2素子複合
" 980	サンケン	PA	Si.TMe	-100	-6	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-100	>30	-4	-3A	-12	500					20*			102	2SC2260 とコンプリ
" 981	"	"	"	-120	-6	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-120	>30	-4	-3A	-12	500					20*			102	2SC2261 とコンプリ
" 982	"	"	"	-140	-6	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-140	>30	-4	-3A	-12	500					20*			102	2SC2262 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考				
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}					バイアス									
									(μA)	V _{CEB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE}	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *			f _T *	C _{ob}	r _{bb} *	
2SA983	日電	RF	Si.E	-30	-4	-20	200	125	-0.1	-25	40~200	-10	-3	-10	3	G _{pe} > 14dB, NF = 4.5dB (12V, 3mA, 900MHz)				1000*	0.5	210A	フォワード AGC		
" 984	三洋	AF	Si.EP	-60	-5	-500	500	150	-1	-40	60~320	-5	-50	-10	10					120*	9	138	2SC2274 とコンプリ		
" 985	日電	PA	Si.E	-120	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-120	150	-5	-300	-5	200					180*	29	268	2SC2275 とコンプリ		
" 986	"	"	"	-130	-4.5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-50	-120	150	-5	-1A	-5	1A					60*	250	10	295		
" 987	"	AF	"	-40	-5	-100	500	125	-0.05	-40	400	-6	-1	-6	1					90*	<10	138			
" 988	"	"	"	-120	-5	-50	500	125	-0.05	-120	500	-6	-1	-6	1					100*	2	138			
" 989	"	"	"	-60		-100	250	125	-1	-60	200	-6	-1	-6	10					180*	4.5	12	138		
" 990	"	LN	"	-60	-5	-100	250	125	-0.1	-60	400	-6	-1	-6	1	NV = 25mV (5V, 1mA, G _r = 80dB, FLAT)				180*	4.5	13	138		
" 991	"	AF.LN	"	-60	-5	-100	500	125	-0.05	-60	400	-6	-1	-6	1	V _{no} < 45mV (5V, 1mA, R _c = 100kΩ, A _v = 80dB)				90*	5.5	138	2SC1844 とコンプリ		
" 992	"	"	"	-120	-5	-50	500	125	-0.05	-120	500	-6	-1	-6	1	V _{no} < 40mV (5V, 1mA, R _c = 100kΩ, A _v = 80dB)				100*	2	138	2SC1845 とコンプリ		
* " 993	日立	RF.AF	"	-50	-5	-500	625	150	-0.1	-50	60~320	-3	-150	-3	10					120*	8	138D	2SC2277 とコンプリ		
* " 994	三菱	AF	Si.EP	-40	-5	-300	500	125	-0.1	-35	150~1200	-6	-1	-6	1					125*	13	C _{FB} 25pS	138B	274D	2素子複合
" 995	"	定電流回路	"	-100	-5	-100	200/unit	125	-0.1	-100	500	-6	-1	-6	1	h _{FE1} /h _{FE2} = 0.5 ~ 1.0 ΔV _{BE} < 10mV				100*	3				
" 996																									
* " 997	富士通	RF	Si.EP	-20	-5	-1A	500	150	-0.5	-15	200	-5	-10	-5	10					150*	10	15*	138		
* " 998	"	"	"	-50	-5	-1A	500	150	-0.5	-40	200	-5	-10	-5	10					150*	10	15*	138		
" 999	三菱	AF	Si.E	-50	-6	-200	300	125	-0.1	-50	90~500	-6	-1	-6	10	NF < 20dB (6V, 0.3mA, 100Hz)				200*	7	138			
* " 1000	"	"	"																						
* " 1001	富士通	PA	Si.EP	-130	-4.5	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-50	-130	100	-5	-500	-10	1A					40*	350		102		
* " 1002	"	"	"	-120	-4.5	-12A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-120	100	-5	-500	-10	1A					40*	450		102		
* " 1003	"	"	"	-150	-4.5	-12A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-150	100	-5	-500	-10	1A					40*	450		102		
* " 1004	日立	RF.AF	Si.E	-40	-5	-100	310	150	-0.1	-18	160~800	-12	-2	-12	2					200*	1.8		138D		
" 1005	日電	RF	"	-40	-5	-30	250	125	-0.1	-40	90	-10	-1	-10	1	NF = 3.5dB (-10V, -1mA, f = 1MHz)				400*	1.1	C _{FB} < 20pS	138		
" 1006	"	PA	"	-180	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-150	120	-5	-150	-10	100					80*	45	10*	268		
* " 1007	"	PA.SW	"	-150	-4.5	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-50	-150	150	-5	-1A	-5	200	t _{on} = 0.2μs, t _{off} = 1μs				50*	250		102	2SC2337 とコンプリ	
" 1008	"	SW	"	-100	-7	-2A	15W (T _c =25°C)	150	-10	-100	40~200	-5	-1A			t _{on} < 0.5μs, t _f < 0.5μs t _{stg} < 1.5μs							268	2SC2331 とコンプリ	
" 1009	"	"	Si.T	-350	-7	-2A	15W (T _c =25°C)	150	-10	-350	80	-5	-100			t _{on} < 1μs, t _f < 1μs t _{stg} < 2.5μs							268		
" 1010	"	"	Si.E	-100	-7	-7A	40W (T _c =25°C)	150	-10	-100	40~200	-5	-3A			t _{on} < 0.5μs, t _f < 0.5μs t _{stg} < 1.5μs							268	2SC2334 とコンプリ	
" 1011	三洋	PA	Si.EP	-180	-6	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-10	-120	60~200	-5	-300	-10	50					100*	30		268	2SC2344 とコンプリ	
" 1012	東芝	SW	Si.E	-60	-5	-5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-50	70~240	-1	-1A	-4	1A	t _{on} = 0.1μs, t _f = 0.1μs t _{stg} = 1μs				60*	170		268	2SC2562 とコンプリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考			
				V _{CEO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値 (μA)	V _{CEB} (V)	直流又はパルス V _{CE} (V)	I _C (mA)	バイアス V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE}	h _{je}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)			h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αβ} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)
2SA1043	富士通	SW	Si.EP	-120	-5	-30A	150W (T _c =25°C)	175	-50	-120	100	-5	-3A	-10	2A				60*	1000		299	2SC2433 とコンプリ
" 1044	"	"	"	-70	-5	-30A	150W (T _c =25°C)	175	-50	-70	100	-5	-3A	-10	2A				60*	1000		299	2SC2434 とコンプリ
" 1045	"	"	"	-100	-5	-10A	100W (T _c =25°C)	175	-50	-100	3000	-3	-2A									102	4-端子 2SC2435 とコンプリ
" 1046	"	"	"	-100	-5	-15A	100W (T _c =25°C)	175	-50	-100	3000	-3	-3A									102	4-端子 2SC2436 とコンプリ
" 1047	三洋	PA	"	-180	-5	-80	1W	150	-1	-120	60~320	-5	-10	-10	10				130*	3.2		296	2SC2441 とコンプリ
" 1048	東芝	AF	Si.E	-50	-5	-150	200	125	-0.1	-50	70~400	-6	-2	-10	1	NF=1dB (-6V, 0.1mA, 1kHz)			>80*	4		287	2SC2458 とコンプリ
" 1049	"	"	"	-120	-5	-100	200	125	-0.1	-120	200~700	-6	-2	-6	1	NF=1dB (-6V, 0.1mA, 1kHz)			100*	4		287	2SC2459 とコンプリ
" 1050	"	PA	"	-140	-5	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-10	-140	55~240	-5	-1A	-10	1A				70*	220	2*	102	2SC2460 とコンプリ
" 1051	"	"	"	-150	-5	-15A	150W (T _c =25°C)	150	-10	-150	55~240	-5	-1A	-10	1A				60*	350	2*	102	2SC2461 とコンプリ
" 1052	日立	AF	"	-30	-5	-100	150	125	-0.5	-20	100~500	-12	-2	-12	2				280*	3.3		176	
" 1053	日電	SW	"	-40	-5	-200	600	150	-0.1	-30	150	-1	-10									138D	
" 1054	"	"	"	-60	-5	-600	600	150	-0.02	-50	200	-10	-150									138D	
" 1055	"	"	"	-25	-4	-200	600	150	-0.05	-20	150	-1	-2									138D	
" 1056	"	"	"	-40	-5	-600	600	150	-0.1	-35	150	-2	-150									138D	
" 1057																							
" 1058																							
" 1059	日電	SW, Diff	Si.E	-20	-3	-30	250/unit. (T _c =25°C)	200	-0.1	-15	60	-10	-10			t _{on} <10nS t _{off} <10nS	h _{FE1} /h _{FE2} =0.6~1.0 ΔV _{BE} <20mV					307B	2素子複合
" 1060	松下	PA	Si.EP	-80	-5	-5A	60W (T _c =25°C)	150	-50	-80	90	-5	-1A	-5	500				20*	170	10	152	
" 1061	"	"	"	-100	-5	-6A	70W (T _c =25°C)	150	-50	-100	90	-5	-1A	-5	500				20*	240	10	152	
" 1062	"	"	"	-120	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-50	-120	90	-5	-1A	-5	500				20*	290	10	152	
" 1063	"	"	"	-150	-5	-6A	80W (T _c =25°C)	150			40~280	-5	-2A	-10	500				50*			102	2SC2487 とコンプリ
" 1064	"	"	"	-150	-5	-8A	100W (T _c =25°C)	150			40~280	-5	-2A	-10	500				50*			102	2SC2488 とコンプリ
" 1065	"	"	"	-150	-5	-10A	120W (T _c =25°C)	150			40~280	-5	-2A	-10	500				50*			102	2SC2489 とコンプリ
" 1066	ソニー	LN	Si.EPa	-70	-5	-200	500	120	-0.1	-50	95~420	-3	-10	-10	10				120*	13		138	2SC2014 とコンプリ
" 1067	サンケン	PA	Si.EP	-120	-5	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-120	60	-4	-3A	-12	500				50*	140	40	102	
" 1068	"	"	"	-150	-5	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-150	60	-4	-3A	-12	500				50*	140	40	102	
" 1069	日電	SW	Si.E	-80	-12	-5A	30W (T _c =25°C)	150	-10	-60	40~200	-5	-3A			t _{on} <0.5μS t _{off} <1.5μS						268	2SC2516 とコンプリ
" 1070																							
" 1071																							
" 1072	富士通	PA	Si.P	-120	-5	-12A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-120	110	-5	-1A	-10	1A				60*	300	1.5*	102	2SC2522 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考			
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}			バイアス		h_{fe} h_{fe}^*	h_{ie} h_{ie}^* (Ω)	h_{re} h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe}^* (μU)			$f_{\beta 0}$ $f_{\beta 0}^*$ (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} $r_{bb}(\text{real})^*$ (Ω)
									I_{CB1}	$V_{CB(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$											
2SA1073	富士通	PA	Si.P	-160	-5	-12A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-160	110	-5	-1A	-10	1A					60*	300	1.5*	102	2SC2523 とコンパリ
" 1074																								
" 1075	富士通	PA	Si.P	-120	-5	-12A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-120	110	-5	-1A						60*				163	2SC2525 とコンパリ
" 1076	"	"	"	-160	-5	-12A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-160	110	-5	-1A						60*				163	2SC2526 とコンパリ
" 1077	"	"	"	-120	-5	-10A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-120	110	-5	-1A	-10	1A				60*	300	1.5*	268	2SC2527 とコンパリ	
" 1078	"	"	"	-120	-5	-2A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1	-120	120	-5	-300	-10	500				140*	100	12*	268	2SC2528 とコンパリ	
" 1079	"	"	"	-160	-5	-2A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1	-160	120	-5	-300	-10	500				140*	100	12*	268	2SC2529 とコンパリ	
" 1080	"	"	"	-40	-7	-500	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-0.1	-40	150	-5	-10	-10	10				30*	65	15*	268	2SC2530 とコンパリ	
" 1081	日立	AF	Si.E	-90	-5	-100	400	125	-0.1	-50	250~800	-12	-2	-12	2				90*	3.5			138	2SC2543 とコンパリ
" 1082	"	"	"	-120	-5	-100	400	125	-0.1	-50	250~800	-12	-2	-12	2				90*	3.5			138	2SC2544 とコンパリ
" 1083	"	AF.LN	"	-60	-5	-100	400	125	-0.1	-50	250~800	-12	-2	-12	2	$c_n = 0.5\text{nV}$ (6V, 10mA, 1kHz)			90*	3.5			138	2SC2545 とコンパリ
" 1084	"	"	"	-90	-5	-100	400	125	-0.1	-50	250~800	-12	-2	-12	2	"			90*	3.5			138	2SC2546 とコンパリ
" 1085	"	"	"	-120	-5	-100	400	125	-0.1	-50	250~800	-12	-2	-12	2	"			90*	3.5			138	2SC2547 とコンパリ
" 1086																								
" 1087																								
" 1088																								
" 1089																								
" 1090	東芝	RF.SW	Si.E	-60	-8	-200	300	175	-0.1	-60	70~400	-1	-10	-10	10	$t_{on} = 30\text{nS}$, $t_f = 30\text{nS}$ $t_{off} = 400\text{nS}$			250*	4	30	49C	2SC2550 とコンパリ	
" 1091	"	RF	Si.T	-300	-8	-100	400	150	-0.1	-300	90	-10	-20	-10	20				70*	6	15		138	
" 1092	松下	"	Si.EP	-60	-5	-50	250	125	-0.1	-30	450	-5	-2	-5	20				220*	8	5		138	
" 1093	東芝	PA	Si.E	-120	-5	-8A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-120	120	-5	-1A	-10	1A				90*	150	2*		179	
" 1094	"	"	"	-140	-5	-12A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-140	55~240	-5	-1A	-10	1A				70*	220	2*		125	2SC2564 とコンパリ
" 1095	"	"	"	-160	-5	-15A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-160	55~240	-5	-1A	-10	1A				60*	350	2*		125	2SC2565 とコンパリ
" 1096	松下	RF	Si.EP	-70	-5	-2A	1.2W	150	-1	-20	120	-5	-1A	-5	500				150*	55	110		222	
" 1097																								
" 1098																								
" 1099																								
" 1100	三菱	AF.RF	Si.E	-50	-6	-200	300	125	-0.1	-50	90~500	-6	-1	-6	10	$NF < 20\text{dB}$ ($f = 100\text{Hz}$, 6V, 0.3mA)			200*	7			138B	
" 1101																								
" 1102	サンケン	PA	Si.EP	-80	-6	-6A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	80	-4	-2A	-12	500				20*	150	15		324	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考				
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}			バイアス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μM)			$f_{\alpha b}$ f_{T}^* (Mc)	C_{ob} f_{T}^* (pF)	$R_{bb'}$ $h_{ib}(\text{real})^*$ (Ω)	
									μA	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE}(V)$	$I_E(\text{mA})$	$V_{CE}(V)$	$I_E(\text{mA})$										
2SA1133	松下	PA	Si.EP	-200	-6	-2A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-200	60~200	-10	-400									268	2SC2660 とコンプリ		
"	1134																								
"	1135	サンケン	PA	Si.EMe	-80	-6	-4A	55W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-80	90	-4	-1A	-10	200					10*	100	14	324	
"	1136	ローム	RF.LN	Si.EP	-120	-5	-100	300	125	-0.5	-100	270	-6	-2	-6	2	$NF=0.2\text{dB}$ (-6V, -0.1mA, 100Hz)			90*	4	C_c $r_{bb'}$ 150pS	138		
"	1137	"	"	"	-80	-5	-100	300	125	-0.5	-75	270	-6	-2	-6	2	$NF=0.2\text{dB}$ (-6V, -0.1mA, 100Hz)			90*	4	C_c $r_{bb'}$ 150pS	138		
"	1138	日電	RF.LN	Si.E	-80		-10	500	125	-0.1	-70	400	-6	-1	-6	1	$NF=1.5\text{dB}$ (6V, 1mA, 1kHz)			180*	1.4	C_c $r_{bb'}$ 92pS	278		
"	1139																								
"	1140																								
"	1141	日電	PA	Si.T	-115	-5	-10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-80	140	-2	-1A	-2	1A					90*	390		162	2SC2681 とコンプリ
"	1142	"	"	Si.E	-180	-5	-100	8W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1	-180	200	-5	-10	-10	20					160*	5.8	27*	225	
"	1143																								
"	1144	東芝	RF	Si.E	-150	-5	-50	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-0.1	-150	150	-5	-10	-10	10					200*	2.5	50	342	
"	1145	"	"	"	-150	-5	-50	800	150	-0.1	-150	160	-5	-10	-10	10					200*	2.5	70*	241	
"	1146	"	PA	"	-140	-5	-10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-140	120	-5	-1A	-10	1A					70*	220	2*	179	
"	1147	"	"	"	-180	-5	-15A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-160	120	-5	-1A	-10	1A					60*	350	2*	102	
"	1148																								
"	1149																								
"	1150	東芝	AF	Si.E	-35	-5	-800	300	125	-0.1	-30	100~320	-1	-100	-5	10					120*	19		287	2SC2710 とコンプリ
"	1151	日電	"	"	-60	-5	-100	250	125	-0.1	-60	200	-6	-1	-6	10	$NF=6\text{dB}$ (-6V, -0.3mA, $f=100\text{Hz}$)			180*	4.5		138	2SC2718 とコンプリ	
"	1152	"	RF.SW	"	-80	-5	-300	600	150	-0.1	-80	200	-1	-50	-6	10	$t_{on}=50\text{nS}$, $t_{off}=450\text{nS}$ $t_{stg}=400\text{nS}$			100*	13		138	2SC2719 とコンプリ	
"	1153	"	"	"	-60	-5	-500	600	150	-0.1	-40	140	-2	-150	-10	20	$t_{on}<35\text{nS}$, $t_{off}<255\text{nS}$ $t_{stg}<225\text{nS}$			400*	5		138D	2SC2720 とコンプリ	
"	1154	"	"	"	-60	-5	-700	1W	150	-0.1	-60	200	-1	-100	-6	10	$t_{on}=65\text{nS}$, $t_{off}=540\text{nS}$ $t_{stg}=490\text{nS}$			120*	25		278	2SC2721 とコンプリ	
"	1155	三菱	Diff.	"	-100	-5	-100	200/unit.	125	-0.1	-100	600	-6	-1	-6	1	$h_{FE1}/h_{FE2}=0.8\sim 1.0$ $dV_{BE}<10\text{mV}$			100*	3		283	2素子複合	
"	1156	日電	SW	Si.T	-400	-7	-500	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-400	80	-5	-100			$t_{on}<1\mu\text{S}$, $t_f<1\mu\text{S}$ $t_{stg}<4\mu\text{S}$						225		
"	1157																								
"	1158	東芝	RF.AF	Si.E	-80	-5	-100	400	125	-0.1	-80	400	-6	-2	-10	2					200*	3	30	138	
"	1159																								
"	1160	東芝	RF	Si.E	-20	-6	-2A	900	150	-10	-20	240	-1	-500	-1	500					150*	60	11	241	
"	1161	"	"	Si.EP	-15	-2	-30	200	125	-0.1	-5	50	-5	-10	-5	10	$NF=3.5\text{dB}$ (-5V, -3mA, 1GHz)			3500*	0.95	55*	138C		
"	1162	"	AF	Si.E	-50	-5	-150	150	125	-0.1	-50	250	-6	-2	-10	1					150*	4	30	176	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)			f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)
									I _{CB0} (μA)	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(MA)}	V _{CB(V)}	I _{E(MA)}									
2SA1193	日立	SW	Si.E	-60	-7	-500	900	125	-1	-60	3000	-3	-250							251	ターリントン		
" 1194	"	"	"	-60	-7	-1A	8 W (T _c =25°C)	150	-1	-60	5000	-3	-500							170	ターリントン		
" 1195	東芝	RF	"	-160	-6	-1.5A	15W (T _c =25°C)	175	-1	-150	160	-5	-200				50*	27	10	168			
" 1196	日立	SW	Si.T	-400	-5	-100	10W (T _c =25°C)	150	-1	-350	120	-20	-20							245			
" 1197	"	"	Si.E	-60	-7	-1A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-60	3000	-3	-500							245			
" 1198	ローム	RF.AF	Si.EP	-80	-5	-50	400	125	-0.5	-75	390	-6	-2	-12	2			140*	3.5	C _{crs1} 130pS	138		
" 1199	"	"	"	-50	-5	-700	400	125	-0.5	-30	270	-6	-10	-6	10			100*	12	C _{crs1} 200pS	138		
" 1200	東芝	"	Si.T	-150	-5	-50	500	150	-0.1	-150	110	-5	-10	-5	10			120*	4	10	212		
" 1201	"	"	Si.E	-120	-5	-800	500	150	-0.1	-120	140	-5	-100	-5	100			100*	27	3*	212		
" 1202	"	"	"	-80	-5	-400	500	150	-0.1	-80	140	-2	-50	-2	50			100*	9	5	212		
" 1203	"	"	"	-30	-5	-1.5A	500	150	-0.1	-30	180	-2	-500	-2	500			100*	40	5*	212		
" 1204	"	"	"	-35	-5	-800	500	150	-0.1	-30	200	-1	-100	-5	10			120*	19	25	212		
" 1205	サンケン	PA	Si.EP	-70	-6	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-70	100	-0.5	-5A	-12	3A			20*	650	7	324		
" 1206	日電	SW	Si.E	-15	-4.5	-50	600	150	-0.1	-8	80	-1	-10								138D		
" 1207	三洋	RF.AF	Si.TP	-180	-5	-70	600	150	-0.1	-80	180	-5	-10	-10	10			150*	2.5	C _{crs1} 40pS	138		
" 1208	"	AF.SW	"	-180	-5	-70	900	150	-0.1	-80	180	-5	-10	-10	10			t _{on} =0.1μS, t _f =0.2μS t _{stg} =1μS	150*	2.5		294	2SC2910 とコンパリ
" 1209	"	"	"	-180	-5	-140	10W (T _c =25°C)	150	-0.1	-80	180	-5	-10	-10	10			t _{on} =0.1μS, t _f =0.1μS t _{stg} =1.5μS	150*	4		296	2SC2911 とコンパリ
" 1210	"	"	"	-200	-5	-140	10W (T _c =25°C)	150	-0.1	-160	180	-5	-10	-10	10			t _{on} =0.1μS, t _f =0.1μS t _{stg} =1.5μS	150*	4		296	2SC2912 とコンパリ
" 1211	東芝	SW	Si.E	-35	-5	-100	200	125	-0.1	-35	200	-12	-2	-12	10			t _{on} <100nS, t _f <200nS t _{stg} <1μS	400*	2.5	70	287	
" 1212																							
" 1213	東芝	RF.AF	Si.E	-50	-5	-2A	500	150	-1	-50	130	-2	-500	-2	500			100*	40	5*	212		
" 1214	"	RF	"	-60	-5	-2A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-60	120	-2	-150	-2	150			35*	45	20	342		
" 1215	サンケン	PA	Si.EP	-160	-5	-4A	150W (T _c =25°C)	150	-100	-160	80	-4	-5A	-12	2A			50*	400	10	256	2SC2921 とコンパリ	
" 1216	"	"	"	-180	-5	-17A	200W (T _c =25°C)	150	-100	-180	70	-4	-8A	-12	2A			40*	500	8	256	2SC2922 とコンパリ	
" 1217	東芝	RF	Si.E	-40	-5	-3A	10W (T _c =25°C)	150	-0.1	-40	150	-2	-500	-2	500			100*	35	10	342		
" 1218	日電	SW	"	-60	-5	-600	360	200	-0.01	-50	200	-10	-150					t _{on} <45nS, t _{off} <300nS t _{stg} <290nS				49C	
" 1219	"	AF	"	-60	-5	-100	250	125	-0.1	-60	200	-6	-1	-6	10			NF=6dB (6V, 0.3mA, 100Hz)	180*	45		42	2SC2947 とコンパリ
" 1220	"	PA	"	-120	-5	-1.2A	20W (T _c =25°C)	150	-50	-110	150	-5	-300	-5	300			160*	29	10	225		
" 1221	"	RF.PA	"	-160	-5	-500	1 W	150	-0.2	-100	200	-2	-100	-10	20			50*	30	10	278		
" 1222	"	"	"	-160	-5	-500	1 W	150	-0.2	-100	200	-2	-100	-10	20			50*	30	10	278		

2SB

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie} (Ω)	h _{ie} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μT)			f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	τ _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
★ 2SB 12	富士通	AF	Ge. A	-30	-50	50	70	-15	-30			-6	1	-0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8		61	2S113		
★ " 13	"	"	"	-30	-50	100	70	-15	-30			-6	1	-0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8		61	2S114		
★ " 14	"	LN	"	-30	-50	100	70	-15	-30			-6	1	-0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8	NF = 5 dB (f = 1kc)	61	2S115		
★ " 15	"	AF	"	-60	-50	100	70	-15	-60			-6	1	-0.98*	30*	3.5*	0.4*	0.8		61	2S116		
★ " 16	"	PA	"	-16	-600	1.8W (T _c =25°C)	70	-20	-5	50	-2	-50								93	2S119		
★ ".16A	"	"	"	-20	-600	1.8W (T _c =25°C)	70	-20	-5	50	-2	-50								93			
★ " 17	"	"	"	-32	-600	1.8W (T _c =25°C)	70	-20	-5	50	-2	-50								93	2S120		
★ " 17A	"	"	"	-40	-600	1.8W (T _c =25°C)	70	-20	-5	50	-2	-50								93			
★ " 18	"	"	"	-60	-600	1.8W (T _c =25°C)	70	-20	-5	50	-2	-50								93	2S121		
★ " 18A	"	"	"	-80	-600	1.8W (T _c =25°C)	70	-20	-5	50	-2	-50								93			
★ " 19	"	"	"	-16	-2.5A	5.5W (T _c =25°C)	70	-100	-5	50	-2	-50								94	2S122		
★ " 20	"	"	"	-32	-2.5A	5.5W (T _c =25°C)	70	-100	-5	50	-2	-50								94	2S123		
★ " 21	"	"	"	-60	-2.5A	5.5W (T _c =25°C)	70	-100	-5	50	-2	-50								94	2S124		
★ " 22	三洋	"	"	-25	-12	-200	300	85	-15	-20	100	-1.5	-100						1	63	2SD30 とコンプリ		
" 23	"	AF	"	-15	-5	-10	40	75	-10	-15			-6	1	70	3000	6	30	1.5		12A		
" 24	"	"	"	-15	-10	-15	100	75	-15	-15			-6	1	70	3000	6	30	1.5	12	12A		
" 25	東芝	PA	"	-60	-12	-1.5A (T _c =25°C)	75	-160	-12	60	-1.5	-1A	-1.5	500				0.25			102	2S26A	
" 26	"	"	"	-32	-12	-1.5A (T _c =25°C)	75	-160	-12	60	-1.5	-1A	-1.5	500				0.25			102	2S 26	
★ " 26A	"	"	"	-60	-12	-1.5A (T _c =25°C)	75	-160	-12	60	-1.5	-1A	-1.5	500				0.25			102		
★ " 27	ソニー	"	"	-15	-10	-0.5A	85	-800	-15	29	-1.5	-200						f _{αc} = 7kc	200		103	2T305	
★ " 28	"	"	"	-15	-10	-0.5A	85	-800	-15	68	-1.5	-200						f _{αc} = 7kc	200		103	2T305	
★ " 29	"	"	"	-15	-10	-0.5A	85	-800	-15	115	-1.5	-200						f _{αc} = 7kc	200		103	2T305	
★ " 30	"	"	"	-15	-10	-0.5A	85	-800	-15	68	-1.5	-200						f _{αc} = 7kc	200		103	2T306	
★ " 31	"	"	"	-15	-10	-0.5A	85	-800	-15	115	-1.5	-200						f _{αc} = 7kc	200		103	2T306	
★ " 32	富士通	AF	"	-20	-2.5	-50	150	85	-14	-12			-9		40	1500	4.2	16.5	0.8		12A	2S 32	
★ " 33	"	PA	"	-20	-2.5	-50	150	85	-14	-12	70	-1	-50	-6	1	80	2600	5.5	20.8	1	12A	2SD33 とコンプリ	
★ " 34	"	"	"	-20	-2.5	-150	250	85	-14	-12	70	-1	-150	-6	1	85	2450	4.9	22.5	0.8	71A	2SD34 とコンプリ	
★ " 37	"	"	"	-30	-12	-50	150	85	-14	-30	70	-1	-50	-6	1	80	2600	5.5	20.8	1	12A	2SD37 とコンプリ	
★ " 38	"	"	"	-30	-12	-150	250	85	-16	-30	70	-1	-150	-6	1	85	2450	4.9	22.5	0.8	71A	2SD38 とコンプリ	
★ " 39	"	LN	"	-10	-10	-2	50	85	-10	-10			-4	0.5	65	3570	9.44	25		NF = 4 dB (f = 1kc)	12A	2S 39	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考							
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直流又はパルス hFE		バイアス		h _{je}	h _{ie} (Ω)	h _{ib} * (Ω)	h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oc} * (μU)			f _{ab} fT* (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{ib} h _{ie} (real)* (Ω)				
★ 2SB 40	東芝	SW	Ge. A	-40	-12	-100	80	75	-10	-12	100	-1	-100	-6	1		t _r =0.55μS, t _f =0.35μS t _s =0.6μS		>0.7	<50	<180	12A						
★ "	41	富士通	PA	"	"	-1.2A	44 W (T _c =25°C)	91	-2mA	-30	65	-1.5	-1A	-14.4	50		PG = 30dB P ₀ = 10W (B級 PP Z _i = 24Ω)					102	2S 41					
★ "	42	"	"	"	"	-1.2A	44 W (T _c =25°C)	91	-2mA	-30	65	-1.5	-1A	-14.4	50		PG = 30dB P ₀ = 10W (B級 PP Z _i = 24Ω)					102	2S 42					
★ "	43	東芝	"	"	"	-25	-12	-50	150	75	-10	-12	70	-1	-50	-6	1			1	35		12A					
★ "	43A	"	"	"	"																		12A					
★ "	44	"	AF	"	"	-30	-12	-50	80	75	-10	-12												12A	2S 44			
★ "	46	"	"	"	"	-25	-12	-50	80	75	-5	-12												12A	2S 46			
★ "	47	"	LN	"	"	-25	-12	-50	80	75	-14	-25												12A	2S 47			
★ "	48	ソニー	AF. PA	"	"	-16		-100	140	65	-16	-16	43	-1	-20	-6	1	-0.973*	28*	8*	0.6*	2.5	25		84A	2T 31		
★ "	49	"	"	"	"	-16		-100	140	65	-16	-16	83	-1	-20	-6	1	-0.985*	28*	8*	0.6*	3.0	25		84A	2T 31		
★ "	50	"	"	"	"	-16		-100	140	65	-16	-16	131	-1	-20	-6	1	-0.990*	28*	8*	0.6*	3.5	25		84A	2T 31		
★ "	51	"	PA	"	"	-30	-3	-200	200	85	-16	-25	43	-1	-20	-6	1	-0.973*	28*	8*	0.6*	2.0	25		84A	2T 32		
★ "	52	"	"	"	"	-30	-3	-200	200	85	-16	-25	83	-1	-20	-6	1	-0.985*	28*	8*	0.6*	3.0	25		84A	2T 32		
★ "	53	"	"	"	"	-30	-15	-250	200	85	-10	-30	70	-1	-20	-6	1	-0.982*	28*	7*	0.6*	3.0	25		84A	2T 32		
★ "	54	東芝	AF	"	"	-30	-12	-150	150	75	-14	-30													12A	2S 54		
★ "	55	"	PA	"	"	-60	-12	-50	150	75	-14	-25	80	-1	-50	-6	1								12A	2S56A		
★ "	56	"	"	"	"	-30	-12	-150	150	75	-14	-30	80	-1	-50	-6	1								12A	2S 56		
★ "	56A	"	"	"	"	-45	-12	-150	150	75	-14	-25	80	-1	-50	-6	1								12A			
★ "	57	富士通	AF	"	"	-30	-10	-100	100	70	-15	-30														78		
★ "	58	"	"	"	"	-12	-2.5	-50	100	70	-15	-12														78		
★ "	59	"	SW	"	"	-30	-10	-100	150	85	-15	-30	70	-1	-50											84B	12C	
★ "	60	"	AF	"	"	-20	-2.5	-50	150	85	-14	-12														12A		
★ "	60A	"	"	"	"	-20	-2.5	-50	150	85	-14	-12	70	-1	-50											12A		
★ "	61	"	"	"	"	-30	-12	-50	150	85	-10	-30														12A	2S 61	
★ "	62	東芝	PA	"	"	-60	-12	-500	2 W (T _c =35°C)	75	-70	-12	60	-1	-500	-1	100										101	
★ "	63	"	"	"	"	-32	-12	-500	2 W (T _c =35°C)	75	-70	-12	60	-1	-500												101	
★ "	64	"	"	"	"	-32	-12	-500	2 W (T _c =35°C)	75	-70	-12	60	-1	-500												101	
★ "	64	"	"	"	Ge. D	-100	-1	-6A	25 W (T _c =25°C)	75	-330	-12	70	-1.5	-1A	-1.5	500										102	
★ "	65	富士通	SW	Ge. A	-30	-12	-100	150	85	-15	-30															12A	2S 65	
★ "	66	日立	AF	"	"	-30	-12	-50	100	85	-15	-30														12C	2S 11 2N215C	
★ "	67	"	PA	"	"	-55	-12	-150	350 (按熱設計)	70	-10	-12	63	-1	-150	-6	1	45	1360	2.1	21	1	45	70		66	2S193 HJ 43	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CB} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μΩ)	f _{at} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)
									μA	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _β *									
★ 2SB 96	松下	PA	Ge. A	-32	-10	-125	125	75	-12	-10	80	-1									16	OC 76	
★ " 97	東芝	LN	"	-18	-12	-5	40	75	-14	-30											5		
★ " 98	日電	AF	"	-30		-50	125	75	-20	-6	35	-1	-50	-6	1	40	30*	3.5*	0.3*	1	35	84A	ST340
★ " 99	"	AF	"	-30		-50	125	75	-20	-6	130	-1	-50	-6	1	120	30*	3.5*	0.25*	1.5	35	84A	ST340
★ " 100	"	LN	"	-30	-10	-50	100	75	-10	-30				-6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	NF = 3.5dB (f = 1kc)	84A	2S100 ST34H
★ " 101	"	AF. PA	"	-30	-10	-50	125	75	-10	-30				-6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	35	84A	2S101 ST34F
★ " 102	"	"	"	-30	-10	-50	180	75	-10	-30				-6	1	60	30*	2.5*	0.3*	1.2	35	91	2S102 ST34FR
★ " 103	"	"	"	-30	-10	-100	125	75	-10	-30	70	-1	-50	-6	1		P _e = 400mW (B級 PP P _G = 25dB (Z _i = 300Ω))		1.2		84A	2S103 ST34G	
★ " 104	"	"	"	-30	-10	-100	180	75	-10	-30	70	-1	-50	-6	1		P _e = 400mW (B級 PP P _G = 25dB (Z _i = 300Ω))		1.2		91	2S104 ST34GR	
★ " 105	"	"	"	-30	-10	-500	500	75	-100	-30	70	-2	-200	-2	200				0.5		81	2S105 ST35	
★ " 106	"	"	"	-30	-10	-500	3 W (B級PP)	75	-100	-30	70	-2	-200	-2	200				0.5		95	2S106 ST35R	
★ " 107	"	"	"	-30		-2A (T _c = 25°C)	10 W (T _c = 25°C)	75	-500	-30	70	-2	-1A	-2	200		P _e = 7 W (B級 PP P _G = 30dB (Z _i = 25Ω))		0.4		102	2S107 ST36	
★ " 107A	"	"	"	-60		-3A (T _c = 25°C)	20 W (T _c = 25°C)	75	-500	-60	70	-2	-1A	-2	200		P _e = 7 W (B級 PP P _G = 30dB (Z _i = 25Ω))		0.4		102	2S107 ST36A	
★ " 108	"	PA	"	-40	-10	-500	500	75	-100	-40	70	-2	-200	-2	200				0.5		81		
★ " 108A	"	"	"	-60	-10	-500	500	75	-100	-60	70	-2	-200	-2	200				0.5		81		
★ " 108B	"	"	"	-80	-10	-500	500	75	-100	-80	70	-2	-200	-2	200				0.5		81		
★ " 109	"	"	"	-40	-10	-500	3 W (B級PP)	75	-100	-40	70	-2	-200	-2	200				0.5		95		
★ " 109A	"	"	"	-60	-10	-500	3 W (B級PP)	75	-100	-60	70	-2	-200	-2	200				0.5		95		
★ " 109B	"	"	"	-80	-10	-500	3 W (B級PP)	75	-100	-80	70	-2	-200	-2	200				0.5		95		
★ " 110	"	AF	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6				-6	1	30	30*	2.5*	0.5*	1		19A	ST330
★ " 111	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6				-6	1	45	30*	2.5*	0.5*	1		19A	ST331
★ " 112	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6				-6	1	60	30*	2.5*	0.5*	1		19A	ST332
★ " 113	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6				-6	1	80	30*	2.5*	0.5*	1		19A	ST333
★ " 114	"	PA	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6	65	-1	-20	-6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5		19A	ST381
★ " 115	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6	85	-1	-20	-6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5		19A	ST382
★ " 116	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6	110	-1	-20	-6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5		19A	ST383
★ " 117	"	"	"	-25	-10	-50	100	85	-10	-6	140	-1	-20	-6	1		30*	2.5*	0.5*	1.5		19A	
★ " 118	松下	"	"	-15	-10	-1.5A (T _c = 25°C)	50 W (T _c = 25°C)	75	-100	-14	60	-7	-0.3A	-7	300				0.2		102		
★ " 119	"	"	"	-32	-10	-1.5A (T _c = 25°C)	50 W (T _c = 25°C)	75	-100	-14	60	-7	-0.3A	-7	300				0.2		102	OC 19	
★ " 120	富士通	AF	"	-32	-2.5	-20	150	85	-6.5	-12				-12	2	70	P _G = 41 dB (A級 S) P _e = 5 mW				12A		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考				
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{je}	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μU)			f _β f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	τ _β h _{ie} (real)* (Ω)	
									V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{FB} *
★ 2SB121	富士通	SW	Ge. A	-105	-50	-100	50	85	-14	-2.5	60	-0.35	-5	-6	1				0.5			12A		
" 122	東芝	"	"	-80	-40	-1.5A	20 W (T _c =25°C)	75	-160	-12	60	-1.5	-1A	-1.5	500				0.25			102		
" 123	"	"	"	-40	-30	-5A	20 W (T _c =25°C)	75	-1mA	-40								0.25	<300	<40	102			
" 124	"	"	"	-60	-25	15A	40 W (T _c =25°C)	75	-1.2mA	-12	70	-1.5	-15A	-6	500				0.3			107		
" 125	"	"	"	-36	-25	-15A	40 W (T _c =25°C)	75	-1.2mA	-12	70	-1.5	-15A	-6	500				0.3			107		
★ " 126	松下	PA	"	-32	-10	-3.5A	30W (T _c ≤45°C)	90	-220	-14	35	-1	-1A	-6	1A				f _β = 6 kc			102	OC 26	
★ " 127	"	"	"	-32	-10	-3.5A	30W (T _c ≤45°C)	90	-220	-14	75	-1	-1A	-6	1A				f _β = 6 kc			102	OC 27	
★ " 128	"	"	"	-80	-40	-6A	30W (T _c ≤45°C)	90	-220	-14	40	-1	-1A								102	OC 28		
★ " 128A	"	"	"	-120	-60	-6A	54 W (T _c =25°C)	90	-200	-14	50	-1	-1A								102			
★ " 129	"	"	"	-80	-40	-6A	54 W (T _c =25°C)	90	-200	-14	85	-1	-1A								102	OC 29		
★ " 129A	"	"	"	-120	-60	-6A	54 W (T _c =25°C)	90	-200	-14	85	-1	-1A								102			
★ " 130	"	"	"	-32	-10	-1.5A	6.5 W (T _c =25°C)	75	-200	-14	60	-7	-0.3	-7	300				0.2			100	OC 30	
★ " 131	富士通	"	"	-40	-12	-1.5A	65 W (T _c =25°C)	90	-2mA	-30	65	-1.5	-1A	-14.4	50				f _β = 5 kc			102	2S131	
★ " 131A	"	"	"	-40	-12	-1.5A	65 W (T _c =25°C)	90	-2mA	-30	65	-1.5	-1A						f _β = 5 kc			102		
★ " 132	"	"	"	-60	-12	-1.5A	65 W (T _c =25°C)	90	-2mA	-30	65	-1.5	-1A	-14.4	50				f _β = 5 kc			102		
★ " 134	三菱	AF. LN	"	-30	-15	-100	100	85	-10	-25				-6	1	70	2100	3.2	21	NF = 4 dB (f = 1kHz, I _C = 0.5mA)			12B	
★ " 135	"	AF	"	-30	-15	-100	100	85	-10	-25				-6	1	70	2100	3.2	21			12B		
★ " 136	"	PA	"	-25	-12	-150	150	85	-10	-25	120	-1.5	-50									12B		
★ " 137	"	"	"	-30	-15	-5A	30 W (T _c =25°C)	85	-500	-20	80	-1.5	-1A									103		
★ " 138	"	"	"	-60	-30	-5A	30 W (T _c =25°C)	85	-500	-30	80	-1.5	-1A									103		
★ " 140	ソニー	"	"	-40	-12	-1.5A	12 W (T _c =25°C)	85	-600	-40	74	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T301	
★ " 141	"	"	"	-60	-12	-1.5A	12 W (T _c =25°C)	85	-600	-60	74	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T302	
★ " 142	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25°C)	85	-1mA	-30	24	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T303	
★ " 143	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25°C)	85	-1mA	-30	37	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T303	
★ " 144	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25°C)	85	-1mA	-30	75	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T303	
★ " 145	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25°C)	85	-1mA	-30	37	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T304	
★ " 146	"	"	"	-30	-12	-1A	10 W (T _c =25°C)	85	-1mA	-30	75	-1.5	-1A						f _β = 7 kc	200		103	2T304	
★ " 147	"	"	"	-60	-12	-1.5A	12 W (T _c =25°C)	85	-600	-50	60	-1.5	-200						f _β = 7 kc	200		103		
★ " 148	東芝	SW	"	-80	-25	-15A	40 W (T _c =25°C)	75	-1.2mA	-12	70	-1.5	-15A	-6	0.5A				0.3			107		
★ " 149	"	"	"	-40	-30	-8A	25 W (T _c =25°C)	75	-230	-12	60	-1.5	-8A	-1.5	0.5A				0.25	<400	<30	102		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考							
				V_{CB0} (V)	V_{E0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}			バ イ ア ス		h_{fe}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)			$f_{\beta b}$ f_{T^*} (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)				
									μA	$V_{CB}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$										h_{fe}^*	h_{ie}	h_{re}	h_{oe}
★ 2SB150	東芝	SW	Ge. A	-105	-50	-40	50	75	-50	-105	35	-0.35	-5	-6	1									12A	2S150			
★ " 151	富士通	"	"	-80	-60	-5A	50 W ($R=25^\circ\text{C}$)	100	-500	-30	40	-1.5	-3A	-1.5	1A							$f_{\beta e} = 5\text{kc}$			102			
★ " 152	"	"	"	-100	-60	-5A	50 W ($R=25^\circ\text{C}$)	100	-500	-30	40	-1.5	-3A	-1.5	1A							$f_{\beta e} = 5\text{kc}$			102			
★ 152A	"	"	"	-100	-60	-5A	50 W ($R=25^\circ\text{C}$)	100	-3mA	-100	70	-1	-1A									$f_{\beta e} > 4.5\text{kc}$			102			
★ " 153	日立	AF	"	-12	-2.5	-70	150	85	-14	-12															12A			
★ " 154	"	PA	"	-12	-2.5	-70	150	85	-14	-12	70	-1.5	-50													12A		
★ " 155	"	AF	"	-16	-2.5	-300	150	85	-14	-12																12A		
★ " 156	"	PA	"	-16	-2.5	-300	150	85	-14	-12	70	-1	-150	-4	1	45	$P_o = 600\text{mW}$ (B級 PP) $PG = 27\text{dB}$ ($Z_i = 86\Omega$)									12A		
★ 156A	"	"	"	-20	-6	-300	150	85	-14	-20	70	-1	-150	-4	1	45										12A		
★ " 157	松下	AF	"	-7	-7	-5	10	55	-10	-2												$f_{\beta e} > 10\text{kc}$			2A	OC 57		
★ " 158	"	"	"	-7	-7	-5	10	55	-10	-2												$f_{\beta e} > 10\text{kc}$			2A	OC 58		
★ " 159	"	AF	"	-7	-7	-5	10	55	-10	-2												$f_{\beta e} > 10\text{kc}$			2A	OC 59		
★ " 160	"	PA	"	-7	-7	-5	10	55	-10	-2	75	-2	-0.5													2A	OC 60	
★ " 161	日電	"	"	-30		-100	125	75	-10	-6	50	-1	-50	-6	1											84A	2S161 ST341	
★ " 162	"	"	"	-30		-100	180	75	-10	-6	50	-1	-50	-6	1											91	2S162 ST341R	
★ " 163	"	"	"	-30		-100	125	75	-10	-6	70	-1	-50	-6	1											84A	2S163 ST342	
★ " 164	"	"	"	-30		-100	180	75	-10	-6	70	-1	-50	-6	1											91	2S164 ST342R	
★ " 165	"	"	"	-30		-100	125	75	-10	-6	100	-1	-50	-6	1											84A	2S165 ST343	
★ " 166	"	"	"	-30		-100	180	75	-10	-6	100	-1	-50	-6	1											91	2S166 ST343R	
★ " 168	富士通	AF	"	-9	-2.5	-100	150	85	-14	-9																	12A	
★ " 169	"	PA	"	-9	-2.5	-100	150	85	-14	-9	80	-1	-50	-3	1	$PG = 22\text{dB}$ (B級 PP) $P_o = 100\text{mW}$ ($Z_i = 100\Omega$)										12A		
★ " 170	松下	AF	"	-30	-10	-100	125	85	-12	-10																	12B	OC 70
★ " 171	"	"	"	-30	-10	-100	125	85	-12	-10																	12B	OC 71
★ " 172	"	PA	"	-32	-10	-125	125	85	-12	-10	50	-1	$I_B = -2\text{mA}$	-6	10												12B	2SD31 とコンプアリ
★ " 173	"	LN	"	-30	-10	-100	125	85	-12	-10				-6	1	100											12B	2S 74
★ " 174	"	PA	"	-20	-6	-300	225	75	-20	-12	65	-0.5	-300	-6	50												12B	OC 74
★ " 175	"	AF	"	-30	-10	-100	125	85	-12	-10				-6	1	100											12B	OC 75
★ " 176	"	PA	"	-32	-10	-125	125	85	-12	-10	90	-1	$I_B = -2\text{mA}$														12B	2SD32 とコンプアリ
★ " 177	"	"	"	-60	-10	-125	125	85	-12	-10	90	-1	$I_B = 2\text{mA}$														12B	OC 77
★ " 178	"	"	"	-20	-6	-300	225	85	-20	-12	56	$V_{CB} = 0V$	-300														17	2SD178 とコンプアリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考		
				V_{CE0} (V)	V_{E0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)	直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μV)	$f_{\beta b}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)			r_{bb} $r_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)	
										$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$										$h_{f\beta}^*$
★ 2SB178A	松下	PA	Ge. A	-40	-6	-320	225	85	-20	-12	56	$V_{CB}=0V$	-300							17	2SD178A とコンプリ		
" 179	東芝	AF	"	-25	-12	-50	80	75	-14	-30										12A	2S179		
★ " 180	富士通	PA	"	-40	-12	-0.5A	$\frac{5.5\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$ $\frac{12\text{ W}}{(T_c=35^\circ\text{C})}$	92	-1mA	-40	70	-1.5	-500								83		
★ " 180A	"	"	"	-40	-12	-0.5A	$\frac{12\text{ W}}{(T_c=35^\circ\text{C})}$	90	-500	-30	70	-1.5	-500					$f_{\alpha c} = 13\text{kc}$			83		
★ " 181	"	"	"	-60	-12	-0.5A	$\frac{5.5\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	92	-1mA	-60	70	-1.5	-500								83		
★ " 181A	"	"	"	-60	-12	-0.5A	$\frac{12\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	90	-200	-30	70	-1.5	-500					$f_{\alpha c} = 13\text{kc}$			83		
★ " 183	日立	AF	"	-12	-2.5	-20	50	85	-12	-12											3		
★ " 184	"	PA	"	-12	-2.5	-20	50	85	-12	-12	100	-2	-5								3		
★ " 185	三洋	"	"	-25	-12	-150	200	85	-15	-20											12B		
★ " 186	"	"	"	-25	-12	-150	200	85	-15	-20											12B		
★ " 187	"	"	"	-25	-12	-150	200	85	-15	-20											12B	2SD187 とコンプリ	
★ " 188	"	"	"	-25	-12	-150	200	85	-15	-20											12B	2S188	
★ " 189	東芝	"	"	-25	-12	-250	250	75	-14	-25	75	-1	-100								62	2S189	
" 190	沖	AF	"	-25	-12	-50	90	80	-15	-25												12A	
" 191	"	"	"	-25	-12	-50	90	80	-15	-25												12A	
" 192	"	"	"	-25	-12	-50	90	80	-15	-25												12A	
" 193	"	"	"	-25	-12	-100	200	80	-15	-25												75	
" 194	"	"	"	-25	-12	-100	200	80	-15	-25												75	
" 195	"	"	"	-25	-12	-100	200	80	-15	-25												75	
" 196	"	"	"	-30	-12	-500	500	80	-100	-30	50	-2	-200									82	
" 197	"	"	"	-50	-12	-500	500	80	-100	-50	50	-2	-200									82	
" 198	沖	"	"	-70	-12	-500	500	80	-100	-70	50	-2	-200									82	
★ " 199	富士通	PA	"	-12	-2.5	-300	250	85	-14	-12	80	-1	-150									71A	
★ " 200	東芝	"	"	-32	-12	-400	225	75	-40	-12	75	-1	-150						0.5			77	
★ " 201	"	SW	"	-35	-12	-400	300	75	-30	-12	150	-1	-150						0.5			84A	
★ " 202	"	PA	"	-32	-12	-400	225	75	-40	-12	140	-1	-150						0.5			77	
" 203	新電元	"	"	-40	-40	-20A	$\frac{80\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$ $\frac{80\text{ W}}{(T_c=35^\circ\text{C})}$	85	-5mA	-40	40	-1.5	-15A									105	L10
" 204	"	"	"	-40	-40	-30A	$\frac{80\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	85	-5mA	-40	100	-1.5	-15A									105	
" 205	"	"	"	-80	-40	-20A	$\frac{80\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	85	-5mA	-80	40	-1.5	-15A	-6	2A				$f_{\alpha c} = 2.5\text{kc}$			105	H10
" 206	"	"	"	-80	-40	-30A	$\frac{80\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	85	-5mA	-80	100	-1.5	-15A	-6	2A				$f_{\alpha c} = 2.5\text{kc}$			105	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考					
				V _{CE0} (V)	V _{EO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{fe} *	h _{ic} h _{is} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)			f _{ob} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{th} h _{ic} (real)* (Ω)		
									μA	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)												
★ 2SB232	松下	PA	Ge. D	-130	-0.5	-6A	54 W (T _c =25°C)	90	-220	-14	60	-1	-200											102	
★ " 233	"	"	"	-130	-0.5	-6A	54 W (T _c =25°C)	90	-220	-14	150	-1	-200											102	
★ " 234	"	SW	"	-180	-1.3	-6A	54 W (T _c =25°C)	90	-220	-14	25	-1	-6A											102	
★ " 235	東芝	"	Ge. A	-80	-25	-15A	60 W (T _c =25°C)	85	-1.2mA	-12	60	-2	-5A	-6	0.5A					0.3				109	
★ " 236	"	"	"	-60	-25	-15A	60 W (T _c =25°C)	85	-1.2mA	-12	60	-2	-5A	-6	0.5A					0.3				109	
★ " 237	"	"	"	-36	-25	-15A	60 W (T _c =25°C)	85	-1.2mA	-12	60	-2	-5A	-6	0.5A					0.3				109	
★ " 238	日電	PA	"	-40	-15	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-100	-40	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 239	"	SW	"	-80	-30	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-100	-80	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 239A	"	"	"	-100	-30	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-200	-100	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 240	"	PA	"	-40	-15	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-200	-40	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 240A	"	"	"	-60	-30	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-200	-60	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 241	"	SW	"	-80	-30	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-200	-80	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 241A	"	"	"	-100	-30	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-200	-100	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 242	"	PA	"	-30	-15	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-1mA	-30	40	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 242A	"	"	"	-60	-20	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-1mA	-60	40	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 243	"	"	"	-30	-15	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-1mA	-30	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 243A	"	"	"	-60	-20	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-1mA	-60	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 244	"	SW	"	-80	-30	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-1mA	-80	40	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 245	"	"	"	-80	-30	-1A	13 W (T _c =25°C)	90	-1mA	-80	60	-1	-0.3A	-1	200					0.5				83	
★ " 246	"	PA	"	-40	-20	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-500	-40	60	-1.5	-2A	-1.5	200					>0.2				102	
★ " 247	"	SW	"	-60	-20	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-500	-60	60	-1.5	-2A	-1.5	200					>0.2				102	
★ " 248	"	PA	"	-40	-20	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-1mA	-40	60	-1.5	-2A	-1.5	200					>0.2				102	
★ " 248A	"	"	"	-60	-20	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-1mA	-60	60	-1.5	-2A	-1.5	200					>0.2				102	
★ " 249	"	SW	"	-80	-40	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-1mA	-80	60	-1.5	-2A	-2	200					>0.2				102	
★ " 250	"	PA	"	-30	-20	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-5mA	-30	40	-1.5	-2A	-2	200					0.35				102	
★ " 250A	"	"	"	-60	-20	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-5mA	-60	40	-1.5	-2A	-2	200					0.35				102	
★ " 251	"	"	"	-30	-20	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-5mA	-30	60	-1.5	-2A	-2	200					0.35				102	
★ " 251A	"	"	"	-60	-20	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-5mA	-60	60	-1.5	-2A	-2	200					0.35				102	
★ " 252	"	SW	"	-80	-40	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-5mA	-80	40	-1.5	-2A	-2	200					0.35				102	
★ " 252A	"	"	"	-120	-40	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-5mA	-120	40	-1.5	-2A	-2	200					0.35				102	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス		h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)			h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αβ} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fe} *	h _{fe}									
★ 2SB253	日電	SW	Ge. A	-80	-40	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-5mA	-80	60	-1.5	-2A	-2	200					0.35			102		
★ " 253A	"	"	"	-120	-40	-5A	54 W (T _c =25°C)	90	-5mA	-120	60	-1.5	-2A	-2	200					0.35			102		
★ " 254	三洋	PA	"	-35	-12	-1A	12 W (T _c =25°C)	85	-200	-25	100	-1.5	-200	-1.5	200					0.7			101		
★ " 255	"	"	"	-35	-12	-1A	4.8 W (T _c =25°C)	85	-500	-25	50	-1.5	-200	-1.5	200					0.4			101		
★ " 256	"	"	"	-25	-12	-1A	12 W (T _c =25°C)	85	-200	-25	100	-1.5	-200	-1.5	200					0.7			101		
★ " 257	東芝	LN	"	-18	-12	-5	60	75	-3	-12				-6	1	125	2500	5	4.5	NF = 5 dB (V _{CE} = -3V, I _E = 0.5mA)			12A		
" 258	"	PA	Ge. D	-120	-1	-15A	60 W (T _c =25°C)	75	-3.5mA	-12	60	-1.5	-15A	-6	500					1.5			109		
" 259	"	"	"	-80	-1	-15A	60 W (T _c =25°C)	75	-3.5mA	-12	60	-1.5	-15A	-6	500					1.5			109		
" 260	"	"	"	-50	-1	-15A	60 W (T _c =25°C)	75	-3.5mA	-12	60	-1.5	-15A	-6	500					1.5			109		
★ " 261	富士通	AF	Ge. A	-20	-2.5	-30	65	85	-12	-12				-6	1	45	2000	6	20	2.5			4		
★ " 262	"	PA	"	-20	-2.5	-30	65	85	-12	-12	60	-1.5	-30	-6	115	90	3000	6	30	3			4	2SD162 (トコンプ)	
★ " 263	"	"	"	-20	-2.5	-150	200	85	-14	-12	65	-1	-150	-6	1	60	1650	4.3	19	1.5				12A	
★ " 264	日電	LN	"	-30	-10	-50	100	75	-5	-6				-1.5	0.5	70	57 *	4 *	1.5 *	NF = 3 dB (V _{CE} = -1.5V, I _E = 0.5mA)			19A		
★ " 265	東芝	SW	"	-40	-12	-100	170	75	-10	-12	62	-1	-100	-6	1		t _r = 2.5μS, t _f = 1.4μS		1.3	30	140		84A		
★ " 266	ゼネラル	AF	"	-25		-150	150	85	-10	-12				-6	1	67	1800	3.7	23				12A		
★ " 267	"	PA	"	-25		-150	150	85	-10	-12	70	-1	-150										12A		
★ " 268	三菱	"	"	-30		-150	250	85	-14	-25	75	-1	-150										71A		
★ " 269	ゼネラル	LN	"	-25		-150	150	85	-10	-15				-6	1	67	2000	4	23	NF = 4 dB (V _{CE} = -2V, I _E = 0.5mA)			12A		
★ " 270	三洋	AF	"	-12	-5		150	85	-15	-6				-6	1	80	3000	8	35				12A		
" 271	"	PA	"	-25	-10	-500	720 (T _c =25°C)	85	-60	-12	80	-1.5	-0.1A	-1.5	100					0.5			12A		
" 272	"	"	"	-25	-10	-500	720 (T _c =25°C)	85	-60	-12	100	-6	-0.1A	-1.5	100					0.8			12A		
★ " 273	"	"	"	-35	-10	-500	720 (T _c =25°C)	85	-60	-12	100	-6	-0.1A	-1.5	100					0.8			12A		
★ " 274	日立	"	Ge. D	-80	-1.5	-6A	50 W (T _c =25°C)	91	-5mA	-80	30	-1.5	-4A	-1.5	500					1			3.5	103	
★ " 275	"	SW	"	-120	-1.5	-6A	50 W (T _c =25°C)	91	-5mA	-120	40	-1.5	-4A	-1.5	500					1			3.5	103	
★ " 276	"	"	"	-120	-1.5	-10A	50 W (T _c =25°C)	91	-5mA	-120	35	-1.2	-10A	-1.5	500					1			3.5	103	
★ " 277	松下	LN	Ge. A	-15		-5	80	75	-12	-2				-6	1	100	2800	3.8	35	NF = 5 dB			20		
★ " 278	"	AF	Si. A	-25	-20	-50	250	150	-0.1	-10				-6	1	28	1300	1.8	13	1			16		
★ " 279	"	"	"	-25	-20	-50	250	150	-0.1	-10				-6	1	50	2100	2.4	17	1			16		
★ " 280	"	"	"	-32	-12	-250	300	150	-0.1	-10	24	-2	-30	-6	1	25	800	1.1	10	1.5 *			16		
★ " 281	"	"	"	-60	-12	-250	300	150	-0.1	-10	24	-2	-30	-6	1	40	1400	1.7	18	1.5 *			16		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考			
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)		直流又はパルス h _{FPE}		バ イ ア ス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(rea)} * (Ω)	
									V _{CEB} (V)	I _{CB} (mA)	V _{CEB} (V)	I _E (mA)	h _{fe}	I _E (mA)										
★ 2SB282	松下	SW	Ge. A	-80	-40	-6A	30 W (T _c =25°C)	90	-100	-0.5	21	-1	-6A	-6	1 A					0.25	160		103	
★ "	283	"	"	-60	-20	-6A	30 W (T _c =25°C)	90	-100	-0.5	53	-1	-6A	-6	1 A					0.25	160		103	
★ "	284	"	"	-60	-20	-6A	30 W (T _c =25°C)	90	-100	-0.5	30	-1	-6A	-6	1 A					0.25	160		103	
★ "	285	"	"	-80	-40	-6A	30 W (T _c =25°C)	90	-100	-0.5	36	-1	-6A	-6	1 A					0.25	160		103	
★ "	286	"	"	Ge. D	-80	-0.5	-6A	43 W (T _c =25°C)	90	-220	-14	17	-1	-6A									103	
★ "	287	"	"	"	-80	-1.3	-6A	43 W (T _c =25°C)	90	-220	-14	36	-1	-6A									103	
★ "	288	"	"	Ge. A	-32	-10	-125	125	75	-10	-10	50	-0.7	-125									12A	
★ "	289	"	"	"	-60	-10	-125	125	75	-10	-10	50	-0.7	-125									12A	
★ "	290	東芝	LN	"	-18	-12	-40	65	75	-4	-12				-3	0.5	110	3500	6	20	5	9.5	84A	
★ "	291	"	AF	"	-30	-12	-150	150	75	-10	-12	70	-1	-50	-6	1	100	4200	6	30	1	35	84A	
★ "	292	"	PA	"	-30	-12	-150	150	75	-10	-12	80	-1	-50	-6	1	100	4200	6	30	1	35	84A	
★ "	292A	"	"	"	-60	-12	-150	150	75	-10	-12	80	-1	-50									84A	
★ "	293	ゼネラル	"	"	-18		-250	150	85	-10	-12	70	-1	-150									12B	
★ "	294	"	AF	"	-18		-250	150	85	-10	-12				-4	1	36	1000	2.9	18			12B	
★ "	295	富士通	SW	"	-100	-40	-5A	40 W (T _c =25°C)	85	-3mA	-100	70	-1	-1A	-1	1 A					f _{oe} = 4.5 kc		102	
★ "	296	東芝	"	Ge. D	-130	-3	-10A	35 W (T _c =25°C)	75	-1mA	-50	35	-1.5	-10A									102	
★ "	297																							
★ "	298																							
★ "	299	ゼネラル	SW	Ge. A	-30	-25	-150	150	85	-10	-12	65	-1	-150									12B	
★ "	300	東芝	PA	Ge. D	-100	-1	-10A	35 W (T _c =25°C)	75	-330	-12	60	-1.5	-5A									102	
★ "	301	"	"	"	-60	-1	-10A	35 W (T _c =25°C)	75	-330	-12	60	-1.5	-5A									102	
★ "	302	日立	LN	Ge. A	-10	-5	-2	40	85	-6	-10				-4	0.5	80	4500	4	26	NF = 4 dB (f = 1 kc)		12B	
★ "	303	三洋	LN.AF	"	-25	-12	-20	100	75	-15	-15				-2	0.5	180	12KΩ	30	50	NF = 3.5 dB (V _{CE} = -6V, I _E = 1mA)		12B	
★ "	304	富士通	SW	"	-30	-10	-500	225	70	-15	-30	70	-1	-50									84B	
★ "	304A	"	"	"	-45	-15	-500	225	70	-10	-35	70	-1	-50									84B	
★ "	305																							
★ "	306	東芝	SW	Ge. A	-100	-50	-20	75	75	-10	-105	60	-0.35	-2									84A	
★ "	307																							
★ "	308																							
★ "	309	松下	PA	Ge. DB	-75	-1	-8A	43 W (T _c =25°C)	90	-200	-0.5	62	V _{CEB} = 0V	I _E = 1 A	-4	1 A					f _{oe} = 17 kc		102	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考		
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe} h_{fs}^*	h_{ie} h_{is}^* (Ω)	h_{re} h_{rs}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{os}^* (μO)	f_{β} f_T^* (Mc)			C_{ob} (pF)	τ_{bb} $h_{ie(\text{real})}^*$ (Ω)
									(μA)	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$									
★ 2SB424	東芝	SW	Ge. A	-80	-40	-3A	30 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-160	-12	60	-1.5	-1A							102			
★ "	"	PA	"	-60	-12	-3A	30 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-160	-12	60	-1.5	-1A							102			
★ "	"	"	"	-32	-12	-3A	30 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-160	-12	60	-1.5	-1A							102			
★ "	富士通	SW	"	-45	-15	-500	225	70	-15	-45	60	-1	-100	-6	1			1		84B			
★ "	"	PA	"	-45	-15	-500	225	70	-15	-45	90	-1	-100	-6	1			1		84B			
★ "	日電	"	"	-30		-50	100	85	-16	-30	150	-1	-20							19A			
★ "	松下	"	Ge. DB	-70		-20A	80 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	90	-20mA	-70	60	$V_{CB}=0V$	-4A							109			
★ "	富士通	"	Ge. A	-32	-12	-500	200	85	-20	-12	120	-1	-150	-6	1	80	2400	8.9	38	12A			
★ "	"	PA. SW	Ge. D	-150	-2	-5A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	100	-1mA	-40	70	-2	-5A	-5	500				3 *	102			
★ "	"	SW	Ge. A	-70	-40	-15A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-4mA	-30	50	-2	-5A							109			
★ "	東芝	PA	Si. T	-50	-5	-3A	25 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-30	90	-5	-1A	-5	500					268	2SD234 とコンプアリ		
★ "	"	"	"	-40	-5	-3A	25 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-30	90	-5	-1A	-5	500					268	2SD235 とコンプアリ		
★ "	沖	AF	Ge. A	-25		-120	120	85	-10	-12	60	-0.5	-10	-5	1	80	33 *	2.4 *	0.4 *	12A			
★ "	"	"	"	-45		-120	120	85	-10	-12	60	-0.5	-10	-5	1	80	33 *	2.4 *	0.4 *	12A			
★ "	"	"	"	-70		-120	120	85	-10	-12	60	-0.5	-10	-5	1	80	33 *	2.4 *	0.4 *	12A			
★ "	東芝	"	"	-30	-12	-150	150	75	-14	-12				-6	1	70-270	4000	8	45	12A			
★ "	"	LN	"	-30	-12	-150	150	75	-14	-12				-6	1	70-270	4000	8	45	12A			
★ "	日立	PA	Ge. DB	-160	-1	-6A	40 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	100	-250	-30	50	-1.5	-200							103			
★ "	"	SW	"	-160	-1.5	-6A	40 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	100	-500	-30	50	-1.5	-4A							103			
★ "	"	AF. LN	Ge. A	-18	-12	-10	100	85	-10	-12				-6	1	150	3900	7.4	53	12A			
★ "	"	"	"	-18	-12	-10	100	85	-7	-12				-6	1	160	4300	7.7	59	12A			
★ "	富士通	PA	Ge. D	-40	-1	-1.5A	10 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-200	-12	100	-2	-1A	-5	0.5A					101			
★ "	"	"	"	-60	-1	-1.5A	10 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-100	-12	100	-2	-1A	-5	0.5A					101			
★ "	"	PA. SW	"	-220	-3	-6A	45 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	90	-500	-50	35	-1	-6A	-5	0.5A					102			
★ "	松下	PA	Ge. A	-32	-10	-1A	13 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	90	-1mA	-32	50	-0.5	-1A							100			
★ "	"	"	"	-50	-20	-3.5A	22.5 W ($T_c=50^\circ\text{C}$)	100	-3mA	-14	$-35 \frac{V}{V}$ $V_{CB}=0V$ 138	-3A	-2	0.5A					$f_{\alpha} > 7\text{kHz}$	102			
★ "	ゼネラル	PA	Ge. A	-25		-500	200	85	-20	-12	120	-1	-150							12A			
★ "	三菱	"	"	-25	-6	-1A	300	85	-30	-12	80	-1	-150							69			
★ "	"	"	"	-25	-6	-1A	300	85	-30	-12	150	-1	-150							69			
★ "	"	PA. SW	"	-30	-15	-300	250	85	-12	-25	120	-1	-100	-6	1					68			

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考			
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直 流 又 は パ ル ス hFE			バ イ ア ス		h_{fe}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μC)			$f_{\alpha\beta}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie}(real)^*$ (Ω)
									(μA)	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(mA)$	$V_{CB}(V)$	$I_E(mA)$	h_{fe}^*									
★ 2SB481	松下	PA	Ge. A	-32	-10	-1A	6 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	90	-1mA	-32	50	-0.5	-1 A	-2	100								100	
★ "	482 東芝	AF	"	-35	-12	-50	120	85	-6	-12				-6	1	200	6500	9	56				12A	
★ "	483 新電元	PA. SW	"	-80	-40	-15A	60 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-5mA	-80	100	-1.5	-10 A										102	
★ "	484 "	"	"	-100	-40	-15A	60 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-5mA	-100	100	-1.5	-10 A										102	
★ "	485 "	"	"	-140	-40	-15A	60 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-5mA	-140	100	-1.5	-10 A										102	
★ "	486 東芝	AF. LN	"	-25	-12	-50	120	85	-5	-12				-6	1	200	6500	9	56		NF = 3 dB ($f = 1\text{kc}$)		12A	
★ "	487 富士通	PA	"	-30	-2.5	-500	5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-20	-12	60	-1	-300										98A	
★ "	488 "	"	"	-60	-12	-500	5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-20	-12	60	-1	-300										98A	
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					
	"	"	"																					

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考		
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie}^* h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe}^* h_{ob}^* (μU)	$f_{\alpha b}$ f_T^* (Mc)			C_{ob} $h_u(\text{real})^*$ (pF)	r_{bb}^* $h_u(\text{real})^*$ (Ω)
									I_{CBO} (μA)	$V_{CB(V)}$	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$									
2SB511	三洋	PA	Si.E	-35	-5	-1.5A	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-20	40~320	-2	-1A	-5	500							268	
" 512	松下	"	Si.EMe	-60	-8	-3A	$\frac{25\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-30	-20	60	-3	-1A									268	2SD365 とコンプリ
" 513	"	"	"	-60	-8	-3A	$\frac{25\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-30	-20	60	-3	-1A									267	
" 514	三洋	"	Si.E	-50	-5	-2A	$\frac{20\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-20	40~320	-2	-1A	-5	500			8*				268	2SD330 とコンプリ
" 515	"	"	"	-50	-5	-2A	$\frac{20\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-20	40~320	-2	-1A	-5	500			8*				267	2SD331 とコンプリ
★ " 516	日立	"	Ge.A	-20		-100	150	85	-25	-12	110	-1.5	-50									12C	
" 517	"	"	"																				
★ " 518	ソニー	PA	Si.EMe	-90	-8	-7A	$\frac{60\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-50	50	-2	-1A									103	
★ " 519	"	"	"	-110	-8	-10A	$\frac{80\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-50	50	-2	-1A									102	
★ " 520	"	"	"	-140	-8	-12A	$\frac{100\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-50	50	-2	-5A	-2	5A							102	2SD340 とコンプリ
" 521	"	"	"	-60		-5A	$\frac{25\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-50	50	-2	-2.5A									268	
" 522	"	"	"	-60		-5A	$\frac{25\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-50	50	-2	-2.5A									267	
★ " 523	三菱	"	Si.EP	-40	-5	-2A	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-1	-25	120	-4	-500									180	2SD360 とコンプリ
" 524	"	"	"	-60	-5	-1.5A	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-1	-25	100	-4	-500									180	2SD361 とコンプリ
" 525	"	"	"	-30	-4	-1A	800	135	-1	-25	150	-1	-500	-6	10			100*				242	2SD355 とコンプリ
★ " 526	"	"	"	-90	-5	-800	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-10	-25	100	-4	-300									180	2SD356 とコンプリ
" 527	"	"	"	-110	-5	-800	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-10	-25	100	-4	-300									180	2SD357 とコンプリ
" 528	"	"	"	-130	-5	-800	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-10	-25	100	-4	-300									180	2SD358 とコンプリ
" 529	"	"	"	-40	-5	-2A	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-1	-25	110	-4	-500									180	2SD359 とコンプリ
★ " 530	東芝	"	Si.EMe	-110	-5	-8A	$\frac{80\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-50	80	-5	-1A									102	
" 531	"	"	Si.TMe	-100	-5	-6A	$\frac{50\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-50	40~240	-5	-1A	-5	1A							102	
★ " 532	松下	"	Si.EMe	-80	-5	-5A	$\frac{60\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-1mA	-50	100	-4	-1A	-10	500			8*	180			102	
★ " 533	"	"	Ge.A	-20	-12	-2A	$\frac{6\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	85	-200	-20	150	V_{CB} 0V	I_E 2A	-2	100			1.2*				84C	
★ " 534	日立	"	"	-20	-6	-500	200	85	-25	-12	150	-1	-150									12A	
★ " 535	"	"	"	-35		-1A	$\frac{5\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	85	-20	-12	100	-0.5	-500									84B	
" 536	日電	"	SiE	-130	-5	-1.5A	$\frac{20\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-1	-120	110	-5	-300	-5	100			40*	35			268	2SD381 とコンプリ
" 537	"	"	"	-130	-5	-1.5A	$\frac{20\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-1	-120	110	-5	-300	-5	100			40*	35			267	2SD382 とコンプリ
★ " 538	日立	"	Ge.A	-65	-30	-15A	$\frac{75\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	100	-10mA	-65	100	-2	-10A									102	
★ " 539	日電	"	Si.TMe	-130	-6	-10A	$\frac{100\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	-100	-120	75	-5	-2A									102	2SD287 とコンプリ
★ " 540	東芝	"	Ge.A	-50	-12	-2A	$\frac{6\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	85	-100	-25	120	-2	-3A	-1	100			1.4				84B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB(V)}	直流又はパルス hFE V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	バイアス V _{CB(V)}	I _{E(mA)}	h _{FE} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oc} h _{cb} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(real)} * (Ω)	
★ 2SB541	日電	PA	Si.TMe	-110	-6	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-100	80	-5	-1A	-10	200					7 *	320	102	2SD388 とコンプリ	
★ "	三菱	"	Si.EP	-20	-5	-300	300	125	-1	-20	150	-2	-150	-6	10					150 *		138B	2SD392 とコンプリ	
"	543	"	"																					
"	544	三洋	PA	Si.EP	-25	-5	-1A	900	150	-1	-20	60-560	-2	-50	-10	50				180 *	25	294	2SD400 とコンプリ	
"	545	"	"																					
★ "	546	日電	PA	Si.TMe	-200	-5	-2A	20W (T _c =25°C)	150	-50	-150	90	-10	-400									268	2SD401 とコンプリ
★ "	547	"	"	"	-200	-5	-2A	20W (T _c =25°C)	150	-50	-150	90	-10	-400									267	2SD402 とコンプリ
"	548	"	"	Si.E	-100	-5	-800	10W (T _c =25°C)	150	-1	-80	90	-5	-200	-5	100				70 *	25	225	2SD414 とコンプリ	
"	549	"	"	"	-100	-5	-800	10W (T _c =25°C)	150	-1	-80	90	-5	-200	-5	100				70 *	25	225	2SD415 とコンプリ	
"	550	"	PA.SW	Si.EMe	-100	-10	-5A	25W (T _c =25°C)	150	-100	-80	80	-5	-1A	-10	100				10 *		134		
"	551	日立	PA	Si.T	-50	-4	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-100	-20	35-200	-4	-1A	-4	500				32 *		153	2SD830 とコンプリ	
"	552	東芝	PA	Si.TMe	-220	-5	-15A	150W (T _c =25°C)	150	-100	-150	25-80	-5	-5A	-10	1A				3.5 *	300	102	2SD552 とコンプリ	
"	553	"	SW.PA	Si.T	-70	-5	-7A	40W (T _c =25°C)	150	-30	-70	70-240	-1	-1A	-4	1A	t _{on} = 0.2μS, t _{off} = 0.5μS			10 *	250	268	2SD553 とコンプリ	
"	554	"	PA	Si.TMe	-180	-5	-15A	150W (T _c =25°C)	150	-100	-90	40-140	-5	-2A	-5	2A				6 *	450	102	2SD424 とコンプリ	
"	555	"	"	"	-140	-5	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-60	40-140	-5	-2A	-5	2A				6 *	330	102	2SD425 とコンプリ	
★ "	556	"	"	"	-120	-5	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-60	40-140	-5	-2A	-5	2A				6 *	330	102	2SD426 とコンプリ	
"	557	"	"	"	-120	-5	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-60	40-140	-5	-1A	-5	1A				7 *	280	102		
"	558	"	"	"	-100	-5	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-100	-50	40-140	-5	-1A	-5	1A				7 *	220	102	2SD428 とコンプリ	
"	559	三洋	"	Si.EP	-20	-5	-1.2A	8W (T _c =25°C)	150	-1	-15	60-320	-2	-500	-10	50				150 *	30	296	2SD439 とコンプリ	
"	560	"	"	"	-100	-5	-700	900	150	-1	-20	60-560	-5	-50	-10	50				100 *	15	294	2SD438 とコンプリ	
"	561	日立	"	Si.E	-25	-5	-700	500	150	-1	-20	85-240	-1	-150	-1	150				350 *	20	138	2SD467 とコンプリ	
"	562	"	"	"	-25	-5	-1A	900	150	-1	-20	85-240	-2	-500	-2	500				350 *	38	251	2SD468 とコンプリ	
"	563	日電	PA.SW	Si.EMe	-80	-5	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-100	-70	70	-2	-1A			t _{on} = 0.4μS, t _{off} = 1.2μS					134	2SD297 とコンプリ	
"	564	"	PA	Si.E	-30	-5	-1A	800	150	-0.1	-30	200	-1	-100	-6	10				110 *	36	278		
"	565	日立	"	Si.T	-50	-4	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-100	-20	100	-4	-1A									267	
★ "	566	"	"	"	-70	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-1	-20	60-320	-4	-1A	-4	500				15 *		268	2SD476 とコンプリ	
★ "	567	"	"	"	-200	-6	-2A	30W (T _c =25°C)	150	-1	-120	150	-4	-50									267	
★ "	568	"	"	"	-200	-6	-2A	30W (T _c =25°C)	150	-1	-120	60-320	-4	-50								30	268	SD478 とコンプリ
"	569	モトローラ	"	Si.E	-40	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-500	-40	6000	-3	-2A									252	2SD479 とコンプリ
"	570	"	"	"	-60	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-500	-60	6000	-3	-2A									252	2SD480 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考								
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		h _{FE} 最大値		h _{FE}	h _{FE}	h _{FE}	h _{FE}			f _α	C _{ob}	r _{bb'}	h _{ie} (real)*				
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)											h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *
2SB601	日電	PA.SW	Si.E テリントロン	-100	-7	-5A	30W (T _c =25°C)	150	-10	-100	2000- 15000	-2	-3A											268	2SD560 とコンプリ			
" 602																												
" 603	日電	SW	Si.T	-500	-7	-500	800	175	-10	-500	>50	-5	-100												84B			
" 604	松下	PA	Si.TMe	-70	-5	-4A	30W (T _c =25°C)	150	-1mA	-70	120	-5	-500												268			
" 605	日電	"	Si.E	-60	-5	-700	800	150	-0.1	-60	200	-1	-100												278	2SD571 とコンプリ		
" 606	富士通	SW	Si.EP	-250	-5	-500	800	175	-0.5	-200	70	-10	-10												84C			
" 607	松下	PA	Ge.A	-30	-10	-1A	3W (T _c =25°C)	85	-10	-10	60	-0.5	-1A	-2	100										84C			
" 608																												
" 609																												
" 610																												
" 611	日立	PA	Si.E	-150	-6	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-10	-120	120	-5	-1A													102		
" 612	"	"	"	-180	-6	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-10	-160	100	-5	-1A													102		
" 613	"	"	"	-250	-6	-15A	150W (T _c =25°C)	150	-10	-220	120	-5	-2A													102		
" 614																												
" 615	三菱																											
" 616	日電	PA	Si.E	-100	-5	-5A	60W (T _c =25°C)	150	-10	-80	80	-5	-1A	-5	100											295	2SD586 とコンプリ	
" 617	"	"	Si.T	-120	-5	-6A	70W (T _c =25°C)	150	-50	-100	80	-5	-1A	-5	200											295	2SD587 とコンプリ	
" 618	"	"	"	-150	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-50	-120	80	-5	-1A	-5	200											295	2SD588 とコンプリ	
" 619	松下	"	Ge.A	-32	-10	1.3A	300	90	-10	-10	115	-0.5	-300													12A		
" 620	"	"	Si.EP	-25	-5	-50	250	125	-1	-10	250	-5	-2	-10	1											138		
" 621	"	AF	"	-30	-5	-1A	600	135	-0.001	-20	160	-10	-500	-5	1											138		
" 622	サンケン	PA	Si.TMe	-400	-6	-300	800	150	-100	-400	>30	-4	-50	-5	100											84B	2SD593 とコンプリ	
" 623																												
" 624	日電	AF	Si.E	-30	-5	-700	200	150	-0.1	-30	200	-1	-100	-6	10											176	2SD596 とコンプリ	
" 625																												
" 626																												
" 627	松下	PA	Ge.A	-40	-14	-10A	13W (T _c =25°C)	85	-1mA	-40	150	V _{CE} -0.5	-3A														83	
" 628	日電	"	Si.E	-160	-5	-1.5A	20W (T _c =25°C)	150	-1	-120	80	-5	-300	-5	100												268	2SD608 とコンプリ
" 629																												
" 630	日電	PA	Si.E	-200	-5	-2A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-150	80	-10	-500	-10	500												268	2SD610 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考				
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バ イ ア ス		h_{fe} h_{fe}^*	h_{ie} h_{ie}^* (Ω)	h_{re} h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oc} h_{oc}^* (μV)	$f_{\alpha b}$ f_{β}^* (Mc)			C_{ob} (pF)	r_{ib} $r_{ib}(\text{real})^*$ (Ω)		
									μA	$V_{CE}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$											
★ 2SB691	松下	PA	Si.EMe	-130	-5	-5A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-80	100	-5	-1A	-5	500					7 *	190	152	2SD727 とコンプリ		
★ "	692	"	"	-150	-5	-6A	70W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-100	100	-5	-1A	-5	500					7 *	300	152	2SD728 とコンプリ		
"	693	日立	SW.PA	Si.EPa	-100	-7	-20A	125W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	I_{CBO} -1	-80	1000~ 20000	-3	-10A								102	ダーリントン ダンプ内蔵		
"	694	"	PA	"	-100	-7	-25A	125W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	I_{CBO} -100	-80	1000~ 20000	-3	-12A								102	ダーリントン ダンプ内蔵		
★	695	松下	"	Si.EMe	-170	-5	-7A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-120	100	-5	-1A	-5	500						7 *	350	152	2SD731 とコンプリ
"	696	三洋	"	"	-150	-6	-8A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	40~320	-5	-1A	-5	1A						15 *		102	2SD732 とコンプリ
"	697	"	"	"	-160	-6	-12A	100W	150	-100	-80	40~320	-5	-1A	-5	1A						15 *		102	2SD733 とコンプリ
"	698	"	"	Si.EP	-25	-5	-700	600	150	-1	-20	60~560	-2	-5A	-10	50						250 *	13	138	2SD734 とコンプリ
★	699	日立	"	Si.T	-160	-5	-12A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-120	35~200	-5	-1A										332	2SD735 とコンプリ
★	700	"	"	"	-160	-5	-12A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-120	60~200	-5	-1A										332	2SD736 とコンプリ
"	701	"	"	"	-160	-5	-12A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-140	120	-5	-1A										332	
★	702	"	"	"	-160	-5	-12A	125W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-140	60~200	-5	-1A										332	2SD738 とコンプリ
"	703	日電	PA.SW	Si.E	-100	-5	-4A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-80	100	-5	-500	-5	100						18 *	110	268	2SD743 とコンプリ
"	704	"	"	"																					
"	705	日電	PA	Si.T	-140	-5	-10A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-140	80	-5	-2A	-5	200						17 *	430	340	2SD745 とコンプリ
★	706	"	"	"	-180	-5	-10A	200W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-180	80	-5	-2A	-5	200						14 *	450	265	2SD746 とコンプリ
"	707	"	PA.SW	Si.E	-80	-7	-7A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-60	40~200	-1	-3A										268	2SD568 とコンプリ
"	708	"	"	"	-80	-7	-7A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-60	40~200	-1	-3A										268	2SD569 とコンプリ
"	709	松下	AF	Si.EP	-25	-5	-100	200	125	-1	-10	90~650	-10	-2A	-10	1						80 *	2.7	176	2SD601 とコンプリ
"	710	"	"	"	-30	-5	-500	200	125	-0.1	-10	160	-10	-150	-10	50						200 *	6	176	2SD602 とコンプリ
"	711	サンケン	PA	"	-80	-6	-6A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	1000	-4	-7A										298	ダーリントン
"	712	"	"	"	-100	-6	-6A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-100	1000	-4	-7A										298	ダーリントン
"	713	松下	"	Si.EMe	-200	-5	-9A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-140	100	-5	-1A	-5	500						7 *		152	2SD751 とコンプリ
"	714	"	"	Ge.A	-20	-10	-2A	6W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	85	-500	-20	120	-0.6	-2A	-2	100						1.2 *		84C	
"	715	日立	"	Si.E	-100	-5	-50	750	150	-0.5	-80	250~800	-12	-2	-12	5						120 *	1.8	251	2SD755 とコンプリ
"	716	"	"	"	-120	-5	-50	750	150	-0.5	-80	250~800	-12	-2	-12	5						150 *	1.8	251	2SD756 とコンプリ
"	717	"	"	"	-160	-5	-50	1.25W	150	-10	-140	60~320	-5	-10	-5	10						140 *	5.5	234	2SD757 とコンプリ
"	718	"	"	"	-200	-5	-50	1.25W	150	-10	-160	60~320	-5	-10	-5	10						140 *	5.5	234	2SD758 とコンプリ
★	719	"	"	"	-160	-5	-2A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-140	35~320	-5	-150	-5	150						100 *	32	268	2SD759 とコンプリ
★	720	"	"	"	-200	-5	-2A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-160	35~200	-5	-150	-5	150						100 *	32	268	2SD760 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)													外形	備考		
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}			バイアス			h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oc} h_{ob}^* (μV)	f_{ob} f_{rc}^* (Mc)			C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)
									I_{CBO} (μA)	V_{CB} (V)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	V_{CB} (V)	I_E (mA)	I_{CBO} (μA)	I_C (mA)									
★ 2SB721	日立	PA	Si.E	-25	-5	-700	625	150	-0.1	-20	100~320	-1	-350	-1	150					350*	20		138D	2SD754 とコンプリ	
" 722	"	"	Si.T	-160	-5	-15A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-140	100	-5	-1A										102		
★ " 723	"	"	"	-200	-5	-15A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-160	35~200	-5	-1A										102	2SD753 とコンプリ	
★ " 724	松下	"	Si.EMe	-60	-5	-3A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-30	-20	80	-3	-1A										268		
" 725	"	AF	Si.EP	-60	-5	-100	250	125	-1	-10	250	-5	-2	-5	1	120	3.4k	1.5	13				138		
" 726	"	"	"	-80	-5	-100	250	125	-0.1	-10	360	-5	-2	-5	1	400	1.6k	1.5	12				138		
" 727	日立	SW	Si.E	-120	-7	-6A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-120	1000~ 20000	-3	-3A										268	ターリントン タンパ内蔵	
" 728																									
" 729																									
" 730																									
" 731	日電	PA.SW	Si.E	-60	-6	-1A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-0.1	-50	250	-2	-100	-2	10					75*	25		225		
" 732																									
" 733	日電	PA	Si.E	-20	-6	-2A	1W	150	-0.1	-16	300	-2	-100	-2	10					>50*	27		278	2SD773 とコンプリ	
" 734	"	"	"	-60	-6	-1A	1W	150	-0.1	-50	250	-2	-100	-2	10					80*	23		278	2SD774 とコンプリ	
" 735																									
" 736	日電	PA	Si.E	-60	-5	-300	200	150	-0.1	-50	200	-1	-50	-6	10					100*	13		176	2SD780 とコンプリ	
" 737	ローム	AF.LN	Si.EP	-50	-5	-300	250	125	-0.5	-30	120~560	-6	-10	-6	10	$V_{CC} < 150\text{mV}$ (10V, 1mA, $R_C = 100\text{k}\Omega$, $A_c = 80\text{dB}$)			100*		2	138	2SD786 とコンプリ		
" 738	日立	PA	Si.E	-20	-6	-2A	900	150	-2	-16	100~320	-2	-100	-2	10					80*	50		251	2SD787 とコンプリ	
" 739	"	"	"	-20	-6	-2A	900	150	-2	-16	100~320	-2	-100	-2	10					80*	50		251	2SD788 とコンプリ	
" 740	"	"	"	-70	-6	-1A	900	150	-1	-55	100~320	-2	-100	-2	10					65*	35		251	2SD789 とコンプリ	
" 741	"	"	"	-70	-6	-1A	900	150	-1	-55	200	-2	-100	-2	10					65*	35		251	2SD790 とコンプリ	
" 742	日電	"	"	-20	-6	-2A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-0.1	-16	300	-2	-100										225		
★ " 743	"	PA.SW	"	-40	-5	-3A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1	-30	100	-5	-1A	-5	100					55*	75		225	2SD793 とコンプリ	
" 744	"	"	"	-70	-5	-3A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1	-45	100	-5	-500	-5	100					45*	60		225	2SD794 とコンプリ	
" 745	松下	LN	Si.EP	-35	-5	-50	300	135	-0.1	-10	490	-5	-2	-5	1	500	3.5k	1.4	12	$NF = 0.5\text{dB}$ (-10V, -1mA, $f = 1\text{kHz}$)			151		
" 746	日立	PA	"	-25	-5	-500	400	150	-0.2	-18	120	-1	-50	-1	50					260*	4.6	C_{rbb} 12pS	138		
" 747	松下	"	"	-80	-5	-5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-80	90	-5	-1A										268		
" 748	日立	"	Si.T	-120	-5	-6A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-80	100	-5	-1A										332		
" 749	"	"	"	-120	-5	-7A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-100	100	-5	-1A										332		
" 750	松下	PA.SW	Si.EP	-60	-5	-2A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-60	1000~ 10000	-4	-1A										268	ターリントン	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考								
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _F E		β イ ア ス		h _{FE}	h _{FE} h _{FE} *	h _{FE} h _{FE} * (Ω)	h _{FE} h _{FE} * (×10 ⁻⁴)			h _{FE} h _{FE} * (μU)	f _α f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)				
									μA	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}											h _{FE}	h _{FE} *		
2SB751	松下	PA.SW	Si.EP	-60	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-200	-60	1000~ 10000	-3	-3A											268	ゲーリントン			
" 752																												
" 753	東芝	SW.PA	Si.T	-100	-5	-7A	40W (T _c =25°C)	150	-5	-100	70~240	-1	-1A	-4	1A								10*	250	268	2SD843 とコンプリ		
" 754	"	"	"	-50	-5	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-10	-50	70~240	-1	-1A	-5	1A								10*	300	179	2SD844 とコンプリ		
" 755	"	PA	"	-150	-5	-12A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-150	55~160	-5	-1A	-10	1A								20*	450	125	2SD845 とコンプリ		
" 756																												
" 757	富士電機	SW.PA	Si.EP	-40	-5	-15A	80W (T _c =25°C)	150	-10	-40	>40	-2	-5A													211	2SD847 とコンプリ	
" 758	日電	PA	Si.T	-120	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-50	-110	80	-5	-1A														295	
" 759	松下	AF.RF	Si.EP	-25	-5	-50	250	125	-1	-10	90~700	-5	-2														276	
" 760	"	PA	"	-60	-5	-1A	30W (T _c =25°C)	150	-200	-60	120	-4	-200														268	
" 761	"	"	"	-60	-5	-3A	35W (T _c =25°C)	150	-200	-60	100	-4	-1A														268	
" 762	"	"	"	-60	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-400	-60	100	-4	-1A														268	
" 763	"	"	"	-60	-5	-5A	60W (T _c =25°C)	150	-400	-60	120	-4	-1A														152	
" 764	三洋	AF.PA	Si.EP	-60	-5	-1A	900	150	-1	-50	60~320	-2	-50	-10	50								150*	20	294	2SD863 とコンプリ		
" 765	日立	SW	Si.TP	-120	-7	-3A	30W (T _c =25°C)	150	-100	-120	1000~ 20000	-3	-1.5A														268	ゲーリントン ダンパ内蔵
" 766	松下	PA	Si.EP	-30	-5	-1A	500	125	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50								200*	20	336	2SD874 とコンプリ		
" 767	"	"	"	-80	-5	-500	500	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50								120*	20	336	2SD875 とコンプリ		
" 768	日電	"	Si.T	-200	-5	-2A	20W (T _c =25°C)	150	-50	-150	40~200	-10	-400	-10	400								10*			185	2SD1033 とコンプリ	
" 769																												
" 770																												
" 771																												
" 772	日電	PA.SW	Si.E	-40	-5	-3A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-30	160	-2	-1A	-5	100								80*	55	225	2SD882 とコンプリ		
" 773	"	PA	Si.T	-100	-5	-6A	70W (T _c =25°C)	150	-50	-90	80	-5	-1A														295	
" 774	松下	AF	Si.EP	-30	-15	-100	250	125	-1	-10	120~650	-10	-2										150*	4	138			
" 775	三洋	PA.SW	Si.P	-100	-6	-6A	60W (T _c =25°C)	150	-100	-40	60~200	-5	-1A	-5	1A								13*	150	155	2SD895 とコンプリ		
" 776	"	"	"	-120	-6	-7A	70W (T _c =25°C)	150	-100	-80	60~200	-5	-1A	-5	1A								15*	200	155	2SD896 とコンプリ		
" 777	富士電機	AF.PA	Si.EP	-80	-7	-10A	80W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	120	-5	-2A														211	
" 778	"	"	"	-120	-7	-10A	80W (T _c =25°C)	150	-1mA	-120	120	-5	-2A														211	
" 779	松下	AF	"	-25	-7	-500	200	125	-0.1	-25	65~220	-2	-500	-10	50								150*	15	176	2SD813 とコンプリ		
" 780	"	"	"	-30	-5	-500	400	125	-0.1	-20	60~340	-10	-150										200*	6	276			

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考											
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{je} $h_{j\beta}^*$	h_{ie} $h_{i\beta}^*$ (Ω)	h_{re} $h_{r\beta}^*$ ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	$f_{\beta\beta}$ f_T^* (Mc)			C_{ob} (pF)	r_{bb} $r_{be(react)}^*$ (Ω)									
									μA	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$																		
2SB781	日立	PA	Si.T	-50	-5	-4A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-50	200	-5	-500											268								
" 782	"	"	"	-60	-5	-4A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-50	120	-5	-500												268							
" 783	"	"	"	-80	-5	-4A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-60	100	-5	-500												268							
" 784																																
" 785																																
" 786	ローム	AF.PA	Si.EP	-40	-5	-2A	5W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1	-24	10000	-3	-500												232	ターリントン						
" 787	日立	"	Si.E	-120	-5	-50	625	150	-10	-100	120	-5	-10													138D						
" 788	松下	AF.LN	Si.EP	-120	-7	-20	400	135	-0.1	-50	180-1040	-5	-2													151						
" 789	"	AF	"	-100	-5	-500	1W (プリント基板使用)	150			65-330	-10	-150													336	2SD968 とコンプリ					
" 790	"	"	"	-25	-7	-500	600	135	-0.1	-25	65-220	-2	-500								150*	15				151						
" 791	日立	SW	Si.T	-120	-7	-8A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-120	1000- 20000	-3	-4A														268	2SD870 とコンプリ				
" 792	松下	AF	Si.EP	-150	-5	-50	200	125	-1	-100	90-450	-5	-10														176	2SD814 とコンプリ				
" 793	"	"	"	-30	-5	-1A	1W	150	-0.1	-20	50-340	-10	-500															151				
" 794	日電	PA.SW	Si.E	-60	-8	-1.5A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-60	7000	-2	-1A															225	ターリントン			
" 795	"	"	"	-80	-8	-1.5A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-10	-80	7000	-2	-1A															225	ターリントン			
" 796	"	PA	Si.T	-200	-5	-10A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-200	80	-5	-2A	-5	200													102	2SD987 とコンプリ			
" 797																																
" 798	日電	PA	Si.E	-30	-5	-1A	2W 150 (セラミック基板使用)	150	-0.1	-30	200	-1	-100	-6	10														336	2SD999 とコンプリ		
" 799	"	"	"	-60	-5	-700	2W 150 (セラミック基板使用)	150	-0.1	-60	200	-1	-100	-6	10															336	2SD1000 とコンプリ	
" 800	"	AF	"	-80	-5	-300	2W 150 (セラミック基板使用)	150	-0.1	-80	290	-1	-50	-6	10															336	2SD1001 とコンプリ	
" 801	"	"	"	-45	-5	-1A	400	150	-0.1	-30	100	-2	-150	-5	10															336		
" 802	"	"	"	-60	-5	-1A	400	150	-0.1	-30	90	-2	-150	-5	10															336		
" 803	"	"	"	-100	-5	-1A	400	150	-0.1	-30	90	-2	-150	-5	10															336		
" 804	"	"	"	-100	-5	-1A	2W 150 (セラミック基板使用)	150	-0.1	-100	200	-2	-100	-5	10																336	2SD1005 とコンプリ
" 805	"	"	"	-100	-5	-700	2W 150 (セラミック基板使用)	150	-0.1	-100	200	-1	-100	-10	10																336	2SD1006 とコンプリ
" 806	"	"	"	-120	-5	-700	2W 150 (セラミック基板使用)	150	-0.1	-120	200	-1	-100	-10	10																336	2SD1007 とコンプリ
" 807	松下	"	Si.EP	-150	-5	-50	1W 150 (プリント基板使用)	150	-1	-100	90-450	-5	-10	-10	10																336	2SD1009 とコンプリ
" 808	三洋	PA	"	-20	-5	-700	250	125	-1	-15	160-960	-2	-50	-10	50															92	2SD1012 とコンプリ	
" 809																																
" 810	日電	AF	Si.E	-30	-5	-700	350	150	-0.1	-30	200	-1	-100	-6	10																42	2SD1020 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)		直流又はパルス hFE V _{CE} (V) I _C (mA)		バイアス V _{CB} (V) I _E (mA)		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)	
2SB811	日電	PA	Si. E	-30	-5	-1A	350	150	-0.1	-30	200	-4	-100	-6	10								42	2SD1021 とコンプリ
" 812	松下	"	Si. EP	-60	-5	-4A	60W (T _c =25°C)	150	-400	-60	40-250	-4	-3A										152	2SD1032 とコンプリ
" 813	三洋	"	Si. TP	-60	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-100	-40	100	-2	-1A										268	
* " 814	松下	AF. LN	Si. EP	-120	-5	-20	200	125	-0.1	-50	260-1040	-5	-2										176	
" 815	三洋	AF	"	-20	-5	-700	200	125	-0.1	-15	160-960	-2	-50	-10	50						250*	13	176	2SD1048 とコンプリ
" 816	"	PA. SW	Si. P	-150	-6	-8A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-80	60-200	-5	-1A	-5	1A						15*	220	155	2SD1046 とコンプリ
" 817	"	"	"	-160	-6	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-100	-80	60-200	-5	-1A	-5	1A						15*	300	155	2SD1047 とコンプリ
" 818	日立	AF. PA	Si. E	-100	-7	-10A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-100	2000	-3	-5A										332	テーリントン ダンパ内蔵
" 819	松下	AF	Si. EP	-50	-5	-1.5A	1W	150	-1	-20	30-220	-5	-1A								150*	45	151	
" 820	日電	PA	Si. T	-350	-7	-1A	15W (T _c =25°C)	150	-10	-300	50	-5	-100										185	
" 821	ローム	LN	Si. EP	-50	-5	-300	250	125	-0.5	-30	270	-6	-10	-6	1		8.1k	2.9	19.6	NF=1dB (f=10MHz)			235	
" 822	"	AF	"	-40	-5	-2A	750	135	-1	-20	180	-3	-500										235	
" 823	三洋	PA	"	-100	-6	-6A	40W (T _c =25°C)	150	-100	-40	100	-5	-1A										268	
" 824	"	"	"	-60	-6	-5A	30W (T _c =25°C)	150	-100	-40	120	-2	-1A										268	
" 825	"	PA. SW	"	-60	-6	-7A	40W (T _c =25°C)	150	-100	-40	100	-2	-1A										268	
" 826	"	"	"	-60	-6	-12A	40W (T _c =25°C)	150	-100	-40	100	-2	-1A										268	
" 827	"	"	"	-60	-6	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-100	-40	100	-2	-1A										155	
" 828	"	"	"	-60	-6	-12A	80W (T _c =25°C)	150	-100	-40	100	-2	-1A										155	
" 829	"	"	"																					
" 830	日立	PA	Si. E	-20	-6	-2A	900	150	-2	-16	220	-2	-100										251	
" 831	"	"	"	-25		-700	150	125	-1	-20	140	-1	-150										176	2SD1101 とコンプリ
" 832	ソニー	SW. PA	Si. Pa	-1000	-10	10	25W (T _c =25°C)	120	I _{CES} -10	-1000	>50	-5	-1	-10	1						4.5*	4.3	268	2SD1068 とコンプリ
" 833	東芝	AF. PA. SW	Si. T	-80	-5	-30A	150W (T _c =25°C)	150	-100	-80	4000	-5	-20A										102	テーリントン ダンパ内蔵
" 834	"	AF. PA	"	-60		-3A	30W (T _c =25°C)	150	-100	-60	100	-5	-500										268	
" 835	松下	AF	Si. EP	-20	-5	-1A	500	150	-1	-10	90-360	-2	-500								200*	40	151	
" 836	日立	PA	Si. E	-25	-5	-2.5A	20W (T _c =25°C)	150	-20	-25	160	-2	-500										245	2SD1077 とコンプリ
" 837	"	"	"	-35	-5	-2.5A	20W (T _c =25°C)	150	-20	-35	160	-2	-500										245	
" 838	"	"	"	-50	-4	-2A	20W (T _c =25°C)	150	-20	-50	120	-4	-50										245	
" 839	"	"	"	-80	-4	-2A	20W (T _c =25°C)	150	-20	-80	120	-4	-50										245	
" 840	"	"	"	-180	-5	-1.5A	20W (T _c =25°C)	150	-10	-160	100	-5	-150	-5	150						140*	25	245	2SD1080 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考					
				V_{CB0} (V)	V_{E0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バ イ ア ス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T^* (Mc)			C_{ob} (pF)	$\tau_{bb'}$ $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)			
									μA	$V_{CB}(\text{V})$	$V_{CE}(\text{V})$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(\text{V})$	$I_E(\text{mA})$												
2SB901	日立	AF. PA	Si. T	-60		-4A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-20	120	-4	-1A											268		
" 902	松下	AF	Si. EP	-30	-15	-100	200	125	-1	-10	300	-10	-2											176		
" 903	三洋	PA	"	-60	-6	-12A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-40	140	-2	-1A											268		
" 904	"	"	"	-60	-6	-20A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-40	140	-2	-1A											346		
" 905	東芝	"	Si. E	-150	-6	-1.5A	1 W	150	-1	-150	120	-5	-200											344		
" 906	"	AF. PA	Si. T	-60	-7	-3A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-60	100	-5	-500											344		
" 907	"	PA	Si. E	-60	-5	-3A	1 W	150	-1	-60	5000	-2	-1A										344	ダークトント ンパ内蔵		
" 908	"	"	"	-100	-5	-4A	1 W	150	-1	-100	5000	-2	-1A										344	ダークトント ンパ内蔵		
" 909	ローム	AF	Si. EP	-40	-5	-1A	1 W	135	-0.5	-20	180	-3	-100											235		
" 910	"	"	"	-80	-5	-700	1 W	135	-0.5	-50	180	-3	-100											235		
" 911	"	"	"	-40	-5	-2A	1 W	135	-1	-20	180	-3	-500											235		
" 912	三洋	PA	"	-70	-6	-10A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-40	5000	-2	-5A											346	ダークトント ンパ内蔵	
" 913	"	"	"	-110	-6	-8A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	4000	-3	-4A											346	ダークトント ンパ内蔵	
" 914	"	"	"	-70	-6	-10A	70W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-40	5000	-2	-5A											102	ダークトント ンパ内蔵	
" 915	"	"	"	-70	-6	-15A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-40	5000	-2	-7A											102	ダークトント ンパ内蔵	
" 916	"	"	"	-110	-6	-8A	70W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	4000	-3	-4A											102	ダークトント ンパ内蔵	
" 917	"	"	"	-110	-6	-10A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	4000	-3	-5A											102	ダークトント ンパ内蔵	
" 918	富士通	AF	"	-250	-5	-500	500	150	-0.5	-200	70	-2	-100											138		
" 919	三洋	PA	"	-60	-6	-8A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-40	150	-2	-1A												268	
" 920	"	"	"	-120	-6	-5A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	150	-2	-1A												268	
" 921	"	"	"	-120	-6	-7A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	150	-2	-1A												268	
" 922	"	"	"	-120	-6	-12A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	150	-2	-1A												346	
" 923	"	"	"	-120	-6	-20A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	150	-2	-1A												102	
" 924	"	"	"	-120	-6	-25A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	150	-2	-1A												102	
" 925	松下	SW	Si. P	-40	-5	-7A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-40	50-260	-2	-2A												268	
" 926																										
" 927																										
" 928	松下	PA	Si. EP	-200	-6	-2A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-200	60-240	-10	-150												363	2SD1250 とコンパリ
" 929	"	"	"	-60	-5	-3A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40-250	-4	-1A												363	2SD1252 とコンパリ
" 930	"	"	"	-60	-5	-4A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40-250	-4	-1A												363	2SD1253 とコンパリ

$t_{on}=0.1\mu\text{S}$, $t_f=0.1\mu\text{S}$
 $t_r=0.3\mu\text{S}$

150 * 140

$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_f=0.3\mu\text{S}$
 $t_r=1.2\mu\text{S}$

$t_{on}=0.2\mu\text{S}$, $t_f=0.2\mu\text{S}$
 $t_r=0.3\mu\text{S}$

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考			
				V_{CB0} (V)	V_{E0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe}	h_{ie}^* (Ω)	h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe}^* (μU)	f_{β}^* (Mc)			C_{ob} (pF)	r_{bb}^* $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)	
									μA	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$										h_{fb}^*
★ 2SC 38	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc.	Si. E	40	3	200	750	175	0.1	30			10	-10	50			200*	4	50	84B			
★ " 39	富士通	RF	Si. Me	25	3	50	250	150	0.1	10			6	-1	50			500*	2.3	80*	49C			
★ " 39A	"	"	Si. P	25	3	50	250	150	0.1	10			6	-3	120	NF < 6 dB ($f = 1 \text{ Mc}$)		350*	3	65*	49C			
★ " 40	"	"	Si. Me	25	3	50	250	150	0.1	10			6	-1	50			750*	2.3	80*	49C			
★ " 41	ソニー	"	"	150		5 A	$\frac{50 \text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	60 mA	150	28	10	1 A	10	-0.5A			20	250	5	103			
★ " 42	"	"	"	150	6	5 A	$\frac{50 \text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	60 mA	150	28	10	1 A	10	-0.5A			20	250	5	103			
★ " 42A	"	"	"	200	6	5 A	$\frac{50 \text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	30	50	40	10	1 A	10	-0.5A			20*	250		103			
★ " 43	"	"	"	100	6	5 A	$\frac{50 \text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	60 mA	100	28	10	1 A	10	-0.5A			20	250	5	103			
★ " 44	"	"	"	50	6	5 A	$\frac{50 \text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	60 mA	50	28	10	1 A	10	-0.5A			20	25	5	103			
★ " 45	日電	RF	Si. P	45		100	500	150	1	30	50	2	10	10	-10	50		160*	4	130*	84B			
★ " 46	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc. SW	Si. Me	60	5	300	600	150	0.1	10	50	1	10	6	-1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35*	84C	
★ " 47	"	"	"	40	5	300	600	150	1	6	50	1	10	6	-1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35*	84C	
★ " 48	"	"	"	120	5	300	600	150	0.1	10	50	1	10	6	-1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35*	84C	
★ " 49	日電	RF. IF. Conv Mix. Osc	Si. E	120	6	300	800	175	0.5	60	60	10	150	10	-50	60		160*	10	17	84B			
★ " 50	松下	RF. Conv Mix. Osc	Ge. A	20	20	200	100	75	3	5				6	-1	45		12	20	100	20			
★ " 51	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc. PA	Si. Me	60	5	300	1 W	150	0.1	10	50	1	10	6	-1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35	80	
★ " 52	"	"	Si. P	40	5	100	500	150	0.03	10	50	1	10	6	-1	50	28*	1.5*	0.1*	350*	4	40*	84C	
★ " 53	"	RF. IF. Conv Mix. Osc. PA	"	25	3	100	600	150	0.5	10	50	1	10	6	-1	50		300*	4	40*	84C			
★ " 54	"	RF. IF. Conv Mix. Osc. SW	"	40	5	100	300	150	0.03	10	50	1	10	6	-1	50	28*	1.5*	0.1*	350*	4	40*	49C	
★ " 55	"	RF. IF. Conv Mix. Osc. PA	"	25	3	100	360	150	0.5	10	50	1	10	6	-1	50		300*	4	40*	49C			
★ " 56	"	RF. Conv Mix. Osc	"	20	3	25	200	120	2	12				6	-2	80		180*	2.3	80*	30			
★ " 57	日電	PA	Si. Me	75	4	500	$\frac{13 \text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	30	30	30	10	150					110*	22		83			
★ " 58	松下	RF. IF. Conv Mix. Osc. PA	"	60	1.5	60	600	175	2	12	50	12	10	12	-10	50		250*	2.5	170	84A			
★ " 58A	"	"	"	140	1.5	60	600	175	2	12	50	12	10	12	-10	50		250*	2.5	170	84A			
★ " 59	日電	RF	Si. E	120	6	300	800	175	0.5	60	35	10	150	10	-50	35		150*	10	17	84B			
★ " 60	三洋	"	Ge. A	20	10	20	100	85	15	20				6	-1	50		5	15	80	12B			
★ " 61	富士通	RF. IF. Conv Mix. Osc. SW	Si. Me	30	5	300	1.2 W	175	1	10	50	1	10	6	-1	50	28*	0.8*	0.1*	180*	15	35	80	
★ " 62	日立	SW	Si. P	40	5	50	360	175	0.025	15	100	1	10	10	-10			300*	5.5		49C			
★ " 63	日電	"	Si. Me	25	3	50	300	150	1	15	40	1	10	10	-10			400*	4.5		49C			
★ " 64	三洋	RF	"	80	2	50	600	175	1.5	20				20	-5	50		100*	5	80	84B			

2SC

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE			バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)			f _{βB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (resl)* (Ω)	
									μA	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *
2SC 65	三洋	RF	Si.Me	150	4	50	600	175	15	150	30	20	5	20	-5	20				200*	<10	<200	84B		
" 66	"	"	"	150	2	50	600	175	1.5	20						20	-5	70		130*	5	100	84B		
" 67	日電	SW	Si.E	40	5	200	360	175	0.1	15	80	1	10						t _{on} < 20nS, t _{off} < 40nS t _{sig} < 20nS				49C		
" 68	"	SW	"	40	5	200	360	150	0.1	15	100	1	10	10	-10				t _{on} < 20nS, t _{off} < 40nS t _{sig} < 20nS		400*	3.5	40*	49C	
" 69	"	RF	"	120	6	300	800	175	0.5	60	50	1	150	10	-50	50			h _{fj} = 18dB (f = 20MHz)		160*	10	17	84B	
* " 70	東芝	RF	Si.TMe	180		20	800	150	1	30						30	-2	45			125*	1.8	100	84A	
* " 71	"	SW	Ge.A	18	12	200	150	85	7	12	100	0.5	100											84A	
* " 72	"	"	"	18	12	200	150	85	7	12	100	0.5	100											84A	
* " 73	ソニー	RF.Conv.Mix Osc	Ge.G	15		5	30	75	8	15				6	-1	-0.976*			PG = 27dB (f = 2Mc)		20	2		18	2S132 2T 73
* " 74	東芝	RF	Si.P	30	5	100	360	175	4	15				6	-2	50					100	2.5	100	84A	
* " 75	ソニー	IF	Ge.G	15		5	30	75	8	15				6	-1	-0.96*			PG = 41dB (f = 455kc)		10	2.1		18	2S133 2T 75
* " 76	"	"	"	15		5	30	75	8	15				6	-1	-0.96*			PG = 37dB (f = 455kc)		10	2.1		18	2S134 2T 76
* " 77	"	"	"	15		5	30	75	8	15				6	-1	-0.96*			PG = 32dB (f = 455kc)		10	2.1		18	2S135 2T 77
* " 78	"	RF.Conv.Mix Osc	"	15		5	30	75	2	15				6	-1	-0.98*					20	1.5		18	2S136 2T 78
* " 79	富士通	"	Si.Me	15	3	50	300	175	1	10				6	-1	50					500*	2.3	80*	49C	
* " 80	日電	"	Si.E	30	3	80	200	175	0.1	20				10	-5	55					200*	3.5	40	50C	
* " 81	三菱	PA	Si.Me	50		5 A	125 W (T _c = 25°C)	150	10 mA	50	30	10	1 A	10	-1 A	30					5	300	5	108	
* " 82	"	"	"	100		5 A	125 W (T _c = 25°C)	150	10 mA	100	30	10	1 A	10	-1 A	30					5	300	5	108	
* " 83	"	"	"	150		5 A	125 W (T _c = 25°C)	150	10 mA	150	30	10	1 A	10	-1 A	30					5	300	5	108	
* " 84	"	SW	Ge.A	25	20	200	120	85	25	25	40	0.5	20											12A	
* " 85	"	"	"	25	20	400	120	85	25	25	30	0.3	200											12A	
* " 86	"	"	"	25	20	400	120	85	25	25	60	0.3	200											12A	
* " 87	富士通	RF.Conv.Mix Osc.SW.PA	Si.Me	30	3	100	600	175	1	10	50	1	10	10	-10	50					250*	4	90*	84C	
* " 88	"	"	"	120	3	100	600	175	1	10	50	1	10	10	-10	50					250*	3	70*	84C	
" 92	日電	PA	Si.E	100	5	2 A	20 W (T _c = 25°C)	175	0.1	50	35	10	350	10	-350				P _b = 9 W (f = 100Mc)		190*	35	25*	83	
" 93	"	"	"	80	5	2 A	20 W (T _c = 25°C)	175	0.1	50	35	10	350	10	-350				P _b = 9 W (f = 100Mc)		190*	35	25*	83	
" 94	"	"	"	100	5	2 A	20 W (T _c = 25°C)	175	0.1	50	35	10	350	10	-350				P _b = 9 W (f = 100Mc)		190*	35	25*	83	
" 95	東芝	RF.PA	Si.Me	140		100	800	150	1	30				10	-10						140*	10	80	84A	
" 96	"	チョップパ	Si.EP	25	5	150	500	175	0.01	15	60			10	-10						150*	17	50	88A	2素子 複合
* " 97	日電	RF.SW	Si.E	60	5	1 A	800	175	1	40	60	10	150	10	-50	90			t _{on} = 25nS, t _{off} = 75nS t _s = 50nS		250*	10	17*	84B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)										外形	備考				
				V_{CB0} (V)	V_{E0} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)			f_{ob} $f_{f\beta}^*$ (Mc)	f_{β}	$f_{T_{dB}}$ $f_{T_{dB}}^*$ (Ω)	
									I_{CB}	V_{CB}	V_{CE}	I_C	V_{CB}	I_E										h_{fe}
★ 2SC98	松下	SW	Si.EP	20	5	100	300	175	0.1	20	45	0.35	10	2	-10				350*	< 5		49C		
★ # 99	"	"	"	20	5	100	300	175	0.1	20	80	0.35	10	2	-10				350*	< 5		49C		
★ # 100	日電	RF.SW	Si.E	40	5	200	150	200	0.025	20	60	1	10	10	-10	80	$t_d + t_r < 40\text{nS}$ $t_s + t_f < 70\text{nS}$		400*	35	40*	23		
★ # 101	東芝	RF	Si.Me	60	5.5	2 A	$\frac{60\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	10 mA	20				10	-0.5A	30	$h_{fe} = 16$ ($f = 1\text{ Mc}$)			350	$C_c \tau_{bb}^*$ 18 nS	101		
★ # 102	"	"	"	50		7 A	$\frac{100\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	45 mA	50				10	-0.5A	25	$h_{fe} = 10$ ($f = 1\text{ Mc}$)			850	$C_c \tau_{bb}^*$ 10 nS	109		
★ # 103	"	SW	Si.P	25	5	50	250	175	1	15	35	1	10				$t_d + t_r < 40\text{nS}$ $t_s < 500\text{nS}, t_f < 60\text{nS}$						49C	
★ # 103A	"	"	"	30	5	80	250	175	0.2	15	100	1	10										49C	
★ # 104	"	RF	"	25		50	250	175	1	15				10	-10	32			250*	4	30	49C		
★ # 104A	"	"	"	30	5	80	250	175	0.2	15	60	1	10										49C	
★ # 105	"	"	"	30	5	80	250	175	0.005	15	35	1	0.1	10	-10	60			250*	4	30	49C		
★ # 106	"	SW.PA	Si.E	60	5	1.5 A	$\frac{15\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	3 mA	30	20	5	0.5A	12	-200	30			100*	50	7	83		
★ # 107	"	"	"	60	5	1 A	$\frac{15\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	3 mA	30	20	5	0.5A	12	-200	30			100*	50	7	83		
★ # 108	"	RF.SW	Si.EMe	90	5	600	600	150	1	30	35	2	150	10	-10				90*	20	55	84A		
★ # 109	"	SW	"	50	5	600	600	150	1	30	35	2	150										84A	
★ # 110	日立	RF.PA	Si.Me	40	5	200	750	175	1	20				6	-10	80			160*	7	55	84A		
★ # 111	"	"	"	50	5	200	750	175	1	20				6	-10	50			160*	10	60	84A		
★ # 112	"	SW	"	40	5	200	750	175	1	20	50	2	200										84A	
★ # 113	"	"	"	50	5	200	750	175	1	20	50	2	200										84A	
★ # 114	"	"	"	50	5	200	750	175	1	20	50						$t_d = 20\text{nS}, t_s = 110\text{nS}$ $t_r = 50\text{nS}, t_f = 20\text{nS}$						84A	
★ # 115	ソニー	RF	Si.EMe	30	5	50	750	175	3	30	50	5	3	20	-10	50			200*	3	100*	84A		
★ # 116	日立	RF.PA	"	50	5	200	750	175	1	20	40	2	200	6	-10	40			120*	14	70	84A		
★ # 117	"	SW.PA	Si.TP	75	5	600	$\frac{13\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	5	40	40	15	30	15	-30	45			112*	15	20	83		
★ # 118	"	PA	"	80	5	600	$\frac{13\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	5	40				15	-30	45			120*	15	20	83		
★ # 119	"	"	"	75	5	600	$\frac{13\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	5	40				15	-30	45			130*	15	20	83		
★ # 120	日電	RF	Si.E	40	1	25	250	150	0.1	10	40	10	0.05	10	-1	90	27	2	0.1	200*	4	40	84B	
★ # 121	"	RF.Conv.Mix Osc	"	40	1	25	250	175	1	30				10	-1	40	35*	2*	0.15*	130*	4	30*	84B	
★ # 122	"	"	"	40	1	25	250	175	1	30				10	-1	90	35*	2*	0.15*	160*	4	40*	84B	
★ # 123	"	"	"	40	1	25	250	175	1	30				10	-1	140	35*	2*	0.1*	180*	4	40*	84B	
★ # 124	"	"	"	40	1	25	250	175	0.2	30	40	10	0.05	10	-1	90	35*	2*	0.1*	200*	4	40*	84B	
★ # 125	ソニー	RF.SW	Si.EMe	100	5	50	750	175	3	30	50	5	3	20	-10	50			200*	3	$C_c \tau_{bb}^*$ 100 pS	84C		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{ob} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	J _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
★ 2SC126	ソニー	RF. SW	Si. EMe	140	5	50	750	175	3	30	50	5	3	20	-10	50			200*	3	C _{rbb} = 100 pS	84C	
★ "	日電	RF. Conv. Mix Osc	Si. E	20		25	200	175	2	15				10	-1	150			200*	4	40*	84B	
★ "	松下	SW	Ge. A	30	20	200	150	85	3	5	40	0.5	100	5	-3			7*	9			84A	
★ "	"	"	"	25	20	200	150	85	3	5	60	0.5	100	5	-3			10*	9			84A	
★ "	富士通	RF. Conv. Mix Osc. PA	Si. EP	60		1A	20W (T _c = 25°C)	175	0.1	10	40	10	20	10	-20	40			160*	15	35*	83	
★ "	"	SW	"	40	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10					t _r = 8 nS, t _f = 20 nS t _s = 20 nS				49C	
★ "	"	"	"	20	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10					t _r = 8 nS, t _f = 20 nS t _s = 20 nS				49C	
★ "	"	"	"	20	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10					t _r = 8 nS, t _f = 20 nS t _s = 20 nS				49C	
★ "	"	"	"	40	5	300	350	175	0.02	10	60	1	10					t _r = 10 nS, t _f = 25 nS t _s = 100 nS				49C	
★ "	"	"	"	20	5	300	350	175	0.02	10	60	1	10					t _r = 10 nS, t _f = 25 nS t _s = 100 nS				49C	
★ "	"	"	"	80	5	300	350	175	0.02	10	60	1	10					t _r = 10 nS, t _f = 25 nS t _s = 100 nS				49C	
★ "	"	"	"	25	5	300	350	175	0.05	10	50	1	10									49C	
★ "	日電	RF. PA	Si. E	60	5	500	800	175	1	40	50	10	30	10	-30	50			h _{fe} = 12dB (f = 100 MHz)	400*	4	40*	85B
★ "	"	"	"	60	5	500	800	175						10	-30	50			h _{fe} = 12dB (f = 100 MHz)	400*	4	40*	85B
★ "	"	"	"	60	5	500	800	175	2	40				10	-30	50				400*	4	40*	85B
★ "	ソニー	RF	Si. EMe	60		1A	1.7W	175	12	30				10	-50	-0.97*				150*	13	20*	84C
★ "	沖	"	Si. EP	20	5	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95				450*	4	70*	49C
★ "	"	RF. SW	"	30	5	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95			t _d = 12 nS, t _{sig} = 10 nS t _r = 16 nS, t _{off} = 32 nS	450*	4	70*	49C
★ "	"	"	"	40	5	200	360	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95			t _d = 12 nS, t _{sig} = 10 nS t _r = 16 nS, t _{off} = 32 nS	450*	4	70*	49C
★ "	"	"	"	50	5	200	360	175	0.1	15	65	1	10	10	-10	85			t _d = 12 nS, t _{sig} = 15 nS t _r = 16 nS, t _{off} = 32 nS	450*	3	70*	49C
★ "	"	"	"	60	5	200	360	175	0.1	15	65	1	10	10	-10	85			t _d = 12 nS, t _{sig} = 15 nS t _r = 16 nS, t _{off} = 32 nS	450*	3	70*	49C
★ "	"	RF	"	30	5	200	360	175	0.1	15				10	-10	70				500*	3	70*	49C
★ "	"	"	"	50	5	200	360	175	0.1	15				10	-10	80				500*	3	70*	49C
★ "	"	"	"	60	5	200	360	175	0.1	15				10	-10	80				500*	3	70*	49C
★ "	ソニー	"	Si. EMe	30	5	1A	750	175	5	30	50	4	100	10	-50	-0.96*				120*	12	20*	84C
★ "	日電	RF. IF. Conv Osc	Si. E	120	6	300	800	175	10	60	45	10	150	10	-50	45				160*	14	45*	84B
★ "	日立	RF	"	20	5	100	750	175	1	20				6	-10				80*	7	70	84B	
★ "	"	"	"	40	5	100	750	175	1	40	20~120	6	10	6	-10				>40*	7	70	84B	
★ "	"	"	"	60	5	100	750	175	1	60	20~120	6	10	6	-10				>40*	7	70	84B	
★ "	"	"	"	120	5	100	750	175	1	120	65	5	50	5	-10	40			140*	6	80	84B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考			
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直 流 又 は パ ル ス h_{FE}			バ イ ア ス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)			$f_{\alpha b}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} $r_{be(creal)}^*$ (Ω)
									μA	V_{CB} (V)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	V_{CB} (V)	I_E (mA)										
★ 2SC213	富士通	RF. PA	Si. P	50		600	1.5 W	175	0.1	10			10	-20	50				150*	15	35*	83		
★ "	"	"	"	25		600	1.5 W	175	1	10			10	-20	50				150*	15	35*	83		
★ "	"	"	"	80		600	1.5 W	175	0.1	10			10	-20	50				150*	15	35*	83		
★ "	"	SW	"	50	5	300	650	175	0.1	10	50	1	50									84 B		
★ "	"	"	"	25	5	300	650	175	1	10	50	1	50									84 B		
★ "	"	"	"	80	5	300	650	175	0.1	10	50	1	50									84 B		
★ "	"	RF	Si. EP	50		700	650	175	0.1	10			10	-20	50				150*	15	25*	84 B		
★ "	"	"	"	25		700	650	175	1	10			10	-20	50				150*	15	25*	84 B		
★ "	"	"	"	80		700	650	175	0.1	10			10	-20	50				150*	15	25*	84 B		
★ "	"	RF. PA	"	50		1 A	1.5 W	175	0.1	10			10	-20	20				150*	15	25*	83		
★ "	"	"	"	25		1 A	1.5 W	175	1	10			10	-20	20				150*	15	25*	83		
★ "	"	"	"	80		1 A	1.5 W	175	0.1	10			10	-20	20				150*	15	25*	83		
★ "	"	SW	"	50	5	700	650	175	0.1	10	50	1	100									84 B		
★ "	"	"	"	25	5	700	650	175	1	10	50	1	100									84 B		
★ "	"	"	"	80	5	700	650	175	0.1	10	50	1	100									84 B		
★ "	"	"	"	80	5	1 A	1.5 W	175	0.1	10	50	1	100									83		
★ "	"	RF Conv. Mix Osc. PA	"	80	3	200	350	175	0.02	10			6	-1	60				350*	4	50*	49 C		
★ "	"	SW	Si. EP	50	5	700	650	175	1	10	40	1	150									84 B		
★ "	"	"	"	25	5	700	650	175	1	10	40	1	150									84 B		
★ "	"	"	"	80	5	700	650	175	1	10	40	1	150									84 B		
★ "	"	RF. PA	"	100		1.5 A	1.8 W	175	1 mA	30			10	-150	20				140*	35	25*	83		
★ "	"	"	"	100		1.5 A	1.5 W	175	1 mA	30			10	-150	20				120*	35	25*	83		
★ "	"	"	"	90		500	1.8 W	175	0.1	10			10	-20	17				100*	15	25*	83		
★ "	"	RF	Si. EP	30		300	350	175	0.05	10			6	-1	80				450*	5	50*	49 C		
★ "	"	RF. AF	"	40	5	100	650	175	0.1	10			6	-1	80				350*	4	50*	84 B		
★ "	"	SW	"	50	5	300	350	175	0.05	10	60	1	10									49 C		
★ "	"	日 電 SW	Si. EMe	100	5	5 A	75 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	5 mA	100	35	10	1 A	2	-1 A					35		102		
★ "	"	"	"	60	5	5 A	75 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	10 mA	60	35	10	1 A	10	-1 A					35		102		
★ "	"	"	"	100	5	5 A	75 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	10 mA	100	35	10	1 A	10	-1 A					35		102		
★ "	"	"	"	140	5	5 A	75 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	10 mA	140	35	10	1 A	10	-1 A					35		102		

$t_r < 20\text{nS}$, $t_f < 50\text{nS}$
 $t_s < 100\text{nS}$
 $t_d = 0.03\mu\text{S}$, $t_s = 1\mu\text{S}$
 $t_r = 0.47\mu\text{S}$, $t_f = 0.5\mu\text{S}$
 $t_d = 0.03\mu\text{S}$, $t_s = 1\mu\text{S}$
 $t_r = 0.47\mu\text{S}$, $t_f = 0.5\mu\text{S}$
 $t_d = 0.03\mu\text{S}$, $t_s = 1\mu\text{S}$
 $t_r = 0.47\mu\text{S}$, $t_f = 0.5\mu\text{S}$

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}			バイアス		h _{fe}	h _{ie} * (Ω)	h _{ie} * (Ω)	h _{re} * (×10 ⁻⁴)			h _{oe} * (μU)	f _{αβ} (f _T)* (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fe} *										
★ 2SC244	日電	SW	Si.Eme	60	5	5 A	75 W (T _c =25°C)	175	50mA	60	35	10	1 A	10	-1 A					35			102		
★ " 245	"	"	"	120	5	5 A	75 W (T _c =25°C)	175	20mA	120	35	10	1 A	10	-1 A					35			102		
★ " 246	"	"	"	180	5	5 A	75 W (T _c =25°C)	175	20mA	180	35	10	1 A	10	-1 A					35			102		
★ " 247	富士通	RF. PA	Si. P	100	3	100	600	175	1	30				6	-2	60				150*	3	70*	84 B		
★ " 248	"	"	"	70	5	50	300	175	1	30				6	-2.5	60				170*	2.5	50	49 C		
★ " 249	"	"	"	70	5	70	500	175	1	30				6	-2.5	60				170*	2.7	50	84 B		
★ " 250	"	RF.Conv.Mix Osc	"	20	2	25	60	150	2	12				6	-2	45				170*	2	65	13 A		
★ " 251	日電	"	Si. E	30	3	30	200	150	1	15				6	-5	50			NF < 6 dB (f = 1 Mc)	900*	1	70*	50 C		
★ " 251A	"	"	"	30		30	200	150	1	15				6	-5	50			NF < 6 dB (f = 1 Mc)	900*	1	70*	50 C		
★ " 252	"	"	"	30	3	30	200	150	1	15				6	-5	50				900*	1	70*	50 C		
★ " 253	"	"	"	30	3	30	200	150	1	15				6	-5	50			NF < 6 dB (f = 70 Mc)	900*	1	70*	50 C		
★ " 254	沖	RF. PA	Si. EP	50	5	800	650	175	2	40	50	1	150	10	-50	55				250*	13	20*	84 A		
" 255	"	"	"	80	5	800	650	175	1	40	45	1	150	10	-50	50				250*	13	20*	84 A		
" 256	"	"	"	90	5	800	650	175	1	40	45	1	150	10	-50	50				.50*	13	20*	84 A		
" 257	"	"	"	50	5	800	800	175	2	40	50	1	150	10	-50	55				250*	13	20*	91		
" 258	"	"	"	80	5	800	800	175	1	40	45	1	150	10	-50	50				250*	13	20*	91		
" 259	"	"	"	90	5	800	800	175	1	40	45	1	150	10	-50	50				250*	13	20*	91		
" 260	"	PA	"	30	5	1 A	1.6W	175	2	20	60	10	150	10	-50	65				280*	15	23*	83		
" 261	"	"	"	60	5	1 A	1.6W	175	1	20	60	10	150	10	-50	65				280*	14	23*	83		
" 262	"	"	"	80	5	1 A	1.6W	175	1	20	60	10	150	10	-50	65				280*	13	23*	83		
" 263	"	RF	"	15		120	100	100	0.4	9				5	-1	60				200*	3	70*	21		
" 264	"	RF. SW	"	30	5	120	100	100	0.1	9	75	1	10	5	-5	85			t _d =12nS, t _{sig} =10nS t _r =15nS, t _{off} =30nS	400*	3	70*	21		
" 265	"	"	"	40	5	120	100	100	0.1	9	75	1	10	5	-5	85				400*	3	70*	21		
★ " 266	日電	RF. AF	Si. E	30	5	30	100	150	0.1	25	75	3	0.5	6	-1	80	2000	0.55	10	250*	1.6	45	23		
★ " 267	"	RF. PA	"	35	5	200	150	150	1	35	70	1	20	6	-1	45				90*	6.5	25	23		
★ " 268	"	RF. PA. SW	"	60	5	30	150	150	5	50	40	1	1	6	-1	55				150*	1.6	50	23		
★ " 269	"	SW	"	25	5	200	150	150	1	15	85	0.5	1						t _{on} <20nS, t _{off} <40nS t _{sig} <20nS				23		
★ " 270	ソニー	PA	Si. Me	270	6	5 A	50 W (T _c =25°C)	150	1mA	50	40	3	2 A	10	-500	56				22*	250	5	103		
★ " 271	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si. E	25	3	20	100	150	1	12				6	-2	70			NF < 8 dB (f = 70 Mc)	1100*	0.7	C _e r _{bb'} 10 pS	23		
★ " 272	"	"	"	25	3	20	100	150	1	12				6	-2	70			NF = 8 dB (f = 900 Mc)	1200*	0.7	C _e r _{bb'} 3 pS	23		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考		
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V _e)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大值 (μA)	V_{CB} (V)	直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe}	h_{ie}	h_{re}	h_{ob}	f_{ab}			C_{ob}	r_{bb}
										V_{CE} (V)	I_C (mA)	V_{CB} (V)	I_E (mA)	h_{fe}^*	(Ω)	($\times 10^{-4}$)	(μU)	(Mc)	(pF)	(Ω)			
★	2SC273	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.E	120	5	50	500	150	1	60			30	-3	50			150*	2.5	25	84B	
	" 274																						
	" 275																						
	" 276																						
	" 277																						
	" 278																						
	" 279																						
★	" 280	日立	Diff	Si.E	30	5	10	80	125	0.01	20	80	-6	0.1									15
★	" 281	"	RF	Si.E.Pa	30	5	100	200	175	0.1	20	170	6	10	6	-0.1	50	$h_{fe} = 8$ (6V, 10mA, 20Mc)	>80*	7	70	12C	
★	" 282	"	SW	"	30	5	100	350	175	1	20	100	6	10	6	-10			180*	7	60	12A	
★	" 283	"	PA	"	50	5	100	350	175	0.1	20	65	6	10	6	-10	100		180*	7	60	12A	
★	" 284	"	SW	"	70	5	100	350	175	1	20	60	6	10	6	-10			160*	7	60	12A	
★	" 285	富士通	PA	Si.EP	50		200	500	150	0.1	10			-10	60				320*	3.5	80*	84B	
	" 285A	"	RF.PA	"	50		300	500	150	0.1	10			-10	60	KF ₂ >30dB, KF ₃ >55dB (15V, 50mA, 1Mc)		500*	3.5	60*	84B		
★	" 286	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si.E	20		10	100	150	1	12			-2	70	PG = 24dB (f = 100Mc)		900*	0.7	$C_c r_{bb}$ 15 pS	23		
★	" 287	"	"	"	20	2	10	100	150	1	12			-2	70	PG = 20dB (f = 200Mc)		900*	0.7	$C_c r_{bb}$ 12 pS	23		
★	" 288	"	"	"	30	2	20	100	150	1	12			-2	70	$P_o = 23\text{mW}$ (f = 300Mc)		1100*	0.7	$C_c r_{bb}$ 10 pS	23		
★	" 289	"	"	"	25	2	20	100	150	1	12			-2	70	NF = 9dB (f = 900Mc)		1100*	0.7	$C_c r_{bb}$ 4 pS	23		
★	" 290	"	PA	"	70	5	2 A	20 W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	3 mA	30	35	10	350	10	-350			$P_o = 6\text{ W}$ (f = 100Mc)	160*	35	25*	83
★	" 291	ソニー	"	"	70	5	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	-50	70		90*	18	$C_c r_{bb}$ 50 pS	84C	
★	" 292	"	"	"	100	5	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	-50	70		90*	18	$C_c r_{bb}$ 50 pS	84C	
★	" 293	"	"	"	130	5	3 A	1 W	175	3	30	70	2	100	10	-50	70		90*	18	$C_c r_{bb}$ 50 pS	84C	
★	" 294	日電	Diff	"	25	5	50	300	175	0.1	10	80	1	1	6	-2		$h_{FE1}/h_{FE2} = 0.8 - 1.0$	200*	4.5	40	87B	2 素子 複合
★	" 295	"	Ch	"	15	5	50	300	175	1	10	50	1	0.2	6	-2			200*	4.5	40	86B	2 素子 複合
★	" 296	富士通	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	20	3	25	200	175	1	12			-2	80				180*	2.5	100*	50C	
★	" 297	ソニー	PA	Si.E	70	5	3 A	10 W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	3	30	70	2	100	10	-50	70		90*	18	$C_c r_{bb}$ 50 pS	97C	
★	" 298	"	"	"	100	5	3 A	10 W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	3	30	70	2	100	10	-50	70		90*	18	$C_c r_{bb}$ 50 pS	97C	
★	" 299	"	"	"	130	5	3 A	10 W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	3	30	70	2	100	10	-50	70		90*	18	$C_c r_{bb}$ 50 pS	97C	
★	" 300	三菱	RF.SW	Si.EP	25	5	100	260	150	0.5	15	85	10	0.1	15	-10			400*	3.5	$C_c r_{bb}$ 250pS	49C	
★	" 301	"	"	"	25	5	100	260	150	0.01	15	85	10	0.1	15	-10			400*	3.5	$C_c r_{bb}$ 250pS	49C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB(V)}	直流又は V _{CE(V)}	パルス I _C (mA)	h _{FE}	バイアス V _{CB(V)}	I _E (mA)	h _{FE}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)			f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ab} (pF)	r _{bb} r _{bb'(real)} * (Ω)
2SC302	三菱	RF. SW	Si. EP	50	5	100	260	150	0.01	30	85	10	0.1	15	-10				400*	3.5	C _e r _{bb'} 250pS	49C		
* 303	"	RF. PA	"	50	3	500	800	200	50	28	20	28	100	20	-50				200*	10		84B		
* 304	"	"	"	60	4	500	800	200	10	28	25	28	100	20	-50				220*	10		84B		
* 305	"	"	"	80	5	500	800	200	0.05	28	30	28	100	20	-50				220*	10		84B		
* 306	"	RF. SW	"	50	5	500	570	150	0.1	30	85	10	150	10	-30				240*	10	C _e r _{bb'} 300pS	84B		
* 307	"	"	"	80	5	500	570	150	0.01	30	85	10	150	10	-30				240*	10	C _e r _{bb'} 300pS	84B		
* 308	"	"	"	100	5	500	800	200	1	90	65	10	150	10	-30				90*	10	30*	84B		
* 309	"	"	"	120	5	500	570	150	0.1	90	65	10	150	10	-30				120*	6	C _e r _{bb'} 180pS	84B		
* 310	"	"	"	140	5	500	570	150	0.01	90	65	10	150	10	-30				120*	6	C _e r _{bb'} 180pS	84B		
* 311																								
* 312																								
* 313	日立	RF. Conv. Mix Osc	Si. EP	30	2	50	200	200	0.5	10	40	10	10	10	-10	50			1000*	1	C _e r _{bb'} 10 pS	9		
* 314	"	PA	Si. TMe	75	4	1.2 A	2 W	175	10	40				4	-100	25			70*	20	27	83		
* 315	"	"	"	75	4	1.2 A	2 W	175	10	40				4	-100	25			80*	20	25	83		
* 316	松下	RF. Conv. Mix Osc. PA	Si. P	45	5	30	300	175	0.01	10				5	-2	300	6500	1.4	32	50*	4.5	80	49C	
* 317	日立	SW	Si. Me	70	5	100	350	175	0.1	20	100	6	10	6	-10				240*	4.5	75	12A		
* 318	ソニー	RF	Si. E	50	5	100	300	175	0.2	25	90	3	1	6	-2									
* 319	日電	RF. Conv. Mix Osc. PA	"	40	4	300	1.75 W (T _c =25°C)	175	0.5	20	40	10	100	10	-30	40				3	C _e r _{bb'} 100 pS	49C		
* 320	"	"	"	40	4	500	2.5 W (T _c =25°C)	175	0.5	20	40	10	100	10	-30	40				500*	6.5	40*	84B	
* 321	日立	SW. RF	Si. EP	40	5	200	360	175	1	20	35-200	1	10	10	-20				600*	6.5	40*	84B		
* 322	"	"	"	40	5	200	360	175	0.25	20	40	1	10	10	-20				450*	4		49C		
* 323	東芝	"	"	40	5	100	250	175	1	30	50	1	10	10	-20				450*	4		49C		
* 324	富士通	RF. Conv. Mix Osc	Si. P	20	3	25	200	175	2	12				6	-2	70				180*	4.5	60*	49C	
* 325	沖	RF	Si. EP	12	3	50	250	175	0.02	6				5	-5	110				1000*	1.7	90*	50C	
* 326	"	"	"	20	3	50	250	175	0.02	6				5	-5	110				1000*	1.7	90*	50C	
* 327	"	"	"	30	3	50	250	175	0.02	6				5	-5	110				1000*	1.7	90*	50C	
* 328	"	"	"	30	3	20	200	175	0.2	15				6	-5	60				1500	0.65	C _e r _{bb'} 5pS	50C	
* 329	"	"	"	30	3	20	200	175	0.2	15				6	-5	60				1500*	0.65	C _e r _{bb'} 5pS	50C	
* 330	"	RF. LN	"	20	3	20	200	175	0.5	15	60	10	10	10	-10				3500*	0.75	C _e r _{bb'} 2.5pS	128		
* 331	"	"	"	20	3	20	200	175	0.5	15	60	10	10	10	-10				3500*	0.75	C _e r _{bb'} 1.5pS	128		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考				
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)			f _{ββ} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real) (Ω)*	
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _c (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *
2SC332	沖	RF. SW	Si. EP	30	5	200	150	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95			450*	3	70*	48C		
" 333	"	"	"	40	5	200	150	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	95			450*	3	70*	48C		
" 334	"	"	"	60	5	200	150	175	0.1	15	65	1	10	10	-10	85			450*	2	70*	48C		
" 335	"	"	"	50	5	200	250	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	100			450*	3	70*	49C		
" 336	"	"	"	60	5	200	250	175	0.1	15	75	1	10	10	-10	100			450*	3	70*	49C		
" 337	"	RF	Si. P	20	5	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	-1	80			100*	3	50*	49C		
" 338	"	"	"	70	5	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	-1	80			100*	3	50*	49C		
" 339	"	"	"	110	5	20	360	175	0.1	15	73	1	2	5	-1	80			100*	3	50*	49C		
" 340	"	"	"	20	5	20	100	100	0.1	15	170	1	2	5	-1	2200			130*	1.4	60*	21		
" 341	"	"	"	70	5	20	100	100	0.1	15	73	1	2	5	-1	80			120*	1.4	60*	21		
" 342	"	"	"	110	5	20	100	100	0.1	15	73	1	2	5	-1	80			120*	1.4	60*	21		
" 343	"	RF. SW	Si. EP	35	5	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	-30	70			430*	6.5	45*	84A		
" 344	"	"	"	60	5	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	-30	70			430*	6	45*	84A		
" 345	"	"	"	80	5	500	600	175	0.4	20	55	1	150	10	-30	70			430*	5	45*	84A		
" 346	"	RF. SW	"	45	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	-30	75	t _{on} < 80nS, t _{off} < 70nS t _{sig} < 35nS		320*	10	40*	84A		
" 347	"	"	"	60	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	-30	75	t _{on} < 80nS, t _{off} < 70nS t _{sig} < 35nS		320*	10	40*	84A		
" 348	"	"	"	60	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	-30	75	t _{on} < 80nS, t _{off} < 70nS t _{sig} < 35nS		320*	7.5	40*	84A		
" 349	"	"	"	90	5	700	600	175	1	40	70	1	100	10	-30	75	t _{on} < 80nS, t _{off} < 70nS t _{sig} < 35nS		320*	7.5	40*	84A		
" 350	日立	RF. AF. LN	Si. Me	30	5	100	200	175	0.01	20	120	6	0.1	6	-1	160	7000	2	25	180*	7	60	12A	
" 351	東芝	RF	Si. P	40	2	20	200	150	0.5	18				10	-4	50			600*	1.4	15	33		
" 352	ソニー	"	Si. EP	50	5	100	750	175	0.2	25	90	3	1	6	-2		h _{fe} = 4.5dB (f = 100Mc)						84C	
" 353	"	"	"	100	5	100	750	175	0.2	25	90	3	1	6	-2		h _{fe} = 4.5dB (f = 100Mc)						84C	
" 354	富士通	RF. PA	Si. TP	40	4	1.5A	7 W (T _e = 25°C)	200	1	30	100	4	500	4	-100	50			180*	20	10*	84B		
" 355	"	PA	"	75	4	2.5A	15 W (T _e = 25°C)	200	1	30	100	4	500	4	-100	50	P _β = 3 W (f = 150Mc)			180*	20	10*	111	
" 356	日電	SW	Si. E	30	5	200	300	175	1	20	60	1	10	10	-10		t _{on} < 20nS, t _{off} < 40nS t _{sig} < 20nS			400*	4.5	50	46C	
" 357																								
" 358																								
" 359																								
" 360	東芝	RF	Si. P	30	5	100	250	175	1	15				10	-10	100			150*	5	50	49C		
" 361	"	RF. Conv. Mix Osc	"	25	5	100	200	125	0.5	18	40-160	12	2	6	-2	80			150*	4	90	33		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バ イ ア ス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{αβ} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)	
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *
2SC362	東 芝	RF.Conv.Mix Osc	Si.P	25	5	100	200	125	0.5	18	70~280	12	2	6	-2	140				150*	4	90	33	
" 363	"	"	"	25	5	100	200	125	0.5	18	150~500	12	2	6	-2	250				150*	4	90	33	
" 364	"	RF.Conv Mix.Osc	"	25	5	40	200	125	0.5	18				6	-2	400				150*	4	100	33	
" 365	"	"	"																					
" 366	東 芝	RF.Conv Mix.Osc	Si.E	60	5	400	400	125	0.1	40	70~240	1	100	10	-10	60				>100*	10	50	138	
" 367	"	"	"	40	5	400	400	125	0.1	40	70~240	1	100	10	-10	70				>100*	10	50	138	2SA467 とコンプリ
" 368	"	RF.Conv.Mix Osc	"	25	5	100	250	175	0.1	18				10	-1	250				150*	1.5	120	49C	
" 369	"	"	"	18	5	100	200	125	0.1	18				10	-1	250				150*	1.5	120	33	
" 370	"	"	"	30	4	100	200	125	1	18				6	-1	40				150*	2.5	80	33	
" 371	"	"	"	30	4	100	200	125	1	18				6	-1	80				150*	2.5	80	33	
" 372	"	"	"	60	5	150	400	125	0.1	60	70~400	1	10	10	-1					200*	2	50	138	2SA495 とコンプリ
" 373	"	"	"	60	5	150	400	125	0.1	60	200~400	1	10	10	-1					200*	2	50	138	
" 374	"	"	Si.EP	30	4	100	200	125	1	18				6	-1	400				200*	2	50	138	
" 375	"	RF	"	20	2	50	200	125	0.5	15				10	-8	100				600*	1.5	20	33	
" 376	"	"	"	70	4	100	200	125	1	18				6	-1	60				150*	2.5	80	33	
" 377	"	"	"	35	4	30	200	125	0.5	18				12	-2	70				150*	2	40	33	
" 378	"	RF.Conv.Mix	"	35	4	30	200	125	0.5	18	40~240	12	2	10	-1					150*	2	C _c r _{bb} 40pS	33	
" 379	"	RF.Conv.Mix Osc	"	30	4	100	200	125	0.5	18				10	-2	70				150*	2	C _c r _{bb} 40pS	33	
" 380	"	RF	"	35	4	50	300	125	0.1	35				10	-2	70				300*	2	40	33	
" 381	"	"	"	40	4	20	100	125	0.5	18	40~240	12	2	10	-1					100~400*	2	C _c r _{bb} 10~50pS	138	
" 382	"	"	Si.P	40	4	50	250	125	0.1	40	25~140	6	1	6	-1					250*	2	C _c r _{bb} 10pS	33	
" 383	"	"	Si.EP	50	4	50	300	125	0.1	50	>30	10	4	10	-4					>400*	C _{re} <1.2	C _c r _{bb} <30pS	138	7+7-ド AGC
" 384	"	RF.Conv. Mix.Osc	"	20	2	50	200	125	0.5	15	20~100	12.5	12.5	12.5	-12.5					>300*	0.8~2.0		138	
" 385	"	"	"	20	2	20	200	125	0.5	15				6	-1	50				500*	1.4	25	33	
" 386	"	RF.Conv. Mix	"	20	2	20	200	125	0.5	15				3	-8	80				600*	1.6	20	33	
" 387	"	RF.Conv.Mix Osc	"	20	2	50	200	125	0.5	15				3	-8	80				500*	1.6	18	33	
" 388	"	RF.Conv. Mix	"	20	2	20	200	125	0.5	15				10	-8	100				900*	1.4	15	33	
" 389	"	RF	Si.P	20	3	20	150	150	0.1	10				3	-8	80				450*	1.6	18	138	
" 390	"	"	Si.EP	30	3	20	150	150	0.1	10	40~200	10	2	10	-2					500*	0.8	10	50C	
" 391	"	"	"	20	2	20	150	150	1	10				10	-2	70				1200*	1	C _c r _{bb} <6pS C _c r _{bb} 5pS	50C	

P_o = 8 mW (f = 930 Mc)

PG > 32 dB (f = 45 Mc)

NF = 2 dB (f = 100 Mc, 10V, 2mA)

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)				電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考					
				V _{CE0}	V _{EB0}	I _C	P _C	T _j	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バ イ ア ス		h _{fe}	h _{ie}	h _{re}	h _{oe}			f _β *	C _{ob}	r _{bb'} *		
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(μA)	V _{CEB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fs} *	(Ω)	(×10 ⁻⁴)	(μΩ)			(Mc)	(pF)	(Ω)		
★ 2SC452	三 菱	PA	Si.TP	100	4	1.2A	25 W (T _a =25°C)	200	500	28	>15	28	350	28	-100	30				180*	20	15*	112		
★ " 453	"	"	"	90	4	1.2A	25 W (T _a =25°C)	200	500	28	>10	28	350	28	-100	30				170*	20	15*	112		
★ " 454	日 立	RF.Conv. Mix	Si.EP _a	30	5	100	200	125	0.5	18	100-500	12	2	12	-2				230*	<3.5			138		
★ " 455	"	"	"	30	5	100	200	125	1	18				12	-2	40			230*	1.8	40		37		
★ " 456	松 下	PA	Si.EP	50	1.5	600	750	175	1	12		6	80	6	-80	20			200*	10	C _c r _{bb'} 100pS		84B		
★ " 457	日 電	Diff	Si.E	25	5	50	300	175	0.1	10		80	1	1	6	-2		hFE1/hFE2=0.8-1.0	200*	4.5	40*		87B	2素子複合	
★ " 458	日 立	RF	Si.EP _a	30	5	100	200	125	0.5	18	100-500	12	2	5	-0.1	130	16.5k	0.7	11	230*	<3.5		138	2SA1029 とコングアリ	
★ " 459	"	RF.Conv. Mix	"	30	5	100	200	125	1	18	160	12	2	12	-2	110	2800	1.6	20	230*	1.8	100	138		
★ " 460	"	"	Si.P _a	30	5	100	200	125	0.5	18	35-200	12	2	12	-2				230*	1.8			138		
★ " 461	"	"	"	30	5	100	200	125	0.5	18	35-200	12	2	12	-2				230*	1.8			138		
★ " 462	"	RF	"	40	4	50	200	200	0.5	20				10	-4	90	PG=26dB (f=45Mc)		600*	0.9			9		
★ " 463	"	"	"	40	4	50	200	200	0.5	20				10	-4	90	PG=15dB (f=200Mc)		600*	0.8			9	フワード AGC	
★ " 464	"	RF.Conv. Mix.Osc	"	30	2	50	200	200	0.5	10				6	-1	40	PG=28dB (f=45Mc)		1100*	1	C _c r _{bb'} 10pS		9		
★ " 465	"	"	"	30	2	50	200	200	0.5	10				6	-1	40			1100*	1	C _c r _{bb'} 10pS		9		
★ " 466	"	"	"	30	2	50	200	200	0.5	10				6	-1	40	PG=14dB (f=200Mc)		1100*	1	C _c r _{bb'} 10pS		9		
★ " 467	富 士 通	SW	Si.EP	20	4	50	300	175	0.5	10		40	1	10										49C	
★ " 468	日 立	"	"	40	5	200	200	175	1	20		60	1	10	10	-20			450*	4			8A		
★ " 469	日 電	RF.Conv.Mix Osc	Si.E	20	5	30	100	125	0.1	15		90	3	0.5	6	-1	100		250*	1.6	50*		23		
★ " 470	ソ ニ ー	RF	Si.EP	90	5	100	750	175	1	25		60	5	3	6	-5			150*	2	C _c r _{bb'} 20pS		84C		
★ " 471	日 立	AF	Si.Me	30	5	100	200	175	0.1	20				6	-0.1	50			160*	7	70		8A		
★ " 472	"	SW	"	V _{CEB} 30	5	100	200	175	0.1	20		100	6	10					180*	7	60		8A		
★ " 473	"	"	Si.TMe	70	5	100	200	175	0.1	20		80	6	10					180*	4.5	75		8A		
★ " 474	"	"	Si.Me	V _{CEB} 70	5	100	200	175	0.1	20		60	6	10					160*	7			8A		
★ " 475	日 電	RF.AF.LN	Si.E	20	5	100	150	150	0.1	15		300	3	0.5	3	-0.5	350	15kΩ	18	3.5	100*		23		
★ " 476	"	RF.AF	"	20	5	100	150	150	0.1	15		350	3	0.5	3	-0.5	400	15kΩ	20	3.8	100*		23		
★ " 477	松 下	RF	Si.EP	50	5	30	140	175	1	10		170	10	1					230*	C _{re} 0.5pS			50C		
★ " 478	"	RF.Conv.Mix Osc	"	50	1.5	120	300	175	1	12		20	12	20	12	-1	15		180*	4	C _c r _{bb'} 75pS		49C		
★ " 479	日 立	SW	"	60	5	600	650	175	1	40		40-160	1	100							<20		123		
★ " 480	"	"	"	60	5	600	800	175	1	30		40-160	1	150									123		
★ " 481	東 芝	PA	"	60	5	1A	600	150	10	30		35	2	150	6	-100				Po > 1 W (f=50MHz, V _{CE} =24V, P _i =0.1W)	>100*	<30	<25	84B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} /h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αB} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
									I _{CB1} (μA)	V _{CB(V)}	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SC512	東芝	PA.SW	Si.T	100	5	1.5A	800	175	1	30	30~150	2	200	10	-30				60*	25		84B	2SA512 とコンパリ
★	"	"	"	70	5	1A	800	150	3	30			10	-50	50				50*	30		84B	2SA513 とコンパリ
★	"	"	Si.TMe	300	3	100	4 W (T _c =25°C)	150	0.1	300			10	-50	60				20*	7		98A	
★	"	"	"	300	3	100	6 W (T _c =25°C)	150	100	300			10	-50	60				20*	7		99	
"	"	RF.PA	Si.DB	100	5	1.5A	800	175	0.5	30	60	2	200	5	-200	60			50*	25	10	84B	
"	"	"	"	140	5	1.5A	800	175	0.5	30	60	2	200	5	-200	60			50*	25	10	84B	
"	"	PA	Si.EP	60	4	2A	10 W (T _c =25°C)	175	10	30	10~140	5	500	10	-200				300*	25	10	97B	
★	"	"	Si.TMe	140	5	5A	50 W (T _c =25°C)	150	10mA	50	40	5	5A	5	-5A	40	h _{fe} = 2 (f = 20Mc)			70	10	102	
★	"	"	"	180	5	5A	50 W (T _c =25°C)	150	1mA	50	40	5	5A	5	-5A	40	h _{fe} = 2 (f = 20Mc)			70	10	102	
"	"	"	"	110	5	7A	50 W (T _c =25°C)	150	10mA	50	30~300	5	1A	10	-1A				10*	90	15	102	
"	"	"	"	130	5	7A	50 W (T _c =25°C)	150	100	130	30~300	5	1A	10	-1A				10*	90	15	102	
★	"	"	"	80	5	7A	50 W (T _c =25°C)	150	10mA	50	30~300	5	1A	10	-1A				10*	90	15	102	
"	"	"	"	100	5	7A	50 W (T _c =25°C)	150	100	100	30~300	5	1A	10	-1A				10*	90	15	102	
★	"	"	"	50	5	7A	50 W (T _c =25°C)	150	10mA	50	30~300	5	1A	10	-1A				10*	90	15	102	
"	"	"	"	70	5	7A	50 W (T _c =25°C)	150	100	70	30~300	5	1A	10	-1A				10*	90	15	102	
"	"	"	Si.T	140	5	1.5A	10 W (T _c =25°C)	175	1	30	30~150	2	200	10	-30				60*	25	10	97B	
★	"	"	"	120	5	1.5A	10 W (T _c =25°C)	175	3	30				10	-50	50			50*	25	10	97B	
"	"	"	"	100	5	1.5A	10 W (T _c =25°C)	175	1	30	30~150	2	200	10	-30				60*	25	10	97B	
★	"	"	"	70	5	1.5A	10 W (T _c =25°C)	150	3	30				10	-50	50			50*	35	10	97B	
★	松下	"	Si.TMe	165	5	55	2.3W (T _c =25°C)	175	2	12				20	-45	20			250*	2.5	C _c r _{bb} 25pS	84B	
★	"	RF	Si.P	35	3	10	130	175	1	10				10	-2.5	50			340*	1	20	50C	
★	日立	RF.PA	Si.EP	20	5	150	200	125	0.5	20	100	1	150	6	-1	70			100*	12	35	37	
★	"	RF.AF	Si.P	30	5	100	100	125	0.5	18	160	12	2	12	-2	160	2800	0.7	20	230*	1.8	100	36
★	"	RF.Conv.Mix Osc	"	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	150			230*	1.8	100	36	
★	"	"	"	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	40			230*	1.8	40	36	
★	"	"	"	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	110	PG = 26dB (f = 10.7Mc)		230*	1.8	100	36	
★	"	"	"	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	85	PG = 29dB (f = 10.7Mc)		230*	1.8	40	36	
★	"	"	"	30	5	100	100	125	0.5	18				12	-2	85	PG = 17dB (f = 100Mc)		230*	1.8	40	36	
"	"	"	Si.EP	30	4	20	100	125	0.5	10	35~200	6	1	6	-5				940*	0.9	C _c r _{bb} 5 pS	138	
"	三洋	"	Si.P	40	5	100	200	125	1	35	320	6	1	6	-1				100*	3	C _c r _{bb} 250pS	138	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)													外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	直流又はパルス h _{FE}			バ イ ア ス		h _{je}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{αβ} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(real)*} (Ω)					
										V _{CE} (V)	I _c (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{je} *										h _{ie} *	h _{re} *	
* 2SC566	日電	RF. PA	Si.E	50	4	300	800	175	0.2	35	70	10	100	10	-30				700*	4			85B			
" 567	"	RF	"	30	3	20	200	150	0.5	15				6	-2	80			1300*	0.55		C _c r _{bb} = 3 pS	50C			
" 568	"	"	"	30	3	20	200	150	0.1	15				6	-2	80			1100*	0.7		C _c r _{bb} = 2.1 pS	50C			
* " 569	東光	SW	Si.EP	40	4.5	150	150	150	0.5	20	60	1	10											22	KT 200	
* " 570	"	"	"	40	4.5	200	300	150	0.5	20	60	1	10											28	KT 210	
* " 571	松下	PA	"	36	4	500	6 W (T _c =25°C)	175	5	20	70	13.5	100	13.5	-100	70				320*	27	5*		84B		
* " 572	"	"	"	36	4	1 A	10 W (T _c =25°C)	175	5	20	80	13.5	200	13.5	-200	80				330*	27	5*		111		
* " 573	"	"	"	36	4	2 A	20 W (T _c =25°C)	175	10	20	80	13.5	400	13.5	-400	80				350*	27	4.5*		111		
* " 574	"	RF. PA	"	80	4	1 A	7.5 W (T _c =25°C)	175	0.5	80	> 5	10	500	10	-100	15				280*	15		C _c r _{bb} = 20 pS	110		
" 575	"	"	"	80	4	1 A	5 W (T _c =25°C)	175	0.5	40	20	5	500	10	-100	20				210*	7		C _c r _{bb} = 18 pS	84C		
" 576	"	RF. SW	"	40	5	500	360	200	0.1	20	40	1	10	6	-2	60				650*	2.5	20		49C		
" 577	"	"	"	40	5	500	360	200	0.1	20	80	1	10	6	-2	80				600*	2.5	20		49C		
* " 578	日電	SW	Si.E	60	5	500	600	175	1	30	60	1.5	150												84B	
* " 579	"	"	"	30	5	200	360	175	0.1	15	80	0.4	50												49C	
* " 580	"	RF. Conv. Mix Osc. PA	"	60	5	1 A	800	175	1	40	60	10	150	10	-50	80				250*	10	20*		84B		
* " 581	松下	RF. Conv. Mix. Osc	Si.EP	30	5	30	140	175	1	10				10	-1	85				230*	1.5	20		50C		
* " 582	"	PA	Si.Me	300	3	100	6.5 W (T _c =70°C)	150	100	300	65	10	50	10	-50	60				35*	8	30		99		
* " 583	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	30	2.5	20	200	200	0.01	15	25-150	1	2	5	-2	80				1300*	1.2		C _c r _{bb} = 8 pS	50C		
* " 584	"	RF. PA	"	80	4	2 A	17.5 W (T _c =25°C)	200	1 mA	80	10	10	500	10	-500	15				200*	30		C _c r _{bb} = 20 pS	111		
* " 585	"	PA	Si.EP	65	4	3 A	20 W (T _c =25°C)	175	12	30	80	28	200	28	-200	30				350*	14	6.5*		111		
* " 586	"	"	Si.EMe	150	6	5 A	50 W (T _c =25°C)	150	15 mA	150	30	4	5 A	4	-5A	20				55*	130	8		102		
" 587	松下ソニー 東芝	RF	Si.P	45	5	30	300	175	0.01	10				10	-2	300				80*	3	80		49C		
" 587A	"	"	"	45	5	30	300	175	0.01	10				10	-2	300				80*	3	80		49C		
* " 588	富士通 ソニー	"	Si.DB	30	5	100	600	175	1	15				10	-10	100				200*	2.5	50		84B		
" 589	ソニー 松下	"	"	165	5	80	750	175	2	25	40	5	3	20	-3	40				200*	2		C _c r _{bb} = 35 pS	84B		
* " 590	日電	"	"	120	5	300	800	175	1	60	70	10	150	10	-50	70				150*	12	30*		84B		
* " 591	富士通、 沖電	RF. PA	"	100	4	1.5 A	20 W (T _c =25°C)	175	1 mA	30	10~40	10	150	10	-150	20				150*	35	25*		83		
* " 592	富士通	PA	Si.TP	75	4	2.5 A	13 W (T _c =25°C)	175	1	30	60	4	0.5 A	28	-100	60				180*	20	10*		111		
* " 593	松下	RF. Conv. Mix. Osc	Si.EP	50	5	30	165	175	1	10	40~160	10	1	10	-1	100				230*	1.5	18		50C		
* " 594	富士通、 日電、 三菱	RF. PA	Si.E	60	5	200	750	175	0.1	45	40~240	1	10	10	-10					<100*	< 5	<120*		84B		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考		
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} (μA)	最大値 V _{CE} (V)	直 流 又 は バ ル ス hFE		バ イ ア ス		h _{FE}	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *	h _{FE} *			f _β *	f _β *
2SC595	日立電	SW	Si.EP	30	5	200	300	150	1	15	60	1	10	10	-10	60	t _{on} < 100nS, t _{off} < 100nS	450*	4	40*	49C		
" 596	富士通	RF.PA	"	60	5	500	800	175	0.5	20	25-100	10	30	10	-30	50		400*	6	40*	85B		
" 597	松下電	PA	"	65	4	1 A	6 W (T _c =25°C)	175	5	30				28	-100	30		400*	7	12*	84B		
" 598	松下電	"	"	65	4	1.5A	10 W (T _c =25°C)	175	5	30				28	-100	30		400*	7	12*	111		
" 599	三菱電	"	"	60	4	1.5A	20 W (T _c =25°C)	200	500	28	30	28	50	28	-50	50	PG = 8 dB (f = 220Mc, P ₁ = 1.9W)	500*	25	7*	114		
" 600	松下電	"	"	65	4	3 A	20 W (T _c =25°C)	175	12	30				28	-200	30		400*	14	7.5*	111		
" 601	富士通	RF.SW	"	40	5	100	300	175	0.1	20	60	1	10	10	-10	80	t _d + t _r < 12nS, t _s < 13nS, t _r + t _f < 18nS	580*	2.4	20	49C		
" 602	富士通	RF	"	30	3	30	200	150	1	15				6	-5	60	NF = 5 dB (f = 70Mc)	800*	1.3	70*	50C		
" 603	日電	Ch	Si.E	7	7	50	200	150	1	6	100	0.5	0.1				h _{FEB} /h _{FEE} = 0.1-1.0, ΔV _{BE} < 100μV, γΔV _{BE} < 5μV, γC, ΔI _{BE} < 2nA	70*	5.5	C _c r _{bb'} 2nS	47	2素子複合 双方性	
" 604																							
" 605	日電	RF.Conv.Mix Osc	Si	30	4	20	150	150	0.2	20	60	10	2	10	-2	70		480*	0.5	C _c r _{bb'} 2pS	23	フェード AGC	
" 606	"	"	"	30	4	20	150	150	0.2	20	60	10	2	10	-2	70		530*	0.5	C _c r _{bb'} 1.6pS	23	フェード AGC	
★ " 607	日立	PA	Si.T	75	4	600	1 W	175	5	40				10	-50	50		70*	25	20*	84A		
★ " 608	"	"	"	75	4	1.5A	10 W (T _c =25°C)	175	5	40				10	-50	60		70*	25	20*	97B		
★ " 609	"	"	"	75	4	1.5A	10 W (T _c =25°C)	175	5	40				10	-50	60		80*	25	25*	97B		
★ " 610	松下電		Si.TP	100	4	10A	100 W (T _c =25°C)	175	10mA	40	50	1	1A				P _o = 32W (f = 40MHz, V _{CE} = 40V, P _I = 7.5W)					109	
" 611	日電、 富士通、 東芝、 松下電	RF.Conv Mix.Osc	Si.EP	20	3	20	200	150	1	10				10	-2	80	NF = 2.5dB (f = 70Mc)	1000*	1	C _c r _{bb'} 3pS	50C		
" 612	東芝、 日電、 松下電	RF	"	35	2	20	180	175	1	10				10	-2	80	NF = 2.5dB (f = 70Mc)	1300*	1	Z _r = 30Ω	50C		
★ " 613	日電	SW	"	40	5	200	360	200	0.1	20	80	1	10				t _{on} < 25nS, t _{off} < 25nS, t _{sr} < 20nS					49C	
★ " 614	三洋	Osc.PA	Si.P	80	4	1.5 A	7.5 W (T _c =25°C)	175	1	40	80	10	250	10	-250			200*	12.5	8	84B		
★ " 615	"	"	"	30	4	1.5 A	7.5 W (T _c =25°C)	175	1	10	80	10	250	10	-250			200*	12.5	8	84B		
" 616	"	"	"	80		1.5 A	13 W (T _c =25°C)	175	1	40				10	-250	80		200*	12.5	8	83		
" 617	"	"	"	30		1.5 A	13 W (T _c =25°C)	175	1	10				10	-250	80		200*	12.5	8	83		
" 618	富士通	RF	Si.EP	25	4	25	150	150	0.1	12				6	-2	50	NF = 4.5dB (f = 70Mc)	800*	1.3	60*	50C		
" 618A	"	"	"	25	4	25	150	150	0.1	12				6	-2	50	NF = 3dB (f = 70Mc)	800*	1.3	60*	50C		
★ " 619	三菱	SW.PA	Si.EP	30	5	200	250	125	1	25	110	6	10				t _{on} < 40nS, t _{off} < 250nS, t _{sr} < 150nS					138B	
" 620	"	RF.PA	"	50	5	200	250	125	1	25	90	6	10	6	-1			250*	7	C _c r _{bb'} 100pS	138B		
★ " 621	"	RF.Conv.Mix Osc.SW	"	25	4	100	150	150	1	25	75	6	10	6	-1	80	2500	0.4	15	150*	2.5	C _c r _{bb'} 100pS	8 A
★ " 622	"	RF.Conv.Mix Osc	"	25	4	100	150	150	1	25	75	6	10	6	-1	80	2500	0.4	15	150*	2.5	C _c r _{bb'} 100pS	11A
★ " 623	東光	SW	"	40	4.5	150	150	150	0.5	20	60	1	10				t _r < 30nS, t _f < 30nS, t _s < 60nS					22	KT-2003

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)							電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考		
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_c (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大 ⁴⁾		直流又はパルス h_{FE}			バイアス		h_{fe}	h_{ie} h_{iE}^* (Ω)	h_{re} h_{rE}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oE}^* (μC)	$f_{\alpha\beta}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)			$r_{bb'}$ $r_{bE}(\text{real})^*$ (Ω)	
									μA	$V_{CB(V)}$	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$	h_{fe}^*										h_{ie}^*
★	2SC624	東光	SW	Si.EP	40	4.5	200	300	150	0.5	20	60	1	10									28	KT-2103	
	"	625																							
★	"	626	日電	RF.Conv.Mix Osc. PA	Si.E	50	5	200	750	175	0.1	20			10	-10	130			350*	4	45*	84B		
	"	627	富士通	RF.AF.SW	Si.T	200	4	100	700	175	5	100	80	10	50	6	-2	50	1000	0.8	10	20*	6	25	84B
	"	628	日電	RF.PA	Si.E	40	4	500	2.5W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	0.4	20	40	10	100	10	-30	40	$P_o = 2\text{W}$ ($f=200\text{Mc}$, $V_{cc}=15\text{V}$)		700*	5.5	40*	84B	
★	"	629	ソニー	RF.Conv Mix. Osc	Si.DB	18		30	150	120	0.2	15	30	3	1	6	-1	36			800*	1.3	$C_c r_{bb'}$ 15pS	38	
	"	630																							
★	"	631	ソニー	RF.AF.LN	Si.E	25	6	100	250	120	0.2	25	350	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	38
	"	632	"	RF.LN	"	40	6	100	250	120	0.2	25	350	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	38
★	"	633	"	RF.Conv.Mix Osc. SW	"	25	6	100	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-2		$t_r < 60\text{nS}$, $t_f < 150\text{nS}$ $t_{sig} < 500\text{nS}$		140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	38	
★	"	634	"	"	"	40	6	100	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-2		$t_r < 60\text{nS}$, $t_f < 150\text{nS}$ $t_{sig} < 500\text{nS}$		140*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 350pS	38	
	"	635	日電	PA	Si.E	65	4	1.5A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	3	18	15~200	10	500	18	-150	50	$P_o > 4\text{W}$ ($f=175\text{Mc}$, $V_{cc}=18\text{V}$)		450*	10	10*	111	
	"	636	"	"	"	65	4	3A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	10	18	15~200	10	1A	18	-150	50	$P_o > 7\text{W}$ ($f=260\text{Mc}$)		350*	16	8*	111	
	"	637	"	"	"	40	4	1A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	10	20	>20	13.5	500	13.5	-100	50			500*	16.5	10*	111	
	"	638	"	"	"	40	4	2A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	20	20	>20	13.5	1A	13.5	-200	50			400*	28	8*	111	
	"	639	"	SW	"	40	5	200	360	200	0.1	20	90	1	10	10	-10		$t_{on} < 12\text{nS}$, $t_{off} < 18\text{nS}$ $t_s < 3\text{nS}$		750*	1.8		49C	
★	"	640	"	RF	"	30	5	100	150	150	0.1	25	270	3	0.5	3	-0.5	300	15k Ω	16	3	100*	8	30*	23
★	"	641	日立	SW.RF	Si.EP	40	5	100	100	125	0.25	20	45~160	0.5	1	10	-10		$t_{on}=20\text{nS}$, $t_{off}=35\text{nS}$ $t_s=12\text{nS}$		400*	<6		138	
★	"	642	東芝	PA	Si.TMe	1100	5	1A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	30~160	15	150	15	-200				2*	55	10	102	水平偏向用
★	"	643	"	"	"	1100	5	2.5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	>7	15	2A	15	-200				>2	80	10	102	
★	"	644	松下	RF.AF.LN	Si.EP	30	5	50	150	125	1	10	250	5	2	5	-2	200	5000	0.7	10	160*	2.3	$C_c r_{bb'}$ 110pS	138
★	"	645	"	RF.Conv.Mix Osc	"	30	5	30	140	175	1	10	40~150	10	1	10	-1	100			200*	C_{re} 0.65	22	243	
★	"	646	"	PA	Si.TMe	60	5	4A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10mA	60	55	4	2.5A	4	-100	70			50*	110	12	102	
	"	647	"	"	"	80	5	5A	50W ($T_c=10^\circ\text{C}$)	150	10mA	80	40	4	4A	10	500				43*	160	7	102	
★	"	648	日立	RF	Si.E	30		30	100	150	0.1	20	280	6	0.1	5	-0.1	320	17k Ω	1.9	12	350*	1.7	80*	182C
★	"	649	"	RF.AF.LN	"	30	6	30	200	175	0.1	20	120	6	0.1	5	-0.1	150	36k Ω	9.4	3.1	220*	2.7	85	12A
★	"	650	"	"	"	30	6	30	200	175	0.1	20	250	6	0.1	5	-0.1	300	86k Ω	2.8	8.5	220*	2.7	75	12A
	"	651	日電	PA	"	45	4	300	750	150	0.1	20	20~200	10	100	10	-30	80			1100*	2.4	27*	84B	
	"	652	"	"	"	40	3	300	750	150	0.2	20	>20	10	100	10	-30	80			1100*	2.4	27*	84B	
	"	653	"	RF	"	25	3	200	150	150	0.1	12			6	-2	120	NF < 4dB (1Mc) NF < 22dB (1kc)			1400*	0.6	60*	50C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{βB} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)	
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
2SC654	日電	RF	Si.E	40	3	300	800	150	1	35				15	-50	80				650	2.9	21*	85B	
* 655	松下	RF.AF.PA	Si.EP	10	2	10	75	125	1	10	400	5	2	5	-2	250	3500	2.5	35	80*	4.5	70	34	
* 656	"	RF	"	10	2	5	50	125	1	10				10	-5	130			550*	1.5	C _e r _{bb'} 80pS	34		
* 657	ソニー	RF.Conv.Mix Osc	Si.DB	18		30	150	120	0.2	15	50	10	4	6	-1	50				500*	1.1	C _e r _{bb'} 15pS	38	
* 658	三菱	"	"	25	4	20	150	150	1	12	60	6	1	6	-1	60			550*	1.5	C _e r _{bb'} 30pS	8A		
* 659	"	"	"	25	4	20	150	150	1	12	60	6	1	6	-1	60			400*	1.5	C _e r _{bb'} 40pS	8A		
* 660	"	RF.Conv Mix	Si.P	25	4	20	150	150	0.5	20	60	10	3	10	-3	60			600*	1	C _e r _{bb'} 3pS	11A	フォワード AGC	
* 661	"	"	"	25	4	20	150	150	0.5	20	60	10	3	10	-3	60			600*	1	C _e r _{bb'} 4pS	11A	フォワード AGC	
* 662	"	RF.Conv Mix.Osc	Si.EP	25	2	20	150	150	0.5	10				6	-2	40			800*	1	C _e r _{bb'} 4pS	9		
* 663	"	"	"	25	2	20	150	150			10-300	10	10						900*	1.4	C _e r _{bb'} 5pS	11A		
* 664	日立	PA.SW	Si.T	100	5	5A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	30	80	5	1A										102	
* 665	"	"	"	130	6	7A	50W (T _c =25°C)	150	200	30	30-130	5	5A										102	
* 666																								
* 667																								
* 668	三洋	RF.Conv. Mix.	Si.TP	25	3	30	150	125	1	10	25-560	6	1	6	-1					600*	C _{re} 0.75	C _e r _{bb'} <30pS	92	
* 669	ソニー	PA	Si.E	30	5	2A	1W	175	5	25	70	2	100	10	-50	70			65*	18		181		
* 669A	"	"	Si.Eme	100	6	3A	10W (T _c =25°C)	175	3	25	170-400	2	100	10	-50	70			65*	35		181		
* 670																								
* 671																								
* 672																								
* 673																								
* 674	三洋	RF.Conv. Mix.	Si.TP	25	4	30	150	125	1	10	40-320	6	1	6	-1					600*	C _{re} 0.75	C _e r _{bb'} 17pS	92	
* 675	芝電	SW	Si.Me	250	6	7A	50W (T _c =25°C)	180	10	30	30	10	0.5A										102	
* 676	"	"	"	200	6	7A	50W (T _c =25°C)	180	10	30	30	10	0.5A										102	
* 677	"	"	"	150	6	7A	50W (T _c =25°C)	180	30	30	40	10	0.5A										102	
* 678	"	"	"	100	6	7A	50W (T _c =25°C)	180	100	30	40	10	0.5A										102	
* 679	日立	PA	Si.T	300	6	2A	30W (T _c =25°C)	175	1	30	60	10	20	10	-200	190				20*	75	20	153	
* 680	"	"	"	200	6	2A	12.5W (T _c =25°C)	150	1	30	180	10	200	10	-200	190				20*	75	20	153	
* 681	"	SW	"	200	5	6A	50W (T _c =25°C)	150	I _{CBX} 15mA	200													102	水平偏向用
* 682	"	RF	Si.P	20	3	20	180	175	0.1	10	60	10	2	10	-2	75				550*	C _{re} 0.37		9	フォワード AGC

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)				電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考				
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}			バイアス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} $h_{i\beta}^*$ (Ω)	h_{re} $h_{r\beta}^*$ ($\times 10^{-4}$)			h_{ob}^* (μV)	$f_{\beta b}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} C_{re} (pF)	r_{bb} $r_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)
									μA	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$	h_{fb}^*									
★ 2SC683	日立	RF	Si.P	20	3	20	180	175	0.1	10	60	10	2	10	-2	75	PG = 21dB ($f = 200\text{Mc}$)	550*	Cre 0.37	9	7	フォワード AGC		
★ " 684	"	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	30	2	50	200	125	0.5	10	>40	10	10	10	-10	50	PG = 8mW ($f = 930\text{Mc}$)	1100*	1.2	Cc rbb 10pS	37			
★ " 685	"	PA	Si.T	300	4	100	4W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	150	5	150	60-120	10	50	10	-50	50		25*	5		153			
★ " 686	日電	RF	Si.E	150	6	50	800	175	0.01	100	90	10	25	10	-25	100		180*	2.6	10*	84B			
★ " 687	松下	SW	Si.EP	150	6	5A	50W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	150	15mA	150	30	4	5A				$t_r < 2\mu\text{S}$, $t_f < 1\mu\text{S}$				102			
★ " 688	三菱	PA	"	60	4	1.5A	20W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	200	500	25				10	-100	30	PG = 8.5dB ($f = 150\text{Mc}$, $P_i = 1.9\text{W}$)		20		114			
★ " 689	日立	SW	"	40	5	100A	300	175	0.25	20	85	1	10	10	-10		$t_{on} = 6.5\text{nS}$, $t_{off} = 8\text{nS}$ $t_{10} = 3\text{nS}$	>600*	1.8		49C			
★ " 690	三菱	PA	"	60	5	3A	30W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	500	30	50	10	100				$P_o = 25\text{W}$ ($f = 150\text{MHz}$, $V_{CC} = 25\text{V}$, $P_i = 5\text{W}$)				113			
★ " 691	"	"	"	60	4	00	8.6W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	200	30	50	10	100				$P_o = 3.5\text{W}$ ($f = 150\text{MHz}$, $V_{CC} = 24\text{V}$, $P_i = 0.3\text{W}$)				113			
★ " 692	"	"	"	60	5	1A	15W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	200	30	50	10	100				$P_o = 9\text{W}$ ($f = 150\text{MHz}$, $V_{CC} = 28\text{V}$, $P_i = 3\text{W}$)				113			
★ " 693	三洋	RF.LN	Si.P	40	5	50	100	125	1	35	160-960	6	1	6	-1				100*	4		138		
★ " 694	"	"	"	40	5	50	100	125	1	35	160-960	6	1	6	-1				100*	4		138		
★ " 695	日電	AF.RF	Si.E	20	5	30	100	150	0.1	15	150	3	0.1	6	-1	200	6000	0.9	20	150*	2	50*	23	
★ " 696	松下	PA	Si.EP	100	5	3A	750	175	3	30	55	$V_{CB} = 2\text{V}$	100	2	-100	80			100*	20	Cc rbb 40pS	84B	2SA546 とコンプリ	
★ " 696A	"	"	"	130	5	3A	750	175	3	30	55	$V_{CB} = 2\text{V}$	100	2	-100	80			100*	20	Cc rbb 40pS	84B	2SA546A とコンプリ	
★ " 697	"	"	"	100	5	3A	10W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	3	30	55	$V_{CB} = 2\text{V}$	100	2	-100	80			100*	22	Cc rbb 40pS	97B	2SA547 とコンプリ	
★ " 697A	"	"	"	130	5	3A	10W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	3	30	55	$V_{CB} = 2\text{V}$	100	2	-100	80			100*	22	Cc rbb 40pS	97B	2SA547A とコンプリ	
★ " 698	日電	RF.PA	Si.E	100	5	3A	10W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	1	60	80	2	0.5A	10	-50	85			90*	35	15*	97B		
★ " 699	三菱	PA	Si.TP	50	4	1A	10W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	200	50	12				12	-100	30	PG = 9dB ($f = 27\text{MHz}$, $P_i = 0.5\text{W}$)		20		97B			
★ " 700	"	"	Si.EP	60	3	500	5W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	200	100	20				20	-50	30	PG = 11dB ($f = 150\text{MHz}$, $P_i = 0.2\text{W}$)		6		84C			
★ " 701	"	"	"		3	750	5W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	200	100	15				15	-50	30	PG = 10dB ($f = 150\text{MHz}$, $P_i = 0.2\text{W}$)		7		84C			
★ " 702	"	"	"	40	4	750	8.6W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	100	15	50	10	100				$P_o = 3\text{W}$ ($f = 150\text{MHz}$, $V_{CC} = 15\text{V}$, $P_i = 0.25\text{W}$)				113			
★ " 703	"	"	"	40	5	2A	21W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	1mA	15	50	10	100				$P_o = 12\text{W}$ ($f = 175\text{MHz}$, $V_{CC} = 13.5\text{V}$, $P_i = 3.5\text{W}$)				113			
★ " 704	"	"	"	40	5	4A	34W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	2mA	15	50	10	100				$P_o = 17\text{W}$ ($f = 175\text{MHz}$, $V_{CC} = 13.5\text{V}$, $P_i = 5.5\text{W}$)				113			
★ " 705	三洋	RF.Conv. Mix.Osc.	"	15	3	30	120	125	1	10	70	6	1	6	-1				800*	1.5	Cc rbb 14pS	27		
★ " 706	"	RF	"	15	3	30	120	125	1	10	80	6	1	6	-1				700*	1.1	Cc rbb 17pS	27		
★ " 707	日立	RF	Si.P	20	3	20	150	175	0.1	10	50	10	2	10	-2	75	PG = 12dB ($f = 800\text{MHz}$)	650*	0.4		9			
★ " 708	"	SW	Si.T	60	4	1A	750	150	10	30	30-160	4	50	4	-30				15*	25		84B	2SA537 とコンプリ	
★ " 708A	"	"	"	100	4	1A	750	150	10	30	30-160	4	50	4	-30				15*	25		84B	2SA537A とコンプリ	
★ " 709	三菱	RF.Conv Mix.Osc	Si.EP	25	4	100	200	125	1	25	75	6	10	6	-1	60			180*	3.5	Cc rbb 180pS	138B		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)										外 形	備 考				
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)	$V_{CB(V)}$	直流又はパルス h_{FE} $V_{CE(V)}$ / $I_C(\text{mA})$	バイアス $V_{CB(V)}$ / $I_E(\text{mA})$	h_{FE} h_{fb}^*	h_{ic} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	$f_{\beta b}$ f_T (Mc)	C_{ob} (pF)			$r_{bb'}$ $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)			
2SC710	三菱	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	30	4	30	200	125	1	25	90	6	1	6	-1				200*	2	$C_c \tau_{bb'}$ 20pS	138B		
" 711	"	RF.AF	"	30	4	100	200	125	0.1	25	250	6	1	6	-1		8500	0.6	40	150*	2.5	$C_c \tau_{bb'}$ 200pS	138B	
" 712	"	AF	"	30	4	100	200	125	1	25	90	6	10	6	-1		2500	0.4	15	150*	2.5	$C_c \tau_{bb'}$ 150pS	138B	
* " 712A	"	"	"	30	4	100	200	125	1	25	75	6	10	6	-1	80	2500	0.4	15	180*	2.5	$C_c \tau_{bb'}$ 150pS	138B	
* " 713	"	SW	"	30	4	100	200	125	0.1	25	90	6	10				$t_{on} < 60\text{nS}, t_{off} < 150\text{nS}$ $t_{\text{sig}} < 120\text{nS}$		150*	2.5		138B		
* " 714	"	"	"	70	5	200	250	125	0.1	25	60	6	10	6	-10		$t_{on} < 40\text{nS}, t_{off} < 250\text{nS}$ $t_{\text{sig}} < 150\text{nS}$		200*	7		138B		
* " 715	三洋	RF.V	"	40	5	100	120	125	1	35	180	6	1	6	-1		3500	0.8		140*	4	$C_c \tau_{bb'}$ 250pS	27	
* " 716	"	"	"	20	5	100	100	125	1	15	180	6	1	6	-1		3500	0.8	13	140*	4	$C_c \tau_{bb'}$ 250pS	27	
* " 717	日立	RF.Conv.Mix Osc	"	30	2	50	200	125	0.5	10	>40	10	10	6	-1	40	PG=18dB ($f=200\text{Mc}$)		1100*	1.2	$C_c \tau_{bb'}$ 10pS	37		
" 718	富士通	SW	"	20	4	200	300	175	0.4	15	60	1	10	10	-10		$t_r = 4\text{nS}, t_f = 9\text{nS}$			800*	2		49C	
" 719	"	"	"	20	4	200	200	175	0.4	15	60	1	10	10	-10		$t_r = 4\text{nS}, t_f = 9\text{nS}$			800*	2		46C	
* " 720	"	RF	Si.P	25	3	20	200	175	0.05	6				6	-2	100	PG=30dB (=45Mc)		500*	1.2	80*	50C	フォワード AGC	
* " 721	"	"	"	25	3	20	200	120	0.05	6				6	-2	100	PG=30dB ($f=45\text{Mc}$)		500*	1.4	80*	30	フォワード AGC	
* " 722	"	RF.Conv.Mix Osc	Si.EP	20		25	200	125	0.5	12				6	-2	80				700*	1.5	80*	138	
* " 723	"	"	Si.P	20		25	200	125	1	12				6	-2	60				500*	1.5	80*	138	
" 724	"	RF.SW	Si.EP	30	5	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	-2	70	$t_r < 20\text{nS}, t_f < 50\text{nS}$ $t_{\text{sig}} < 250\text{nS}$		250*	4	80*	138		
" 725	"	"	"	60	5	200	200	125	0.05	10	60	1	10	6	-2	70	$t_r < 20\text{nS}, t_f < 50\text{nS}$ $t_{\text{sig}} < 250\text{nS}$		250*	4	80*	138		
* " 726	"	SW	"	20	4	200	200	125	1	15	60	1	10		-2		$t_r = 4\text{nS}, t_f = 9\text{nS}$ $t_{\text{sig}} = 6\text{nS}$					30		
" 727	"	RF.AF.SW	Si.T	100	3	100	350	175	1	30	90	4	10	6	-2	60	1200	1	12	20*	9	40	49C	
" 728	"	"	"	200	6	100	350	175	1	30	90	4	10	6	-2	60	1200	1	12	20*	10	40*	49C	
* " 729	日電	RF	Si.E	50	5	200	600	175	0.5	30				10	-10	60				250*	4	40	84B	
" 730	三菱	PA	Si.EP	40	4	400	1.03W	175	10	15	50	10	100				$P_o = 1.5\text{W}$ ($f = 150\text{MHz}, V_{CC} = 13.5\text{V}, P_i = 0.1\text{W}$)					84B		
" 731	松下	"	"	40	4	500	2.5W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	1	20	70	13.5	100				$P_o = 1.2\text{W}$ ($f = 500\text{MHz}, V_{CE} = 13.5\text{V}, P_i = 0.3\text{W}$)					84B		
* " 732	東芝	LN	Si.E	60	5	150	400	125	0.1	60	200~700	6	2	6	-1					150*	2		138	
* " 733	"	RF	"	35	5	100	300	125	0.1	18	70~700	6	2	6	-1					>80*	7	$C_c \tau_{bb'}$ 150pS	33	
* " 734	"	"	"	70	5	150	300	125	0.1	18	70~400	1	20	6	-10					150*	5	15	33	2SA561 ヒコンソリ
* " 735	"	"	"	35	5	400	300	125	0.1	18	70~400	1	100	5	-50					300*	7	$C_c \tau_{bb'}$ 150pS	33	
* " 736	日電	SW	"	135	5	5A	50W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	500	60	60	10	1A				$t_{on} < 2\mu\text{S}, t_{off} < 4\mu\text{S}$ $t_{\text{sig}} = 3\mu\text{S}$					102		
" 737	三菱	PA	Si.EP	60	5	1.5A	17W ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	175	500	30	50	10	100				$P_o = 14\text{W}$ ($f = 150\text{MHz}, V_{CC} = 25\text{V}, P_i = 1.9\text{W}$)					113		
" 738	"	RF Conv. Osc	"	25	4	20	150	125	1	12	55~180	6	1	6	-1					440*	1.5	$C_c \tau_{bb'}$ 30pS	138B	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考			
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値 (μA)	V _{CE(V)}	直流又はパルス h _{FE} I _{C(mA)}	バイアス V _{CB(V)}	I _{E(mA)}	h _{FE} h _{FB} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _β f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	T _{bb} h _{ib(real)} * (Ω)	
★ 2SC739	三菱	RF.Conv.Mix.Osc	Si.EP	25	4	20	150	125	1	12			6	-1	60				350*	1.5	C _c T _{bb} * 30pS	138B	
★ "	"	"	"	25	2	20	150	150	0.5	10	40	10	10	-10	40			900*	1.4	C _c T _{bb} * 5pS	11A		
★ "	"	PA	"	40	4	300	2.5W (T _c =25°C)	175	1	15	50	10	100			P _o =0.3W (f=150Mc, V _{CC} =13.5V, P _m =10mW)					84B		
★ "	富士通	"	"	65	4	1.5A	12.5W (T _c =25°C)	175	5	30			10	-150	30			400*	8	10*	111		
★ "	"	"	"	65	4	3A	25W (T _c =25°C)	175	10	30			10	-300	30			350*	16	7*	111		
★ "	富士通	PA	Si.EP	50	4	1.5A	12.5W (T _c =25°C)	175	10	10			10	-150	45			450*	8	8*	111		
★ "	"	"	"	45	4	3A	25W (T _c =25°C)	175	20	10			10	-300	35			350*	20	6*	111		
★ "	"	"	"																				
★ "	富士通	PA	Si.EP	36	4	1A	12.5W (T _c =25°C)	175	10	10			10	-150	25			400*	16	7*	111		
★ "	"	"	"	36	4	2A	25W (T _c =25°C)	175	25	10			10	-300	25			350*	32	5*	111		
★ "	"	"	"																				
★ "	東芝	RF	Si.EP	20	2	20	100	150	1	10			10	-8	50			650*	1.9	30	46C		
★ "	"	SW	Si.E	40	5	200	400	125	0.1	40	40~240	1	10	10	-10			400*	4	30	138		
★ "	日電	RF.Conv.Mix.Osc	"	25		20	100	150	1	12			6	-2	70			1100*	0.7	C _c T _{bb} * 12pS	23		
★ "	"	RF.AF	"	20		150	150	150	1	20	100	1	20	6	-1	80		90*	6.5	25	23		
★ "	"	RF	"	15		100	150	150	0.1	15	270	3	0.5	3	-0.5	300	15kΩ	16	3	100*	8	30*	23
★ "	ソニー	PA	"	100	6	4A	10W (T _c =25°C)	175	3	50	80	2	100	10	-50	60		65*	35	C _c T _{bb} * 5pS	181		
★ "	日電	RF.Conv.Mix.Osc	"	30		20	100	150	1	12			6	-2	70			1100*	0.7	C _c T _{bb} * 10pS	23		
★ "	芝電	PA	Si.TMe	280	5	8A	60W (T _c =25°C)	150	10	30			5	-0.5A	35			18*	275	10	102		
★ "	"	"	"	180	5	8A	60W (T _c =25°C)	150	10	30			5	-0.5A	35			18*	275	10	102		
★ "	"	"	"	100	5	8A	60W (T _c =25°C)	150	100	30			5	-0.5A	35			18*	275	10	102		
★ "	松下	RF.Conv.Mix.Osc	Si.P	30	3	20	150	175	100	30	>25	10	2	10	-2	40	PG = 8dB (f = 900 Mc)		675*	C _{re} 0.28	60	50C	
★ "	"	"	"	30	3	20	150	175	100	30	>25	10	2	10	-2	40			600*	C _{re} 0.28	60	50C	
★ "	三菱	"	Si.EP	25	3	20	100	125	0.5	12	70	6	1	6	-1			470*	1.4	C _c T _{bb} * 15pS	138B		
★ "	日電	SW	Si.E	40	5	200	360	200	0.1	20	85	1	10	10	-10	80			750*	2	C _c T _{bb} * 25pS	49C	
★ "	三菱	PA	Si.TMe	60		2A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	30	60	4	1A			P _o = 20W (f = 27MHz, V _{cc} = 25V, P _i = 3W)					102		
★ "	"	"	"	120		2A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	30	60	4	1A			P _o = 19W (f = 27MHz, V _{cc} = 35V, P _i = 2W)					102		
★ "	"	"	"	180		2A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	30	60	4	1A			P _o = 19W (f = 27MHz, V _{cc} = 35V, P _i = 2W)					102		
★ "	"	PA.SW	"	60	5	10A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	30	25	4	2A			I _r < 3μS, I _f < 1μS I _{sig} < 2μS					102		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考							
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		hfe	h_{ie} hjb*	h_{re} h _{rj} *	h_{oe} h _{oB} *	f_{ob} f _{fT} *			C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h _{ie(external)} *					
									μA	$V_{CB(V)}$	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$										hfe	h_{ie} hjb*	h_{re} h _{rj} *	h_{oe} h _{oB} *	
★ 2SC799	日電	RF. PA	Si. E	80	5	1.5A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1	40	90	10	150	10	-150	$P_o = 3.5\text{W}$ ($f = 27\text{MHz}, V_{ce} = 12\text{V}, P_i = 0.4\text{W}$)	250*	15						97B				
★ "	"	RF	"	30	4	10	100	150	0.1	25	100	6	2	6	-2	85					1000*	0.5	$C_c r_{bb'}$ 5 pS	23				
★ "	"	RF. PA	Si. TMe	75	5	500	13 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1	50	50	10	150	10	-50	45					100*	32	12*	83				
★ "	富士通	PA. SW	Si. EP	60	4	500	1 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	5	12	30	4	150	20	-15	$P_o = 1.3\text{W}$ ($f = 27\text{M}, V_{ce} = 12\text{V}, P_i = 75\text{mW}$)	180*	5	12*		180*	9	7*	84B				
★ "	"	"	Si. TP	60	4	1.5A	5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1	12	70	4	400			$P_o = 3.5\text{W}$ ($f = 27\text{Mc}, V_{ce} = 12\text{V}, P_i = 0.5\text{W}$)	90*				90*	9	7*	84B				
★ "	ソニー	RF. Conv. Mix. Osc	Si. DB	15		20	150	100	0.5	15	50	3	1	6	-4					$h_{fe} = 12$ ($f = 100\text{Mc}$)		0.32	40*	24				
★ "	"	RF. AF. SW	Si. DB	100	5	200	475	120	1	25	100	5	3	10	-2						160*	3	$C_c r_{bb'}$ 80 pS	84B				
★ "	"	PA	Si. TMe	650	10	10A	125 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5mA	500	30	3	2A	10	-0.5A	50					5*	280	5	102				
★ "	"	"	"	500	10	10A	125 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5mA	500	50	3	100	10	-0.5A	50					5*	300	5	102				
★ "	"	"	"	300	8	5A	80 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	50	100	3	2A	10	-500						12*	310	$C_c r_{bb'}$ 700 pS	102				
★ "	富士通	RF	Si. EP	25	3	20	200	150	0.1	12				6	-2	90					1200*	1.4	40*	50C				
★ "	"	RF. PA	"	40	3	300	500	150	1	35				15	-50	70					750*	3.8	25*	85B				
★ "	"	RF	"	4	30	180	175	0.5	15	60	10	2	10	-2							800*	0.9	50	50C				
★ "	"	SW	"	20	4	100	250	150	0.5	10	50	1	10									2.5		49C				
★ "	"																											
★ "	日電	RF. PA	Si. E	30	5	500	400	125	0.2	18	150	5	50	10	-10	140					180*	13	25	44				
★ "	"	RF. Osc PA	"	60	5	200	250	125	0.1	45	80	1	50	10	-10	80					200*	5.5	25	138	2SA539 とコンプリ			
★ "	三菱	RF	Si. EP	60		1A	1W	200	10	28	100	6	0.1	10	-30						140*	12	$C_c r_{bb'}$ 60 pS	84B				
★ "	"	"	"	30		20	120	150	0.1	12	80	10	1							$G_{ps} = 13\text{dB}$ ($f = 500\text{MHz}, V_{ce} = 6\text{V}, I_C = 4\text{mA}$)				50C				
★ "	"	"	Si. TP	160	5	100	800	200			20-180	10	10								100*	4.5	$C_c r_{bb'}$ 14 pS	84A				
★ "	日立	PA	Si. EP	65	4	1A	6 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	65				28	-100	30					500*	7.5	12	84C				
★ "	"	"	"	65	4	1.5A	10 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	65				28	-100	30					500*	7.5	10	111	スタッドは インチネジ			
★ "	松下	RF. Conv. Mix Osc. PA	"	40	4	300	2.5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1	20				13.5	-100	70					450*	6.5	15*	84B				
★ "	"	"	"	40	4	500	2.5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1	20				13.5	-100	70					550*	6.5	15*	84B				
★ "	日電	RF	Si. E	30	3	60	600	150	0.1	10	>30	10	15	10	-15	130					1500*	0.9	$C_c r_{bb'}$ 3 pS	85B				
★ "	"	"	"	50	3	120	650	150	0.1	10	>20	10	30	10	-50	130					1300*	2.2	$C_c r_{bb'}$ 4 pS	85B				
★ "	富士通	SW	Si. T	300	6	2A	30 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	20	150	75	10	0.5A												99			
★ "	"	RF	Si. TMe	100	6	300	700	175	1	30	100	4	50	30	-10						20*	10	30	84B				
★ "	"	RF. SW	"	100	6	500	700	175	1	30	100	4	50	30	-10					$I_{on} < 0.2\mu\text{S}, I_f < 0.2\mu\text{S}$ $t_{sig} < 2\mu\text{S}$	20*	10	30	84B				
★ "	松下	RF. AF	Si. EP	30	5	50	250	125	1	10	65-700	5	2	5	-2	220					3600	0.4	20	220*	2.2	70	138	2SA564 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _c (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αβ} f _T * (MHz)			C _{ob} (pF)	τ _{bb} h _{ie} (real)* (ns)
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
★ 2SC828A	松下	RF. AF	Si. EP	45	5	50	250	125	1	10	65~700	5	2	5	-2	220	220*	2.2	70	138	2SC564A とコンパリ		
" 829	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	30	5	30	250	125	1	10	40~500	10	1	10	-1	130	230*	1.3	35	138			
★ " 830	日立	PA	Si. T	100	4	3 A	25 W (T _c = 25°C)	150	100	20	30~200	4	1 A	4	-1 A		6*	120		153	2SB551 とコンパリ		
" 831	日電	PA	Si. E	50	4	2 A	23 W (T _c = 25°C)	175	5	20	15~200	10	1 A	10	-30	80	500*	18		111			
" 832																							
" 833	日立 東芝 三洋	SW	Si. TMe	450	6	2 A	25 W (T _c = 25°C)	150	100	200	80	10	100	10	-100	100	t _{on} < 2μs, t _{off} < 3μs t _{sig} < 4μs	50		99			
" 834																							
" 835																							
★ " 836	日電	RF	Si	30	4	20	200	125	0.2	20	70	10	4	10	-4	60	600*	0.9	C _c τ _{bb} 3 pS	138	フェワード A G C		
★ " 837	"	"	Si. E	30	4	20	250	125	0.2	20	40	10	10	10	-10	30	PG = 20dB (f = 45Mc)	550*	1.6		138		
★ " 838	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	50	5	30	250	125	0.1	15	80	3	0.5	6	-1	90		250*	1.8	C _c τ _{bb} 20 pS	138		
★ " 839	"	"	"	50	5	50	250	125	0.1	15	100	3	0.5	6	-1	90	NF = 2.5dB (f = 1 Mc)	250*	2	C _c τ _{bb} 25 pS	138		
★ " 840	松下	PA	Si. TMe	100	5	2 A	20 W (T _c = 25°C)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	-100	60		50*	90	25	99		
★ " 840A	"	RF. Conv. Mix. Osc	Si. EP	150	5	2 A	20 W (T _c = 25°C)	150	5mA	100	60	3	1 A	3	-100	60		50*	90	25	99		
★ " 841	富士通	PA	"	36			6 W (T _c = 25°C)	175	5	12	50	4	500	12	-150			450*	12	12*	84B		
★ " 842	"	"	"	36		1 A	10 W (T _c = 25°C)	175	5	12	40	4	1 A	12	-150			450*	13	10*	111		
★ " 843	"	"	"	36		2 A	20 W (T _c = 25°C)	175	12	12	50	4	2 A	12	-150			350*	25	7*	111		
★ " 844	"	"	"	40	2	400	3.5 W (T _c = 25°C)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 1.1W (f = 175Mc, V _{CE} = 12V)	800*	3	20*	84B		
★ " 845	"	"	"	55	3.5	400	3.5 W (T _c = 25°C)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 1.4W (f = 100Mc, V _{CE} = 28V)	800*	3	20*	84B		
" 846																							
" 847	富士通	RF	Si. EP	30	5	200	350	175	0.5	12	160	4	10	6	-1			70*	10	40	49C		
" 848	"	RF. LN	"	30	5	200	350	175	0.1	12	160	4	10	6	-1		3500	0.1	5	60*	10	40	49C
" 849	"	SW. AF	"	30	5	300	350	175	0.5	12	160	4	10	6	-1		3500	0.1	5	t _r < 0.08 μs, t _f < 0.15 μs t _{sig} < 0.8 μs		49C	
" 850	"	SW. PA	"	50	7	500	350	175	0.5	12	160	4	10	6	-1			70*			49C		
★ " 851	日電	PA	Si. E	50	5	8 A	75 W (T _c = 25°C)	200	500	30	50	5	5 A								102A		
" 852	"	RF	"	45	3	80	500	150	0.5	15	100	6	20	6	-20			1100*	2	C _c τ _{bb} 3.7 pS	85B		
★ " 853	日電	RF. PA	"	70	5	200	400	125	0.1	60	70	2	150	10	-10	110		90*	7.5	40*	44	2SA545 とコンパリ	
★ " 854	富士通	PA	Si. EP	40	2	300	2.5 W (T _c = 25°C)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 0.75 W (f = 175Mc, V _{CE} = 12V)	800*	2.5	20*	84B		
★ " 855	"	"	"	40	2	400	3 W (T _c = 25°C)	175	1	12	25	5	100	15	-30	40	P _o = 0.9 W (f = 175Mc, V _{CE} = 12V)	800*	2.5	20*	84B		
★ " 856	日立	RF	Si. TP _a	150	5	50	300	175		20	50	6	10	6	-10			150*	2.5	25*	12A		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 氣 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)										外 形	備 考			
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe} h_{fe}^*	h_{ie} h_{ie}^* (Ω)	h_{re} h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe}^* (μM)			$f_{\alpha b}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)
									μA	$V_{CB(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$									
2SC915	富士通 沖 日電	SW	Si. EP	30	5	300	300	175	0.2	20	70	1	30					2.5		49C			
" 916	"	"	"	100	5.5	1.5A	2W	175	10	80	70	1	400					30		83			
" 917	日立	RF	Si. P	40		50	300	175	10	40	40	10	10	10	-10			800*	1	C_{crbb}^* 5pS	56C		
" 918	ソニー	"	Si. DB	20		30	188	100	0.2	15	80	10	4	10	-4	$h_{fe} = 12\text{dB}$ ($f = 100\text{MHz}$)			0.7	C_{crbb}^* 10pS	205C		
" 919																							
" 920	日電	RF. Conv. Mix. Osc. LN	Si. E	50	5	30	150	150	0.1	15	75	3	0.5	6	-1	$NF = 2.5\text{dB}$ ($f = 1\text{Mc}$)		250*	1.6	C_{crbb}^* 30pS	23		
" 921	"	RF. Conv. Mix. Osc.	"	25	2	10	100	150	0.1	12	65	3	0.5	6	-1			650*	0.9	C_{crbb}^* 9pS	23		
" 922	"	"	"	30	5	20	250	125	0.1	20	80	6	1	6	-1			650*	1.1	C_{crbb}^* 15pS	138		
" 923	"	RF. AF	"	40	5	100	250	125	0.05	40	500	3	0.5	6	-1			100*	3.5	50	138		
" 924	"	"	Si. EP	30		50	250	125	0.1	15	100	3	0.5	6	-1	130	3800	0.6	8	250*	1.8	C_{crbb}^* 20pS	138
" 925	"	RF. AF. SW	"	30	5	50	250	125	0.1	30	130	12	2	12	-2	140	2300	3.5	45	250*	1.8	50	138
" 926	ソニー	RF. SW	Si. DB	115	3.5	100	100	120	0.2	115	50	3	1	10	-2			160*	2.5	C_{crbb}^* 40pS	38		
" 927	三洋	RF. LN	Si. TP	30	3	20	150	125	1	25	80	6	1	6	-3			500*	0.7	C_{crbb}^* 3.0pS	205C		
" 928	"	RF	"	30	3	20	150	125	1	25	80	6	1	6	-3			500*	0.7	C_{crbb}^* 3pS	205C		
" 929	"	RF. Conv. LN	Si. EP	30	5	30	250	125	1	10	100	6	1	6	-1			300*	C_{rco} 1.3	C_{crbb}^* 20pS	138		
" 930	"	RF	"	30	5	30	250	125	1	10	80	6	1	6	-1			300*	C_{rco} 1.3	C_{crbb}^* 20pS	138		
" 931	"	PA	Si. TMe	50		3A	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	125	1mA	45	70	2	1A	5	-0.5A			120*	100	35	120		
" 932	"	"	"	30		3A	$\frac{10\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	125	1mA	25	70	2	1A	5	-0.5A			120*	100	35	120		
" 933	"	AF	Si. EP	50	5	300	300	125	1	45	150	5	20	6	-5			300*	5	C_{crbb}^* 120pS	138		
" 934	"	"	"	20	5	300	300	125	1	15	150	5	20	6	-5			300*	5	C_{crbb}^* 120pS	138		
" 935	日立	PA	Si. T	300	5	2.5A	$\frac{50\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	I_{CBX} 1mA	300	14	10	300									102	
" 936	"	"	"	1000	5	1A	22W	125	I_{CBX} 1mA	1000	45	10	100									102	
" 937	"	"	"	1200	6	2.5A	$\frac{22\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	125	I_{CBX} 1mA	1200	8	10	2.5A			$t_f < 1.2\mu\text{S}$						102	
" 938	日電	RF	Si. E	60	5	200	250	125	0.1	60	80	1	50	10	-10			90*	7.5	40*	138		
" 939	"	PA. SW	Si. EMe	150	7	5A	$\frac{50\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	2mA	60	70	5	5A	10	-200			20*	150	20*	102		
" 940	"	"	Si. EMe	200	7	5A	$\frac{50\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	2mA	90	40	5	5A	10	-200			20*	150	20*	102		
" 941	東芝	RF. LN	Si. E	35	4	100	400	125	0.1	20	40-240	12	2	10	-2	$NF = 2\text{dB}$ ($f = 1\text{Mc}$, $I_E = -1\text{mA}$)		120*	C_{re} 2.2	C_{crbb}^* 30pS	138		
" 942	富士通	RF	Si. EP	20	3	20	$\frac{300}{\text{unit}}$	175	0.5	10				6	-2	70		700*	1.3	80*	122C		
" 943	日電	"	Si. E	60	8	200	300	150	0.5	40	150	1	10	10	-10			250*	3.4	40	49C		
" 944	"	RF. AF. SW	"	60	8	100	250	125	0.1	40	180	10	2	6	-10			250*	2.2	C_{crbb}^* 40pS	138		

直結2段
2素子複合

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)										外 形	備 考					
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CE} (V)	直流又はパルス h_{FE}	バイアス	h_{je}	h_{ie}	h_{ib}^*	h_{re}	h_{rb}^*	h_{oe}			h_{ob}^*	f_{ab}	f_T^*	C_{ob}	r_{bb}
★	2SC975	三菱 PA	Si.EP	35	5	1.5A	17 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	200	15	50	10	100											126	
★	" 976	" " "	"	55	4	400	5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	30	50	28	20											126	
★	" 977	" " "	"	55	4	600	10 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	300	30	50	28	50											126	
★	" 978	" " "	"	55	4.5	1.2A	18 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	500	30	50	28	50											126	
	" 979	東芝 RF.SW	Si.E	70	5	100	300	175	0.1	70	40-240	1	10	10	-10				250*	3			49C	2SA499 とコンプリ	
	" 980	" " "	"	70	5	100	400	125	0.1	50	70-240	1	10	10	-10				250*	3	30		138		
	" 981	" PA	"	100	5	5 A	25 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	40	70	1.5	5 A	5	-500				10*	80	10		99		
★	" 982	" AF.SW	"	40	10	300	400	125	0.1	40	>5000	5	10										138	ゲ-リ-ン-ト-ン	
★	" 983	" " "	Si.TP	250	5	50	600	150	0.1	30	40-240	5	10	30	-10				120*	<5.5	25		131		
★	" 984	日立	Si.EPa	50	4	500	350	175	0.5	20	80	3	10	3	-10				230*	5	24*		12A	2SA565 とコンプリ	
★	" 985	日電 RF.LN	Si.E	20	3	40	200	150	0.5	10	80	5	15	5	-15	NF = 5.3dB ($f = 2\text{Gc}$, 5V, -4mA)		3200*	0.6		$C_c r_{bb}$ 1 pS		26		
★	" 986	" RF	"	35	3	200	3.5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	1	20	100	15	70	15	-70				2500*	1		$C_c r_{bb}$ 3 pS		146A	
★	" 987	" " "	"	20	3	30	150	150	0.5	10	80	10	10	10	-10	NF = 8 dB ($f = 4\text{Gc}$, 10V, -3mA)		4500*	0.35		$C_c r_{bb}$ 0.6 pS		26		
	" 988	" " "	"	20	3	30	200	200	0.1	10	100	10	10	10	-10	NF < 2.5dB ($f = 500\text{Mc}$, 10V, -3mA)		3000*	C_{re} 0.5	30*		50C			
★	" 989	" " "	"	20	3	50	300	200	0.5	10	80	1	30	3	-15				3000*	0.9	30*		25		
★	" 990	" PA	"	50	4	2 A	24 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	10	20	40	10	1 A	10	-300	$P_o = 15\text{W}$ ($f = 400\text{Mc}$, $V_{ce} = 18\text{V}$, $P_i = 4.3\text{W}$)		400*	25				116		
★	" 991	東芝	Si.EP	36	4	400	600	175	1	15	30	3	100	10	-50	$P_o = 1.3\text{W}$ ($f = 175\text{Mc}$, $V_{ce} = 12\text{V}$, $P_i = 0.1\text{W}$)		500*	5	10			84B		
★	" 992	" " "	"	36	4	600	600	175	1	15	30	3	100	10	-50	$P_o = 2.5\text{W}$ ($f = 175\text{Mc}$, $V_{ce} = 12\text{V}$, $P_i = 0.5\text{W}$)		500*	5	10			84B		
★	" 993	富士通 RF	"	25		200	200	175	0.05	10				6	-1	80			400*	3.5	50*		46C		
	" 994	東芝 RF.PA	"	36	3	100	600	175	1	15	20-400	3	100	10	-10				500*	3.8			84B		
	" 995	" RF.PA	Si.TP	300	5	150	800	150	0.1	100	25-400	10	50	10	-30				100*	4.2	10		84B		
	" 996	" " "	"	300	5	150	1.2W	150	0.1	100	25-400	10	50	10	-30				100*	4.2	10		97B		
	" 997	" RF	Si.P	40		25	150	150	0.025	10	70	10	4	10	-4				600*	1.5			117C		
	" 998	" PA	Sj.EP	40	4	400	600	175	1	15	>20	5	50	5	-50				550*	6.5			84B		
★	" 999	" RF.PA.SW	Si.TMe	1500	5	1.5A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	50	15	150	15	-200				1	70	10		102		
★	" 1000	" LN	Si.E	60	5	150	400	125	0.1	60	200-700	6	2	6	-1				80*	6			138	2SA493 とコンプリ	
	" 1001	" RF.PA	Si.EP	40	4	500	5 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1	15	>20	5	100	10	-50	$P_o = 1.2\text{W}$ ($f = 470\text{Mc}$, $V_{ce} = 12.6\text{V}$, $P_i = 0.3\text{W}$)		700*	6.5	25*		84B			
★	" 1002	" " "	"	36	4	1 A	10 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	20	15	60	2	200	12.6	-100	$P_o = 3\text{W}$ ($f = 470\text{Mc}$, $V_{ce} = 12.6\text{V}$, $P_i = 1\text{W}$)		700*	10	20*		84B			
★	" 1003	" " "	"	36	4	2 A	20 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	50	15	50	2	400	12.6	-200	$P_o = 6\text{W}$ ($f = 470\text{Mc}$, $V_{ce} = 12.6\text{V}$, $P_i = 2.5\text{W}$)		350*	20	10*		111			
★	" 1004	" PA	Si.TMe	1100	5	500	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	30-160	15	150	15	-200				5.5*	40			102		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考			
				V_{CE0} (V)	V_{E0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μS)	f_{ab} f_T^* (Mc)			C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)	
									I_{CB0} (μA)	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE(V)}$	$I_E(\text{mA})$	$V_{CE(V)}$										$I_E(\text{mA})$
2SCI004A	東芝	PA. SW	Si.TMe	1500	5	500	$\frac{50\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	10	500	30~160	15	150	15	-200					5.5*	40	10	102	
* " 1005	"	PA	"	1100	5	5 A	$\frac{50\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	10	500	12	15	4 A	15	-500					3*	150	5	102	
" 1006	日電	RF. AF	Si.E	50	5	30	300	150	0.05	30	600	3	1	6	-1	15k	1.5	35	90*	3.5	50*	49C	2SA579 とコンプリ	
" 1007	"	RF. SW	"	60	8	20	300	150	0.1	40	150	1	10	10	-10				250*	3.4	30*	49C		
" 1008	"	RF	"	80	8	700	800	150	0.1	60	160	2	50	10	-50				75*	17	25*	84B	2SA708 とコンプリ	
* " 1009	"	RF. Conv. Mix. Osc. LN	"	50	5	50	150	125	0.1	15	80	3	0.5	6	-1	NF=2.5dB (f=1MHz, 6V, 0.5mA)			250*	2	$C_c^* 66'$ 25pS	176		
" 1010	"	AF. LN	"	50	5	30	300	150	0.05	30	550	3	1	6	-1	15k	1.5	35	90*	3.5	50*	49C	2SA578 とコンプリ	
" 1011	三菱	PA	Si.EP	40	4	750	$\frac{8.6\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	100	15	50	10	100			$P_o = 3\text{ W}$ (f=150 MHz, $V_{ce}=15\text{ V}$, $P_i=250\text{ mW}$)						271		
* " 1012	松下		Si.TP	165	5	60	$\frac{2.5\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$		2	12	60	20	40	10	-3	35	300	0.4	2.7	100*		$C_c^* 66'$ 60pS	84B	
* " 1013	三菱	SW. P	Si.EP	35	5	1.5A	$\frac{7\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1	25	80	4	500			$t_{on} < 0.2\mu\text{S}$, $t_{off} < 1.2\mu\text{S}$ $t_s < 1\mu\text{S}$						132		
* " 1014	"	"	"	50	5	1.5A	$\frac{7\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1	25	70	4	500			$t_{on} < 0.2\mu\text{S}$, $t_{off} < 1.2\mu\text{S}$ $t_s < 1\mu\text{S}$						132		
* " 1015	"	PA	"	40	4.5	3 A	$\frac{33\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	500	15	50	10	100			$P_o = 14\text{ W}$ (f=450 MHz, $V_{ce}=13.5\text{ V}$, $P_i=6\text{ W}$)						126		
* " 1016	"	"	"	35		500	2 W	200	50	15	50	10	100			$P_o = 1.3\text{ W}$ (f=500 MHz, $V_{ce}=12\text{ V}$, $P_i=0.3\text{ mW}$)						271		
" 1017	"	"	"	75	4	1 A	$\frac{4\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	125	10	30	50	10	100			$P_o = 60\text{ mW}$ (f=27 MHz, $I_c=25\text{ mA}$, $V_{ce}=12\text{ V}$)						132		
* " 1018	"	"	"	75	4	1 A	$\frac{4\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	125	10	30	50	10	100			$P_o = 1.4\text{ W}$ (f=27 MHz, $P_i=75\text{ mW}$, $V_{ce}=12\text{ V}$)						132		
* " 1019	"	"	"	60		4 A	$\frac{40\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	1mA	30	50	10	100			$P_o = 28\text{ W}$ (f=500MHz, $V_{ce}=28\text{ V}$, $P_i=20\text{ W}$)						188		
* " 1020	"	"	"	60		8 A	$\frac{70\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	2mA	30	50	10	100			$P_o = 45\text{ W}$ (f=500MHz, $V_{ce}=28\text{ V}$, $P_i=20\text{ W}$)						188		
* " 1021	"	"	"	60	5	6 A	$\frac{60\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	2mA	30	50	10	100			$P_o = 45\text{ W}$ (f=90 MHz, $V_{ce}=28\text{ V}$, $P_i=5\text{ W}$)						127		
* " 1022	"	"	"	60	5	6 A	$\frac{60\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	2mA	30	50	10	100			$P_o = 45\text{ W}$ (f=150 MHz, $V_{ce}=28\text{ V}$, $P_i=10\text{ W}$)						127		
* " 1023	富士通	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. P	25	3	25	150	125	2	12	40	6	1	6	-2				200*	1.8		138		
* " 1024	三洋	PA	Si.TMe	60	4	3 A	$\frac{25\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1 mA	55	25~200	2	1 A										99	
" 1025	"	"	"	200	6	3 A	$\frac{25\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1 mA	180	40~320	2	500	5	-500				8*	100		99		
* " 1026	富士通	RF. Conv.	Si. P	25	3	25	150	125	2	12	70	6	1	6	-2	NF=2.5 dB (f=1MHz, 6V, 1mA)					70*	138		
* " 1027	三洋	SW	Si.Me	250	5	6 A	$\frac{50\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1 mA	30	> 9	2	5 A										102	
" 1028																								
" 1029																								
" 1030	日立	PA	Si.T	150	6	6 A	$\frac{50\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1 mA	30	80	5	1 A	5	-1 A				10*	180		102	2SA756 とコンプリ	
" 1031	日電	SW	Si.TMe	300	6	2 A	$\frac{30\text{ W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	5	150	220	10	500	10	-100	$t_{on} < 5\mu\text{S}$, $t_{off} < 15\mu\text{S}$ $t_{stg} < 5\mu\text{S}$			15*			99		
* " 1032	富士通	RF	Si. P	25	3	25	150	125	2	12	100	6	1	6	-2				200*	1.8	70*	138		
* " 1033	松下	RF. AF	Si. TP	200	5	25	300	175	2	12	> 30	10	5	10	-3	38	300	0.4	'2.9	135*	3.3	$C_c^* 66'$ 60pS	49C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}			バイアス		h _{fe}	h _{ie} (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μΩ)			f _{αβ} (Mc)	C _{ob} (pF)	τ _{1/2} h _{ie} (real)* (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _c (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
2SC1034	ソニー	PA. SW	Si. TMe	1100	13	1 A	25W (T _c =25°C)	150	5 mA	800	18	3	750	10	-200				5 *	95	C _{ob} 88pF 220pS	100		
* 1035	三洋	LN	Si. TP	30	3	20	150	150	1	25	100	6	1	6	-3	NF=6dB (f=800MHz, 11V, 2mA)			700 *	0.7	C _{ob} 88pF 2.5pS	205C		
* 1036	"	RF	"	30	3	20	150	150	1	25	100	6	1	6	-3				700 *	0.7	C _{ob} 88pF 2.5pS	205C		
* 1037	日電	PA	Si. E	60	4	4 A	50W (T _c =25°C)	175	1 mA	30	50	10	1 A			P ₀ =33W (f=160Mc, V _{cc} =28V, P _i =10W)						111		
* 1038	"	"	"	40	3	150	3.75W (T _c =25°C)	175	50	20	15~200	10	70	10	-70	P ₀ =800mW (f=2.3GHz, V _{cc} =18V, P _i =250mW)			2000 *	2.5		129		
* 1039	"	"	"	40	3	250	7.5W (T _c =25°C)	175	100	20	15~200	10	100	10	-100	P ₀ =1.4W (f=2.3GHz, V _{cc} =18V, P _i =630mW)			2000 *	4		129		
* 1040	"	"	"	45	4	1.2 A	15W (T _c =25°C)	175	1 mA	30	15~200	10	1 A			P ₀ =8W (f=500MHz, V _{cc} =18V, P _i =2W)						184		
* 1041	"	"	"	40	3	150	3.75W (T _c =25°C)	175	50	20	15~200	10	70	10	-70	P ₀ =900mW (f=2GHz, V _{cc} =18V, P _i =250mW)			2000 *	2.5		129		
* 1042	"	"	"	40	3	250	7.5W (T _c =25°C)	175	100	20	15~200	10	100	10	-100	P ₀ =1.6W (f=2GHz, V _{cc} =18V, P _i =630mW)			2000 *	4		129		
* 1043	"	RF. LN	"	45	3	300	6W (T _c =25°C)	175	0.1	30	80	10	100	15	-50	P ₀ =15dB (f=500MHz, 50mA) NF=3.5dB (f=200MHz, 50mA)			2200 *	2.5		129		
* 1044	"	RF	"	45	4	30	250	200	50nA	30	100	6	6	-6				1000 *	NF=8dB (f=200MHz)			50C		
* 1045	三洋	RF. PA	Si. T	1000	5	1 A	25W (T _c =25°C)	125	5	100	25~200	15	200									102		
* 1046	"	PA	Si. TMe	1000	6	3 A	25W (T _c =25°C)	150	100	100	8	5	2 A	5	-100	t _r <1.5μS			4 *	150	35	102		
* 1047	松下	RF	Si. EP	30	3	15	150	125	10	30	120	6	1	6	-1				650 *	C _{re} 0.88pF	30	138		
* 1048	三洋	"	Si. Me	200	6	50	600	150	10	100	90	10	25	10	-10				120 *	3.5		84B		
* 1049	"	"	"																					
* 1050	三洋	PA	Si. TMe	300	6	1 A	40W (T _c =25°C)	150	1 mA	150	90	5	300	5	-300				5 *	50		102		
* 1051	"	"	"	150	6	7 A	60W (T _c =25°C)	150	1 mA	30	90	5	1 A	5	-1 A				8 *	230		102		
* 1052	富士通	SW	Si. EP	75	5	1 A	800	175	0.5	50	40	1	500		t _{on} <50nS, t _{off} <70nS t _{stg} <40nS							84B		
* 1053	"	"	"	75	5	700	800	175	0.2	40	50	1	500		t _{on} <40nS, t _{off} <60nS t _{stg} <45nS							123		
* 1054	"	RF. LN	"	35	3	50	180	175	0.5	12	60	6	1	6	-2	NF=3dB (f=200MHz, 6V, 1mA)			700 *	1	30 *	205C		
* 1055	日立	PA. SW	Si. T	130	6	7 A	25W (T _c =25°C)	175	200	30	60	4	5 A		t _{on} =0.4μS, t _{off} =4μS t _{stg} =35μS							153		
* 1056	ソニー	RF	Si. PaMe	260	5	100	750	175	1	100	150	5	3	20	-20				180 *	7		181		
* 1057	富士通	PA	Si. EP	50	3.5	1 A	12W (T _c =25°C)	175	500	20	50	5	500		P ₀ =6.5W (V _{cc} =24V, f=700MHz, P _i =2W)			800 *	8		133			
* 1058	"	"	"	50	3.5	2 A	20W (T _c =25°C)	175	1 mA	20	50	5	1 A		P ₀ =11.5W (V _{cc} =24V, f=700MHz, P _i =4W)							133		
* 1059	日立	"	"	300	4	150	8W (T _c =70°C)	150			60	10	50										153	
* 1060	"	PA	Si. T	50	4	3 A	25W (T _c =25°C)	150	100	20	35~320	4	1 A	4	-500				8 *	100		267	2SA670 とコンパリ	
* 1061	"	"	"	50	4	3 A	25W (T _c =25°C)	150	100	20	35~320	4	1 A	4	-500				8 *	100		268	2SA671 とコンパリ	
* 1062	富士通	SW	Si. TMe	200	4	100	700	175	2	100	60	2	50		t _{on} <3.2μS, t _{off} <12μS t _{stg} =8μS							5	84B	
* 1063	ソニー	"	Si. DB	10	5	1 A	750	150	1	10	60	1	65		t _{on} <60nS, t _f <100nS t _{stg} <300nS								84C	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考								
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _α f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(real)} * (Ω)						
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)															
2SC1093																													
# 1094																													
# 1095																													
★ # 1096	日電	PA	Si.E	40	5	3 A	10W (T _c =25°C)	150	1	30	100	5	1 A	5	-100										65 *	55	167	2SA634 とコンプ))	
# 1097																													
★ # 1098	日電	PA.SW	Si.E	70	5	3 A	10W (T _c =25°C)	150	1	45	100	5	500	5	-100										60 *	40	167	2SA636 とコンプ))	
★ # 1099	"	SW	Si.TMe	1200	7	4.5 A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	1000	25	15	3 A																102
★ # 1100	"	"	"	1100	7	4.5 A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	1000	25	15	3 A																102
# 1101	"	"	"	1100	5	1 A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	1000	60	15	500																102
★ # 1102	"	PA. SW	"	300	7	100	11W (T _c =25°C)	150	100	300	90	10	10	30	-10										80 *	3.5	10	134	
★ # 1103	"	PA	Si.T	250	7	100	800	150	100	250	80	10	10	30	-10										80 *	4.5	30	84B	
★ # 1104	"	SW	"	300	5	700	20W (T _c =25°C)	150	100	200	80	10	400																134
★ # 1105	"	PA	"	300	5	100	15W (T _c =25°C)	150	100	200	80	10	50	50	-20										20 *	5	30	134	
# 1106	"	SW	"	350	5	2 A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	200	80	15	500																102
★ # 1107	サンケン	PA	Si.TMe	80		4 A	25W (T _c =25°C)	150	100	80	120	4	1 A	10	-200										10 *	25	26 *	268	
★ # 1108	"	"	"	100		4 A	25W (T _c =25°C)	150	100	100	120	4	1 A	10	-200										10 *	25	26 *	268	
★ # 1109	"	"	"	80		4 A	25W (T _c =25°C)	150	100	80	120	4	1 A	10	-200										10 *	25	26 *	267	
★ # 1110	"	"	"	100		4 A	25W (T _c =25°C)	150	100	100	120	4	1 A	10	-200										10 *	25	26 *	267	
# 1111	"	"	"	140	6	6 A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	140	60	4	3 A	12	-500										10 *	115	12 *	102	
# 1112	"	"	"	160	6	6 A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	160	60	4	3 A	12	-500										10 *	115	12 *	102	
# 1113	"	PA. SW	"	120	10	6 A	40W (T _c =25°C)	150	1mA	120	60	4	5 A	12	-500														99
# 1114	"	PA	"	300	7	4 A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	300	60	4	1 A	12	-100										10 *	50	26 *	102	
# 1115	"	"	"	140	6	10 A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	140	60	4	3 A	12	-500										10 *	165	13 *	102	2SA746 とコンプ))
# 1116	"	"	"	180	6	10 A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	180	60	4	3 A	12	-500										10 *	165	13 *	102	2SA747 とコンプ))
★ # 1117	日立	RF	Si. P	20	3	20	150	150	1	15	150	10	2	10	-2														50C
# 1118	日電	"	Si. E	45	4	2 A	27W (T _c =25°C)	175	2mA	30	50	10	1 A	10	-300											400 *	30	184	
# 1119	"	RF	"	20	3	30	250	175	0.1	10	100	10	10	10	-10														130
★ # 1120	東芝	PA	Si.EP	35	4	1.5 A	10W (T _c =25°C)	175	5	15	40	5	500	10	-100											700 *	8	20 *	135
★ # 1121	"	"	"	35	4	3 A	20W (T _c =25°C)	175	25	15	40	5	1 A	10	-200											500 *	20	10 *	135
★ # 1122	"	"	"	35	4	4.5 A	30W (T _c =25°C)	175	100	15	40	5	1.5 A	10	-100											400	20	135	

G_{0P} = 13dB, NF = 5.6dB
(12V, 2mA, f = 800MHz)
P₀ = 14.5W
(f = 500MHz, V_{ce} = 18V, P_i = 5W)

P₀ = 4W
(f = 470MHz, P_i = 1W, V_{ce} = 12.6V)
P₀ = 8.5W
(f = 470MHz, P_i = 3W, V_{ce} = 12.6V)
P₀ = 14W
(f = 470MHz, P_i = 6W, V_{ce} = 12.6V)

850 *
Cre
0.35

400 *

4500 *
Cre
0.4

700 *

500 *

400

26 *

30

26 *

26 *

12 *

12 *

102

99

26 *

13 *

13 *

130

20 *

10 *

135

135

135

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考		
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{cb} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ib'(real)} * (Ω)
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SC1123	ソニー	Mix	Si. DB	35	3	100	300	100	0.2	15	70	3	1	10	-5	h _{fe} = 15dB (f = 100MHz)		550 *	2.1	C _e τ _{bb'} 8 pS	138D		
" 1124	"	PA	Si.PaMe	140	6	1 A	950	120	1	50	160	2	100	10	-10			120 *	6.5	C _e τ _{bb'} 150pS	174		
" 1125																							
" 1126	ソニー	RF. Osc	Si. DB	30	3	50	250	100	0.2	15	50	3	1	10	-8	h _{fe} = 15dB (f = 100MHz)		550 *	1.5	C _e τ _{bb'} 16 pS	138C		
" 1127	"	RF	Si.PaMe	180	8	100	950	120	1	100	60	5	3	10	-2			30 *	2.5	C _e τ _{bb'} 80pS	174		
" 1128	"	"	"	35	3	100	300	100	0.3	15	70	3	1	10	-10	h _{fe} = 16dB (f = 100MHz)		550 *	1.6	C _e τ _{bb'} 7 pS	138C		
" 1129	"	"	"	35	3	30	300	100	0.2	15	70	10	4	10	-4	h _{fe} = 12dB (f = 100MHz)		400 *	1	C _e τ _{bb'} 12 pS	138C		
★ " 1130	オリジソ	PA. SW	SiT	800	6	3.5A	80W (T _c =25°C)	150	2mA	800	15	5	2 A	10	-1A	t _{on} < 1μS, t _{off} < 2μS		4 *	150	10	102		
★ " 1131	"	"	"	600	6	3.5A	80W (T _c =25°C)	150	2mA	600	15	5	2 A	10	-1A	t _{on} < 1μS, t _{off} < 2μS		4 *	150	10	102		
" 1132	"	"	"	1200	6	2.5A	30W (T _c =25°C)	125	1mA	1200	15	5	0.5A	10	-1A	t _{on} < 1μS, t _{off} < 1.2μS		3.5 *	110	10	102		
" 1133																							
" 1134																							
" 1135																							
★ " 1136	オリジソ	PA. SW	Si. T	200	6	30A	200W (T _c =25°C)	150	5mA	200	20	5	10A	10	-1A			9 *	650	5	154		
" 1137																							
★ " 1138	オリジソ	PA. SW	Si. T	800	6	30A	200W (T _c =25°C)	150	5mA	800	20	15	10 A	10	-1A			9 *	650	5	154		
★ " 1139	"	"	"	600	6	30A	200W (T _c =25°C)	150	5mA	600	20	5	10 A	10	-1A			9 *	650	5	154		
★ " 1140	"	"	"	800	6	15 A	150W (T _c =25°C)	150	3mA	800	15	5	7.5A	10	-1A	t _{on} < 1.5μS, t _{off} < 5μS		10 *	350	10	102		
★ " 1141	"	"	"	600	6	15 A	150W (T _c =25°C)	150	3mA	600	15	5	7.5A	10	-1A	t _{on} < 1.5μS, t _{off} < 5μS		10 *	350	10	102		
" 1142	"	"	"	800	6	10A	125W (T _c =25°C)	150	3mA	800	15	5	5 A	10	-1A	t _{on} < 1.5μS, t _{off} < 3μS		4 *	270	10	102		
" 1143	"	"	"	600	6	10A	125W (T _c =25°C)	150	3mA	600	15	5	5 A	10	-1A	t _{on} < 1.5μS, t _{off} < 3μS		4 *	270	10	102		
" 1144																							
" 1145																							
" 1146																							
" 1147																							
" 1148																							
" 1149																							
" 1150	富士通	SW	Si. EP	60	5	1 A	800	175	0.5	40	50	1	500			t _{on} < 35nS, t _{off} < 55nS t _{strg} < 50nS					123		
★ " 1151	三菱	RF. PA	Si. EMe	900	5	1 A	50W (T _c =25°C)	125	200	500	60	10	150	15	-200			5 *	65	25	102		
★ " 1152	"	"	"	300	5	2.5A	50W (T _c =25°C)	125	200	300	60	10	500	15	-200			5 *	65	25	102		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考						
				V _{CB0} (V)	V _{E0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{je}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _μ (real)* (Ω)				
									I _{CB} (μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *			
★ 2SC1153	三菱	SW	Si.EMe	1200	6	2.5A	50W (T _c =25°C)	125	1mA	1200	20	10	2.5A											102			
★ " 1154	"	"	"	1200	6	3.5A	50W (T _c =25°C)	125	1mA	1200	20	10	3.5A											102			
★ " 1155	"	SW. PA	Si. EP	70	5	800	7W (T _c =25°C)	150	10	25	100	4	300											132			
★ " 1156	"	"	"	90	5	800	7W (T _c =25°C)	150	10	25	100	4	300											132			
★ " 1157	"	"	"	110	5	800	7W (T _c =25°C)	150	10	25	100	4	300											132			
★ " 1158	日電	Osc	Si. E	35	4	20	150	150	1	15	80	10	5	10	-5							1100*	0.8	C _c r _{bb'} 6 pS	23		
★ " 1159	"	"	"	35	4	20	150	150	1	15	80	10	5	10	-5							1100*	0.8	C _c r _{bb'} 6 pS	23		
★ " 1160	"	PA	"	200	6	1A	15W (T _c =25°C)	150	5	200	80	5	200	10	-200							20*	30	40*	134		
★ " 1161	"	"	"	200	6	1A	15W (T _c =25°C)	150	5	200	80	5	200	10	-200							20*	30	40*	134		
★ " 1162	日立	"	Si.EPa	35	5	2.5A	10W (T _c =25°C)	150	20	35	60~320	2	500	2	-200							180*	30		160	2SA715 とコンプリ	
★ " 1163	松下	PA	Si. P	300	3	100	20.8W (T _c =25°C)	150	100	300	70	10	50	10	-20							55*	8	30	236		
★ " 1164	東芝	RF	Si. EP	50	3	300	600	150	0.3	20	25~90	10	50	20	-50							1400*	2.2	<15	85B		
★ " 1165	"	PA	"	40	4	500	700	175	1	15	>20	5	100	10	-50							P _o = 1.0W, P _i = 0.3W (f = 470MHz, V _{cc} = 12.6V)	600*	6.5	25*	84B	
★ " 1166	"	"	Si. E	70	5	200	600	150	0.1	20	100	2	50	10	-10							120*	6	10	131	2SA661 とコンプリ	
★ " 1167	"	"	Si. TMe	1200	5	1.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	>10	10	500	10	-100							3*	45		102	水平偏向用	
★ " 1168	"	"	Si. T	300	5	150	12.5W (T _c =25°C)	150	0.1	100	25~240	10	50	10	-30							100*	5	10	99		
★ " 1169	"	RF	Si. EP	40	4	1A	800	175	1	15	>20	5	100	10	-50							P _o > 2.5W (f = 175MHz, V _{cc} = 13.5V, P _i = 0.25W)	600*	6.5	25	97B	
★ " 1170	"	PA	Si. TMe	1200	5	3.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	12	10	3A	10	-0.5A							4*	80	10	102		
★ " 1170A	"	"	"	1400	5	3.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	12	10	3A	10	-0.5A							4*	80	10	102		
★ " 1171	"	"	"	1100	5	1A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	30~160	15	150	15	-200							>0.5	80	10	102		
★ " 1172	"	"	"	1500	5	5A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	20	10	2A	10	-500							5*	80	10	102		
★ " 1173	"	RF. PA	Si. E	30	5	3A	10W (T _c =25°C)	150	1	20	70~240	2	500	2	-500							100*	35		268	2SA473 とコンプリ	
★ " 1174	日立	PA	Si. TMe	1200	6	3.5A	50W (T _c =25°C)	150	I _{cmx} 1mA	1200	8	10	3.5A	15	-200							4*	120	10	102		
★ " 1175	三洋	RF	Si. TP	50	5	200	400	125	10	40	100	6	50	6	-10							170*	5		138		
★ " 1176	三菱	PA	Si. EP	40	4.5	1A	15W (T _c =25°C)	175	100	15	30	10	100									P _o = 7.5W, η = 70% (f = 175MHz, P _i = 1.5W, V _{cc} = 13.5V)			113		
★ " 1177	"	"	"	40	4.5	2.5A	25W (T _c =25°C)	175	1mA	15	30	10	100									P _o = 17W, η = 80% (f = 175MHz, P _i = 3.5W, V _{cc} = 13.5V)			113		
★ " 1178	"	"	"	40	4.5	5A	35W (T _c =25°C)	175	2mA	15	50	10	100									P _o = 23W, η = 80% (f = 175MHz, V _{cc} = 13.5V, P _i = 7W)			113		
★ " 1179																											
★ " 1180	三洋	RF	Si. TP	30	3	20	150	150	1	25	130	6	1	10	-2							800*	C _c r _{bb'} 0.3	C _c r _{bb'} 3 pS	50C		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)						電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルスhFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μΩ)	f _{βB} (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb'} h _{ie'(real)*} (Ω)		
									V _{CE(V)}	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CE(V)}	I _{E(mA)}											
★ 2SC181	三洋	RF	Si.EP	40	3	50	300	125	1	35	15-120	6	1	6	-1					400*	C _{re} 1		205C		
★ "	"	"	"	25	3	50	300	125	1	20	15-120	6	1	6	-1					400*	C _{re} 1		205C		
★ "	"	"	"																						
★ "1184	日電	SW	Si.TMe	900	5	1 A	50W (T _c =25°C)	150	500	800	60	10	200							t _r <10μS, t _f <3.5μS, t _{sig} <1.5μS			102		
★ "1185	"	"	"	300	5	700	50W (T _c =25°C)	150	100	200	90	10	400							t _r <2.5μS, t _f <2μS, t _{sig} <1.5μS			102		
★ "1186	"	"	"																						
"1187	日電	RF	Si.P	40	4	25	250	125	0.1	20	90	10	3	10	-3					700*	0.4	C _c τ _{bb'} 12pS	138C	フワー-F AGC	
"1188	"	"	Si.E	40	4	30	250	125	0.1	20	90	10	10	10	-10					850*	0.5	C _c τ _{bb'} 9pS	138C		
"1189	"	"	"	50	4	30	250	125	0.1	20	90	10	10	10	-10					850*	0.5	C _c τ _{bb'} 9pS	138C		
"1190	松下	PA	Si.EP	36	4	2.5 A	30W (T _c =25°C)	175	100	20	50	13.5	400							P _o =16W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =4W)	600*	17		142	
"1191	"	"	"	36	4	3.5 A	45W (T _c =25°C)	175	0.5mA	20	50	13.5	800							P _o =27W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =8W)		50		143	
"1192	"	"	"	36	4	5 A	60W (T _c =25°C)	175	1mA	20	60	13.5	1 A							P _o =37W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =14W)	350*	100		143	
"1193	東芝	LN	"	20	2	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	-10					NF=3.5dB PG=11dB (10V, 2mA, 2GHz)	4500*	0.8	20*	140	
"1194	"	"	"																						
"1195	東芝	PA.SW	Si.T	200	5	2.5 A	100W (T _c =25°C)	150	10	200	30-150	5	1 A												102
"1196	"	PA	Si.EP	60	4.5	750	10W (T _c =25°C)	175	5	15	50	10	1 A	10	-150					P _o >3W (f=700MHz, V _{ce} =28V, P _i =1W)	800*	5		135	
"1197	"	"	"	60	4.5	2.5 A	30W (T _c =25°C)	175	10	15	55	10	1 A	10	-150					P _o >9W (f=700MHz, V _{ce} =28V, P _i =3W)	700*	<25		135	
★ "1198	"	"	"	45	4	3.5 A	30W (T _c =25°C)	175	50	15	>20	10	1 A	10	-150					P _o =20W (f=700MHz, V _{ce} =28V, P _i =9W)	800*	30		213	
"1199	"	RF.LN	"	50	3	300	600	150	0.1	20	80	10	20	10	-20					NF=2.5dB (10V, -10mA, 200MHz)	1400*	2.2	C _c τ _{bb'} 5pS	85B	
"1200	"	PA	"	40	3.5	180	2.5W (T _c =25°C)	175	1	20	120	5	100	5	-100					P _o =1.05W (f=2GHz, P _i =0.4W, V _{ce} =18V)	1700*	2.3		136	
"1201	"	"	"																						
"1202	"	"	"																						
"1203	"	"	"																						
★ "1204	日立	RF.AF	Si.EP	30		100	310	125	0.5	18	250	12	2	12	-0.1	130	16.5k	0.7	11	230*	1.8	60*	37A		
★ "1205	"	RF.Mix Conv.Osc	Si.P	30		100	310	125	0.5	18	120	12	2	12	-2					230*	1.5	C _c τ _{bb'} 13pS	37A		
★ "1206	三菱	RF.PA	Si.EP	45	4.5	1.7 A	25W (T _c =25°C)	175	1mA	30	50	25	50							P _o =10W (f=770MHz, V _{ce} =25V, P _i =4W)				209	
★ "1207	"	"	"	45	4.5	3 A	30W (T _c =25°C)	175	2mA	30	50	25	50							P _o =16W (f=770MHz, V _{ce} =25V, P _i =7W)				209	
"1208	"	"	"	36	5	10 A	60W (T _c =25°C)	175	2mA	15	50	10	500							P _o =37W, η=70% (f=175MHz, V _{ce} =13.5V, P _i =15W)				127	
"1209	"	"	"	25	4	700	500	125	1	25	100	1	500	6	-10					150*	15	C _c τ _{bb'} 100pS	138B	2SA695 とコンプリ	
"1210	"	"	"	45	4	500	500	125	1	25	100	2	150	6	-10					130*	10	C _c τ _{bb'} 100pS	138B	2SA696 とコンプリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	J _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{je} h _{jb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oc} h _{ob} * (μΩ)	f _{αB} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie'(real)} * (Ω)		
									I _{CB0} (μA)	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}											
2SC1211	三菱	RF.PA	Si.EP	65	4	500	500	125	1	25	100	2	150	6	-10					130*	10	C _c 70pF 100pS	138B	2SA697 とコンプリ	
" 1212	日立	PA	Si.EPa	50	4	1A	8W (T _c =25°C)	150	5	50	60~200	4	50	4	-30					160*	30		160	2SA743 とコンプリ	
" 1213	"	AF	"	35	4	500	400	125	0.5	20	60~320	3	10									138	2SA673 とコンプリ		
" 1214	"	"	"	50	4	500	600	125	0.5	20	60~320	3	10									138			
" 1215	松下	"	Si.EP	30	3	50	200	125	100	30	100	10	2	10	-10					1200*	C _{re} 1pF	30	138		
" 1216	日電	SW	Si.E	40	5	200	300	150	0.1	30	140	1	10	10	-10	t _{on} < 20nS, t _{off} < 40nS t _{sig} < 20nS				500*	3		49C		
" 1217	"	RF.SW	"	150	5	300	750	175	0.1	100	70	10	50	10	-50					250*	3.7	13*	84B	2SA712 とコンプリ	
" 1218	"	"	"	80	5	500	750	175	0.1	50	80	10	50	10	-50					370*	3.5	20*	84B		
★ " 1219	富士通	RF	Si.EP	30	5	500	200	125	1	12	160	2	100	6	-1					60*	12	70*	138		
★ " 1220	"	"	"	50	5	500	200	125	0.5	12	160	2	100	6	-1					60*	12	70*	138		
" 1221																									
" 1222	日電	RF.LN	Si.E	60	5	100	250	125	0.05	60	500	3	0.5	6	-1					100*	3.5	50	138	2SA640 とコンプリ	
" 1223	三菱	PA	Si.EP	30	4	500	800	175	50	15	70	15	30										84B		
★ " 1224	"	SW.PA	"	130	5	800	7W (T _c =25°C)	150	10	25	100	4	300										132		
" 1225																									
" 1226	松下	PA	Si.EP	40	5	2A	10W (T _c =25°C)	150	1	20	120	5	1A	5	-500									161	2SA699 とコンプリ
" 1227	富士通	SW	Si.TMe	300	5	10A	100W (T _c =25°C)	175	20	150	50	5	5A	5	-1A	t _{on} < 1 μS, t _{off} < 1.5 μS t _{sig} < 4 μS				27*			102		
" 1228	"	"	"	500	5	10A	100W (T _c =25°C)	175	20	150	15	5	5A	5	-1A	t _{on} < 2.5 μS, t _{off} < 2.5 μS t _{sig} < 4 μS				15*			102		
" 1229	"	"	"	250	5	10A	100W (T _c =25°C)	175	100	150	50	5	5A	5	-1A	t _{on} < 1 μS, t _{off} < 1.5 μS t _{sig} < 4 μS				27*			102		
" 1230	"	"	"	450	5	10A	100W (T _c =25°C)	175	100	150	15	5	5A	5	-1A	t _{on} < 2.5 μS, t _{off} < 2.5 μS t _{sig} < 4 μS				15*			102		
" 1231	"	"	Si.EP	20	4	200	300	175	0.4	15	60	1	10	10	-10	t _r < 10nS, t _f < 15nS t _{sig} < 12nS				800*	2		49C		
★ " 1232	"	PA	"	45	3.5	1A	12W (T _c =25°C)	175	500	20	50	5	500			P _o = 6W (f = 700MHz, V _{cc} = 18V, P _i = 2W)							133		
★ " 1233	"	"	"	45	3.5	2A	20W (T _c =25°C)	175	1mA	20	50	5	1A			P _o = 11W (f = 700MHz, V _{cc} = 18V, P _i = 4W)							133		
★ " 1234																									
★ " 1235	三洋	RF.PA	Si.T	300	4	100	6.5W (T _c =25°C)	150	5	100	30~160	10	50	30	-20					60*		7.5			
" 1236	東芝	LN	Si.EP	20	2	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	-10	NF = 5.0dB PG = 7.0dB (10V, 5mA, 4GHz) (10V, 10mA, 4GHz)				6500*	0.8	20*	140		
★ " 1237	"	PA	Si.EMe	85	4	2A	10W (T _c =25°C)	150	10	20	40	5	500	5	-100	P _o = 3.5W (f = 27MHz, V _{cc} = 12V, P _i = 0.4W)				100*	30		268		
★ " 1238	三菱	"	Si.EP	35	4	150	5W (T _c =25°C)	175	50	25	50	15	40			PG = 11dB (f = 770MHz, I _C = 40mA, V _{cc} = 15V)							312		
★ " 1239	"	"	"	80	4.5	4A	12.5W (T _c =25°C)	175	10	30	50	10	100			P _o = 3.4W (f = 27MHz, P _i = 0.4W, V _{cc} = 12V)							97B		
★ " 1240	"	RF	"	40	3	50	350	175	0.1	25	70	10	10	10	-10					600*	1.5	C _c 4.5 pS	138B		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	直流又はパルス hFE				バイアス			h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)			h _{oe} h _{ob} * (μS)	f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)
										V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)									
2SC1241	東芝	PA	Si. EP	40	4	1.5A	10W (T _c =25°C)	175	100	15	>10	5	500	10	-250	P _o > 6W (f=175MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =1W)	400*	18	7*	135					
" 1242	"	"	"	40	4	3A	20W (T _c =25°C)	175	250	15	>10	5	800	10	-500	P _o = 14W (f=175MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =2.5W)	350*	40	5*	135					
* " 1243	三菱	SW. PA	"	25	5	1.5A	7W (T _c =25°C)	150	1	16	100	4	500			t _{on} < 0.2μS, t _{off} < 1.2μS t _{sig} < 1μS				132	2SA703 トコンプリ				
" 1244																									
" 1245																									
* " 1246	富士通	RF	Si. EP	30	5	500	500	175	0.5	12	160	2	100	6	-1				60*	12	70*	138			
* " 1247	"	"	"	50	5	500	500	175	0.5	12	160	2	100	6	-1				60*	12	70*	138			
" 1248	日電	LN	Si. E	20	3	30	300	150	0.1	10	100	10	7	10	-7	NF=2dB (f=60MHz, 10V, 7mA)	2500*	1.2		145					
" 1249	"	RF	"	45	3	300	2.8W 30×50×1 放射率使用	150	1	25	80	15	65	15	-65	K _{F1} > 53dB, K _{F2} > 85dB (15V, 65mA, 60kHz, P _o =0dB)	1700*	3		146A					
" 1250	"	"	"	45	3	300	2.8W 50×50×1 放射率使用	150	1	25	80	15	65	15	-65	K _{F1} > 70dB, K _{F2} > 100dB (15V, 65mA, 60kHz, P _o =0dB)	1900*	3		146B					
" 1251	"	"	"	45	3	300	7W (T _c =25°C)	200	0.1	30	20~200	10	50	15	-50	G _p = 15dB (f=500MHz)	2200*	NF=3.5dB (f=200MHz)			129				
" 1252	"	"	"	45	3	300	800	200	0.1	10	20~200	10	50	15	-70	G _p = 17dB (f=200MHz)	1700*	NF < 4dB (f=200MHz)			84B				
" 1253	"	"	"	45	3	300	800	200	0.1	20	20~200	15	50	15	-50	G _p = 18dB (f=200MHz)	2000*	NF=3dB (f=200MHz)			84B				
" 1254	"	"	"	45	4	30	250	200	0.1	30	100	6	6	6	-6	G _p = 22dB (f=200MHz)	1000*	NF=3dB (f=200MHz)			50C				
" 1255	"	"	"	30	3	100	3.5W (T _c =25°C)	200	0.1	20	100	10	50	15	-50	G _p = 10dB (f=2GHz)	2700*	1				129			
* " 1256	"	PA	"	36	4	800	5.5W (T _c =25°C)	200	10	20	50	10	300			P _o = 3W (f=175MHz, V _{cc} =12V, P _i =0.3W)						84B			
* " 1257	"	"	"	36	4	1.5A	14W (T _c =25°C)	200	20	20	50	10	800			P _o = 8W (f=175MHz, V _{cc} =12V, P _i =1W)						184			
* " 1258	"	"	"	36	4	3A	28W (T _c =25°C)	200	50	20	50	10	1.5A			P _o = 14W (f=175MHz, V _{cc} =12V, P _i =3W)						184			
* " 1259	"	"	"	36	4	6A	58.3W (T _c =25°C)	200	1mA	20	50	10	3A			P _o = 30W (f=175MHz, V _{cc} =12V, P _i =10W)						149			
" 1260	"	RF	"	45	4	30	250	200	0.1	30	40~200	6	6	6	-6	G _p = 14dB (f=500MHz)	2000*	NF=3dB (f=500MHz)			50C				
" 1261	富士通	LN	Si. EP	20	3	20	300	150	0.1	10	100	10	7	10	-7	NF=2dB (f=60MHz, 10V, 7mA)	2500*	1.2				147			
" 1262	"	RF	"	45	3	300	2.8W 30×50×1 放射率使用	150	1	25	80	15	65	15	-65	K _{F1} > 70dB, K _{F2} > 100dB (15V, 65mA, 60kHz, P _o =0dB)	1700*	3				148			
" 1263	"	"	"	45	3	300	2.8W 50×50×1 放射率使用	150	1	25	80	15	65	15	-65	K _{F1} > 70dB, K _{F2} > 100dB (15V, 65mA, 60kHz, P _o =0dB)	1900*	3				148			
" 1264	"	"	"	30	3	100	400	150	0.5	25	100	10	40	10	-40		2000*	2.3	25*			147			
" 1265	日電	Diff	Si. E	20	3	50	300	175	0.5	10	100	5	1	5	-15	h _{FE} /h _{FE0} =0.8~1.0, ΔV _{BE} <8mV (V _{CE} =5V, I _C =1mA)	3000*	1.5	30*			189			
" 1266	"	SW	"	100	5.5	1.5A	2W	175	25	80	60	1	400	1	-100	t _{on} < 63nS, t _{off} < 210nS t _{sig} < 19nS	150*	30				83			
" 1267	"	RF	"	45	3	300	7W (T _c =25°C)	200	0.1	30	80	15	50	15	-50	G _p = 15dB (f=200MHz)						129			
" 1268	"	"	"	20	3	50	250	200	0.1	8	100	8	10	8	-10	G _p = 7.4dB (f=4GHz)	6000*	NF=4.3dB (f=4GHz)				190			
" 1269	"	"	"	20	3	50	250	200	0.1	8	100	8	10	8	-10	G _p = 7.4dB (f=4GHz)	6500*	NF=4.8dB (f=4GHz)				190			
" 1270	"	"	"	20	3	50	250	200	0.1	8	100	8	10	8	-10	G _p = 7.4dB (f=4GHz)	6500*	NF=5.5dB (f=4GHz)				190			

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直流又はパルス V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE}	バイアス V _{BE} (V)	h _{FE} h _{FB} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)			h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αβ} f _T * (Mc)
2SC1271	日電	RF	Si.E	20	3	30	250	200	0.05	8	100	8	10	8	-10					6000*	C _{re} 0.4	190	
# 1272	"	"	"	20	3	100	1W	200	50nA	15	80	10	40	10	-40	G _{pe} = 4dB (f = 4GHz)				4000*	C _{re} < 2	190	
# 1273	"	"	"	20	3	100	1W (T _c = 25°C)	175	50nA	15	80	10	40	10	-60	G _{pe} = 4dB (f = 4GHz)						190	
# 1274	"	SW	"	40	5	300	300	175	0.25	20	70	1	30	8	-10	t _{on} < 80nS, t _{off} < 86nS t _{stg} < 65nS				350*	2.5	49C	
# 1275	"	RF	"	30	3	50	250	200	0.1	15	80	10	10	10	-10	G _p = 15dB NF = 3dB (f = 500MHz) (f = 300MHz, 3mA)				2000*	1.1	50C	
# 1276	"	RF.SW	"	40	5	100	200	125	0.1	30	120	1	10	10	-10	t _{on} < 20nS, t _{off} < 40nS t _{stg} < 20nS				600*	3	60*	138
# 1277	"	RF	"	60	5	500	250	125	0.5	30	140	2	100	10	-20					60*	20	30*	138
# 1278	"	RF.SW	"	150	5	50	250	125	0.1	100	120	3	15	10	-10					150*	4.5	15	138
# 1279	"	"	"	180	5	50	250	125	0.1	100	120	3	15	10	-10					150*	4.5	15	138
# 1280	"	RF	ゲリトロン Si.E	15	10	300	250	125	0.1	10	20,000	5	100	10	-10					180*	5	220*	138
# 1281	沖	"	Si.P	20	5	20	300	175	0.1	15	200	1	10μA	5	-1					120*	2	60*	49C
# 1282	"	"	"	70	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	-1					120*	2	60*	49C
# 1283	"	"	"	110	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	-1					120*	2	60*	49C
★ # 1284	三洋	Osc	Si.EP	30	3	50	200	125	0.1	20	25~200	6	1	6	-1					700*	C _{re} 0.92	138	
★ # 1285	"	RF.AF	Si	40	5	100	200	125	1	35	200	6	1	6	-1	180	2000	0.8	12	140*	3	C _c τ _{bb'} 200pS	138
# 1286																							
# 1287																							
# 1288	沖	RF.SW	Si.EP	7	3	60	200	175	0.5	6	50	1	20	4	-20	t _d < 600pS, t _f < 650pS t _r < 650pS				4500*	1	50*	144
# 1289																							
# 1290	沖	PA	Si.EP	40	3	200	750	175	0.5	20	70	10	100	10	-50						2	35*	84B
# 1291																							
★ # 1292	三菱	PA.SW	Si.EMe	300	5	2.5A	80W (T _c = 25°C)	150	200	300	25	10	500			t _r < 1.5μS, t _f < 3μS, t _{stg} < 2μS						102	
# 1293	三洋	RF	Si.EP	25	3	50	300	125	1	20	15~120	6	1	6	-1					400*	C _{re} 1.3	C _c τ _{bb'} 25pS	138
# 1294																							
# 1295	三洋	PA	Si.TMe	1000	7	2A	40W (T _c = 25°C)	150	100	100	3~13	5	1A			t _f < 1.3μS						102	
★ # 1296	"	SW	Si.T	1300	6	5A	50W (T _c = 25°C)	150	100	100	> 4	5	3.5A										102
# 1297	日電	PA	Si.E	50	4	3.5A	50W (T _c = 25°C)	175	1mA	30	50	10	2A	10	-700	P _o = 26W (f = 175MHz, V _{cc} = 18V, P _i = 10W)				190*	75	149	
# 1298	"	"	"	50	4	5A	80W (T _c = 25°C)	175	2mA	30	50	10	3A	10	-1A	P _o = 37W (f = 175MHz, V _{cc} = 18V, P _i = 10W)				130*	110	149	
# 1299	富士通	SW	Si.TMe	300	5	30A	200W (T _c = 25°C)	175	50	150	40	5	10A	5	-2A	t _{on} < 2.5μS, t _f < 2.5μS t _{stg} < 4μS				25*		191	
# 1300	"	"	"	500	5	30A	200W (T _c = 25°C)	175	50	150	25	5	15A	5	-2A	t _{on} < 4μS, t _f < 2.5μS t _{stg} < 4μS				20*		191	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)				電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)													外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)		直 流 又 は パ ル ス h _{FE}			バ イ ア ス		h _{FE} h _{FM} *	h _{ic} h _{ic} *	h _{re} h _{re} *	h _{oe} h _{oe} *	f _{βB} f _T *			C _{ob} (pF)	τ _{bb'} h _{ie} (real) (Ω)		
									V _{CB} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE}										h _{ic} *	h _{re} *
2SC1301	富士通	SW	Si.TMe	250	5	30A	200W (T _c =25°C)	175	200	150	40	5	10A	5	-2A	t _{on} <2.5μs, t _f <2.5μs t _{sig} <4μs				25*					191	
" 1302	"	"	"	400	5	30A	200W (T _c =25°C)	175	200	150	25	5	15A	5	-2A	t _{on} <4μs, t _f <2.5μs t _{sig} <4μs				20*					191	
" 1303	松下	PA	Si.EP	40	4	300	600	175	1	20	70	13.5	100	10	-30	P _o =0.6W (f=175MHz, V _{cc} =15V, P _i =0.05W)				700*	6.5	15			84B	
* " 1304	日立	"	Si.T	300	5	500	20W (T _c =25°C)	150	I _{CBX} 100	300	60	10	100	10	-50					7*	16	20*			153	
" 1305	"	"	"																							
" 1306	日電	PA	Si.E	65	4	3A	12W (T _c =25°C)	150	10	40	80	10	500	10	-150	P _o =5.5W (f=50MHz, V _{cc} =12V, P _i =0.5W)				300*	20				268	
" 1307	"	"	"	70	4	8A	25W (T _c =25°C)	150	20	40	20~150	10	2A	10	-500	P _o =15W (f=50MHz, V _{cc} =12V, P _i =3W)				150*	80				268	
" 1308	三洋	SW	Si.TMe	1500	6	7A	50W (T _c =25°C)	150	100	100	>3	5	4A			t _r <1.4μs									102	水平偏向用
* " 1309	三菱	SW	Si.EMe	1200	6	5A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	1200	20	10	5A			t _r <1.5μs, t _f <3μs t _{sig} <2μs									102	
" 1310	"	RF.A.F. LN SW	Si.EP	30	4	100	200	125	0.1	25	250	6	1	6	-1		8500	0.6	40	150*	2.5	C _c τ _{bb'} 200pS			175	
" 1311	"	RF.A.F. SW	"	30	4	100	200	125	0.1	25	250	6	1	6	-1		8500	0.6	40	150*	2.5	C _c τ _{bb'} 200pS			175	
" 1312	"	RF.A.F. LN	"	35	4	100	200	125	0.1	25	500	6	1	6	-1		19k	1.3	22	150*	2.5	C _c τ _{bb'} 230pS			138B	
" 1313	"	"	"	50	4	100	200	125	0.1	50	350	6	1	6	-1		19k	1.3	22	150*	2.5	C _c τ _{bb'} 230pS			138B	
* " 1314	"	PA	"	40	4.5	5A	45W (T _c =25°C)	175	2mA	15	30	10	200			P _o =34W (f=175MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =9W)									127	
* " 1315	"	"	"	35	4.5	500	4W (T _c =25°C)	175	50	15	50	10	100			P _o =0.5W (f=150MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =0.2W)									84B	
" 1316	ソニー	PA.SW	Si.TMe	750	10	1A	23W (T _c =25°C)	120	200	50	8	3	2A	10	-200					8.5*	120	C _c τ _{bb'} 410pS			100	
" 1317	松下	PA	Si.EP	30	5	500	400	125	0.1	20	160	10	150	10	-50					200*	6	3.5*			138	2SA719 とコンパリ
" 1318	"	"	"	60	5	500	400	125	0.1	20	160	10	150	10	-50					200*	6	3.5*			138	2SA720 とコンパリ
* " 1319	日電	RF	Si.P	40	4	25	250	125	0.1	20	90	10	3	10	-3					600*	1.2	C _c τ _{bb'} 12pS			138	フォワード AGC
* " 1320	"	"	Si.E	50	4	30	250	125	0.1	20	100	10	10	-10					850*	1.4	C _c τ _{bb'} 9pS			138		
" 1321	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	30	4	10	100	125	0.1	25	80	6	2	6	-2					900*	1.3	C _c τ _{bb'} <20pS			176	
* " 1322	富士通	SW	Si.TMe	250	5	15A	100W (T _c =25°C)	175	100	150	50	5	5A	5	-1A	t _{on} <1μs, t _f <1.5μs t _{sig} <4μs				27*					102	
" 1323	三菱	PA	Si.EP	30	4	500	5W (T _c =25°C)	175	50	15	70	15	30			PG=14.2dB (f=220MHz, I _C =30mA, V _{cc} =13.5V)									271	
" 1324	"	"	"	35	4	150	800	175	50	25	70	10	30			G _μ =10dB (f=770MHz, I _C =30mA, V _{cc} =15V)									85B	
* " 1325	日電	SW	Si.TMe	1500	6	6A	80W (T _c =25°C)	150	20	1000	19	15	1A			t _r <2.5μs, t _f <1μs, t _{sig} <1.5μs									102	
" 1326	松下	PA	Si.EP	55		400	5W (T _c =25°C)	175	I _{CB0} 20	V _{CE} 28	30	5	50	15	-25	P _o >1W (f=400MHz, V _{cc} =28V, P _i =0.1W)				700*	<3				84B	
" 1327	"	RF, LN	"	35	5	50	150	125	0.1	10	540	5	2	5	-2		5500	0.4	25	250*	2.2	70		138	2SA721 とコンパリ	
" 1328	"	"	"	55	5	50	150	125	0.1	10	540	5	2	5	-2		5500	0.4	25	250*	2.2	70		138	2SA722 とコンパリ	
* " 1329	日電	RF	Si.E	50	5	8A	60W (T _c =25°C)	200	2mA	30	100	10	5A			P _o =32W (f=70MHz, V _{cc} =12V, P _i =8W)									149	
* " 1330	"	RF.AF	"	50	5	100	400	125	0.1	40	150	6	1	6	-1		4800	4.5	17	250*	4.5	25*			44	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CBO}	V _{EB0}	I _C	P _C	T _J	I _{CBO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}				バ イ ア ス		h _{je}	h _{ie}	h _{re}			h _{oe}	f _β	C _{ob}	τ _{bb'}
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{jb} *	h _{ib} *	h _{rb} *	h _{ob} *	f _β *			(pF)	h _{ie} (real)		
★ 2SC1331	日電	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. P	20	3	20	150	150	50nA	10	100	5	4	10	-4					750*	C _{re} 0.37	C _e τ _{bb'} 10pS	50C		
# 1332																									
# 1333	日電	PA	Si. E	45	3	1A	10W (T _c =25°C)	175	100	30	20~200	10	300	10	-200	G _{pe} = 5 dB (f=1GHz, V _{ce} =18V, P _i =1W)				1200*	8		184		
# 1334	"	"	"	45	3	1A	11.6W (T _c =25°C)	200	100	30	15~250	10	300			G _{pe} = 4 dB (f=1GHz, V _{ce} =24V, P _i =2W)							184		
★ # 1335	日立	LN	Si.EPa	30	5	100	200	125	0.5	18	250~1200	12	2	NF=3dB (f=120Hz, I _C =0.1mA)					230*	<3.5			138		
# 1336	日電	RF	Si. E	20	3	30	250	200	0.1	10	100	10	10	10	-10	G _{pe} = 11dB (f=2GHz)				4500*	NF=3dB (f=2GHz)		190		
# 1337	三菱	PA	Si. EP	35	4.5	2A	20W (T _c =25°C)	175	200	15	50	10	100			P _o = 8.5W (f=485MHz, V _{ce} =13.5V, P _i =2W)							126		
# 1338	"	"	"	35	4.5	3A	30W (T _c =25°C)	175	500	15	50	10	100			P _o = 16W (f=485MHz, V _{ce} =13.5V, P _i =6W)							126		
# 1339	"	"	"	35		5A	40W (T _c =25°C)	175	1mA	15	50	10	100			P _o = 28W (f=485MHz, V _{ce} =13.5V, P _i =12W)							126		
# 1340	"	"	"	35	4	1A	5W (T _c =25°C)	175	100	25	70	10	100			G _{pe} = 19dB (f=220MHz, V _{ce} =15V, I _C =100mA)							312		
# 1341																									
# 1342	日立	RF. Conv. Mix. Osc.	Si. P	30	4	30	100	125	0.5	10	35~200	6	1	6	-1	G _{pr} = 17dB (f=100MHz, V _{CE} =6V, I _C =1mA)				320*	1.1	C _e τ _{bb'} 20pS	138		
★ # 1343	"	PA.SW	Si. T	130	5	10A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	30	35~200	5	1A	5	-1A				15*	240			102	2SA753 とコンプリ	
# 1344	"	LN	Si.EPa	30	5	100	200	125	0.5	18	250~1200	12	2	NF<1dB (f=1kHz, I _C =0.1mA)					230*	<3.5	C _e τ _{bb'} 12pS		138		
# 1345	"	"	"	55	5	100	200	125	0.5	18	250~1200	12	2	NF<1dB (f=1kHz, I _C =0.1mA)					230*	<3.5	C _e τ _{bb'} 12pS		138		
★ # 1346	松下	PA	Si. EP	30	5	500	600	125	0.1	20	160	10	150	10	-50				200*	6	3.5*	171	2SA730 とコンプリ		
★ # 1347	"	"	"	60	5	500	600	125	0.1	20	160	10	150	10	-50				200*	6	3.5*	171	2SA731 とコンプリ		
# 1348	ソニー	SW	Si. TMe	1000		4A	125W (T _c =25°C)	120	2mA	800	8	3	2A	10	-2A				5*	175	C _e τ _{bb'} 200pS	102	水平偏向用		
# 1349	富士通	"	Si. EP	20	4	200	200	175	0.4	15	60	1	10			t _e = 4 nS, t _f = 9 nS t _{stg} = 6 nS							46C		
# 1350																									
# 1351																									
# 1352																									
# 1353																									
# 1354	松下	PA	Si. EP	55	4	5A	60W (T _c =25°C)	175	1mA	20	50	13.5	1A			P _o = 37W (f=175MHz, V _{CE} =24V, P _i =8W)							143		
# 1355	富士通	"	"	40	3.5	700	7W (T _c =25°C)	175	100	20	80	5	200	12	-200	P _o = 2W (f=700MHz, V _{ce} =18V, P _i =0.5W)				1800*	5		159		
# 1356	"	"	"	40	3.5	1A	12W (T _c =25°C)	175	200	20	80	5	500	12	-300	P _o = 6W (f=700MHz, V _{ce} =18V, P _i =2W)				1800*	8		159		
# 1357																									
# 1358	日電	SW	Si. TMe	1400	6	4.5A	50W (T _c =25°C)	150	20	1000	19	15	500			t _f < 1μS, t _{stg} < 10μS							102		
# 1359	松下	RF	Si. EP	30	5	30	250	125	0.1	10	100	10	1	10	-1				300*	C _{re} 0.9pF	22		138	2SA838 とコンプリ	
# 1360	"	"	"	50	4	50	650	135	0.1	20	50	10	10	10	-10				500*	1.5	20		165		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)						電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)													外 形	備 考
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _c (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe} h _{jb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ib'(real)} * (Ω)			
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)								h _{fe} = 3 dB (f = 100MHz)		
2SC1361	ソニー	RF.LN	Si.PaMe	25	6	200	320	100	0.2	25	200	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C _e r _{bb'} 350pS	138	
# 1362	"	"	"	50	6	200	320	100	0.2	25	200	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C _e r _{bb'} 350pS	138	
# 1363	"	RF	"	25	6	200	320	100	0.2	25	200	3	1	6	-2					140*	4.5	C _e r _{bb'} 350pS	138	
# 1364	"	"	Si.PaMe	50	6	200	320	120	0.2	25	200	3	1	6	-2					140*	4.5	C _e r _{bb'} 300pS	138	
# 1365	日電	"	Si.E	45	3	300	800	200	0.5	20	80	15	50	15	-70					1700*	4.5	NF = 3 dB (f = 200MHz)	84B	
# 1366	"	"	"	45	3	300	800	200	0.5	20	80	10	50	15	-50					2000*	4.5	NF = 3 dB (f = 200MHz)	84B	
★ # 1367	日立	PA	Si.TMe	1000	5	1A	50W (T _e =25°C)	125	10	500	45	10	200	15	-200					6*	60	25	102	
# 1368	"	"	Si.EPa	25	5	2.5A	8W (T _e =25°C)	150	20	25	60-320	2	500	2	-200					180*	30		160	
# 1369																								
# 1370																								
# 1371																								
★ # 1372	富士通	RF.SW	Si.EP	30	5	200	200	125	0.5	10	100	1	10	6	-2					250*	4	80*	138	
# 1373	日立	SW	"	25	4	100	300	175	1	20	90	4	35			t _{on} < 100nS, t _{off} < 325nS t _{stg} < 200nS							49C	
# 1374	"	"	"	25	4	100	300	175	0.25	20	>30	1	70			t _{on} < 7nS, t _f < 6nS t _{stg} < 12nS							49C	
# 1375	"	"	"	25	4	100	300	175	0.05	5	>54	0.4	50			t _{on} < 45nS, t _{off} < 60nS							49C	
# 1376	"	"	"	40	4	500	300	175	I _{CE5} 0.5	20	65	1	150	10	-30					590*	2.7		49C	
★ # 1377	東芝	PA	Si.E	90	4	6A	20W (T _e =25°C)	150	10	60	>20	5	1A	5	-200	P _o > 8W (f = 27MHz, V _{cc} = 12V, P _i = 1W)				100*	60		268	
★ # 1378	"	"	"	40	4	4A	35W (T _e =25°C)	175	100	15	>10	5	10A	10	-200	P _o = 25W (f = 175MHz, V _{cc} = 13.5V, P _i = 6W)				150*	65	2*	135	
★ # 1379	"	"	"	40	4	7A	70W (T _e =25°C)	175	100	15	>10	5	1A	10	-200	P _o = 40W (f = 175MHz, V _{cc} = 13.5V, P _i = 12W)				150*	130	1*	193	
# 1380	"	RF	"	55	5	100	200	150	0.1	18	200-700	6	2	6	-1					80*	6		49C	
# 1381	"	RF.PA	"	100	5	1A	800	150	1	30	70-240	2	150	2	-150					50*	20	10	342	
# 1382	"	"	"	80	5	750	800	150	0.1	30	70-240	2	150	2	-150					100*	15		342	
# 1383	松下	PA	Si.EP	30	5	1A	750	135	0.1	20	160	10	500	10	-50					200*	11	3.5*	165	
# 1384	"	"	"	60	5	1A	750	135	0.1	20	160	10	500	10	-50					200*	11	3.5*	165	
# 1385	日立	SW	"	60	5	500	800	175	0.5	30	>35	1.1	300			t _{on} < 40nS, t _{off} < 60nS							123	
# 1386	"	"	"	70	5	1A	800	175	100	60	>30	1	60		30	t _{on} < 30nS, t _{off} < 55nS							123	
# 1387	富士通	RF	"	25	3	150	600	150	0.5	20	100	10	40	10	-40					1600*	2.5	40*	84B	
# 1388	"	SW	"	100	6	1A	800	200	0.5	70	>15	3	500			t _{on} < 50nS, t _{off} < 110nS t _{stg} < 80nS							84C	
# 1389																								
# 1390	日立	RF.LN	Si.E	20	3	50	200	125	1	18	500	12	2	12	-2	NF = 0.5dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				230*	2	C _e r _{bb'} 12pS	138	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値		直流又はパルス hFE				バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)			h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(REAL)} * (Ω)
									(μA)	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CE(V)}	I _E (mA)										
★ 2SC1421	富士通	RF	Si. EP	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	10	6	-10	NF = 6 dB (f = 2GHz, I _C = 4mA)			5500*	0.7	25*	199			
" 1422	"	"	"	15	3	40	250	150	0.5	10	80	6	20	6	-20	"			5500*	0.8	25*	199			
★ " 1423	"	"	"	15	3	30	250	150	0.5	10	80	6	15	6	-15	NF = 3.5dB (f = 2GHz, I _C = 4mA)			7000*	0.7	25*	199			
" 1424	日電	"	Si. E	30	3	50	250	200	0.1	15	80	10	10	10	-10	G _p = 15dB (f = 500MHz)			2000*	1.1		50C			
" 1425	"	PA	"	45	3	1 A	11.6W (T _C = 25°C)	200	100	30	15-250	10	300			G _p = 5dB (f = 1GHz, V _{cc} = 18V, P _i = 1W)						184			
" 1426	"	RF	"	35	3	200	3.5W (T _C = 25°C)	200	0.1	20	100	10	50	10	-50				2700*	1		85B			
" 1427	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	30	4	10	100	125	0.1	25	120	6	2	6	-2				1000*	0.7	C _c r _{bb'} 3pS	176			
" 1428	"	"	"	50	5	50	150	125	0.1	15	110	3	0.5	6	-1				250*	1.5	C _c r _{bb'} 25pS	176			
" 1429	ソニー	PA	Si. E PAMe	16	6	2 A	950	120	0.1	16	200	2	100	2	-10				80*	26	C _c r _{bb'} 300pS	174			
" 1430	"	RF. PA	Si. EMe	110		1.5A	500	150	100	50	100	2	400	2	-200				50*	50	C _c r _{bb'} 25pS	181			
" 1431	"	"	"	110	5	2A	1.5W	150	10	50	100	2	400	2	-100				80*	25	C _c r _{bb'} 25pS	99			
" 1432	新日無	SW	Si. EP	30	10	300	300	125	1	20	40,000	6	100			t _{on} < 600nS, t _{off} < 1.2μS t _{sig} < 600nS						138	2SA796 とコンプリ		
★ " 1433	東芝	PA. SW	Si. TMe	600	5	5 A	50W (T _C = 25°C)	150	100	500	20-300	5	1 A	50		t _{on} < 2μS, t _f < 1.5μS t _{sig} < 10μS				100		102			
★ " 1434	"	"	"	600	5	15 A	150W (T _C = 25°C)	150	500	500	30-300	5	3 A	50		t _{on} < 2μS, t _f < 2.5μS t _{sig} < 15μS				200		102			
★ " 1435	"	"	"	600	5	40 A	300W (T _C = 25°C)	150	1mA	500	30-300	5	10 A	50		t _{on} < 11μS, t _f < 1.5μS t _{sig} < 10μS				600		196			
" 1436	サンケン	SW	Si. TMe	230	6	15A	100W (T _C = 25°C)	150	1mA	230	20	4	5 A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS, t _d < 0.5μS				10*		102			
" 1437	"	"	"	230	6	50A	200W (T _C = 25°C)	150	1mA	230	20	4	10A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS				10*		230			
" 1438	富士通	RF	Si. EP	150	5	50	500	150	1	140	150	5	10	5	-10				130*	3		138			
" 1439	"	"	"	150	5	50	500	150	1	140	150	5	10	5	-10				130*	3		138			
" 1440	サンケン	SW	Si. TMe	150	6	15A	100W (T _C = 25°C)	150	1mA	150	20	4	5 A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS, t _d < 0.5μS				10*		102			
" 1441	"	"	"	200	6	15A	100W (T _C = 25°C)	150	1mA	200	20	4	5 A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS, t _d < 0.5μS				10*		102			
" 1442	"	"	"	150	6	50A	200W (T _C = 25°C)	150	1mA	150	20	4	10A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS				10*		230			
" 1443	"	"	"	200	6	50A	200W (T _C = 25°C)	150	1mA	200	20	4	10A	12	-500	t _r < 1.5μS, t _f < 1μS t _{sig} < 4μS				10*		230			
" 1444	"	PA	"	80	6	6 A	40W (T _C = 25°C)	150	1mA	80	80	4	1 A	10	-500				10*	85	12*	99	2SA764 とコンプリ		
" 1445	"	"	"	100	6	6 A	40W (T _C = 25°C)	150	1mA	100	80	4	1 A	10	-500				10*	85	12*	99	2SA765 とコンプリ		
★ " 1446	松下	"	Si. TP	300	5	100	10W (T _C = 70°C)	150	100	300	70	10	50	30	-20				55*	8	10	268			
" 1447	東芝	RF. PA	Si. T	300	5	150	20W (T _C = 25°C)	150	1	240	40-170	10	50	50	-20				80*	7	30	268			
★ " 1448	"	"	Si. TMe	150	5	1.5A	25W (T _C = 25°C)	150	20	100	75	10	500	10	-500				5*	50	25	268			
" 1449	日電	PA	Si. E	40	5	2 A	10W (T _C = 25°C)	150	0.5	35	90	2	300	5	-100				55*	20	40*	225			
★ " 1450	松下	"	Si. Me	150	5	400	20W (T _C = 80°C)	150	30	60	70	5	100	10	100				15*	50	25	99	2SA766 とコンプリ		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB(V)}	直流又はパルスhFE V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	バイアス V _{CB(V)}	I _{E(mA)}	h _{fe} h _β *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oc} h _{ob} * (μG)			f _{ab} f _f * (Mc)	C _{ob} C ₁ (pF)	r _{ob} r _{ib} (real)* (Ω)
2SC145L	富士通	RF	Si.EP	150	5	50	700	175	1	140	150	5	10	5	-10	t _{on} < 1μS, t _{off} < 10μS t _{stg} < 9.5μS	130*	2	70*	248			
★	"	"	"	150	5	50	700	175	1	140	150	5	10	5	-10	t _{on} < 1μS, t _{off} < 10μS t _{stg} < 9.5μS	130*	2	70*	248			
★	"	東芝	"	55	5	100	200	150	0.1	30	120	1	10	10	-1		150*	5	20	195			
"	"	サンケン	PA	300	6	4A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	300	>20	5	1A	12	-100		10*			102			
"	"	"	"																				
★	"	日電	PA	300	7	200	15W (T _c =25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10		80*	3.8	30	99			
"	"	"	RF	Si.E	35	3	150	800	200	0.1	20	100	10	50	10	-50	NF < 3.2dB (f=200MHz, V _{CE} =10V, I _C =20mA)	2700*	C _{re} 1	45*	85B		
"	"	"	"	"	20	3	50	300	200	0.1	10	100	5	30	5	-15	(S ₂₁) _{1dB} = 9dB (f=1GHz)	3000*	C _{re} 0.9	30*	130		
"	"	富士通	"	Si.EP	15	3	70	300	175	0.5	10	80	6	40	6	-40		5000*	1	25*	199		
"	"	"	"	"	15	3	30	250	175	0.5	10	80	6	10	6	-10	NF=4.5dB (f=2GHz, V _{CE} =6V, I _C =4mA)	4500*	0.7	25*	199		
"	"	"	"	"	15	3	40	250	175	0.5	10	80	6	20	6	-20	"	4500*	0.8	25*	199		
"	"	"	"	"	15	3	30	250	175	0.5	10	80	6	15	6	-15	NF=3.5dB (f=2GHz, V _{CE} =6V, I _C =4mA)	6500*	0.7	25*	199		
"	"	東芝	SW	Si.T	450	5	4A	75W (T _c =25°C)	175	10	150	18	5	1A	6	-300	t _{on} < 5μS, t _f < 3μS t _{stg} < 5μS	25*	125	5*	102		
"	"	"	PA	Si.EP	50	3.5	500	4W (T _c =25°C)	175	250	20	80	5	200	12	-100	P _o =1.2W (f=175MHz, V _{cc} =12V, P _i =50mW)	1300*	3.5		84C		
"	"	"	"	"	50	3.5	500	7W (T _c =25°C)	175	250	20	80	5	200	12	-100	P _o =1.8W, η=55% (f=0.7GHz, V _{cc} =24V, P _i =0.3W)	1600*	4.5		231		
"	"	新電元	SW	Si.DB	450	4	3A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	450	16	5	1.5A	10	1A	t _{on} < 2μS, t _f < 2μS t _{stg} < 4μS	10*	60		204		
"	"	"	"	"	500	4	3A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	500	12	5	1.5A	10	1A	"	10*	60		204		
"	"	"	"	"	450	4	10A	100W (T _c =25°C)	150	10mA	450	16	5	5A	10	1A	"	10*	300		102		
"	"	"	"	"	500	4	10A	100W (T _c =25°C)	150	10mA	500	12	5	5A	10	2A	"	10*	300		102		
"	"	"	"	"	450	4	30A	200W (T _c =25°C)	150	10mA	450	16	5	10A	10	2A	"	10*	700		266		
"	"	"	"	"	500	4	30A	200W (T _c =25°C)	150	10mA	500	12	5	10A	10	2A	"	10*	700		266		
"	"	日立	RF	Si.EP	40	10	300	500	125	0.1	30	2000- 100000	5	10	5	-10	t _{on} =60nS, t _{off} =800nS t _{stg} =350nS	>50*	<10	220	138	ゲーリントン	
"	"	松下	PA	"	250	5	70	600	125	2	12	120	10	5	10	-10		80*	5	C _{cr} 60pS	138		
"	"	ソニー	RF.PA	Si.PaMe	16	6	2A	750	120	0.2	16	300	2	100	2	-10		60*	30	C _{cr} 600pS	259	2SA772 とコンプリ	
"	"	"	"	"	100	6	1A	750	120	0.2	25	300	2	100	2	-10		80*	16	C _{cr} 300pS	259	2SA773 とコンプリ	
★	"	東芝	PA	Si.EP	38		5A	40W (T _c =25°C)	175	1mA	15	50	5	1A		P _o =28W (f=470MHz, V _{cc} =12.6V, P _i =12W)				135			
"	"	サンケン	SW	Si.T	230	6	9A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	230	20	4	5A		t _{on} < 1.5μS, t _f < 1μS t _{stg} < 4μS				102			
★	"	松下	RF.LN	Si.EP	35	5	50	150	175	0.1	10	540	5	2	5	-2	5500	0.4	25	150*	2.2	70	243
"	"	富士通	PA	"	36	3.5	500	3W (T _c =25°C)	175	100	12	50	2	200	12	-100	P _o =1.2W (f=175MHz, V _{cc} =12.5V, P _i =50mW)	1000*	4		84B		
★	"	"	"	"	36	3.5	500	7W (T _c =25°C)	175	100	12	50	2	500	12	-100	P _o =2.4W, η=60% (f=470MHz, V _{cc} =12.5V, P _i =0.3W)	1200*	5		246		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考		
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αB} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(real)} *
									V _{CE1} (V)	I _{C1} (mA)	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}									
★ 2SC1481	富士通	PA	Si. EP	36	3.5	1 A	12W (T _c =25°C)	175	200	12	50	2	1A	12	-200	P _o =5W, η=60% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =1W)	1000*	10		246			
★ " 1482	"	"	"	36	3.5	2 A	20W (T _c =25°C)	175	500	12	50	2	2A	12	-500	P _o =8.5W, η=70% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =2W)	800*	18		246			
" 1483	"	LN	"	20	3	40	300	150	0.1	10	100	6	10	6	-10	NF=2dB (f=100MHz, V _{CE} =6V, I _C =5mA)	3000*	0.9	25*	214			
" 1484	"	RF	"	45	3	300	5W (T _c =25°C)	150	1	25	80	15	65	15	-65		2000*	2.8	25*	215			
" 1485	"	SW	Si. T	250	6	125	350	175	1	30	90	4	10			t _r < 2μS, t _f < 2.5μS t _{sig} < 6μS z				49C			
" 1486	モトローテ	PA	Si. EP	36	4	400	5W (T _c =25°C)	200	1mA	15	80	5	100			G _{pe} =10dB, η>60% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, I _C =0.24A)		11		216	2N5944		
" 1487	"	"	"	36	4	800	15W (T _c =25°C)	200	1mA	15	80	5	200			G _{pe} =9dB, η>60% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, I _C =0.5A)		18		216	2N5945		
" 1488	"	"	"	36	4	2 A	37.5W (T _c =25°C)	200	2mA	15	80	5	500			G _{pe} =7dB, η>60% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, I _C =1.3A)		38		216	2N5946		
" 1489	"	"	"	36	4	6 A	60W (T _c =25°C)	200	2.5mA	15	80	5	1 A			G _{pe} =4.3dB, η>65% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =10W)		55		217	2N6136		
" 1490	"	"	"	36	4	1 A	12W (T _c =25°C)	200	250	15	80	5	250			G _{pe} =13dB, η>50% (f=175MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =0.25W)		15		217	2N6080		
" 1491	"	"	"	36	4	2.5A	31W (T _c =25°C)	200	500	15	50	5	500			G _{pe} =7dB, η>60% (f=175MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =3.6W)		70		217	2N6081		
" 1492	"	"	"	36	4	4 A	65W (T _c =25°C)	200	1mA	15	50	5	1 A			G _{pe} =7dB, η>65% (f=175MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =6W)		110		217	2N6082		
" 1493	"	"	"	36	4	4 A	65W (T _c =25°C)	200	1mA	15	50	5	1 A			G _{pe} =6.5dB, η>65% (f=175MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =8.1W)		110		217	2N6083		
" 1494	"	"	"	36	4	6 A	80W (T _c =25°C)	200	2.5mA	15	40	5	1 A			G _{pe} =5dB, η>70% (f=175MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =14.3W)		170		217	2N6084		
" 1495	"	"	"	36	4	400	2W (T _c =25°C)	200	500	15	80	5	50			G _{pe} =9dB, η>60% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =0.1W)		6		218	2N6256		
" 1496																							
" 1497																							
" 1498	モトローテ	PA	Si. EP	36	4	2.5A	45W (T _c =25°C)	200	1mA	15	80	5	1 A			G _{pe} =7dB, η>60% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =3.75W)		65		219			
" 1499	"	"	"	36	4	6 A	115W (T _c =25°C)	200	20mA	15	60	5	4 A			G _{pe} =6dB, η>55% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =7.6W)		85		219			
" 1500	"	"	"	36	4	8 A	115W (T _c =25°C)	200	20mA	15	60	5	4 A			G _{pe} =4.9dB, η>55% (f=470MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =13W)		85		219			
" 1501	松下	PA	Si. TP	300	5	100	10W (T _c =70°C)	150	100	300	70	10	50	30	-20			55*	8	10	236		
" 1502																							
★ " 1503	東芝	PA	Si. EP	50		3 A	30W (T _c =25°C)	175	500	20	50	5	1 A			P _o =13W (f=260MHz, V _{CC} =20V, P _i =1W)				135			
" 1504	サンケン	SW	Si. TMe	400	6	2 A	40W (T _c =25°C)	150	1mA	400	60	4	1 A	12	-100	t _r < 2μS, t _f < 6μS t _{sig} < 9μS		10*			99		
" 1505	日電	PA	Si. T	300	7	200	15W (T _c =25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10			80*	<4.5	30	268		
" 1506	"	"	"	300	7	200	15W (T _c =25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10			80*	<4.5	30	267		
" 1507	"	"	"	300	7	200	15W (T _c =25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10			80*	<4.5	30	250		
" 1508																							
" 1509	松下	PA	Si. EP	80	5	500	750	135	0.1	20	160	10	150	10	-50			120*	11		165	2SA777 とコンプソ	
" 1510	三菱	"	"	47	4.5	1 A	10W (T _c =25°C)	175	200	30	50	25	100			P _o =4.5W (f=770MHz, V _{CC} =25V, P _i =1.2W)				2k*	209		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oc} h _{ob} * (μV)			f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ib} (real)* (Ω)
									I _{CB01} (μA)	V _{CE1} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SC1511	日電	PA	Si.E	50	4	3 A	50W (T _c =25°C)	175	2mA	30	60	10	700								233		
" 1512	"	"	"	50	4	5 A	65.2W (T _c =25°C)	175	3mA	30	60	10	1 A								233		
* " 1513	日立	RF	Si.Pa	40	3	300	800	175			35~250	15	30	15	-30		1800*	C _{re} <3pF			85C		
" 1514	"	RF.PA	Si.T	300	5	100	1.25W	150			30~200	20	20	20	20		80*	<4			234		
" 1515	"	SW	Si.T	200	5	50	200	125	0.1	20	30~300	6	10	6	-10		>60*	<10	C _e r _{bb'} 40pS		138		
" 1516	"	PA.SW	Si.E	35	5	1.5A	10W (T _c =25°C)	150	20	30	60~200	2	500	2	-200	t _{on} ≧ 140nS, t _{off} = 650nS t _{st} = 600nS	110*	35			234		
" 1517	"	"	Si.T	50	4	1 A	10W (T _c =25°C)	150	5	30	160	4	50	4	-50		10*	30	50*		234		
" 1518	松下	PA	Si.EP	25	5	1 A	750	135	0.1	25	160	2	500	10	-50		150*	12	3.5k*		165		
" 1519	日電	"	Si.TP	250	7	200	10W (T _c =25°C)	150	0.1	200	90	10	10	10	-10		80*	3.5	30		289		
" 1520	"	"	"	250	7	200	10W (T _c =25°C)	150	0.1	150	80	10	10	30	-10		80*	<4.5	30		290		
" 1521	"	"	"	250	7	200	10W (T _c =25°C)	150	0.1	150	80	10	10	30	-10		80*	<4.5	30		291		
" 1522	"	"	"	250	7	200	10W (T _c =25°C)	150	0.1	200	90	10	10	10	-10		80*	3.5	30		292		
* " 1523	日立	RF.PA	Si.Pa	40	3	300	3.5W (T _c =25°C)	175	10	15	35~250	15	50			G _{pe} > 17dB, NF < 5dB (f=200MHz, V _{CE} =15V)	2000*	C _{re} 3			269		
" 1524	富士通	PA	Si.EP	50	3.5	1 A	12W (T _c =25°C)	175	200	20	50	5	500	12	-250	P ₀ = 8W, η = 55% (f=700MHz, V _{CE} =24V, P _i =2W)	800*	8			246		
" 1525	"	"	"	50	3.5	2 A	20W (T _c =25°C)	175	400	20	50	5	1 A	12	-500	P ₀ = 13W, η = 55% (f=700MHz, V _{CE} =24V, P _i =4W)	800*	13			246		
" 1526	"	"	"	50	3.5	3 A	25W (T _c =25°C)	175	600	20	50	5	2 A	12	-500	P ₀ = 22W, η = 55% (f=700MHz, V _{CE} =24V, P _i =7.5W)	1000*	18			246		
" 1527	"	"	"																				
* " 1528	三菱	PA	Si.EP	40	4.5	2.5A	25W (T _c =25°C)	175	500	25	40	10	100			P ₀ = 16W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =3.5W)					271		
" 1529	"	RF	"	30	4	20	120	150	0.1	12	60	10	5			G _{pe} = 13dB (f=770MHz, V _{CE} =10V, I _c =5mA)					50C		
" 1530	"	PA	"	50	4.5	350	5W (T _c =25°C)	150	100	30	50	10	100			P ₀ = 1.5W (f=1GHz, V _{CE} =28V, P _i =0.25W)					312		
" 1531	"	"	"																				
* " 1532	東芝	SW	Si.TMe	300	5	30A	200W (T _c =25°C)	150	500	300	20~100	5	20A									196	
" 1533	富士通	PA	Si.EP	45	3.5	500	7W (T _c =25°C)	175	100	20	50	5	200	12	-200	P ₀ = 2.2W (f=700MHz, V _{CE} =18V, P _i =0.5W)	1.8GHz*	5			246		
" 1534	"	"	"	45	3.5	1 A	12W (T _c =25°C)	175	200	20	50	5	500	12	-300	P ₀ = 7W (f=700MHz, V _{CE} =18V, P _i =2W)	1.6GHz*	8			246		
" 1535	"	"	"	45	3.5	2 A	25W (T _c =25°C)	175	400	20	50	5	1 A	12	-500	P ₀ = 12W (f=700MHz, V _{CE} =18V, P _i =4W)	1.2GHz*	13			246		
" 1536	"	"	"	45	3.5	4 A	40W (T _c =25°C)	175	800	20	50	5	3 A	12	-700	P ₀ = 24W (f=700MHz, V _{CE} =18V, P _i =10W)	800*	23			246		
" 1537	ローム	RF.ConV.Mix Osc.AF.PA.SW	"	50	5	30	150	125	1	30	330	3	0.5	6	-1		13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	C _e r _{bb'} 120pS	235
" 1538	"	RF.ConV.Mix Osc.AF.PA.LN	"	50	5	30	150	125	1	30	330	3	0.5	6	-1	NF=3dB (f=1kHz)	13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	C _e r _{bb'} 120pS	235
" 1539	"	RF.ConV.Mix Osc.AF.PA	"	25	5	30	150	125	1	15	330	3	0.5	6	-1		13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	C _e r _{bb'} 120pS	235
" 1540	"	RF.ConV.Mix Osc.AF.PA.LN	"	25	5	30	150	125	1	15	330	3	0.5	6	-1	NF=3dB (f=1kHz)	13.2k	0.65	3.7	200*	3.5	C _e r _{bb'} 120pS	235

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)													外形	備考			
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μT)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie'(real)} * (Ω)					
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *	h _{ib} *	
2SC1541	ローム	RF Conv. Mix Osc. AF. PA	Si. EP	40	5	150	300	125	1	24	330	3	10	6	-1		25.9k	0.8	7.7	250*	4.5	C _c r _{ob} ' 150pS	235			
" 1542	"	"	"	25	5	150	300	125	1	15	330	3	10	6	-1		25.9k	0.8	7.7	250*	4.5	C _c r _{ob} ' 150pS	235			
" 1543	"	SW. AF	"	40	5	20	150	125	1	24	220	3	10	6	-1		20k	0.585	5.8	250*	3	C _c r _{ob} ' 150pS	235			
" 1544	"	"	"	25	5	20	150	125	1	15	220	3	10	6	-1		20k	0.585	5.8	250*	3	C _c r _{ob} ' 150pS	235			
" 1545	"	RF Conv. Mix Osc. PA	"	40	6	300	300	125	1	24	10,000	5	100	5	-10					250*	3	C _c r _{ob} ' 100pS	235			
" 1546	"	RF Conv. Mix Osc. PA. SW	"	25	6	300	300	125	1	15	10,000	5	100	5	-10					250*	3	C _c r _{ob} ' 100pS	235			
★ " 1547	松下	RF	Si. P	30	3	20	150	175	1	25	100	10	2	10	-3	G _{ps} = 16dB, NF = 4dB (f = 800MHz, I _C = 3mA)			900*	0.8	60*	50C	213			
★ " 1548	東芝	PA	Si. EP	50		5A	45W (T _c = 25°C)	175	1mA	20	50	5	1A			P _o = 23W (f = 260MHz, V _{CC} = 20V, P _i = 4W)										
★ " 1549	富士通	AF	"	150	5	50	750	175	1	140	150	5	10					130*	20	70*	247					
★ " 1550	松下	PA	Si. TP	250	5	100	10W (T _c = 25°C)	150	100	250	100	50	5	30	-20				100*	3.5	15	236				
" 1551	東芝	LN	Si. EP	20	2	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	-10	G _{ps} = 7dB, NF = 45dB (f = 4GHz, I _C = 5mA)			6.5GHz*	0.7	15*	237				
" 1552	"	"	"	20	3	30	250	175	0.1	10	70	10	10	10	-10	G _{ps} = 10.5dB, NF = 3.5dB (f = 2GHz, I _C = 5mA)			4.5GHz*	0.8	15*	237				
" 1553	"	"	"	20	3	30	175	175	0.1	10	100	10	5	10	-10	G _{ps} = 15dB, NF = 1.2dB (f = 500MHz, I _C = 3mA)			4.5GHz*	0.9	40*	50C				
" 1554	"	RF	"	30	3	120	1.2W (T _c = 25°C)	175	1	10	100	5	50	10	-50	G _{ps} = 12.5dB (f = 1GHz, I _C = 30mA)			4GHz*	1.7	15*	238				
" 1555	"	"	"	30	3	120	1.2W (T _c = 25°C)	175	1	10	100	5	50	10	-50	G _{ps} = 12.5dB (f = 1GHz, I _C = 30mA)			4GHz*	1.7	15*	239				
" 1556	"	"	"	30	3	120	1.2W (T _c = 25°C)	175	1	10	100	5	50	10	-30	G _{ps} = 14dB (f = 500MHz)			3.5GHz*	2	25*	85B				
" 1557	"	PA	"	40	3.5	180	3W (T _c = 25°C)	175	1	10	150	5	50	18	-50	P _o = 1.1W (f = 1GHz, V _{CC} = 18V, P _i = 0.3W)			3GHz*	2.2	10*	85B				
" 1558	"	LN	"	15	3	80	250	175	0.1	10	75	8	50	5	-30	G _{ps} = 10dB (f = 2GHz)			7GHz*	1.1	20*	237				
" 1559	"	"	"	15	3	80	400	175	0.1	10	75	3	50	5	-30	G _{ps} = 10dB (f = 2GHz)			7GHz*	1.1	20*	238				
" 1560	日電	RF	Si. E	25	3	70	580	200	1	15	70	10	20	10	-20	S ₂₁ ² = 6.5dB (10V, 20mA, 2GHz)			4500*	C _{ref} 4.5		306				
" 1561	富士通	PA	Si. EP	55	3.5	500	7W (T _c = 25°C)	175	100	20	50	5	200	12	200	P _o = 3W (f = 700MHz, V _{CC} = 28V, P _i = 0.5W)			1.8GHz*	4.6		246				
" 1562	"	"	"	55	3.5	1A	12W (T _c = 25°C)	175	200	20	50	5	500	12	300	P _o = 9W (f = 700MHz, V _{CC} = 28V, P _i = 2W)			1.6GHz*	7		246				
" 1563	"	"	"	55	3.5	2A	25W (T _c = 25°C)	175	400	20	50	5	1A	12	500	P _o = 15W (f = 700MHz, V _{CC} = 28V, P _i = 4W)			1.2GHz*	12		246				
" 1564	"	"	"	55	3.5	4A	40W (T _c = 25°C)	175	800	20	50	5	3A	12	700	P _o = 30W (f = 700MHz, V _{CC} = 28V, P _i = 10W)			800*	23		246				
" 1565	松下	"	Si. P	150	5	250	10W (T _c = 90°C)	150	30	60	120	10	100	10	-50				150*	10	15	236	2SA795 とコンプリ			
★ " 1566	"	RF	Si. TP	250	5	100	4W (T _c = 25°C)	150	1mA	250	100	20	4	10	-3				35	300	0.4	2.7	100*	3.2	C _c r _{ob} ' 50pS	222
" 1567	"	PA	Si. EP	100	5	500	1.2W	150	1	100	160	10	150	10	-50				120*	11	3.5k*	222	2SA794 とコンプリ			
" 1568	"	"	"	18	5	1A	4W (T _c = 25°C)	150	0.1	18	200	2	500	6	-50				150*	12	3.5k*	222	2SA900 とコンプリ			
" 1569	東芝	"	Si. T	300	5	150	12.5W (T _c = 25°C)	150	1	100	40-170	10	50	10	-30				100*	5	10	268				
" 1570	三洋	LN	Si. EP	55	5	100	200	125	0.1	18	160-960	6	1	6	-1	NF = 1.5dB (f = 100Hz, V _{CE} = 6V, I _C = 0.1mA)			100*	3	C _c r _{ob} ' 250pS	138				

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考				
				V_{CB0} (V)	V_{E0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス		h_{FE}		バイアス		h_{fe}	h_{ie}	h_{re}			h_{oe}	$f_{\alpha\beta}$	$C_{\alpha\beta}$	r_{bb}
									(μA)	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(mA)$	$V_{CB}(V)$	$I_E(mA)$	h_{fb}^*	h_{ib}^*									
2SC1571	三洋	LN	Si.EP	40	5	100	200	125	0.1	18	160~960	6	1	6	-1	$NF=1.5\text{dB}$ ($f=100\text{Hz}$, $V_{CE}=6\text{V}$, $I_C=0.1\text{mA}$)				100*	3	$C_{\alpha\beta}$ 250pS	138		
" 1572																									
" 1573	松下	AF	Si.TP	250	5	70	600	135	2	12	120	10	5	10	-3	35	300	0.4	2.7	80*	5	$C_{\alpha\beta}$ 60pS	165		
" 1574	東芝	LN	Si.EP	20	2	30	400	175	0.1	10	70	10	5	10	-10	$G_{ps}=15\text{dB}$, $NF=12\text{dB}$, 4.5GHz ($f=500\text{MHz}$)($f=500\text{MHz}$), ($f=3\text{mA}$)				11.5	20*		85B		
" 1575																									
" 1576	東芝	SW	Si.T	450	6	8 A	$\frac{100\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	100	450	30~150	5	1 A			$t_{on} = 1\mu\text{S}$, $t_f = 0.8\mu\text{S}$ $t_{stg} = 3\mu\text{S}$								102	
" 1577	サンケン	"	Si.TMe	500	6	8 A	$\frac{80\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1mA	500	30	4	3 A	12	-500					7*	55	4*	102		
" 1578	"	"	"	600	6	8 A	$\frac{80\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1mA	600	30	4	3 A	12	-500					7*	55	4*	102		
" 1579	"	PA	"	500	6	15A	$\frac{150\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1mA	500	20	4	5 A	12	-500					7*	80	3*	102		
" 1580	"	"	"	600	6	15A	$\frac{150\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1mA	600	20	4	5 A	12	-500					7*	80	3*	102		
" 1581	東芝	PA	Si.EP	65		7 A	$\frac{80\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	3mA	30	30	10	5 A			$P_o = 50\text{W}$ ($f=30\text{MHz}$, $V_{CC}=28\text{V}$, $P_i=2\text{W}$)							223		
" 1582	"	"	"	65		13A	$\frac{140\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	6mA	30	30	10	10A			$P_o = 100\text{W}$ ($f=30\text{MHz}$, $V_{CC}=28\text{V}$, $P_i=8\text{W}$)							223		
" 1583	三菱	Diff. LN	"	50	5	100	200/omit	125	0.1	25	250~1200	6	-1	6	-1	$\Delta V_{BE} = 10\text{mVmax}$ $h_{FE1}/h_{FE2} = 0.8 - 1.0$				100*	3.0		274B	2素子 複合	
" 1584	サンケン	PA	Si.TMe	150	6	15A	$\frac{150\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1mA	150	60	4	5 A	12	-500	$t_{r1} = 1.3\mu\text{S}$ $t_{f1} = 2\mu\text{S}$	$t_f = 1\mu\text{S}$			10*	110	10*	102	2SA907 とコンプリ	
" 1585	"	"	"	200	6	15A	$\frac{150\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1mA	200	60	4	5 A	12	-500	$t_{r1} = 1.3\mu\text{S}$ $t_{f1} = 2\mu\text{S}$	$t_f = 1\mu\text{S}$			10*	110	10*	102	2SA908 とコンプリ	
" 1586	"	"	"	250	6	15A	$\frac{150\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1mA	250	60	4	5 A	12	-500	$t_{r1} = 1.3\mu\text{S}$ $t_{f1} = 2\mu\text{S}$	$t_f = 1\mu\text{S}$			10*	110	10*	102	2SA909 とコンプリ	
" 1587	三菱		Si.EP	45	4.5	3 A	$\frac{50\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	1mA	30	50	25	200			$P_o = 30\text{W}$ ($f=295\text{MHz}$, $V_{CC}=23\text{V}$, $P_i=6\text{W}$)							224		
" 1588	日電		Si.E	36	4	300	$\frac{1.7\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	125	100	30	55	10	100	10	-30	$P_o = 0.4\text{W}$ ($f=225\text{MHz}$, $V_{CC}=12\text{V}$, $P_i=10\text{mW}$)				900*	<10		167B		
" 1589	"	"	"	36	4	700	$\frac{2.5\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	100	30	15~200	10	300	10	-50	$P_o = 1.5\text{W}$ ($f=225\text{MHz}$, $V_{CC}=12\text{V}$, $P_i=0.2\text{W}$)				700*	<15		167B		
" 1590	"	"	"	36	4	1.2A	$\frac{13.5\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	1mA	30	15~200	10	500	10	-300	$P_o = 5.5\text{W}$ ($f=225\text{MHz}$, $V_{CC}=12\text{V}$, $P_i=0.7\text{W}$)				400*	<25		226		
" 1591	"	"	"	36	4	2.5A	$\frac{30\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	175	2mA	30	15~200	10	1 A	10	-500	$P_o = 15.5\text{W}$ ($f=225\text{MHz}$, $V_{CC}=12\text{V}$, $P_i=4\text{W}$)				250*	<50		226		
" 1592	"	"	"	30	3	100	$\frac{3.5\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	200	0.1	20	100	10	50	10	-50					2700*	C_{re} 1		129		
" 1593	"	RF	"	40	3	150	$\frac{4.375\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	200	50	20	15~200	10	70	10	-70					2000*	2.5		129		
" 1594	"	PA	"	35	3	200	$\frac{7\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	200	10	20	60	10	100	10	-100	$G_{ps} 10.5\text{dB}$ ($f=1\text{GHz}$, $V_{CE}=15\text{V}$, $I_C=100\text{mA}$)				2500*	C_{re} 2.8		129		
" 1595	"	RF	"	35	3	300	$\frac{7\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	200	10	20	60	10	100	10	-100	$G_{ps} = 3.5\text{dB}$ ($f=2.3\text{GHz}$, $V_{CC}=18\text{V}$, $P_i=30\text{dBm}$)				2500*	C_{re} 2.8		129		
* " 1596	富士通	RF	Si.EP	150	5	50	450	175	1	140	60	5	10	5	-10	$t_{on} < 1\mu\text{S}$, $t_{off} < 10\mu\text{S}$ $t_{stg} < 9.5\mu\text{S}$				130*	2	70*	55C		
" 1597	"	AF	"	150	5	50	450	175	1	140	150	5	10							130*	20	70*	244		
" 1598																									
" 1599																									
" 1600	日電	RF	Si.E	40	3	250	$\frac{4.375\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	200	100	20	15~200	10	100	10	-100	$P_{osc} = 28.5\text{dBm}$ ($f=1.7\text{GHz}$, $V_{CE}=-18\text{V}$)				2000*	C_{re} 3		315		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直 流 又 は バ ル ス h _{FE}			バ イ ア ス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)			f _{αβ} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	τ _{bb'} h _{ie(REAL)} * (Ω)	
									(μA)	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}	h _{fe}										h _{ib} *
2SC1601	新日無	RF, AF, LN	Si, EP	35		100	200	175	0.05	20	150	6	1	6	-0.1	NF=2dB (f=1kHz)	50k	5	15	200*	2	C _c τ _{bb'} 60pS	243		
" 1602	"	RF, AF	"	35		100	150	125	0.05	20	150	6	1	6	-0.1		50k	5	15	200*	2	C _c τ _{bb'} 60pS	27		
" 1603	三菱	PA	"	18	4	600	6 W (T _c =25°C)	175	100	10	50	7	100			P ₀ =1.5W (f=485MHz, V _{cc} =7.2V, P _i =0.3W)								312	
" 1604	"	"	"	18	4	300	5 W (T _c =25°C)	175	30	10	40	7	50			P ₀ =0.35W (f=485MHz, V _{cc} =7.2V, P _i =50mW)								255	
" 1605	"	"	"	35	4.5	3.5A	30W (T _c =25°C)	175	500	25	50	10	100			P ₀ =16W (f=175MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =1.7W)								113	
" 1606	"	PA	"	40	4	600	6 W (T _c =25°C)	175	100	25	50	10	100			P ₀ =3 W (f=175MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =0.2W)								271	
" 1607	富士通	RF	Si, EP	40	3.5	100	180	175	100	20	50	5	50	12.5	-10	G _{pe} =12dB (f=200MHz)					4			50C	
" 1608	"	PA	"	40	3.5	500	5 W (T _c =25°C)	175	100	20	50	5	200			P ₀ =1.6W (f=470MHz, V _{cc} =12.5V, P _i =0.3W)					5			231	
" 1609	日電	SW	Si, EMe	140	6	25A	120W (T _c =25°C)	175	10	140	30	2	13A			t _{on} <0.5μS, t _{off} <2μS t _{stg} <1.5μS								102	
" 1610	"	"	"	150	7	10A	100 W (T _c =25°C)	175	100	100	60	5	5 A			t _{on} <0.5μS, t _{off} <2μS t _{stg} <1.5μS								102	
" 1611																									
" 1612																									
" 1613	ローム	SW	Si, TP	130	5	30	150	125	1	80	56~270	3	5	5	-2						60*	6		235	
" 1614	"	"	"	180	5	30	150	125	1	120	56~270	3	5	5	-2						60*	6		235	
" 1615	"	"	"	210	5	30	150	125	1	150	56~270	3	5	5	-2						60*	6		235	
" 1616																									
" 1617	東芝	PA	Si, T	300	5	7 A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	250	30~150	5	1 A	5	-500						10*	100		102	水平偏用
" 1618	サンケン	"	Si, TMe	80	6	6 A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	80	60	4	3 A	12	-500						10*	85	12*	102	2SA807 とコンプアリ
" 1619	"	"	"	100	6	6 A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	100	60	4	3 A	12	-500						10*	85	12*	102	2SA808 とコンプアリ
" 1620	松下	PA	Si, EP	36	3	600	10W (T _c =25°C)	175	100	15	50	13.5	100	13.5	-150	P ₀ =2.6W, G _{pe} =6.34dB (f=500MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =0.6W)					1200*	7		227	
" 1621	日電	SW	Si, E	25	5	200	150	125	0.1	15	85	0.5	1	10	-10	t _{on} <20μS, t _{off} <40μS t _{stg} <20μS					400*	<6		176	
" 1622	"	RF, AF	"	40	5	100	150	125	0.05	25	500	3	0.5	6	-1						100*	3.5	50	176	
" 1623	"	"	"	60	5	100	150	125	0.1	60	200	6	1	6	-10						250*	3	25*	176	
" 1624	東芝	PA	Si, P	120	5	1 A	15W (T _c =25°C)	150	1	50	70~240	5	150	5	-150						30*	20		268	2SA814 とコンプアリ
" 1625	"	"	"	100	5	1 A	15W (T _c =25°C)	150	1	50	70~240	5	150	5	-150						30*	20		268	2SA815 とコンプアリ
" 1626	"	"	Si, E	80	5	750	15W (T _c =25°C)	150	0.5	30	70~240	2	150	2	-150						100*	15		268	2SA816 とコンプアリ
" 1627	"	"	"	80	5	300	600	150	0.1	50	70~240	2	50	2	-50						150*	6		138	2SA817 とコンプアリ
" 1628	"	"	Si, T	180	5	50	1 W	150	1	100	70~240	5	10	10	-10						120*	<5		249	2SA818 とコンプアリ
" 1629	サンケン	PA	Si, TMe	90	6	6 A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	90	1000	4	1 A	12	-500						10*	95	80*	102	
" 1630	ソニー	RF	Si, E PaMe	175	5	30	750	175	1	25	100	5	3	10	-2	h _{fe} =1dB (f=100MHz)					3	C _c τ _{bb'} 40pS	181		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考						
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直流又はパルス hFE		バイアス		h _{je}	h _{ie} *	h _{re} *	h _{ob} *	f _β * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} ' (Ω)				
2SC1631	ソニー	RF.LN	Si.PaMe	25	6	200	250	100	0.2	25	200	3	1	6	-0.1	170	36k	2.4	3.3	h _{re} =3dB (f=100MHz)	4.5	C _e r _{bb} ' 300pS	138				
" 1632	"	"	"	50	6	200	320	120	0.2	25	200	3	1	6	-2					h _{re} =1.0dB (f=100MHz)	4.5	C _e r _{bb} ' 300pS	138				
" 1633	"	"	"	25	6	200	320	120	0.2	25	200	3	1							h _{re} =1.4dB (f=100MHz)	4.5	C _e r _{bb} ' 300pS	138				
" 1634	"	"	"	50	6	200	320	120	0.2	25	200	3	1	6	-2					h _{re} =1.0dB (f=100MHz)	4.5	C _e r _{bb} ' 300pS	138				
" 1635	富士通	SW	Si.EP	70	5	1A	800	175	0.3	40	50	1	500							t _{on} < 35nS, t _{off} < 55nS t _{stg} < 50nS			123				
" 1636	ソニー	LN.SW	Si.E	50	25	20	300	120	0.2	50	500~2000	3	1	6	-2					NF=2dB (6V, 0.1mA, f=10Hz)	30*	4	138				
" 1637	"	"	"	50	25	20	250	120	0.2	50	66~525	3	1	10	-1						20*	4	C _e r _{bb} ' 30pS	138			
" 1638	富士通	RF	Si.EP	40	3	300	600	175	0.5	20	100	10	20	10	-20						1400*	3	40	85C			
" 1639	ローム	RF.AF	"	25	5	30	250	125	1	15	270	3	0.5	5	-10						200*	3.5	C _e r _{bb} ' 120pS	138			
" 1640	"	RF.LN	"	25	5	30	250	125	1	15	560	3	0.5	5	-10					NF=3dB (5V, 1mA, f=1kHz)	200*	3	C _e r _{bb} ' 120pS	138			
" 1641	"	RF.AF	"	40	5	150	300	125	1	24	390	3	10	5	-20						250*	4.5	C _e r _{bb} ' 150pS	138			
" 1642	"	"	"	25	5	150	300	125	1	15	390	3	10	5	-20						250*	4.5	C _e r _{bb} ' 150pS	138			
" 1643	"	AF.SW	"	40	5	30	250	125	1	24	220	3	10							t _{on} < 200nS, t _{off} < 300nS t _{stg} < 200nS			138				
" 1644	"	"	"	25	5	30	250	125	1	15	220	3	10							t _{on} < 200nS, t _{off} < 300nS t _{stg} < 200nS			138				
" 1645	"	AF	"	40	6	300	300	125	1	24	>1000	5	100	5	-10						250*	3		138	ターリントン		
" 1646	"	"	"	25	6	300	300	125	1	15	>1000	5	100	5	-10						250*	3		138	ターリントン		
" 1647	"	AF.SW	"	50	5	30	250	125	1	30	270	3	0.5	5	-10						200*	3.5	C _e r _{bb} ' 120pS	138			
" 1648	"	RF.LN	"	50	5	30	250	125	1	30	560	3	0.5	5	-10					NF=3dB (5V, 1mA, f=1kHz)	200*	3	C _e r _{bb} ' 120pS	138			
" 1649	"	SW	Si.TP	130	5	30	250	125	1	80	56~270	3	5	5	-2						60*	6		138			
" 1650	"	"	"	180	5	30	250	125	1	120	56~270	3	5	5	-2						60*	6		138			
" 1651	"	"	"	210	5	30	250	125	1	150	56~270	3	5	5	-2						60*	6		138			
" 1652	"	AF.SW	Si.EP	40	5	500	300	125	1	20	82~390	3	100	5	-20						250*	6.2		235	2SA874 とコンブリ		
" 1653	日電	RF.SW	Si.E	150	5	50	150	125	0.1	100	130	3	15	10	-10						t _{on} < 0.6μS t _{stg} < 1.5μS	t _{off} < 2μS	150*	4.5	15	176	
" 1654	"	"	"	180	5	50	150	125	0.1	100	100	3	15	10	-10						t _{on} < 0.6μS t _{stg} < 1.5μS	t _{off} < 2μS	150*	4.5	15	176	
" 1655	"	RF	"	16	3	30	150	175	0.1	10	100	3	10	6	-20						8000*	C _e r _o 0.5	40*	320			
" 1656	"	"	"	10	3	30	150	200	0.1	10	100	3	10	5	-20						7000*	C _e r _o 0.4	40*	320			
" 1657	"	RF.SW	"	16	3	30/unit	150/unit	175	0.1	10	100	3	10	6	-20						hFE1/hFE2=0.6~1.0	8000*	C _e r _o < 0.5		307A	2素子複合	
" 1658	"	"	"	10	3	30/unit	150/unit	200	0.1	10	100	3	10	5	-20						hFE1/hFE2=0.6~1.0	7000*	C _e r _o < 0.5		307A	"	
" 1659	"	RF	Si.E	20	3	80	500	200	0.1	10	100	5	30	6	-30						S _{21e} ² =13dB (f=1GHz, V _{CE} =6V, I _C =30mA)	7000*	C _e r _o 0.6	18*	306		
" 1660	"	"	"	20	3	80	500	200	0.1	10	100	5	30	6	-30						S _{21e} ² =13dB (f=1GHz, V _{CE} =6V, I _C =30mA)	7000*	C _e r _o 0.6	18*	306		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考		
				V _{CEO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CBO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μS)	f _{αB} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie'(real)} * (Ω)
									(μA)	V _{CEB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SC1781	日立	RF	Si.E	70	5	500	350	175	0.5	50	80~240	3	10	3	-10	t _{on} =35nS, t _{off} =350nS t _{stg} =300nS	150*	6	350*	49C			
" 1782	サンケン	PA	Si.TMe	140	6	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	140	60	4	3A	12	-500		10*	165	13*	102			
" 1783	"	"	"	180	6	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	180	60	4	3A	12	-500		10*	165	13*	102			
" 1784	"	"	"	150	6	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	150	20	4	5A			t _r <1.5μS t _{stg} <4μS				102			
" 1785	"	"	"	200	6	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	200	20	4	5A			t _r <1.5μS t _{stg} <4μS				102			
" 1786	"	"	"	230	6	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	230	20	4	5A			t _r <1.5μS t _{stg} <4μS				102			
★ " 1787	松下	RF.LN	Si.EP	35	5	30	150	125	0.1	10	540	5	2	10	-1	NF=6dB (100Hz, 10V, 200μA)	150*	2.2	70	276	2SA880 とコンプリ		
★ " 1788	"	PA	"	25	7	500	600	135	10	25	160	2	500	10	-50		150*	6	3.5k	138	2SA1128 とコンプリ		
★ " 1789	"	RF.Mix. Conv.Osc	"	25	3	50	200	125	0.1	25	100	10	2	10	-10		1200*	1.05	20	138			
★ " 1790	"	RF	"	25	3	15	150	175	100	25	50	10	2	10	-3		3000*	1.2	20	50C			
" 1791	日電	PA	Si.E	45	4	1A	11W (T _c =25°C)	200	500	30	60	10	500	10	-300	P ₀ =6W (f=1GHz, V _{cc} =18V, P _i =2W)	1200*	C _{re} <7		184			
" 1792	"	"	"	45	4	2A	22W (T _c =25°C)	200	1mA	18	60	10	500	10	-600	P ₀ =10W (f=1GHz, V _{cc} =18V, P _i =4W)	800*	C _{re} <14		184			
" 1793																							
" 1794																							
" 1795																							
" 1796																							
" 1797	日電	PA	Si.E	50	3.5	300	6W (T _c =25°C)	200	200	28	60	10	100			P ₀ =1.6W, η=33% (f=2GHz, V _{cc} =28V, P _i =0.5W)		C _{re} <3		118B			
" 1798	"	"	"	50	3.5	1A	11.6W (T _c =25°C)	200	500	28	60	10	150			P ₀ =3.1W, η=35% (f=2GHz, V _{cc} =28V, P _i =0.5W)		C _{re} <6		118B			
" 1799	"	"	"	50	3.5	2A	19.5W (T _c =25°C)	200	500	28	60	10	200			P ₀ =6.3W, η=33% (f=2GHz, V _{cc} =28V, P _i =1W)		C _{re} <9		118B			
" 1800	"	"	"	50	3.5	3A	29W (T _c =25°C)	200	500	28	60	10	500			P ₀ >10W, η=35% (f=2GHz, V _{cc} =28V, P _i =3.2W)		C _{re} <10		118B			
" 1801	新日無	RF	Si.EP	30	3	30	150	125	0.5	15	60	10	5	10	-10		1300*	1	C _{re} r _{bb'} 6pS	138D			
" 1802	"	"	"	30	3	20	150	125	0.5	15	60	6	2	10	-2		700*	1	C _{re} r _{bb'} 2.5pS	138D			
" 1803	日電	RF.LN	Si.E	30	3	130	580	200	0.1	20	100	5	50	5	-50		2700*	C _{re} 1	15*	306			
" 1804	三菱	PA	Si.EP	47	4	1A	10W (T _c =25°C)	175	200	30	50	25	100			P ₀ =4.5W (f=770MHz, V _{cc} =25V, P _i =1W)				273			
" 1805	"	"	"	45	4	2A	30W (T _c =25°C)	175	1mA	35	50	25	100			P ₀ =12W (f=770MHz, V _{cc} =25V, P _i =3.5W)				273			
★ " 1806	"	"	"	45	4	4A	50W (T _c =25°C)	175	2mA	35	50	25	200			P ₀ =26W (f=770MHz, V _{cc} =25V, P _i =8W)				273			
★ " 1807	"	RF.PA	"	18	4	0.1A	300	175	30	10	10~180	7.2	20			P ₀ =25mW (f=485MHz, V _{cc} =7.2V, P _{in} =5mW)							
" 1808	"	"	"	35	3.5	1A	10W (T _c =25°C)	175	100	15	10~180	10	0.1A			P ₀ =3.5W (f=485MHz, V _{cc} =13.5V, P _{in} =0.4W)				312			
" 1809	ローム	RF.Mix Osc.Conv	"	25	4	20	150	125	0.5	20	39~180	6	1	6	-1		500*	1.4		138			
" 1810	ソニー	PA	Si.T	700	12	300	950	120	2	12	50	5	10	10	-10		13*	8.5	C _{re} r _{bb'} 170pS	174B			

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)				電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)													外形	備考	
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	直流又はバラス hFE			バ イ ア ス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _{bb'} h _{ie(Real)} * (Ω)
										V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}	V _{CE(V)}									
2SC1901	富士通	RF	Si.EP	25	3	20	200	175	0.1	12	150	8	5					1400*	1.2	40*	84C		
" 1902	"	"	"	40	3	300	500	175	0.1	35	80	14	55					650*	2.8	25*	84C		
" 1903	"	AF.RF	"	150	5	50	1W	150	1	140	150	5	10	5	-10			130*	2	70*	328		
" 1904	"	"	"	150	5	50	1W	150	1	140	150	5	10	5	-10			130*	2	70*	328		
" 1905	松下	PA	Si.TP	350	7	200	15W (T _c =25°C)	150	10	300	100	10	50	30	-20			45*	7.5	10	268		
" 1906	日立	RF.Conv.	Si.EP	30	2	50	300	125	0.5	10	>40	10	10	10	-10	V _{OSC} =550mV (f=275MHz, V _{CE} =9V, I _C =7mA)		1000*	1	C _{e rbb'} 10pS	138		
" 1907	"	Osc.RF	"	30	2	50	300	125	0.5	10	>40	10	10	10	-10	V _{OSC} =630mV (f=930MHz, V _{CB} =10V, I _C =10mA)		1100*	1	C _{e rbb'} 10pS	138		
" 1908	ソニー	RF	Si.E	30	4	30	500	120	1	25	80	6	1	6	-1			200*	2	C _{e rbb'} 25pS	138	2SA925 とコンパリ	
" 1909	日電	PA	"	75	4	3A	10W (T _c =25°C)	150	10	40	60	10	500	10	-150	P _o =8.5W (f=27MHz, V _{CE} =12V, P _i =0.2W)		160*	50	4	268		
" 1910	東芝	Diff	Si.EP	15	2	80	200/unit	175	0.1	5	75	3	50	5	-30	ΔV _{BE} <30mV, γΔV _{BE} <0.2mV/°C (3V, 50mA)		7000*	1.1	15*	282A		
" 1911	"	"	"	20	2	30	150/unit	175	0.1	10	80	5	10	5	-10	ΔV _{BE} <15mV, γΔV _{BE} <0.1mV/°C (5V, 10mA)		6500*	0.66	15*	282A		
" 1912	"	"	"	20	2	30	150/unit	175	0.1	10	80	5	10	5	-10	ΔV _{BE} <15mV, γΔV _{BE} <0.1mV/°C (5V, 10mA)		6500*	0.66	15*	282B		
" 1913	松下	RF	"	150	5	1A	15W (T _c =25°C)	150	10	130	150	10	150	10	-50			120*	20	3k	268		
" 1914	三菱	AF.RF	"	90	5	50	200	125	0.1	50	250-1200	6	1	6	-1			150*	1.8		138B		
" 1915	"	"	"	120	5	50	800	135	1	100	150-800	10	10	10	-10			200*	2.3		242	2SA905 とコンパリ	
" 1916																							
" 1917																							
" 1918																							
" 1919	三菱	LN	Si.EP	50	5	30	200	125	0.1	50	250-1200	6	1	6	-1	NF=0.9dB (6V, 100μA, 10Hz)		150*	1.9		138B		
" 1920	東芝	Diff	"	15	2	80	200/unit	175	0.1	5	75	3	30	5	-30	ΔV _{BE} <30mV, γΔV _{BE} <0.2mV/°C (3V, 50mA)		7000*	1.1	15*	282B		
" 1921	日立	RF	Si.T	250	5	50	600	150	1	120	30-300	6	10	6	-10			130*	3	25*	251		
" 1922	"	SW	"	1500	6	2.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	600				5	-400	t _r <1μS		5*	90	15	102	水平偏向用	
" 1923	東芝	RF.Conv. Mix.Osc	Si.EP	40	4	20	100	125	0.5	18	40-200	6	1	6	-1	NF=2.5dB (100MHz)		550*	C _{e rbb'} 0.7	C _{e rbb'} <30pS	138		
" 1924	日電	Diff.SW	Si.E	20	3	50	300	200	0.1	10	30-300	5	10	5	-15			3000*	C _{e r1} 1.1		309B	2素子複合	
" 1925	"	"	"	20	3	50	300	200	0.1	10	30-300	5	10	5	-15	hFE1/hFE2=0.8-1.0 ΔV _{BE} <10mV (5V, 10mA)		3000*	C _{e r1} 1.1		309A	2素子複合	
" 1926	"	"	"	30	3	50	200/unit	200	0.05	15	80	10	10	10	-10	hFE1/hFE2=0.8-1.0		2000*	C _{e r1} 1.1		309B	2素子複合	
" 1927	"	"	"	30	3	50	300	200	0.05	15	80	10	10	10	-10			2000*	C _{e r1} 1.1		309A	2素子複合	
" 1928	ソニー	RF	"	50	25	50	315	120	0.2	50	400	3	1	10	-20			35*	4	C _{e rbb'} 150pS	38		
" 1929	松下	PA	Si.P	300	6	400	25W (T _c =25°C)	150	10	300	150	5	100	10	-100			80*	12	15	268		
" 1930	富士通	RF	Si.EP	16	3	30	150	175	0.1	10	80	3	10	6	-20			8000*	0.3	30*	284		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)													外形	備考		
				V _{CBO} (V)	V _{CEO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値 (μA)	V _{CE(V)}	直流又はパルス h _{FE}	バイアス		h _{fe}	h _{ie} (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μΩ)	f _{αβ} (Mc)	C _{ob} (pF)	τ _{bb'} (real)* (ns)					
2SC1991	日電	RF	Si.E	60	5	100	625	150	0.05	60	170	10	2	6	-10					250*	1.5	C _e τ _{bb'} 40pS	138D		
" 1992	"	RF.AF	"	50	6	100	300	150	0.06	50	235	5	2	5	-2	238	5 k	5	32	300*	3	C _e τ _{bb'} 250pS	138F		
" 1993	"	"	"	30	5	100	300	150	0.06	30	290	5	2	5	-2	330	5 k	5	32	300*	3	C _e τ _{bb'} 250pS	138F		
" 1994	"	RF.AF.LN	"	45	5	100	300	150	0.06	45	380	5	2	5	-10	NF=1.5dB (f=1kHz, V _{CE} =5V, I _C =0.2mA)				300*	3	C _e τ _{bb'} 250pS	138F		
" 1995	"	"	"	50	5	100	300	150	0.06	50	380	5	2	5	-10	NF=1.5dB (f=1kHz, V _{CE} =5V, I _C =0.2mA)				300*	3	C _e τ _{bb'} 250pS	138F		
" 1996	"	RF	"	50	5	800	625	150	0.1	20	200	1	100	5	-10					100*	11	C _e τ _{bb'} 100pS	138F		
" 1997	"	"	"	30	5	800	625	150	0.1	20	200	1	100	5	-10					100*	11	C _e τ _{bb'} 100pS	138F		
" 1998	"	RF.AF	"	80	6	100	500	150	0.05	80	140	5	2	5	-2	320	5 k	4.9	28.5	300*	3.7	C _e τ _{bb'} 250pS	138F		
" 1999	"	"	"	50	6	100	500	150	0.05	50	140	5	2	5	-2	320	5 k	4.9	28.5	300*	3.7	C _e τ _{bb'} 250pS	138F		
" 2000	"	RF	"	60	5	200	600	150	0.1	60	90	6	1	6	-1					70*	3.7	C _e τ _{bb'} 6pS	138		
" 2001	"	RF.AF	"	30	5	700	600	150	0.1	30	200	1	100	6	-10					170*	13	C _e τ _{bb'} 50pS	138	2SA952 とコンブリ	
" 2002	"	"	"	60	5	300	600	150	0.1	60	200	1	50	6	-10					140*	7	C _e τ _{bb'} 25pS	138	2SA953 とコンブリ	
" 2003	"	"	"	80	5	300	600	150	0.1	80	200	1	50	6	-10					140*	7	C _e τ _{bb'} 25pS	138	2SA954 とコンブリ	
" 2004																									
" 2005																									
" 2006																									
" 2007																									
" 2008	ソニー	RF	Si.E	35	3	100	300	100	0.2	15	70	3	1	10	-5					560*	1.5	C _e τ _{bb'} 8pS	138F		
" 2009	"	"	"	35	3	25	250	100	0.3	15	70	3	1	10	-10					630*	1.4	C _e τ _{bb'} 8pS	138C		
" 2010	"	"	"	35	3	30	300	100	0.2	15	70	10	4	10	-4					400*	1	C _e τ _{bb'} 12pS	138C		
" 2011	"	"	"	30	3	50	250	100	0.2	15	50	3	1	10	-8					630*	1.3	C _e τ _{bb'} 16pS	138C		
" 2012	"	"	"	30	4	30	500	120	1	25	80	6	1	6	-1					200*	2	C _e τ _{bb'} 25pS	138		
" 2013	"	"	"	35	3	25	300	100	0.2	15	100	10	4	10	-4	NF=3dB (12V, 4mA, 200MHz)				700*	1	C _e τ _{bb'} 10pS	138C		
" 2014	"	LN	Si.EPa	100	5	200	500	120	0.1	50	95~420	3	10	10	-10					100*	7		138	2SA1066 とコンブリ	
" 2015																									
" 2016																									
★ " 2017	三菱	SW	Si.T	450	7	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	450	>10	3	5A	10	-500	t _r =0.4μS, t _f =0.5μS t _{stg} =2.5μS				>10*			102		
★ " 2018	"	"	"	300	7	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	300	>12	3	10A			t _r =0.4μS, t _f =0.6μS t _{stg} =2.4μS							102		
★ " 2019	"	"	"	300	7	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	300	>15	3	10A			t _r =0.4μS, t _f =0.6μS t _{stg} =2.4μS							102		
" 2020	ソニー	RF.PA	Si.E	45	4	2A	12W (T _c =25°C)	150	2	40	60	2	100	2	-100	P _O =7W, (f=27MHz, V _{CE} =12V, P _i =0.2W)				270*	20		268		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe} h _β *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} r _{be(Real)} * (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	V _{CE} (V)									
2SC2021	ローム	AF, RF Osc, SW	Si, EP	50	5	100	300	125	0.5	30	120-820	6	1	12	-2				180*	2	235	2SA937 とコンプリ	
" 2022	サンケン	PA	Si, TMe	300	6	1 A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	300	100	4	200	12	-100				10*	18	20	298	
" 2023	"	"	"	300	6	2 A	40W (T _c =25°C)	150	1mA	300	100	4	500	12	-200	f _c = 0.3 μS, t _f = 1 μS t _{rise} = 4 μS			10*	30	20	298	
" 2024	富士通	AF, RF	Si, EP	80	5	1 A	1 W	150	0.5	60	70	1	200	10	-30				150*	10	<50*	328	
" 2025	日電	RF	Si, E	35	3	50	350	200	0.1	20	100	5	25	5	-25	NF = 2.6dB (5V, 25mA, 200MHz)			2200*	C _{re} 1.3		50C	
" 2026	"	RF, LN	"	30	3	50	250	150	0.1	15	80	10	10	10	-10	G _{re} = 15dB (10V, 10mA, 500MHz)			2000*	C _{re} 0.75		138C	
" 2027	日立	SW	Si, T	1500	7	5 A	50W (T _c =25°C)	150	10	600				5	-100	t _f < 1.5 μS			8*	150	10	102	水平偏向用
" 2028	富士通	"	Si, EP	80	5	1.5A	5 W (T _c =25°C)	150	1	30	200	5	100			P _c = 0.7W (f = 27MHz, V _{CE} = 12V, P _i = 30mW)				18		328	
" 2029	"	"	"	80	5	2 A	10W (T _c =25°C)	150	10	30	100	5	100			P _c = 5W (f = 27MHz, V _{CE} = 12V, P _i = 0.3W)				60		268	
" 2030																							
" 2031	富士通	PA	Si, EP	45	3.5	500	7.5W (T _c =25°C)	175	100	20	50	5	200			P _c = 2.5W, η _c = 60% (f = 470MHz, V _{CE} = 21V, P _i = 0.3W)				5		330	
" 2032	"	"	"	45	3.5	1 A	12.5W (T _c =25°C)	175	200	20	50	5	500			P _c = 5.5W, η _c = 60% (f = 470MHz, V _{CE} = 21V, P _i = 1W)				8		330	
" 2033	"	"	"	45	3.5	3 A	30W (T _c =25°C)	175	600	20	50	5	2 A			P _c = 18W, η _c = 65% (f = 470MHz, V _{CE} = 21V, P _i = 6W)				18		330	
* " 2034	松下	"	"	120	5	2 A	12W (T _c =25°C)	150	1	40	120	5	1 A	5	-500	P _c = 3.8W (f = 50MHz, V _{CE} = 13.5V, P _i = 0.5W)			150*	40	3k*	84B	
" 2035	富士通	AF, RF	"	50	5	300	300	150	0.1	30	80	1	10	10	-10				350*	4	50*	275	
" 2036	東芝	PA	Si, E	80	5	1 A	1 W	150	0.1	60	150	2	150	10	-100				150*	12	8*	342	
" 2037	日電	RF, LN	"	30	3	50	250	150	0.1	15	80	10	10	10	-10	G _{re} = 13dB (10V, 10mA, 500MHz)			2000*	C _{re} 0.9		138D	
" 2038																							
" 2039	三菱	PA	Si, EP	70	4	8 A	80W (T _c =25°C)	175	1mA	30	50	28	1 A			P _c = 50W, η _c = 70% (f = 30MHz, V _{CE} = 28V, P _i = 0.5W)						302	
" 2040	"	"	"	40	4	500	5 W (T _c =25°C)	175	100	30	50	20	100			G _{re} = 20dB (f = 220MHz, V _{CE} = 20V, I _C = 100mA)						312	
" 2041																							
" 2042																							
* " 2043	富士通	RF, PA	Si, EP	60	5	8 A	25W (T _c =25°C)	150	10	30	500	5	500	5	-150	P _c = 16W (V _{CE} = 12V, f = 27MHz, P _i = 1W)			220*	70		268	
" 2044	"	"	"	55	35	6 A	65W (T _c =25°C)	175	1.2mA	20	50	5	5 A			P _c = 42W (V _{CE} = 28V, f = 770MHz, P _i = 15W)				3.7		329	
" 2045																							
" 2046																							
" 2047																							
" 2048																							
" 2049																							
* " 2050	松下	RF, PA	Si, EP	60	5	I _{CM} 8 A	20W (T _c =25°C)	150	20	40	>20	10	2 A	10	-500	P _c > 13W, η _c > 60% (f = 50MHz, V _{CE} = 12V, P _i = 3W)			150*	80		268	
" 2051	富士通	AF, RF	"	60	6	250	500	150	0.5	40	150	1	10	10	-10				300*	3	<105*	138	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バ イ ア ス		h _{je} h _{jb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αβ} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(ideal)} * (Ω)
									(μA)	V _{CEB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CEB} (V)	I _E (mA)									
2SC2082	日電	RF.PA	Si.E	38	3	2.2A	25W (T _c =25°C)	175	750	30	100	10	600	10	-600	P _o = 39.5dBm, η = 70% (V _{cc} =12.6V, f=500MHz, P _i =34dBm)			550*	C _{re} 17		43	
" 2083	"	"	"	38	3	3A	34W (T _c =25°C)	175	1mA	30	100	10	800	10	-800	P _o = 42dBm, η = 75% (V _{cc} =12.6V, f=500MHz, P _i =38dBm)			400*	C _{re} 24		43	
" 2084																							
" 2085	松下	PA	Si.TP	300	5	100	10W (T _c =25°C)	150	10	300	80	10	50	30	-20					55*	8	10	268
" 2086	三菱	"	Si.EP	75	4	1A	800	135	100	30	70	10	100			P _o = 450mW, η = 60% (f=27MHz, V _{cc} =12V, P _i =15mW)						242	
" 2087	沖	RF.AF	"	300	5.5	5	100	175	1	30	50	5	1	6	-1	60	1k	0.8	15	80*	5	C _{rrb'} 30pS	49C
" 2088	東芝	LN	Si.E	120	5	50	300	125	0.1	120	200~700	6	2	6	-1	600	16k	1.2	12	150*	2	40	138
" 2089	"	"	"	120	5	50	300	125	0.1	120	200~700	6	2	6	-1	600	16k	1.2	12	150*	2	40	138
" 2090																							
* 2091	日立	PA	Si.E	75	5	1A	750	150	1	40	20~200	10	500	10	-150	P _o = 1.8W, η > 60% (f=27MHz, V _{cc} =12V, P _i =35mW)			>150*	<20		160	
* 2092	"	"	"	75	4	3A	12W (T _c =25°C)	150	10	40	60	10	500	10	-150	P _o = 5W, η > 60% (f=27MHz, V _{cc} =12V, P _i =0.2W)			250*	40		268	
" 2093	日電	Osc.PA	"	28	3	200	5W (T _c =25°C)	200	0.5	10	40	6	100			S ₂₁ ² = 4 dB (6V, 100mA, 1GHz)				C _{re} 1.5		311	
" 2094	三菱	PA	Si.EP	40	4.5	3.5A	30W (T _c =25°C)	175	2mA	25	50	10	100			P _o = 17.5W, η = 70% (f=470MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =2W)						272	
" 2095																							
" 2096																							
" 2097	三菱	RF.PA	Si.EP	50	5	15A	125W (T _c =25°C)	175	5mA	25	50	10	100			P _o = 85W, η = 65% (f=30MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =4W)						303	
" 2098	東芝	PA	"	70	4	6A	20W (T _c =25°C)	150	100	40	200~100	5	4A	5	-500	P _o = 15W (f=28MHz, V _{CE} =12V, P _i =1W)			>100*	80		268	
" 2099	"	"	"	40	4	6A	60W (T _c =25°C)	175	1.5mA	15	20~185	5	1A	5	-500	P _o = 25W (f=28MHz, V _{CE} =12.5V, P _i =1.1W)			100*	<250		325	
" 2100	"	"	"	40	4	15A	150W (T _c =25°C)	175	3mA	15	50	5	10A			P _o = 60W, PEP (f=28MHz, V _{CE} =12.5V, P _i =3W PEP)						281	
" 2101	"	"	"	35	3.5	2A	15W (T _c =25°C)	175	100	15	>10	5	1A	10	-100	P _o = 8W (f=175MHz, V _{CE} =12.5V, P _i =0.5W)			400*	<25		316	
" 2102	"	"	"	35	3.5	3.5A	35W (T _c =25°C)	175	1mA	15	>10	5	1A			P _o = 17W (f=175MHz, V _{CE} =12.5V, P _i =1.3W)				<80		316	
" 2103	"	"	"	40	4	6A	50W (T _c =25°C)	175	1mA	15	50	5	1A			P _o = 26W (f=175MHz, V _{CE} =12.5V, P _i =4W)						316	
" 2104	"	"	"	35	3.5	800	7.5W (T _c =25°C)	175	1mA	15	150	5	500			P _o = 4W (f=470MHz, V _{CE} =12.6V, P _i =0.4W)				10		316	
" 2105	"	"	"	35	3.5	1.4A	15W (T _c =25°C)	175	1mA	15	80	5	1A			P _o = 7W (f=470MHz, V _{CE} =12.6V, P _i =1W)				15		316	
" 2106	"	"	"	35	3.5	2.8A	30W (T _c =25°C)	175	1.5mA	15	120	5	1.5A			P _o = 13W (f=470MHz, V _{CE} =12.6V, P _i =3W)				25		316	
" 2107	日電	RF	Si.E	60	8	100	150	125	0.1	40	160	1	10	10	-10					300*	3.5	40	176
" 2108																							
" 2109	日電	RF.SW	Si.E	60	8	200	300	150	0.1	40	160	1	10	10	-10	I _{on} = 45nS, I _{off} = 250nS I _{str} = 190nS			300*	3.2	40	304	
" 2110																							
" 2111	日電	RF.SW	Si.E	40	5	200	300	150	0.1	30	120	1	10	10	-10	I _{on} < 20nS, I _{off} < 40nS I _{str} < 20nS			500*	4	120	304	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考							
				V _{CEO} (V)	V _{CEO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値 (μA)	V _{CEB} (V)	直流又はパルス h _{FE} V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE} h _{FB} *	h _{FE} h _{FB} * (Ω)	h _{FE} h _{FB} * (×10 ⁻⁴)	h _{FE} h _{FB} * (μU)	J _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)					
2SC2232																												
" 2233	東芝	PA	Si.T	200	5	4 A	40W (T _c =25°C)	150	10	170	30-150	5	1 A	5	-500											268		
" 2234	"	"	Si.EP	35	3.5	10A	70W (T _c =25°C)	150	2mA	15	>10	5	5 A	10	-400	P _o >40W, η>60% (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =10W)				300*	<160				316			
" 2235	"	"	Si.E	120	5	800	900	150	0.1	120	80-240	5	100	5	-100											241	2SA965 とコンプリ	
" 2236	"	"	"	30	5	1.5A	900	150	0.1	30	100-320	2	500	2	-500											241	2SA966 とコンプリ	
" 2237	三菱	"	Si.EP	35	4	2 A	20W (T _c =25°C)	175	500	25	50	10	100			P _o =7.5W, η=65% (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =0.25W)									272			
" 2238	東芝	RF.PA	Si.E	160	5	1.5A	25W (T _c =25°C)	150	1	160	70-240	5	100	10	-100											268	2SA968 とコンプリ	
" 2239	"	"	"	160	5	1.5A	25W (T _c =25°C)	150	1	160	70-240	5	100	10	-100											99	2SA969 とコンプリ	
" 2240	"	AF.LN	"	120	5	100	300	125	0.1	120	200-700	6	2	6	-1	NF<6 dB (f=10Hz, 6V, 0.1mA)		NF<2dB (f=1kHz)		100*	3					138		
" 2241	"	PA	Si.T	300	7	150	20W (T _c =25°C)	150	1	240	40-170	10	50	10	-30											268		
" 2242	"	"	"	300	5	150	25W (T _c =25°C)	150	1	240	40-170	10	50	50	-20											268		
" 2243	富士電機	SW	Si.TP	450	7	5 A	100W (T _c =25°C)	150	1 mA	450	>10	5	2 A			t _{on} <1 μS, t _f =1 μS t _{off} <2 μS										102		
" 2244	"	"	"	450	7	8 A	100W (T _c =25°C)	150	1 mA	450	>10	5	3 A			t _{on} <1 μS, t _f =1 μS t _{off} <2 μS										102		
" 2245	"	"	"	450	7	10A	100W (T _c =25°C)	150	1 mA	450	>10	5	4 A			t _{on} <1 μS, t _f =1 μS t _{off} <2 μS										102		
" 2246	"	"	"	450	7	15A	100W (T _c =25°C)	150	1 mA	450	>10	5	6 A			t _{on} <1 μS, t _f =1 μS t _{off} <2 μS										102		
" 2247	"	"	"	450	7	5 A	40W (T _c =25°C)	150	1 mA	450	>10	5	2 A			t _{on} <1 μS, t _f =1 μS t _{off} <2 μS										321		
" 2248	"	"	"	450	7	8 A	40W (T _c =25°C)	150	1 mA	450	>10	5	3 A			t _{on} <1 μS, t _f =1 μS t _{off} <2 μS										321		
" 2249	"	"	"	250	7	30A	200W (T _c =25°C)	150	1 mA	250	>10	5	15A			t _{on} <2 μS, t _f <1 μS t _{off} <4 μS										266		
" 2250	"	"	"	450	7	30A	200W (T _c =25°C)	150	1 mA	450	>10	5	15A			t _{on} <2 μS, t _f <1 μS t _{off} <4 μS										266		
" 2251	富士通	PA	Si.EP	45	3.5	500	7 W (T _c =25°C)	175	100	20	50	5	200			P _o =1.8W (f=900MHz, V _{CE} =18V, P _i =0.5W)									159			
" 2252	"	"	"	45	3.5	1 A	12W (T _c =25°C)	175	200	20	50	5	500			P _o =4.5W (f=900MHz, V _{CE} =18V, P _i =1.5W)									159			
" 2253	"	"	"	45	3.5	2 A	25W (T _c =25°C)	175	400	20	50	5	1 A			P _o =9 W (f=900MHz, V _{CE} =18V, P _i =4 W)									159			
" 2254	"	"	"	45	3.5	4 A	40W (T _c =25°C)	175	800	20	50	5	3 A			P _o =12W (f=900MHz, V _{CE} =18V, P _i =6 W)									159			
" 2255	"	"	"	45	3.5	6 A	65W (T _c =25°C)	175	1.2mA	20	50	5	5 A			P _o =22W (f=900MHz, V _{CE} =18V, P _i =10W)									329			
" 2256	サンケン	"	Si.TMe	200	6	15A	150W (T _c =25°C)	150	100	200	60	4	5 A	12	-500												102	
" 2257	松下	"	Si.EP	180	5	50	1 W	150	1	100	170	5	10	10	-10												222	
" 2258	"	AF.RF	Si.TP	250	7	100	1 W	150	100	250	>40	20	40	10	-10												222	
" 2259	三菱	LN.Diff	Si.EP	100	5	50	200/unit	125	0.1	70	250-1200	6	1	6	-1	h _{FE1} /h _{FE2} =0.8-1.0				100*	1.8				274B	2素子複合		
" 2260	サンケン	PA	Si.TMe	160	6	8 A	80W (T _c =25°C)	150	100	100	>30	4	3 A	12	-500												102	2SA980 とコンプリ
" 2261	"	"	"	180	6	8 A	80W (T _c =25°C)	150	100	120	>30	4	3 A	12	-500												102	2SA981 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE}	h _{ie} h _{is} * (Ω)	h _{re} h _{rs} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{os} * (μΩ)	f _{αB} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ic(ac)} * (Ω)	
									(μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	V _{CE} (V)										I _E (mA)
2SC2262	サンケン	PA	Si.TMe	200	6	8 A	80W (T _c =25°C)	150	100	140	>30	4	3 A	12	-500				15*				102	2SA982 とコンプリ
" 2263	松下	RF	Si.EP	60	5	50	250	125	0.1	30	500	5	2	10	-1				70*	15	9.5k	138		
* " 2264	"	AF.PA	"	90	5	1 A	750	135	0.1	20	100~350	0.5	1 A	10	-50				200*	<20		165		
" 2265	日立	RF	Si.P	35	4	20	150	175	0.1	10	30~150	10	2	10	-2				550*	<0.6		50C		
" 2266	"	SW	Si.T	500	7	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	400	30	5	5 A									102		
" 2267	"	"	"	400	5	100	400	150	1	250	35~200	20	20	10	-10				70*	4		49C	2SA1024 とコンプリ	
" 2268																								
" 2269																								
" 2270	東芝	SW.PA	Si.E	50	8	5 A	10W (T _c =25°C)	150	0.1	40	140~450	2	500	2	-500				100*	40		342		
" 2271	三洋	RF	Si.TP	300	6	100	900	150	1	200	40~200	10	10	30	-10				>50*	<7.5		294		
" 2272	日電	RF.LN	Si.E	20	3	35	250 (T _c =90°C)	200	0.1	8	50~250	6	5	6	-5				10000*	C _{re} 0.2		320		
" 2273	"	"	"	25	3	65	400 (T _c =40°C)	200	0.1	8	50~250	8	7	8	-7				8500*	C _{re} 0.2		320		
" 2274	三洋	AF	Si.EP	60	5	500	600	150	1	40	60~320	5	50	10	-10				120*	5		138	2SA984 とコンプリ	
" 2275	日電	PA	Si.E	120	5	1.5A	25W (T _c =25°C)	150	1	120	150	5	300	5	-200				200*	19		268	2SA985 とコンプリ	
* " 2276	"	"	"	130	4.5	7 A	80W (T _c =25°C)	150	50	120	150	5	1 A	5	-1A				100*	150	15	295		
* " 2277	日立	RF	"	50	5	500	625	150	0.1	50	60~320	3	150	3	-10				120*	7		138D	2SA993 とコンプリ	
" 2278	"	"	Si.T	300	5	100	1.25W	150		I _{CE0} 1	V _{CE} 250	30~200	20	20	-20				80*	C _{re} 2		234C		
" 2279	東芝	RF.PA	"	300	5	100	10W (T _c =25°C)	150	0.1	300	30~150	10	20	10	-20				35*	3		177		
" 2280																								
" 2281	日電	RF.PA	Si.E	38	3	1.5A	17W (T _c =25°C)	175	500	30	60	10	400						P _o = 39.2dBm, η = 65% (V _{CE} = 13.5V, f = 175MHz, P _i = 26dBm)	C _{re} 12		129		
" 2282	"	"	"	38	3	3 A	34W (T _c =25°C)	175	1mA	30	60	10	800						P _o = 43dBm, η = 65% (V _{CE} = 13.5V, f = 175MHz, P _i = 3.4dBm)	C _{re} 25		43		
" 2283	"	"	"	38	3	750	10W (T _c =25°C)	175	250	30	60	10	200						P _o = 35.5dBm, η = 60% (V _{CE} = 12.6V, f = 500MHz, P _i = 25dBm)	C _{re} 6		326		
" 2284	"	"	"	38	3	1.5A	17W (T _c =25°C)	175	500	30	60	10	400						P _o = 39.5dBm, η = 65% (V _{CE} = 12.6V, f = 500MHz, P _i = 333m)	C _{re} 12		326		
" 2285	"	"	"	38	3	3 A	34W (T _c =25°C)	175	1mA	30	60	10	800						P _o = 42.3dBm, η = 60% (V _{CE} = 12.6V, f = 500MHz, P _i = 38dBm)	C _{re} 25		326		
" 2286	"	PA	"	38	3	750	10W (T _c =25°C)	200	250	30	60	10	200						P _o = 35dBm, η = 60% (V _{CE} = 13.5V, f = 175MHz, P _i = 18dBm)		6	326		
" 2287	"	RF.PA	"	38	3	1.5A	17W (T _c =25°C)	175	500	30	60	10	400						P _o = 39.5dBm, η = 65% (V _{CE} = 13.5V, f = 175MHz, P _i = 26dBm)	C _{re} 12		326		
" 2288	"	"	"	38	3	3 A	34W (T _c =25°C)	175	1mA	30	60	10	800						P _o = 43dBm, η = 65% (V _{CE} = 13.5V, f = 175MHz, P _i = 34dBm)	C _{re} 25		326		
" 2289	"	"	"	25	2.5	1.5A	17W (T _c =25°C)	175	500	20	60	7	400						P _o = 38.5dBm, η = 70% (V _{CE} = 7.8V, f = 175MHz, P _i = 28.5dBm)	C _{re} 12		326		
" 2290	東芝	PA	Si.EP	45	4	20A	175W (T _c =25°C)	175			10~150	5	10A						P _o = 60W (PEP) (f = 28MHz, V _{CE} = 12.5V, P _i = 2.5W)		<500	281		
" 2291	三菱	定電流回路 駆動負荷	"	100	5	100	200/unit	125	0.1	100	250~1200	6	1	6	-1				h _{FE1} /h _{FE2} = 0.8~1.25	100*	2.5	274C	2素子複合	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}			バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)			f _{αβ} f _T * (Mc)	C _{ob} C _{re} (pF)	r _{bb'} r _{bb'(real)} * (Ω)	
									(μA)	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CE(V)}	I _E (mA)										
2SC2292	新電元	SW	Si.T	500	7	8 A	80W (T _c =25°C)	150	100	500	20	2	4 A	10	-1 A	t _{on} <1μS, t _{off} <3μS	t _f <0.7μS	20*						102	T8M40F1
" 2293	"	"	"	500	7	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	500	20	2	5 A	10	-1 A	t _{on} <1μS, t _{off} <3μS	t _f <0.7μS	20*						102	T10M40F1
* " 2294	松下	RF	Si.EP	30	5	30	250	125	1	10	100	10	1	10	-1			200*	2	20			138		
" 2295	"	"	"	30	5	30	200	125	0.1	10	50-220	10	1	10	-1	NF=2.8dB (100MHz, 10V, 1mA)		>150*	C _{re} 0.9	Z _{rb} 22			176	2SA1022 とコンパリ	
" 2296																									
* " 2297	日立	PA	Si.E	55	4	8 A	25W (T _c =25°C)	150	0.1	45	100	10	2 A	10	-150	P _o >16W, (f=27MHz, η>60%, V _{CC} =12V, P _i =1W)		130*	140	0.4			268		
" 2298	"	RF	"	30	10	1 A	8 W (T _c =25°C)	150	10	30	>4000	3	400										160	ダーリントン	
* " 2299	富士通	"	Si.EP	20	5	1 A	500	150	0.5	15	200	5	10	5	-10			150*	10	15*			138		
" 2300	"	"	"	50	5	1 A	500	150	0.5	40	200	5	10	5	-10			150*	10	15*			138		
" 2301	日電	PA	Si.E	45	2	2.8A	46W (T _c =25°C)	200	2 mA	30	30	10	2 A			P _o =16W (f=800MHz, V _{CC} =18V, P _i =3.6W)								164	
" 2302	サンケン	SW	Si.T	500	10	7 A	40W (T _c =25°C)	150	100	500	15	4	5 A			t _{on} <1.3μS, t _{off} <3.5μS	t _f <1.2μS							100	
" 2303	"	"	"	500	10	7 A	40W (T _c =25°C)	150	100	500	15	4	5 A			t _{on} <1.3μS, t _{off} <3.5μS	t _f <1.2μS							102	
" 2304	"	"	"	500	10	12A	100W (T _c =25°C)	150	100	500	15	4	10A			t _{on} <1.3μS, t _{off} <3.5μS	t _f <1.2μS							102	
" 2305																									
" 2306	サンケン	SW	Si.TMe	450	6	15A	150W (T _c =25°C)	150	1mA	450	>10	4	5 A	12	-500	t _{on} =0.35μS, t _{off} =2.1μS	t _f =0.35μS	7*						102	
" 2307	"	"	Si.TP	500	10	12A	100W (T _c =25°C)	150	100	500	15	4	7 A			t _{on} <0.7μS, t _{off} <2.5μS	t _f <0.7μS							324	
" 2308	日立	AF	Si.E	55	5	100	200	125	0.5	18	100-320	12	2	12	-2			230*	1.8				138	2SA1030 とコンパリ	
" 2309	"	"	"	55	5	100	200	125	0.5	18	250-1200	12	2	12	-2			230*	1.8				138		
" 2310	"	LN	"	55	5	100	200	125	0.5	18	100-320	12	2	12	-2	NF=3 dB (6V, 0.1mA, 120Hz)		230*	1.8				138	2SA1032 とコンパリ	
" 2311	富士通	SW	Si.EP	50	5	1 A	1 W	150	0.5	40	55	1	500			t _{on} =45nS, t _{off} =90nS t _{sig} =70nS							328		
" 2312	三菱	PA	"	60	5	6 A	25W (T _c =25°C)	150	500	30	50	10	100			P _o =18.5W (V _{CC} =12V, f=27MHz, P _i =1.5W)							301B		
" 2313	"	"	"	40	4	10A	60W (T _c =25°C)	175	1mA	25	50	10	1 A			P _o =38W (f=63MHz, V _{CC} =12V, P _i =3.5W)							323		
" 2314	三洋	RF.PA	"	75	5	1 A	5 W (T _c =25°C)	150	1	40	60-320	5	500	10	-50	P _o =1.8W (f=27MHz, η>60%, V _{CC} =12V, P _i =35mW)		250*	15				296		
" 2315	サンケン	PA	Si.TMe	80	6	6 A	50W (T _c =25°C)	150	100	80	800	4	500	12	-500			30*	140	20			298		
" 2316	"	"	"	100	6	6 A	50W (T _c =25°C)	150	100	100	800	4	500	12	-500			30*	140	20			298		
" 2317	"	"	"	200	6	1 A	30W (T _c =25°C)	150	100	200	1000	4	200	12	-100			30*	45	45			298		
" 2318	東芝	"	Si.EP	40	3.5	350	3.5W (T _c =25°C)	175	1	30	30-180	5	100	10	-90	G _{ps} =16dB (10V, 90mA, 250MHz)		2700*	2.9				85B		
" 2319	"	"	"	40	3.5	350	5 W (T _c =25°C)	175	1	30	30-180	5	100	10	-90	G _{ps} =16dB (10V, 90mA, 250MHz)		2900*	3.5				270		
" 2320	三菱	AF	Si.E	50	6	200	300	125	0.1	50	90-800	6	1	6	-10	NF<15dB (6V, 0.1mA, 1kHz)		200*	3.5				138		
* " 2321	富士通	RF.AF	Si.EP	130	4.5	8 A	80W (T _c =25°C)	150	50	130	100	5	500	10	-1A			60*	250				102	2SA1001 とコンパリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス			h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)			f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} C _{re} (pF)	r _{bb'} r _{bb'(real)} * (Ω)
									μA	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}										
2SC2352	日電	Mix	Si.E	30	4	30	250	125	0.1	20	100	10	5	10	-5	G _{re} = 23dB (10V, 3mA, 200MHz)				850*	C _{re} 0.37		138C	
" 2353	"	"	"	30	3	50	200	125	0.1	15	100	10	5	10	-5	G _{re} = 12.5dB (10V, 5mA, 900MHz)				2300*	0.85		210A	
" 2354	サンケン	PA	Si.TMe	300	6	1A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	30	100	4	200	12	-100					10*	18	20	99	
" 2355																								
" 2356	富士通	SW.PA	Si.TMe	500	7	10A	100W (T _c =25°C)	175	100	500	20	5	5A			t _r = 1μS, t _f = 0.7μS t _{stg} = 1.6μS							102	
* " 2357	"	"	"	1000	6	10A	150W (T _c =25°C)	175	100	1000	15	5	5A			t _r = 1.5μS, t _f = 0.8μS t _{stg} = 2.5μS							102	
* " 2358	"	"	"	1000	6	10A	150W (T _c =25°C)	175	100	1000	15	5	5A			t _r = 1.5μS, t _f = 0.8μS t _{stg} = 2.5μS							102	
" 2359	"	"	"	450	5	4A	40W (T _c =25°C)	175	100	450	20	5	2A			t _r = 0.3μS, t _f = 0.45μS t _{stg} = 1.3μS							99	
" 2360	松下	RF	Si.P	30	3	20	200	135			>20	10	3	10	-3	G _{ps} = 16dB, NF = 4dB (f = 800MHz)				1100*			337A	
* " 2361	"	PA	Si.EP	70	6	4A	25W (T _c =25°C)	150	10	20	50~240	3	2.5A	10	-200					70*			268	
" 2362	三洋	AF.LN	"	120	5	50	400	125	1	80	160~960	6	1	6	-1	V _{NO} < 35mV (30V, 1mA, R _o = 56kΩ, A _v = 77dB)				130*	1.8		138 2SA1016 とコンプリ	
" 2363	"	AF	"	120	5	50	500	125	1	80	100~560	6	1	6	-1					130*	1.8		138 2SA1017 とコンプリ	
" 2364	サンケン	PA	Si.TMe	200	6	5A	80W (T _c =25°C)	150	100	200	1000	4	1A	12	-500					15*	130	20	324	
" 2365	"	"	"	600	6	6A	50W (T _c =25°C)	150	100	600	12	4	3A	12	-500					10*	55	3.5	102	
" 2366	富士通	SW.PA	"	500	7	40A	300W (T _c =25°C)	175	100	500	20	5	20A			t _r = 1μS, t _f = 1μS t _{stg} = 2μS							41	
" 2367	日電	RF.LN	Si.E	20	3	80	580	200	1	8	50~300	8	20	8	-20	S _{21c} ² = 9dB (8V, 20mA, 2GHz)				8000*	C _{re} 0.4		314	
" 2368	"	RF	"	30	3	50	250	150	0.1	15	40~200	10	10	10	-10	S _{21c} ² = 14.5dB (10V, 10mA, 500MHz)				2800*	0.7		210B	
" 2369	"	"	"	25	3	70	250	150	0.1	15	70	10	20	10	-20	G _{re} = 14dB, NF = 1.8dB (f = 1GHz, I _c = 5mA)				4500*	0.75		210B	
" 2370	東芝	PA	"	35	3.5	800	7.5W (T _c =25°C)	175	500	15	50	5	500			P _s = 4W (f = 470MHz, V _{cc} = 12.6V, P _i = 0.4W)							208	
" 2371	日電	RF	Si.T	300	7	100	10W (T _c =25°C)	150	0.1	200	40~250	10	10	30	-10					80*	C _{re} < 3		225	
" 2372																								
" 2373	日電	PA	Si.E	200	7	7.5A	40W (T _c =25°C)	150	10	150	35	5	5A	5	-100	t _f < 1μS				10*			268	
" 2374																								
" 2375	三洋	AF	Si.EP	150	5	50	900	150	1	80	100~560	6	1	6	-1					130*	1.8		294 2SA1019 とコンプリ	
" 2376	東芝	PA	Si.T	300	5	150	20W (T _c =25°C)	150	1	240	80	10	50	50	-20					50*	6	50	342	
" 2377	松下	RF	Si.EP	30	3	15	200	150	0.1	10	150	6	1	6	-1					650*	1.2	70	151	
" 2378	日電	AF	Si.E	70	5	100	250	125	0.1	70	200	6	1	6	-10	NF < 15dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				250*	3.5		138	
" 2379	東芝	PA	Si.EP	35	3.5	1.4A	15W (T _c =25°C)	175	1mA	15	80	5	1A			P _s > 6W, η > 60% (f = 470MHz, V _{cc} = 12.6V, P _i = 1W)				15			325	
" 2380	"	"	"	35	3.5	2.8A	30W (T _c =25°C)	175	1.5mA	15	>10	5	1.5A			P _s > 12W, η > 60% (f = 470MHz, V _{cc} = 12.6V, P _i = 3W)				28			325	
" 2381	"	"	"	35	3.5	6A	50W (T _c =25°C)	175	1mA	15	>10	5	3A			P _s > 25W, η > 60% (f = 470MHz, V _{cc} = 12.6V, P _i = 10W)				< 80			325	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)				電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)													外 形	備 考	
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値 (μA)	V _{CE(V)}	直流又はパルス h _{FE} V _{CE(V)} I _C (mA)	バイアス V _{CB(V)} I _E (mA)	h _{FE} h _{FB} *	h _{FE} h _{FB} *	h _{FE} h _{FB} *	h _{FE} h _{FB} *	f _{αB} f _T *	C _{ob} (pF)	r _{th} h _{FE} (real) (Ω)				
2SC2382	東芝	PA	Si.EP	40	4	12A	100W (T _c =25°C)	175	2mA	15	>10	5	10A					P _o >50W (f=175MHz, V _{CC} =12.5V, P _i =15W)		120		281	
" 2383	"	"	Si.E	160	6	1A	900	150	1	150	60~320	5	200	5	-200				>20*	<20	20	241	2SA1013 とコンプリ
" 2384	"	"	"	160	6	1A	10W (T _c =25°C)	150	1	150	60~320	5	200	5	-200				>20*	<20	20	249	2SA1014 とコンプリ
" 2385	三菱	AF.LN.RF	Si.EP	70	5	100	200	125	0.1	50	250~1200	6	1	6	-10		V _{NO} <300mV (10V, 1mA, R _c =100kΩ, A _v =80dB)		130*	11.5	12	138B	
" 2386	"	RF	"	70	5	300	500	125	0.1	70	600	6	1	6	-10				125*	12.5	10	138B	
* " 2387	日立	SW	Si.T	500	5	8A	100W (T _c =25°C)	150	100	400	>15	5	3A				t _{on} = 1 μS, t _f = 0.6 μS t _{on} = 1.5 μS					102	
" 2388	富士通	SW.PA	Si.TMe	450	5	4A	75W (T _c =25°C)	175	100	450	20	5	2A				t _i = 0.25 μS, t _f = 0.45 μS t _{is} = 1.3 μS					102	
" 2389	ローム	AF.LN	Si.EP	120	5	50	300	125	0.5	100	180~820	6	2	12	-2		V _{NO} <150mV (10V, 1mA, R _c =100kΩ, A _v =80dB)		140*	2.5		138	2SA1038 とコンプリ
" 2390	"	"	"	80	5	50	300	125	0.5	75	180~820	6	2	12	-2		V _{NO} <150mV (10V, 1mA, R _c =100kΩ, A _v =80dB)		140*	2.5		138	2SA1039 とコンプリ
" 2391	東芝	PA	"	35	3.5	800	7.5W (T _c =25°C)	175	1mA	15	>10	5	500				P _o > 3W, η > 50% (f=470MHz, V _{CC} =12.6V, P _i =0.4W)			<10		325	
" 2392	"	"	"	35	3.5	3.5A	30W (T _c =25°C)	175	1mA	15	>10	5	1A				P _o > 15W, η > 60% (f=470MHz, V _{CC} =12.6V, P _i =6W)			30		325	
" 2393	"	"	Si.E	80	4	4A	12.5W (T _c =25°C)	150	15	40	50	5	2A				P _o = 8W (f=28MHz, V _{CC} =12V, P _i =0.4W)					268	
" 2394	"	"	Si.EP	45	4	6A	20W (T _c =25°C)	150	100	35	20~100	5	1A				P _o = 16W, η > 60% (f=50MHz, V _{CC} =12V, P _i =3W)			110		268	
" 2395	"	"	"	40	4	5A	40W (T _c =25°C)	150			>20	5	1A	5	-1A		P _o = 10W (PEP) (f=28MHz, V _{CC} =12.5V, P _i <0.2W)		200*	<150		325	
" 2396	日立	AF	Si.E	60	5	100	400	125	0.1	50	250~1200	12	2	12	-2				90*	3		138	2SA1025 とコンプリ
* " 2397	"	PA	"	60	5	8A	25W (T _c =25°C)	150	1	45	100~200	10	2A	10	-100		P _o > 18W (f=27MHz, V _{CC} =12V, P _i =1W)		100	120		268	
" 2398	ソニー	PA.SW	Si.EPa	100	5	10A	95W (T _c =25°C)	120	10	50	>50	2	100	2	-1A				80*	240		102	2SA1028 とコンプリ
* " 2399	日立	RF	Si.EP	30	4	20	310	125	0.5	10	35~200	6	1	6	-5		G _p = 20dB, NF = 3.5dB (6V, 1mA, 100MHz)		940*	0.9	C _{crms} ' 12pS	138D	
" 2400	"	SW	"	40	5	100	310	125	0.25	20	100	1	10	10	-10		t _{on} < 10nS, t _{off} < 15nS t _{is} < 7nS		1200*	1.8		138D	
" 2401	"	RF.SW	Si.P	40	10	300	310	125	0.1	30	10000	5	10	5	-10		t _{on} < 150nS, t _{off} < 1500nS t _{is} < 800nS		200*	3.5	C _{crms} ' 12pS	138D	ゲ-リントン
" 2402	富士通	SW.PA	Si.TMe	300	7	15A	150W (T _c =25°C)	175	100	300	20	5	5A				t _r = 1 μS, t _f = 0.7 μS t _{is} = 1.6 μS					102	
" 2403	"	"	"	300	7	40A	300W (T _c =25°C)	175	100	300	20	5	20A				t _r = 1 μS, t _f = 1 μS t _{is} = 2 μS					41	
" 2404	松下	RF	Si.EP	30	3	15	100	125			>40	6	1	6	-1		G _p = 24dB, NF = 3.3dB (f=100MHz)		650*	C _{re} 0.8		176	
" 2405	"	AF.LN	"	35	5	50	200	125	0.1	10	180~1040	5	2				V _{NO} = 110mV (10V, 1mA, R _c =100kΩ, A _v =80dB)					176	
" 2406	"	"	"	55	5	50	200	125	0.1	10	180~1040	5	2				V _{NO} = 110mV (10V, 1mA, R _c =100kΩ, A _v =80dB)					176	
" 2407	日電	RF	Si.E	35	3	150	600	150	0.5	20	60	10	50				P _o = 160mW (f=500MHz, V _{CC} =12.6V, P _i =5mW)			1		138C	
" 2408	"	"	"	35	3	150	600	150	0.5	20	100	10	50	10	-50		S ₂₁ e ² = 21dB (10V, 50mA, 200MHz)		3500*	1.25		138C	
" 2409	ローム	AF	Si.EP	50	9	100	300	125	0.5	30	180~560	6	1	12	-2		NF = 0.5dB (1kHz, 6V, 30mA)		180*	2		138	
" 2410	"	RF.IF.Conv Mix.Osc	"	40	5	100	250	125	0.5	24	30~180	6	2	12	-2				230*	1.8		138	
" 2411	"	AF.Osc.SW	"	40	5	500	200	125	1	20	82~390	3	10	5	-20				250*	6		335	2SA1036 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CE} (V)	直流又はパルス hFE V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)			f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ib} (real)* (Ω)
2SC2412	ローム	AF, RF Osc, SW	Si, EP	50	5	100	200	125	0.5	30	120-560	6	1	12	-2				180*	2		335	2SA1037 とコンプリ
"	2413	"	RF, IF, Osc	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	300*	1.3		335	
"	2414	松下	SW	SiTMe	500	7	2A	70W (T _c =25°C)	150	100	500	>8	5	1A								102	
"	2415	"	"	"	500	7	7A	90W (T _c =25°C)	150	100	500	>8	5	3A								102	
"	2416	"	"	"	500	7	10A	120W (T _c =25°C)	150	100	500	>8	5	5A								102	
"	2417																						
"	2418																						
"	2419	東芝	PA	Si, E	65	4	1A	6W (T _c =25°C)	150	100	30	50	3	150								84B	
"	2420	"	"	Si, EP	40	4	6A	70W (T _c =25°C)	150	2mA	15	>10	5	5A							110	316	
"	2421	富士電機	"	Si, TP	200	7	5A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	200	700	4	1A	12	-500			30*	35	100*	102	
"	2422	"	"	"	150	7	5A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	150	700	4	1A	12	-500			40*	60	80*	102	
"	2423	"	"	"	200	7	5A	40W (T _c =25°C)	150	1mA	200	700	4	1A	12	-500			30*	35	100*	321	
"	2424	"	"	"	150	7	5A	40W (T _c =25°C)	150	1mA	150	700	4	1A	12	-500			40*	60	80*	321	
"	2425	富士通	AF, PA	"	300	5	300	1.5W	175	1	270	80	10	50					20*			268	
"	2426																						
"	2427	富士通	SW	Si, TP	500	7	7A	40W (T _c =25°C)	150	10	450	20	5	2A								268	
"	2428	"	SW, PA	Si, EP	180	5	12A	120W (T _c =25°C)	175	50	180	100	5	500	10	-1A				60*	200	102	
"	2429	"	SW	"	450	7	15A	150W (T _c =25°C)	175	100	450	15	5	10A								102	
"	2430	"	SW, PA	"	120	5	10A	100W (T _c =25°C)	175	50	120	100	5	1A	10	-1A			80*	200		102	2SA1040 とコンプリ
"	2431	"	"	"	120	5	15A	100W (T _c =25°C)	175	50	120	100	5	1.5A	10	-1A			80*	250		102	2SA1041 とコンプリ
"	2432	"	"	"	70	5	15A	100W (T _c =25°C)	175	50	70	100	5	1.5A	10	-1A			80*	250		102	2SA1042 とコンプリ
"	2433	"	"	"	120	5	30A	150W (T _c =25°C)	175	50	120	100	5	3A	10	-2A			80*	500		299	2SA1043 とコンプリ
"	2434	"	"	"	70	5	30A	150W (T _c =25°C)	175	50	70	100	5	3A	10	-2A			80*	500		299	2SA1044 とコンプリ
"	2435	"	"	"	100	5	10A	100W (T _c =25°C)	175	50	100	3000	3	2A								102	2SA1045 とコンプリ
"	2436	"	"	"	100	5	15A	100W (T _c =25°C)	175	50	100	3000	3	3A								102	2SA1046 とコンプリ
"	2437	富士電機	SW	Si, TP	450	7	7A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	450	>10	4	3A								102	
"	2438	"	"	"	150	7	7A	50W (T _c =25°C)	150	100	150	120	5	1A								268	
"	2439	"	"	"	150	7	7A	50W (T _c =25°C)	150	100	150	120	5	1A								268	
"	2440	"	"	"	450	7	5A	40W (T _c =25°C)	150	100	400	>15	5	2A								268	
"	2441	三洋	PA	Si, EP	180	5	80	1W	150	1	120	60-320	5	10	10	-10			150*	2.7		296	2SA1047 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)										外形	備考				
				V_{CB0} (V)	V_{E0} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	* I_{CB0} 最大値		直流又はパルス h_{FE}			バ イ ア ス		h_{je} h_{jb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{se} h_{sb}^* ($\times 10^{-4}$)			h_{oe} h_{ob}^* (μT)	f_{ab} f_{T^*} (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)
									μA	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_c(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$	h_{je}									
* 2SC2472	日立	RF.LN	Si.E	30	3	50	300	125	0.5	24	>20	10	5	10	-5					2200*	0.85	$C_{rbb'}$ 12pS	138C	
* "	"	RF	"	30	3	50	300	125	0.5	24	>20	10	5	10	-5					2200*	0.5	$C_{rbb'}$ 12pS	138C	
"	日電	SW	"	60	6	200	600	150	0.1	30	150	1	10										138D	
"	"	"	"	60	5	600	600	150	0.01	50	200	10	150										138D	
"	"	"	"	30		200	600	150	0.05	20	150	1	2										138D	
"	"	"	"	60	6	600	600	150	0.1	35	150	1	150										138D	
"	"	"	"																					
"	"	"	"																					
"	松下	RF.Osc.Mix	Si.EP	30	3	50	100	125			>25	10	2	10	-2					1200*	C_{re} 1		176	
"	東芝	PA	Si.E	150	6	1.5A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1	150	60-320	5	200	5	-200					>20*	13	20	342	2SA1021 とコンプリ
"	"	AF.RF	Si.T	300	7	100	900	150	1	240	30-150	10	20	10	-20					>50*	3		241	
"	"	PA	Si.E	160	6	1.5A	15W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1	150	100-320	5	200	5	-200					120*	<20	20	178	
"	松下	"	Si.TP	80	5	5A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	80	90	5	1A	5	-500					20*	100	10	152	
"	"	"	"	100	5	6A	70W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	100	90	5	1A	5	-500					20*	140	10	152	
"	"	"	"	120	5	7A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	120	90	5	1A	5	-500					20*	190	10	152	
* "	"	"	Si.EMe	150	5	6A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40-280	5	1A	10	-500					50*			102	2SA1063 とコンプリ
"	"	"	"	150	5	8A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40-280	5	1A	10	-500					50*			102	2SA1064 とコンプリ
"	"	"	"	150	5	10A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40-280	5	1A	10	-500					50*			102	2SA1065 とコンプリ
"	富士通	"	Si.EP	55	3.5	10A	90W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1.6mA	20	50	5	6A								48		168	
"	サンケン	PA.SW	Si.EMe	100	15	6A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	100	600	4	1A	12	-500					30*	200	15	298	
"	"	PA	Si.EP	120	5	10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	120	60	4	3A	12	-500					70*	100	60	102	
"	"	"	"	150	5	10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	150	60	4	3A	12	-500					70*	100	60	102	
"	日電	"	Si.E	25	2	750	8.75W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	100	20	60	7	100										326	
"	"	"	"	25	2	1.5A	17.5W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	100	20	60	7	200										326	
"	"	"	"	35	3	10A	88W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	2mA	20	60	10	1A										233	
"	松下	RF	Si.EP	70	5	2A	1.2W	150	10	20	120	5	1A	5	-500					150*	35	110	222	
"	東芝	"	Si.E	30	3	50	300	125	1	10	80	10	10	10	-10					3500*	1.15	40*	138C	
"	"	"	"	20	2	30	300	125	0.1	10	80	10	5	10	-10					4000*	0.9	45*	138C	
"	2500	SW.PA	"	30	6	2A	900	150	0.1	30	140-600	1	500	1	-500					150*	27		241	
"	新電元	SW	Si.T	500	7	3A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	500	20	2	1.5A	10	-300					20*			268	T3V40F1

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考		
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CE0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αB} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(REAL)} * (Ω)
									(μA)	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CE(V)}									
2SC2562	東芝	SW	Si.E	60	5	5 A	25W (T _c =25°C)	150	1	50	70~240	1	1 A	4	-1A	t _{on} =0.1μS, t _{off} =1μS	120*	80		268	2SA1012 とコンプリ		
" 2563	"	PA	"	120	5	8 A	80W (T _c =25°C)	150	50	120	120	5	1 A	10	-1A		90*	90	2*	179			
" 2564	"	"	"	140	5	12A	120W (T _c =25°C)	150	10	140	55~240	5	1 A	10	-1 A		90*	130	2*	125	2SA1094 とコンプリ		
" 2565	"	"	"	160	5	15A	150W (T _c =25°C)	150	10	160	55~240	5	1 A	10	-1 A		80*	200	2*	125	2SA1095 とコンプリ		
" 2566																							
* " 2567	松下	RF	Si.EP	35	5	50	100	125	0.1	10	350	5	2	5	-20		320*	3.5	45	293			
" 2568	日電	PA	Si.T	300	7	200	10W (T _c =25°C)	150	0.1	200	80	10	10	30	-10		80*	3.5	30	225			
" 2569	富士電機	SW	Si.TP	150	7	6 A	40W (T _c =25°C)	150	100	150	80	4	2 A			t _{on} <1μS, t _{off} <2μS				321			
" 2570	日電	RF	Si.E	25	3	70	250	150	0.1	15	40~200	10	20	10	-20		5000*	C _{re} 0.7		138C			
" 2571																							
" 2572	日電	SW	Si.E	60	8	200	360	200	0.1	40	200	1	10	10	-10	t _{on} <80nS, t _{off} <420nS t _{tr} <320nS	300*	3.5		49C			
" 2573																							
" 2574																							
" 2575	三菱	AF.RF	Si.E	50	6	200	300	125	0.1	50	90~800	6	1	6	-10	N _F <15dB (f=1kHz, 6V, 0.1mA)	200*	3.5		138B			
" 2576																							
" 2577	サンケン	PA	Si.TMe	120	6	6 A	60W (T _c =25°C)	150	100	120	80	4	2 A	12'	-500		20*	110	12	324			
" 2578	"	"	"	140	6	7 A	70W (T _c =25°C)	150	100	140	80	4	3 A	12	-500		20*	150	8	324			
" 2579	"	"	"	160	6	8 A	80W (T _c =25°C)	150	100	160	80	4	3 A	12	-500		20*	200	10	324			
" 2580	"	"	"	180	6	9 A	90W (T _c =25°C)	150	100	180	80	4	3 A	12	-500		20*	250	7	324			
" 2581	"	"	"	200	6	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	200	80	4	3 A	12	-500		20*	250	10	324			
" 2582	松下	RF	Si.EP	45	5	1 A	1.2W	150	0.1	20	160	10	500	10	-50		200*	12	15	236			
" 2583																							
" 2584	日電	PA	Si.E	38	3	4 A	40W (T _c =25°C)	200	1.5mA	30	60	10	800			P _o =22W (f=175MHz, V _{CC} =13.5V, P _i =2.5W)				327			
" 2585																							
" 2586	日電	PA	Si.E	35	3	400	7 W (T _c =25°C)	200	100	20	60	10	100			P _o =1.6W (f=500MHz, V _{CC} =12.6V, P _i =0.2W)				84B			
* " 2587	"	"	"	150	5	10A	120W (T _c =25°C)	150	50	130	150	5	1 A	5	--200		70*	150	15	340			
* " 2588	"	"	Si.T	130	5	12A	120W (T _c =25°C)	150	50	120	150	5	2 A	5	-1A		60*	170	15	340			
* " 2589	"	"	Si.E	180	5	10A	200W (T _c =25°C)	150	50	160	90	5	2 A	5	-1A		60*	300	15	102			
" 2590	松下	"	Si.EP	120	5	500	5 W	150			65~330	10	150	10	-50		250*			222	2SA1110 とコンプリ		
" 2591	"	"	"	150	5	1 A	20W (T _c =25°C)	150			65~330	10	150	10	-50		250*			268	2SA1111 とコンプリ		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie'(real)} * (Ω)	
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
2SC2682	日電	PA	Si.E	180	5	100	8W (T _c =25°C)	150	1	180	200	5	10	10	-20				160*	3.5	33*	225		
" 2683																								
" 2684																								
" 2685																								
" 2686																								
" 2687	日電	PA	Si.T	300	5	200	1W	150	0.1	200	120	10	10	30	-10				80	2.5	25	278		
" 2688	"	RF.PA	"	300	5	200	10W (T _c =25°C)	150	0.1	200	40~250	10	10	30	-10				80*	C _{re} <3		225		
" 2689	"	PA	"	300	5	200	10W (T _c =25°C)	150	0.1	200	100	10	10	30	-10				80*	3	30	167		
" 2690	"	"	Si.E	120	5	1.2A	20W (T _c =25°C)	150	50	110	150	5	300	5	-200				160*	19	15	225		
" 2691																								
" 2692																								
" 2693	東芝	PA	Si.E	70	4	5A	40W (T _c =25°C)	150	1mA	40	50	5	1A						P _o = 12W (PEP) (f=28MHz, V _{cc} =12.5V, P _i =0.2W(PEP))			325		
" 2694	三菱	"	Si.EP	35	4	20A	140W (T _c =25°C)	175	5mA	15	50	10	1A						P _o = 75W, η=70% (f=175MHz, V _{cc} =12.5V, P _i =15W)			303	各リード・ ソケット間 絶縁	
" 2695	"	RF.PA	"	35	4	10A	75W (T _c =25°C)	175	2mA	15	50	10	1A						P _o = 32W, η=60% (f=520MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =9W)			272		
" 2696																								
" 2697																								
" 2698																								
" 2699																								
" 2700	富士通	PA	Si.EP	45	3.5	1A	12W (T _c =25°C)	175	200	20	50	5	500								9	20	159	
" 2701	"	"	"	35	3.5	300	3.5W (T _c =25°C)	175	500	24	50	10	100								< 3	50	183A	
" 2702	"	"	"	35	3.5	500	6W (T _c =25°C)	175	500	24	50	10	100								< 4	70	183A	
" 2703	東芝	RF	Si.E	30	5	1A	900	150	0.1	30	200	2	100	2	-100				150*	13	20	241		
" 2704	"	"	"	150	5	50	10W (T _c =25°C)	150	0.1	150	150	5	10	10	-10				200*	1.8	50	342		
" 2705	"	"	"	150	5	50	800	150	0.1	150	160	5	10	10	-10				200*	1.8	70	241		
" 2706	"	PA	"	140	5	10A	100W (T _c =25°C)	150	50	140	120	5	1A	10	-1A				90*	130	2*	179		
" 2707	"	"	"	180	5	15A	150W (T _c =25°C)	150	50	160	120	5	1A	10	-1A				80*	200	2*	102		
" 2708																								
" 2709																								
" 2710	東芝	AF	Si.E	35	5	800	300	125	0.1	30	100~320	1	100	5	-10				120*	13		287	2SA1150 とコンプリ	
" 2711	"	PA	"	35	3.5	800	7.5W (T _c =25°C)	175	500	15	50	5	500						P _o = 6W (f=175MHz, V _{cc} =12.5V, P _i =0.4W)			208		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)	直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe}	h_{ie}	h_{ib}^*	h_{re}	h_{ob}^*	h_{oe}		
				V_{CE}	I_B	P_D	I_{CBO}	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$	h_{fe}	h_{ie} (Ω)	h_{ib}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{re} ($\times 10^{-4}$)	h_{ob}^* (μS)	f_{ab} f_{T^*} (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{i\omega' \text{real}}^*$ (Ω)		
2SC2712	東芝	RF. AF	Si. E	60	5	150	150	125	0.1	60	350	6	2	10	-1		150*	2	50	176	
" 2713	"	"	"	120	5	100	150	125	0.1	120	350	6	2	10	-1	$NF=1\text{ dB}$ (6V, 0.1mA, 100Hz)	100*	3	18	176	
" 2714	"	RF	"	40	4	20	100	125	0.5	40	100	6	1	6	-1		550*	1	$C_{rbb'}$ 15pS	176	
" 2715	"	"	"	35	4	50	150	125	0.1	35	100	12	2	10	-1		150*	2	$C_{rbb'}$ 30pS	176	
" 2716	"	"	"	35	4	100	150	125	0.1	35	100	12	2	10	-1		120*	2.5	$C_{rbb'}$ 20pS	176	
" 2717	"	"	Si. EP	30	4	50	300	125	0.1	30	40~240	12.5	12.5	12.5	-12.5	$G_{re}=28-36\text{dB}$ ($V_{CE}=12.5\text{V}$, $I_C=12.5\text{mA}$, $f=45\text{MHz}$)	>300*	0.8~2.0	$C_{rbb'}$ <25pS	138C	
" 2718	日電	AF	Si. E	60	5	100	250	125	0.1	60	200	6	1	6	-10	$NF<15\text{dB}$ (6V, 0.1mA, $f=1\text{kHz}$)	250*	3		138	
" 2719	"	RF. SW	"	80	5	300	600	150	0.1	80	200	1	50	6	-10	$t_{on}=50\text{nS}$, $t_{off}=560\text{nS}$ $t_{str}=480\text{nS}$	140*	7		138	
" 2720	"	"	"	60	5	500	600	150	0.1	40	150	1	150	10	-20	$t_{on}<35\text{nS}$, $t_{off}<275\text{nS}$ $t_{str}<225\text{nS}$	400*	3.5		138D	
" 2721	"	"	"	60	5	700	1W	150	0.1	60	200	1	100	6	-10	$t_{on}=60\text{nS}$, $t_{off}=650\text{nS}$ $t_{str}=600\text{nS}$	110*	13		278	
" 2722	サンケン	PA	Si. TMe	100	6	15A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	100	80	4	5A	12	-500		20*	270	7	256	
" 2723	"	SW	"	450	6	15A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	450	20	4	5A	12	-1A		30*	260	4.6	324	
" 2724	三菱	RF	Si. E	30	4	30	200	125	1	25	35~180	6	1	6	-1	$NF=3\text{ dB}$ (6V, 1mA, 10.7MHz)	200*	2	$C_{rbb'}$ 20pS	175	
" 2725	"	Diff.	"	100	5	100	200/unit	125	0.1	100	600	6	1	6	-1	$h_{FE1}/h_{FE2}=0.8-1.0$ $dV_{BE}<10\text{mV}$	100*	2.5		283	
" 2726	日立	RF	"	15	3	20	200	125	1	12	100	4	2	4	-2	$G_{re}=16\text{dB}$, $NF=4\text{ dB}$ (6V, 2mA, 900MHz)	1100*	0.5	$C_{rbb'}$ 8pS	240A	
" 2727	"	RF. LN	"	15	3	20	200	125	1	12	110	4	2	4	-2	$G_{re}=21\text{dB}$, $NF=2.3\text{dB}$ (6V, 2mA, 200MHz)	1000*	C_{re} 0.8	$C_{rbb'}$ 10pS	240C	
" 2728	"	Conv.	"	15	3	50	200	125	1	12	100	4	5	4	-5	$G_{re}=14\text{dB}$, $NF=6\text{ dB}$ (6V, 5mA, 900MHz)	2500*	1	$C_{rbb'}$ 12pS	240A	
" 2729	"	"	"	15	3	50	200	125	1	12	80	4	5	4	-5	$G_{re}=21\text{dB}$, $NF=4\text{ dB}$ (6V, 2mA, 200MHz)	1300*	0.8	$C_{rbb'}$ 10pS	240C	
" 2730	"	Osc.	"	15	3	50	200	125	1	12	110	4	5	4	-5	$V_{ce}=32\text{mV}$ (6V, 6mA, 930MHz)	1600*	0.96	$C_{rbb'}$ 15pS	240B	
" 2731	"	Conv.	"	20	3	50	200	125	1	16	80	10	5	10	-5	$G_{re}=17\text{dB}$, $NF=9.5\text{dB}$ (10V, 3mA, 900MHz)	3500*	1	$C_{rbb'}$ 9pS	240A	
" 2732	"	"	"	30	4	20	150	125	1	10	60	10	3	10	-3	$G_{re}=14\text{dB}$, $NF=4\text{ dB}$ (12V, 2mA, 900MHz)	1000*	0.5	$C_{rbb'}$ 6pS	176	
" 2733	"	"	"	30	3	50	150	125	1	10	120	10	10	10	-10	$G_{re}=20\text{dB}$, $NF=4\text{ dB}$ (12V, 2mA, 200MHz)	1000*	0.8	$C_{rbb'}$ 12pS	176	
" 2734	"	"	"	20	3	50	150	125	1	10	90	10	10	10	-10	$G_{re}=15\text{dB}$, $NF=9\text{ dB}$ (12V, 2mA, 900MHz)	3500*	0.9	$C_{rbb'}$ 10pS	176	
" 2735	"	Osc.	"	30	3	50	150	125	1	10	100	10	10	10	-10	$V_{ce}=500\text{mV}$ (12V, 6mA, 300MHz)	1000*	0.9	$C_{rbb'}$ 10pS	176	
" 2736	"	Conv.	"	30	3	50	150	125	1	15	80	10	5	10	-5	$G_{re}=12\text{dB}$, $NF=6\text{ dB}$ (12V, 2mA, 900MHz)	2200*	0.6	$C_{rbb'}$ 11pS	176	
" 2737	日電	LN	"	20	3	80	600	150	1	10	80	8	20	8	-20	$1S_{21}^2=11\text{dB}$, $NF=1.2\text{dB}$ (1GHz, 1GHz, 5mA)	8000*	C_{re} 0.65		138C	
" 2738	松下	SW	Si. TMe	500	7	2A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	500	>8	5	1A			$t_{on}<1\mu\text{S}$, $t_f<1\mu\text{S}$ $t_{str}<2.5\mu\text{S}$				268	
" 2739	"	"	"	500	7	7A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	500	>8	5	3A			$t_{on}<1\mu\text{S}$, $t_f<1\mu\text{S}$ $t_{str}<2.5\mu\text{S}$				268	
" 2740	"	"	"	500	7	10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	500	>8	5	5A			$t_{on}<1\mu\text{S}$, $t_f<1\mu\text{S}$ $t_{str}<2.5\mu\text{S}$				152	
" 2741	富士通	PA	Si. EP	36	3.5	1A	7W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	12	50	2	500	12	-100	$P_o=2.5\text{W}$ ($f=175\text{MHz}$, $V_{ce}=12.5\text{V}$, $P_i=50\text{mW}$)	2000*	5	7*	169	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電気的特性 (T _a = 25°C)										外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{E0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB(V)}	直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie}	h _{re}	h _{oe}			f _{ab}	C _{ob}
										V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}	h _{fe} *	h _{ie} * (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} * (μY)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(real)*} (Ω)		
2SC2802	日電	PA	Si. T	300	5	200	10W (T _c =25°C)	150	0.1	200	40~250	10	10	30	-10				80*	< 3		185
" 2803	松下	RF	Si. EP	150	5	1 A	20W (T _c =25°C)	150	5	100	160	10	150	10	-50				200*	20	100	222
" 2804	東芝	"	Si. P	25	3	20	200	125	0.1	10	100	10	2	10	-2				900*	0.85	C _e r _{bb'} 4 pS	347A
" 2805	"	"	Si. E	30	3	50	200	125	0.1	15	100	3	8	10	-8				1000*	1	C _e r _{bb'} 6 pS	347B
" 2806	"	"	"	30	3	50	200	125	0.1	15	100	3	8	10	-8				900*	1	C _e r _{bb'} 6 pS	347B
" 2807																						
" 2808	ローム	RF. AF	Si. EP	160	5	50	500	125	0.5	120	390	6	2	12	-2				140*	3	C _e r _{bb'} 120pS	138
" 2809	サンケン	PA	Si. TMe	300	6	2 A	50W (T _c =25°C)	150	1 mA	300	80	4	300	10	-100				20*	45	14	324
" 2810	"	SW	Si. TP	500	10	7 A	50W (T _c =25°C)	150	100	500	15	4	3 A			t _{on} < 0.7 μS, t _{off} < 0.7 μS t _{stg} < 2.5 μS					298	
" 2811	日電	Osc.	Si. E	45	4	1 A	17.5W (T _c =25°C)	200	150	30	60	10	500	10	-300	P _{base} = 1.4W (f = 950MHz × 2, V _{cc} = 18V, I _c = 350mA)		1200*	C _{re} 6.5		157	
" 2812	三洋	RF	Si. EP	55	5	150	200	125	0.1	35	400	6	1	6	-1				100*	3	C _e r _{bb'} 250pS	176
" 2813	"	"	"	25	3	30	150	125	0.1	10	150	6	1	6	-4				600*	1.1	C _e r _{bb'} 18pS	176
" 2814	"	"	"	30	5	30	150	125	0.1	10	150	6	1	6	-1				320*	1.5	C _e r _{bb'} 12pS	176
" 2815	日立	SW	Si. T	300	7	5 A	40W (T _c =25°C)	150	20	250	40	5	2.5A			t _{on} < 0.5 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 1.5 μS					268	
" 2816	"	"	"	500	7	5 A	40W (T _c =25°C)	150	50	400	20	5	2.5A			t _{on} < 0.5 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 1.5 μS					268	
" 2817	"	"	"	300	7	10A	80W (T _c =25°C)	150	20	250	40	5	5 A			t _{on} < 0.5 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 2 μS					332	
" 2818	"	"	"	500	7	10A	100W (T _c =25°C)	150	50	400	20	5	5 A			t _{on} < 0.5 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 1.5 μS					332	
" 2819	"	"	"	500	7	15A	100W (T _c =25°C)	150	50	400	20	5	7.5A			t _{on} < 0.5 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 1.5 μS					102	
" 2820	"	"	"	400	7	20A	125W (T _c =25°C)	150	50	400	20	5	10A			t _{on} < 1 μS, t _{off} < 1 μS t _{stg} < 2.5 μS					102	
" 2821	"	RF. AF	Si. E	20	6	50	150	125	1	6	500	1	10	12	-2				200*	1.8	100	176
" 2822	日電	SW	"	75	6	800	360	200	0.01	60	200	10	150	20	-20	t _{on} < 35nS, t _{off} < 300nS t _{stg} < 290nS		350*	4		49C	
" 2823	東芝	PA	"	120	5	7 A	70W (T _c =25°C)	150	50	120	15000	5	1 A	5	-1A				60*	90	10	203
" 2824	"	RF	"	120	5	1 A	15W (T _c =25°C)	150	0.1	120	150	5	100	5	-100				120*	15	3*	342
" 2825	サンケン	PA	Si. TMe	80	6	6 A	70W (T _c =25°C)	150	100	80	800	4	1 A	10	-500				35*	140	25	324
" 2826	新電元	SW	Si. T	500	7	3 A	40W (T _c =25°C)	150	100	500	13	2	1.5A			t _{on} < 1 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 2 μS					268	
" 2827	"	"	"	500	7	6 A	50W (T _c =25°C)	150	100	500	13	2	3 A			t _{on} < 1 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 2 μS					268	
" 2828	"	"	"	500	7	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	500	13	2	5 A			t _{on} < 1 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 2 μS					197	
" 2829	"	"	"	500	7	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	500	13	2	3 A			t _{on} < 1 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 2 μS					102	
" 2830	"	"	"	500	7	20A	200W (T _c =25°C)	150	100	500	13	2	10A			t _{on} < 1 μS, t _{off} < 0.5 μS t _{stg} < 2 μS					202	
" 2831	松下	"	"	800	8	1.5A	25W (T _c =25°C)	150	100	800	> 8	5	1 A			t _{on} < 1 μS, t _{off} < 1 μS t _{stg} < 3 μS					268	

ターリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考					
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_J ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値 (μA)	$V_{CB(V)}$	直流又はバルス h_{FE} $V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	バイアス $V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$	h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	f_{ab} f_{T^*} (Mc)			C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(\text{real})}^*$ (Ω)			
2SC2892	日電	PA	Si. E	55	3	750	13W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	250	30	60	10	200											129		
" 2893	"	"	"	55	3	1.5A	22W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	500	30	60	10	400											129		
" 2894	"	"	"	55	3	3A	44W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	1 mA	30	60	10	800											43		
" 2895	"	"	"	55	3	6A	83W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	2 mA	30	60	10	1.5A											233		
" 2896	"	"	"	55	3	12A	140W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	4 mA	30	60	10	2 A											233		
" 2897	"	"	"	55	3	15A	175W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	6 mA	30	60	10	3 A											233		
" 2898	日立	SW	Si. T	500	7	8 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	400	20	5	4 A											268		
" 2899	"	"	"	500	7	500	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	20	400	20	5	250											160		
" 2900	サンケン	PA	Si. TMe	350	6	4 A	90W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	350	70	5	1 A	12	-100							10 *	140	10	324	
" 2901	日電	SW	Si. E	40	5	200	600	150	0.1	20	90	1	10	10	-10							750 *	1.8		138D	
" 2902	オリジ	"	Si. T	800	8	15A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	800	15	5	7.5A												102	
" 2903	"	"	"	800	8	25A	200W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	800	15	3	10A												102	
" 2904	三菱	PA	Si. EP	50	5	22A	200W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	5 mA	15	50	10	1 A												303	
" 2905	"	"	"	35	4	15A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	2 mA	15	50	10	1 A												303	
" 2906	日電	"	Si. E	25	2	2.2A	22W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	300	20	60	7	300												326	
" 2907	富士電機	SW	Si. TP	400	7	5 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	400	150	5	1 A												268	
" 2908	日電	"	Si. E	200	12	5 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	100	160	5	300												162	
" 2909	三洋	RF. AF	Si. EP	180	5	70	600	150	0.1	80	200	5	10	10	-10							150 *	2	$C_{rbb'}$ 40pF	138	
" 2910	"	AF. SW	"	180	5	70	900	150	0.1	80	100-400	5	10	10	-10							150 *	2		294	
" 2911	"	"	"	180	5	140	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	0.1	80	100-400	5	10	10	-10							150 *	3		296	
" 2912	"	"	"	200	5	140	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	0.1	160	100-400	5	10	10	-10							150 *	3		296	
" 2913	東芝	SW	Si. T	500	7	8 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	400	22	5	3 A												134	
" 2914	"	"	"	500	7	10A	120W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	400	20	5	5 A												102	
" 2915	日電	PA	Si. E	35	3	20A	175W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	4 mA	20	60	10	2 A												368	
" 2916																										
" 2917	日電	PA	Si. E	35	3	20A	175W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	4 mA	20	80	10	2 A													368
" 2918	"	"	"	35	3	5 A	63W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	1 mA	20	50	10	500												327	
" 2919																										
" 2920	富士通	SW	Si. EP	450	7	15A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	450	15	2	10A													102
" 2921	サンケン	PA	"	160	5	15A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	160	80	4	5 A	12	-2A							60 *	200	15	256	

2SA1208
とコンプリ

2SA1209
とコンプリ

2SA1210
とコンプリ

2SA1215
とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考							
				V _{CEO}	V _{CEO}	I _C	P _C	T _J	I _{CEO} 最大値		直流又はパルス hFE				バイアス			h _{je}	h _{ie}			h _{re}	h _{oe}	f _β	C _{ob}	r _{bb'}	h _{ie} (real)*	
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fb} *	h _{ib} * (Ω)	h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{ob} * (μY)	(Mc)			(pF)	(Ω)					
2SC2922	サンケン	PA	Si.EP	180	5	17A	200W (T _e =25°C)	150	100	180	70	4	8A	12	-2A					50*	250	10	256	2SA1216 とコンパリ				
" 2923	松下	RF	Si.TP	300	7	100	1.5W	150	1	200	120	50	5	30	-20					140*	2.4	40	161					
" 2924	"	"	"	300	7	100	10W (T _e =25°C)	150	1	300	120	50	5	30	-20					150*	2.4	45	361					
" 2925	"	"	Si.EP	60	15	700	750	150	1	20	1000	10	150	10	-50					250*	11	35	138					
" 2926	ローム	"	"	30	4	50	300	125	0.5	20	120	10	5	5	-10					1100	1.2	C _e r _{bb'} 10pS	138					
" 2927	日立	"	Si.T	300	5	200	10W (T _e =25°C)	150	0.1	250	120	10	50	20	-30					80*	4	20*	234					
" 2928	"	SW	"	1500	7	5A	80W (T _e =25°C)	150	100	1200	20	5	500			t _{on} < 1 μS, t _f < 1 μS								102				
" 2929	富士電機	"	Si.TP	450	7	3A	40W (T _e =25°C)	150	100	450	20	5	500			t _{on} < 1.5 μS, t _f < 0.8 μS									268			
" 2930	"	"	"	500	10	30A	200W (T _e =25°C)	150	1 mA	500	20	5	10A			t _{on} < 1 μS, t _f < 1 μS									172			
" 2931	三菱	PA	Si.EP	35	3	600	10W (T _e =25°C)	175	1 mA	15	30	10	100			P _o = 1.7W (V _{CC} = 12.5V, f = 900MHz, P _i = 0.3W)										272		
" 2932	"	"	"	35	3	2A	20W (T _e =25°C)	175	2 mA	15	30	10	100			P _o = 7W (V _{CC} = 12.5V, f = 900MHz, P _i = 1W)										272		
" 2933	"	"	"	35	3	4A	40W (T _e =25°C)	175	2 mA	15	30	10	200			P _o = 16W (V _{CC} = 12.5V, f = 900MHz, P _i = 3W)										272		
" 2934	日立	RF	Si.T	300	5	200	12.5W (T _e =25°C)	150	0.1	250	120	10	50	20	-30					80*	4	20*	160					
★ " 2935	"	"	"	300	5	200	15W (T _e =25°C)	150	0.1	250	100	10	50	20	-30					80*	6	20*	160					
" 2936	"	SW	"	500	10	30A	150W (T _e =25°C)	150	200	400	20	5	15A			t _{on} < 1 μS, t _f < 1 μS										349		
" 2937	新電元	"	"	500	7	8A	80W (T _e =25°C)	150	100	500	20	2	4A	10	-1A	t _{on} < 1 μS, t _f < 0.7 μS				20*						119	T8W40F1	
" 2938	"	"	"	500	7	10A	100W (T _e =25°C)	150	100	500	20	2	5A	10	-1A	t _{on} < 1 μS, t _f < 0.7 μS				20*						119	T10W40F1	
" 2939	"	"	"	500	7	10A	100W (T _e =25°C)	150	100	500	13	2	5A			t _{on} < 1 μS, t _f < 0.5 μS										119		
" 2940	"	"	Si.TP	230	7	30A	300W (T _e =25°C)	150	100	230	20	0.5	30A			t _{on} < 0.9 μS, t _f < 0.4 μS											266	
" 2941	日電	PA	Si.T	25	1.5	220	5.5W (T _e =25°C)	200	0.5	15	20-200	8	100	8	-100	P _o = 25dBm (12V, 120mA, 7.5GHz)				6000*	1					311		
" 2942	サンケン	SW	Si.TMe	230	7	50A	200W (T _e =25°C)	150	100	230	25	0.5	30A			t _{on} < 1.2 μS, t _{off} < 2 μS											230	
" 2943	ソニー	"	Si.EP	390	5.5	15A	80W (T _e =25°C)	120	100	350	40	2	1A	3	-1A	t _{on} < 50 μS, t _{off} < 1.25 μS				70*	160					350		
" 2944	富士電機	SW	Si.TP	250	7	15A	100W (T _e =25°C)	150	100	250	40	5	2A			t _{on} < 0.8 μS, t _f < 0.4 μS											220	
" 2945	"	"	"																									
" 2946	日電	SW	Si.E	330	7	2A	15W (T _e =25°C)	150	10	250	60	5	100			t _{on} < 1 μS, t _f < 1 μS											186	
" 2947	"	AF	"	60	5	100	250	150	0.0	60	200	6	1	6	-10	NF < 15dB (6V, 0.1mA, 1kHz)				250*	3					42	2SA1219 とコンパリ	
★ " 2948	日立	SW	Si.T	500	10	50A	300W (T _e =25°C)	150	200	400	20	5	25A			t _{on} < 1 μS, t _f < 1 μS											351	
" 2949	日電	PA	Si.E	25	1.5	110	2.75W (T _e =25°C)	200	0.25	15	20-200	8	50	8	-50	P _o = 21.5dBm (12V, 80mA, 7.5GHz)				6500*	0.65					311	NE243187	
" 2950	"	"	"	25	1.5	220	5.5W (T _e =25°C)	200	0.5	15	20-200	8	100	8	-100	P _o = 25dBm (12V, 120mA, 7.5GHz)				6000*	1					311	NE243287	
" 2951	"	"	"	25	1.5	440	9.7W (T _e =25°C)	200	1	15	20-200	8	200	8	-200	P _o = 28dBm (12V, 200mA, 7.5GHz)				5500*	2.9					367	NE243499	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _e = 25°C)											外形	備考			
				V _{CBO} (V)	V _{EO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値		直 流 又 は バ ル ス h _{FE}			バ イ ア ス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{ra} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)			f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(test)} * (Ω)
									(μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)									
2SC2982	東芝	RF	Si.E	30	6	2 A	500	150	0.1	30	370	1	500	1	-500					250*	26	10	212	
" 2983	"	"	"	160	5	1.5A	20W (T _e =25°C)	150	1	120	120	5	100	10	-100					100*	25	4*	344	
" 2984	日電	PA	"	45	3	6 A	70W (T _e =25°C)	200	4.5mA	30	50	10	4.5A								270		352	
" 2985	"	"	"	45	3	2 A	30W (T _e =25°C)	200	1 mA	18	60	10	500								11		184	
" 2986	東芝	"	"	40		50	300	125	0.1	40	140	6	1	6	-1					350*	1.6	15	138	
" 2987	日電	"	Si.T	140	5	12A	120W (T _e =25°C)	150	50	120	130	5	2 A	5	-1A					60*	150	15	162	
" 2988	松下	"	Si.EP	36	3	500	5 W (T _e =25°C)	150	10	20	50	13.5	200	10	-100					1000*	6	26*	222	
" 2989	"	"	"	36	4	1 A	15W (T _e =25°C)	150	100	20	80	13.5	400	10	-300					600*	25	9.5*	268C	
" 2990																								
" 2991	松下	PA	Si.EP	36	3	600	10W (T _e =25°C)	150	10	20	50	13.5	200	10	-100					2500*	4	18*	353	
" 2992	"	"	"	36	3	1.5A	20W (T _e =25°C)	150	50	20	50	13.5	400	10	-200					2000*	25	17*	353	
" 2993																								
" 2994																								
" 2995	東芝	RF	Si.E	40		50	200	125	0.1	40	140	6	1	6	-1					350*	1.6	15	287	
" 2996	"	"	"	40		50	150	125	0.1	40	140	6	1	6	-1					350*	1.6	15	176	
" 2997	日電	"	"	20	1.5	80	350	200	1	8	100	8	20	8	-20					8000*	0.4		320	
" 2998	三洋	SW	Si.EP	60	5	150	400	150	0.1	40	240	6	1										138	
" 2999	"	RF	"	25	3	30	150	125	0.1	10	100	6	1	6	-4					750*	1.5	C _{e, rbb'} 15pS	92	
" 3000	"	"	"	30	5	30	250	125	0.1	10	200	6	1	6	-1					320*	1.5	C _{e, rbb'} 15pS	138	
" 3001	三菱	PA	"	20	3.5	3 A	20W (T _e =25°C)	175	500	10	50	5	100										272	
" 3002																								
" 3003																								
" 3004	日立	SW	Si.E	30	7	3 A	10W (T _e =25°C)	150	20	24	10000	3	1.5A										160	ダーリントン
" 3005	"	Osc	"	15	3	50	150	125	0.3	12	200	4	5	4	-5					1600*	0.8	C _{e, rbb'} 10pS	176	
" 3006	東芝	PA	"	35	3.5	1 A	10W (T _e =25°C)	175	1 mA	15	50	5	500										279	
" 3007	"	RF.AF	"	50	5	2 A	8 W (T _e =25°C)	175	1	50	130	2	500	2	-500					100*	30	7*	84B	
" 3008	日電	PA	"	35	3	10A	70W (T _e =25°C)	200	2 mA	20	60	10	1 A								60		326	
" 3009	"	"	"	25	2	1.5A	17.5W (T _e =25°C)	200	200	20	60	7	200								8		326	
" 3010	"	"	"	25	2	3 A	35W (T _e =25°C)	200	400	20	60	7	400								16		326	
" 3011	東芝	RF	"	20	3	30	150	125	1	10	120	5	10	5	-10					6500*	0.7	66*	176	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB(V)}	直流又はパルス h _{FE} V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}	h _{FE}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)			f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} r _{bb'} (Ω)	
2SC3012	日電	PA	Si.T	130	5	10A	100W (T _c =25°C)	150	50	120	130	5	2A	5	-1A					60*	150	15	162	
" 3013	日立	Osc	Si.E	15	3	50	150	125	0.5	12	80	4	5	4	-5	V _{CE} = 200mV (6V, 5mA, 300MHz)			900*	0.9	C _{FB} ' 10pS	176		
" 3014	"	Conv	"	15	3	50	150	125	0.5	12	90	4	5	4	-5	G _c = 14.9dB (6V, 2mA, 900MHz)			3000*	98	C _{FB} ' 4pS	176		
" 3015	"	"	"	15	3	50	150	125	0.5	12	100	4	5	4	-5	G _c = 21dB (6V, 2mA, 200MHz)			1300*	1	C _{FB} ' 10pS	176		
" 3016	"	Osc	"	15	3	50	150	125	0.5	12	90	4	5	4	-5	V _{CE} = 125mV (6V, 5mA, 930MHz)			1450*	0.95	C _{FB} ' 10pS	176		
" 3017																								
" 3018	三菱	PA	Si.EP	20	3.5	1.5A	10W (T _c =25°C)	175	300	10	50	5	100			P _o = 3.5W (V _{CE} = 7.2V, f = 175MHz, P _i = 0.15W)						272		
" 3019	"	"	"	35	4	400	1.5W (T _c =25°C)	135	500	15	50	10	50			P _o = 600mW (V _{CE} = 12.5V, f = 520MHz, P _i = 20mW)						354		
" 3020	"	"	"	35	4	1A	10W (T _c =25°C)	175	300	15	50	10	100			P _o = 3.5W (V _{CE} = 12.5V, f = 520MHz, P _i = 0.3W)						272		
" 3021	"	"	"	35	4	2A	20W (T _c =25°C)	175	500	15	50	10	100			P _o = 8W (V _{CE} = 12.5V, f = 520MHz, P _i = 1.2W)						272		
" 3022	"	"	"	35	4	7A	50W (T _c =25°C)	175	2mA	15	50	10	1A			P _o = 16W (V _{CE} = 12.5V, f = 520MHz, P _i = 6W)						272		
" 3023	日立	SW	Si.T	1500	6	3A	50W (T _c =25°C)	150	100	1500	10	5	300			t _{on} < 2μS, t _f < 0.5μS t _{off} < 5μS						102		
" 3024	"	"	"	1700	6	3A	50W (T _c =25°C)	150	100	1700	10	5	300			t _{on} < 2μS, t _f < 0.5μS t _{off} < 5μS						102		
" 3025	"	"	"	1500	6	5A	50W (T _c =25°C)	150	100	1500	20	5	300			t _{on} < 1.5μS, t _f < 0.5μS t _{off} < 5μS						102		
" 3026	"	"	"	1700	6	5A	50W (T _c =25°C)	150	100	1700	20	5	300			t _{on} < 1.5μS, t _f < 0.5μS t _{off} < 5μS						102		
" 3027	"	"	"	1500	6	8A	50W (T _c =25°C)	150	100	1500	15	5	300			t _{on} < 2μS, t _f < 0.5μS t _{off} < 5μS						102		
" 3028	"	"	"	1700	6	8A	50W (T _c =25°C)	150	100	1700	15	5	300			t _{on} < 2μS, t _f < 0.5μS t _{off} < 5μS						102		
" 3029	日電	RF	Si.E	15	2	5	50	150	0.1	5	120	1	0.25	1	-0.5	G _{max} = 14dB, NF = 3dB (1GHz, 1V, 0.25mA, 1GHz)			4060*			210B		
" 3030	富士電機	SW	Si.TP	900	7	7A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	900	15	5	3A			t _{on} < 0.5μS, t _f < 0.8μS t _{off} < 2.5μS						211	ターリントン	
" 3031	"	"	"	900	7	7A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	900	15	5	3A			t _{on} < 0.5μS, t _f < 0.8μS t _{off} < 2.5μS						102	ターリントン	
" 3032	"	"	"	900	7	7A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	900	15	5	3A			t _{on} < 0.5μS, t _f < 0.8μS t _{off} < 2.5μS						211	ターリントン	
" 3033	"	"	"	900	7	7A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	900	15	5	3A			t _{on} < 0.5μS, t _f < 0.8μS t _{off} < 2.5μS						102	ターリントン	
" 3034	"	"	"	250	7	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	250	40	5	2A			t _{on} < 1μS, t _f < 1μS t _{off} < 2μS						102		
" 3035	オリジン	"	Si.T	300	8	5A	40W (T _c =25°C)	150	30	200	15	5	2A			t _{on} < 1.5μS, t _f < 1μS t _{off} < 3.5μS						153		
" 3036	"	"	"	800	8	5A	40W (T _c =25°C)	150	3	640	15	5	2A			t _{on} < 1.5μS, t _f < 1μS t _{off} < 3.5μS						153		
" 3037	ソニー	RF	Si.E	20	3	70	400	150	0.2	19	80	10	10	10	-10	NF = 1.2dB (10V, 3mA, 500MHz)			5000*	0.85	C _{FB} ' 2.7pS	138C		
" 3038	三洋	SW	Si.EP	500	7	4A	40W (T _c =25°C)	150	10	400	45	5	400			t _{on} < 1μS, t _f < 1μS t _{off} < 2.5μS						268		
" 3039	"	"	"	500	7	7A	50W (T _c =25°C)	150	10	400	40	5	800			t _{on} < 1μS, t _f < 1μS t _{off} < 2.5μS						268		
" 3040	"	"	"	500	7	8A	80W (T _c =25°C)	150	10	400	40	5	800			t _{on} < 1μS, t _f < 1μS t _{off} < 2.5μS						346		
" 3041	"	"	"	500	7	8A	80W (T _c =25°C)	150	10	400	40	5	800			t _{on} < 1μS, t _f < 1μS t _{off} < 2.5μS						102		

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_o = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_o = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考						
				V_{CBO}	V_{EBO}	I_c	P_c	T_j	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe}	h_{ie}	h_{re}	h_{oe}	f_{ab}			C_{ob}	τ_{bb}				
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	($^\circ\text{C}$)	(μA)	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(mA)$	$V_{CB}(V)$	$I_E(mA)$	h_{fb}^*	h_{ib}^* (Ω)	h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{ob}^* (μU)	(Mc)			(pF)	$h_{ie(real)}^*$ (Ω)				
2SC3132	日立	SW	Si. E	30	7	3 A	$\frac{10W}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	20	24	10000	3	1.5A											245	ターリントン		
" 3133																											
" 3134																											
" 3135																											
" 3136	東芝	RF	Si. E	30	2	50	250	125	1	25	150	10	2	10	-2											138C	
" 3137																											
" 3138																											
" 3139																											
" 3140																											
" 3141																											
" 3142																											
" 3143																											
" 3144																											
" 3145																											
" 3146																											
" 3147																											
" 3148																											
" 3149																											
" 3150																											
" 3151																											
" 3152																											
" 3153																											
" 3154																											
" 3155	日電	RF. LN	Si. E	120	5	50	200	150	0.1	120	500	6	1	6	-1												176
" 3156																											
" 3157																											
" 3158																											
" 3159																											
" 3160																											
" 3161																											

$NF=1.3dB$
(1 kHz)

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考					
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はバリス		h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{FE} *	h _{FE} (Ω)			h _{FE} (×10 ⁻⁴)	h _{FE} (μΩ)	f _{ab} (Mc)	C _{ob} (pF)	T _{th} h _w (real)* (Ω)
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{FE} *	h _{FE} *										
★ 2SD 11	日電	SW	Ge. A	25	15	300	150	85	10	25	70	1	20	6	- 1						2.5			84 A		
★ "	12	松下	PA	Si. Me	75	4	2.5A	60 W (T _c =25°C)	150	10mA	75	50	4	1 A										103		
★ "	13	"	"	"	35	4	10A	100 W (T _c =25°C)	150	40mA	35	40	10	2.5A										109		
★ "	14	"	"	"	75	4	10A	100 W (T _c =25°C)	150	45mA	75	30	4	10A										109		
★ "	15	サンケン	PA. SW	Si. DJ	60	6	6 A	80 W (T _c =25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	-500					2			102		
★ "	16	"	"	"	100	6	6 A	80 W (T _c =25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	-500					2			102		
★ "	17	"	"	"	150	6	6 A	80 W (T _c =25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	-500					2			102		
★ "	18	"	PA	"	200	6	6 A	80 W (T _c =25°C)	150	50	40	50	4	1.5A	12	-500					2			102		
★ "	19	日電	"	Ge. A	25	10	300	150	85	12	12	31	1	20	6	- 1					> 1			84 A	2SB219 とコンプリア	
★ "	20	"	"	"	25	10	300	150	85	12	12	50	1	20	6	- 1					> 1			84 A	2SB220 とコンプリア	
★ "	21	"	"	"	25	10	300	150	85	12	12	72	1	20	6	- 1					> 1			84 A	2SB221 とコンプリア	
★ "	22	"	"	"	25	10	300	150	85	12	12	97	1	20	6	- 1					> 1			84 A	2SB222 とコンプリア	
★ "	23	"	"	"	25	10	300	150	85	12	12	150	1	20	6	- 1					> 1			84 A	2SB223 とコンプリア	
★ "	24	三洋	"	Si. Me	300	2	100	6 W (T _c =70°C)	110	1.5	100	60	10	50	30	-20					25*	17		99		
★ "	25	日電	"	Ge. A	25	10	100	110	75	14	12	70	1	50	6	- 1					1			12 A		
★ "	26	三菱	PA. SW	Si. EP	40	5	7 A	50 W (T _c =25°C)	175	100	30	10	4	5 A										103		
★ "	26A	"	"	"	60	5	7 A	50 W (T _c =25°C)	175	100	30	10	4	5 A										103		
★ "	26B	"	"	"	100	5	7 A	50 W (T _c =25°C)	175	100	30	10	4	5 A										103		
★ "	26C	"	"	"	150	5	7 A	50 W (T _c =25°C)	175	100	30	10	4	5 A										103		
★ "	27	松下	PA	Ge. A	32	10	500	280	90	10	0.5	95	0.5	300										12 A		
★ "	28	ソニー	"	Si. DJ	70		3 A	18 W (T _c =25°C)	150	20	30	100	1	100										100		
★ "	29	"	"	"	70		3 A	18 W (T _c =25°C)	150	20	30	100	1	100										100		
★ "	30	三洋	"	Ge. A	25	12	200	300	85	15	20	100	1.5	100	6	- 1								63	2SB22 とコンプリア	
★ "	31	松下	"	"	25	10	125	125	75	15	10	50	1	100										12 B	2SB172 とコンプリア	
★ "	32	"	"	"	25	10	125	125	75	15	10	90	1	100										12 B	2SB176 とコンプリア	
★ "	33	富士通	"	"	20	2.5	50	150	85	14	12	70	1	50	6	- 1	60	1780	3.8	17.3	2			12 A	2SB33 とコンプリア	
★ "	34	"	"	"	20	2.5	150	250	85	14	12	100	1	150	6	- 1	60	1800	5	20	2			71 A	2SB34 とコンプリア	
★ "	35	松下	"	"	20	10	60	83	75	10	10	72	1	18										4		
★ "	36	"	"	"	20	10	60	83	75	10	10	150	1	37.5										4		
★ "	37	富士通	"	"	30	12	50	150	85	14	30	7	1	50	6	- 1	60	1780	3.8	17.3	2			12 A	2SB37 とコンプリア	

2SD

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考				
				V_{CBO}	V_{EBO}	I_C	P_C	T_J	I_{CBO} 最大値		直 流 又 は バ ル ス hFE			バ イ ア ス		h_{fe}	h_{ie}	h_{re}	h_{oe}			$f_{\alpha b}$	C_{ob}	$r_{bb'}$	
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	($^\circ\text{C}$)	(μA)	V_{CB} (V)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	V_{CB} (V)	I_E (mA)	h_{fb}^*	(Ω)	($\times 10^{-4}$)	(μU)	(Mc)			(pF)	(Ω)		
★ 2SD 38	富士通	PA	Ge. A	30	12	150	250	85	16	30	75	1	150	6	-1	60	1800	5	20	2			71A	2SB38 とコンプリ	
" 39																									
" 40																									
" 41	東芝	PA	Si. DJ	80	10	10A	200W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	200	50	60	5	1A											102	
" 42																									
★ " 43	東芝	PA	Ge. A	25	12	50	110	75	14	12	70	1	50	6	-1					24	1			12A	
★ " 43A	"	"	"	45	12	150	110	75	14	12	70	1	50	6	-1					24	1			12A	
★ " 44	"	AF	"	25	12	50	80	75	14	12				6	-1	85	2500	5	30	>0.5	25			12A	
★ " 45	ソニー	PA	Si. Me	150	6	5 A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5mA	50	40	10	1 A												102
★ " 46	"	"	"	150	6	5 A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5mA	50	40	10	1 A												102
★ " 47	"	"	"	100	6	5 A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5mA	15	40	10	1 A												102
★ " 48	富士通	"	Si. DJ	100	10	3 A	20 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	15	30	50	4	750							1.5					83
" 49	ソニー	"	"	100	10	3 A	18 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	20	30	50	3	1 A	10	-0.5A					2					100
" 50	富士通立	"	"	100	10	6 A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	15	30	30	4	1.5A							1.5					102
" 51	ソニー	"	Si. Me	100	6	5 A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5mA	15	60	3	2 A	10	-0.5A					10					102
" 52	サンケン	PA. SW	Si. DJ	100	10	6 A	80 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	10	40	20	4	3 A	12	-0.5A					2					102
★ " 53	富士通	"	"	90	12	10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	20	30	25	4	5 A	6	-0.5A					1.2					102
★ " 54	"	"	"	100	12	10A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	20	30	25	4	5 A	6	-0.5A					1.2					109
" 55	東芝	PA	"	100	10	20A	200W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10mA	50	24	5	10A							1					102
★ " 56	ソニー	"	"	220	18	3 A	30 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	50	50	1	100												100
★ " 57	三菱	PA. SW	"	30	10	3 A	20 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	200	20	70	4	1 A												100
★ " 58	"	"	"	60	10	3 A	20 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	40	40	70	4	1 A												100
★ " 59	"	"	"	100	5	6 A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	50	60	4	1 A												102
★ " 60	"	"	"	150	5	6 A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	50	60	4	1 A												102
★ " 61	ソニー	AF. PA. LN	Ge. A	30	10	100	120	75	10	25	50	1	10	6	-1	-0.977*	28 *	1.2 *	0.29 *	1	35				58
★ " 62	"	SW	"	30	10	100	120	75	10	25	50	1	10	6	-1	-0.977*	28 *	1.2 *	0.25 *	1	35				58
★ " 63	"	PA	"	25		100	120	75	10	25	50	1	10	6	-1					1	35				58
★ " 64	"	AF	"	25		100	120	75	15	25	100	1	10	6	-1	-0.987 *	28 *	1.2 *	0.25 *	1	35				58
★ " 65	"	"	"	25		100	120	75	15	25	50	1	10	6	-1	-0.977 *	28 *	1.2 *	0.25 *	1	35				58
★ " 66	"	"	"	25		100	120	75	15	25	25	1	10	6	-1	-0.958 *	28 *	1.2 *	0.25 *	0.8	35				58

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)													外 形	備 考
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	直 流 又 は パ ル ス h _{FE}			バ イ ア ス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αβ} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(real)} * (Ω)		
										V _{CB} (V)	I _C (mA)	I _E (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
★ 2SD 67	三洋	PA	Si.TMe	120	5	5 A	50 W (T _e =25°C)	150	5 mA	80	80	5	1 A						100*			102	
★ " 68	"	"	"	75	5	5 A	50 W (T _e =25°C)	150	5 mA	60	80	5	1 A						100*			102	
" 69	ソニー	"	"	140		3 A	50 W (T _e =25°C)	150	100	50	150	3	100									102	
" 70	日電	PA	Si	40	5	2 A	15 W (T _e =25°C)	175	100	24	80	2	1 A									150	
★ " 71	"	"	"	100	5	2 A	15 W (T _e =25°C)	175	100	40	80	2	0.5 A									150	
★ " 72	三洋	"	Ge. A	25		600	720 (T _e =25°C)	85	50	20	150	1.5	200									12 A	2SB405 とコンプリ
" 73	日電	"	Si.EMe	100	5	5 A	60 W (T _e =25°C)	175	5mA	100	70	10	1 A						20*			102	2SB506 とコンプリ
" 74	"	"	"	150	5	5 A	60 W (T _e =25°C)	175	5mA	150	70	10	1 A						20*			102	2SB506 とコンプリ
★ " 75	日立	AF	Ge. A	25	12	100	150	85	14	25				6	-1	40	1260	3	15.8	4		12 A	2SB75 とコンプリ
★ " 75A	"	PA	"	45	12	100	150	85	25	45				6	-1	40	1260	3	15.8	4		12 A	
" 76																							
★ " 77	日立	PA	Ge. A	25	12	100	150	85	14	25	85	1.5	50	6	-1	55	1680	3.1	16.3	3.5		12 A	2SB77 とコンプリ
★ " 77A	"	"	"	45	12	100	150	85	25	45	85	1.5	50	6	-1	55	1680	3.1	16.3	3.5		12 A	
" 78	日電	PA. SW	Si.E	100	12	2 A	1 W	175	1	60	80	2	500	10	-50					50*		84B	2SB504 とコンプリ
" 79	"	"	"	100	12	2 A	15 W (T _e =25°C)	175	1	60	80	2	500	10	-50					50*		97B	2SB505 とコンプリ
" 80	サンケン	PA. SW	Si. DJ	30	6	6 A	50 W (T _e =25°C)	150	200	20	60	4	1 A	10	-200					3		102	
" 81	"	"	"	60	6	6 A	50 W (T _e =25°C)	150	50	40	60	4	1 A	10	-200					3		102	
" 82	"	"	"	100	6	6 A	50 W (T _e =25°C)	150	30	50	60	4	1 A	10	-200					3		102	
" 83	"	"	"	150	6	6 A	50 W (T _e =25°C)	150	30	50	60	4	1 A	10	-200					3		102	
" 84	"	"	"	200	6	6 A	50 W (T _e =25°C)	150	30	50	60	4	1 A	10	-200					3		102	
" 85																							
" 86																							
" 87																							
★ " 88	ソニー	PA	Si.TMe	100	8	5 A	80 W (T _e =25°C)	150	100	50	80	3	2 A									102	
" 89																							
" 90	サンケン	PA. SW	Si. DJ	30	6	3 A	20 W (T _e =25°C)	150	200	20	40	4	1 A	10	-200					3.5		100	
" 91	"	"	"	60	6	3 A	20 W (T _e =25°C)	150	50	40	40	4	1 A	10	-200					3.5		100	
" 92	"	"	"	100	6	3 A	20 W (T _e =25°C)	150	30	50	40	4	1 A	10	-200					3.5		100	
" 93	"	"	"	150	6	3 A	20 W (T _e =25°C)	150	30	50	40	4	1 A	10	-200					3.5		100	
" 94	"	"	"	200	6	3 A	20 W (T _e =25°C)	150	30	50	40	4	1 A	10	-200					3.5		100	



型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考			
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{FE}	h _{FE} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)			f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ot} (pF)	r _{bb} h _{ie(Real)} * (Ω)
									μA	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}										
★ 2SD124	日立	SW	Si. DJ	60	10	6 A	60 W (T _e =25°C)	175	25	30	30	4	1.5A	12	-50	t _{on} =1.6μS, t _f =5.5μS t _{stg} =2.2μS	>0.5				102			
" 124A	"	"	"	75	10	7 A	60 W (T _e =25°C)	175	25	30	40	4	1.5A	4	-1A	t _{on} =1.6μS, t _f =5.5μS t _{stg} =2.2μS	1				102			
★ " 125	"	"	"	100	10	6 A	60 W (T _e =25°C)	175	25	30	40	4	1.5A	12	-50		>0.5				102			
★ " 125A	"	"	"	100	10	7 A	60 W (T _e =25°C)	175	25	30	40	4	1.5A	4	-1A	t _{on} =1.6μS, t _f =5.5μS t _{stg} =2.2μS	1				102			
★ " 126	"	PA. SW	Si. DJ	150	5	7 A	60 W (T _e =25°C)	175	25	30	10	4	6 A	4	-1A	t _{on} =1.6μS, t _{off} =6μS t _{stg} =2.2μS					102			
★ " 127	ソニー	PA	Ge. A	23		500	250	85	15	15	82	1	20	6	-1		28*	2.5*	0.4*	4		12A		
★ " 127A	"	"	"	23		500	250	85	15	15	82	1	20	6	-1		28*	2.5*	0.4*	4		12A		
★ " 128	"	"	"	32		500	250	85	15	15	82	1	20	6	-1		28*	2.5*	0.4*	4		12A		
★ " 128A	"	"	"	32		500	250	85	15	15	82	1	20	6	-1		28*	2.5*	0.4*	4		12A		
★ " 129	東芝	"	Si. DJ	90	10	3 A	25 W (T _e =25°C)	150	1mA	50	30~200	5	500	10	-500				1*	250		99		
★ " 130	"	"	"	60	10	3 A	25 W (T _e =25°C)	150	1mA	50	30~200	5	500	10	-500				1*	250		99		
" 131	"	"	Si. T	100	5	5 A	50 W (T _e =25°C)	150	100	50	60	5	1 A									102		
" 132	日電	"	Si.EmE	100	6	20 A	150 W (T _e =25°C)	175	5mA	65	40	5	20 A									106		
" 133																								
★ " 134	ソニー	SW	Ge. A	60		3	30	65	8	15	40	5	3							2		18		
" 135																								
★ " 136	富士通	PA	Si. T	200	3	100	4 W (T _e =25°C)	150	10	150	80	10	50									98A		
★ " 137	"	"	"	300	3	100	4 W (T _e =25°C)	150	10	150	80	10	50									98A		
★ " 138	"	PA. SW	"	200	3	1 A	30 W (T _e =25°C)	175	20	150	75	10	0.5A									101		
★ " 139	"	"	"	300	3	1 A	30 W (T _e =25°C)	175	20	150	75	10	0.5A									101		
" 140																								
★ " 141	日電	PA	Si. E	20	5	3 A	15 W (T _e =25°C)	175	100	12	80	2	1 A									150		
★ " 142	"	"	"	40	5	3 A	15 W (T _e =25°C)	175	100	20	80	2	1 A									150		
★ " 143	"	"	"	80	5	2 A	15 W (T _e =25°C)	175	100	40	80	2	0.5A									150		
★ " 144	"	"	"	100	5	2 A	15 W (T _e =25°C)	175	100	50	80	2	0.5A									150		
" 145																								
" 146	富士通	PA. SW	Si. DJ	40	5	1 A	20 W (T _e =25°C)	175	20	30	60	4	500	6	-0.5A					1.4		101		
" 147	"	"	"	60	5	1 A	20 W (T _e =25°C)	175	20	30	50	4	500	6	-0.5A					1.4		101		
" 148	"	SW	"	70	5	2 A	20 W (T _e =25°C)	175	20	30	35	4	2 A	4	-100					1.2*		101		
" 149	"	PA. SW	"	70	5	1 A	800	175	20	30	40	4	1 A	4	-100					1.2		84B		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ie} *	h _{re}	h _{rb} *	h _{oe}			f _{ab} f _T *	C _{ob}	r _{bb}	h _{ie} (real)*
				15W (T _c =25°C)	10A	1A	150	100	40	80	2	1A	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fb} *	(Ω)	(×10 ⁻⁴)	(μΩ)	(Mc)	(pF)	(Ω)		
★	2SD150	日電	PA	Si.E	50	5	1A	150	100	40	80	2	1A											150	2SA613 とコンプリ
	" 151	"	SW	Si.EMe	100	6	10A	175	1mA	60	35	10	10A											102	
★	" 152	"	PA	Si.E	150	6	1A	175	100	70	70	2	0.5A											150	
★	" 153	"	PA.SW	Si.TMe	250	6	10A	175	1mA	200	70	5	1A											200	
★	" 154	"	PA	Si.EMe	80	5	3A	150	1mA	60	65	2	2A											150	
★	" 155	"	"	"	80	5	3A	150	1mA	60	65	2	2A											134	2SA616 とコンプリ
★	" 156	富士通	"	Si.T	200	3	100	150	10	150	80	10	50	30	-10					20*	8		25*	99	
	" 157	"	"	"	300	3	100	150	10	150	80	10	50	30	-10					20*	8		25*	99	
★	" 158	"	PA.SW	"	200	3	1A	175	20	150	75	10	0.5A	10	-100						15*			99	
★	" 159	"	"	"	300	3	1A	175	20	150	75	10	0.5A	10	-100						15*			99	
	" 160	"	"	Si.DJ	100	8	1.5A	175	10	30	50	10	750											83	
	" 161	"	PA	"	120	12	10A	175	20	30	30	4	5A	6	-500						1			102	
★	" 162	"	AF.PA	Ge.A	20	2.5	30	85	12	12	80	1.5	30	6	-1	60	2000	4	17	3				4	2SB262 とコンプリ
	" 163	サンケン	PA.SW	Si.DJ	60	6	10A	150	50	40	30	4	5A	12	-500						2			102	
	" 164	"	"	"	100	6	10A	150	50	40	30	4	5A	12	-500						2			102	
	" 165	"	"	"	150	6	10A	150	50	40	30	4	5A	12	-500						2			102	
	" 166	"	"	"	200	6	10A	150	50	40	30	4	5A	12	-500						2			102	
★	" 167	富士通	AF.PA	Ge.A	20	2.5	500	200	85	20	12	120	1	150										12A	
	" 168	"	SW	Si.DJ	80	6	10A	175	30	30	2500	4	5A							V _{CE(sat)} < 3.0V (I _C = 5A, I _B = 25mA)	V _{BE(sat)} < 3.5V (I _C = 5A, I _B = 25mA)			102	ダーリントン接続
	" 169	"	"	"																					
★	" 170	日立	PA	Ge.A	25	6	500	200	85	20	12	150	1	150										12A	2SB370 とコンプリ
	" 171	ソニー	"	Si.TMe	450		3.5A	125W (T _c =25°C)	150	100	50	70	3	1A										102	
	" 172	富士通	PA.SW	Si.DJ	60	6	10A	175	20	30	25	4	5A	6	-500						1.2			102	
	" 173	"	"	"	100	6	10A	175	20	30	25	4	5A	6	-500						1.2			102	
	" 174	"	PA	"	60	6	5A	175	20	30	25	4	5A	6	-500						1.2			102	
	" 175	"	PA.SW	"	100	6	5A	175	20	30	25	4	5A	6	-500						1.2			102	
	" 176	"	"	"	90	12	10A	175	20	30	25	4	5A	6	-500						1.2			102	
	" 177	"	"	"	120	12	10A	175	20	30	25	4	5A	6	-500						1.2			102	
★	" 178	松下	PA	Ge.A	20	6	300	225	75	27	12	90	0.5	300										17	2SB178 とコンプリ
★	" 178A	"	"	"	40	6	300	225	75	27	12	90	0.5	300										17	2SB178A とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考			
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイア		h_{fe}	h_{ie} (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	f_{ab} f_T^* (Mc)			C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)	
									(μA)	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(mA)$	$V_{CB}(V)$	$I_E(mA)$										h_{fb}^*
2SD206	新電元	PA. SW	Si. DJ	50	8	10A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50mA	30	20	5	5 A	10	-1A	50	7	70	10m $\bar{\sigma}$	f_{oe} 18kc			102	
* 207	"	"	"	100	8	10A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50mA	30	20	5	5 A	10	-1A	50	7	70	10m $\bar{\sigma}$	f_{oe} 18kc			102	
* 208	"	"	"	150	8	10A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50mA	30	20	5	5 A	10	-1A	50	7	70	10m $\bar{\sigma}$	f_{oe} 18kc			102	
* 209																								
* 210																								
* 211	サンケン	PA. SW	Si. DJ	60	6	10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	40	30	4	5 A	12	-500					8			102	
* 212	"	"	"	90	6	1 A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	40	30	4	5 A	12	-500					8			102	
* 213	"	"	"	110	6	10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	40	30	4	5 A	12	-500					8			102	
* 214	"	"	"	130	6	10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	40	30	4	5 A	12	-500					8			102	
* 215	富士通	PA	"	40	5	1 A	800	175	20	30	70	4	500	4	-100					1.2			84B	
* 216	"	"	"	60	5	1 A	800	175	20	30	70	4	500	4	-100					1.2			84B	
* 217	日電	"	Si.EMe	120	7	7 A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	500	80	60	5	4 A	10	-200					10*			102	2SA648 とコンプリ
* 218	"	"	"	150	7	7 A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	500	80	60	5	4 A	10	-200					10*			102	2SA649 とコンプリ
* 219	サンケン	PA. SW	Si. DJ	40	6	1 A	500	150	1	20	80	4	200	5	-100					8			84B	
* 220	"	"	"	80	6	1 A	500	150	1	20	80	4	200	5	-100					8			84B	
* 221	"	"	"	110	6	1 A	500	150	1	20	80	4	200	5	-100					8			84B	
* 222	"	"	"	40	7	1.5 A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	20	80	4	500	5	-100					8			97B	
* 223	"	"	"	80	7	1.5 A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	20	60	4	500	5	-100					8			97B	
* 224	"	"	"	110	7	1.5 A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	20	40	4	500	5	-100					8			97B	
* 225																								
* 226	松下	PA	Si. DJ	40	8	3 A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	20	50	3	1 A	10	-200					f_{oe} 25kHz			99	
* 227	日電	"	Si. E	30	5	300	250	125	0.1	15	150	1	50										138	2SA642 とコンプリ
* 228	"	"	"	30		300	400	125	0.1	15	120	1	300	10	-10	200							44	
* 229																								
* 230																								
* 231	富士通	SW. AF	Si.TMe	50	5	30A	125W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	30	25	4	10 A										102	
* 232	"	"	"	120	7	30A	125W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	1mA	50	25	4	10 A										102	
* 233																								
* 234	東芝	PA	Si. T	60	10	3 A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	20	40~240	5	500	10	-500					3*	90		268	2SB434 とコンプリ
* 235	"	"	"	50	10	3 A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	20	40~240	5	500	10	-500					3*	90		268	2SB435 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 氣 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考						
				V _{CEO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値 (μA)	V _{CEB} (V)	直流又はパルス h _{FE} V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CEB} (V)	I _E (mA)	バイアス I _E (mA)	h _{FE} h _{FE} *	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)			h _{oe} h _{oe} * (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)		
★ 2SD266	オリジン	PA. SW	Si. T	800	10	6 A	100 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	40	5	3 A												102	
" 267																										
" 268																										
" 269																										
" 270																										
★ " 271	オリジン	PA	Si. T	800	10	2 A	30 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	20	5	1 A	12	-500								f _{ce} 150kHz		100	
★ " 272	"	"	"	800	10	2 A	30 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	40	5	1 A	12	-500								f _{ce} 150kHz		100	
★ " 273	"	PA. SW	"	800	10	5 A	80 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	20	5	2 A	12	-1 A								f _{ce} 150kHz		102	
★ " 274	"	"	"	800	10	5 A	80 W (T _c =25°C)	150	2mA	800	40	5	2 A	12	-1 A								f _{ce} 150kHz		102	
" 275																										
" 276																										
" 277																										
" 278																										
" 279																										
" 280																										
" 281																										
" 282																										
★ " 283	日電	PA. SW	Si. E	120	5	5 A	25 W (T _c =25°C)	150	200	40	55	1	5 A												134	
" 284	"	"	"	120	5	5 A	25 W (T _c =25°C)	150	200	40	80	5	1 A	10	-100							20 *		134	2SB550 とコンパリ	
★ " 285	"	"	"	100	5	5 A	25 W (T _c =25°C)	150	200	40	40	1	5 A											134		
★ " 286	"	PA	Si. TMe	180	7	10 A	100 W (T _c =25°C)	150	300	100	75	5	2 A												102	
★ " 287	"	"	"	200	7	10 A	100 W (T _c =25°C)	150	300	100	75	5	2 A												102	
" 288	日電	"	Si. T	80	5	3 A	20 W (T _c =25°C)	150	10	60	100	5	500	5	-100								35 *	55	268	
" 289	"	"	"	80	5	3 A	20 W (T _c =25°C)	150	10	60	100	5	500	5	-100								35 *	55	267	
★ " 290	ソニー	PA. SW	Si. TMe	80		5 A	10 W (T _c =25°C)	120	100	150	100	3	2 A												153	
★ " 291	"	RF. PA	Si. DJ	70	10	3 A	18 W (T _c =25°C)	150	20	30	100	1	100	10	-500								4 *	250	153	
★ " 292	"	PA	"	70	10	3 A	18 W (T _c =25°C)	150	20	30	100	1	100	10	-500								4 *	250	153	
" 293	オリジン	"	Si. T	800	10	10 A	125 W (T _c =25°C)	150	3mA	800	20	5	5 A												102	
" 294	"	"	"	800	10	10 A	125 W (T _c =25°C)	150	3mA	800	40	5	5 A												102	
" 295	オリジン	PA. SW	Si. T	800	10	30 A	200 W (T _c =25°C)	150	5 mA	800	20	5	10 A	12	-2.5A								f _{ce} 150kHz		154	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考				
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値 (μA)	$V_{CB}(V)$	直流又はパルス h_{FE} $V_{CE}(V)$ $I_C(\text{mA})$	バ イ ア ス $V_{CB}(V)$ $I_E(\text{mA})$	h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oc} h_{ob}^* (μD)	f_{ab} f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ic}(\text{real})^*$ (Ω)						
2SD296	オリジ	PA. SW	Si. T	800	10	30 A	200 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5 mA	800	40	5	10 A	12	-2.5A					f_{sw} 150kHz				154	
" 297	日電	"	Si. EMe	150	7	3 A	25 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	500	80	70	2	2 A	10	-100									134	
" 298																									
" 299	松下	PA. SW	Si. Me	1500	5	5 A	16 W ($T_c=90^\circ\text{C}$)	115	1mA	1500	> 2	5	4 A			$V_{CE(sat)} < 10\text{V}$ (4.5 A, 2 A)		$V_{BE(sat)} < 1.6\text{V}$ (4.5 A, 2 A)						102	
" 300	"	"	"	1500	5	5 A	16 W ($T_c=90^\circ\text{C}$)	115	1mA	1500	> 3	10	2.5 A			$V_{CE(sat)} < 10\text{V}$ (2.5 A, 0.85 A)		$V_{BE(sat)} < 1.6\text{V}$ (2.5 A, 0.85 A)						102	水平偏向用
" 301	富士通	SW	Si. DJ	80	6	10 A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	30	30	2500	4	5 A			$t_d < 11\mu\text{S}$, $t_r < 53\mu\text{S}$, $t_{sig} < 16\mu\text{S}$								102	ゲーリントン 接続
" 302																									
" 303																									
" 304																									
" 305																									
" 306																									
" 307																									
" 308																									
" 309																									
" 310	オリジ	PA. SW	Si. T	800	10	15 A	150 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	3mA	800	20	5	7.5 A	12	-2 A					f_{sw} 150kHz				102	
" 311	"	"	"	800	10	15 A	150 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	3mA	800	40	5	7.5 A	12	-2 A					f_{sw} 150kHz				102	
" 312	松下	PA	Si. TMe	800	6	500	25 W ($T_c=10^\circ\text{C}$)	150	1mA	800	60	10	600	10	-100					5 *				102	
" 313	三洋	"	Si. T	60	5	3 A	30 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	20	40~320	2	1 A	5	-500					8 *	65			268	
" 314	"	"	"	60	5	3 A	30 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	20	40~320	2	1 A	5	-500					8 *	65			267	
" 315	"	"	"	60	5	4 A	35 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	20	40~320	2	1 A	5	-500					8 *				99	2SB509 とコンプリ
" 316	ソニー	"	Si. TMe	80	5	7 A	80 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	50	70	2	3 A	10	-500					12 *	260			102	
" 317	松下	PA	Si. T	60	8	3 A	25 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	20	60	3	1 A	10	-200					$f_{sw} =$ 25 kHz				268	
" 318	"	"	"	60	8	3 A	25 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	20	60	3	1 A	10	-200					$f_{sw} =$ 25 kHz				267	
" 319	"	"	Si. DJ	110	7	10 A	100 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	40	35	4	5 A	10	-500					1 *				102	
" 320	三洋	PA. SW	Si. T	300	6	2 A	50 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	100	15	1 A												102	
" 321	松下	"	Si. TMe	250	6	6 A	60 W ($T_c=75^\circ\text{C}$)	150	2 mA	250	40	5	5 A			$t_f < 1\mu\text{S}$								102	
" 322	日電	PA	"	120	7	7 A	80 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	300	120	60	5	4 A											102	
" 323	"	"	"	150	7	7 A	80 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	300	150	60	5	4 A											102	
" 324	松下	"	"	300	3	100	10 W ($T_c=70^\circ\text{C}$)	150	100	300	80	10	50											153	
" 325	三洋	"	Si. T	35	5	1.5 A	10 W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	20	40~320	2	1 A	5	-500					8 *				268	2SB511 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考		
				V_{CB0}	V_{EBO}	I_C	P_C	T_j	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{fe}	h_{ie}	h_{re}	h_{oe}	f_{β}			C_{ob}	r_{bb}
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	($^\circ\text{C}$)	(μA)	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$	h_{fe}^*	(Ω)	($\times 10^{-4}$)	(μU)	(Mc)			(pF)	(Ω)
★ 2SD326	ソニー	PA. SW	Si.TMe	330	5	1 A	23W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	15	100	80	5	100							6.5*		100	
★ " 327	日電	PA	Si.E	40	5	500	250	125	0.2	25	140	1	100							50*		138	2SA723 とコンプリ
" 328	"	PA. SW	"	100	7	1 A	800	150	1	60	100	2	200	10	-50							84B	2SB510 とコンプリ
" 329	富士通	SW	Si.DJ	70	5	1 A	800	175	20	30	40	4	1 A									84B	
" 330	三洋	PA	Si.T	50	5	2 A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	20	40~320	2	1 A	5	-200					8*		268	2SB514 とコンプリ
" 331	"	"	"	50	5	2 A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	20	40~320	2	1 A	5	-200					8*		267	2SB515 とコンプリ
★ " 332	"	"	Si.DJ	130	10	7 A	65W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	50	40~200	5	1 A									102	
" 333																							
" 334	松下	PA	Si.DJ	110	7	6 A	75W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	110	100	4	1 A	10	-500					f_{oe} 25kHz		162	
★ " 335	日電	"	Si.EMe	80	7	3 A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	300	60	80	5	2 A									102	
" 336	"	"	Si.E	40	5	500	750	135	0.2	25	140	1	100									45	2SA707 とコンプリ
" 337																							
★ " 338	ソニー	PA	Si.EMe	70	8	7 A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	50	50	2	3 A									102	
★ " 339	"	"	"	90	8	10 A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	50	50	2	4 A	2	-4A					5*		102	
★ " 340	"	"	"	110	8	12 A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	50	50	2	5 A	2	-5A					> 3*		102	
" 341	日立	PA. SW	Si.DJ	100	7	15 A	115W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	200	5mA	100	20~70	4	4 A	4	-1 A					> 0.8*		102	
" 342	ソニー	PA	"	70		3 A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	30	100	1	100									268	
" 343	"	"	"	70		3 A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	30	100	1	100									267	
" 344	"	"	"	70		3 A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	30	100	1	100									268	
" 345	"	"	"	70		3 A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	30	100	1	100									267	
" 346	"	"	Si.EMe	60		5 A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	50	50	2	2.5A									268	
" 347	"	"	"	60		5 A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	50	50	2	2.5A									267	
" 348	三洋	SW	Si.TMe	1500	6	7 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	1000	> 4.5	5	5 A									102	水平偏向用
" 349	日電	AF	Si.E	30	5	50	150	125	0.1	25	500	3	0.5	3	-1							176	
" 350	松下	SW	Si.Me	1500	5	5 A	22W ($T_c=90^\circ\text{C}$)	115	1mA	1500	> 3	10	4 A									102	
★ " 351	"	PA	Si.TMe	650	6	5 A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5mA	650	15	5	5 A	10	-500					40*	150	102	
" 352	"	"	Ge.A	32	10	1 A	650	90	25	10	150	0.5	300	2	-10					$NF < 25 \text{ dB}$ ($f = 1 \text{ kHz}, V_{CB} = 5 \text{ V}, I_E = -5 \text{ mA}$)	$f_{\alpha} > 10 \text{ kHz}$	12B	
" 353	三洋	"	Si.TMe	150	6	2 A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	30	40~170	5	1 A	5	-1A					8*		102	
" 354																							
" 355	三菱	PA	Si.EP	30	4	1 A	800	135	1	25	150	1	500	6	-10					100*		242	2SB525 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考					
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値		直流又はパルス hFE		バ イ ア ス		h _{fe}	h _{ie} (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μΩ)	f _{αT} (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(ideal)*} (Ω)			
									μA	V _{CEB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *	h _{ib} *	
2SD386	三洋	PA	Si.TMe	200	6	2 A	25W (T _c =25°C)	150	1mA	180	40~320	2	500										268			
" 387	"	"	"	200	6	2 A	25W (T _c =25°C)	150	1mA	180	40~320	2	500										267			
* " 388	日電	"	"	150	7	8 A	80W (T _c =25°C)	150	100	100	80	5	1 A	10	-200				9 *	190		102	2SB541 とコンプリ			
" 389	松下	"	Si.DJ	60	8	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	-200				f _{αc} 25kHz				268			
* " 390	"	"	"	60	8	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	-200				f _{αc} 25kHz				267			
" 391																										
* " 392	三菱	PA	Si.EP	20	5	300	300	125	1	20	150	2	150	6	-10					150 *			138B	2SB542 とコンプリ		
* " 393	"	PA.SW	Si.EhMe	500	5	6 A	100W (T _c =25°C)	150	10	400	7	5	5 A										102			
* " 394	"	"	"	700	5	6 A	100W (T _c =25°C)	150	10	450	7	5	5 A										102			
* " 395	"	"	"	700	5	8 A	100W (T _c =25°C)	150	10	450	8	5	7 A										102			
" 396	日立	"	Si.TMe	700	6	15A	125W (T _c =25°C)	150	5	400	30	2	7.5A										102			
" 397																										
" 398																										
" 399																										
" 400	三洋	PA	Si.EP	25	5	1 A	900	150	1	20	60~560	2	50	10	-50						180 *	15		294	2SB544 とコンプリ	
* " 401	日電	"	Si.TMe	200	5	2 A	20W (T _c =25°C)	150	50	150	90	10	400	10	-400						5 *			268	2SB546 とコンプリ	
* " 402	"	"	"	200	5	2 A	20W (T _c =25°C)	150	50	150	90	10	400	10	-400						5 *			267	2SB547 とコンプリ	
" 403																										
" 404	東芝	PA	Si.DJ	50	7	6 A	40W (T _c =25°C)	150	100	40	200	1	1 A											268		
" 405	日電	SW.PA	Si.E	70	7	2 A	1 W	175	1	50	4000	2	1 A											84B	ゲーリントン	
" 406	"	"	"	100	7	2 A	1 W	175	1	70	4000	2	1 A											84B	ゲーリントン	
" 407	"	"	Si.EMe	100	7	5 A	25W (T _c =25°C)	175	10	80	4000	2	5 A											83	ゲーリントン	
" 408	"	"	"	150	7	5 A	25W (T _c =25°C)	175	10	100	3000	2	5 A											83	ゲーリントン	
" 409	"	"	"	100	7	5 A	30W (T _c =25°C)	175	10	80	4000	2	5 A											134	ゲーリントン	
" 410	"	"	"	150	7	5 A	30W (T _c =25°C)	175	10	100	3000	2	5 A											134	ゲーリントン	
" 411	"	"	"	100	8	10A	80W (T _c =25°C)	150	100	80	4000	2	10A											102	ゲーリントン	
" 412	"	"	"	150	10	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	100	4000	2	15A											102	ゲーリントン	
" 413	富士通	PA.SW	Si.TMe	200	5	500	800	175	5	150	65	5	200	5	-50						25 *	12.5		84B		
" 414	日電	PA	Si.E	120	5	800	10W (T _c =25°C)	150	1	80	90	5	200	5	-100									45 *	15	225
" 415	"	"	"	120	5	800	10W (T _c =25°C)	150	1	80	90	5	200	5	-100									45 *	15	225

t_{off}=4μS
(I_C=5A, I_{B1}=-I_{B2}=1.3A)

t_{on}<15μS, t_{off}<40μS
t_{sig}<20μS

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE}	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μΩ)			f _{αB} f _{αB} * (Mc)	C _{ob} (pF)	T _{th} h _{th} (real)* (Ω)
* 2SD476	日立	PA	Si. T	70	5	4 A	40W (T _c =25°C)	150	1	50	60~320	4	1 A	4	-500				7 *			268	2SB566 とコンパリ
* " 477																							
* " 478	日立	PA	Si. T	200	6	2 A	30W (T _c =25°C)	150	1	120	60~320	4	50								22	268	2SB568 とコンパリ
" 479	モトローラ	"	Si. E	40	5	4 A	40W (T _c =25°C)	150	500	40	6000	3	2 A									252	2SB569 とコンパリ
" 480	"	"	"	60	5	4 A	40W (T _c =25°C)	150	500	60	6000	3	2 A									252	2SB570 とコンパリ
" 481	"	"	"	80	5	4 A	40W (T _c =25°C)	150	500	80	6000	3	2 A									252	2SB571 とコンパリ
" 482	"	"	Si. TP	275	6	500	20W (T _c =25°C)	150	10	275	80	10	100									252	
" 483	"	"	"	325	6	500	20W (T _c =25°C)	150	10	325	80	10	100									252	
" 484	"	"	"	375	6	500	20W (T _c =25°C)	150	10	375	80	10	100									252	
" 485	"	"	Si. E	40	5	4 A	40W (T _c =25°C)	150	100	40	50	2	1.5A									252	2SB575 とコンパリ
" 486	"	"	"	60	5	4 A	40W (T _c =25°C)	150	100	60	50	2	1.5A									252	2SB576 とコンパリ
" 487	"	"	"	80	5	4 A	40W (T _c =25°C)	150	100	80	50	2	1.5A									252	2SB577 とコンパリ
" 488	"	"	"	40	5	3 A	30W (T _c =25°C)	150	100	40	50	1	500									252	2SB572 とコンパリ
" 489	"	"	"	60	5	3 A	30W (T _c =25°C)	150	100	60	50	1	500									252	2SB573 とコンパリ
" 490	"	"	"	80	5	3 A	30W (T _c =25°C)	150	100	80	50	1	500									252	2SB574 とコンパリ
" 491	"	"	"	70	5	10A	90W (T _c =25°C)	150	1mA	70	40	4	4 A									253	2SB578 とコンパリ
" 492	"	"	"	100	7	15A	115W (T _c =25°C)	200	1mA	100	40	4	4 A									102	
" 493	"	"	"	60	5	5 A	75W (T _c =25°C)	150	100	60	40	2	2.5A									253	2SB579 とコンパリ
" 494	"	"	"	80	5	5 A	75W (T _c =25°C)	150	100	80	40	2	2.5A									253	2SB580 とコンパリ
" 495	"	"	"	100	5	5 A	75W (T _c =25°C)	150	100	100	40	2	2.5A									253	2SB581 とコンパリ
" 496	"	"	"	60	5	8 A	75W (T _c =25°C)	150	500	60	3000	4	4 A									253	2SB582 とコンパリ
" 497	"	"	"	80	5	8 A	75W (T _c =25°C)	150	500	80	3000	4	4 A									253	2SB583 とコンパリ
" 498	"	"	"	100	5	8 A	75W (T _c =25°C)	150	500	100	3000	4	4 A									253	2SB584 とコンパリ
" 499	"	"	"	60	5	8 A	90W (T _c =25°C)	150	100	60	60	2	4 A									253	
" 500	"	"	"	80	5	8 A	90W (T _c =25°C)	150	100	80	60	2	4 A									253	
" 501	"	"	"	100	5	8 A	90W (T _c =25°C)	150	100	100	60	2	4 A									253	
" 502	"	"	"	60	5	8 A	100W (T _c =25°C)	200	500	60	3000	3	4 A									102	2SB585 とコンパリ
" 503	"	"	"	80	5	8 A	100W (T _c =25°C)	200	500	80	3000	3	4 A									102	2SB586 とコンパリ
" 504	"	"	"	60	5	12A	150W (T _c =25°C)	200	500	60	3000	3	6 A									102	2SB587 とコンパリ
" 505	"	"	"	80	5	12A	150W (T _c =25°C)	200	500	80	3000	3	6 A									102	2SB588 とコンパリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考					
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μC)	f _{αB} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} r _{bb'(real)} * (Ω)			
									I _{CEO} (μA)	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CE(V)}										I _E (mA)		
2SD536	富士通	SW	Si.TP	200	5	10A	100W (T _c =25°C)	175	1 mA	200	50	5	5 A											102		
" 537	"	"	"	200	5	10A	100W (T _c =25°C)	175	1 mA	200	50	5	5 A											102		
" 538	"	"	Si.TMe	500	7	10A	100W (T _c =25°C)	175	500	150	15	5	5 A											102		
" 539	"	"	"	400	7	10A	100W (T _c =25°C)	175	500	150	15	5	5 A											102		
" 540	"	"	Si.TP	200	5	30A	200W (T _c =25°C)	175	3 mA	200	40	5	10A											266		
" 541	"	"	"	200	5	30A	200W (T _c =25°C)	175	3 mA	200	40	5	10A											266		
" 542	"	"	"	400	5	30A	200W (T _c =25°C)	175	3 mA	400	25	5	10A											266		
" 543	"	"	"	400	5	30A	200W (T _c =25°C)	175	3 mA	400	25	5	10A											266		
" 544	ソニー	PA	Si.T	100	8	5 A	43W (T _c =25°C)	120	2	50	100	2	100											267		
" 545	三洋	"	Si.EP	25	5	1 A	600	150	1	20	60~320	2	50							180*	15			138	2SB595 とコンプリ	
" 546																										
" 547	東芝	SW	Si.TMe	600	6	+50A -47A	400W (T _c =25°C)	150	1 mA	600	>150	5	50A											319		
" 548	"	"	"	600	5	120A	770W (T _c =25°C)	125	2 mA	600	500	5	60A											158	ターリントン	
" 549	"	SW.PA	Si.E	30	10	1.5A	1 W	150	10	30	>4000	2	150											342	ターリントン	
" 550	"	PA.SW	Si.T	100	5	7 A	40W (T _c =25°C)	150	50	100	120	5	1 A											99		
" 551	"	PA	Si.TMe	150	5	12A	100W (T _c =25°C)	150	100	100	40~140	5	1 A	10	-1A						15*	250		102	2SB681 とコンプリ	
" 552	"	"	"	220	5	15A	150W (T _c =25°C)	150	100	150	25~80	5	5 A	10	-1 A						4*	160		102	2SB552 とコンプリ	
" 553	"	PA.SW	Si.T	70	5	7 A	40W (T _c =25°C)	150	30	70	70~240	1	1 A	4	-1A						10*	250		268	2SB553 とコンプリ	
" 554	日電	PA	"	250	5	2 A	30W (T _c =25°C)	150	10	200	80	5	300											134		
" 555	"	"	"	250	5	10A	200W (T _c =25°C)	150	50	200	70	5	2 A	5	-200						15*	300		102	2SB600 とコンプリ	
" 556	サンケン	"	Si.DJ	110	6	15A	120W (T _c =25°C)	175	1 mA	110	30	4	5 A	12	-500									102		
" 557	"	"	"	140	6	15A	120W (T _c =25°C)	175	1 mA	140	30	4	5 A	12	-500									102		
" 558	日電	PA.SW	Si.E	90	7	2 A	1 W	150	1	70	4000	2	1 A											65	ターリントン	
" 559																										
" 560	日電 富士通	PA.SW	Si.E ターリントン	150	7	5 A	30W (T _c =25°C)	150	1	100	4000	2	3 A												268	2SB601 とコンプリ
" 561																										
" 562																										
" 563																										
" 564																										
" 565	日電	PA.SW	Si.T	400	8	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	400	>100	1.5	6 A											102	ターリントン	

★

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CEO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE} h _{FE} *	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μΩ)	f _β f _β * (Mc)			C _{ob} (pF)	τ _{ob} h _{ob} (real)* (Ω)	
									(μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	h _{FE}										I _C (mA)
★ 2SD597	松下	PA		100	5	5A	60W (T _c =25°C)	150	1mA	60	40~200	5	1A	10	-500					7*			102	
★ " 598	"	"		120	5	6A	80W (T _c =25°C)		1mA	70	40~200	5	1A	10	-500					6*			102	
" 599	三洋		Si.EP	25	5	1A	350	125	1	20	150	2	50	10	-50					180*	15		138	
" 600	"	"	"	100	5	1A	8W (T _c =25°C)	150	1	50	60~320	5	50	10	-50					130*	20		296	2SB631 とコンプリ
" 601	松下	AF	"	30	7	100	200	125	1	10	90~650	10	2	10	-2	V _{NO} < 300mV (10V, 1mA, R _c =100Ω, A _v =80dB)			150*	3.5		176	2SB709 とコンプリ	
" 602	"	"	"	30	5	500	200	125	0.1	20	160	10	150	10	-50					200*	6		176	2SB710 とコンプリ
" 603	"	"	"	30	5	100	250	125	1	10	360	10	2	5	-2	h _{ie} =4kΩ h _{re} =0.15μΩ h _{re} =0.8×10 ⁻⁴			150*	35		276		
★ " 604	日立	PA	Si.T	180	6	5A	100W (T _c =25°C)	150	500	180	400~3200	4	1A	4	-1A					8*	150		102	
" 605	サンケン	"	Si.TMe	600	6	7A	80W (T _c =25°C)	150	500	600	400	2	4A										102	ダーリントン
" 606	"	"	"	600	6	15A	100W (T _c =25°C)	150	500	600	400	2	5A										102	ダーリントン
" 607																								
" 608	日電	PA	Si.E	160	5	1.5A	20W (T _c =25°C)	150	1	120	80	5	300	5	-100					45*	25		268	2SB628 とコンプリ
" 609																								
" 610	日電	PA	Si.T	250	5	2A	25W (T _c =25°C)	150	1	150	80	10	500	10	-500					5*	45		268	2SB630 とコンプリ
★ " 611	富士通	"	Si.DJ	100	6	7A	30W (T _c =25°C)	175	20	30	>30	4	500							1.5			99	
" 612	三洋	"	Si.EP	25	5	2A	10W (T _c =25°C)	150	1	20	60~320	2	500	10	-50					100*	30		296	2SB632 とコンプリ
" 613	"	"	"	100	6	6A	40W (T _c =25°C)	150	100	40	40~320	5	1A	5	-1A					15*	110		268	2SB633 とコンプリ
" 614	サンケン	"	Si.TMe	100	6	3A	800	150	100	100	3000	4	3A	5	-100					15*			84B	ダーリントン
" 615	"	"	"	140	6	3A	800	150	100	140	3000	4	3A	5	-100					15*			84B	ダーリントン
★ " 616	三洋	"	Si.EMe	120	6	7A	60W (T _c =25°C)	150	100	80	40~320	5	1A	5	-1A					15*				
" 617	サンケン	"	Si.TMe	120	6	8A	100W (T _c =25°C)	150	100	120	2500	4	1A										102	ダーリントン
" 618																								
★ " 619	富士通	AF.PA	Si.EP	80	5	1.5A	500	150	1	60	150	1	200	10	-50					100*	<25	<30*	138	
★ " 620	"	PA	"	80	5	1.5A	1W	150	1	60	150	1	200	10	-50					100*	<25	<30*	328	
" 621	三洋	SW	Si.TMe	2500	6	3A	50W (T _c =25°C)	150	50	1000	3~15	10	1.5A										102	水平偏向用
" 622	富士通	"	"	450	5	3A	30W (T _c =25°C)	175	10	150	20	5	1A										99	
" 623																								
" 624	富士通	SW	Si.TMe	200	5	500	800	175	5	150	180	5	200	5	-50								84C	
" 625	ソニー	AF	Si.E	250	7	4A	6.2W (T _c =25°C)	100	3	50	90	2	100	10	-50								84B	
" 626	三洋	SW	Si.TMe	600	6	6A	80W (T _c =25°C)	150	100	350	>300	2	3.5A										102	ダーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考								
				V _{CB0}	V _{EBO}	I _C	P _C	T _J	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe}	h _{ic}	h _{re}	h _{oe}	f _{αβ}			C _{ob}	r _{bb'}						
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fb} *	(Ω)	(×10 ⁻⁴)	(μU)	(Mc)			(pF)	h _{ic(real)} *						
2SD657	東芝	PA	Si.TMe	200	5	1.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	200	40-180	10	500										102						
" 658																													
" 659																													
" 660	富士通	SW	Si.EP	90	6	2A	1W	200	1	70	>60	2	2A											84C					
" 661	松下	LN	"	35	7	100	300	135	0.1	10	540	5	2	5	2										151				
" 662	"	PA	Si.TP	250	5	70	600	135	10	250	100	10	5	10	3	35	300	0.4	2.7			80*	5		151				
" 663	富士電機	PA.SW	"	500	6	6A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	500	>400	1.5	4A												102	ターリントン			
" 664	東芝	SW	Si.T	80	5	7A	40W (T _c =25°C)	150	100	80	2000-15000		3	3A												99	ターリントン		
" 665	"	PA	Si.TMe	200	5	15A	150W (T _c =25°C)	150	100	100	40-140	5	1A	10	-1A								15*	300		102	2SB645 とコンパリ		
" 666	日立	"	Si.E	120	5	50	900	150	10	100	60-320	5	10	5	-10											251	2SB646 とコンパリ		
" 667	"	"	"	120	5	1A	900	150	10	100	60-320	5	150	5	-150												251	2SB647 とコンパリ	
" 668	"	"	"	180	5	50	1W	150	10	160	60-320	5	10	10	-10												160	2SB648 とコンパリ	
" 669	"	"	"	180	5	1.5A	20W (T _c =25°C)	150	10	160	60-320	5	150	5	-500												160	2SB649 とコンパリ	
" 670	"	"	Si.EPa	100	7	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	100	1000-20000		3	8A													102	ターリントン ダンパ付蔵	
★ " 671	松下	SW	Si.EP	30	7	500	600	135	0.1	25	280-700	2	50	10	-50													138	
" 672	"	PA	Si.TMe	300	6	1A	40W (T _c =25°C)	150	5mA	300	150	5	100	10	-100													102	
★ " 673	日立	"	Si.T	120	5	7A	60W (T _c =25°C)	150	1mA	100	60-200	5	1A															102	2SB653 とコンパリ
★ " 674	"	"	"	120	5	7A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	100	60-200	5	1A															102	2SB654 とコンパリ
★ " 675	"	"	"	160	5	12A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	140	60-200	5	1A															102	2SB655 とコンパリ
★ " 676	"	"	"	160	5	12A	125W (T _c =25°C)	150	1mA	140	60-200	5	1A															102	2SB656 とコンパリ
★ " 677	富士電機	SW	Si.TP	450	7	5A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	450	>10	4	2A															102	
★ " 678	松下	PA	Si.EMe	60	5	3A	25W (T _c =25°C)	150	200	60	4000	3	500	3	-1.5A													268	ターリントン
★ " 679	"	"	"	70	5	4A	40W (T _c =25°C)	150	200	70	4000	3	1A	3	-3A													268	ターリントン
" 680																													
" 681																													
" 682																													
" 683	東芝	PA.SW	Si.TMe	600	5	15A	150W (T _c =25°C)	150	500	600	>500	5	5A															102	ターリントン
" 684	"	"	"	600	5	6A	30W (T _c =25°C)	150	500	600	>1500	2	2A															99	ターリントン
" 685	"	"	"	600	5	10A	100W (T _c =25°C)	150	500	600	>400	2	4A															102	ターリントン
" 686	"	"	Si.E	100	5	4A	30W (T _c =25°C)	150	20	100	>2000	2	1A															268	ターリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バ イ ア ス		h _{fe}	h _{ie} * (Ω)	h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} * (μΩ)	f _{αβ} (Mc)			C _{ob} (pF)	T _{th} h _{ie} (real)* (Ω)		
									I _{CB0} (μA)	V _{CB} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fb} *										V _{CE} (V)	I _C (mA)
2SD687	東芝	PA.SW	Si.E	60	5	3A	25W (T _c =25°C)	150	20	60	>2000	2	1A										268	ダーリントン	
" 688	"	"	"	100	10	1.5A	800 (T _c =25°C)	175	10	100	>2000	2	100										84B	ダーリントン 2SB677 とコンプリ	
" 689	"	"	"	100	10	1.5A	10W (T _c =25°C)	150	10	100	>2000	2	100										268	ダーリントン 2SB677 とコンプリ	
" 690	"	"	Si.T	70	5	7A	40W (T _c =25°C)	150	30	70	70-240	1	1A								250		99		
" 691	松下	PA	Si.TMe	100	6	6A	40W (T _c =25°C)	150	10	100	4000	4	1A										288	ダーリントン	
" 692	"	"	"	100	6	6A	50W (T _c =25°C)	150	10	100	4000	4	1A										102	ダーリントン	
" 693	"	SW	"	450	10	10A	80W (T _c =25°C)	150			>150	5	5A										102	ダーリントン	
" 694	東芝	"	"	400	5	30A	300W (T _c =25°C)	150	600	400	>150	5	30A					350					266	ダーリントン	
" 695	"	"	"	400	5	30A	350W (T _c =25°C)	150	1mA	400	>150	5	30A											319	ダーリントン
" 696	"	"	"	400	5	50A	400W (T _c =25°C)	150	1mA	400	>150	5	50A								600			319	ダーリントン
" 697	"	"	"	500	5	100A	770W (T _c =25°C)	125	2mA	500	>100	5	100A											158	ダーリントン
" 698	"	"	"	200	4	600A	2500W (T _c =25°C)	125	5 mA	200	400	5	600A											156	ダーリントン
" 699	"	"	"	300	5	30A	250W (T _c =25°C)	150	600	200	1000	5	10A											266	ダーリントン
" 700	"	"	"	300	5	200A	770W (T _c =25°C)	125	1mA	300	>150	5	200A											158	ダーリントン
" 701																									
" 702	東芝	SW	Si.TMe	400	5	40A	300W (T _c =25°C)	150	1mA	400	>10	5	30A								400			266	
" 703	"	"	"	200	5	30A	300W (T _c =25°C)	150	600	150	>150	5	30A								450			266	ダーリントン
★ " 704	三菱	"	Si.EP	50	7	5A	40W (T _c =25°C)	150	30	50	90-500	1	1A	10	-500					10*				301B	
" 705	富士電機	"	Si.TP	600	15	8A	80W (T _c =25°C)	150	100	450	300	1.5	6A											102	ダーリントン
" 706	"	"	"	345	15	6A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	345	1000	1.5	4A											102	ダーリントン
" 707	"	PA.SW	"	500	6	8A	100W (T _c =25°C)	150	500	500	>200	2	4A											102	ダーリントン
" 708	"	"	"	345	15	6A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	345	1000	1.5	4A											322	ダーリントン
" 709	"	"	"	250	6	4A	25W (T _c =25°C)	150	1 mA	250	>1500	2	2A											322	ダーリントン
" 710	"	"	"	300	7	15A	150W (T _c =25°C)	150	50	300	500	2	12A											102	ダーリントン
" 711	"	"	"	500	6	15A	100W (T _c =25°C)	150	1 mA	500	>100	1.5	10A											102	ダーリントン
★ " 712	三菱	PA	Si.EP	100	5	4A	30W (T _c =25°C)	150	30	100	55-300	5	500	10	-500					8*	45			301B	2SB682 とコンプリ
★ " 713	"	"	"	100	5	5A	40W (T _c =25°C)	150	30	100	55-300	5	1A	10	-500					8*	75			301B	2SB683 とコンプリ
" 714																									
★ " 715	三菱	PA	Si.EP	110	5	7A	80W (T _c =25°C)	150	100	110	2000-24000	4	1A	10	-500					30*				341	ダーリントン
" 716	東芝	"	Si.T	100	5	6A	60W (T _c =25°C)	150	10	100	55-160	5	1A	5	-1A					12*	100			179	2SB686 とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電気的特性 (T _a = 25°C)											外形	備考	
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値 (μA)	V _{CEB} (V)	直流又はパルス hFE		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{αB} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)
2SD717	東芝	SW	Si.T	70	5	10A	80W (T _c =25°C)	150	10	70	70~240	1	1A	4	-1A	t _{on} =0.3μS, t _{off} =2.5μS	10*	350		179		
" 718	"	PA	"	120	5	8A	80W (T _c =25°C)	150	10	120	55~160	5	1A	5	-1A		12*	170		179	2SB688 とコンパリ	
" 719																						
* " 720	三菱	SW	Si.T	400	10	7A	100W (T _c =25°C)	150	100	400	700	2	4.5A							102	ゲリントン	
" 721	サンケン	PA	Si.DJ	100	6	6A	50W (T _c =25°C)	150	100	100	1000	4	7A							298	ゲリントン	
" 722	"	"	"	120	6	6A	50W (T _c =25°C)	150	100	120	1000	4	7A							298	ゲリントン	
* " 723	日立	"	Si.T	100	4	4A	40W (T _c =25°C)	150	I _{CEO} 100μA	V _{CE} 80V	50~250	4	500							268		
* " 724	"	"	"	200	5	4A	30W (T _c =25°C)	150	I _{CEO} 100μA	V _{CE} 150V	>20	5	4A			t _f <1μS				268		
" 725	"	SW	"	1500	7	6A	50W (T _c =25°C)	150	I _{Cmax} 1mA	1500	>5	5	5A			t _f <2μS				102	水平偏向用	
* " 726	"	PA	"	100	5	4A	40W (T _c =25°C)	150	100	80	35~320	5	1A	5	-500			10*	40	268	2SB690 とコンパリ	
* " 727	松下	"	Si.EMe	130	5	5A	60W (T _c =25°C)	150	50	80	60~200	5	1A	5	-500			7*	110	152	2SB691 とコンパリ	
* " 728	"	"	"	150	5	6A	70W (T _c =25°C)	150	50	100	100	5	1A	5	-500			7*	160	152	2SB692 とコンパリ	
" 729	日立	PA.SW	Si.EPa	100	7	20A	125W (T _c =25°C)	150	I _{CEO} 1	80	1000~ 20000	3	10A			t _{on} =2μS, t _{off} =8μS				102	ゲリントン ダンパ内蔵	
" 730	"	"	Si.E	100	7	25A	125W (T _c =25°C)	150	I _{CEO} 1	V _{CE} 80	1000~ 20000	3	12A			t _{on} =2μS, t _{off} =8μS				102	ゲリントン ダンパ内蔵	
" 731	松下	PA	Si.EMe	170	5	7A	80W (T _c =25°C)	150	50	120	100	5	1A	5	-500			7*	180	152	2SB695 とコンパリ	
" 732	三洋	"	"	150	6	8A	80W (T _c =25°C)	150	100	80	40~320	5	1A	5	-1A			15*		102	2SB696 とコンパリ	
" 733	"	"	"	160	6	12A	100W (T _c =25°C)	150	100	80	40~320	5	1A	5	-1A			15*		102	2SB697 とコンパリ	
" 734	"	PA.SW	Si.EP	25	5	700	600	150	1	20	60~560	2	50	10	-50			250*	8	138		
* " 735	日立	PA	Si.T	160	5	12A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	120	35~200	5	1A							332	2SB699 とコンパリ	
* " 736	"	"	"	160	5	12A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	120	60~200	5	1A							332	2SB700 とコンパリ	
" 737	"	"	"	160	5	12A	120W (T _c =25°C)	150	1mA	140	120	5	1A								332	
* " 738	"	"	"	160	5	12A	125W (T _c =25°C)	150	1mA	140	60~200	5	1A								332	2SB702 とコンパリ
" 739																						
" 740																						
" 741	日電	SW	Si.E	40	6	5A	15W (T _c =25°C)	150	1	40	250	2	500	5	-100	t _{on} =1.5μS t _{off} =0.4μS		200*	50		225	
" 742																						
" 743	日電	PA.SW	Si.T	100	5	4A	40W (T _c =25°C)	150	10	80	100	5	500	5	-100			17*	80		268	2SB703 とコンパリ
" 744																						
" 745	日電	PA	Si.T	140	5	10A	120W (T _c =25°C)	150	50	140	80	5	2A	5	-200			15*	270		340	2SB705 とコンパリ
* " 746	"	"	"	180	5	10A	200W (T _c =25°C)	150	50	180	80	5	2A	5	-200			15*	300		265	2SB706 とコンパリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE} h _{FE} *	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μS)			f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(real)*} (Ω)	
									μA	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)											
2SD777	東芝	PA	Si 二重拡散	55±10	6	4 A	100W (T _c =25°C)	150	100	40	1000	5	500										102	
" 778																								
" 779																								
" 780	日電	AF	Si.E	60	5	300	200	150	0.1	50	200	1	50	6	-10					140*	7	176	2SB736 とコンプリ	
" 781	日立	SW	Si.EP	150	5	2 A	1 W	150	1	100	150	5	1.5A			t _f =0.35μS							160	
★ " 782	"	"	Si 二重拡散	300	5	5 A	30W (T _c =25°C)	150	5 mA	300	80	5	300			t _f < 1 μS							268	水平偏向用
" 783	"	"	"	1500	6	4 A	50W (T _c =25°C)	150	I _{CB0} 500	1500	15	5	300			t _f < 2 μS							102	水平偏向用
" 784	"	"	"	1700	6	5 A	50W (T _c =25°C)	150	I _{CB0} 1 mA	1700	10	5	100			t _f < 2 μS							102	水平偏向用
" 785	"	"	Si.T	1900	6	5 A	50W (T _c =25°C)	150	I _{CB0} 1 mA	1900	10	5	100			t _f < 2 μS							102	水平偏向用
" 786	ローム	AF.LN	Si.EP	50	5	300	250	125	0.5	30	120~560	6	10	6	-10	V _{NO} <150mV (10V, 1mA, R _G =100kΩ, A _v =80dB)	100*				4	138	2SB737 とコンプリ	
" 787	日立	PA	Si.E	20	6	2 A	900	150	2	16	100~800	2	100	2	-10		80*	20				251	2SB738 とコンプリ	
" 788	"	"	"	20	6	2 A	900	150	2	16	100~800	2	100	2	-10		80*	20				251	2SB739 とコンプリ	
" 789	"	"	"	100	6	1 A	900	150	1	80	100~800	2	100	2	-10		80*	20				251	2SB740 とコンプリ	
" 790	"	"	"	100	6	1 A	900	150	1	80	100~320	2	100	2	-10		80*	20				251	2SB741 とコンプリ	
" 791																								
" 792	松下	SW	Si.TMe	1500	4	5 A	35W (T _c =90°C)	130	50	750	> 4	10	4 A			t _f < 0.7 μS							102	水平偏向用
★ " 793	日電	PA.SW	Si.E	40	5	3 A	10W (T _c =25°C)	150	1	30	100	5	1 A	5	-100		65*	55				225	2SB743 とコンプリ	
" 794	"	"	"	70	5	3 A	10W (T _c =25°C)	150	1	45	100	5	500	5	-100		60*	40				225	2SB744 とコンプリ	
" 795	"	"	"	50	5	3 A	20W (T _c =25°C)	150	1	50	160	1	500	5	-100		95*	40				268		
" 796	富士電機	SW.PA	Si.TP	500	6	8 A	100W (T _c =25°C)	150	500	500	>200	2	4 A			t _{on} <1.4 μS, t _f < 6 μS t _{stg} <15 μS							102	ターリントン
" 797	東芝	PA.SW	Si.T	100	7	30A	200W (T _c =25°C)	175	100	100	60~200	5	1 A	5	-1A	t _{on} =1.5 μS, t _f =1 μS t _{stg} =6 μS	3*	400				268	ターリントン	
" 798	"	"	"	600	5	6 A	30W (T _c =25°C)	150	500	600	>1500	2	2 A			t _{on} =1 μS, t _f =5 μS t _{stg} =8 μS						35	102	ターリントン
" 799	"	"	"	600	5	6 A	30W (T _c =25°C)	150	500	600	>600	2	2 A			t _{on} =1 μS, t _f =5 μS t _{stg} =8 μS						35	268	ターリントン
★ " 800	日立	SW	"	750	6	4 A	30W (T _c =25°C)	125	I _{CE} S 500	750	15~60	5	1 A	10	-200	t _f =0.15 μS t _{stg} =1.2 μS	8*	85				102		
" 801	"	"	"	800	7	6 A	50W (T _c =25°C)	150	1 mA	800	3.5~12	5	4 A			t _f < 0.5 μS						102		
" 802	"	"	"	900	7	6 A	50W (T _c =25°C)	150	1 mA	900	3.5~12	5	4 A			t _f < 0.5 μS						102		
" 803	松下	PA	Si.DJ	120	6	8 A	100W (T _c =25°C)	150	1 mA	120	>1000	4	1 A			h _{FE} > 7 (V _{CE} =40V, I _C =40A)						102	ターリントン	
" 804																								
" 805	富士電機	SW	Si.TP	600	6	30A	200W (T _c =25°C)	150	1 mA	600	>100	5	30A			t _{on} < 3 μS, t _f < 4 μS t _{stg} <12 μS							266	ターリントン
" 806	"	"	"	600	6	50A	400W (T _c =25°C)	150	1 mA	600	>100	5	50A			t _{on} < 3 μS, t _f < 4 μS t _{stg} <12 μS						254	ターリントン	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考				
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE			バ イ ア ス		h _{fe} h _{fe} *	h _{ie} h _{ie} *	h _{re} h _{re} *	h _{oe} h _{oe} *			f _{os} f _{os} *	C _{ob} (pF)	τ _{bb'} h _{bb'(real)} *	
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fe} *										h _{ie} *
2SD807	サンケン	SW	Si.TMe	1000	7	5 A	50W (T _c =25°C)	150	1 mA	1000	11	4	1 A											102	
" 808	日立	RF	Si.EP	25	5	500	400	150	0.2	18	120	1	50	1	-50					250*	3.2	C _e 12pF	138		
" 809	日電	PA.SW	Si.E	100	6	1 A	10W (T _c =25°C)	150	0.1	50	250	2	100	2	-10					85*	15		225	2SB731 とコンパリ	
" 810	サンケン	PA	Si.EMe	20	20	4 A	30W (T _c =25°C)	150	1 mA	20	400	4	1 A										298		
" 811	東芝	PA.SW	Si.TMe	900	5	8 A	50W (T _c =25°C)	150	1 mA	100	8	5	4 A										102		
" 812	松下	PA	Si.TP	80	5	5 A	50W (T _c =25°C)	150	50	80	90	5	1 A										268		
" 813	"	"	Si.EP	25	7	500	200	125	0.1	25	65~220	2	500	10	-50					150*	6		176		
" 814	"	AF.LN	"	150	5	50	200	125	1	100	65~450	5	10	10	-10					150*	2.3		176		
" 815	富士電機	SW	Si.TP	120	6	30A	300W (T _c =25°C)	150	1 mA	120	300	3	30A										266	ターリントン	
" 816	"	"	"	300	6	4 A	30W (T _c =25°C)	150	1 mA	300	1500	2	3 A										268		
" 817																									
" 818	東芝	SW	Si.TMe	1500	5	2.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	20	5	500	10	-100					3*	95		102	水平偏向用	
" 819	"	"	"	1500	5	3.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	20	5	500	10	-100					3*	95		102	水平偏向用	
" 820	"	"	"	1500	5	5 A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	-100					3*	165		102	水平偏向用	
" 821	"	"	"	1500	5	6 A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	-100					3*	165		102	水平偏向用	
" 822	"	"	"	1500	5	7 A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	20	5	1 A	10	-100					3*	165		102	水平偏向用	
" 823	三洋	SW	Si.EP	200	7	6 A	40W (T _c =25°C)	150	100	40	>20	5	3 A	5	-1 A					15*			268		
" 824	日立	PA	Si.T	120	5	6 A	60W (T _c =25°C)	150	1 mA	80	100	5	1 A										332		
" 825	"	"	"	120	5	7 A	80W (T _c =25°C)	150	1 mA	100	100	5	1 A										332		
" 826	三洋	SW	Si.EP	60	6	5 A	10W (T _c =25°C)	150	1	50	120~560	2	500	10	-50					120*	45		296		
" 827	日立		Si.T	500	7	4 A	80W (T _c =25°C)	150	I _{CS0} 1 mA	500	>500	2	4 A										332	ターリントン タンパ内蔵	
" 828	"	"	"	500	7	4 A	80W (T _c =25°C)	150	5	400	2000	2	4 A										333	ターリントン タンパ内蔵	
" 829	"	"	"	150	7	15A	100W (T _c =25°C)	150	0.1	80	4000	2	15A										332	ターリントン タンパ内蔵	
* " 830	富士通	"	Si.P	150	7	5 A	30W (T _c =25°C)	150	1	100	6000	2	3 A										268	ターリントン	
" 831																									
" 832	富士通	SW	Si.EP	600	6	50A	400W (T _c =25°C)	150	1 mA	600	200	5	50A										228	ターリントン	
" 833	富士電機	SW.PA	Si.TP	60	5	7 A	40W (T _c =25°C)	150	100	60	>4000	3	3 A										268	ターリントン	
" 834	"	"	"	250	10	4 A	25W (T _c =25°C)	150	100	250	>1500	2	2 A										268	ターリントン	
" 835	"	"	"	400	15	6 A	40W (T _c =25°C)	150	100	400	>400	1.5	4 A										268	ターリントン	
" 836	松下	PA	Si.EP	60	5	2 A	35W (T _c =25°C)	150	1 mA	60	1000~ 10000	4	1 A										268	ターリントン	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{FE}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{αβ} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie'(real)} *	
									(μA)	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CB(V)}	I _E (mA)										h _{FE}
2SD837	松下	PA	Si.EP	60	5	4 A	40W (T _a =25°C)	150	200	60	1000~10000	3	3 A									268	ダーリントン	
" 838	三洋	SW	Si.T	2500	6	3 A	50W (T _a =25°C)	150	50	1000	3~15	10	1.5A									102	水平偏向用	
" 839	三菱	"	Si.EP	35	20	4 A	30W (T _a =25°C)	150	10	30	1000~3000	5	500									301B	ダーリントン	
" 840	"	"	"	70	20	5 A	40W (T _a =25°C)	150	10	60	1000~3000	5	500									301B	ダーリントン	
" 841	東芝	"	Si.T	800	5	3 A	40W (T _a =25°C)	150	1mA	800	20	5	500	10	-100	t _{on} < 1 μS, t _{off} < 7 μS	t _f < 1 μS			27 *	4 *	75	268	
" 842	"	AF.PA.SW	"	80	5	30A	150W (T _a =25°C)	150	100	80	4000	5	20A			t _{on} < 2 μS, t _{off} < 20 μS	t _f < 5 μS						102	ダーリントン ダンプ内蔵
" 843	"	PA.SW	"	100	5	7 A	40W (T _a =25°C)	150	5	100	70~240	1	1 A	4	-1A	t _{on} = 0.4 μS, t _{off} = 2.5 μS	t _f = 0.5 μS			10 *	250	268	2SB753 とコンプリ	
" 844	"	PA	"	50	5	7 A	60W (T _a =25°C)	150	10	50	70~240	1	1 A	5	-1A					15 *	250	179	2SB754 とコンプリ	
" 845	"	"	"	150	5	12A	120W (T _a =25°C)	150	50	150	100	5	1 A								200	125		
" 846																								
" 847	富士電機	SW.PA	Si.TP	40	5	15A	80W (T _a =25°C)	150	10	40	>40	2	5 A			t _{on} = 1 μS, t _{off} = 2 μS	t _f = 1 μS						211	2SB757 とコンプリ
" 848	日電	PA	Si.T	120	5	7 A	80W (T _a =25°C)	150	50	110	80	5	1 A										295	
" 849	松下	SW	Si.TMe	1500	5	3 A	70W (T _a =25°C)	150	100	750	7	10	3 A			t _{stg} < 16 μS, t _f < 1 μS							102	
" 850	"	"	"	1500	5	3 A	65W (T _a =25°C)	150	50	750	8	10	2.5A			t _{stg} < 16 μS, t _f < 1 μS							102	
" 851	日電	PA.SW	Si.E	150	8	10A	80W (T _a =25°C)	150	10	100	3000	2	10A			t _{on} = 1 μS, t _{off} = 2 μS	t _f = 1 μS						340	ダーリントン
" 852	"	"	"	150	8	15A	100W (T _a =25°C)	150	10	100	3000	2	15A			t _{on} = 1 μS, t _{off} = 3 μS	t _f = 1 μS						340	ダーリントン
" 853																								
" 854	三菱	PA	Si.EP	100	5	2.2A	10W (T _a =25°C)	150	0.5	50	100	5	1 A	5	-500	t _{on} < 100nS, t _{off} < 500nS					100 *	30	84B	
" 855	松下	"	Si.TP	60	5	1 A	30W (T _a =25°C)	150	200	60	120	4	200										268	
" 856	"	"	"	60	5	3 A	35W (T _a =25°C)	150	200	60	100	4	1 A										268	
" 857	"	"	"	60	5	4 A	40W (T _a =25°C)	150	400	60	100	4	1 A										268	
" 858	"	"	"	60	5	5 A	60W (T _a =25°C)	150	400	60	120	4	1 A										152	
" 859	"	"	"	350	5	750	35W (T _a =25°C)	150	1 mA	350	120	10	300										268	
" 860	"	"	"	350	5	1 A	40W (T _a =25°C)	150	1 mA	350	120	10	300										268	
" 861	"	"	"	350	5	1.5A	45W (T _a =25°C)	150	1 mA	350	120	10	300										268	
" 862	日電	"	Si.E	20	6	2 A	10W (T _a =25°C)	150	0.1	16	300	2	100										225	
" 863	三洋	AF.PA	Si.EP	60	5	1 A	900	150	1	50	60~320	2	50	10	-50						150 *	12	294	2SB764 とコンプリ
" 864	日立	PA.SW	Si.TP	120	7	3 A	30W (T _a =25°C)	150	100	120	1000~20000	3	1.5A			t _{on} = 0.5 μS, t _{off} = 4.5 μS	t _f = 1.1 μS						268	ダーリントン ダンプ内蔵
" 865	富士電機	SW	"	300	6	4 A	40W (T _a =25°C)	150	1 mA	300	1500	2	3 A			t _{on} < 2 μS, t _{off} < 15 μS	t _f < 5 μS						322	ダーリントン
" 866	松下	"	Si.EP	130	7	7 A	40W (T _a =25°C)	150	10	100	60~260	2	3 A	10	-500		t _f = 0.1 μS				30 *		268	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考				
				V_{CE0}	V_{EBO}	I_C	P_C	T_j	I_{CBO} 最大値		直 流 又 は バ ル ス hFE		バ イ ア ス		h_{fe}	h_{ie}	h_{re}	h_{oe}	$f_{\alpha b}$			C_{ob}	r_{bb}		
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	($^\circ\text{C}$)	(μA)	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(mA)$	$V_{CB}(V)$	$I_E(mA)$	h_{fb}^*	h_{ib}^* (Ω)	h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{ob}^* (μU)	(Mc)			(pF)	$h_{ie}(real)^*$ (Ω)		
2SD867	東芝	PA.SW	Si.T	130	7	10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	130	50-200	5	1A	5	-1A	$t_{on}=1.5\mu\text{S}$, $t_{stg}=4.5\mu\text{S}$					3 *	200		102	
" 868	"	SW	Si.TMe	1500	5	2.5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	12	5	500	10	-100	$t_f < 1\mu\text{S}$					3 *	95		102	水平偏向用
" 869	"	"	"	1500	5	3.5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	12	5	500	10	-100	$t_f < 1\mu\text{S}$					3 *	95		102	水平偏向用
" 870	"	"	"	1500	5	5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	12	5	1A	10	-100	$t_f < 1\mu\text{S}$					3 *	165		102	水平偏向用
" 871	"	"	"	1500	5	6A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	12	5	1A	10	-100	$t_f < 1\mu\text{S}$					3 *	165		102	水平偏向用
★ " 872	三菱	SW	Si.TP	500	7	5A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	450	20-45	5	1A			$t_r < 1\mu\text{S}$, $t_f < 1\mu\text{S}$ $t_{stg} < 2\mu\text{S}$								301B	
" 873	東芝	PA.SW	Si.T	160	7	16A	150W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	140	15-60	4	8A	4	-1A	$t_{on}=1.5\mu\text{S}$, $t_f=1\mu\text{S}$ $t_{stg}=6\mu\text{S}$					3 *	350		102	2N3773 相当
" 874	松下	PA	Si.EP	30	5	1A	500	125	0.1	20	160	10	500	10	-50					200 *	20		336	2SB766 とコンパリ	
" 875	"	"	"	80	5	500	500	125	0.1	20	160	10	150	10	-50					120 *	11		336	2SB767 とコンパリ	
" 876	"	"	Si.TP	200	6	1A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	200	500-2000	4	200	4	-100						25 *			268	
" 877	東芝	PA.SW	Si.T	110	7	3A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	110	60-300	5	500	5	-500	$t_{on}=1.5\mu\text{S}$, $t_f=2\mu\text{S}$ $t_{stg}=3\mu\text{S}$					3 *	85		99	
" 878	"	"	"	100	7	15A	115W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	100	100	20-70	4	4A	4	-1A	$t_{on}=2\mu\text{S}$, $t_f=1\mu\text{S}$ $t_{stg}=3.5\mu\text{S}$					3 *	150		102	2N3055 相当
" 879	三洋	SW	Si.EP	30	6	3A	750	150	1	20	210	2	3A	10	-50					200 *	30		138		
" 880	東芝	PA	Si.T	60	7	3A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	60	60-300	5	500	5	-500	$t_{on}=0.8\mu\text{S}$, $t_f=0.8\mu\text{S}$ $t_{stg}=1.5\mu\text{S}$					3 *	70		268	
" 881																									
" 882	日電	PA.SW	Si.E	40	5	3A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1	30	160	2	1A	5	-100						90 *	45		225	2SB772 とコンパリ
" 883	"	PA	Si.T	100	5	6A	70W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	90	80	5	1A											295	
" 884	松下	SW	Si.TP	330	6	7A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	330	25	4	5A			$t_{stg} < 2\mu\text{S}$, $t_f < 1\mu\text{S}$								268	
" 885	"	"	"	330	6	7A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	330	25	4	5A			$t_{stg} < 2\mu\text{S}$, $t_f < 1\mu\text{S}$								268	
" 886	"	PA	"	80	6	3A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	80	500-1500	4	500	12	-200						50 *			268	
" 887	"	"	"	80	6	4A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	80	1000	4	1A											268	
" 888	"	"	"	80	6	6A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	80	1000	4	1A											268	
" 889	"	AF	Si.EP	30	15	100	250	125	1	10	120-650	10	2							150 *	3		138		
" 890	"	"	"	100	15	20	250	135	1	10	300	10	2											138	
★ " 891	"	"	"	30	5	200	250	150	0.1	25	2000-20000	10	200											138	ダーリントン
" 892	"	"	"	30	5	500	400	150	0.1	25	2000-20000	10	500											138	ダーリントン
" 893	"	"	"	30	5	1A	750	150	0.1	25	2000-20000	10	1A											138	ダーリントン
" 894	三洋	AF.PA	"	30	10	1.5A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1	20	>4000	2	500	10	-50					120 *				296	ダーリントン
" 895	"	PA.SW	Si.P	100	6	6A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	40	60-200	5	1A	5	-1A					10 *	110		155	2SB775 とコンパリ	
" 896	"	"	"	120	6	7A	70W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	80	60-200	5	1A	5	-1A					10 *	140		155	2SB776 とコンパリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考			
				V _{CBO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CBO} 最大値		直流又はパルス hFE		バ イ ア ス		h _{FE} h _{FB} *	h _{FE} h _{FB} * (Ω)	h _{FE} h _{FB} * (×10 ⁴)	h _{FE} h _{FB} * (μG)			J _{ab} J _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
★ 2SD927	日立	AF. PA	Si. T	60		4 A	30W (T _e =25°C)	150	100	50	100	.5	500									268	
★ " 928	"	"	"	80		4 A	30W (T _e =25°C)	150	100	50	100	5	500									268	
" 929	富士電機	PA	Si. TP	200	6	5 A	80W (T _e =25°C)	150	1 mA	200	>700	4	1 A									102	
" 930	"	AF. PA	"	200	6	5 A	30W (T _e =25°C)	150	1 mA	200	5000	4	700									268	ゲーリントン
" 931	"	PA	"	200	6	5 A	50W (T _e =25°C)	150	1 mA	200	>700	4	1 A									102	
" 932	日立	"	Si. T	500	7	6 A	80W (T _e =25°C)	150	100	500	1500	2	4 A									332	ゲーリントン
" 933	"	"	"	300	7	6 A	80W (T _e =25°C)	150	100	300	1500	2	4 A									102	ゲーリントン タンパ内蔵
" 934	"	"	"	300	7	6 A	80W (T _e =25°C)	150	100	300	1500	2	4 A									332	ゲーリントン タンパ内蔵
★ " 935	松下	"	Si. TP	250	7	5 A	60W (T _e =25°C)	150	1 mA	200	100	4	1 A									152	
" 936	東芝	SW	Si. TMe	300	6	+30A -47A	400W (T _e =25°C)	150	600	300	>150	5	30A	t _{on} = 1 μS, t _{off} = 10 μS	t _f = 2.5 μS							319	
" 937	"	"	"	400	6	+30A -47A	400W (T _e =25°C)	150	600	400	>150	5	30A	t _{on} = 1 μS, t _{off} = 10 μS	t _f = 2.5 μS							319	
" 938	"	"	"	600	6	+30A -47A	400W (T _e =25°C)	150	600	600	>150	5	30A	t _{on} = 1 μS, t _{off} = 10 μS	t _f = 2.5 μS							319	
" 939	"	"	"	300	6	+40A -47A	400W (T _e =25°C)	150	800	300	>150	5	40A	t _{on} = 1 μS, t _{off} = 10 μS	t _f = 2.5 μS							319	
" 940	"	"	"	400	6	+40A -47A	400W (T _e =25°C)	150	800	400	>150	5	40A	t _{on} = 1 μS, t _{off} = 10 μS	t _f = 2.5 μS							319	
" 941	"	"	"	600	6	+40A -47A	400W (T _e =25°C)	150	800	600	>150	5	40A	t _{on} = 1 μS, t _{off} = 10 μS	t _f = 2.5 μS							319	
" 942	"	"	"	300	6	+50A -47A	400W (T _e =25°C)	150	1 mA	300	>150	5	50A	t _{on} = 1 μS, t _{off} = 8 μS	t _f = 2.5 μS							319	
" 943	"	"	"	400	6	+50A -47A	400W (T _e =25°C)	150	1 mA	400	>150	5	50A	t _{on} = 1 μS, t _{off} = 8 μS	t _f = 2.5 μS							319	
" 944																							
" 945																							
" 946	松下	AF	Si. EP	30	5	1 A	1.2W	150	0.1	25	2000~ 20000	10	1 A									222	ゲーリントン
" 947	ローム	AF. PA	"	40	6	2 A	5W (T _e =25°C)	150	1	24	20000	3	500									232	ゲーリントン
★ " 948	松下	SW	Si. TMe	1600	5	1 A	25W (T _e =25°C)	130	10	750	4	5	1 A	t _{stg} < 12 μS, t _f < 1.2 μS								153	水平偏向用
★ " 949	"	"	"	1500	5	2 A	40W (T _e =25°C)	130	50	750	4	5	2 A	t _{stg} < 13 μS, t _f < 1.2 μS								102	水平偏向用
" 950	"	"	"	1500	5	I _{CP} 4.5A	42W (T _e =25°C)	130			3~10											102	ダンパ内蔵
" 951	"	"	"	1500	5	I _{CP} 5 A	65W (T _e =25°C)	130			4~15			t _f < 0.9 μS								102	ダンパ内蔵
" 952	"	"	"	1500	5	I _{CP} 5 A	70W (T _e =25°C)	130			4~12			t _f < 0.9 μS								102	ダンパ内蔵
" 953	"	"	"	1500	5	I _{CP} 7 A	95W (T _e =25°C)	130			3~8			t _f < 0.8 μS								102	ダンパ内蔵
" 954	"	"	"	1500	5	5 A	95W (T _e =25°C)	130	50	750	7	10	4 A	t _{stg} < 16 μS, t _f < 1 μS								102	水平偏向用
" 955	日立	AF	Si. E	120	5	50	625	150	10	120	120	5	10									138D	
" 956	"	SW	Si. T	1500	6	2.5A	50W (T _e =25°C)	150	I _{CE} 500	1500				t _f < 1 μS								102	水平偏向用 タンパ内蔵

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE} h _{jb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)			r _ω h _{ie(Real)} * (Ω)	
										V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
★ 2SD957	日立	SW	Si. T	1500	6	6 A	50W (T _c =25°C)	150	I _{CEs} 500	1500											102	水平偏向用 タンパ内蔵	
" 958	松下	AF	Si. EP	120	7	20	400	135	0.1	50	180-1040	5	2									151	
" 959	"	SW	"	130	7	4 A	30W (T _c =25°C)	150	10	100	60-260	2	500	10	-500							268	
" 960	"	"	"	130	7	4 A	35W (T _c =25°C)	150	10	100	60-260	2	1 A	10	-500							268	
" 961	"	"	"	130	7	5 A	40W (T _c =25°C)	150	10	100	60-260	2	2 A	10	-500							268	
" 962	サンケン	PA	Si. TP	200	6	5 A	80W (T _c =25°C)	150	100	200	3000	4	1 A									102	ゲーリントン
" 963	"	"	"	200	6	5 A	100W (T _c =25°C)	150	100	200	3000	4	1 A									102	ゲーリントン
" 964																							
" 965	松下	AF	Si. EP	40	7	5 A	750	150	0.1	10	200-500	2	500									138	
" 966	"	"	"	40	7	5 A	1 W	150	0.1	10	200-500	2	500	6	-50							165	
" 967	"	"	"	30	5	200	400	135	0.1	25	7000	10	200									151	ゲーリントン
" 968	"	"	"	100	5	500	1 W (プリント基板使用)	150			65-330	10	150	10	-50							336	2SB789 とコンプリア
" 969	"	"	"	25	7	500	600	135	0.1	25	65-220	2	500									151	
" 970	日立	SW	Si. T	120	7	8 A	50W (T _c =25°C)	150	100	120	1000- 20000	3	4 A									268	2SB791 とコンプリア
" 971	サンケン	PA	Si. TP	300	6	6 A	50W (T _c =25°C)	150	1 mA	300	2000	2	2 A									298	ゲーリントン
" 972	"	"	"	50	6	4 A	30W (T _c =25°C)	150	100	50	3000	4	3 A									298	ゲーリントン
" 973	松下	AF	Si. EP	30	5	1 A	1 W	150	0.1	20	60-340	10	500									151	
" 974	日立	SW	Si. E	120	5	1 A	900	150	1	100	>150	5	1 A									251	水平偏向用
" 975	"	"	"	150	5	2 A	1 W	150	1	100	>150	5	1.5 A									160	水平偏向用
★ " 976	"	"	Si. T	300	6	7 A	50W (T _c =25°C)	150	5 mA	300	>25	5	5 A									268	水平偏向用
" 977	三洋	"	Si. TP	450	6	4 A	40W (T _c =25°C)	150	500	450	300	1.5	3 A									267	ゲーリントン
" 978	"	"	"	450	6	5 A	40W (T _c =25°C)	150	500	450	300	1.5	3 A									268	ゲーリントン
" 979	"	"	"	450	6	10 A	100W (T _c =25°C)	150	500	450	900	2.4	3.6 A									346	
" 980	"	"	"	450	6	7 A	100W (T _c =25°C)	150	500	450	900	2.4	3.6 A									346	
" 981	富士電機	PA	Si. TP	200	6	5 A	100W (T _c =25°C)	150	1 mA	200	3000	4	1 A	12	-500							102	ゲーリントン
" 982	"	"	"	200	6	5 A	40W (T _c =25°C)	150	1 mA	200	3000	4	1 A	12	-500							268	ゲーリントン
" 983	"	"	"	150	6	6 A	40W (T _c =25°C)	150	1 mA	150	3000	4	1 A	12	-500							268	ゲーリントン
" 984																							
" 985	日電	PA. SW	Si. E	150	8	1.5 A	10W (T _c =25°C)	150	10	60	2000- 30000	2	1 A									225	ゲーリントン
" 986	"	"	"	150	8	1.5 A	10W (T _c =25°C)	150	10	80	2000- 30000	2	1 A									225	ゲーリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考						
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA) V _{CB} (V)		直流又はパルス hFE V _{CE} (V) I _C (mA)		バイアス V _{CB} (V) I _E (mA)		h _{FE} h _{FE} *	h _{ie} h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μΩ)			f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{bb} (real)* (Ω)			
2SD987	日電	SW	Si.T	500	8	5A	40W (T _c =25°C)	150	10	400	>100	2	3A										268	ターリントン		
" 988																										
" 989																										
" 990																										
" 991	日立	SW	Si.T	300	7	6A	50W (T _c =25°C)	150	I _{CB0}	300	>500	2	4A											268	ダンパ内蔵	
" 992	日電	PA.SW	Si.E	30	5	2A	10W (T _c =25°C)	150	10	20	>50	5	500											186		
" 993	三洋	SW	Si.TMe	1500	6	3A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	1500	10	5	2A											102	水平偏向用	
" 994	"	"	"	1500	6	8A	50W (T _c =25°C)	150	100	1000	10	5	5A											102	水平偏向用	
" 995	"	"	"	2500	6	3A	50W (T _c =25°C)	150	1mA	2500	10	10	1.5A											102	水平偏向用	
" 996																										
" 997	日電	PA	Si.T	250	5	10A	200W (T _c =25°C)	150	50	200	80	5	2A	5	-200					15*	300		102	2SB796 とコンパリ		
" 998	"	"	Si.E	100	8	1.5A	10W (T _c =25°C)	150	10	60	7000	2	500											225	ターリントン	
" 999	"	"	"	30	5	1A	2W (セラミック基板使用)	150	0.1	30	200	1	100	6	-10										336	2SB798 とコンパリ
" 1000	"	"	"	60	5	700	2W (セラミック基板使用)	150	0.1	60	200	1	100	6	-10										336	2SB799 とコンパリ
" 1001	"	AF	"	80	5	300	2W (セラミック基板使用)	150	0.1	80	200	1	50	6	-10										336	2SB800 とコンパリ
" 1002	"	"	"	45	5	1A	400	150	0.1	30	100	2	150	10	-10										336	
" 1003	"	"	"	60	5	1A	400	150	0.1	30	90	2	150	10	-10										336	
" 1004	"	"	"	100	5	1A	400	150	0.1	30	90	2	150	10	-10										336	
" 1005	"	"	"	100	5	1A	2W (セラミック基板使用)	150	0.1	100	200	2	100	5	-10										336	2SB804 とコンパリ
" 1006	"	"	"	100	5	700	2W (セラミック基板使用)	150	0.1	100	200	1	100	10	-10										336	2SB805 とコンパリ
" 1007	"	"	"	120	5	700	2W (セラミック基板使用)	150	0.1	120	200	1	100	10	-10										336	2SB806 とコンパリ
" 1008																										
" 1009	松下	AF	Si.EP	150	5	50	1W (プリント基板使用)	150	1	100	90~450	5	10	10	-10										336	2SB807 とコンパリ
" 1010	"	"	"	50	15	50	300	125	0.1	20	400~2000	10	2												138	
" 1011	"	"	"	100	15	20	300	125	0.1	50	400~2000	10	2												138	
" 1012	三洋	PA	"	20	5	700	250	125	1	15	160~960	2	50	10	-50										92	2SB808 とコンパリ
" 1013																										
" 1014																										
" 1015	ソニー	SW	Si.E	140	50	2A	900	150	2	100	150~1500	2	10												259	双方向性
" 1016	三洋	"	Si.TMe	1500	6	7A	50W (T _c =25°C)	150	40	1000	7	5	4A												102	水平偏向用

逆方向電流増幅率 h_{FE} = 150~1500
(V_{CE} = 2V, I_E = 10mA)

t_f < 0.9μS

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考						
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直流又はバラス h _{FE} V _{CE} (V)	I _C (mA)	バイアス V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fp} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{αb} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{iw} (real)* (Ω)				
2SD1017	日電	PA	Si.T	250	5	2A	50W (T _c =25°C)	150	100	200	40~250	10	400											162			
" 1018	"	"	"	250	5	4A	80W (T _c =25°C)	150	100	200	40~250	10	500												162		
" 1019																											
" 1020	日電	AF	Si.E	30	5	700	350	150	0.1	30	200	1	100	6	-10							170*	13	42	2SB810 とコンプリ		
" 1021	"	PA	"	30	5	1A	350	150	0.1	30	200	1	100	6	-10							130*	22	42	2SB811 とコンプリ		
" 1022	新電元	SW	Si.T	100	7	5A	30W (T _c =25°C)	150	100	100	>1500	3	3A			t _{on} = 1 μS, t _f = 1.5 μS t _{stg} = 2.5 μS									268	ダーリントン トランジスタ	
" 1023	"	PA.SW	Si.TP	200	7	5A	30W (T _c =25°C)	150	100	200	3000	3	3A			t _{on} < 2 μS, t _f < 5 μS t _{stg} < 8 μS									268	ダーリントン トランジスタ	
" 1024	"	SW	Si.T	100	7	8A	50W (T _c =25°C)	150	100	100	>1500	3	5A			t _{on} = 1 μS, t _f = 1.5 μS t _{stg} = 2.5 μS									268	ダーリントン トランジスタ	
" 1025	"	PA.SW	Si.TP	200	7	8A	50W (T _c =25°C)	150	100	200	3000	3	5A			t _{on} = 2 μS, t _f < 5 μS t _{stg} < 8 μS									268	ダーリントン トランジスタ	
" 1026	"	"	"	100	7	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	100	4000	3	10A			t _{on} < 2 μS, t _f < 3 μS t _{stg} < 5 μS									119	ダーリントン トランジスタ	
" 1027	"	"	"	200	7	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	200	3000	3	10A			t _{on} < 2 μS, t _f < 5 μS t _{stg} < 8 μS									119	ダーリントン トランジスタ	
" 1028																											
" 1029	三洋	PA	Si.TP	60	5	4A	40W (T _c =25°C)	150	100	40	120	2	1A												268		
" 1030	松下	AF	Si.EP	50	15	50	200	125	0.1	20	400~2000	10	2									120*	2.6	176			
" 1031	サンケン	PA	Si.TMe	120	6	6A	50W (T _c =25°C)	150	100	120	4000	2.2	4A												298	ダーリントン	
" 1032	松下	"	Si.TP	60	5	4A	60W (T _c =25°C)	150	400	60	40~250	4	3A			t _{on} = 0.2 μS, t _{off} = 1.4 μS									152	2SB812 とコンプリ	
" 1033	日電	"	Si.T	200	5	2A	20W (T _c =25°C)	150	50	150	40~200	10	400	10	-400							10*		185	2SB768 とコンプリ		
" 1034	東芝	SW	Si.TMe	600	6	300A	1250W (T _c =25°C)	125	2mA	600	300	5	300A			t _{on} < 5 μS, t _f < 20 μS t _{stg} < 15 μS										356	
" 1035	富士通	"	Si.P	150	100	3A	40W (T _c =25°C)	150	1	80	50	4	1A			t _r = 1.1 μS, t _f = 1.5 μS t _{stg} = 3.5 μS										268	ダーリントン
" 1036	"	"	"	150	100	15A	150W (T _c =25°C)	150	1	80	35	4	5A			t _r = 1.2 μS, t _f = 1.8 μS t _{stg} = 3.2 μS										163	
" 1037	"	"	"	150	100	30A	180W (T _c =25°C)	150	5	80	35	4	10A			t _r = 1.2 μS, t _f = 1.6 μS t _{stg} = 2.9 μS										163	
" 1038	"	"	"	150	100	40A	180W (T _c =25°C)	150	5	80	40	4	15A			t _r = 1.3 μS, t _f = 2 μS t _{stg} = 3 μS										163	
" 1039	"	"	"	150	100	3A	40W (T _c =25°C)	150	1	80	50	4	1A			t _r = 1.1 μS, t _f = 1.5 μS t _{stg} = 3.5 μS										99	
" 1040	"	"	"	150	100	15A	150W (T _c =25°C)	150	1	80	35	4	5A			t _r = 1.2 μS, t _f = 1.8 μS t _{stg} = 3.2 μS										102	
" 1041	"	"	"	150	100	30A	180W (T _c =25°C)	150	5	80	35	4	10A			t _r = 1.2 μS, t _f = 1.6 μS t _{stg} = 2.9 μS										102	
" 1042	"	"	"	150	100	40A	180W (T _c =25°C)	150	5	80	40	4	15A			t _r = 1.3 μS, t _f = 2 μS t _{stg} = 3 μS										102	
" 1043	松下	PA	Si.TP	430	10	5A	80W (T _c =25°C)	150	1mA	300	1000	5	5A												102	ダーリントン	
" 1044	"	"	Si.DJ	100	6	6A	60W (T _c =25°C)	150	10	100	700~10000	4	1A												152	ダーリントン	
* " 1045	日立	AF.SW	Si.E	30	6	3A	90W	150	1	10	160~800	2	100	2	-100							200*	30	251			
" 1046	三洋	PA.SW	Si.P	150	6	8A	80W (T _c =25°C)	150	100	80	60~200	5	1A	5	-1A							15*	160	155	2SB816 とコンプリ		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考		
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{ie} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SD1077	日立	PA	Si.E	35	5	2.5A	20W (T _e =25°C)	150	20	35	160	2	500									245	
" 1078	"	"	"	50	4	2A	20W (T _e =25°C)	150	5	50	100	4	50	4						130*		245	
" 1079	"	"	"	80	4	2A	20W (T _e =25°C)	150	5	50	100	4	50	4						130*		245	
" 1080	"	"	"	180		1.5A	20W (T _e =25°C)	150	10	160	100	5	150	5						140*	14	245	2SB840 とコンプリ
" 1081	"	"	"	180		1.5A	20W (T _e =25°C)	150	10	160	100	5	150	5						140*	14	245	2SB841 とコンプリ
" 1082	"	"	"	200	5	1.5A	20W (T _e =25°C)	150	10	160	100	5	150									245	
" 1083	"	PA.SW	Si.EP	150	5	2A	10W (T _e =25°C)	150	1	100	200	5	1.5A									245	水平偏向用
" 1084	"	PA	Si.T	500	4	50A	400W (T _e =25°C)	150	1mA	500	300	5	50A									351	ターリントン
" 1085	"	"	Si.E	300	7	3A	40W (T _e =25°C)	150	100	300	3000	2	2A									268	ターリントン ダンパ内蔵
" 1086																							
" 1087	東芝	AF.PA.SW	Si.T	100	5	15A	100W (T _e =25°C)	150	100	100	3000	3	15A									125	ターリントン
" 1088	"	"	"	300	5	6A	30W (T _e =25°C)	150	500	300	5000	2	2A									268	ターリントン
" 1089	"	"	"	350	5	6A	30W (T _e =25°C)	150	500	300	1000	2	2A									268	ターリントン
" 1090	"	PA	"	200	5	5A	80W (T _e =25°C)	150	100	200	1000	5	1A									203	
" 1091	松下	"	Si.TP	170	6	4A	40W (T _e =25°C)	150	100	170	5000	4	1A									268	ターリントン
" 1092	東芝	"	Si.T	45	6	4A	80W (T _e =25°C)	150	100	40	1000	5	500									203	
" 1093	日立	PA.SW	"	1000	6	7A	50W (T _e =25°C)	150	100	100	20	5	2.5A									102	
" 1094	"	SW	"	1000	6	10A	50W (T _e =25°C)	150	100	1000	30	5	2.5A									102	
" 1095	"	"	"	1200	6	1.5A	50W (T _e =25°C)	150	500	600	8	5	300									102	水平偏向用
" 1096	"	PA	Si.E	25	5	1A	10W (T _e =25°C)	150	1	20	140	2	500									245	
" 1097	"	SW	Si.T	1200	6	2.5A	50W (T _e =25°C)	150	500	600	8	5	300									102	水平偏向用
" 1098	"	"	"	1200	6	3A	50W (T _e =25°C)	150	500	600	8	5	300									102	水平偏向用
" 1099	"	"	"	1200	6	5A	50W (T _e =25°C)	150	500	600	12	5	1A									102	水平偏向用
" 1100																							
" 1101	日立	AF	Si.E	25		700	150	125	1	20	140	1	150									176	2SB831 とコンプリ
" 1102	"	SW	Si.T	1200	6	4A	50W (T _e =25°C)	150	500	600	10	5	1A									102	水平偏向用
" 1103	"	"	"	1200	6	5A	50W (T _e =25°C)	150	500	600	12	5	1A									102	水平偏向用
" 1104	"	"	"	1200	6	6A	50W (T _e =25°C)	150	500	600	12	5	1A									102	水平偏向用
" 1105	松下	PA	Si.DJ	120	7	15A	200W (T _e =25°C)	150	30	40	80	4	5A									102	
" 1106	日電	"	Si.T	450	7	50A	400W (T _e =25°C)	150	1mA	450	300	5	50A									359	ターリントン

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CE0} 最大値 (μA)	V _{CEB} (V)	直流又はパルス h _{FE} V _{CE} (V)	I _C (mA)	バイアス V _{CB} (V) I _E (mA)		h _{je} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{αβ} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie(real)} * (Ω)	
2SD1107	日電	PA	Si.T	500	7	50A	400W (T _c =25°C)	150	1mA	500	300	5	50A										359	ターリントン
" 1108																								
" 1109	日電	PA	Si.T	100	5	6A	70W (T _c =25°C)	150	50	100	80	5	1A										162	
" 1110	"	"	"	120	5	7A	80W (T _c =25°C)	150	50	120	80	5	1A	5	-200					15*	190	162	2SB849 とコンプリ	
" 1111	三洋	AF	Si.EP	80	10	700	600	150	0.1	40	25000	2	50										138	ターリントン
" 1112	松下	"	Si.TP	350	7	200	750	150	10	300	120	10	10										336	
" 1113	日立	PA	Si.T	300	7	6A	40W (T _c =25°C)	150	100	300	3000	2	4A										268	ターリントン デンハ内蔵
" 1114	"	"	"	400	7	6A	50W (T _c =25°C)	150	100	300	3000	2	4A										268	ターリントン デンハ内蔵
" 1115	"	"	"	400	7	3A	40W (T _c =25°C)	150	100	300	3000	2	2A										268	ターリントン デンハ内蔵
" 1116	"	"	"	400	7	3A	40W (T _c =25°C)	150	100	300	3000	2	2A										268	ターリントン
" 1117	富士電機	"	Si.TP	40	7	10A	50W (T _c =25°C)	150	10	40	120	5	2A										268	
" 1118	"	SW	"	80	15	10A	50W (T _c =25°C)	150	10	80	400	5	1A			t _{on} < 1 μS, t _{off} < 1 μS							268	
" 1119	松下	AF	Si.EP	40	7	5A	500	150	0.1	10	260	2	500										336	
" 1120	"	PA	Si.TP	200	6	2A	40W (T _c =25°C)	150	100	200	1000	4	200										268	
" 1121	"	"	"	200	6	3A	50W (T _c =25°C)	150	100	200	1000	4	1A										268	
" 1122	"	"	"	200	6	5A	80W (T _c =25°C)	150	100	200	1000	4	1A										152	
" 1123	"	"	"	200	6	8A	100W (T _c =25°C)	150	100	200	1000	4	1A										152	
" 1124	"	"	"	80	6	8A	80W (T _c =25°C)	150	100	80	1000	4	1A										152	
" 1125	"	"	"	80	6	12A	100W (T _c =25°C)	150	100	80	1000	4	1A										152	
" 1126	日立	PA.SW	Si.T	120	7	10A	50W (T _c =25°C)	150	100	120	3000	3	5A			t _{on} < 2 μS, t _{off} < 16 μS							268	ターリントン デンハ内蔵
" 1127	"	"	"	120	7	10A	50W (T _c =25°C)	150	100	120	3000	2	10A			t _{on} < 2 μS, t _{off} < 16 μS							268	ターリントン デンハ内蔵
" 1128	富士電機	PA	Si.TP	150	6	5A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	150	5000	4	1A	5	-500					22*	54	268	ターリントン	
" 1129	日立	PA.SW	Si.E	100	7	15A	100W (T _c =25°C)	150	100	100	3000	3	8A			t _{on} < 2.5 μS, t _{off} < 10 μS							332	ターリントン
" 1130	"	"	"	100	7	20A	100W (T _c =25°C)	150	100	100	3000	3	10A			t _{on} < 2.5 μS, t _{off} < 10 μS							332	ターリントン
" 1131	"	PA	Si.T	50	4	4A	40W (T _c =25°C)	150	100	20	100	4	1A	4	-500								268	
" 1132	"	"	"	60	4	4A	40W (T _c =25°C)	150	100	20	100	4	1A	4	-500								268	
" 1133	"	"	"	70	5	4A	40W (T _c =25°C)	150	1	50	100	4	1A	4	-500								268	2SB857 とコンプリ
" 1134	"	"	"	70	5	4A	40W (T _c =25°C)	150	1	50	100	4	1A	4	-500								268	2SB858 とコンプリ
" 1135	"	"	"	100	5	4A	40W (T _c =25°C)	150	100	80	100	5	1A	5	-500								268	2SB859 とコンプリ
" 1136	"	"	"	200	5	4A	30W (T _c =25°C)	150	1mA	200	45	5	4A										268	水平偏向用

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta = 25°C)					電気的特性 (Ta = 25°C)											外形	備考				
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値 (μA)	V _{CEB} (V)	直流又はパルス h _{FE} V _{CE} (V)	I _C (mA)	バイアス V _{CEB} (V)	I _E (mA)	h _{FE}	h _{ie} (Ω)	h _{re} (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μΩ)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie'(real)*} (Ω)		
2SD1137	日立	PA	Si. T	100	4	4 A	40W (Tc=25°C)	150	10	100	120	4	500										268	2SB860 とコンプリ	
" 1138	"	"	"	200	6	2 A	30W (Tc=25°C)	150	1	120	140	4	500									20 *	268	2SB861 とコンプリ	
" 1139	"	"	"	200	6	2 A	30W (Tc=25°C)	150	100	120	120	4	50											268	
" 1140	東芝	SW	Si. E	30	10	1.5A	900	150	10	30	7000	2	150											241	ターリントン
" 1141	日立	PA	Si. T	400	7	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	300	3000	2	4 A											268	ターリントン ダンパ内蔵
" 1142	日電	SW	Si. TMe	1500	5	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	20	1000	12	10	500											102	水平偏向用
" 1143	"	"	"	1500	5	5 A	50W (Tc=25°C)	150	20	1000	12	10	1 A											102	水平偏向用
" 1144	"	"	"																						
" 1145	三洋	AF. SW	Si. EP	60	6	5 A	900	150	1	50	100~560	2	500	10	-50									294	
" 1146	ソニー	AF	Si. E	50	50	2 A	900	150	1	40	300	2	10											294	
" 1147	富士電機	PA	Si. TP	120	6	5 A	30W (Tc=25°C)	150	1 mA	120	5000	5	1 A	5	-500									268	ターリントン
" 1148	東芝	"	Si. T	140	5	10A	100W (Tc=25°C)	150	5	140	100	5	1 A											203	
" 1149	松下	AF	Si. EP	100	15	20	200	125	1	60	1000	10	2											176	
" 1150	三洋	SW	"	350	6	6 A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	60	5	3 A											268	水平偏向用
" 1151	松下	"	Si. TMe	1500	5	5 A	95W (Tc=25°C)	130	100	750	40~150	10	3.5A											102	ターリントン ダンパ内蔵
" 1152	日立	AF	Si. E	55		100	200	125	0.5	18	500	12	2											138	
" 1153	三洋	AF. SW	Si. EP	80	10	1.5A	900	150	0.1	40	>4000	2	500	10	-50									294	2SB865 とコンプリ (h _{ie} =1.2kΩ)
" 1154	松下	Si. E	300	5	5 A	50W (Tc=25°C)	150	1 mA	300	30	4	5 A												102	水平偏向用
" 1155	富士電機	"	Si. TP	400	6	50A	300W (Tc=25°C)	150	1 mA	400	400	5	50A											254	ターリントン
" 1156	三菱	PA	Si. EP	100	5	5 A	58W (Tc=25°C)	150	2.5	50	110	5	2.5A											358	
" 1157	富士電機	AF. PA	Si. TP	80	10	4 A	25W (Tc=25°C)	150	100	80	400	5	500											268	
" 1158	"	AF. PA. SW	"	80	10	8 A	40W (Tc=25°C)	150	100	80	400	5	1 A											268	
" 1159	三洋	SW	Si. T	200	6	4.5A	40W (Tc=25°C)	150	100	40	80	5	1 A											268	水平偏向用
" 1160	東芝	PA, SW	Si. E	50	6	2 A	1 W	150	1	30	200	2	1 A											344	
" 1161	三洋	AF	Si. EP	30	5	30	150	150	0.1	15	180	6	1											176	
" 1162	日電	SW	Si. T	500	10	10A	40W (Tc=25°C)	150	10	400	400~3000	2	2 A											268	ターリントン
" 1163	日立	"	"	300	6	7 A	40W (Tc=25°C)	150	5 mA	300	40	5	5 A											268	水平偏向用
" 1164	日電	PA	Si. E	150	8	1.5A	10W (Tc=25°C)	150	10	60	8000	2	1 A											186	ターリントン
" 1165	東芝	SW	Si. TMe	1000	6	100A	1250W (Tc=25°C)	125	2 mA	1000	150	5	100A											356	ターリントン
" 1166	"	"	"	1000	6	200A	2500W (Tc=25°C)	125	3 mA	1000	200	5	200A											357	ターリントン

■ 追補索引

型名	頁	型名	頁	型名	頁	型名	頁	型名	頁	型名	頁	型名	頁	型名	頁	型名	頁		
2SA119	247	2SA964A	248	2SB539C	249	2SB761A	251	2SC97A	253	2SC680A	254	2SC1196A	255	2SC1619A	256	2SC2337A	257	2SD226B	260
" 120	247	" 968A	248	" 546A	249	" 761B	251	" 101A	253	" 681A	254	" 1197A	255	" 1622A	258	" 2388A	258	" 232A	260
" 142A	247	" 968B	248	" 547A	249	" 762A	251	" 108A	253	" 685A	254	" 1206A	255	" 1627A	257	" 2429A	258	" 287A	260
" 217	247	" 985A	248	" 566A	249	" 762B	251	" 109A	253	" 690A	256	" 1206B	255	" 1655A	257	" 2460A	258	" 287B	260
" 431A	247	" 1006A	248	" 611A	251	" 763A	251	" 154B	253	" 711A	254	" 1207A	256	" 1664A	257	" 2461A	258	" 287C	260
" 432A	247	" 1006B	248	" 612A	251	" 763B	251	" 154C	253	" 756A	257	" 1207B	256	" 1707A	256	" 2496A	258	" 317A	260
" 440A	247	" 1007A	248	" 616A	250	" 766A	250	" 168	253	" 780A	255	" 1208A	256	" 1708A	257	" 2497A	258	" 318A	260
" 549A	247	" 1050A	248	" 617A	249	" 773A	251	" 169	253	" 782A	254	" 1212A	254	" 1711A	256	" 2516A	257	" 334A	260
" 559A	247	" 1051A	248	" 618A	249	" 789A	250	" 183A	253	" 805A	259	" 1213A	254	" 1741A	257	" 2522A	258	" 350A	261
" 628A	247	" 1069A	248	" 646A	249	" 793A	250	" 198A	253	" 806A	257	" 1226A	254	" 1746A	256	" 2556A	259	" 363A	260
" 636A	248	" 1072A	248	" 647A	249	" 812A	251	" 219	253	" 807A	255	" 1241A	255	" 1775A	256	" 2567A	259	" 365A	260
" 656A	248	" 1096A	248	" 648A	250	" 849A	251	" 268A	253	" 867A	257	" 1242A	255	" 1864A	259	" 2570A	258	" 366A	260
" 657A	248	" 1107A	248	" 649A	250	" 850A	251	" 268B	253	" 911A	256	" 1247A	256	" 1867A	256	" 2587A	259	" 373A	260
" 658A	248	" 1108A	248	" 653A	250	" 871A	251	" 287A	253	" 914A	254	" 1271A	256	" 1871A	257	" 2588A	259	" 376A	260
" 666A	247	" 1133A	248	" 654A	250	" 872A	251	" 288A	253	" 915A	254	" 1280A	254	" 1890A	257	" 2657A	258	" 380A	261
" 673A	247	" 1166A	248	" 655A	250	" 895A	251	" 317A	253	" 926A	254	" 1318A	259	" 1913A	257	" 2658A	258	" 386	262
" 699A	247	" 1227A	248	" 656A	250	" 896A	251	" 318A	253	" 936A	254	" 1325A	256	" 1914A	257	" 2659A	258	" 387A	262
" 708A	247			" 668A	250	" 925A	251	" 352A	253	" 973A	256	" 1337A	259	" 1930A	256	" 2660A	259	" 389A	260
" 713A	247	2SB57A	249	" 669A	250	" 928A	251	" 353A	253	" 975A	256	" 1338A	259	" 1946A	258	" 2766A	259	" 390A	260
" 728A	247	" 67A	249	" 700A	250	" 929A	251	" 380A	253	" 979A	255	" 1358A	256	" 1965A	257	" 2790A	258	" 401A	261
" 740A	247	" 126A	249	" 702A	250	" 930A	251	" 385A	253	" 980A	255	" 1360A	259	" 1968A	259	" 2831A	258	" 402A	261
" 743A	247	" 127A	249	" 703A	250	" 935A	251	" 386A	253	" 985A	254	" 1367A	254	" 2103A	258	" 2832A	258	" 476A	261
" 745A	247	" 128A	251	" 705A	250	" 936A	251	" 387A	253	" 987A	254	" 1380A	255	" 2122A	256	" 2833A	258	" 538A	260
" 747A	247	" 136A	249	" 705B	250	" 937A	252	" 388A	253	" 988A	254	" 1398A	259	" 2126A	257	" 2834A	258	" 539A	260
" 774A	247	" 207A	249	" 706A	250	" 938A	252	" 395A	253	" 988B	254	" 1403A	255	" 2127A	257	" 2865A	259	" 574A	260
" 775A	247	" 208A	249	" 709A	250	" 939A	252	" 402A	253	" 999A	254	" 1409A	255	" 2128A	257	" 2987A	258	" 581A	264
" 776A	247	" 213A	249	" 710A	250	" 940A	252	" 403A	253	" 1005A	254	" 1410A	255	" 2139A	257	" 3044A	258	" 586A	262
" 778A	247	" 214A	249	" 716A	250	" 941A	252	" 403B	256	" 1008A	255	" 1413A	255	" 2224A	258	" 3056A	258	" 587A	260
" 780A	247	" 216A	249	" 744A	250	" 942A	252	" 403C	256	" 1012A	254	" 1416A	255	" 2228A	258	" 3058A	258	" 588A	260
" 794A	247	" 426A	249	" 745A	251	" 947A	252	" 410C	254	" 1033A	255	" 1448A	256	" 2230A	257			" 592A	264
" 808A	247	" 452A	249	" 748A	250	" 948A	252	" 434A	254	" 1098A	255	" 1469A	256	" 2231A	257	2SD51A	260	" 596	261
" 811A	248	" 495A	249	" 749A	250	" 949A	252	" 487A	254	" 1103A	255	" 1471A	256	" 2238A	257	" 78A	260	" 601A	261
" 817A	248	" 502A	250	" 750A	250	" 950A	252	" 515A	255	" 1116A	255	" 1473A	257	" 2238B	257	" 88A	260	" 602A	261
" 845A	248	" 503A	250	" 750B	250	" 951A	252	" 563A	255	" 1122A	254	" 1478A	255	" 2258A	259	" 170A	260	" 611A	262
" 847A	248	" 504A	249	" 751A	250	" 952A	252	" 631A	257	" 1151A	254	" 1517A	255	" 2258B	259	" 181A	260	" 646A	262
" 856A	247	" 506A	249	" 751B	250	" 953A	252	" 632A	257	" 1153A	254	" 1553A	256	" 2275A	258	" 200A	260	" 666A	261
" 872A	247	" 512A	249	" 758A	251			" 633A	257	" 1170B	255	" 1567A	256	" 2284A	258	" 206A	260	" 667A	261
" 893A	247	" 513A	249	" 759A	251	2SC89	253	" 634A	257	" 1172A	254	" 1573A	255	" 2336A	258	" 207A	260	" 668A	261
" 904A	248	" 539A	249	" 760A	251	" 90	253	" 642A	254	" 1172B	255	" 1573B	259	" 2336B	258	" 208A	260	" 669A	261
" 913A	248	" 539B	249	" 760B	251	" 91	253	" 643A	254	" 1178A	255	" 1605A	256	" 2361A	259	" 226A	260	" 673A	262

追補

追補

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)				電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考							
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス		h _{FE}		h _{FE}		h _{re} (Ω)			h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} (μΩ)	f _{αβ} * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)		
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fe}	h _{fe} *										
2SA119	富士通	RF. PA	Si. EP	-40	-300	650	175	-0.1	-10									200*	4.5	50*	84B					
" 120	"	"	"	-25	-4	-300	650	175	-1	-10								200*	4.5	50*	84B					
" 142A	三菱	RF	Ge. A	-40	-1.5	-15	80	85	-5	-12								8	11	60	12A					
" 217	日立	SW	"	-25	-12	-100	120	85	-1	-12	30-120	-0.3	-100					14	20	200*	50C					
" 431A	東芝	RF	Ge. Me	-20		-5	70	85	-10	-12				-6	1	-0.95*	PG=16dB (f=200MHz)				50C					
" 432A	"	"	"	-20	-0.2	-5	70	85	-10	-12				-6	1	-0.95*	PG=14dB (f=200MHz)				50C					
" 440A	三洋	RF. Conv. Mix. Osc	"	-20	-0.4	-5	60	85	-30	-2				-6	2	50	PG=14dB (f=100MHz)	350*	1.5	70*	48C					
" 549A	日立	SW	Si. EP	-110	-5	-100	200	175	-1	-20	30-200	-1	-10					100*			182C					
" 628A	三菱	RF. AF. SW	"	-60	-4	-100	200	125	-0.1	-25	200	-6	-1	-6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	C _c τ _{ob} 100pS	138B 2SC1008A とコンプリ			
" 673A	日立	RF. AF	Si. E	-50	-4	-500	400	125	-0.5	-20	60-320	-3	-10										138	2SC1213A とコンプリ		
" 699A	松下	PA	"	-50	-5	-2A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-20	120	-5	-1A	-5	500						150*	50	3.3*	161	2SC1226A とコンプリ	
" 708A	日電	RF. AF. SW	"	-100	-8	-700	800	150	-0.1	-60	130	-2	-50	-10	50						95*	25	25*	84B		
" 713A	"	"	Si. E P-インジ	-40	-10	-300	250	125	-0.1	-20	30,000	-5	-100	-10	10						180*	6	200*	138		
" 728A	三菱	RF. AF	Si. EP	-60	-5	-100	200	125	-0.1	-25	200	-6	-10	-6	1		6500	0.3	14	100*	3.5	C _c τ _{ob} 60pS	175			
" 774A	松下	RF. LN	"	-55	-5	-50	150	175	-0.1	-10	540	-5	-2	-5	2		3500	3	60	120*	5	100	243			
" 776A	東芝	"	"	-55	-5	-50	200	150	-0.1	-30	300	-6	-2	-6	1	285	7300	1	21	180*	3	35	195			
" 778A	日立	SW	Si. T	-180	-5	-50	200	125	-1	-150	100	-3	-15	-3	15						50*	10		138		
" 780A	"	PA. SW	Si. E	-80	-4	-1A	10W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	125	-4	-50	-4	50	t _{on} =110nS, t _{off} =900nS					120*	8		234	2SC1517A とコンプリ	
" 893A	"	RF. AF	"	-120	-5	-50	300	125	-0.5	-100	250-800	-12	-2	-12	2	NF=2dB (1kHz, 6V, 50μA)					120*	1.8		138	2SC1890A とコンプリ	
2SA559A	富士通	SW	Si. EP	-40	-5	-200	350	175	-0.5	-10	50	-1	-10			t _i <30μS t _{isg} <250μS									49C	
" 666A	松下	RF. AF. LN	"	-45	-5	-50	150	125	-1	-10	250	-5	-2												138	
" 740A	東芝	RF. PA	Si. TMe	-145	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-10	-100	75	-10	-500	-10	500						5*	55	25		268	
" 743A	日立	"	Si. E	-80	-4	-1A	8W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	120	-4	-50	-4	30						120*	30			160	2SC1212A とコンプリ
" 745A	サンケン	PA	Si. TMe	-120	-6	-8A	70W (T _c =25°C)	150	-1mA	-120	60	-4	-3A	-12	500						15*	220	10*		102	2SC1403A とコンプリ
" 747A	"	"	"	-140	-6	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-1mA	-140	60	-4	-3A	-12	500						15*	255	10*		102	2SC1116A とコンプリ
" 775A	日立	"	Si. T	-120	-4	-700	12.5W (T _c =25°C)	150	-10	-30	90	-4	-50	-4	30						30*	35	25		268	
" 794A	松下	"	Si. EP	-120	-5	-500	1.2W	150			160	-10	-150	-10	50						120*				222	
" 808A	サンケン	"	Si. EMe	-100	-6	-6A	50W (T _c =25°C)	150	-1mA	-100	60	-4	-3A	-12	500						10*	90	8*		102	2SC1619A とコンプリ
" 856A	東芝	RF. LN	Si. EP	-50	-5	-50	150	150	-0.1	-35	450	-6	-1	-6	1	NF=1.3dB (f=100MHz, V _{CE} =-6V, I _C =1mA)				140*	4.5	40		49C		
" 872A	日立	LN	Si. E	-120	-5	-50	300	125	-0.5	-100	250-800	-12	-2	-12	2	NF<1.5dB (f=1kHz, V _{CE} =-6V, I _C =-50μA)				120*	1.8			138	2SC1775A とコンプリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考					
				V _{CEO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CEO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe}	h _{fe} h _{FE} * (Ω)	h _{FE} h _{FE} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{oe} * (μU)			f _{αB} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)		
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{FE} *	V _{BO} <170mV (10V, 1mA, R _θ =100kΩ, A _v =80dB)
2SA817A	東芝	PA	Si.E	-80	-5	-400	800	150	-0.1	-50	70~240	-2	-50	-10	10					100*	14	241	2SC1627A とコンプリ		
" 847A	三菱	AF.LN.RF	Si.EP	-120	-5	-50	200	125	-0.1	-70	250~1200	-6	-1	-6	1				150*	2.5	138B	2SC1708A とコンプリ			
" 904A	"	AF.RF	"	-120	-5	-50	200	125	-0.1	-70	250~1200	-6	-1	-6	1				150*	2.5	138B	2SC1708A とコンプリ			
" 968A	東芝	PA	Si.E	-180	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-160	70~240	-5	-100	-10	100				100*	30	268	2SC2238A とコンプリ			
" 968B	"	"	"	-200	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-160	70~240	-5	-100	-10	100				100*	30	268	2SC2238B とコンプリ			
" 1007A	日電	PA.SW	"	-150	-4.5	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-50	-150	150	-5	-1A	-5	200	t _{on} =0.2μS, t _{off} =1μS t _{sat} =0.7μS			50*	250	102	2SC2337A とコンプリ			
" 1069A	"	SW	"	-80	-12	-5A	30W (T _c =25°C)	150	-10	-80	40~200	-5	-3A			t _{on} <0.5μS, t _f <0.5μS t _{sat} <1.5μS					268	2SC2516A とコンプリ			
* 2SA 636A	日電	PA.SW	Si.E	-70	-5	-3A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-45	100	-5	-500	-5	100				45*	60	167	2SC1098A とコンプリ			
" 656A	東芝	"	Si.TMe	-130	-5	-7A	50W (T _c =25°C)	150	-100	-130	30~300	-5	-1A	-10	1A	t _{on} =0.5μS, t _f =0.4μS t _{sat} =3μS			5*	150	102	2SC519A とコンプリ			
" 657A	"	"	"	-100	-5	-7A	50W (T _c =25°C)	150	-100	-100	30~300	-5	-1A	-10	1A	t _{on} =0.5μS, t _f =0.4μS t _{sat} =3μS			5*	150	102	2SC520A とコンプリ			
" 658A	"	"	"	-70	-5	-7A	50W (T _c =25°C)	150	-100	-70	30~300	-5	-1A	-10	1A	t _{on} =0.5μS, t _f =0.4μS t _{sat} =3μS			5*	150	102	2SC521A とコンプリ			
" 845A	日立	AF.SW	Si.E	-180	-5	-50	200	175	-1	-150	80	-3	-15	-10	10	t _{sat} <1μS			>40*	<10	49C				
" 964A	日電	PA	"	-250	-5	-200	10W (T _c =25°C)	150	-1	-200	180	-10	-10	-10	10				100*	3	16*	167C			
" 985A	"	"	"	-150	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-120	150	-5	-300	-5	200				180*	29	268	2SC2275A とコンプリ			
" 1006A	"	"	"	-200	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-150	120	-5	-150	-10	100				80*	45	10*	268			
" 1006B	"	"	"	-250	-5	-1.5A	25W (T _c =25°C)	150	-1	-150	120	-5	-150	-10	100				80*	45	10*	268			
" 1050A	東芝	"	"	-140	-5	-12A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-140	55~240	-5	-1A	-10	1A				70*	220	2*	102	2SC2460A とコンプリ		
" 1051A	"	"	"	-160	-5	-15A	150W (T _c =25°C)	150	-10	-160	55~240	-5	-1A	-10	1A				60*	350	2*	102	2SC2461A とコンプリ		
" 1072A	富士通	"	Si.P	-150	-5	-12A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-150	110	-5	-1A	-10	1A				60*	300	1.5*	102	2SC2522A とコンプリ		
2SA 913A	松下	AF.RF	Si.EP	-180	-5	-1A	15W (T _c =25°C)	150			65~330	-10	-150	-10	50				120*		268				
" 1096A	"	RF	"	-70	-5	-2A	1.2W	150	-1	-20	120	-5	-1A	-5	500				150*	55	110	222			
" 1107A	日電	PA	Si.E	-150	-5	-10A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-130	150	-5	-1A	-5	200				50*	250	10	340			
" 1108A	"	"	"	-150	-5	-12A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-130	150	-5	-2A	-5	1A				60*	270	10	340			
" 1133A	松下	"	Si.EP	-200	-6	-2A	30W (T _c =25°C)	150	-50	-150	120	-10	-150	-10	200				40*	70	25	268			
" 1166A	日電	"	Si.E	-180	-5	-15A	150W (T _c =25°C)	150	-50	-160	150	-5	-2A	-5	1A				60*	320	10	340			
2SA811A	日電	RF.AF	Si.E	-120	-5	-50	150	125	-0.05	-120	500	-3	-0.5	-3	1				9.2k	2.7	33	100*	3	20*	176
" 1227A	"	PA	Si.T	-150	-5	-12A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-120	130	-5	-2A	-5	1A				60*	260	10	162			

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考					
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{FE}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)			
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *		
★ 2SB67A	日立	AF	Ge.A	-60	-30	150	$\frac{350}{7.5}$ 150 (<small>取換後付</small>)	70															66			
★ " 136A	三菱	PA	"	-60	-12	-300	150	85	-10	-25	120	-1.5	-50											12B		
★ " 216A	三洋	"	"	-60	-10	-3A	24W (T _c =25°C)	85	-500	-20	80	-1.5	-1A				0.5							102		
★ " 426A	東芝	"	"	-45	-12	-3A	30W (T _c =25°C)	85	-160	-12	60	-1.5	-1A											102		
★ " 452A	三菱	"	"	-45	-6	-1A	300	85	-30	-12	150	-1	-150											69		
★ " 495A	"	"	"	-32	-6	-1A	200	85	-20	-12	110	-1	-150											12A		
★ " 512A	松下	"	Si.EMe	-80	-8	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-30	-20	60	-3	-1A											268	2SD365A とコンプリ	
★ " 513A	"	"	"	-80	-8	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-30	-20	60	-3	-1A											267	2SD366A とコンプリ	
2SB504A	日電	PA.SW	Si.E	-100	-10	-2A	1W	175	-1	-80	80	-2	-500											84B	2SD78A とコンプリ	
" 506A	"	"	"	-150	-7	-5A	60W (T _c =25°C)	175	-2mA	-150	70	-5	-1A												102	
★ 2SB57A	富士通	SW	Ge.A	-45	-15	-500	225	85	-15	-45	70	-1	-50	-6	1	0.985*	30*	3*	0.3*	2	t _r <2μS, t ₁₀ <2μS t _f <2μS				84B	
★ " 126A	松下	SW	Ge.A	-60	-10	-3.5A	40W (T _c =45°C)	90	-200	-14	35	-1	-1A												102	
★ " 127A	"	"	"	-60	-10	-3.5A	40W (T _c =45°C)	90	-200	-14	75	-1	-1A												102	
" 207A	新電元	PA	Ge.A	-140	-20	-20A	80W (T _c =25°C)	85	-5mA	-140	40	-1.5	-15A	-6	2A					f _{ae} 2.5kc					105	
" 208A	"	"	"	-140	-20	-30A	80W (T _c =25°C)	85	-5mA	-140	100	-1.5	-15A	-6	2A					f _{ae} 2.5kc					105	
" 213A	"	SW	"	-140	-40	-20A	80W (T _c =25°C)	85	-5mA	-140	40	-1.5	-15A	-6	2A					f _{ae} 2.5kc					105	
" 214A	"	"	"	-140	-40	-30A	80W (T _c =25°C)	85	-5mA	-140	100	-1.5	-15A	-6	2A					f _{ae} 2.5kc					105	
★ " 539A	日電	PA	Si.T	-130	-6	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-50	-120	80	-5	-2A	-5	200					17*	430				102	2SD287A とコンプリ
★ " 539B	"	"	"	-150	-6	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-50	-120	80	-5	-2A	-5	200					17*	430				102	2SD287B とコンプリ
★ " 539C	"	"	"	-160	-6	-10A	100W (T _c =25°C)	150	-50	-120	80	-5	-2A	-5	200					17*	430				102	2SD287C とコンプリ
" 617A	"	"	"	-120	-5	-6A	70W (T _c =25°C)	150	-50	-120	80	-5	-1A	-5	200					14*	220				295	2SD587A とコンプリ
" 618A	"	"	"	-150	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-50	-130	80	-5	-1A	-5	200					14*	340				295	2SD588A とコンプリ
2SB546A	日電	PA	Si.T	-200	-5	-2A	25W (T _c =25°C)	150	-50	-150	90	-10	-400	-10	400					5*					268	2SD401A とコンプリ
" 547A	"	"	"	-200	-5	-2A	25W (T _c =25°C)	150	-50	-150	90	-10	-400	-10	400					5*					267	2SD402A とコンプリ
★ " 566A	日立	"	"		-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-1	-50	60-320	-4	-1A	-4	500					15*					268	2SD476A とコンプリ
" 646A	"	"	Si.E	-120	-5	-50	900	150	-10	-100	60-320	-5	-10	-5	10					140*	4				251	2SD666A とコンプリ
" 647A	"	"	"	-120	-5	-1A	900	150	-10	-100	60-320	-5	-150	-5	150					140*	20				251	2SD667A とコンプリ

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考	
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値 (μA)	V _{CB(V)}	直流又はパルス h _{FE}		バ イ ア ス		h _{je}	h _{ie} *	h _{re} *	h _{oe} *	f _β *			C _{ob}
										V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}	h _{fb} *	h _{ib} * (Ω)	h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{ob} * (μΩ)	f _β * (Mc)	(pF)	h _{μ(real)} *		
2SB648A	日立	PA	Si.E	-180	-5	-50	1 W	150	-10	-160	60~320	-5	-2	-10	10				140 *	4.5	160	2SD668A とコンプリ
" 649A	"	"	"	-180	-5	-1.5A	1 W	150	-10	-160	60~320	-5	-150	-5	150				140 *	27	160	2SD669A とコンプリ
* " 668A	松下	"	Si.Eme	-80	-5	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-200	-60	2000	-3	-500	-3	1.5A				f _β 100kHz		268	ターリントン
* " 669A	"	"	"	-90	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-200	-80	3000	-3	-1A	-3	3A				f _β 100kHz		268	ターリントン
* 2SB653A	日立	PA	Si.T	-120	-5	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-1mA	-100	60~200	-5	-1A	-5	1A	t _f =0.5μS			22 *		102	2SD673A とコンプリ
* " 654A	"	"	"	-120	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-1mA	-100	60~200	-5	-1A	-5	1A	t _f =0.5μS			22 *		102	2SD674A とコンプリ
* " 655A	"	"	"	-160	-5	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-1mA	-140	60~200	-5	-1A	-5	1A	t _f =0.5μS			22 *		102	2SD675A とコンプリ
* " 656A	"	"	"	-160	-5	-12A	125W (T _c =25°C)	150	-1mA	-140	60~200	-5	-1A	-5	1A	t _f =0.5μS			22 *		102	2SD676A とコンプリ
" 705A	日電	"	"	-150	-5	-10A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-140	80	-5	-2A	-5	200				17 *	430	340	2SD745A とコンプリ
" 705B	"	"	"	-160	-5	-10A	120W (T _c =25°C)	150	-50	-140	80	-5	-2A	-5	200				17 *	430	340	2SD745B とコンプリ
* " 706A	"	"	"	-220	-5	-10A	200W (T _c =25°C)	150	-50	-180	80	-5	-2A	-5	200				14 *	450	265	2SD746A とコンプリ
" 710A	松下	AF	Si.EP	-60	-5	-500	200	125	-0.1	-20	160	-10	-150	-10	50				200 *	6	176	2SD602A とコンプリ
" 716A	日立	PA	Si.E	-140	-5	-50	750	150	-0.5	-100	250~500	-12	-2	-12	5				150 *	1.8	251	2SD756A とコンプリ
" 744A	日電	PA.SW	"	-70	-5	-3A	10W (T _c =25°C)	150	-1	-45	100	-5	-500	-5	100				45 *	60	225	2SD794A とコンプリ
" 748A	日立	PA	Si.T	-120	-5	-6A	60W (T _c =25°C)	150	-1mA	-100	60~200	-5	-1A	-5	1A	t _f =0.5μS			22 *		332	2SD824A とコンプリ
" 749A	"	"	"	-120	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-1mA	-100	60~200	-5	-1A	-5	1A	t _f =0.5μS			22 *		332	2SD825A とコンプリ
" 750A	松下	PA.SW	Si.EP	-80	-5	-2A	35W (T _c =25°C)	150	-1mA	-80	1000~ 10000	-4	-1A			t _{on} =0.2μS, t _{off} =2μS			200 *	20	268	ターリントン
" 750B	"	"	"	-100	-5	-2A	35W (T _c =25°C)	150	-1mA	-100	1000~ 10000	-4	-1A			t _{on} =0.2μS, t _{off} =2μS			200 *	20	268	ターリントン
" 751A	"	"	"	-80	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-200	-80	1000~ 10000	-3	-3A			t _{on} =0.2μS, t _{off} =2μS			200 *	20	268	ターリントン
" 751B	"	"	"	-100	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-200	-100	1000~ 10000	-3	-3A			t _{on} =0.2μS, t _{off} =2μS			200 *	20	268	ターリントン
" 766A	"	PA	"	-60	-5	-1A	500	125	-0.1	-20	160	-10	-500	-10	50				200 *	20	336	2SD874A とコンプリ
2SB502A	東芝	PA	Si.TMe	-110	-10	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-100	-110	80	-5	-500	-10	500	t _{on} =1μS, t _{off} =3μS, t _f =1μS			5 *	200	99	2SD877 とコンプリ
" 503A	"	"	"	-80	-10	-3A	25W (T _c =25°C)	150	-100	-80	80	-5	-500	-10	500	t _{on} =1αS, t _{off} =3μS, t _f =1μS			5 *	200	99	
" 616A	日電	PA.SW	Si.E	-100	-5	-5A	60W (T _c =25°C)	150	-10	-80	80	-5	-1A	-5	100				22 *	120	295	2SD586A とコンプリ
* " 700A	日立	PA	Si.T	-160	-5	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-1mA	-120	60~200	-5	-1A	-5	1A	t _f =0.6μS			20 *		332	2SD736A とコンプリ
* " 702A	"	"	"	-160	-5	-12A	125W (T _c =25°C)	150	-1mA	-140	60~200	-5	-1A	-5	1A	t _f =0.6μS			20 *		332	2SD738A とコンプリ
" 703A	日電	PA.SW	Si.E	-100	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-10	-80	100	-5	-500	-5	100				18 *	110	268	2SD743A とコンプリ
" 789A	松下	AF	Si.EP	-120	-5	-500	1 W (プリント基板使用)	150			65~330	-10	-150	-10	50				120 *	20	336	2SD968A とコンプリ
" 793A	"	"	"	-60	-5	-1A	1 W	150	-0.1	-20	60~340	-10	-500					200 *	20	151		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考					
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バ イ ア ス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{αβ} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{th} h _{th} (real)* (Ω)			
									(μA)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CE} (V)	I _E (mA)													
2SB611A	日立	PA	Si.E	-150	-6	-7A	60W (T _c =25°C)	150	-10	-120	120	-5	-1A										102			
" 709A	松下	AF	Si.EP	-45	-5	-500	200	125	-0.1	-20	90~650	-10	-2	-10	1						80*			176		
" 745A	"	LN	"	-55	-5	-50	300	135	-0.1	-10	180~1040	-5	-2											151		
" 758A	日電	PA	Si.T	-130	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-50	-120	80	-5	-1A											295		
" 760A	松下	"	Si.EP	-80	-5	-1A	30W (T _c =25°C)	150	-200	-80	120	-4	-200												268	
" 760B	"	"	"	-100	-5	-1A	30W (T _c =25°C)	150	-200	-100	120	-4	-200												268	
" 761A	"	"	"	-80	-5	-3A	35W (T _c =25°C)	150	-200	-80	100	-4	-1A												268	
" 761B	"	"	"	-100	-5	-3A	35W (T _c =25°C)	150	-200	-100	100	-4	-1A												268	
" 762A	"	"	"	-80	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-400	-80	100	-4	-1A												268	
" 762B	"	"	"	-100	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150	-400	-100	100	-4	-1A												268	
" 763A	"	"	"	-80	-5	-5A	60W (T _c =25°C)	150	-400	-80	120	-4	-1A												152	
" 763B	"	"	"	-100	-5	-5A	60W (T _c =25°C)	150	-400	-100	120	-4	-1A												152	
" 773A	日電	"	Si.T	-120	-5	-6A	70W (T _c =25°C)	150	-50	-100	80	-5	-1A												295	
" 812A	松下	"	Si.EP	-80	-5	-4A	60W (T _c =25°C)	150	-400	-80	100	-4	-1A												152	
" 849A	日電	"	Si.T	-130	-5	-7A	80W (T _c =25°C)	150	-50	-120	80	-5	-1A	-5	200						14*	340		162	2SD1110A とコンパリ	
" 850A	富士電機	"	Si.EP	-80	-7	-10A	50W (T _c =25°C)	150	-10	-80	120	-5	-2A												268	
2SB612A	日立	PA	Si.E	-180	-6	-12A	100W (T _c =25°C)	150	-10	-160	100	-5	-1A												102	
" 759A	松下	AF	Si.EP	-45	-5	-50	250	125	-1	-10	60~700									80*	2.7				276	
" 871A	"	SW	Si.P	-50	-5	-10A	40W (T _c =25°C)	150	-50	-50	60~260	-2	-3A								100*	400			268	
" 872A	"	SW.PA	"	-80	-7	-8A	45W	150	-100	-80	1000~ 10000	-3	-4A												268	
" 895A	"	AF	Si.EP	-60	-5	-1A	1200	150	-0.1	-40	2000~ 20000	-10	-1A												236	シリコン 2SD946A とコンパリ
" 896A	"	SW	Si.P	-50	-5	-10A	35W (T _c =25°C)	150	-50	-50	60~260	-2	-2A								150*	200			268	
" 925A	"	"	"	-50	-5	-7A	30W (T _c =25°C)	150	-50	-50	60~260	-2	-2A								150*	140			268	
" 928A	"	PA	Si.EP	-200	-6	-2A	30W (T _c =25°C)	150	-50	-200	60~240	-10	-150												363	2SD1250A とコンパリ
" 929A	"	"	"	-80	-5	-3A	35W (T _c =25°C)	150			40~250	-4	-1A												363	2SD1252A とコンパリ
" 930A	"	"	"	-80	-5	-4A	40W (T _c =25°C)	150			40~250	-4	-1A												363	2SD1253A とコンパリ
" 935A	"	SW	"	-50	-5	-10A	35W (T _c =25°C)	150	-50	-50	60~260	-2	-2A								150*	200			363	
" 936A	"	"	"	-50	-5	-10A	40W (T _c =25°C)	150	-50	-50	60~260	-2	-3A								100*	400			363	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考				
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バ イ ア ス		h_{fe}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	f_{ab} f_T^* (Mc)			C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)		
									I_{CBO} (μA)	V_{CB} (V)	V_{CE} (V)	I_C (mA)	V_{CB} (V)	I_E (mA)										h_{fb}^*	t_{on}
2SB937A	松下	PA. SW	Si. EP	-80	-5	-2A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-80	1000-10000	-4	-2A											363	ダーリントン 2SD1260A とコンプレ
938A	"	"	"	-80	-5	-4A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-200	-80	1000-10000	-3	-3A											363	ダーリントン 2SD1263A とコンプレ
939A	"	SW	"	-80	-7	-8A	45W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	1000-10000	-3	-4A											363	ダーリントン 2SD1262A とコンプレ
940A	"	PA	"	-200	-6	-2A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-200	60-240	-10	-150											364	2SD1264A とコンプレ
941A	"	"	"	-80	-5	-3A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40-250	-4	-1A											364	2SD1266A とコンプレ
942A	"	"	"	-80	-5	-4A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40-250	-4	-1A											364	2SD1267A とコンプレ
947A	"	SW	"	-50	-5	-10A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-50	60-260	-2	-2A											364	
948A	"	"	"	-50	-5	-10A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-40	60-260	-2	-3A											364	
949A	"	PA. SW	"	-80	-5	-2A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-1mA	-80	1000-10000	-4	-2A											364	ダーリントン 2SD1275A とコンプレ
950A	"	"	"	-80	-5	-4A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-200	-80	1000-10000	-3	-3A											364	ダーリントン 2SD1276A とコンプレ
951A	"	SW	"	-80	-7	-8A	45W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-100	-80	1000-10000	-3	-4A											364	ダーリントン 2SD1277A とコンプレ
952A	"	"	"	-50	-5	-7A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-50	60-260	-2	-2A						150*	140				363	
953A	"	"	"	-50	-5	-7A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	-50	-50	60-260	-2	-2A						150*	140				364	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)													外 形	備 考		
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE			バイアス		h_{fe} h_{fb}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{r1}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	$f_{\alpha b}$ f_{T}^* (Mc)	C_{ob} (pF)			$r_{bb'}$ $r_{bb'(real)}^*$ (Ω)	
									(μA)	$V_{CB(V)}$	$V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$	h_{fb}^*										h_{ib}^*
★ 2SC89	日立	SW	Ge. A	25	20	400	120	85	8	12	20-100	-0.2	20											84A	
★ # 90	"	"	"	25	20	400	120	85	8	12	20-120	-0.3	200											84A	
★ # 91	"	"	"	25	20	400	120	85	8	12	30-200	-0.3	200											84A	
★ # 97A	日電	RF. SW	Si. E	80	5	1 A	800	175	0.5	45	80	10	50	10	-50	$t_{on} < 70\text{nS}$ $t_{off} < 30\text{nS}$, $t_{off} < 90\text{nS}$				350*	6	30	123	2SA571 とコンプリ	
★ # 101A	東芝	RF	Si. TMe	70	5	5 A	$\frac{30\text{W}}{(T_c=25^\circ\text{C})}$	150	1mA	50				10	-0.5A					30	20*	150	15	101	
★ # 108A	"	RF. SW	Si. E	90	5	800	800	175	0.5	80	40-240	2	200	10	-10	$t_{on} = 30\text{nS}$, $t_f = 20\text{nS}$ $t_{off} = 60\text{nS}$				150*	9	55	84B		
★ # 109A	"	"	"	70	5	800	800	175	0.5	60	40-240	2	200	10	-10	$t_{on} = 30\text{nS}$, $t_f = 20\text{nS}$ $t_{off} = 60\text{nS}$				150*	9	55	84B		
★ # 154B	日立	RF	Si. TPa	150	5	100	750	175	10	180	50	10	10	-10	60						220*	2.5	70*	84C	
★ # 154C	"	"	"	200	6	100	750	175	0.1	100	90	10	25	10	-10	60					150*	2.5	15*	84C	
★ # 168	沖	RF. SW	Si. EP	20	5	200	250	175	0.1	15	85	1	10	10	-10	110	$t_{on} < 50\text{nS}$, $t_{off} < 60\text{nS}$ $t_{off} < 40\text{nS}$				400*	4	70*	49C	
★ # 169	"	"	"	40	5	200	250	175	0.1	15	85	1	10	10	-10	110	$t_{on} < 40\text{nS}$, $t_{off} < 44\text{nS}$ $t_{off} < 26\text{nS}$				450*	4	70*	49C	
★ # 183A	日電	RF. V	Si. E	30	5	30	100	150	0.1	25	75	3	0.5	6	-1	80	3000	0.5	6.5		160*	1.8	45	23	
★ # 198A	富士通	PA	Si. EP	50	5	500	800	175	1	10				10	-20	40					350*	6	50*	85C	
★ # 219	"	RF	Si. P	20	5	25	200	175	0.02	12				60		60					600*	1.3		50C	
★ # 268A	日電	RF. PA. SW	Si. E	80	5	30	150	150	3	50				6	-1	55					150*	1.6	50	23	
★ # 268B	"	RF. SW	"	150	5	30	150	150	0.1	100	120	1	1	6	-1						75*	2.8	25*	23	
★ # 287A	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	35	4	20	150	150	1	15	80	10	5	10	-5	80					1100*	0.7	$C_c \tau_{bb'}$ 10pS	23	
★ # 288A	"	"	"	35	4	20	150	150	0.2	15	80	10	5	10	-5	80					1100*	0.7	$C_c \tau_{bb'}$ 10pS	23	
★ # 317A	日立	SW	Si. EMe	100	5	100	350	175	0.1	20	100	6	10	6	-10	$t_{on} < 0.08\mu\text{S}$, $t_f < 0.2\mu\text{S}$ $t_{off} < 0.7\mu\text{S}$					180*	4.5	75	12A	
★ # 318A	ソニー	RF. SW	Si. PaMe	50	5	100	300	175	0.2	25	90	3	1	6	-2		$h_{fe} = 4.5\text{dB}$ ($f = 100\text{MHz}$)					3	$C_c \tau_{bb'}$ 80pS	49C	
★ # 352A	"	"	"	50	5	100	750	175	0.2	25	70	3	1	6	-2		$h_{fe} = 3\text{dB}$ ($f = 100\text{MHz}$)				140*	3	$C_c \tau_{bb'}$ 80pS	181	
★ # 353A	"	"	"	100	5	100	750	175	0.2	25	70	3	1	6	-2		"				140*	3	$C_c \tau_{bb'}$ 80pS	181	
★ # 380A	東芝	IF	Si. P	35	4	30	200	125	0.5	18	40-240	12	2	10	-1						250*	2	20	33	
★ # 385A	"	OSC	Si. EP	30	3	20	200	125	0.5	15	>20	3	8	10	-8		$h_{fe} > 6\text{dB}$ ($f = 100\text{MHz}$)				>600*	<1.5	<35	33	
★ # 386A	"	"	"	20	3	20	200	125	0.5	15	40	3	8	10	-8		$h_{fe} = 6.0\text{dB}$ ($f = 100\text{MHz}$)					1.2	18	33	
★ # 387A	"	RF. Conv. Mix. Osc	"	30	3	50	250	125	0.1	15	>20	3	8	10	-8						1000*	1.2		138	
★ # 388A	"	RF	"	30	4	50	300	125	0.1	50	20-200	12.5	12.5	12.5	12.5						>300*	0.8-2.0		138	
★ # 395A	"	SW	"	20	5	500	300	175	0.1	20	70-200	1	10	10	-10	$t_{on} < 40\text{nS}$, $t_f < 30\text{nS}$ $t_{off} < 50\text{nS}$					400*	4		49C	
★ # 402A	ソニー	RF. Conv. Mix. Osc	Si. E	50	5	100	180	120	0.2	25	90	3	1	6	-1	110					140*	2.5		38	
★ # 403A	"	"	"	50	5	100	180	120	0.2	25	60	3	1	6	-1	75					140*	2.2		38	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)													外 形	備 考								
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値 (μA)	$V_{CB(V)}$	直流又はパルス h_{FE} $V_{CE(V)}$	$I_C(\text{mA})$	バ イ ア ス $V_{CB(V)}$	$I_E(\text{mA})$	h_{je} $h_{j\beta}^*$	h_{ie}^* $h_{i\beta}^*$ (Ω)	h_{re} $h_{r\beta}^*$ ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	$f_{\beta b}^*$ $f_{\beta c}^*$ (Mc)	C_{ob} (pF)	$T_{th}^{(b)}$ $h_{\theta c}(\text{real})^*$ (Ω)										
2SC410A	新電元	SW	Si. DB	200	4	10A	100W ($T_c=35^\circ\text{C}$)	150	20mA	200	37	5	5 A	10	2 A	$t_{on} < 1.2 \mu\text{s}$, $t_{stg} < 4 \mu\text{s}$	$f_{\beta c}$ 0.4												102		
* 434A	"	"	"	200	4	30A	100W ($T_c=35^\circ\text{C}$)	150	20mA	200	28	5	10A	10	2 A		$f_{\beta c}$ 0.4												105		
* 487A	東芝	PA	Si. P	150	5	1.5A	15W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	30	100	2	200	10	-50									20*	85	5	99				
* 642A	"	"	Si. TMe	1500	5	1 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	30~160	15	150	15	-200									2*	55	10	102		水平偏向用		
* 643A	"	"	"	1500	5	2.5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	> 5	15	2 A	15	-100	$t_f < 1 \mu\text{s}$								3*	95	10	102		水平偏向用		
* 680A	日立	"	Si. T	200	6	2 A	12.5W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1	30	180	10	200																153		
* 681A	"	"	"	250	5	6 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	I_{CB0} 15mA	30						$t_f < 0.5 \mu\text{s}$													102	水平偏向用	
* 685A	"	"	Si. TPa	300	4	100	6.5W ($T_c \leq 70^\circ\text{C}$)	150			60	10	50																153		
* 711A	三菱	RF. AF	Si. EP	50	4	100	200	125	0.1	25	250	6	1	6	-1			8500	0.6	40			150*	2.5	$C_c T_{th}^{(b)}$ 200 pS				138B		
* 782A	東芝	PA	Si. TP	300	5	1.5A	25W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	300	150	10	100	10	-100									10*	70	25	99				
* 914A	富士通, 沖電, 日立	SW	Si. EP	40	5	300	300	175	0.2	20	70	1	30	$h_{FE} > 14$ (2V, 300mA)	$t_{on} < 80\text{nS}$, $t_{off} < 86\text{nS}$														49C		
* 915A	"	"	"	30	5	300	300	175	0.2	20	70	1	30	$h_{FE} > 15$ (2V, 200mA)	$t_{on} < 45\text{nS}$, $t_{off} < 42\text{nS}$														49C		
* 926A	ソニー	RF. AF. SW	Si. DB	210	5	30	320	120	0.2	150	100	3	1	10	-10			4500	0.47	4.8			160*	2.2	$C_c T_{th}^{(b)}$ 40 pS				38		
* 936A	日立	PA	Si. TMe	1000	5	1 A	22W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	45	10	100	15	-200									7*	35	25	102				
* 985A	日電	RF. LN	Si. E	20	3	40	300	200	0.1	10	100	10	15	10	-15	$NF = 4 \text{ dB}$ (10V, -3mA, 2GHz)	$PG = 9.5 \text{ dB}$ (2GHz)						3700*	0.6	20*				26		
* 987A	"	"	"	20	3	30	250	200	0.1	10	100	10	10	10	-10	$NF = 3 \text{ dB}$ (10V, -3mA, 2GHz)	$PG = 11 \text{ dB}$ (2GHz)						4500*	C_{re} 0.4	20*				26		
* 988A	"	RF	"	20	3	30	200	200	0.1	10	100	10	10	10	-10	$NF < 2 \text{ dB}$ (10V, -3mA, 500MHz)							3000*	C_{re} 0.5	30*				50C		
* 988B	"	"	"	20	3	30	200	200	0.1	10	100	10	10	10	-10	$NF < 1.5 \text{ dB}$ (10V, -3mA, 500MHz)							3000*	C_{re} 0.5	30*				50C		
* 999A	東芝	RF. PA. SW	Si. TMe	1500	5	2.5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	30	15	200	15	-200									4	80	10	102				
* 1005A	"	PA	"	1400	5	5 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	12	15	4 A	15	-500									3*	150	5	102				
* 1012A	松下	RF. AF	Si. TP	250	5	60	2.5W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	2	12	60	20	40	10	-3			35	300	0.4	2.7			100*	3.5	$C_c T_{th}^{(b)}$ 60 pS				84B	
* 1122A	東芝	PA	Si. EP	35	4	4.5A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	175	50	15	40	5	1.5A	10	-200									400*	20	5	135				
* 1151A	三菱	RF. PA	Si. EMe	1000	5	1 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	125	200	500	60	10	150	15	-200									5*	65	25	102				
* 1153A	"	SW	"	1400	6	2.5A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	125	1mA	1400	20	10	2.5A			$t_r < 1.5 \mu\text{s}$, $t_{stg} < 2 \mu\text{s}$														102	
* 1172A	東芝	PA	Si. TMe	1500	5	5 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	500	20	10	2 A	10	-500	$t_f < 1 \mu\text{s}$								2*	165	10	102		水平偏向用		
* 1212A	日立	PA	Si. EPa	80	4	1 A	8W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5	50	60~200	4	50	4	-30									160*	30					160	2SA743A とコンパリ
* 1213A	"	AF	"	50	4	500	400	125	0.5	20	60~320	3	10																	138	2SA673A とコンパリ
* 1226A	松下	PA	"	50	5	2 A	10W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1	20	120	5	1 A	5	-500									150*	50	3.3*				161	2SA699A とコンパリ
* 1280A	日電	RF	Si. E グーリントン	40	10	300	250	125	0.1	20	30,000	2	100	10	-10									180*	5	220*				138	
* 1367A	日立	PA	Si. TMe	1000	5	1 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	125	10	500	45	10	200	15	-200									6*	60	25	102				

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外形	備考					
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _c (mA)	P _c (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}				バ イ ア ス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)			h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _{ab} f _{fβ} * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie(real)} * (Ω)
									I _{CB0} (μA)	V _{CB(V)}	V _{CE(V)}	I _{C(mA)}	V _{CB(V)}	I _{E(mA)}	h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)									
2SC1380A	東芝	RF.LN	Si.E	55	5	100	200	150	0.1	18	200-700	6	2	6	-1					80*	6		49C		
* # 1409A	日立	PA	Si.TMe	200	6	2A	12.5W (T _c =25°C)	150	1	30	100	10	50	10	-50					20*	95	20	267		
* # 1410A	"	"	"	200	6	2A	12.5W (T _c =25°C)	150	1	30	100	10	50	10	-50					20*	95	20	268		
* # 1413A	"	SW	Si.T	1500	6	5A	50W (T _c =25°C)	150						15	-200	t _j < 2.3μs				4*	175		102	水平偏向用	
* # 1416A	東芝	RF	Si.EP	55	5	50	200	150	0.1	30	350	6	2	6	-1	NF=1dB (f=100Hz, V _{CE} =6V, I _E =-0.1mA)			100*	3	45	195			
* # 1478A	松下	RF.LN	"	55	5	50	150	175	0.1	10	540	5	2	5	-2	5500	0.4	25	150*	2.2	70	243			
* # 1517A	日立	PA.SW	Si.E	80	4	1A	10W (T _c =25°C)	150	5	50	60-200	4	50	4	-50	t _{on} =0.25μs, t _{off} =3.5μs t _{stg} =3μs			150*	30			234		
* 2SC1103A	日電	PA	Si.T	250	7	100	800	150	0.1	150	80	10	10	30	-10					80*	<4.8	30	84B		
* # 1116A	サンケン	"	Si.TMe	200	6	10A	100W (T _c =25°C)	150	1mA	200	60	4	3A	12	-500					10*	165	13*	102	2SA747A とコンプリ	
* # 1170B	東芝	"	Si.TMe	1500	5	3.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	>10	10	1A	10	-500	t _j < 1μs			3*	95	10	102	水平偏向用		
* # 1172B	"	"	"	1500	5	7A	50W (T _c =25°C)	150	10	500	20	10	2A	10	-500	t _j < 1μs			3*	160	10	102	水平偏向用		
* # 1178A	三菱	"	Si.EP	40	4.5	5A	35W (T _c =25°C)	175	2mA	15	30	10	200			P ₀ =26W (f=175MHz, V _{CC} =13.5V, P _i =7W)								113	
* # 1196A	東芝	"	"	45	3.5	1A	10W (T _c =25°C)	175	200	15	50	10	200	10	-50	P ₀ =5W (f=700MHz, V _{CC} =28V, P _i =1W)			1000*	<10			135		
* # 1197A	"	"	"	45	3.5	2A	20W (T _c =25°C)	175	400	15	55	10	500	10	-100	P ₀ =12W (f=700MHz, V _{CC} =28V, P _i =3W)			1000*	<20			135		
* # 1206A	三菱	"	"	45	4.5	1.7A	25W (T _c =25°C)	175	1mA	30	50	25	50			P ₀ =10.5W (f=770MHz, V _{CC} =25V, P _i =4W)							209		
* # 1206B	"	"	"	45	4.5	2A	25W (T _c =25°C)	175	1mA	40	50	25	50			P ₀ =12W (f=770MHz, V _{CC} =25V, P _i =4W)							209		
* # 1241A	東芝	"	"	35	3.5	2A	20W (T _c =25°C)	175	500	15	50	5	1A			P ₀ =11W (f=175MHz, V _{CC} =13.5V, P _i =1W)							135		
* # 1242A	"	"	"	35	3.5	4.5A	20W (T _c =25°C)	175	100	15	40	5	1.5A			P ₀ =13W (f=175MHz, V _{CC} =13.5V, P _i =1.3W)							135		
* # 1403A	サンケン	"	Si.TMe	180	6	8A	70W (T _c =25°C)	150	1mA	180	60	4	3A	12	-500					10*	130	7*	102	2SA745A とコンプリ	
* 2SC515A	東芝	PA.SW	Si.T	300	5	150	20W (T _c =25°C)	175	10	300	40-170	10	50	50	-20					100*	6		99		
* # 563A	松下	RF	Si.EP	40	4	25	300	175	10	40	>38	10	7	10	-5					550*	C _{ce} 0.23		117C		
* # 807A	ソニー	PA	Si.TMe	580	8	10	125W (T _c =25°C)	150	5mA	500	60	3	0.1	10	-500					5.5*	285		102		
* # 780A	東芝	SW	Si.T	150	5	30	400	125	0.1	150	70-240	3	10	10	-2	t _{on} =0.3μs, t _j =0.4μs t _{stg} =2μs			100*	2			138	2SA429 とコンプリ	
* # 979A	"	RF.SW	Si.E	100	5	100	300	175	1	100	40-140	1	10	10	-10	t _{on} =25nS, t _j =30nS t _{stg} =400nS			250*	3			49C		
* # 980A	"	"	"	90	5	100	400	125	0.1	50	70-140	1	10	10	-10	t _{on} =25nS, t _j =30nS t _{stg} =400nS			250*	3			138		
* # 1008A	日電	RF	"	100	8	700	800	150	0.1	60	140	2	50	10	-50					70*	15	25*	84B	2SA708A とコンプリ	
* # 1033A	松下	RF.AF	Si.TP	250	5	25	300	175	2	12	>20	10	5										49C		
* # 1098A	日電	PA.SW	Si.E	70	5	3A	10W (T _c =25°C)	150	1	45	100	5	500	5	-100					60*	40		167	2SA636A とコンプリ	

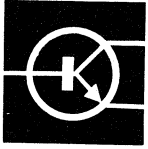
型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電気的特性 (T _a = 25°C)											外形	備考										
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _F F _E		バイアス		h _{fe}	h _{ie} h _{ib} *	h _{re} h _{rb} *	h _{oe} h _{ob} *	f _{αβ} f _T *			C _{ob} (pF)	τ _{bb} h _{ie} (real)*								
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										h _{fb} *	h _{ie} (Ω)	(×10 ⁻⁴)	(μΩ)	(Mc)			
2SC1271A	日電	RF	Si.E	20	3	30	250	200	0.05	8	100	8	10	8	-10									190							
" 1867A	"	SW	Si.EMe	300	7	7A	80W (T _c =25°C)	150	100	250	30	5	3A											102							
* 2SC1207A	三菱	PA	Si.EP																					209							
* " 1207B	"	"	"	45	4	4A	50W (T _c =25°C)	175	2mA	30														209							
" 1208A	"	"	"	36	5	10A	60W (T _c =25°C)	175	2mA	15														127							
" 1247A	富士通	AF.PA	"	50	5	500	500	150	0.5	12	160	2	100									60*	12	70*	138						
" 1325A	日電	SW	Si.TMe	1500	6	6A	80W (T _c =25°C)	150	20	1000	19	15	1A											102							
* " 1358A	"	"	"	1400	6	5.5A	50W (T _c =25°C)	150	20	1000	19	15	500											102							
* " 1448A	東芝	RF.PA	"	150	5	1.5A	25W (T _c =25°C)	150	20	100	70-140	10	500	10	-500								7*	35	25	268					
" 1469A	新電元	SW	Si.T	500	6	10A	100W (T _c =25°C)	150	2mA	500	12	5	5A											102							
" 1471A	"	"	"	500	6	30A	200W (T _c =25°C)	155	2mA	500	15	5	10A											266							
" 1711A	富士通	RF	Si.EP	20	3	30	200	175	0.5	10	80	8	10	8	-10								7.5 GHz*		30*	262					
" 1605A	三菱	RF.PA	"	35	4.5	3.5A	35W (T _c =25°C)	175	500	25	10-180	10	0.1A												113						
2SC911A	三菱	PA	Si.EP	40	4	500	1.7W	175	10	15	50	10	100												271						
" 973A	"	"	"	40	4	700	12W (T _c =25°C)	175	10	15	50	10	100												126						
" 975A	"	"	"	40	5	1.5A	20W (T _c =25°C)	175	100	15	50	10	100												126						
" 1553A	東芝	LN	"	20	3	30	175	175	0.1	10	100	10	5	10	-10										4500*	0.9	40	50C			
" 1775A	日立	RF	Si.E	120	5	50	300	125	0.5	100	400-1200	12	2	12	-2										200*	1.6	138	2SA872A とコンプリ			
" 1930A	富士通	"	Si.EP	16	3	30	150	175	0.1	10	80	3	10	6	-20										8000*	0.35	30	284			
* 2SC403B	ソニー	RF.AF	Si.PaMe	50	4	100	320	120	0.2	25	41-175	3	1	6	-2										h _{re} = 3 dB (f=100MHz)	2	C _c τ _{on} 40pS	38			
" 403C	"	"	"	60	4	100	320	120	0.2	25	41-175	3	1	6	-2										h _{re} = 3 dB (f=100MHz)	2	C _c τ _{ob} 40pS	38			
" 690A	三菱	PA	Si.EP	60	5	4A	35W (T _c =25°C)	175	500	30	50	10	100													P ₀ = 25W (f=150MHz, V _{CC} = 6V, P _i = 4W)			113		
" 1567A	松下	"	"	120	5	500	1.2W	150			160	10	150	10	-150											120*		222	2SA794A とコンプリ		
" 1619A	サンケン	"	Si.TMe	120	6	6A	50W (T _c =25°C)	175	1mA	120	60	4	3A	12	-500											10*	85	12*	102	2SA808A とコンプリ	
" 1707A	日立	AF.SW	Si.E	70	5	100	200	175	0.5	20	100-200	1	10	10	-10											I _{on} = 80nS, I _{off} = 300nS I _{stg} = 220nS	>100*	2.6	49C		
* " 1746A	東芝	RF.LN	Si.EP	50	5	50	150	150	0.1	35	450	6	2	6	-1											NF = 1.3dB (f=100Hz, V _{CC} = 6V, I _c = 0.1mA)	140*	2	60	49C	
" 2122A	"	SW	Si.TMe	1000	8	10A	50W (T _c =25°C)	150	I _C EX 1mA	1000	>15	10	2.5A	10	-100												I _J < 1μS	6*	125	102	水平偏向用

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外形	備考			
				V _{CBO} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CBO} 最大値 (μA)	V _{CE(V)}	直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μΩ)	f _β f _T * (Mc)			C _{ob} C _{re} (pF)	r _{bb} h _{ie(real)} * (Ω)	
											V _{CE(V)}	I _C (mA)	V _{CB(V)}	I _E (mA)										NF < 3dB (6V, 5mA, 500MHz)
2SC1655A	日電	RF.LN	Si.E	16	3	30	150	175	0.1	10	100	3	10	6	-20			8000*	C _{re} 0.5	40*	320			
" 1890A	日立	AF	"	120	5	50	300	125	0.5	100	250-1200	12	2	12	-2			200*	<10		138			
" 1913A	松下	PA	"	180	5	1A	15W (T _c =25°C)	150	100	180	65-330	10	150	10	-50			120*	<10		268			
" 1965A	三菱	"	"	40	4	2A	15W (T _c =25°C)	175	500	25	50	10	100								97B	エミッタ・ケース接続		
" 2127A	新電元	SW	Si.T	200	6	10A	100W (T _c =25°C)	150	250	200	32	3	10A								102			
" 2128A	"	"	"	200	6	30A	200W (T _c =25°C)	150	500	200	22	3	30A								266			
2SC631A	ソニー	RF.AF.LN	Si.E	25	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C _c r _{bb} ' 350pS	38	2SA704 とコンプリ
" 632A	"	RF.LN	"	50	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C _c r _{bb} ' 350pS	38	2SA705 とコンプリ
" 633A	"	RF.Conv.Mix Osc.SW	"	25	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-2	t _r < 60ns, t _f < 150ns t _{sig} < 500ns				140*	4.5	C _c r _{bb} ' 350pS	38	2SA677 とコンプリ
" 634A	"	"	"	50	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-2	t _r < 60ns, t _f < 150ns t _{sig} < 500ns				140*	4.5	C _c r _{bb} ' 350pS	38	2SA678 とコンプリ
" 756A	"	RF.PA	Si.EMe	130	6	4A	10W (T _c =25°C)	175	1	50	100	2	100	10	-100					100*	45	C _c r _{bb} ' 35pS	181	
" 806A	"	PA	Si.TMe	700	10.5	10A	125W (T _c =25°C)	150	5mA	500	40	3	2A	10	-500					5.5*	285	5	102	
" 867A	"	RF.PA	"	520	10	3A	48W (T _c =25°C)	150	50	50	80	3	100	10	-200					8.5*	90	12	100	
" 1664A	サンケン	PA	"	100	6	6A	40W (T _c =25°C)	150	10	100	1000	4	1A	10	-500					20*	75	12	99	
" 1741A	ローム	AF	Si.EP	50	5	500	400	125	0.5	30	82-390	3	100	5	-20					250*	5		138	
" 1871A	日電	SW	Si.TMe	500	7	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	400	>15	5	5A			t _{on} < 1μs, t _f < 1μs t _{sig} < 2μs							102	
" 2337A	"	PA.SW	Si.E	150	4.5	10A	100W (T _c =25°C)	150	50	150	150	5	1A	5	-200	t _{on} = 0.2μs, t _f = 1.8μs t _{sig} = 1.5μs				70*	150		102	2SA1007A とコンプリ
" 2516A	"	SW	"	150	12	5A	30W (T _c =25°C)	150	10	80	40-200	5	3A			t _{on} < 0.5μs, t _f < 0.5μs t _{sig} < 1.5μs							268	2SA1069A とコンプリ
" 1627A	東芝	AF.PA	"	80	5	400	800	150	0.1	50	70-240	2	50	10	-10					100*	10		241	2SA817A とコンプリ
" 1708A	三菱	AF.LN.RF	Si.EP	120	5	50	200	125	0.1	70	250-1200	6	1	6	-1	V _{BE} < 170mV (10V, 1mA, R _e = 100kΩ, A _e = 80dB)				150*	1.8		138B	2SA847A とコンプリ
" 1914A	"	AF.RF	"	120	5	50	200	125	0.1	70	250-1200	6	1	6	-1					150*	1.8		138B	
" 2126A	新電元	SW	Si.T	200	6	3A	30W (T _c =25°C)	150	250	200	42	3	3A			t _{on} < 1μs, t _f < 1μs t _{sig} < 2μs							204	
" 2139A	東芝	"	"	500	6	10A	100W (T _c =25°C)	150	100	400	>20	5	5A			t _r < 1μs, t _f < 1μs t _{sig} < 2.5μs							102	
" 2230A	"	PA	"	200	5	100	800	150	0.1	200	120-400	10	10	10	-10					>50*	<7		241	
" 2231A	"	"	"	200	5	200	12W (T _c =25°C)	150	0.1	200	100-320	10	50	10	-50					>50*	<10		178	
" 2238A	"	"	Si.E	180	5	1.5A	25W (T _c =25°C)	150	1	160	70-240	5	100	10	-100					100*	25		268	2SA968A とコンプリ
" 2238B	"	"	"	200	5	1.5A	25W (T _c =25°C)	150	1	160	70-240	5	100	10	-100					100*	25		268	2SA968B とコンプリ
2SC1473A	松下	AF	Si.TP	300	7	70	750	150			30-220	10	5							50*	10		138	

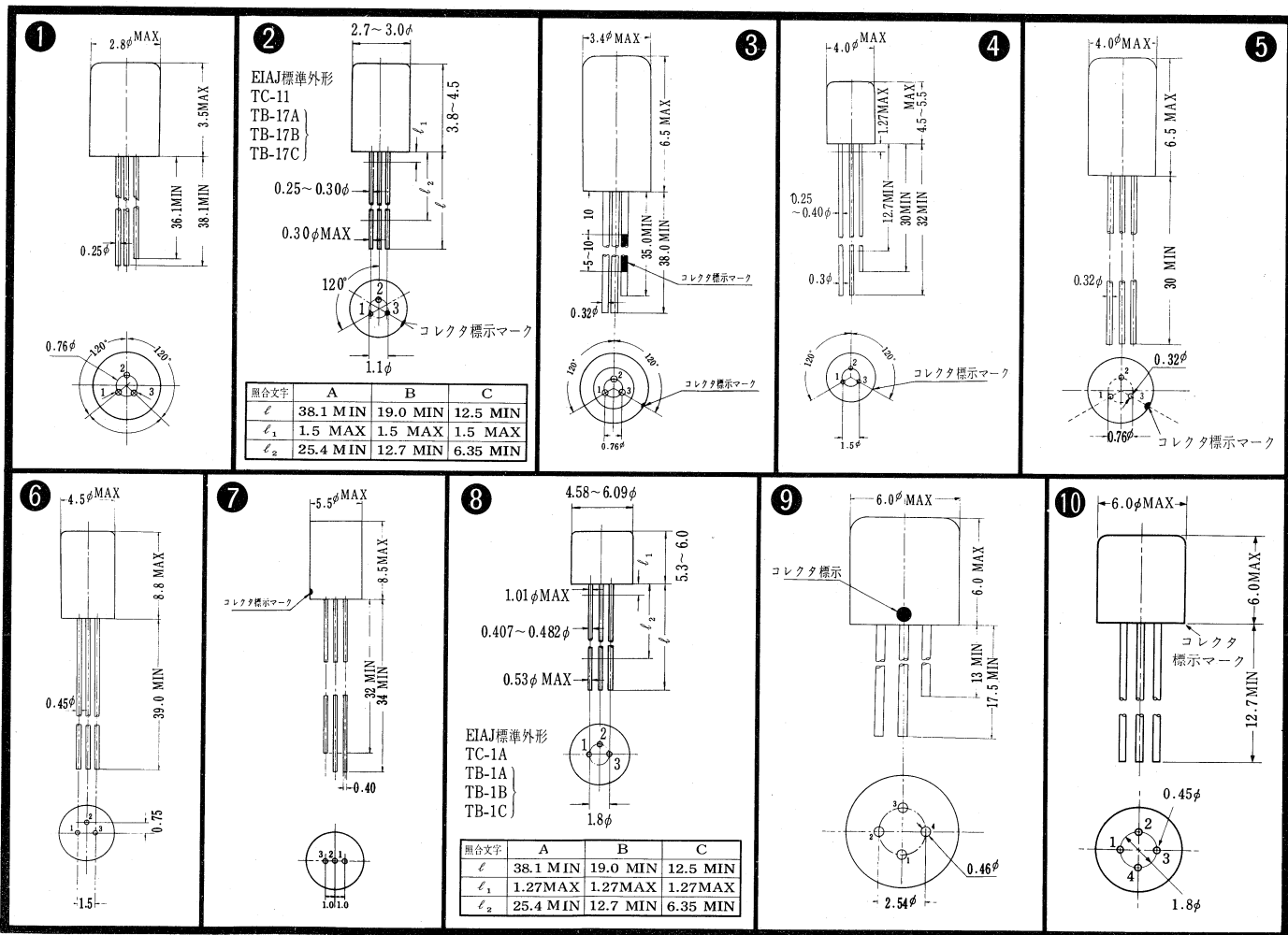
型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス hFE		バイアス			h _{fe}	h _{ie} h _{ik} * (Ω)	h _{re} h _{rk} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ok} * (μΩ)			f _{ob} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie'(real)} * (Ω)	
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fe} *										
2SD51A	ソニー	PA	Si. Me	150	6	5 A	50W (T _c =25°C)	150	100	50	60	3	2 A	10	-500				10*				102		
* 88A	"	"	Si. TMe	100	8	10 A	120W (T _c =25°C)	150	100	50	150	3	2 A										102		
* 170A	日立	"	Ge. A	32	12	500	200	85	20	12	150	1	150										12A	2SB370A とコンプリ	
* 206A	新電元	PA. SW	Si. DJ	50	8	10 A	150W (T _c =25°C)	150	1	30	20	5	5 A	10	-1A				f _{oe} 18kHz				102		
* 207A	"	"	"	100	8	10 A	150W (T _c =25°C)	150	1	30	20	5	5 A	10	-1A				f _{oe} 18kHz				102		
* 208A	"	"	"	150	8	10 A	150W (T _c =25°C)	150	1	30	20	5	5 A	10	-1A				f _{oe} 18kHz				102		
* 226A	松下	PA	"	60	8	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	50	3	1 A	10	-200				f _{oe} 25kHz				99		
* 226B	"	"	"	80	8	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	50	3	1 A	10	-200				f _{oe} 25kHz				99		
* 232A	富士通	SW. AF	Si. TMe	160	7	30 A	125W (T _c =25°C)	175	1mA	50	25	4	10A										102		
* 317A	松下	PA	Si. T	80	8	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	-200				f _{oe} 25kHz				268		
* 318A	"	"	"	80	8	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	60	3	1 A	10	-200				f _{oe} 25kHz				267		
* 334A	"	"	Si. DJ	130	7	6 A	75W (T _c =25°C)	150	1mA	130	100	4	1 A										102		
* 363A	日電	SW	Si. TMe	350	6	30 A	200W (T _c =25°C)	175	100	300	30	5	15A						t _{on} < 2μS, t _{off} < 6.5μS t _{stg} < 4μS				106		
* 365A	松下	PA	"	80	5	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	70	3	1 A						f _{oe} 70kHz				268	2SB512A とコンプリ	
* 366A	"	"	"	80	5	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	70	3	1 A						f _{oe} 70kHz				267	2SB513A とコンプリ	
* 373A	日電	SW	"	350	6	30 A	200W (T _c =25°C)	175	100	300	30	5	15A										106		
* 389A	松下	PA	Si. Dj	80	8	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	-200				f _{oe} 25kHz				268		
* 390A	"	"	"	80	8	3 A	25W (T _c =25°C)	150	30	20	70	3	1 A	10	-200				f _{oe} 25kHz				267		
* 287C	日電	"	Si. T	200	7	10 A	100W (T _c =25°C)	150	50	120	80	5	2 A	5	-200				15*	270			102	2SB539C とコンプリ	
2SD78A	日電	PA. SW	Si. EPa	100	12	2 A	1W (T _c =25°C)	175	1	80	80	2	500	10	-200									84B	2SB504A とコンプリ
* 181A	"	"	Si. TMe	250	7	10 A	100W (T _c =25°C)	175	1mA	200	60	5	5 A	10	-200									102	
* 200A	松下	SW	Si. Me	1500	5	2.5 A	10W (T _c =25°C)	115	1mA	1500	2.5	5	2 A						t _f = 0.7μS					102	
* 287A	日電	PA	Si. T	200	7	10 A	100W (T _c =25°C)	150	50	120	80	5	2 A	5	-200				15*	270			102	2SB539A とコンプリ	
* 287B	"	"	"	200	7	10 A	100W (T _c =25°C)	150	50	120	80	5	2 A	5	-200				15*	270			102	2SB539B とコンプリ	
* 376A	"	PA. SW	Si. TMe	300	7	10 A	100W (T _c =25°C)	175	100	300	50	5	2 A						t _{on} = 0.6μS, t _f = 0.5μS t _{stg} = 3μS					102	
* 574A	新電元	"	Si. DJ	120	4	30 A	400W (T _c =25°C)	150	1mA	120	800	3	15A						t _{on} < 2μS, t _f < 5μS t _{stg} < 4.5μS					266	ターリントン
* 538A	富士通	SW	Si. TP	500	7	10 A	150W (T _c =25°C)	175	100	150	25	5	5 A						t _c = 1μS, t _f = 0.7μS t _{stg} = 1.5μS					102	
* 539A	"	"	"	400	7	10 A	150W (T _c =25°C)	175	100	150	25	5	5 A						t _c = 1μS, t _f = 0.7μS t _{stg} = 1.5μS					102	
* 587A	日電	PA	Si. T	120	5	6 A	70W (T _c =25°C)	150	50	100	80	5	1 A	5	-200				17*	130			295	2SB617A とコンプリ	
* 588A	"	"	"	150	5	7 A	80W (T _c =25°C)	150	50	120	80	5	1 A	5	-200				15*	190			295	2SB618A とコンプリ	

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外 形	備 考			
				V_{CB0} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直 流 又 は バ ル ス hFE			バ イ ア ス		h_{fe} h_{fe}^*	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oc} h_{ob}^* (μU)			f_{ab} f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)
									μA	$V_{CB}(V)$	$V_{CE}(V)$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CB}(V)$	$I_E(\text{mA})$	h_{fe}									
2SD711A	富士電機	SW	Si.TP	600	6	15A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	500	600	200	1.7	15A									102	ダーリントン	
" 795A	日 電	PA	Si.E	50	5	3A	20W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1	40	160	1	500									268		
" 814A	松 下	LN	Si.EP	185	5	50	200	125	1	100	90-450	5	10	10	-10					150*	2.3	176		
" 836B	"	PA	Si.TP	100	5	2A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	100	4000	4	2A									268	ダーリントン	
" 848A	日 電	"	Si.T	130	5	7A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	120	80	5	1A									295		
" 855A	松 下	"	Si.TP	80	5	1A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	200	80	120	4	200									268		
" 855B	"	"	"	100	5	1A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	200	100	120	4	200									268		
" 856A	"	"	"	80	5	3A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	200	80	100	4	1A									268		
" 856B	"	"	"	100	5	3A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	200	100	100	4	1A									268		
" 857A	"	"	"	80	5	4A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	400	80	100	4	1A									268		
" 857B	"	"	"	100	5	4A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	400	100	100	4	1A									268		
" 858A	"	"	"	80	5	5A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	400	80	120	4	1A									152		
" 858B	"	"	"	100	5	5A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	400	100	120	4	1A									152		
" 859A	"	"	"	400	5	750	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	400	120	10	300									268		
" 859B	"	"	"	450	5	750	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	450	120	10	300									268		
" 860A	"	"	"	400	5	1A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	400	120	10	300									268		
" 860B	"	"	"	450	5	1A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	450	120	10	300									268		
* " 861A	"	"	"	400	5	1.5A	45W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	400	120	10	300									268		
* " 861B	"	"	"	450	5	1.5A	45W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1mA	450	120	10	300									268		
" 866A	"	SW	Si.EP	150	7	7A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	100	60-260	2	3A	10	-500		$t_f=0.1\mu\text{S}$		30*			268		
" 883A	日 電	PA	Si.T	120	5	6A	70W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	100	80	5	1A									295		
" 1032A	松 下	"	Si.TP	80	5	4A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	400	80	100	4	1A									152		
" 1032B	"	"	"	100	5	4A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	400	100	100	4	1A									152		
" 1052A	東 芝	"	Si.T	50	7	3A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	50	800	5	500									268		
" 1110A	日 電	"	"	130	5	7A	80W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	120	80	5	1A	5	-200				15*	190		162	2SB849A とコンプリ	
" 1117A	富士電機	"	Si.TP	80	7	10A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	80	120	5	2A									268		
" 1163A	日 立	SW	Si.T	350	6	7A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	5mA	350	40	5	5A				$t_f<0.5\mu\text{S}$					268	水平偏向用	

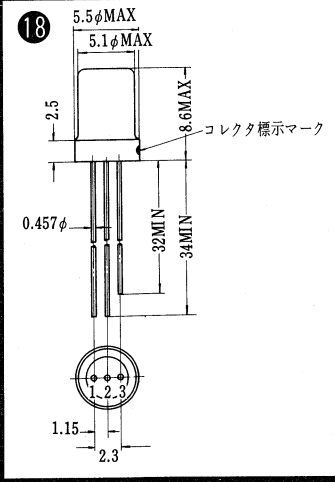
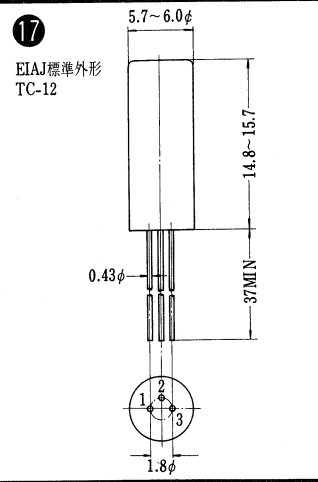
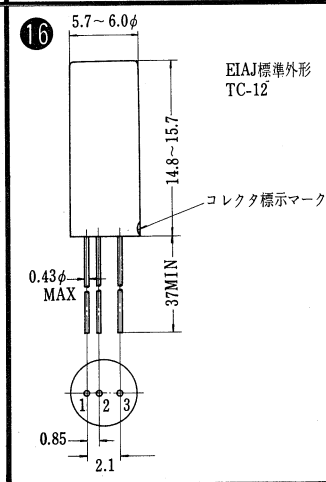
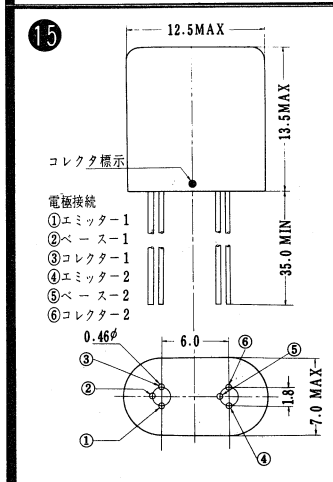
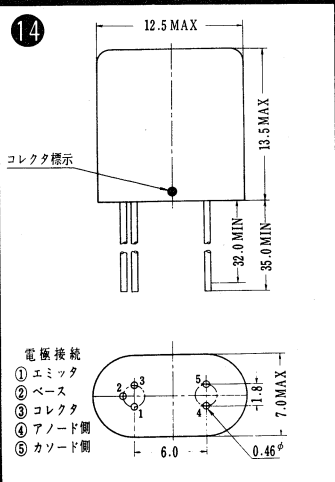
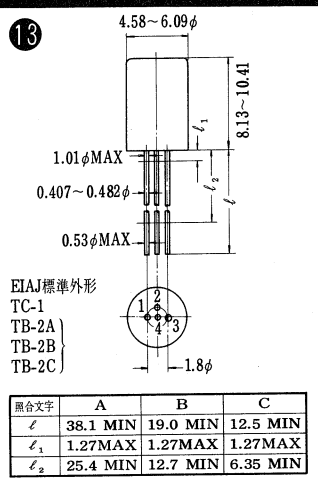
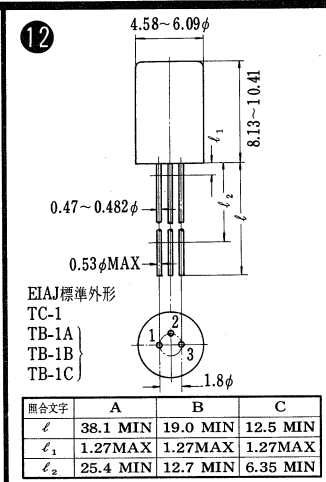
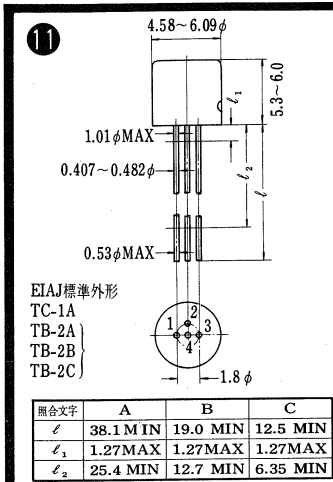
型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)											外形	備考		
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_j ($^\circ\text{C}$)	I_{CBO} 最大値		直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{je}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{ob}^* (μU)	f_{β} f_T^* (Mc)			C_{ob} (pF)	r_{bb} $h_{ie}(\text{real})^*$ (Ω)
									I_{CBO} (μA)	$V_{CB(V)}$	$V_{CE(V)}$	I_C (mA)	$V_{CB(V)}$	I_E (mA)									
2SD581A	日立	PA	Si.E	150	6	7 A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	120	120	5	1 A									102	
" 592A	松下	AF	Si.EP	60	5	1 A	750	150	0.1	20	60~340	10	500					200*	20			138	2SB621A とコンプリ
" 762A	"	PA	Si.TM	80	8	4 A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	20	30~160	3	1 A					f_{α} 25k				268	
" 772A	"	"	Si.TP	200	6	5 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1 mA	200	14<	4	5 A					40*				268	
" 772B	"	"	"	250	6	5 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1 mA	150	14<	4	5 A					40*				268	
" 898B	日立	SW	Si.T	1500	6	3 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	I_{CES} 500	1500												102	水平偏向用 ダンパ内蔵
" 900B	"	"	"	1500	6	5 A	50W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	I_{CES} 500	1500												102	水平偏向用 ダンパ内蔵
" 1176A	松下	SW	Si.P	80	7	8 A	45W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	80	1000~ 10000	3	4 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=4\mu\text{S}$				268	ダーリントン 2SB972A とコンプリ
" 1198A	"	AF	Si.EP	60	5	1 A	750	150	0.1	45	2000~ 20000	10	1 A									151	ダーリントン
" 1205A	"	"	"	60	5	500	400	150	0.1	25	2000~ 20000	10	500									151	ダーリントン
" 1241A	"	AF.PA	Si.DJ	80	8	5 A	60W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	20	80	3	1 A									152	
" 1242A	"	"	"	80	8	6 A	70W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	20	80	3	2 A									152	
" 1243A	"	"	"	80	8	10A	100W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	30	20	80	3	3 A									152	
" 1249A	"	PA	Si.TP	400	5	750	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40~250	10	300					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=2.0\mu\text{S}$				263	
" 1250A	"	"	"	200	6	2 A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	200	60~240	10	150									263	2SB928A とコンプリ
" 1253A	"	"	"	80	5	4 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40~250	4	1 A					$t_{on}=0.4\mu\text{S}$, $t_s=1.2\mu\text{S}$				263	2SB930A とコンプリ
" 1257A	"	SW	Si.EP	150	7	7 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	100	60~260	2	3 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=1.5\mu\text{S}$			30*	263	2SB934A とコンプリ
" 1260A	"	PA	Si.TP	80	5	2 A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1 mA	80	1000~ 10000	4	2 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=4.0\mu\text{S}$				263	ダーリントン 2SB937A とコンプリ
" 1261A	"	"	"	80	5	4 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	200	80	1000~ 10000	3	3 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=4.0\mu\text{S}$				263	ダーリントン 2SB938A とコンプリ
" 1262A	"	"	"	80	7	8 A	45W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	80	1000~ 10000	3	4 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=4.0\mu\text{S}$				363	ダーリントン 2SB939A とコンプリ
" 1263A	"	"	"	400	5	750	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40~250	10	300					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=2.0\mu\text{S}$				364	
" 1264A	"	"	"	200	6	2 A	30W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	50	200	60~240	10	150									364	
" 1266A	"	"	"	80	5	3 A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40~250	4	1 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=2.5\mu\text{S}$				364	
" 1267A	"	"	"	80	5	4 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150			40~250	4	1 A									364	
" 1271A	"	SW	Si.EP	150	7	7 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	10	100	60~260	2	3 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=1.5\mu\text{S}$			30*	364	
" 1274A	"	PA.SW	Si.TP	200	6	5 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1 mA	200	14~100	4	5 A					$t_{sig}<6\mu\text{S}$, $t_f<1\mu\text{S}$				364	
" 1274B	"	"	"	250	6	5 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1 mA	250	14~100	4	5 A					$t_{sig}<6\mu\text{S}$, $t_f<1\mu\text{S}$				364	
" 1257A	"	PA	"	80	5	2 A	35W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	1 mA	80	1000~ 10000	4	2 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=4.0\mu\text{S}$				364	
" 1276A	"	"	"	80	5	4 A	40W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	200	80	1000~ 10000	3	3 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=4.0\mu\text{S}$				364	
" 1277A	"	SW	"	80	7	8 A	45W ($T_c=25^\circ\text{C}$)	150	100	80	1000~ 10000	3	4 A					$t_{on}=0.5\mu\text{S}$, $t_s=4.0\mu\text{S}$				364	



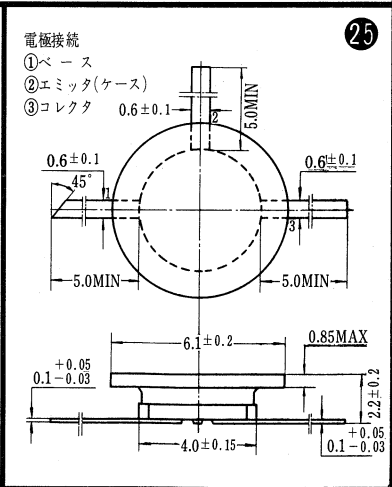
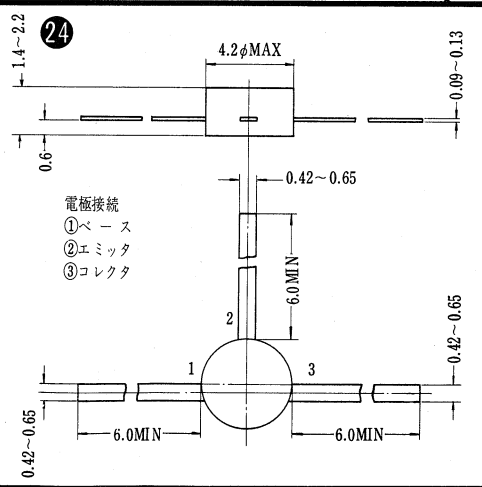
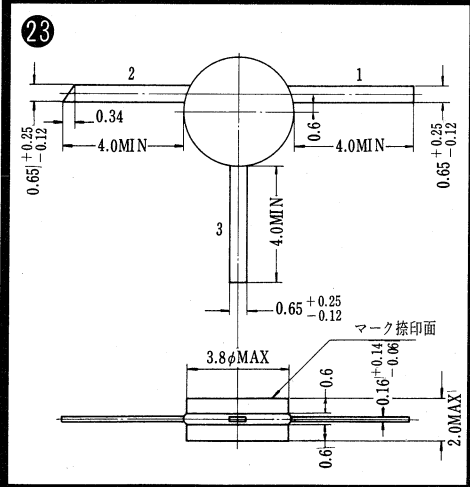
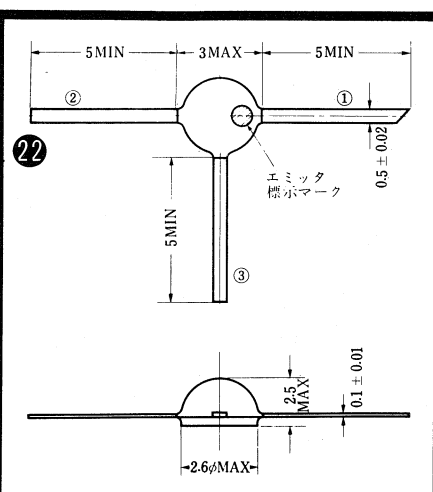
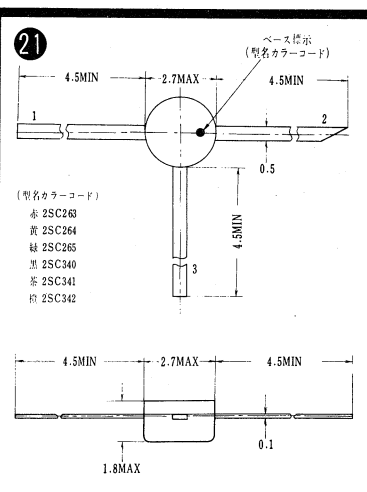
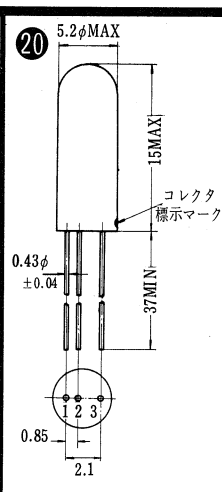
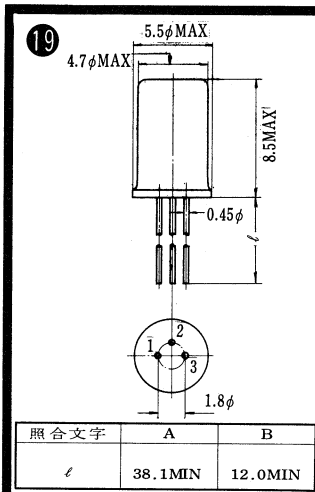
外形寸法図



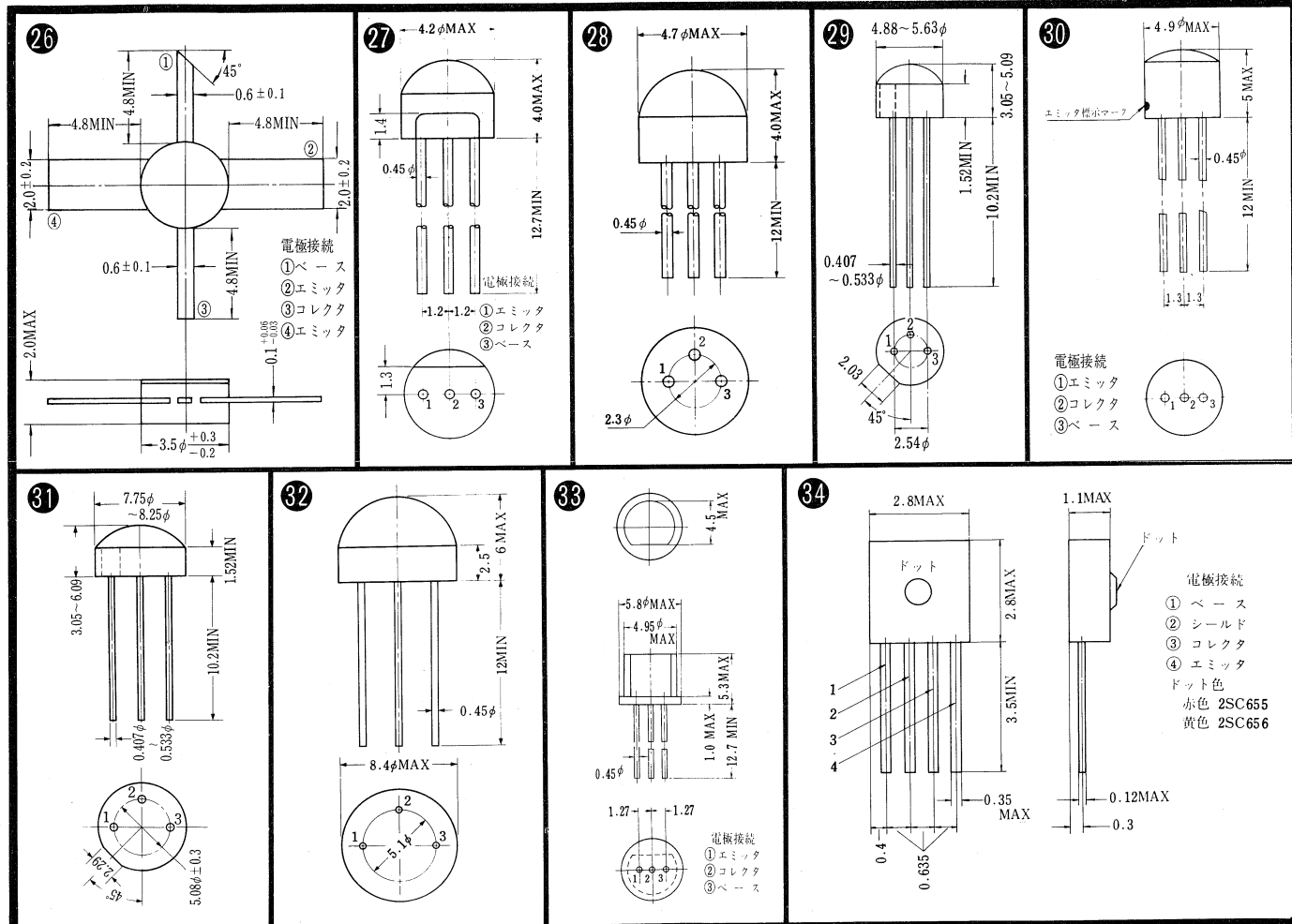
● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

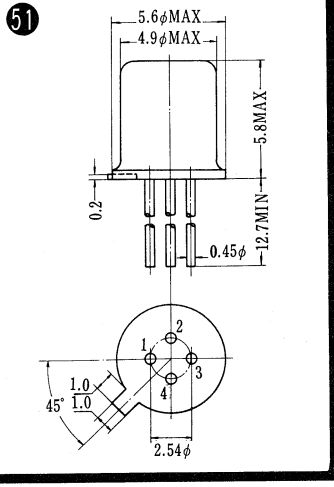
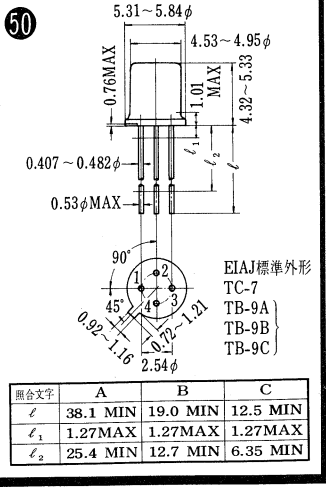
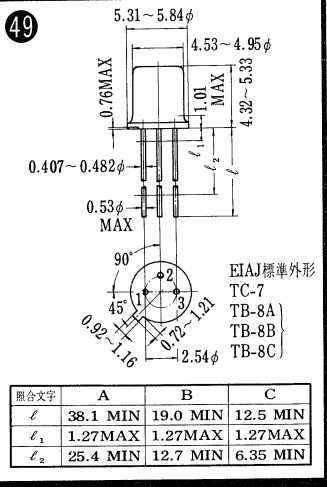
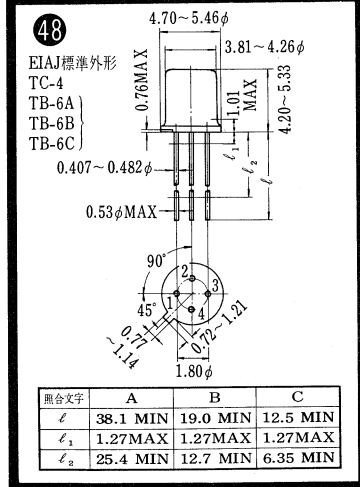
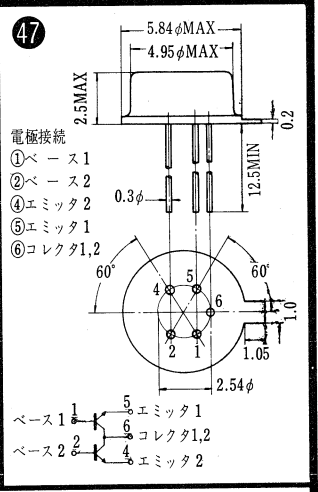
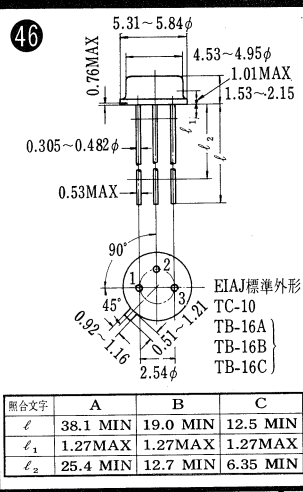
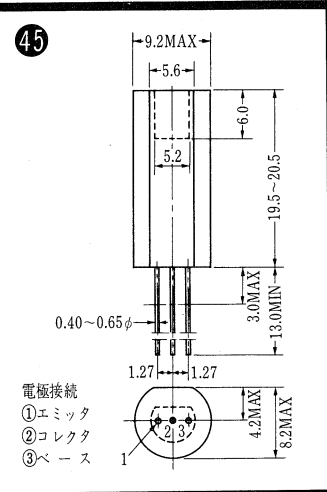
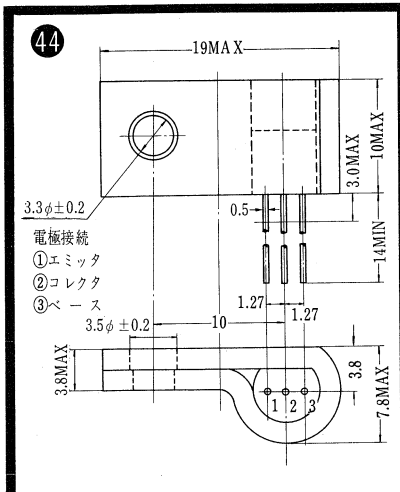


●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



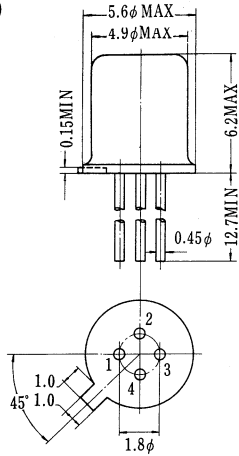
● 電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》

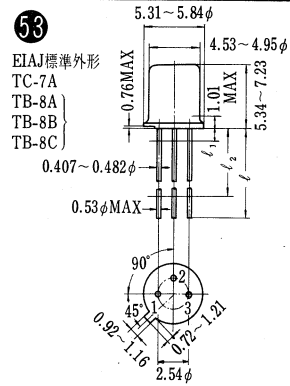


●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

52

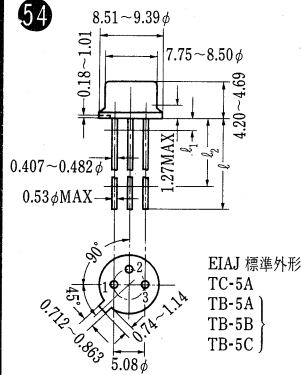


53



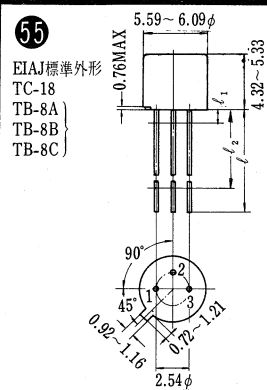
照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27 MAX	1.27 MAX	1.27 MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

54



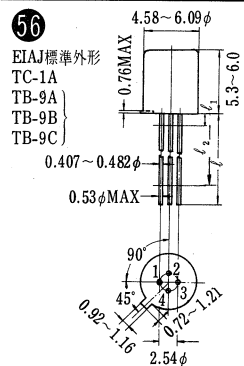
照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27 MAX	1.27 MAX	1.27 MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

55



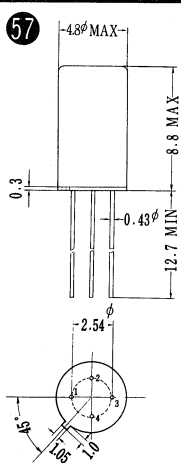
照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27 MAX	1.27 MAX	1.27 MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

56

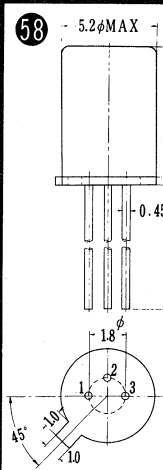


照合文字	A	B	C
ℓ	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
ℓ_1	1.27 MAX	1.27 MAX	1.27 MAX
ℓ_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

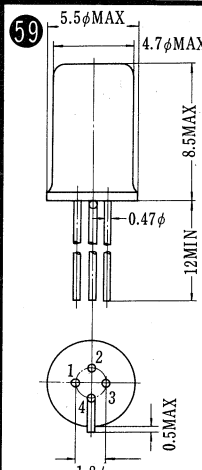
57



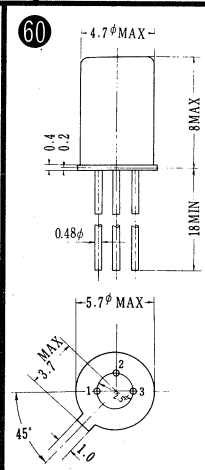
58



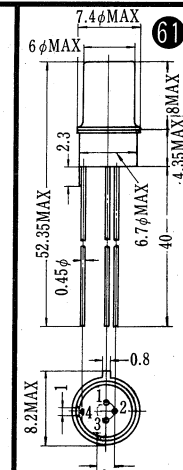
59



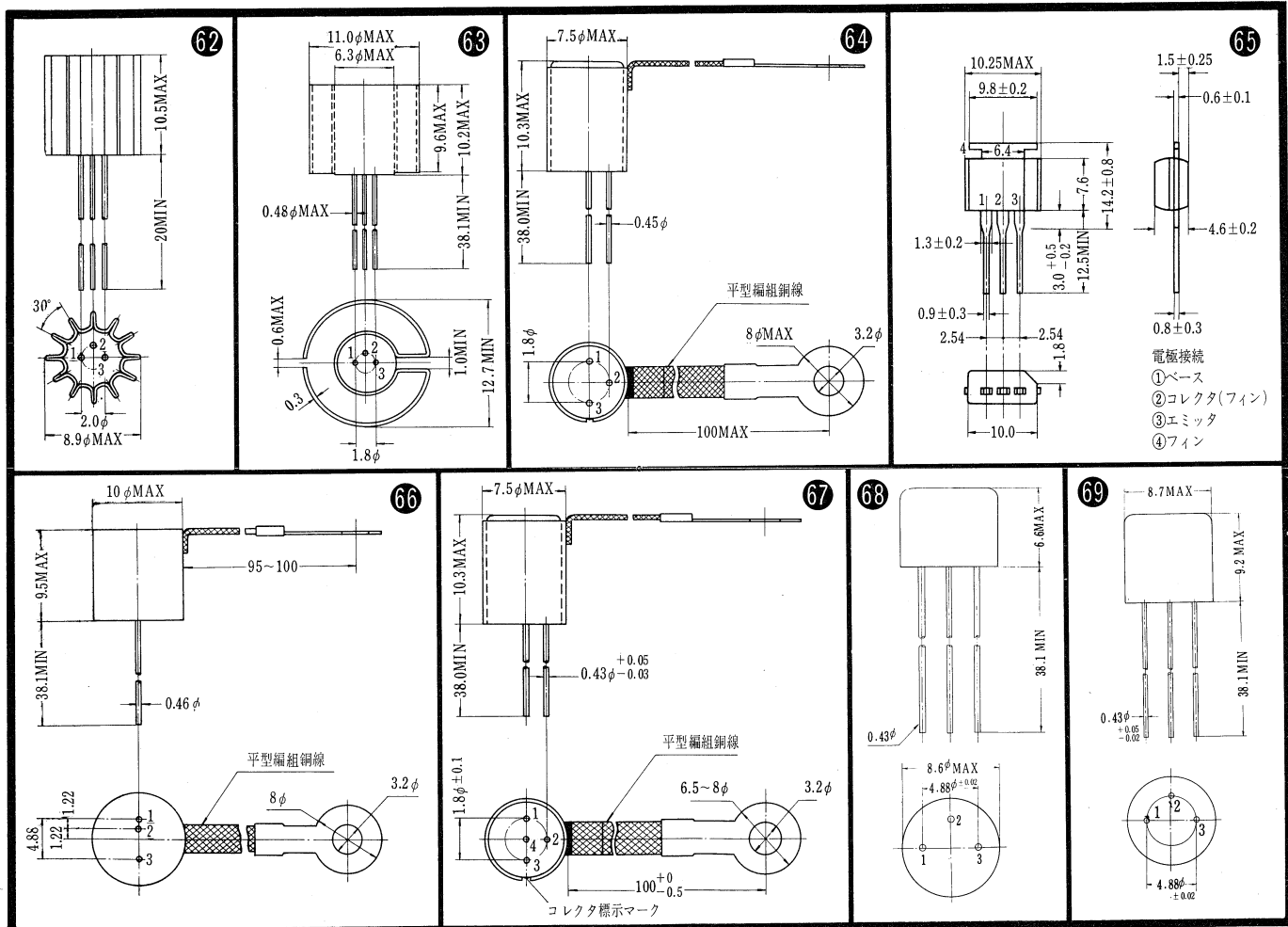
60



61

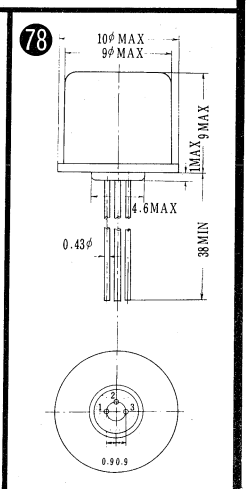
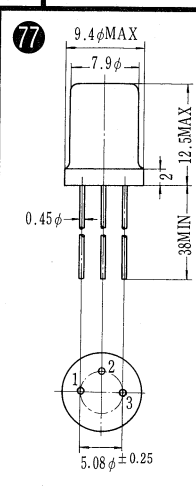
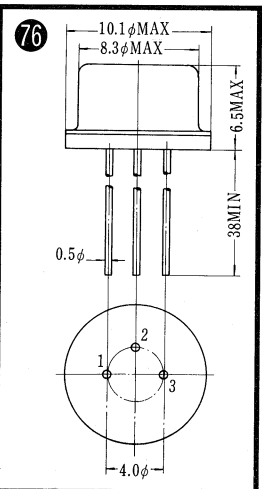
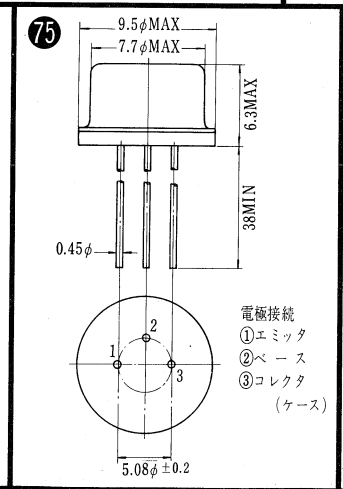
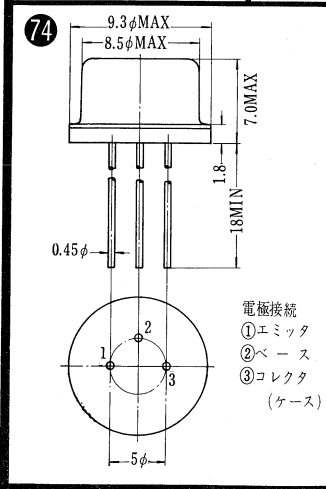
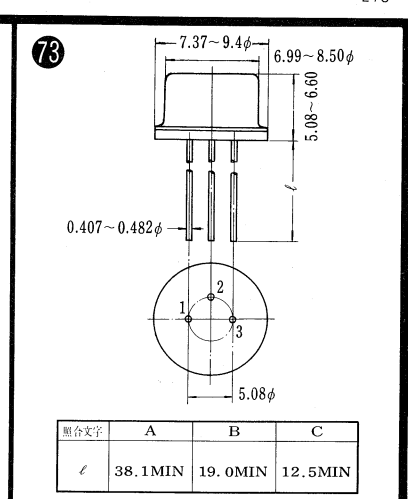
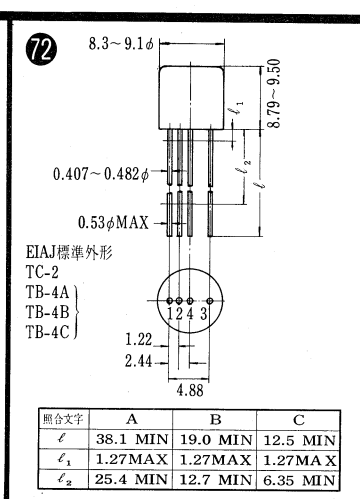
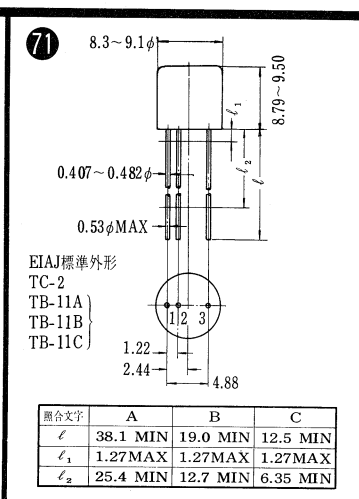
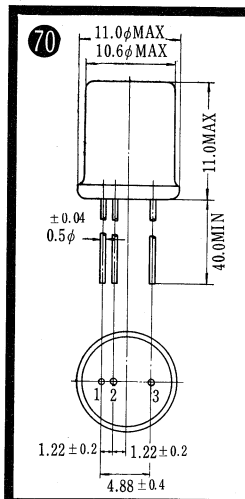


●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

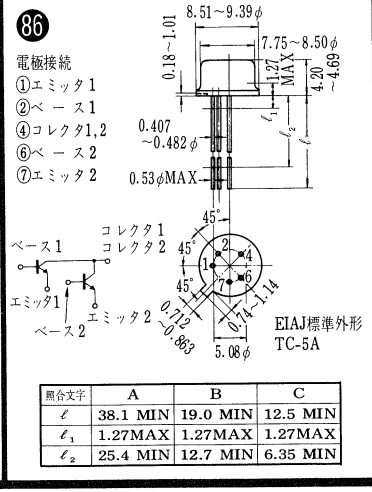
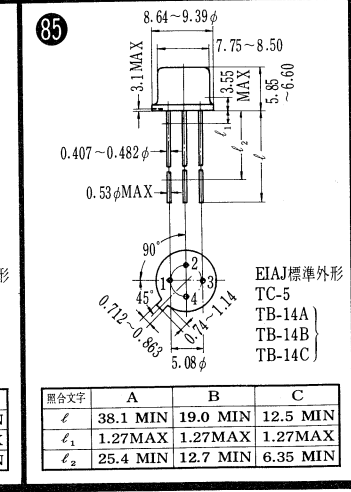
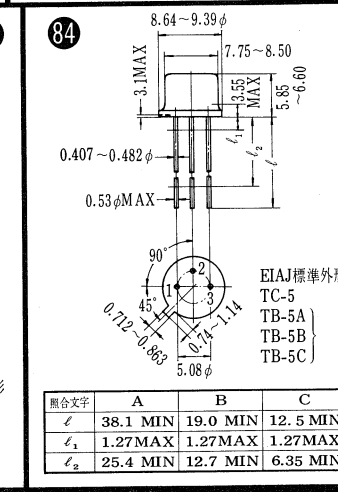
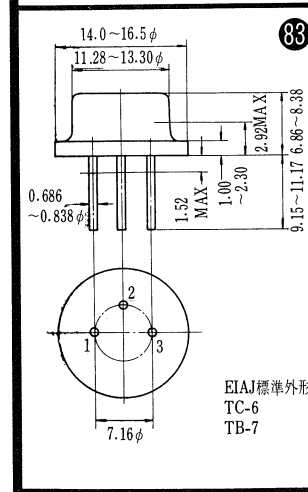
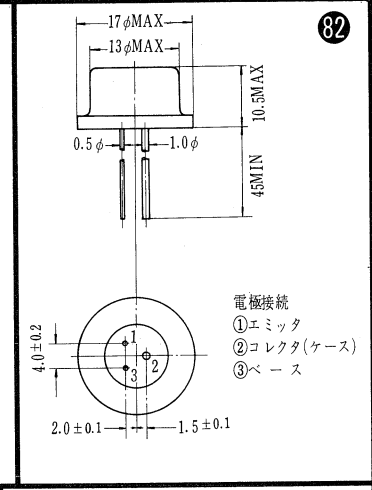
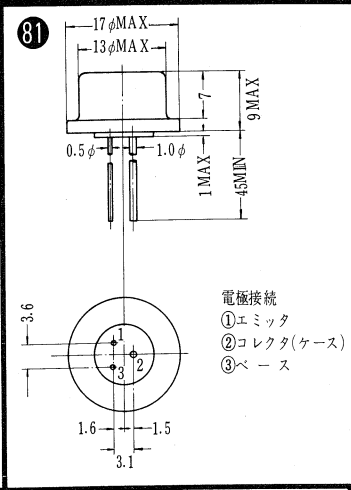
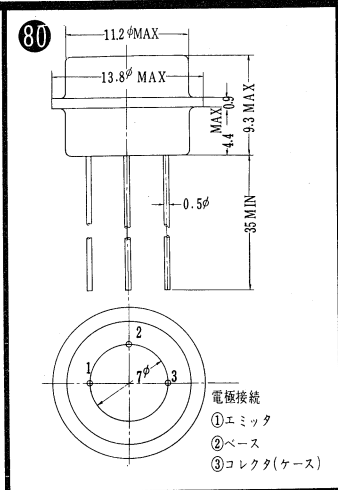
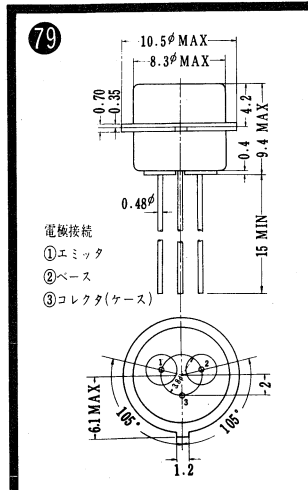


●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

【寸法図単位：mm】

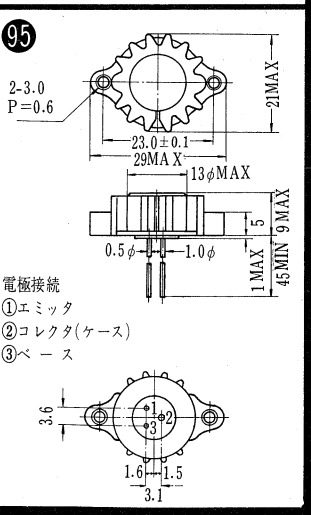
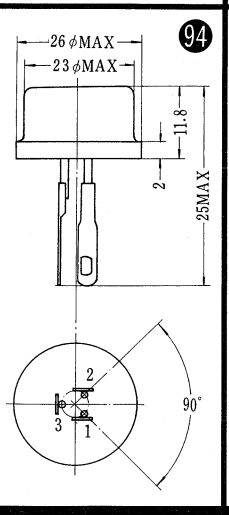
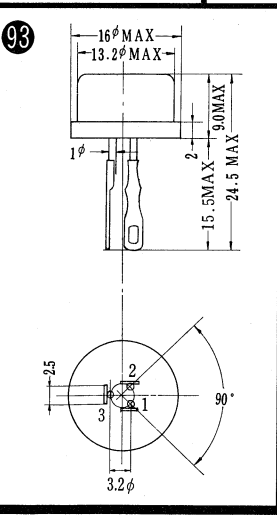
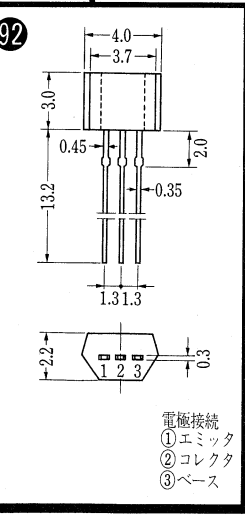
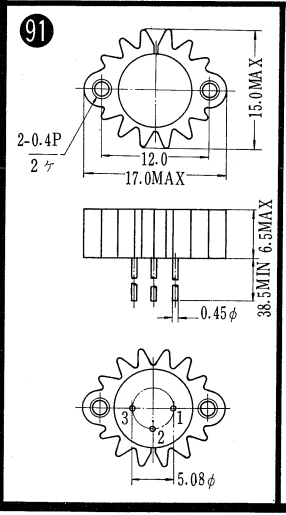
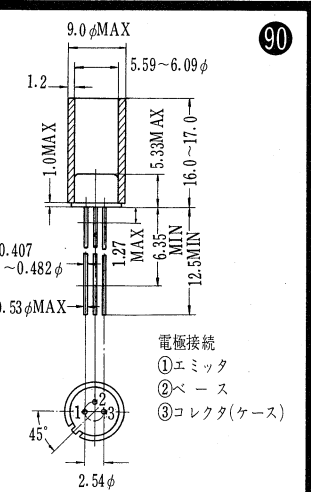
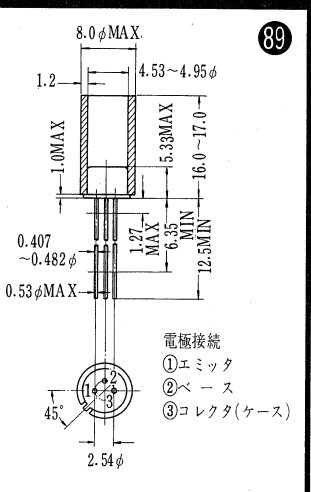
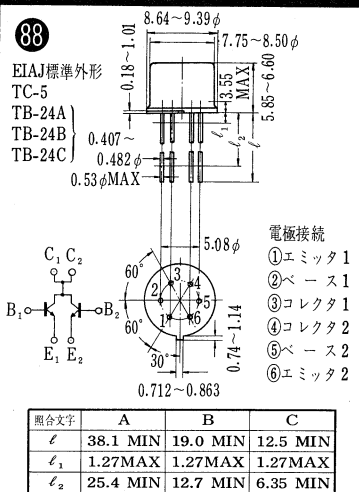
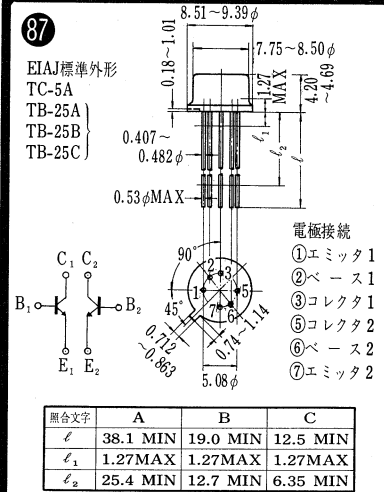


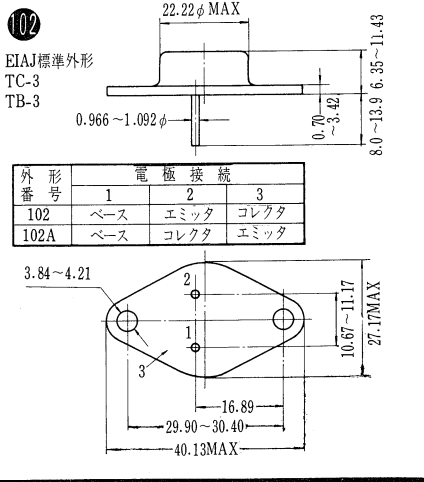
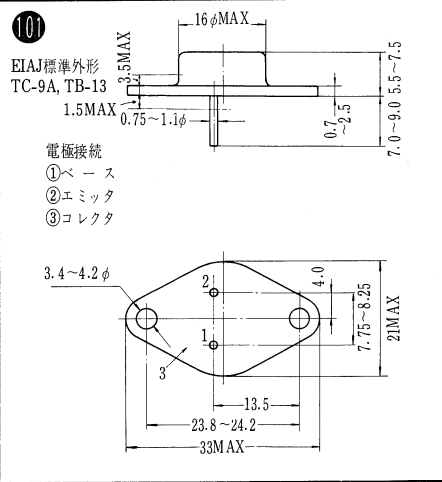
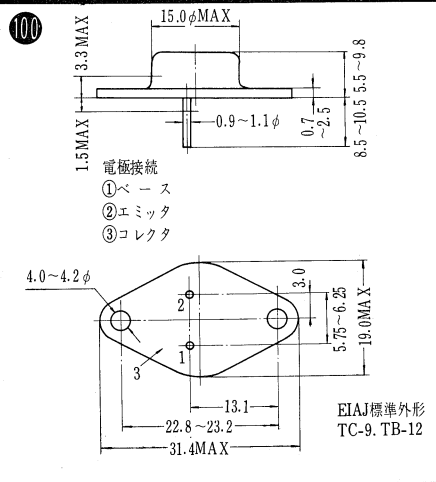
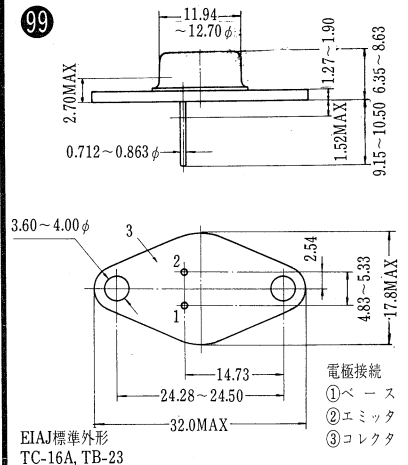
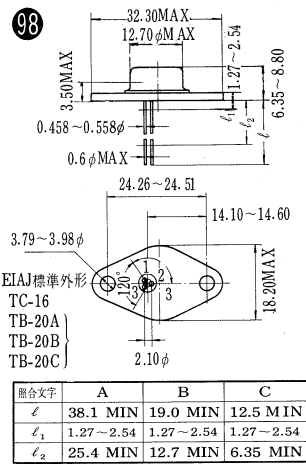
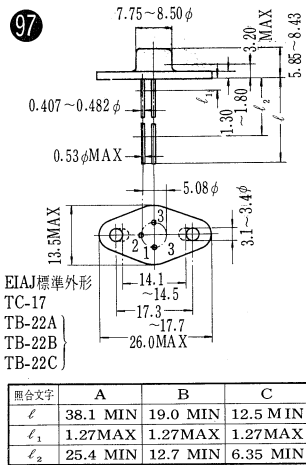
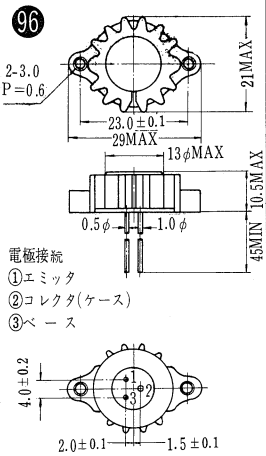
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》

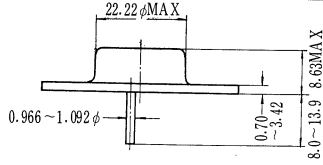




●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

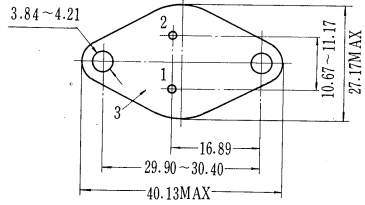
103

EIAJ標準外形
TC-3A, TB-3

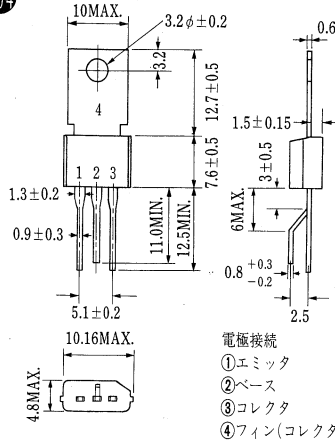


電極接続

- ①ベース
- ②エミッタ
- ③コレクタ



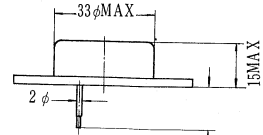
104



電極接続

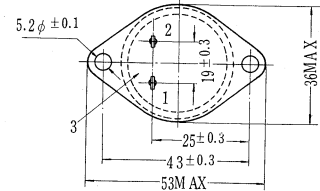
- ①エミッタ
- ②ベース
- ③コレクタ
- ④フィン(コレクタ)

105

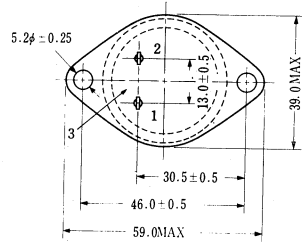


電極接続

- ①ベース
- ②エミッタ
- ③コレクタ(ケース)

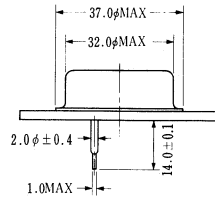
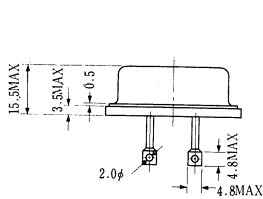


106

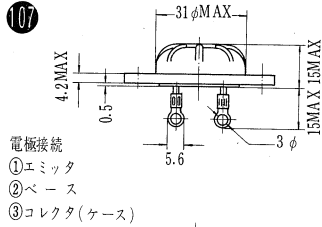


電極接続

- ①ベース
- ②エミッタ
- ③コレクタ(ケース)

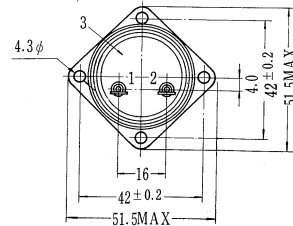


107

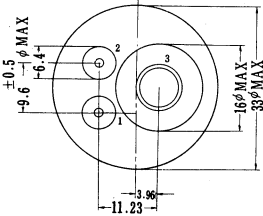
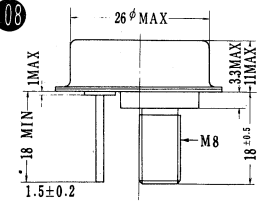


電極接続

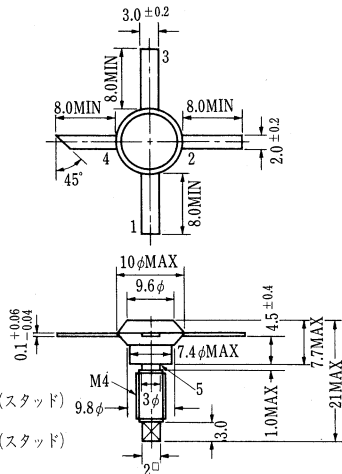
- ①エミッタ
- ②ベース
- ③コレクタ(ケース)



108



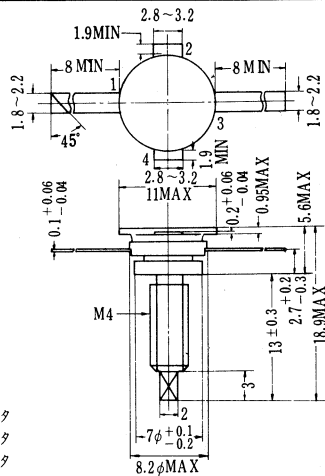
115



電極接続

- ① エミッタ(スタッド)
- ② コレクタ
- ③ エミッタ(スタッド)
- ④ ベース

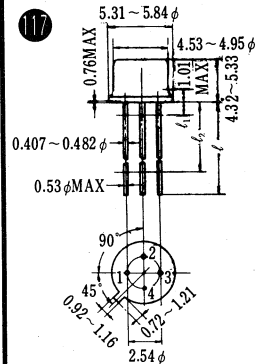
116



電極接続

- ① ベース
- ② エミッタ
- ③ コレクタ
- ④ エミッタ

117

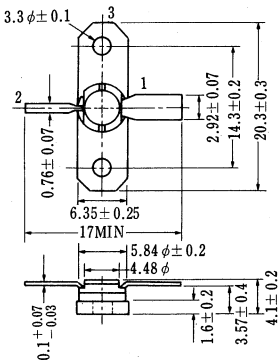


電極接続

- ① ベース
- ② エミッタ
- ③ コレクタ
- ④ シールド

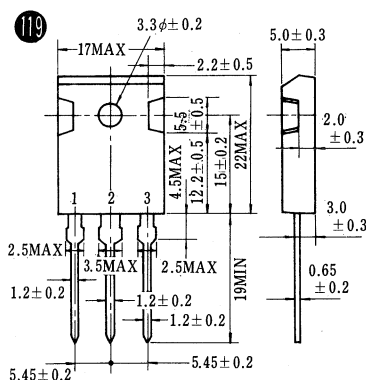
照合文字	A	B	C
l	38.1 MIN	19.0 MIN	12.5 MIN
l_1	1.27 MAX	1.27 MAX	1.27 MAX
l_2	25.4 MIN	12.7 MIN	6.35 MIN

118



外形番号	電極接続		
	1	2	3
118A	ベース	コレクタ	エミッタ
118B	エミッタ	コレクタ	ベース

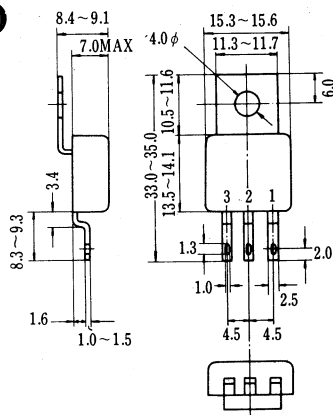
119



電極接続

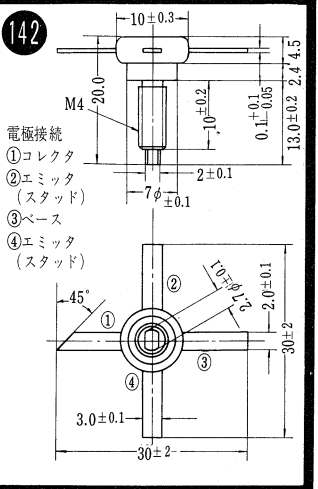
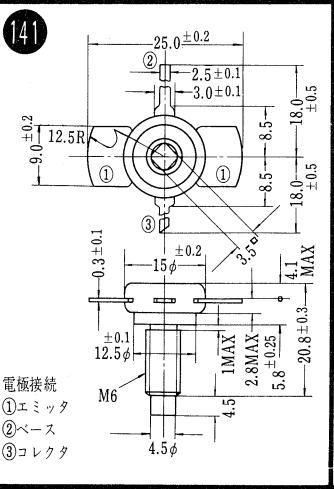
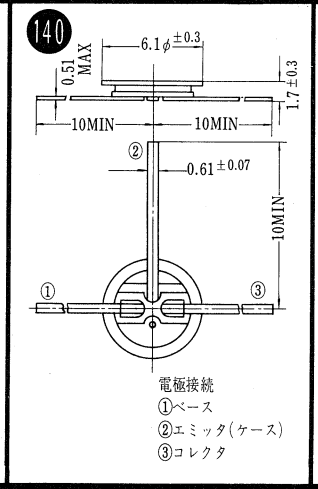
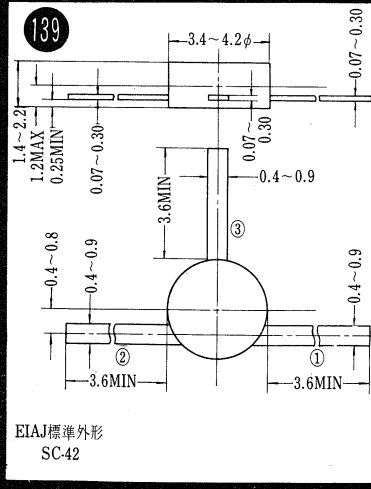
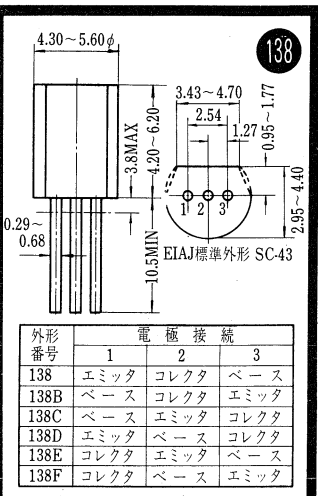
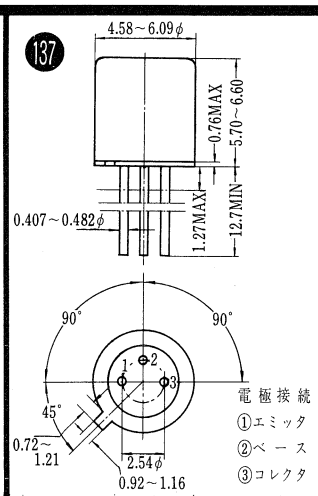
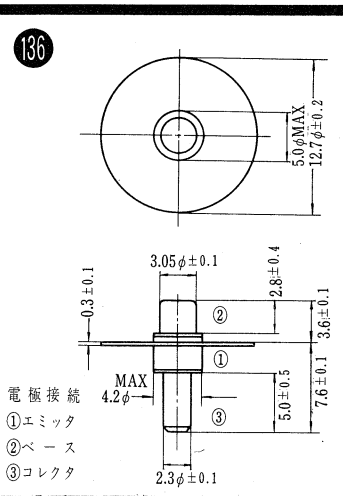
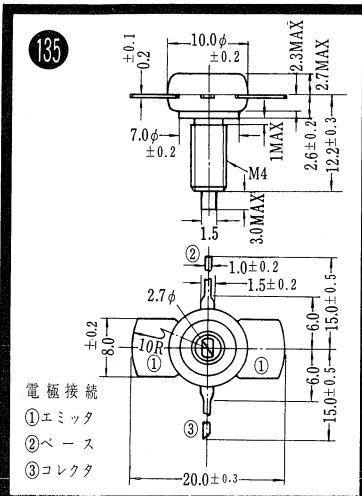
- 1. ベース
- 2. コレクタ
- 3. エミッタ

120

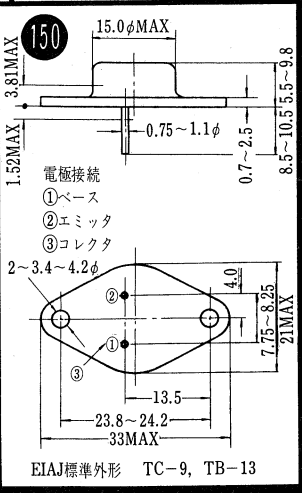
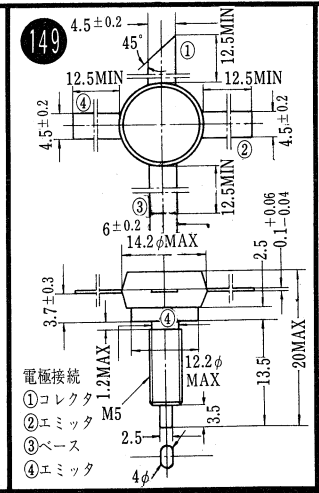
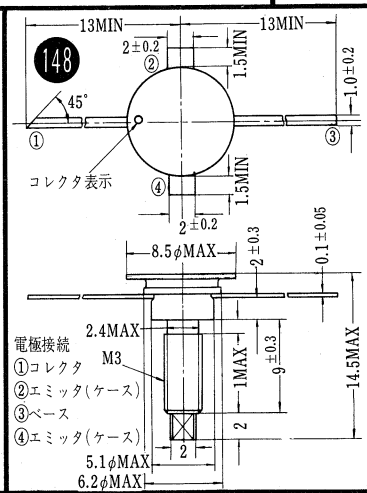
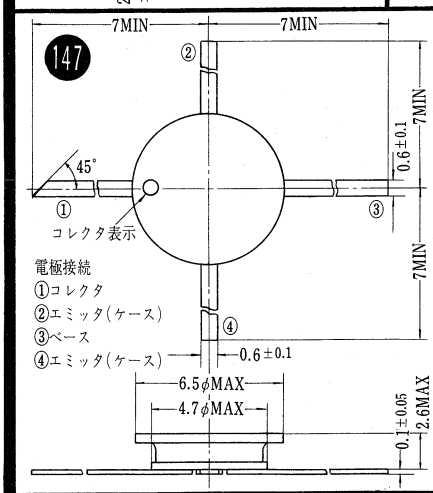
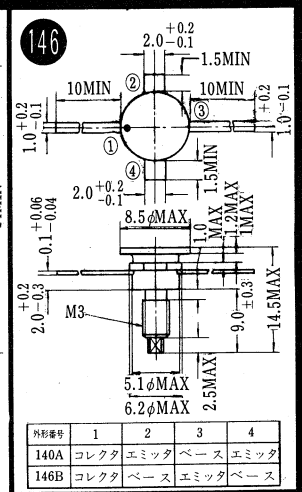
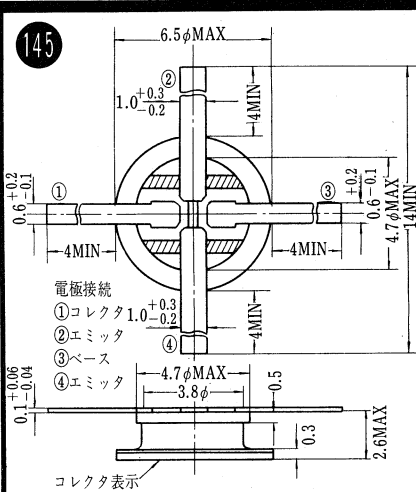
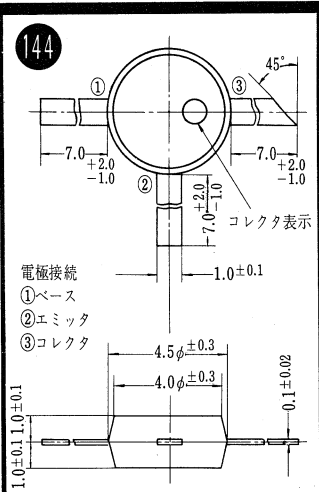
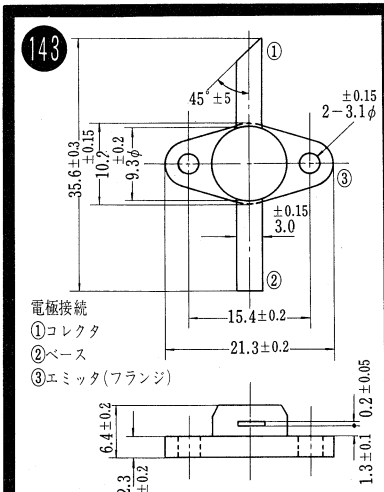


電極接続

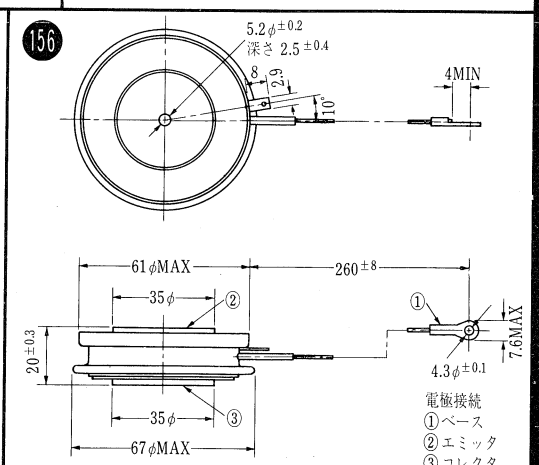
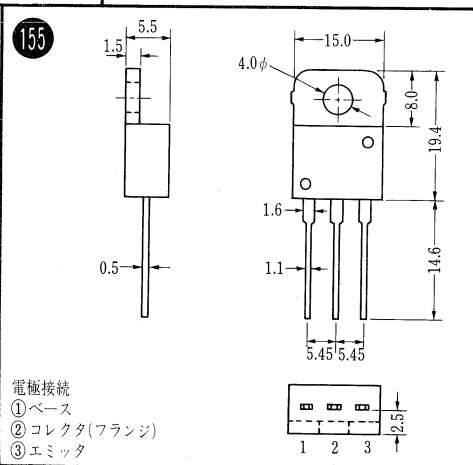
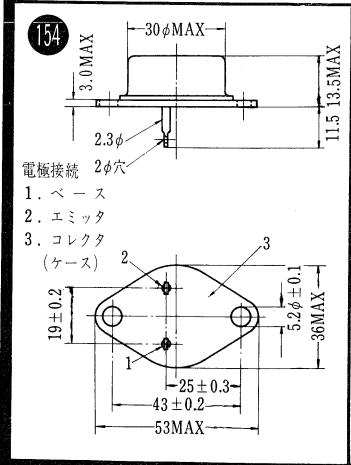
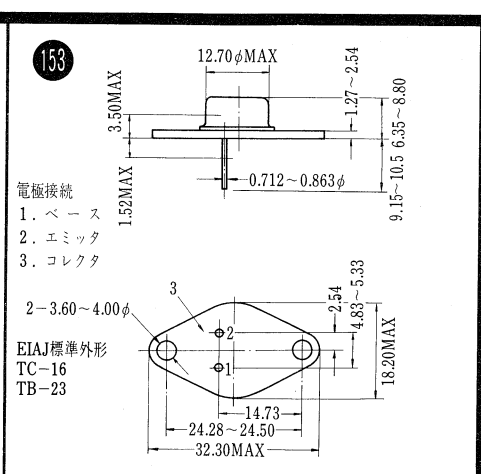
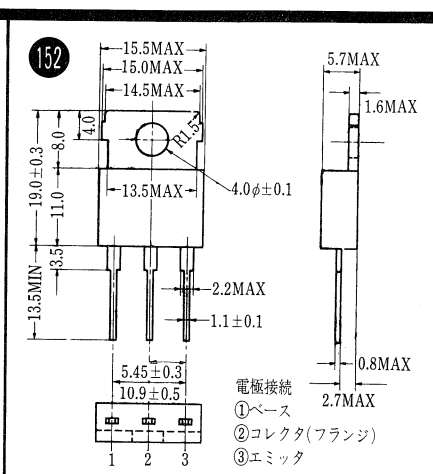
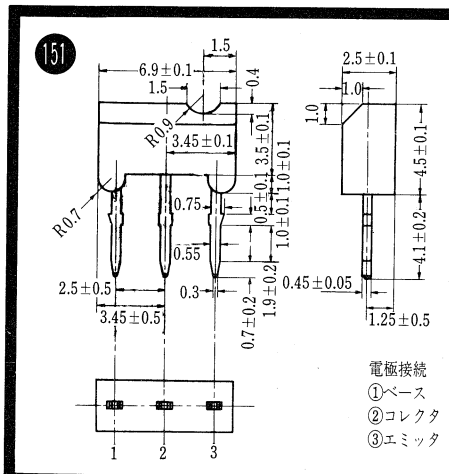
- ① エミッタ
- ② ベース
- ③ コレクタ



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



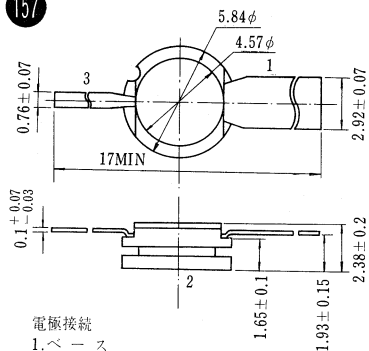
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

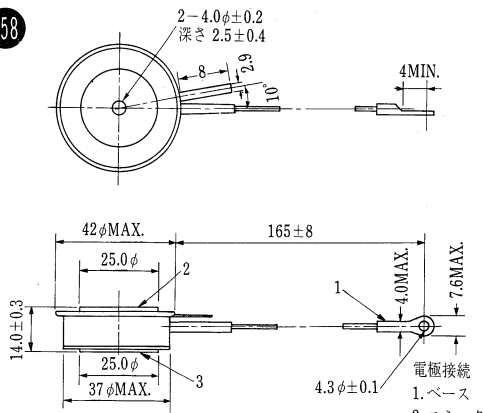
《寸法図単位：mm》

157



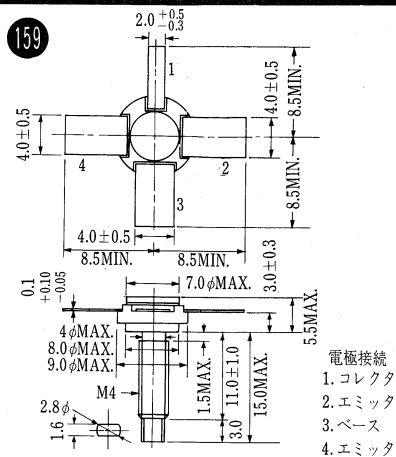
- 電極接続
1. ベース
2. コレクタ
3. エミッタ

158



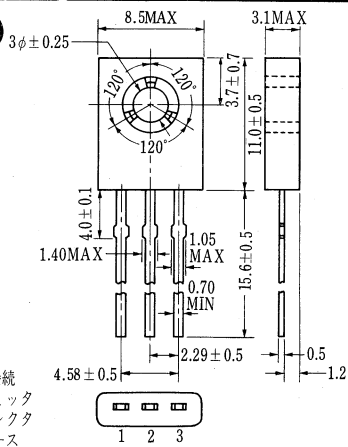
- 電極接続
1. ベース
2. エミッタ
3. コレクタ

159



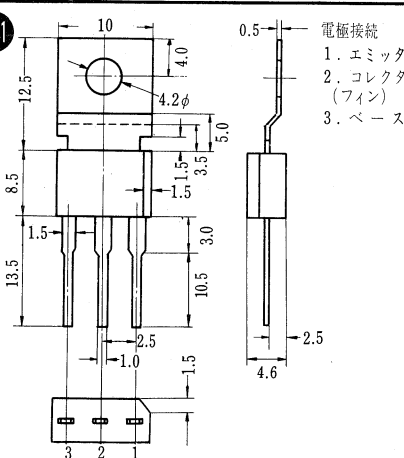
- 電極接続
1. コレクタ
2. エミッタ
3. ベース
4. エミッタ

160



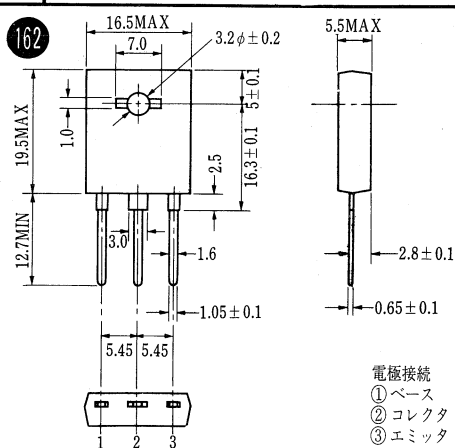
- 電極接続
① エミッタ
② コレクタ
③ ベース

161



- 電極接続
1. エミッタ
2. コレクタ
(フィン)
3. ベース

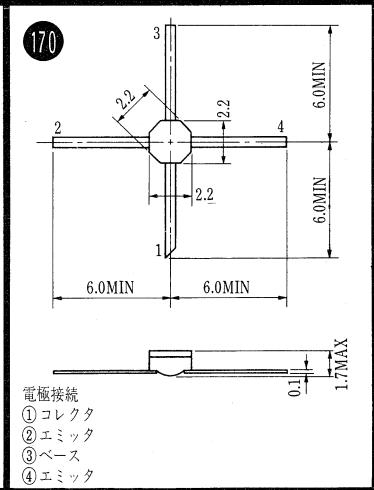
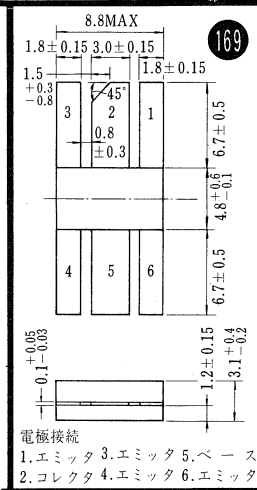
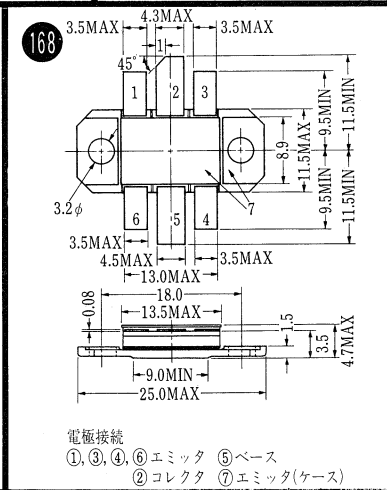
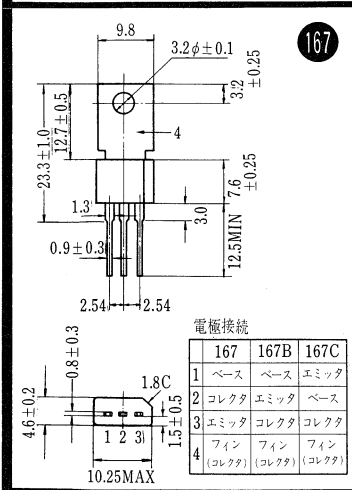
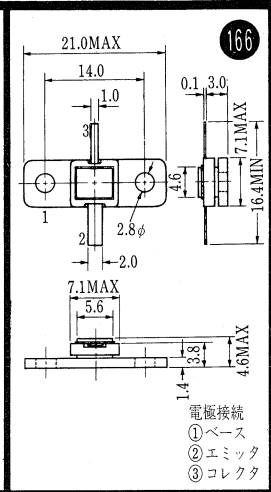
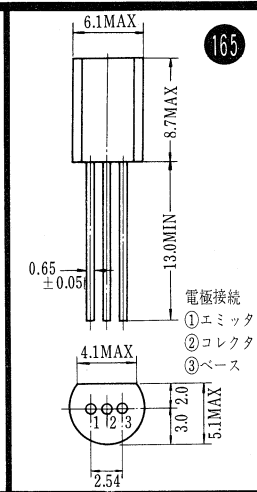
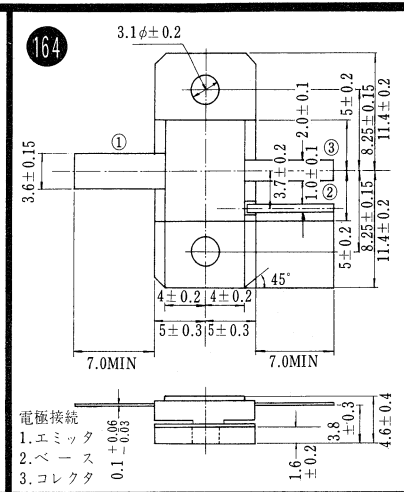
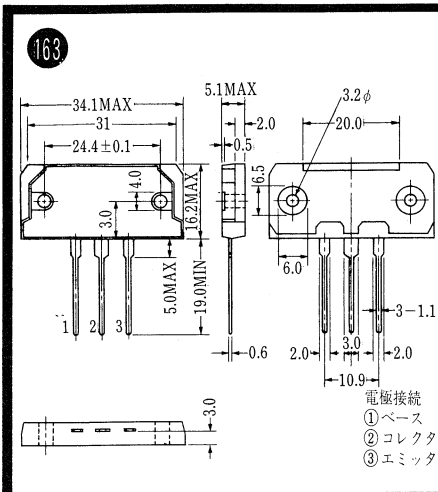
162



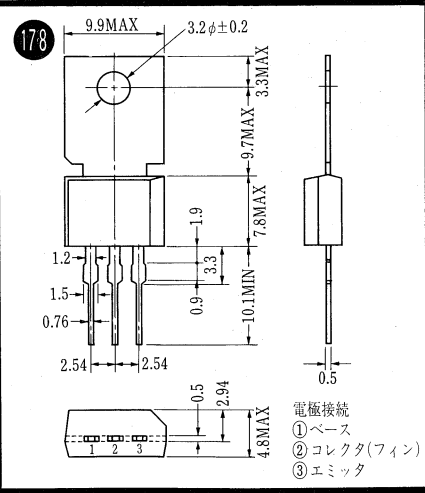
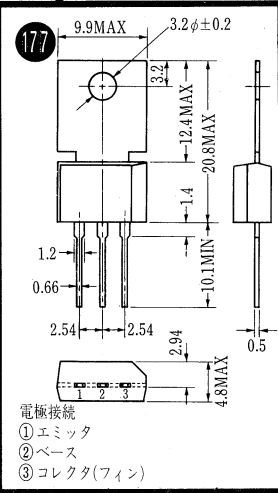
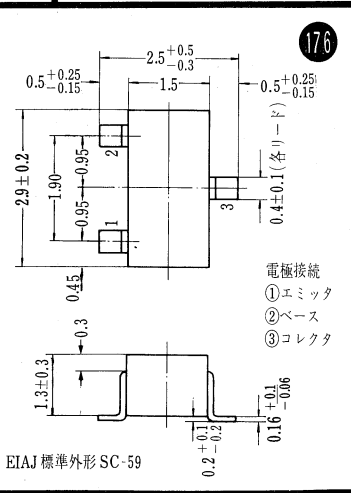
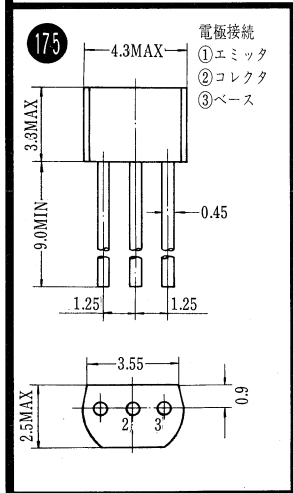
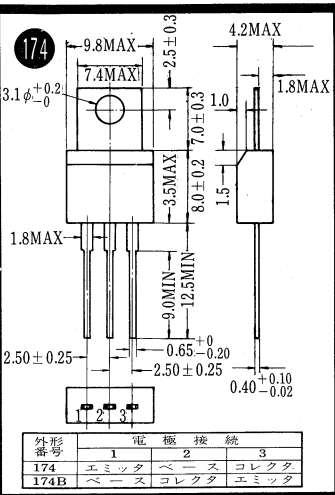
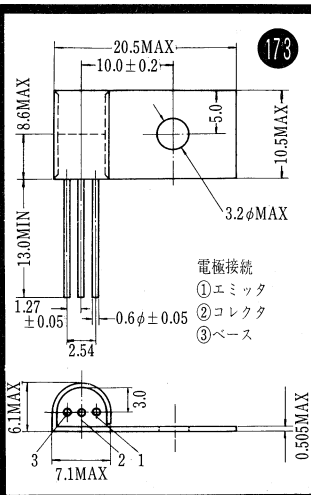
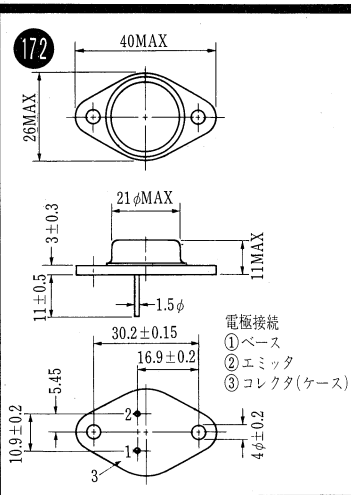
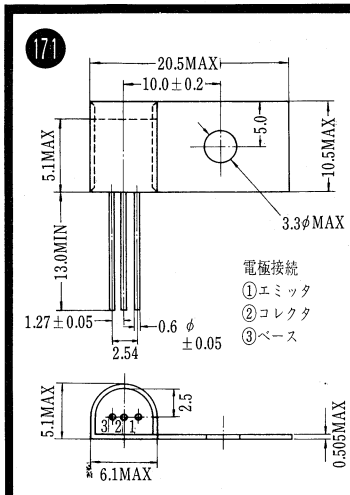
- 電極接続
① ベース
② コレクタ
③ エミッタ

●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位：mm》

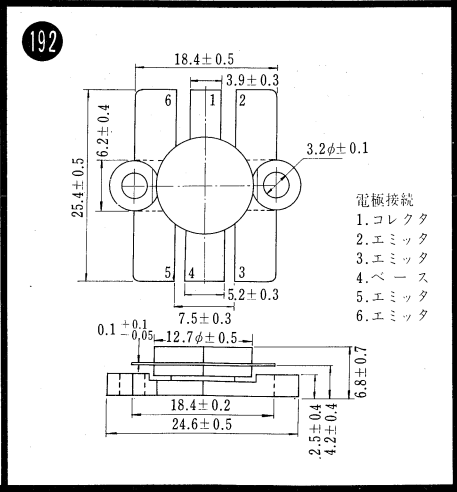
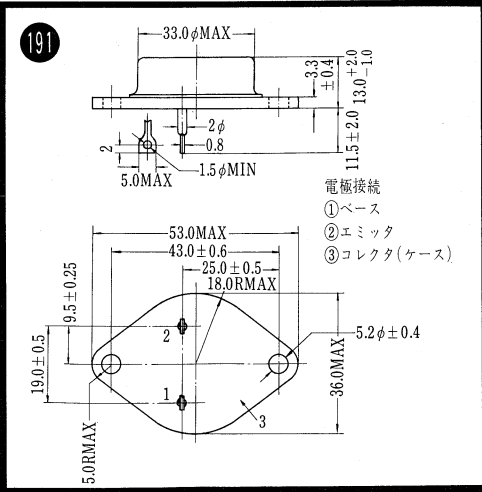
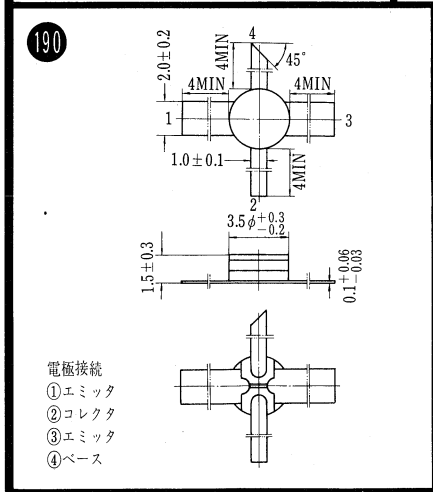
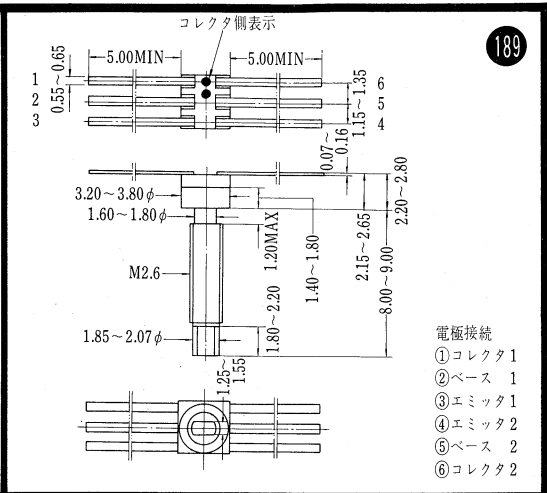
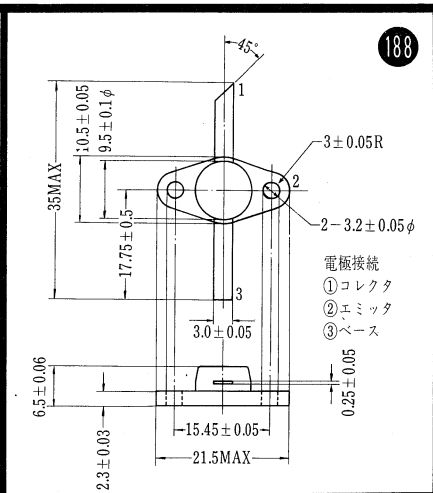
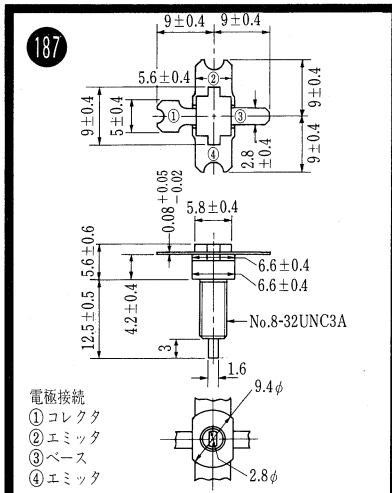


●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

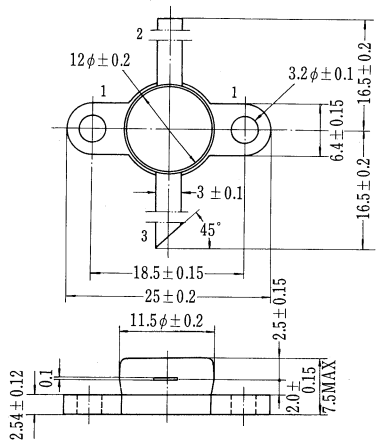
《寸法図単位：mm》



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

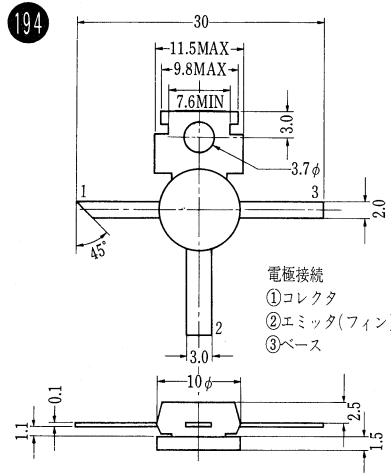
【寸法図単位：mm】

193



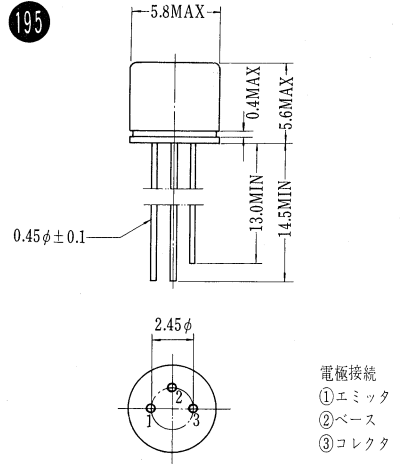
電極接続
①エミッタ
②ベース
③コレクタ

194



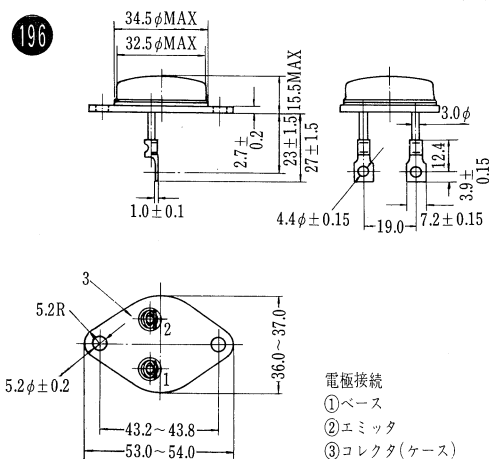
電極接続
①コレクタ
②エミッタ(フィン)
③ベース

195



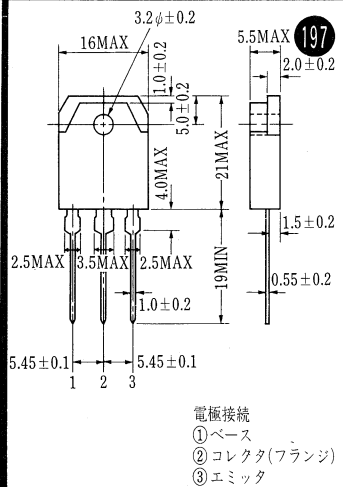
電極接続
①エミッタ
②ベース
③コレクタ

196



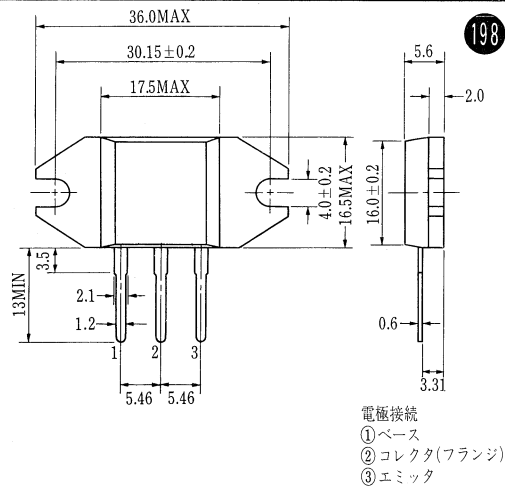
電極接続
①ベース
②エミッタ
③コレクタ(ケース)

197



電極接続
①ベース
②コレクタ(フランジ)
③エミッタ

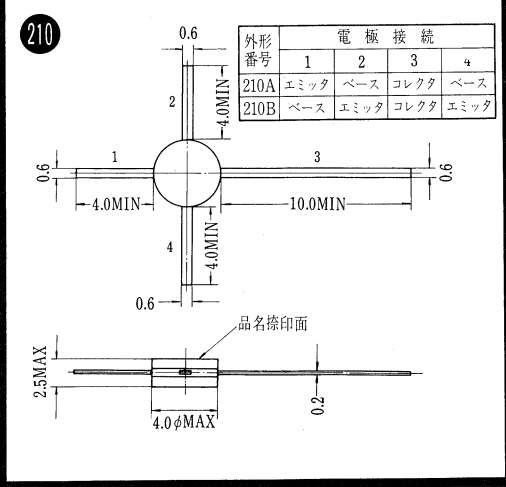
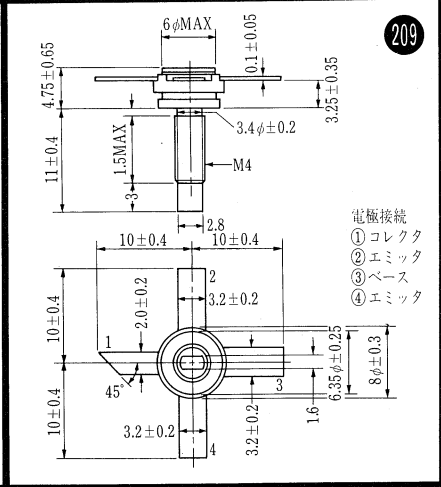
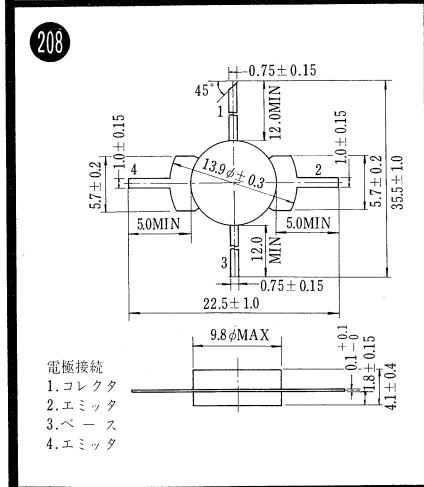
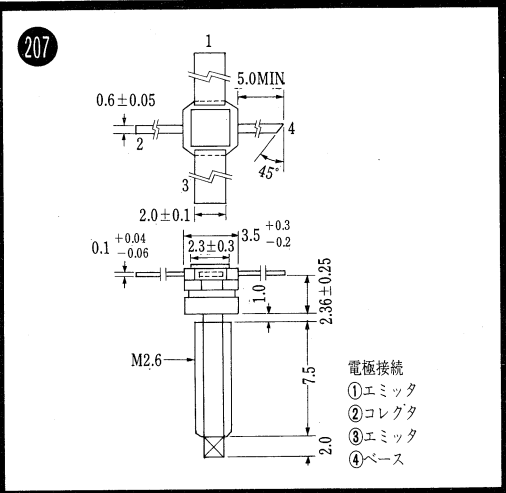
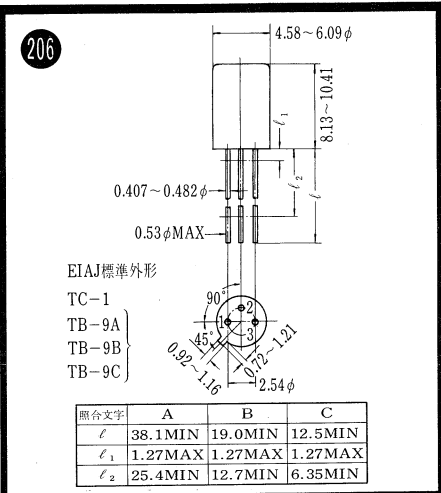
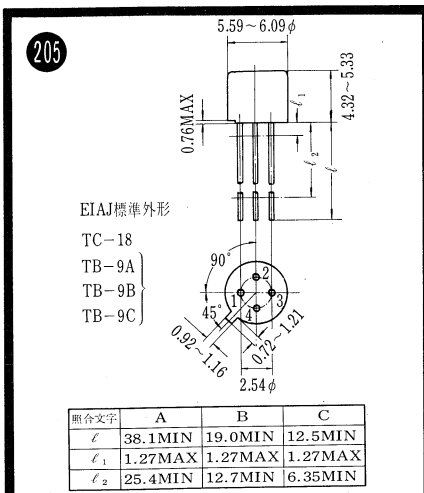
198



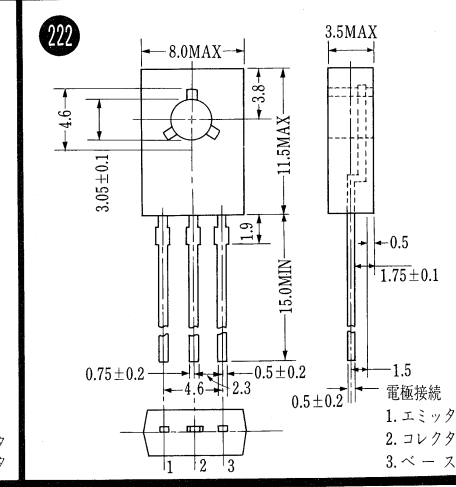
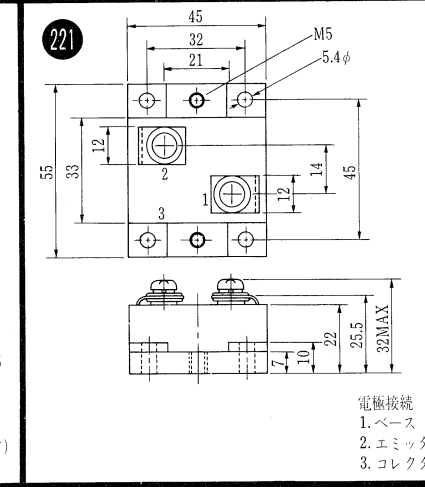
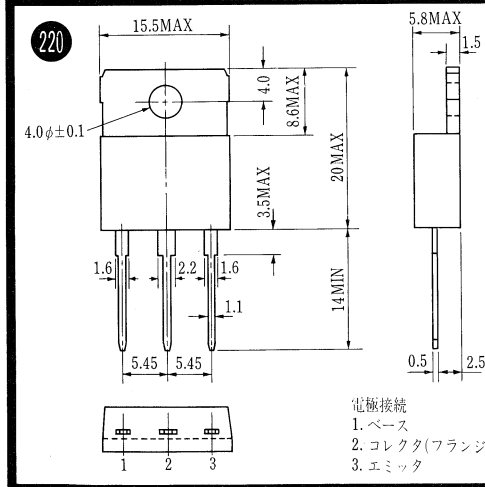
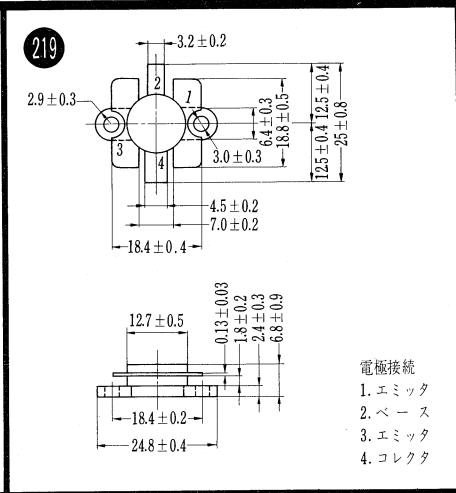
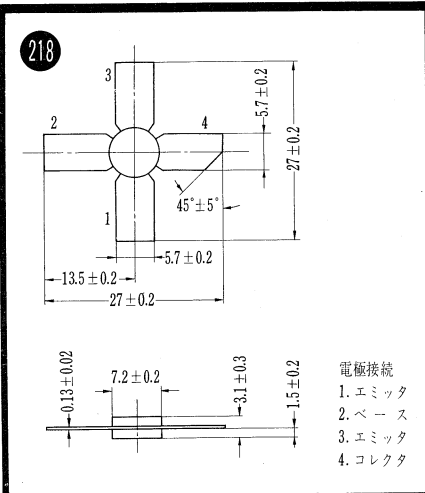
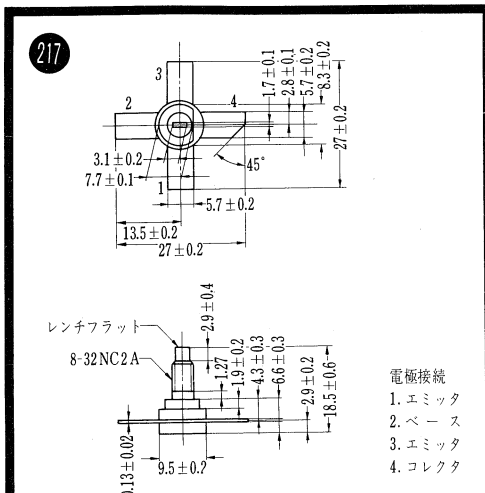
電極接続
①ベース
②コレクタ(フランジ)
③エミッタ

●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

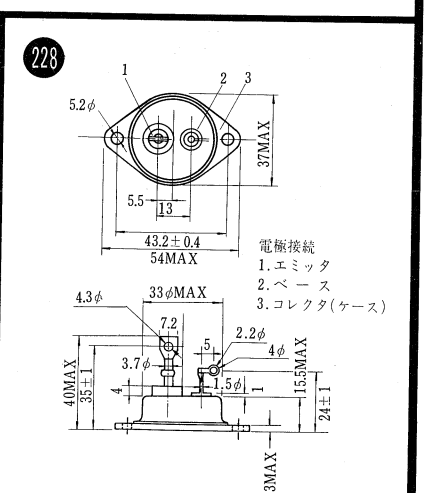
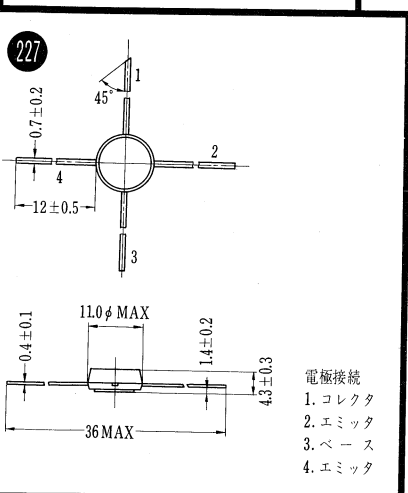
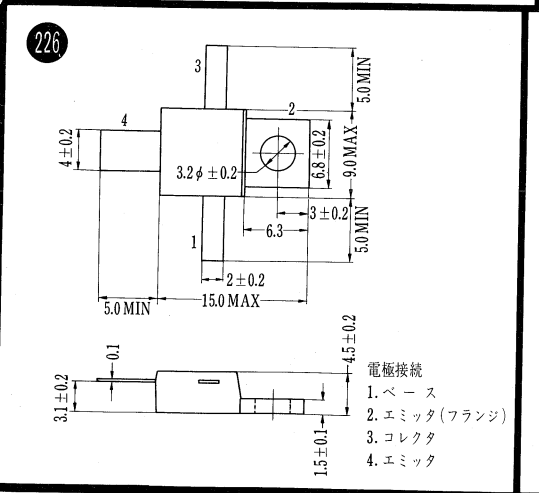
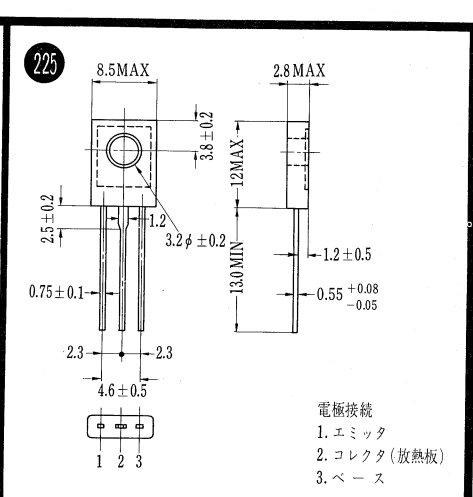
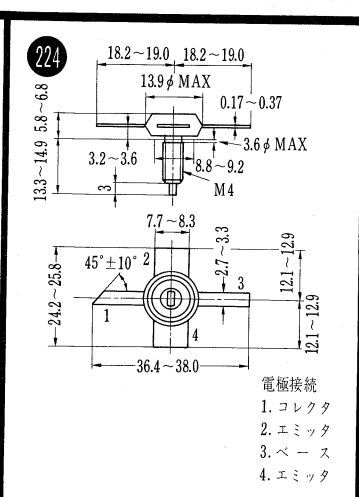
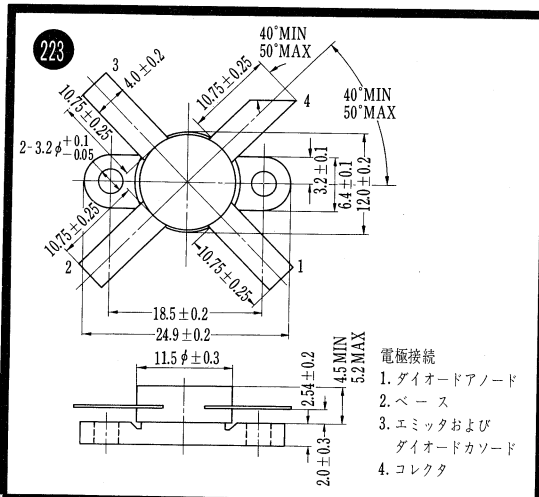
《寸法図単位：mm》



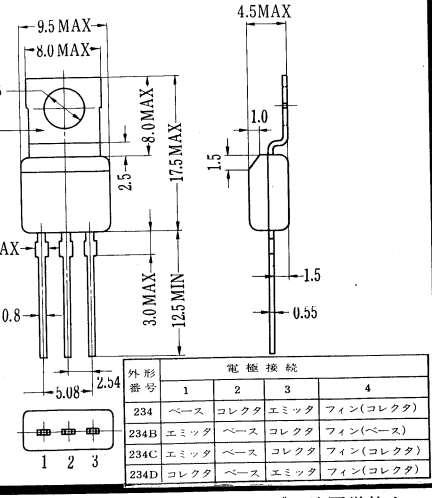
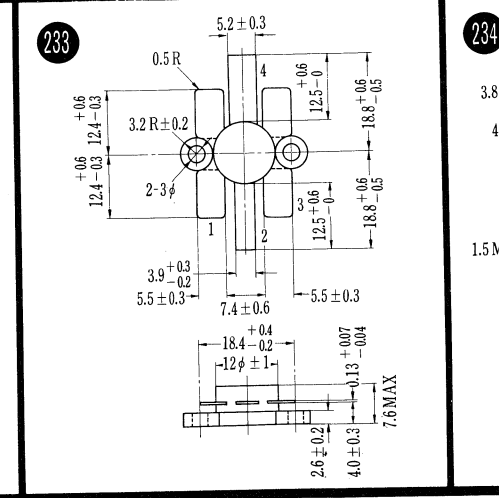
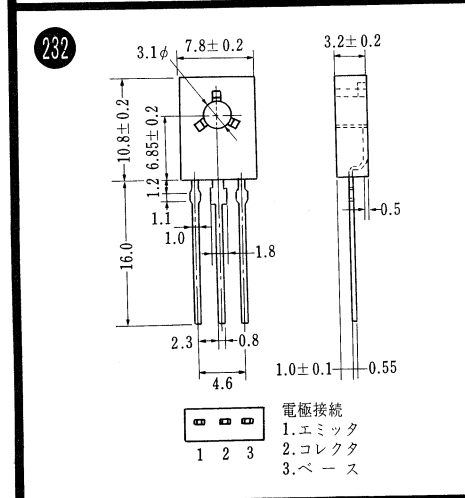
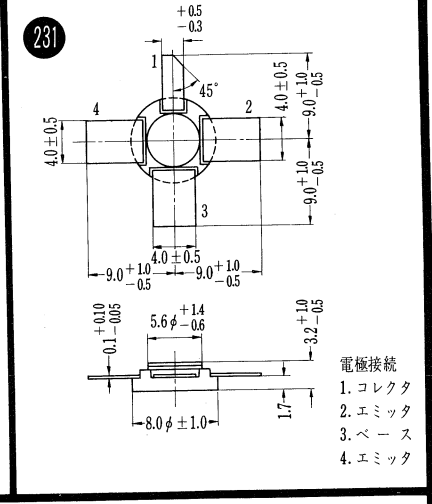
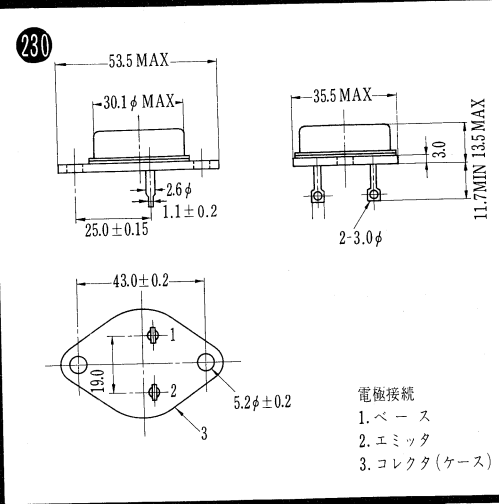
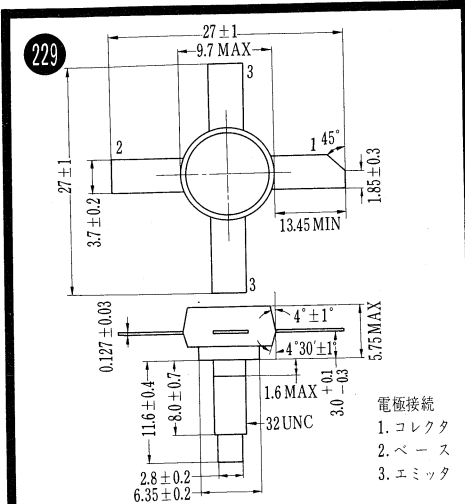
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



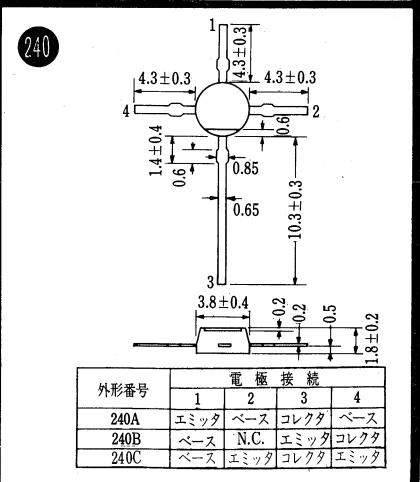
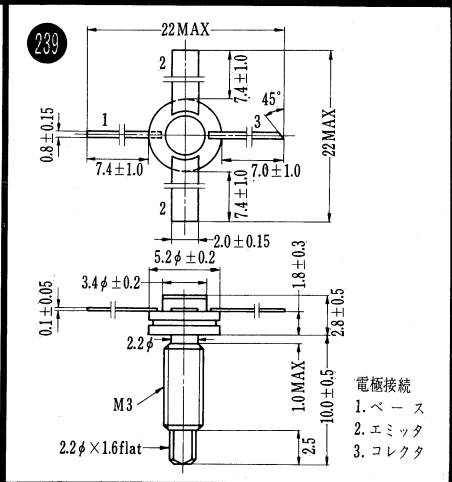
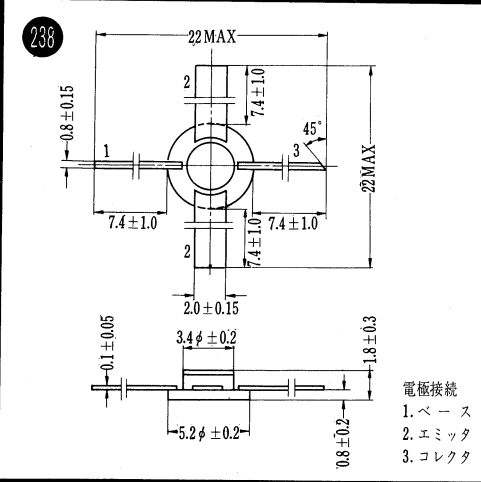
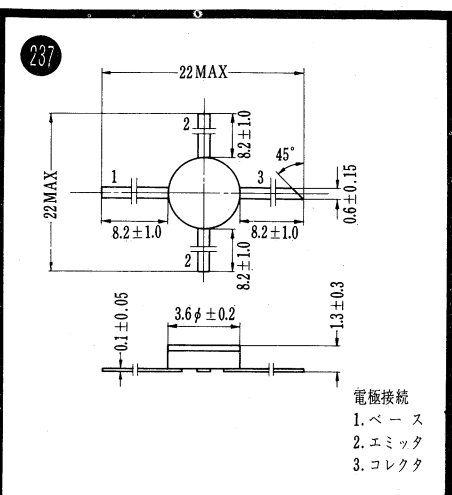
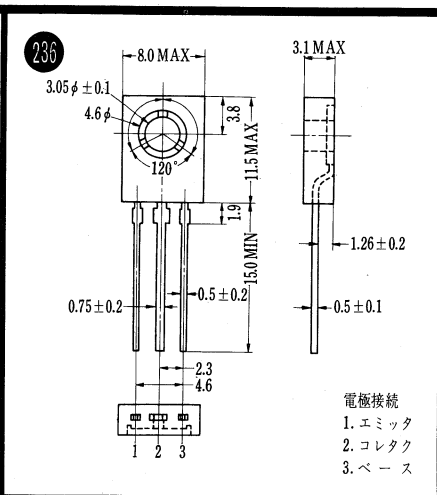
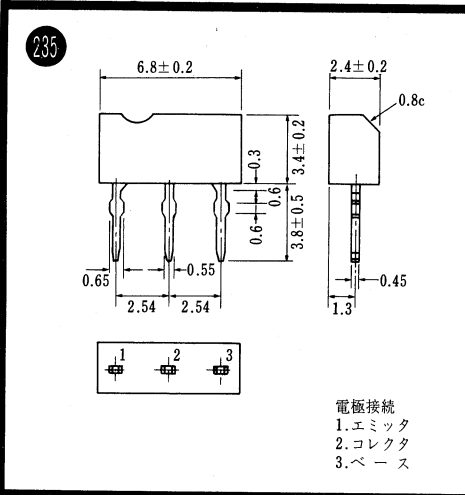
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



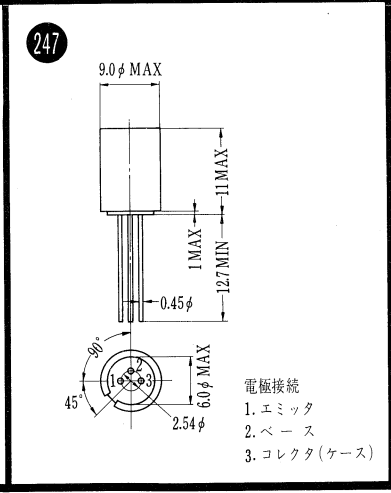
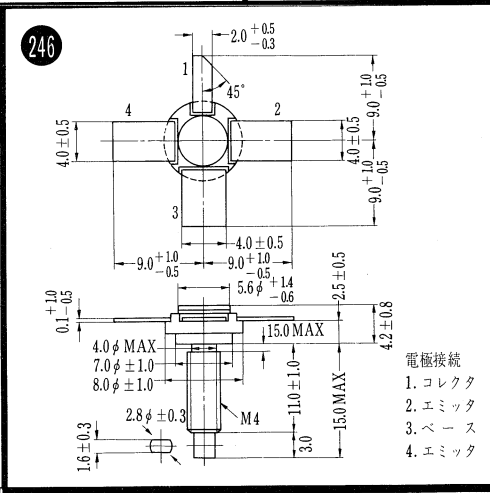
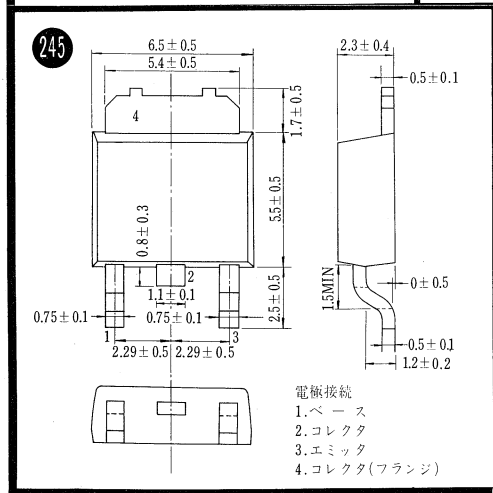
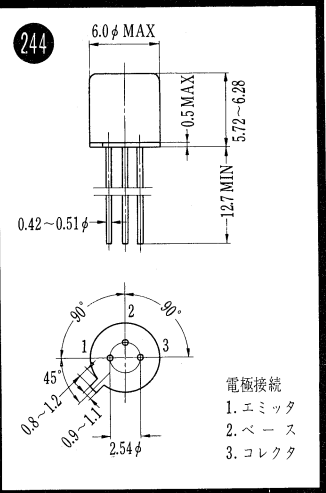
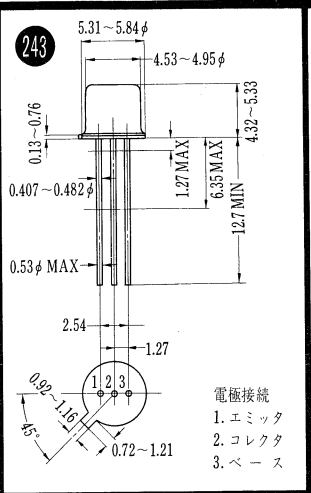
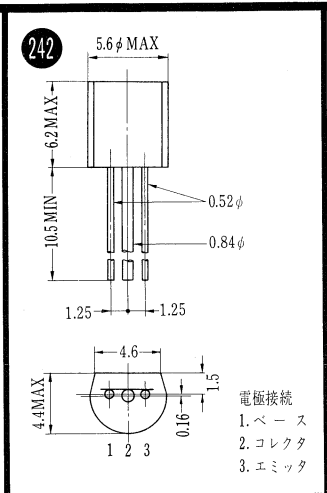
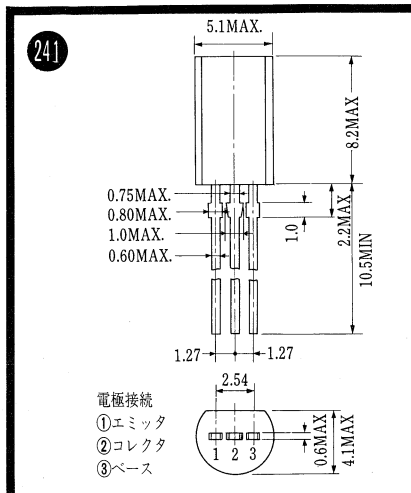
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ, ②ベース, ③コレクタ, ④シールドです

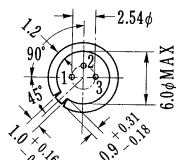
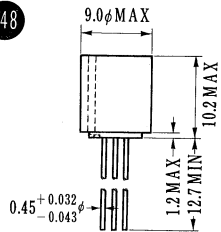


●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ, ②ベース, ③コレクタ, ④シールドです



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

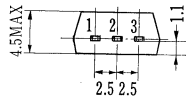
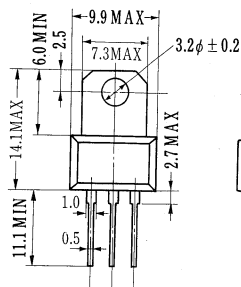
248



電極接続

1. エミッタ
2. ベース
3. コレクタ(ケース)

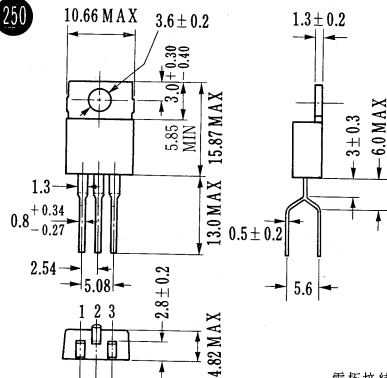
249



電極接続

1. エミッタ
2. ベース
3. コレクタ(フィン)

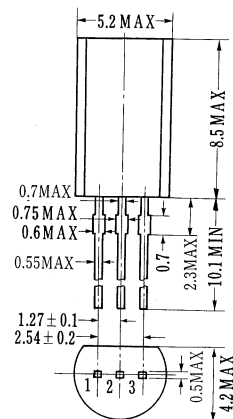
250



電極接続

1. ベース
2. コレクタ(フランジ)
3. エミッタ

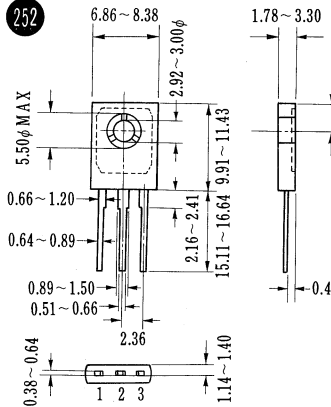
251



電極接続

1. エミッタ
2. コレクタ
3. ベース

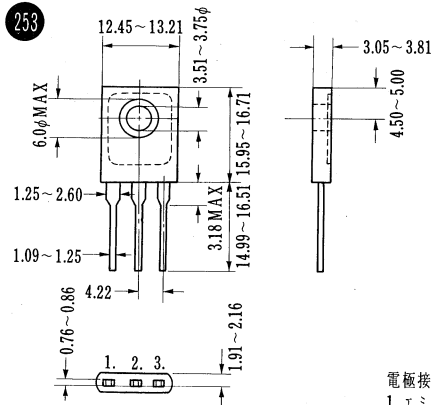
252



電極接続

1. エミッタ
2. コレクタ
3. ベース

253



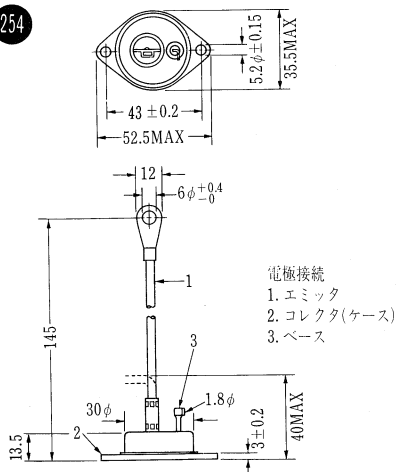
電極接続

1. エミッタ
2. コレクタ
3. ベース

●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

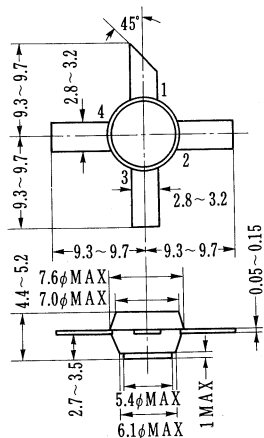
《寸法図単位: mm》

254



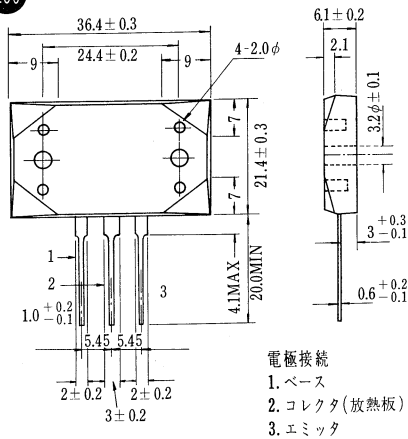
電極接続
1. エミッタ
2. コレクタ(ケース)
3. ベース

255



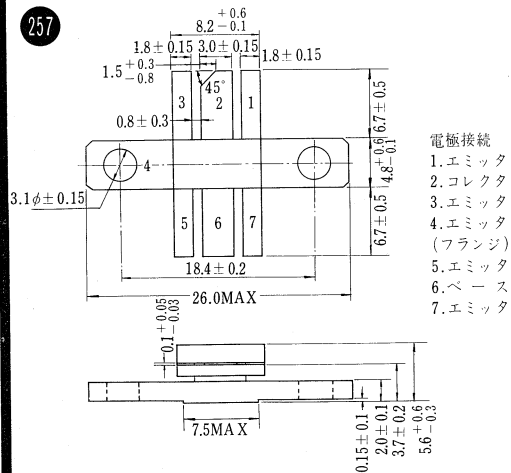
電極接続
1. コレクタ
2. エミッタ
3. ベース
4. エミッタ

256



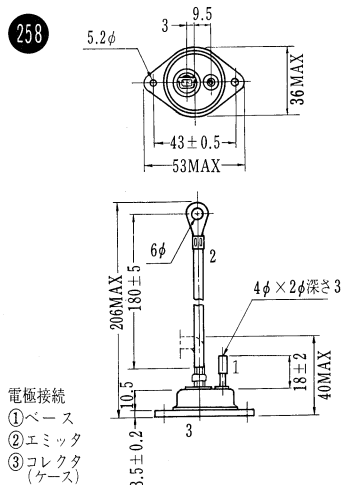
電極接続
1. ベース
2. コレクタ(放熱板)
3. エミッタ

257



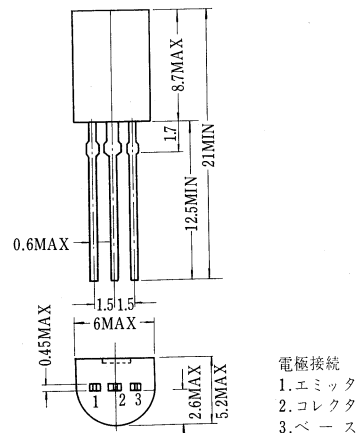
電極接続
1. エミッタ
2. コレクタ
3. エミッタ
4. エミッタ(フランジ)
5. エミッタ
6. ベース
7. エミッタ

258



電極接続
① ベース
② エミッタ
③ コレクタ(ケース)

259

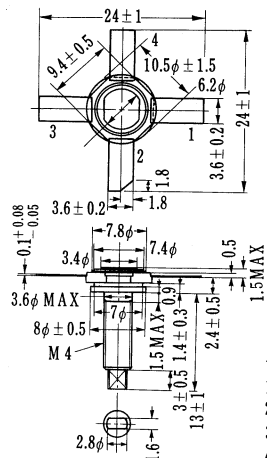


電極接続
1. エミッタ
2. コレクタ
3. ベース

●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位: mm》

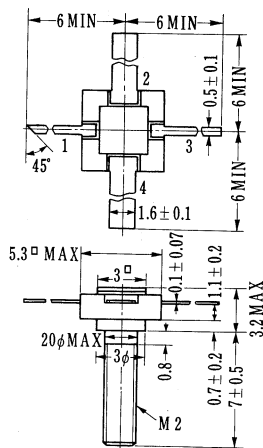
260



電極接続

1. エミッタ
2. コレクタ
3. エミッタ
4. ベース

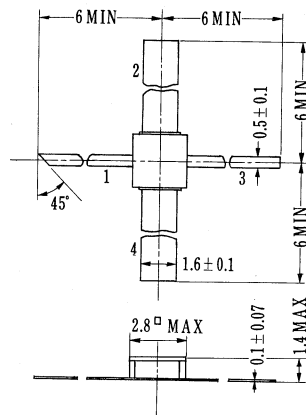
261



電極接続

1. コレクタ
2. エミッタ
3. ベース
4. エミッタ

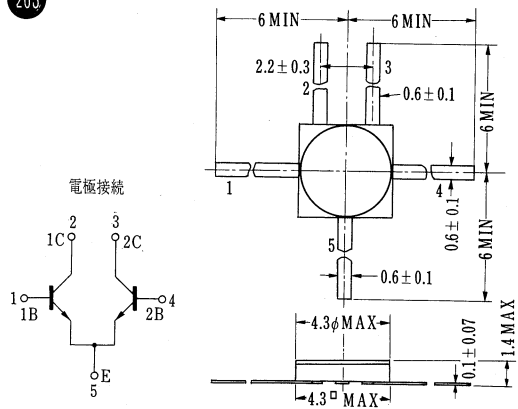
262



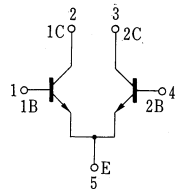
電極接続

1. コレクタ
2. エミッタ
3. ベース
4. エミッタ

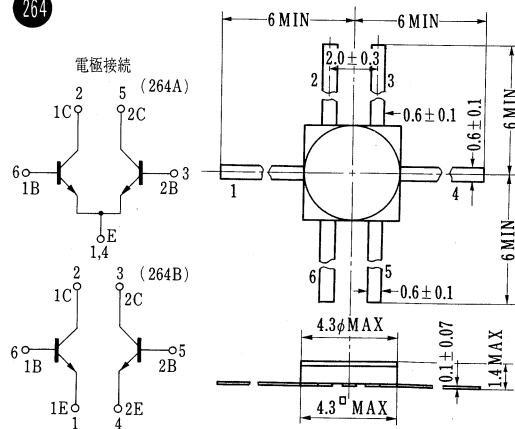
263



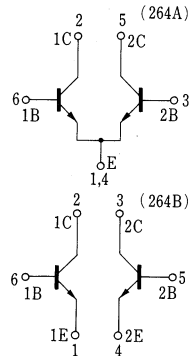
電極接続



264



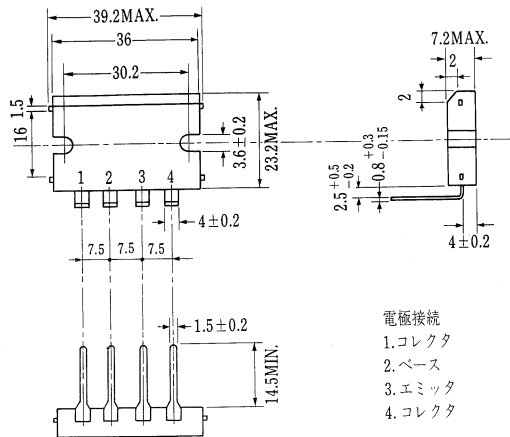
電極接続



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

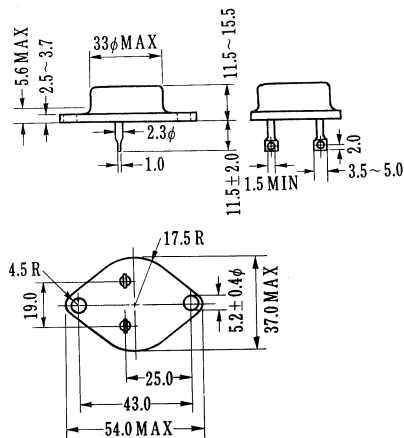
〈寸法図単位: mm〉

265



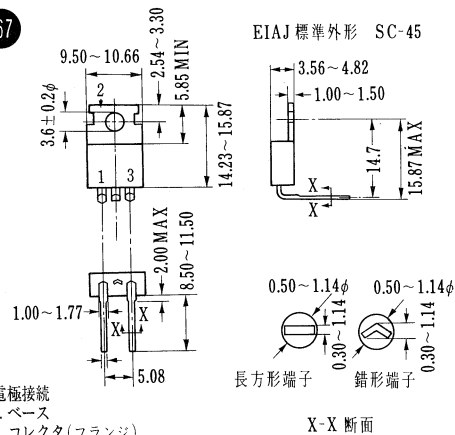
電極接続
1. コレクタ
2. ベース
3. エミッタ
4. コレクタ

266



EIAJ 標準外形
TC-19
TB-30

267

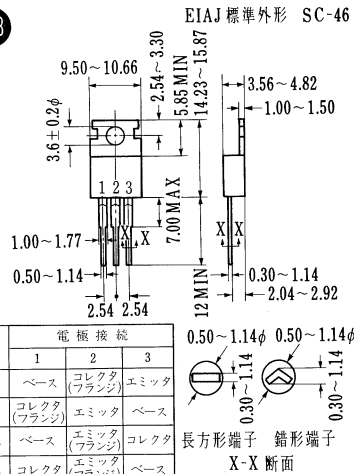


EIAJ 標準外形 SC-45

長方形端子
X-X 断面
錯形端子

電極接続
1. ベース
2. コレクタ(フランジ)
3. エミッタ

268

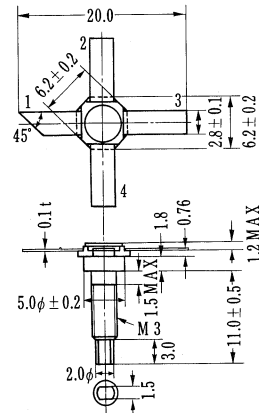


EIAJ 標準外形 SC-46

長方形端子
X-X 断面
錯形端子

外形 番号	電極接続		
	1	2	3
268	ベース	コレクタ (フランジ)	エミッタ
268A	コレクタ (フランジ)	エミッタ	ベース
268B	ベース	エミッタ (フランジ)	コレクタ
268C	コレクタ (フランジ)	エミッタ (フランジ)	ベース

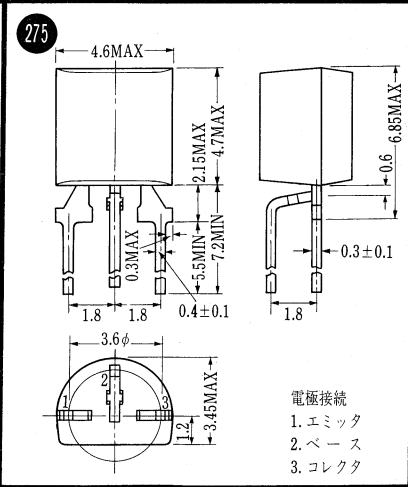
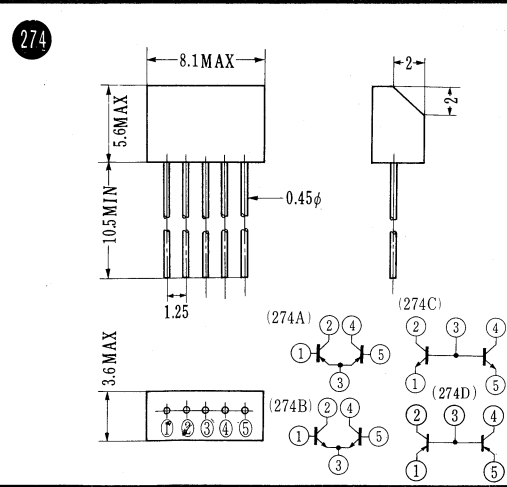
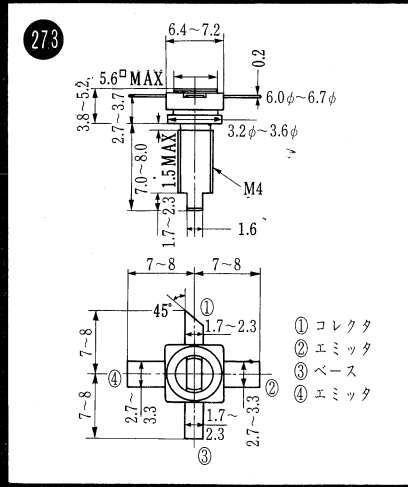
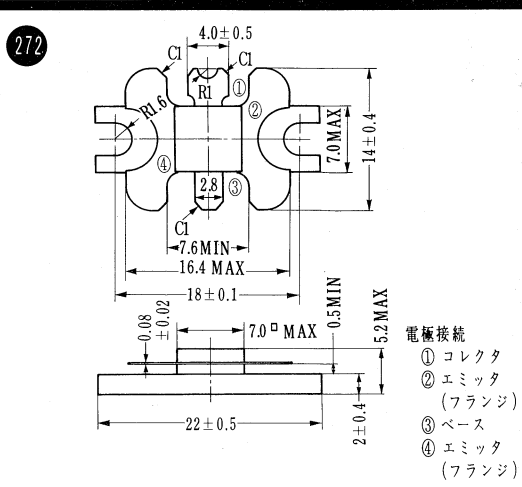
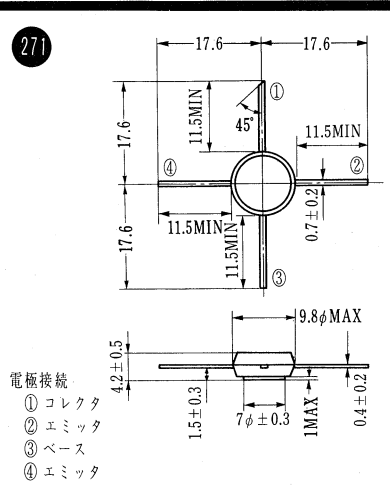
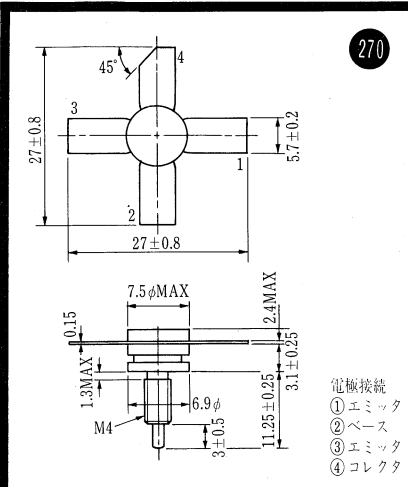
269



電極接続
1. コレクタ
2. エミッタ
3. ベース
4. エミッタ

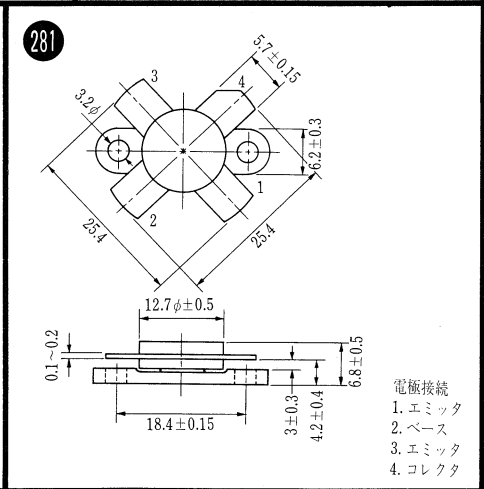
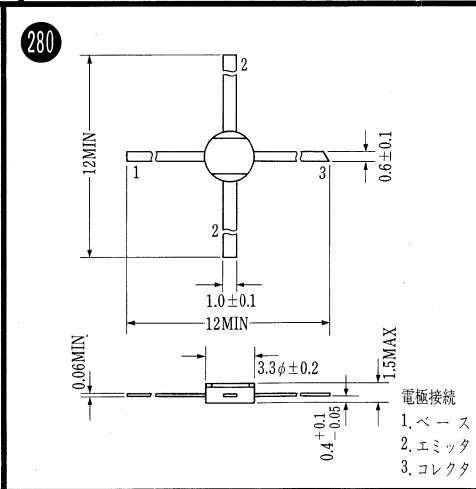
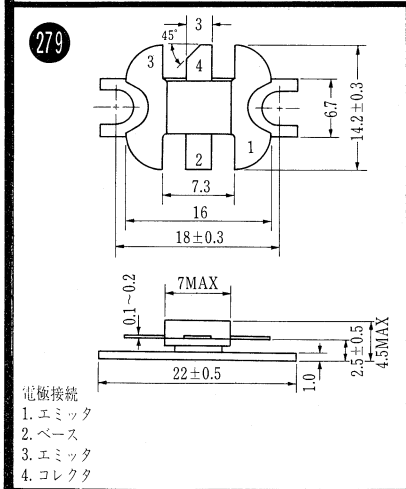
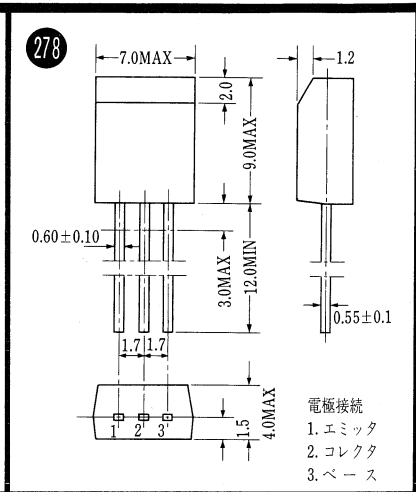
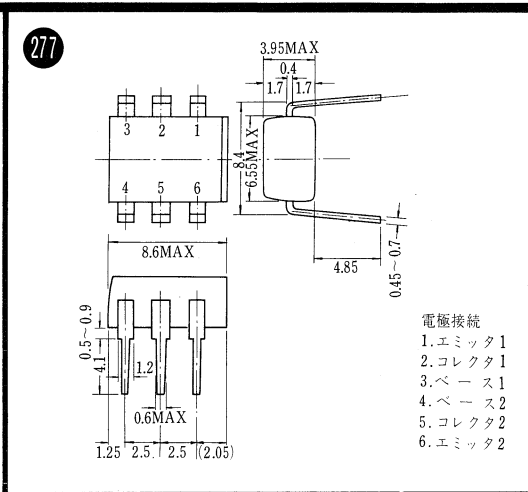
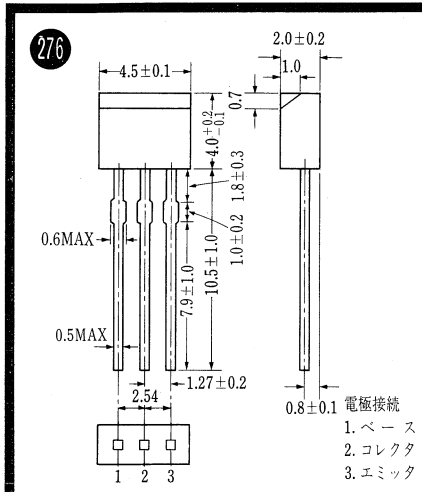
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

《寸法図単位: mm》

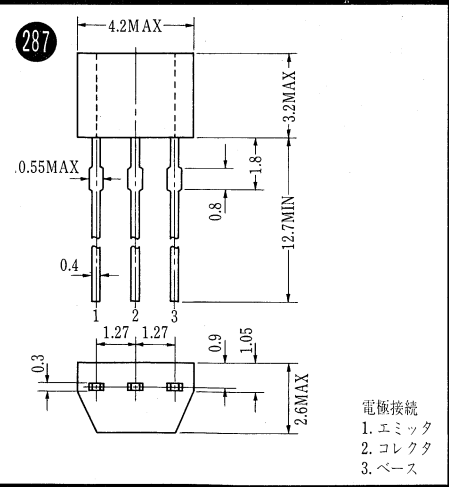
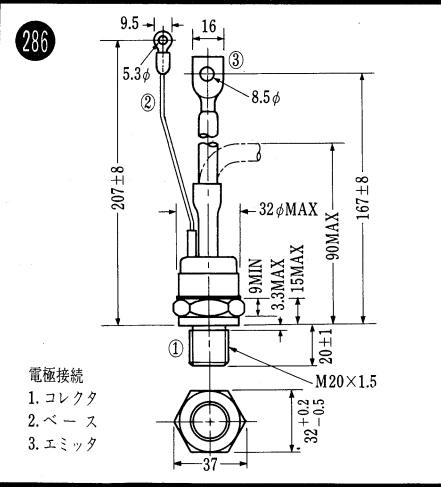
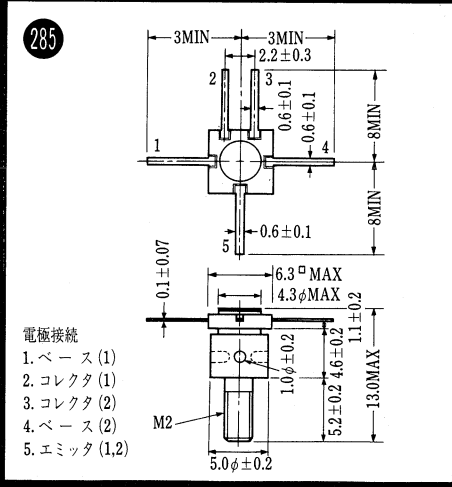
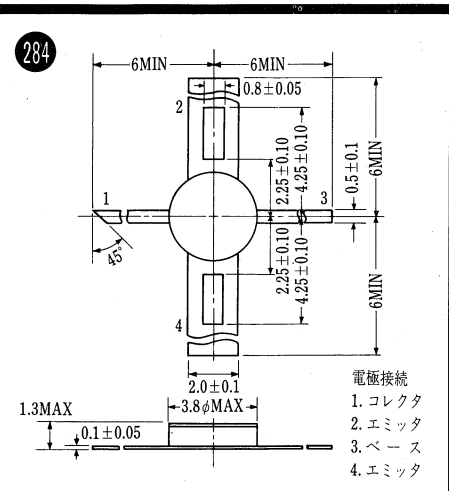
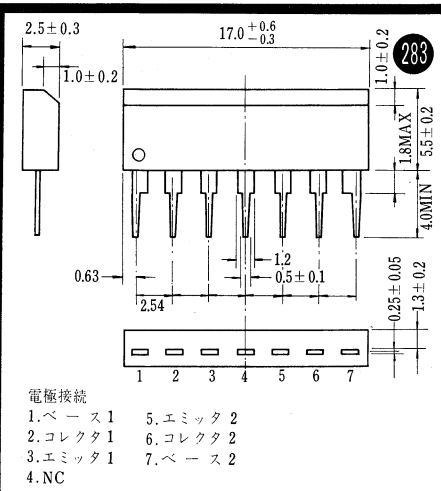
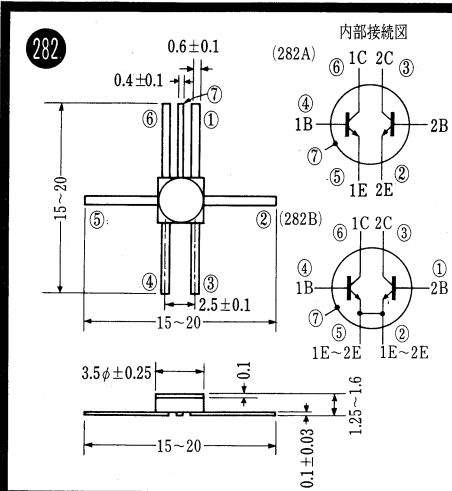


●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

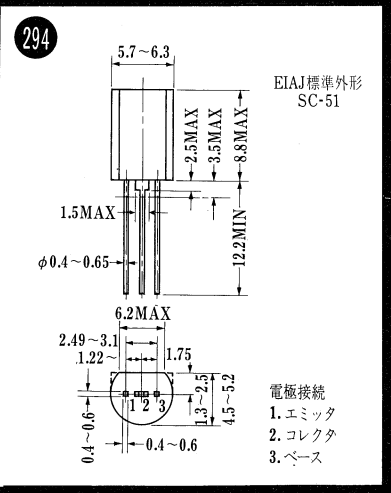
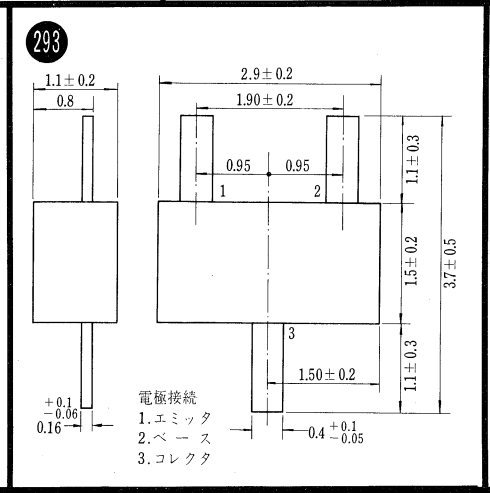
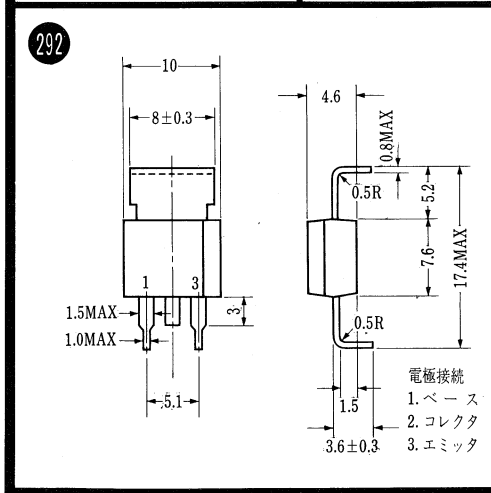
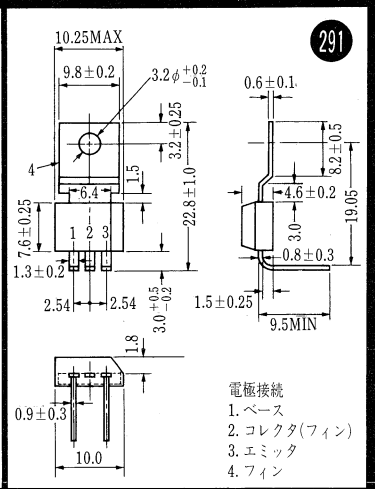
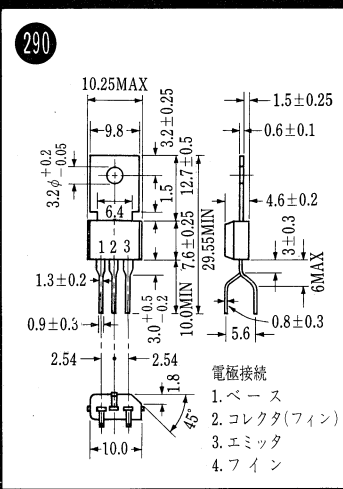
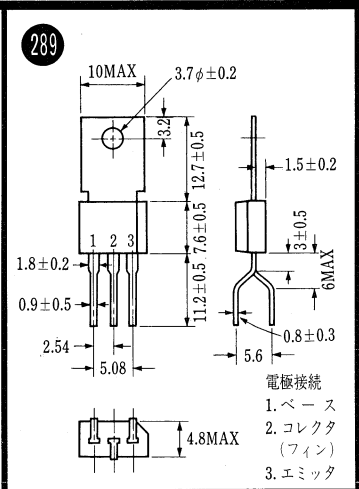
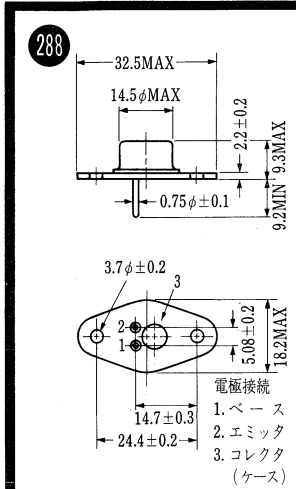
《寸法図単位：mm》



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

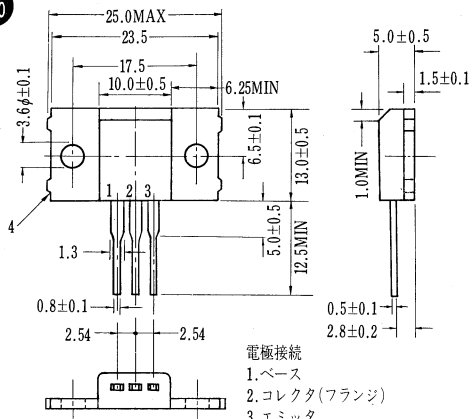


●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです



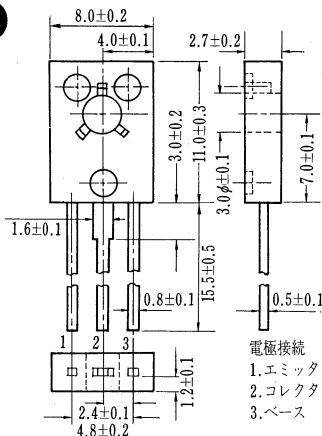
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

295



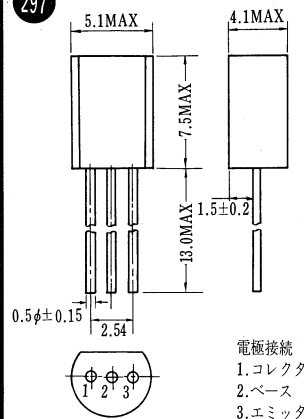
電極接続
 1.ベース
 2.コレクタ(フランジ)
 3.エミッタ
 4.フィン

296



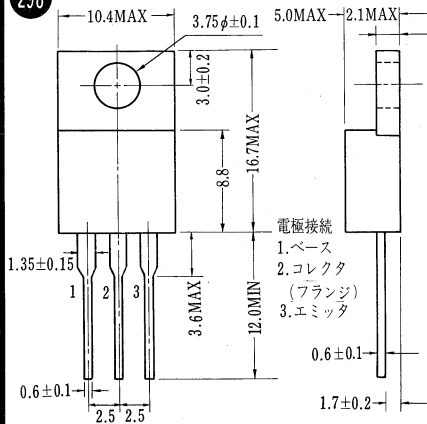
電極接続
 1.エミッタ
 2.コレクタ
 3.ベース

297



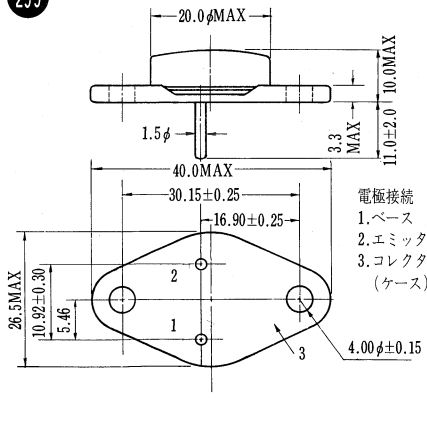
電極接続
 1.コレクタ
 2.ベース
 3.エミッタ

298



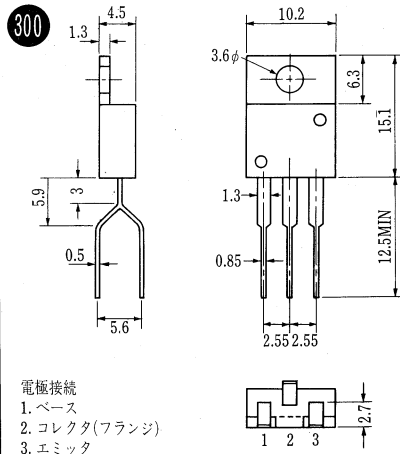
電極接続
 1.ベース
 2.コレクタ
 (フランジ)
 3.エミッタ

299

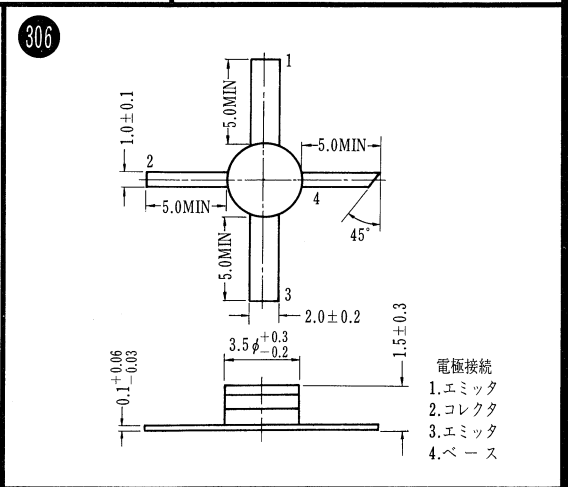
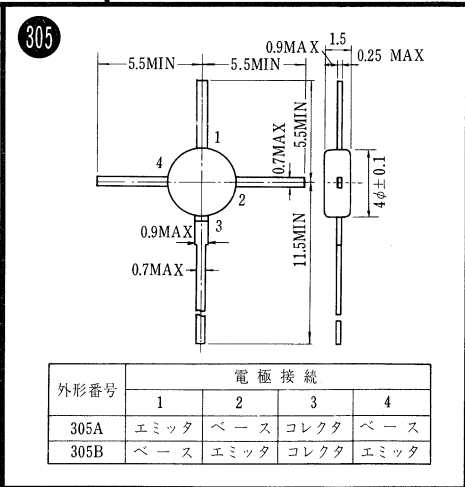
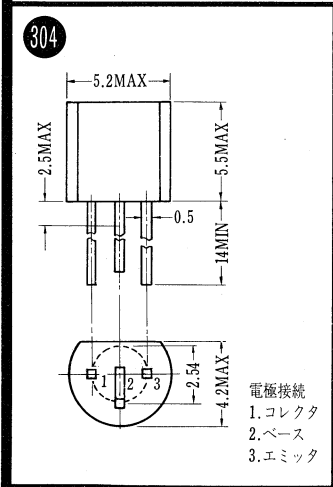
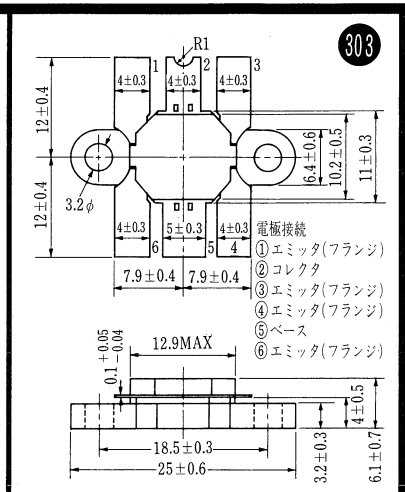
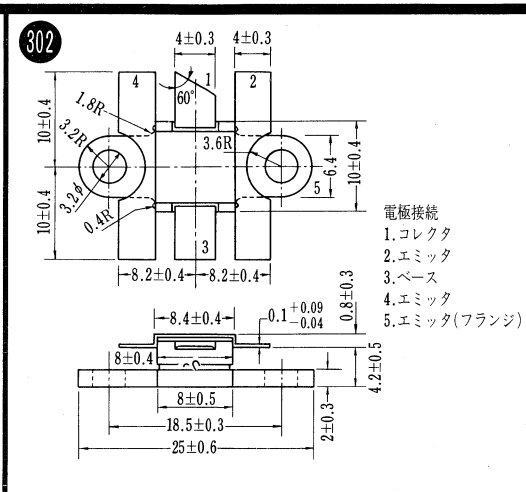
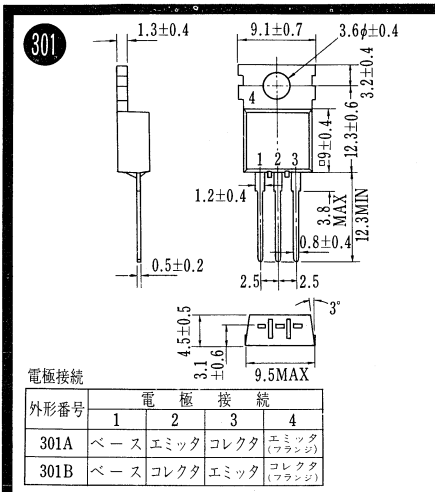


電極接続
 1.ベース
 2.エミッタ
 3.コレクタ
 (ケース)

300

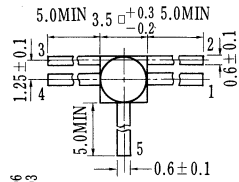


電極接続
 1.ベース
 2.コレクタ(フランジ)
 3.エミッタ

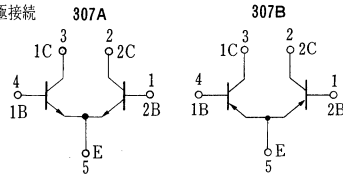


●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

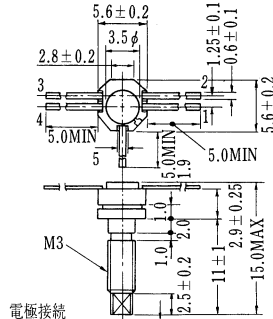
307



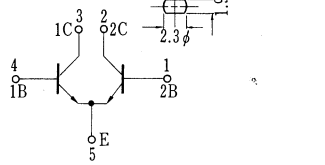
電極接続



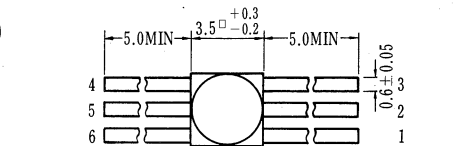
308



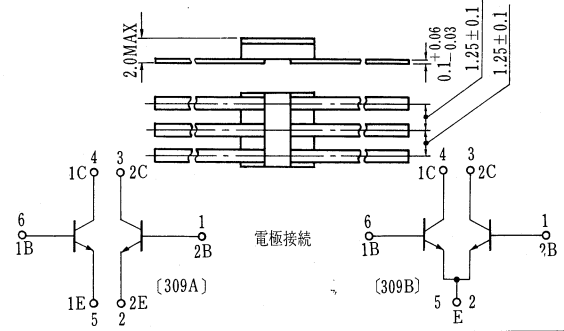
電極接続



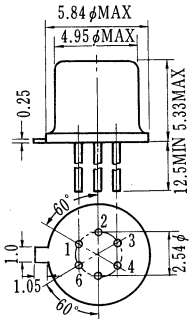
309



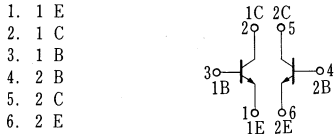
電極接続



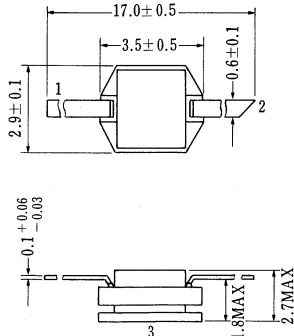
310



電極接続



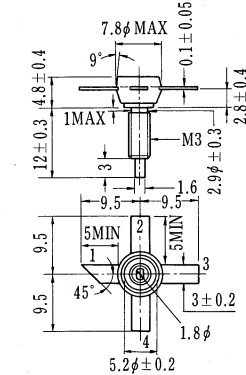
311



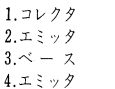
電極接続



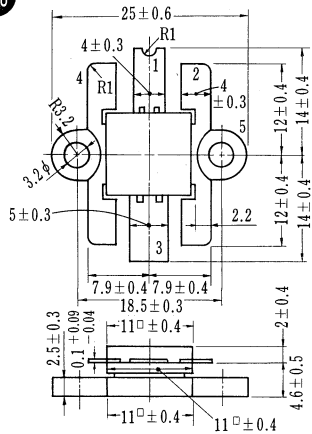
312



電極接続



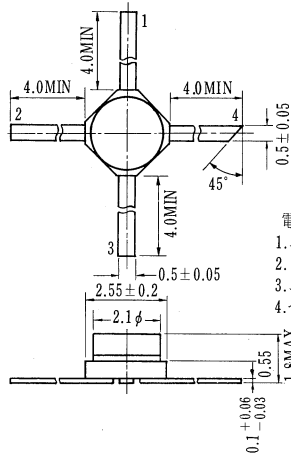
313



電極接続

1. コレクタ
2. エミッタ(フランジ)
3. ベース
4. エミッタ(フランジ)
5. フランジ

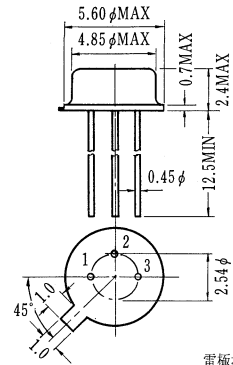
314



電極接続

1. エミッタ
2. コレクタ
3. エミッタ
4. ベース

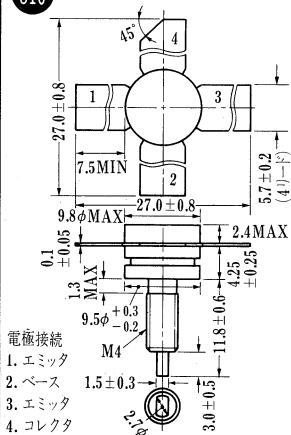
315



電極接続

1. エミッタ
2. ベース
3. コレクタ(ケース)

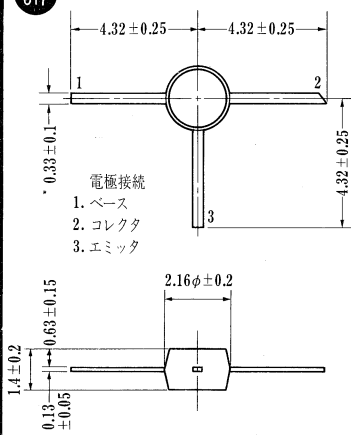
316



電極接続

1. エミッタ
2. ベース
3. エミッタ
4. コレクタ

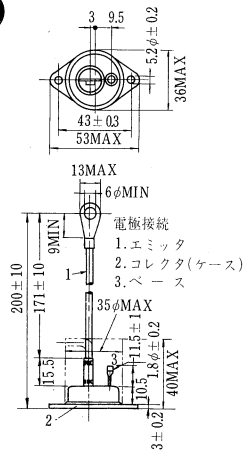
317



電極接続

1. ベース
2. コレクタ
3. エミッタ

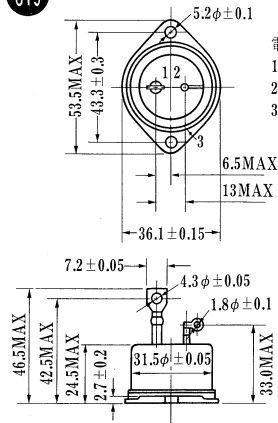
318



電極接続

1. エミッタ
2. コレクタ(ケース)
3. ベース

319

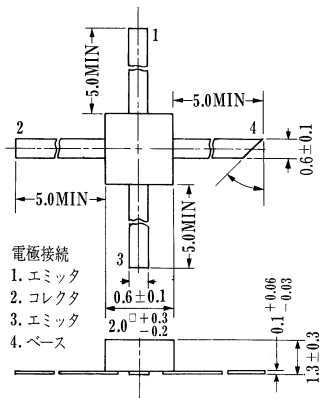


電極接続

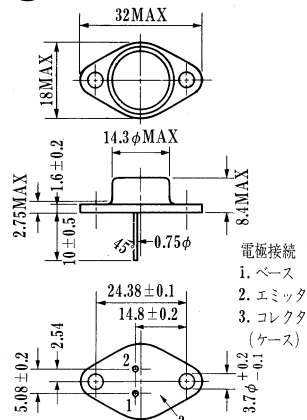
1. エミッタ
2. ベース
3. コレクタ(ケース)

●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです。

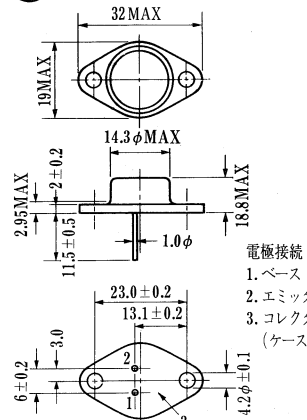
320



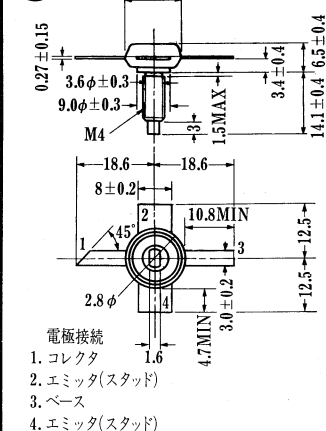
321



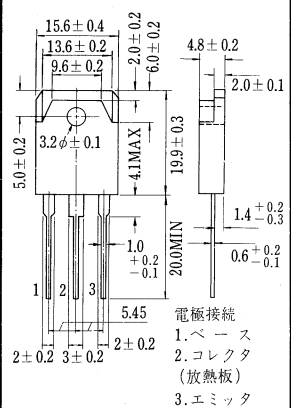
322



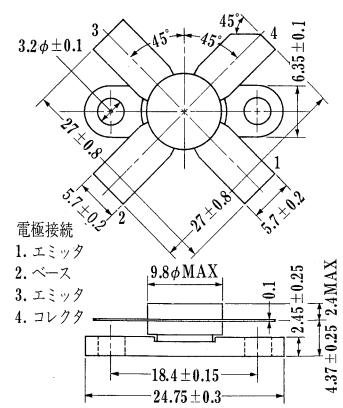
323



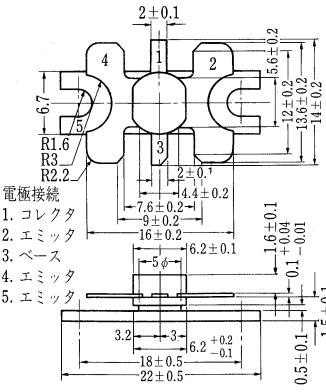
324



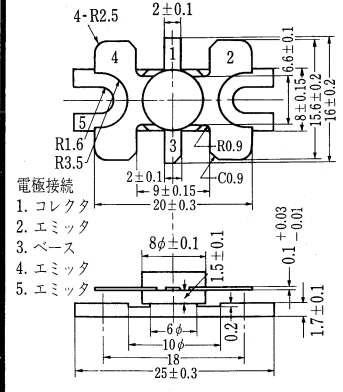
325



326



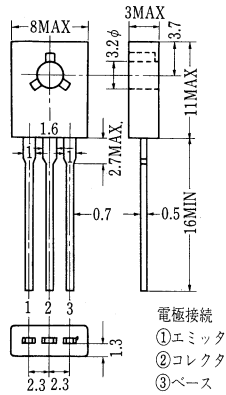
327



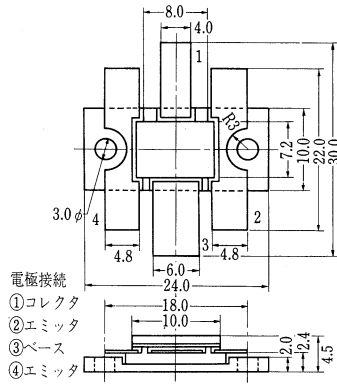
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

〔寸法図単位：mm〕

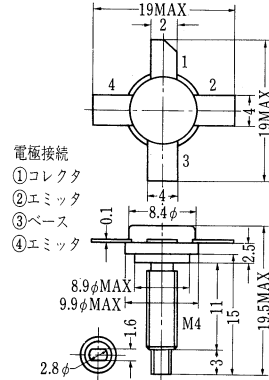
328



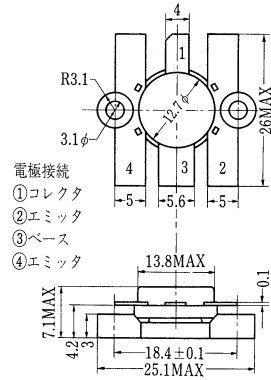
329



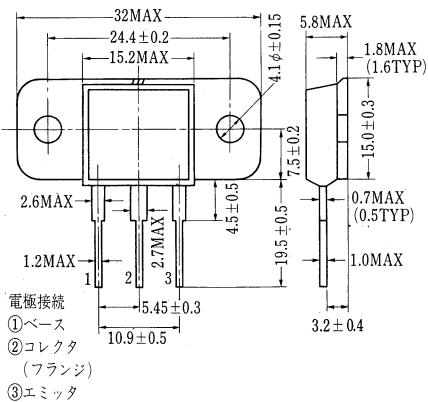
330



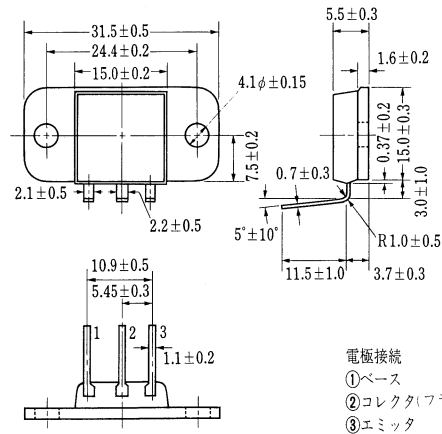
331



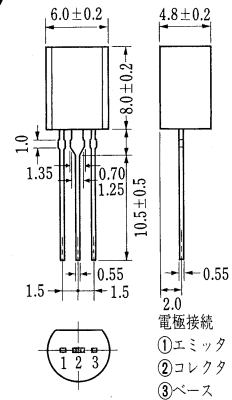
332

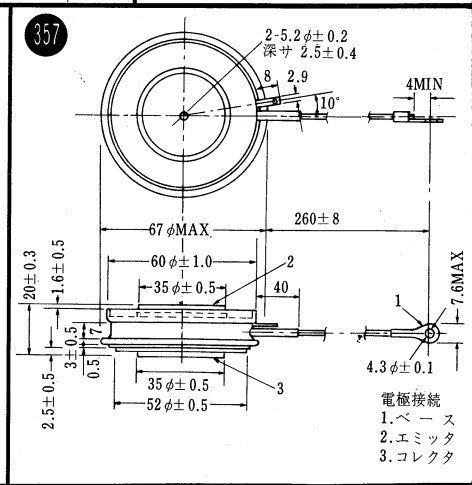
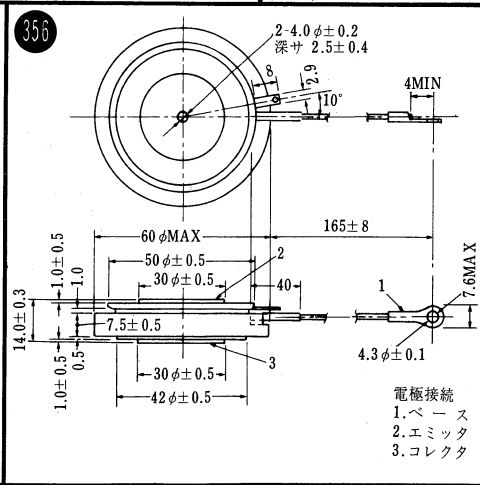
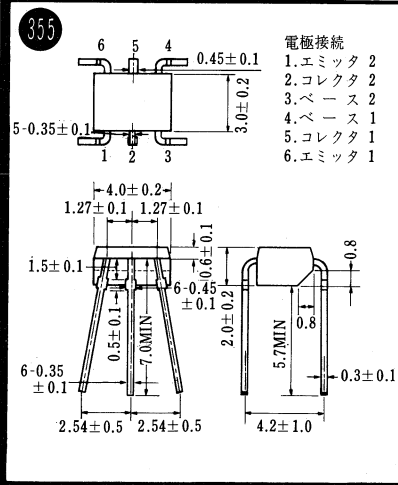
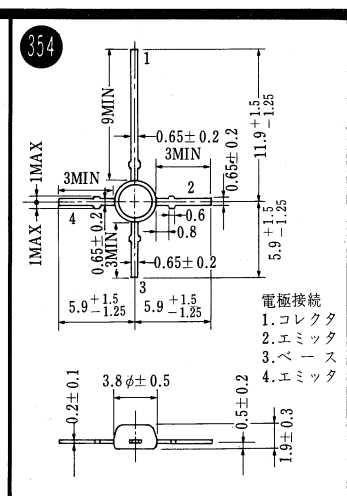
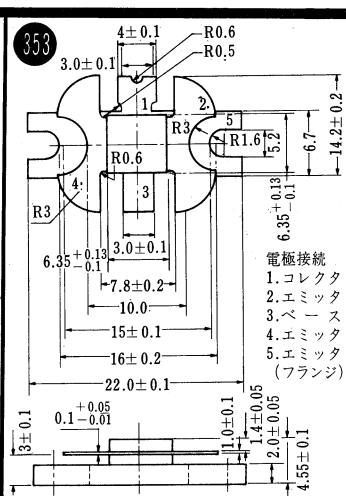
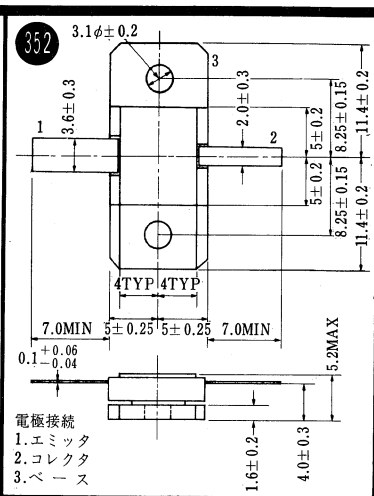
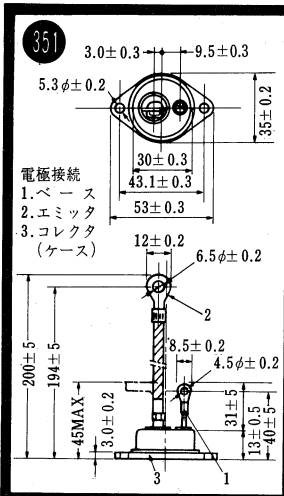


333



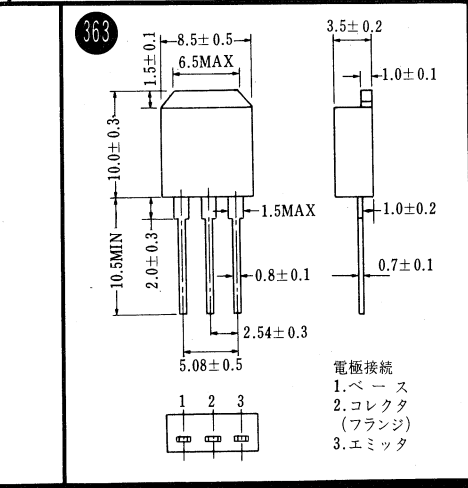
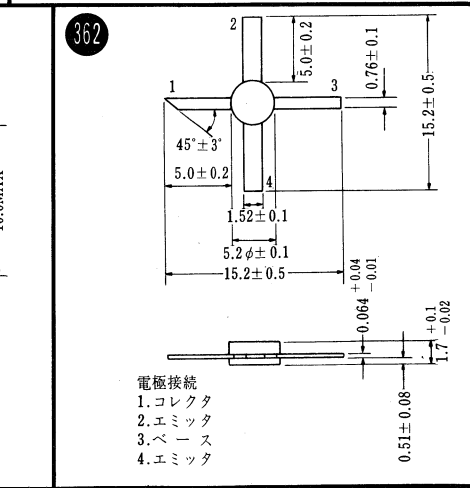
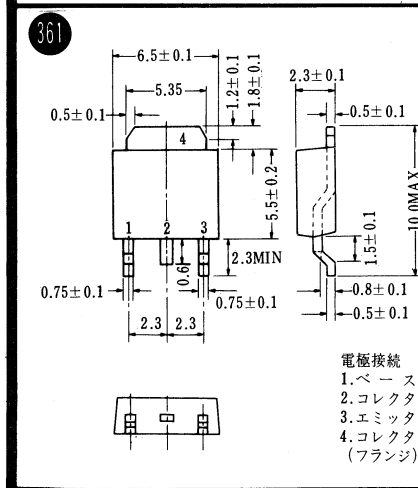
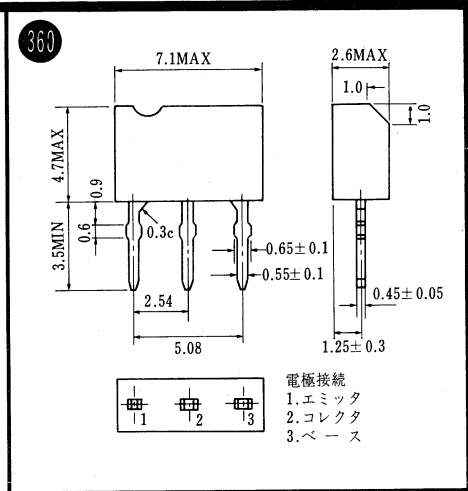
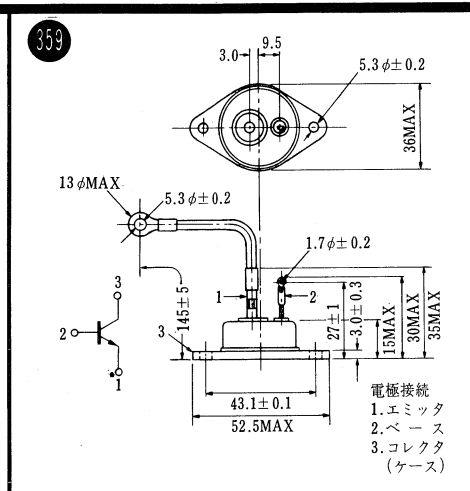
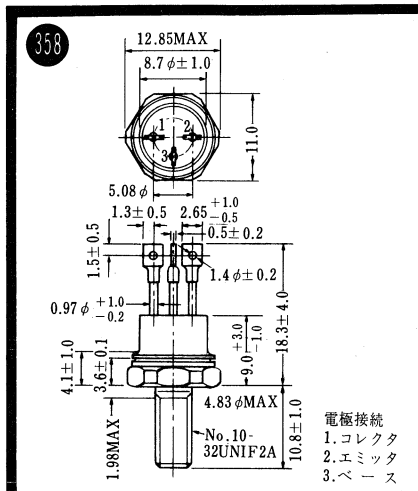
334





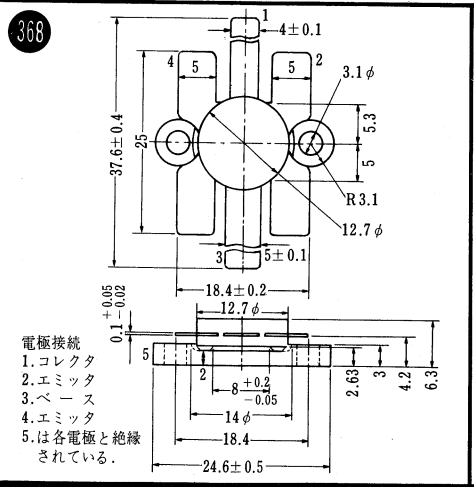
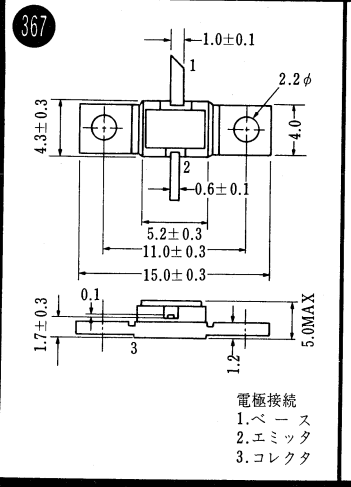
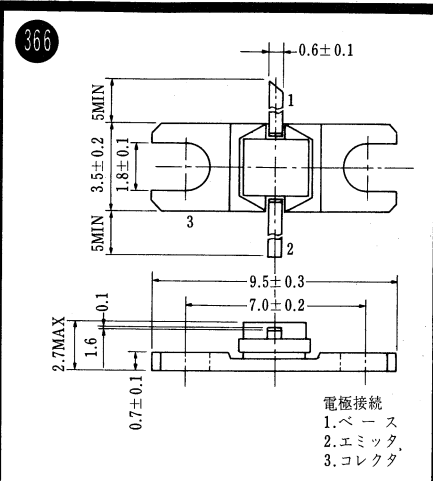
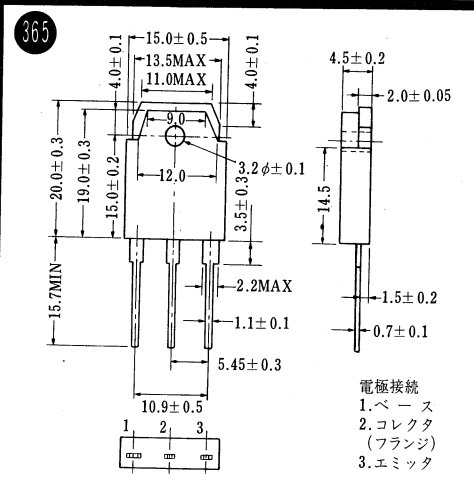
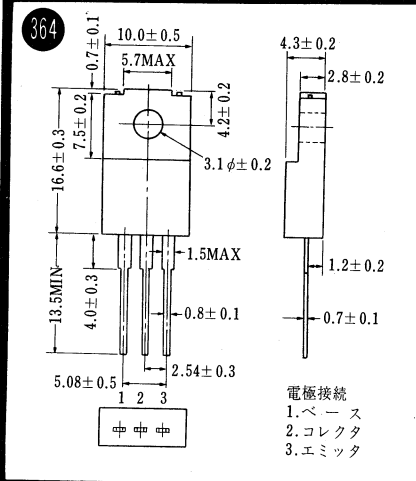
●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ，②ベース，③コレクタ，④シールドです

〔寸法図単位：mm〕



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ, ②ベース, ③コレクタ, ④シールドです

<寸法図単位: mm>



●電極接続で特に指定なき場合は①エミッタ、②ベース、③コレクタ、④シールドです

1982年版 **最新トランジスタ規格表**

昭和41年3月20日 初版発行

昭和57年6月1日 発行

S57.6.1 第1刷

©1966

編集者 時田 元 昭

編集発行人 飛 坐 博

発行所 CQ出版株式会社

〒170 東京都豊島区巢鴨1-14-2

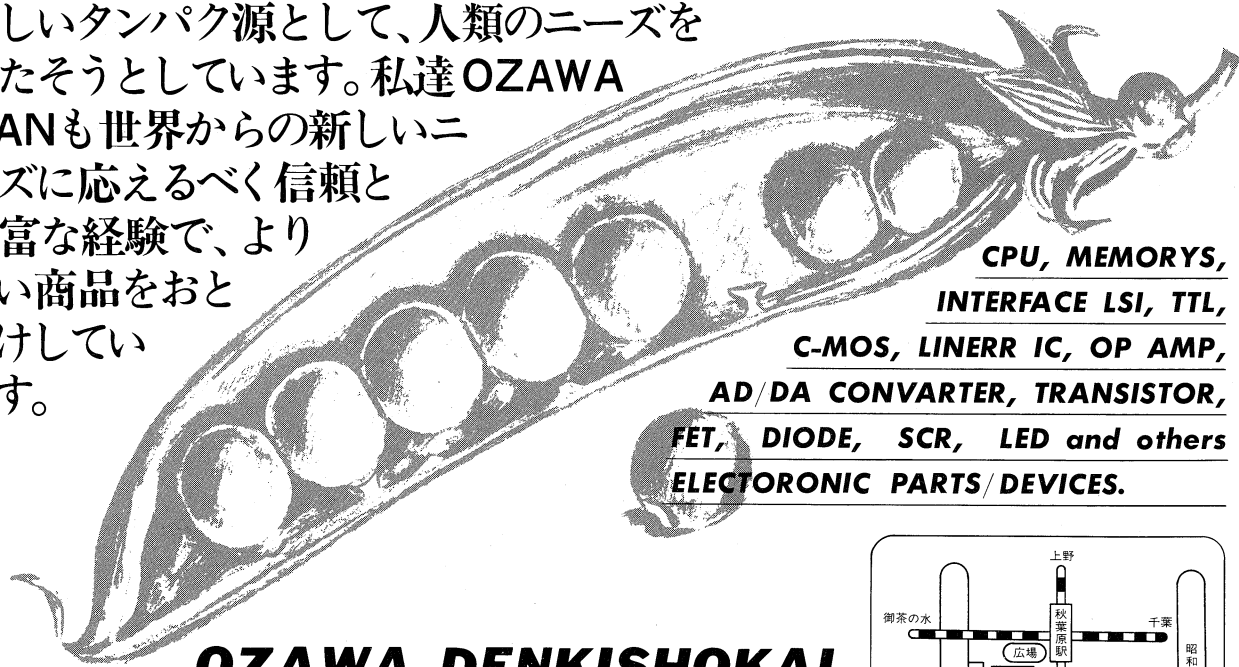
定価 800円

電話 (03)947-6311(代表)

振替 東京0-10665

印刷・製本 株式会社 丹誠社

大豆はその豊富な栄養から畑の肉と呼ばれ、
 新しいタンパク源として、人類のニーズを
 満たそうとしています。私達 OZAWA
 MANも世界からの新しいニ
 ーズに応えるべく信頼と
 豊富な経験で、より
 よい商品をおと
 どけしてい
 ます。



**CPU, MEMORYS,
 INTERFACE LSI, TTL,
 C-MOS, LINERR IC, OP AMP,
 AD/DA CONVARTER, TRANSISTOR,
 FET, DIODE, SCR, LED and others
 ELECTORNIC PARTS/DEVICES.**

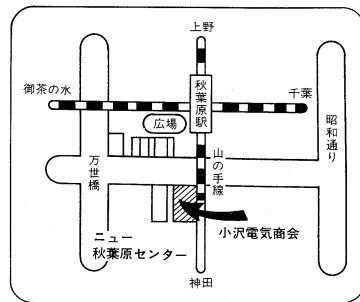
OZAWA DENKISHOKAI

NEW AKIHABARA CENTER, 16-10, 1-CHOME, SOTOKANDA, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN,
 TEL : TOKYO (03)253-4401-9692

(株)小沢電気商会

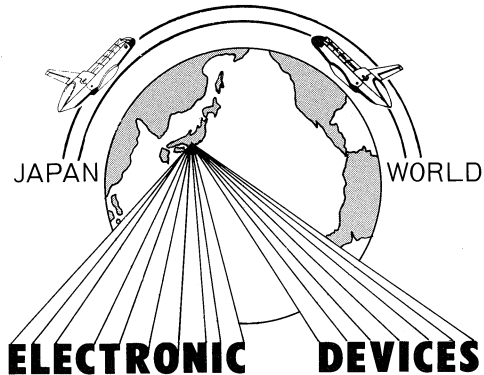
通販部 / 〒140 東京都品川区大井2-24-15 ☎03(771)1994
 営業所 / 〒101 東京都千代田区外神田1-16-10 ☎03(253)4401

※ご注文は現金書留・為替振替で住所・氏名・品名をはっきりと書いてお願い致します。振替 東京 5-49608(ニューアキハバラセンター内)



WE ARE WORLD IC SPECIALISTS

未来産業のニーズに即応する
信頼のADOグループ



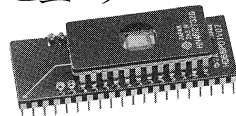
株式会社 亜土電子工業

〒101 東京都千代田区外神田2-4-6 ビルディング ササゲ 7F
TEL 国内 (DOMESTIC) 03-257-1025
海外 (FOREIGN) 03-257-1026
ADOパーツショップ 03-257-0468
ADOマイコンショップ 03-255-9515
TELEX 222-4754 ADO-J
CABLE MIDRAINCO TOKYO



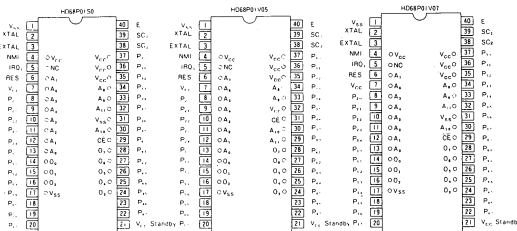
EPROM搭載形8ビットシングル
チップマイクロコンピュータ

HD68P01



HD68P01系の特長

- HMCS6800の拡張命令セット採用
- 8×8乗算機能
- シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI) 内蔵
- 16ビットタイマ内蔵
- 128バイトRAM内蔵 (先頭64バイトは電源オフ時内容保持可能)
- 29本のパラレルI/O端子と2本のデータストロープ端子
- 発振回路内蔵 (セラミックフィルタ適用可能)
- 強力な省電力機能



ピン配置図 (上面図)

●製品系列一覧			●マスクROM内蔵形とEPROM搭載形対応一覧			
ROM容量	適用EPROM	HD68P01	マスクROM内蔵形品名	EPROM搭載形品名	ROMアドレス	
2kバイト	HN462716	HD68P01S0	HD68P01S0	HD68P01S0	●メモリマップのROM先頭アドレスは\$F800です。	
		(HD6801S0)	HD68P01V05	HD68P01V05		
4kバイト	HN462732	HD68P01V05	HD68P01V07	HD68P01V05	●メモリマップのROM先頭アドレスは\$F000です。	
		(HD6801V0)	(HD6801V0)	HD68P01V07		

注1 ()はマスクROM形の相当品形名を示す。
注2 HN482764を使用することによりROM容量を8kバイトまで拡張可能。

HD68P05に関しては、お問い合わせ下さい。資料請求は切手500円分同封して下さい。



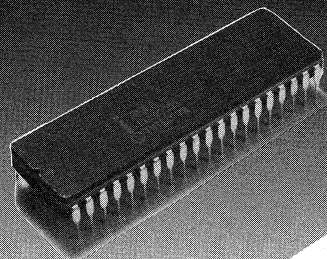
株式会社 **テレビ商会**

日立電子部品卸部

東京都千代田区外神田1-15-6
TEL 03(253)3861(代表)

LSIからパソコンまで

最新の高信頼性商品をお届けします。



内外のCPU及び周辺デバイスをはじめ各社IC、半導体からオーディオ用パーツ、さらに最新のパソコンから光ファイバーケーブルまで豊富に取揃えております。

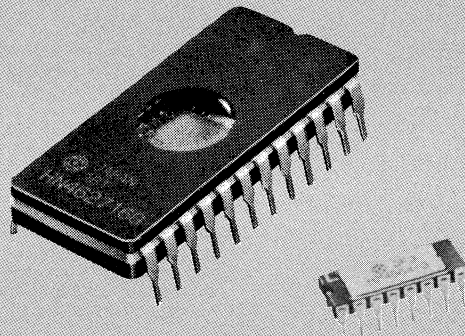
株式
会社

若松通商

本社 直売部 〒101 東京都千代田区外神田1-11-4 ミツワビル2階 ☎03(251)4120
業者関係 ☎03(251)4121
 マイコンセンター 〒101 東京都千代田区外神田1-11-4 ミツワビル7階 ☎03(251)8933
 秋葉原店 〒101 東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館4階
☎03(255)5064
 通販部 〒211 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町1-547-80 ☎044(722)0948
(中原郵便局私書箱37) 本社通販部 ☎03(257)0063

コンピュータ & デバイスの 需要に応える。

ROBIN ELECTRONICS



マイクロコンピュータ・MSI・LSI・IC
 ・TR・CR, 電子部品商社, アマチュア
 からプロフェッショナル迄, 御気軽に
 御連絡下さい。

ロビン電子産業(株)

☎ 03-255-6027

〒101 東京都千代田区神田佐久間町1-16 大橋ビル201号
 TELEX 222-2210 ROBIND-J

三菱半導体新製品群

M5L8086S

16ビットマイクロプロセッサ
5V単一電源、基本クロック最大5MHz、マルチCPU機能。インテル社8086とピン接続及び電気的特性に互換性あり。

M5L2764K

64KビットEPROM
読み出し時5V単一電源使用。インテル社2764とピン接続の互換性あり。入出力は読み出し、プログラムでTTLと直結可能。

M5K4164NP, P

64KビットダイナミックRAM
5V単一電源、低消費電力。全入力ともTTL直結可能で低入力容量。NP、Pともヒドンリフレッシュ動作可能。またP型はオートリフレッシュが可能。

M5M5116P

16K CMOSスタチックRAM
5V単一電源。高速メモリアクセル可能(60、80、100nsの3機種)。入出力TTL直結可能。データ端子は入力、出力が共通。

M5M5117P

16K CMOSスタチックRAM
5V単一電源。高速メモリアクセル可能(60、80、100nsの3機種)。入出力TTL直結可能。三菱M58725P、M5L2716Kとピン接続の互換性あり。

M5M5118P

16K CMOSスタチックRAM
5V単一電源。入出力TTL直結可能。完全スタチック回路——リフレッシュ操作不要。

M5M2167S

16K NMOS高速スタチックRAM
5V単一電源。アクセスタイム最大55ns。インテル社2716と相当品である。

M5W1791-02P/-03P

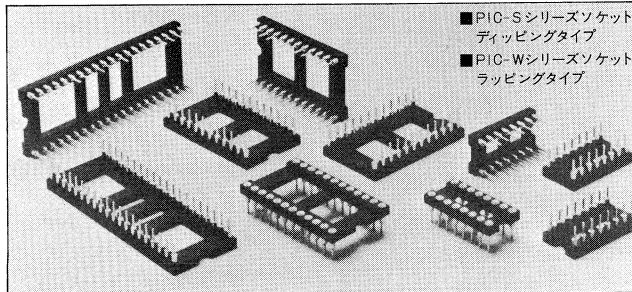
フロッピーディスクコントローラ
5V単一電源、WD社I791-M5W1791-02P、I793-M5W1791-03P相当。

M58990P

8ビット8チャンネルA/Dコンバータ
5V単一電源、入力TTLコンパチ。アナログ入力電圧範囲0-VCC、NS社ADC0808-M58990P、ADC0809-M58990P-1相当。

M5C6847P-1

ビデオディスプレイジェネレーター
5V単一電源。MELPS 85シリーズ 8bit CPUと接続可能。モトローラ社MC6847Pとピン接続に互換性あり。



■PIC-Sシリーズソケット
ディッピングタイプ
■PIC-Wシリーズソケット
ラッピングタイプ

6極より40極まで、
ディッピングタイプとラッピングタイプの
PICシリーズソケット。

●コンタクトは高精密機械加工を施した端子にベリリウム鋼の板ばね構造の接触子を内蔵。●モールド部をプリント基板より浮かして取付けでき、対流冷却が可能。●ディッピングの際、フラックスによる影響がない構造を採用。●ソケットコンタクト部はディップ型ICリード(0.5mm×0.25mm)の平角型からφ0.4~φ0.53のリードも接続可能。●ラッピングタイプ(PIC-Wシリーズ)にはラッピングワイヤーが2本付け及び3本付けできるものがあります。●絶縁物はUL規格94V-Oを使用。

半導体・電子機器部品の総合商社

KEC 小森電機株式会社

本社・東京都千代田区外神田3-10-9 ☎253-1481(代)

埼玉 ☎0486-44-5044 秋葉原 ☎03-253-0777
松本 ☎0263-25-6698 長野 ☎0262-28-7126
新潟 ☎02563-8-5451 西部 ☎0422-32-8761

特約代理店 / 三菱電機, 本多通信, サンケン電気, 日本バーンデイ, フジソク, 帝国通信, 日本モレックス, ミヤマ電器

■海外半導体メーカー・取扱い商社一覧

ADVANCED MICRO DEVICES Inc.

AMERICAN MICROSYSTEMS Inc.

ANALOG DEVICES Inc.

ANALOG SYSTEMS Inc.

ancom

BURR-BROWN RESEARCH Corp.

EMM SEMI Inc.

FAIRCHILD CAMERA AND INSTRUMENT Corp.

GENERAL INSTRUMENT Corp.

HARRIS Co.

INTECH Inc. (F.M.Iを含む)

INTEL Corp.

INTERSIL Inc.

ITT SEMICONDUCTORS

MONOLITHIC MEMORIES Inc.

アドバンスト・マイクロ・デバイス株式会社
東京都杉並区上高井戸1-8-17(第3保谷ビル) ☎03(329)2751

エー・エム・アイ・ジャパン株式会社
東京都港区赤坂2-5-3(日交山王ビル) ☎03(586)8131

アナログ・デバイス・オブ・ジャパン・インコーポレイテッド
東京都千代田区麴町4-7-8(地引第2ビル) ☎03(263)6826

インターニックス株式会社 販売部
東京都新宿区西新宿7-4-7(新宿浜田ビル) ☎03(369)1101

石川産業株式会社
東京都三鷹市新川4-6-10 ☎0422(44)5501~3

日本バー・ブラウン株式会社 技術部
東京都港区赤坂1-6-8(井上赤坂ビル) ☎03(586)8141

日商エレクトロニクス株式会社 周辺機器営業部第1課
東京都中央区築地1-12-22(コンワビル) ☎03(544)8399

フェアチャイルド ジャパン株式会社 営業第一部, 第二部
東京都渋谷区渋谷1-15-21(ポーラ渋谷ビル) ☎03(400)8351

ゼネラル・インストゥルメント・インターナショナル・コーポレーション
東京都港区虎ノ門4-1-13(葺手ビル) ☎03(437)0281

ハリス・セミコンダクター極東支社
東京都渋谷区神泉町8-1(鈴屋ビル) ☎03(476)5581

マイクロテック株式会社 営業部
東京都新宿区西新宿7-9-17 ☎03(363)2317

インテルジャパン株式会社
茨城県筑波郡豊里町東光台5-6 ☎029747-8511

インターニックス株式会社 販売部
東京都新宿区西新宿7-4-7(新宿浜田ビル) ☎03(369)1101

ITT ASIA PACIFIC INC. 半導体部
東京都新宿区西新宿2-6-1(新宿住友ビル私書箱21号) ☎03(347)8881

株式会社エム・エム・アイ・ジャパン
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15 ☎03(403)9061

MOS TECHNOLOGY

MOSTEK Corp.

MOTOROLA Inc.

NATIONAL SEMICONDUCTOR Corp.

PRECISION MONOLITHICS Inc.

RAYTHEON Co.

RCA Corp.

SGS-ATES Inc.

SIEMENS AG

SIGNETICS Corp.

SILICONIX Inc.

TELEDYNE PHILBRICK

TEXAS INSTRUMENTS Inc.

ZELTEX Inc.

ZILOG Inc.

極東貿易株式会社 計測器第2部・第3部
東京都千代田区大手町2-2-1 (新大町ビル) ☎03(244)3511

モステックジャパン株式会社
東京都港区北青山1-2-7 (三洋ビル) ☎03(404)7261

日本モトローラ株式会社
東京都港区南麻布5-2-32 ☎03(440)3311

日本エヌエス株式会社
東京都新宿区西新宿1-25-1 (新宿センタービル) ☎03(349)0811

日本ビー・エム・アイ株式会社
東京都千代田区九段北4-1-11 (原鉄ビル) ☎03(234)1411

新日本無線株式会社 半導体事業部営業部
東京都港区虎ノ門1-22-14 (ミツヤ虎ノ門ビル) ☎03(502)2331

大倉商事株式会社 電子機械部電子部品課
東京都中央区銀座2-3-6 ☎03(566)6291

日本テクセル株式会社 営業部
東京都渋谷区桜ヶ丘13-14 (共伸ビル) ☎03(461)5121

富士エレクトロニックコンポーネンツ株式会社 業務本部第二業務部
東京都千代田区有楽町1-12-1 ☎03(201)2401

日本シグネティックス株式会社
東京都千代田区三番町8-7 (第25興和ビル) ☎03(230)1521

日本シリコンクス株式会社
東京都千代田区飯田橋3-4-4 (第5田中ビル) ☎03(264)7905

テレダインジャパン株式会社
東京都港区赤坂8-1-19 (日本生命赤坂ビル) ☎03(403)8921

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
東京都港区北青山3-6-12 (青山富士ビル) ☎03(498)2111

伯東株式会社 電子部品部一課
東京都新宿区新宿1-1-13 ☎03(341)2611

日本テクセル株式会社 営業部
東京都渋谷区桜ヶ丘13-14 (共伸ビル) ☎03(461)5121

■国内半導体メーカー
住所一覧

- アイコーデンキ(株) 東京都板橋区成増3-24-15 ☎03(975)1110
- 石塚電子株式会社 営業部
東京都江戸川区東小岩3-16-7 ☎03(658)5111
- (株)大泉製作所 営業部
東京都田無市谷戸町2-14-11 ☎0424(23)1611
- 沖電気工業(株) 電子デバイス営業本部営業企画
東京都港区芝浦4-10-3 ☎03(454)2111
- オリジン電気(株) 部品営業部営業一課三係
東京都豊島区高田1-18-1 ☎03(983)7111
- KHエレクトロニクス(株) 営業課
東京都港区赤坂2-10-9(ランディック第二赤坂ビル) ☎03(587)1041
- サンケン電気(株) 半導体・カタログ係
東京都豊島区西池袋1-22-8(池袋千歳ビル) ☎03(986)6151
- (株)三社電機製作所 吹田工場営業部
大阪府吹田市西御旅町1-1 ☎06(383)1256
- シャープ株式会社 電子部品事業本部営業本部業務部
大阪市阿倍野区長池町22-22 ☎06(621)1221
- 新日本無線(株) 半導体事業部営業技術部
東京都港区虎ノ門1-22-14(ミツヤ虎ノ門ビル) ☎03(502)2331
- 新電元工業(株) 文書課
東京都千代田区大手町2-2-1(新大手町ビル) ☎03(279)4431
- スタンレー電気(株) 発光ダイオード販売課
東京都目黒区中目黒2-9-13 ☎03(710)2541
- ソニー株式会社 半導体事業部半導体営業課
東京都品川区北品川6-7-35 ☎03(448)2801
- 立石電機株式会社 京都市右京区花園土堂町10 ☎075(463)1161
- 東京三洋電機(株) 半導体営業部東京営業所
東京都千代田区外神田6-15-13(三洋電機㈱東京支社別館内) ☎03(835)1471
- 東京芝浦電気(株) 半導体営業推進部
神奈川県川崎市幸区堀川町72 ☎044(522)2111

東京無線器材(株)
 東光株式会社
 東洋電機製造(株)
 内藤電誠工業(株)
 (株)日立製作所
 日本インターナショナル整流器(株)
 日本電気株式会社
 日本プレジジョン・サーキット(株)
 浜松テレビ(株)
 富士通株式会社
 富士電機製造(株)
 松下電子部品(株)
 松下電子工業(株)
 三菱電機株式会社
 株式会社モリリカ
 ユニゾン株式会社
 ローム株式会社

電子デバイス事業部
 東京都大田区中央3-19-8 ☎03(775)2521

MIC部販促グループ
 東京都大田区東雪谷2-1-17 ☎03(727)1161

半導体部
 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769 ☎045(881)7121

神奈川県川崎市高津区久本204-2 ☎044(822)7121

電子部品営業本部
 東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル) ☎03(270)2111

営業部販売管理室
 東京都新宿区新宿3-23-7(新宿大栄ビル) ☎03(356)7611

電子デバイス販売事業部計画部
 東京都港区芝5-33-7(徳栄ビル) ☎03(453)5511

営業部
 東京都中央区京橋1-10-3(服部ビル) ☎03(564)6351

営業部AD
 静岡県浜松市市野町1126-1 ☎0534(34)3311

半導体統轄営業部
 東京都港区虎ノ門2-3-13(第18森ビル) ☎03(502)0161

汎電事業部半導体部
 東京都千代田区有楽町1-12-1(新有楽町ビル) ☎03(211)7111

固定抵抗器事業部電子回路営業2課
 大阪府門真市門真1006 ☎06(908)1101

半導体販売事業部企画部販売助成課
 京都府長岡京市神足焼町1 ☎075(921)8151

半導体事業部半導体部
 東京都千代田区丸ノ内2-2-3 ☎03(218)3349

神奈川県横浜市戸塚区和泉町3321 ☎045(802)2861

営業部業務課(本社)
 兵庫県伊丹市東有岡1-18 ☎0727(82)3565

営業部営業課
 京都市右京区西院溝崎町21 ☎075(311)2121

● '82年版
 半導体マニュアル・シリーズ

最新トランジスタ規格表
 定価 800円

最新トランジスタ互換表
 定価 800円

最新ダイオード規格表
 定価 900円

最新FET規格表
 定価 800円

最新電力用素子規格表
 定価 900円

最新OPアンプ規格表〔1〕
 定価 900円

最新OPアンプ規格表〔2〕
 定価 900円

最新リニヤIC規格表
 定価 900円

最新TTL IC規格表
 定価 900円

最新C-MOS IC規格表
 定価 900円

最新メモリIC規格表
 定価 900円

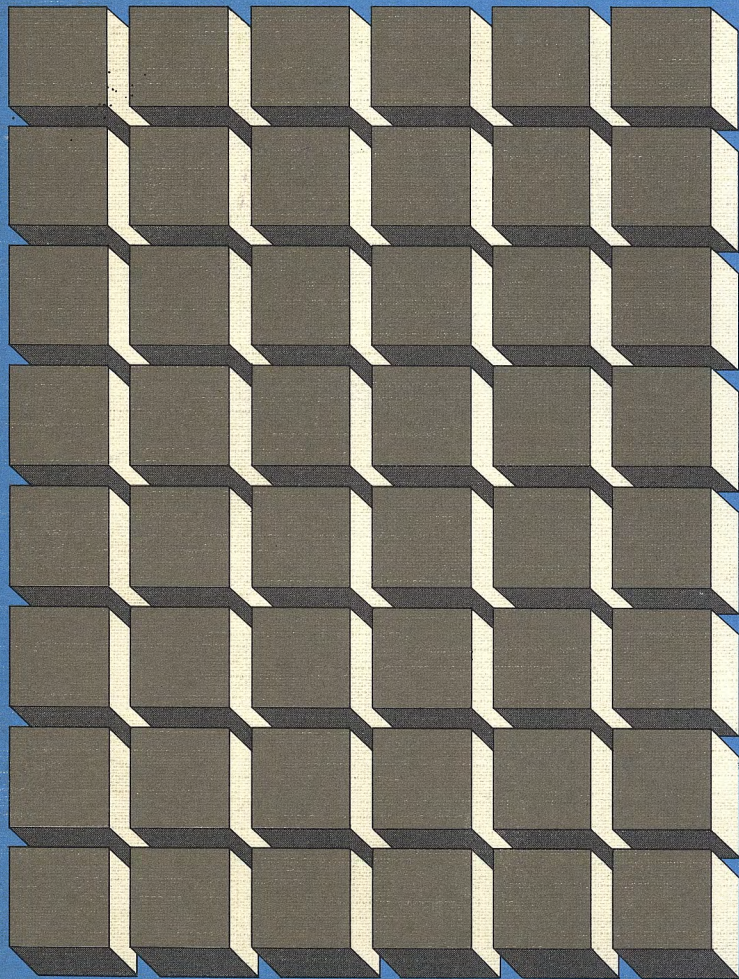
最新インターフェース素子規格表
 定価 900円

最新マイコンBASIC規格表
 定価 900円

最新マイコン周辺LSI規格表
 定価 900円

CQ出版社

THE TRANSISTOR MANUAL



最新 トランジスタ
規格表

'82

定価800円